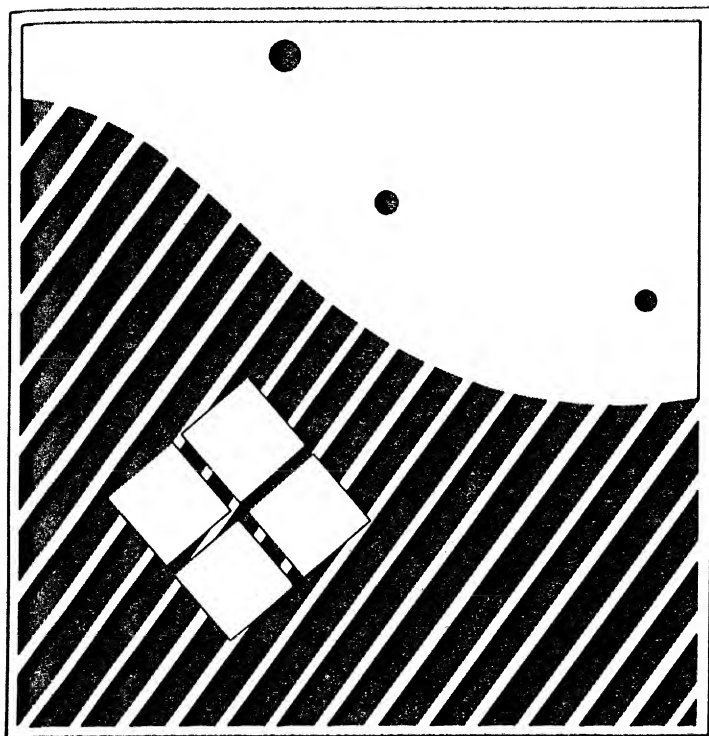
THE FET MANUAL

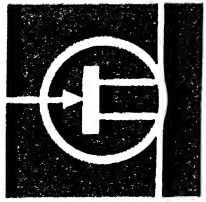
最新 FET【電界効果トランジスタ】規格表

パワーMOS FET(海外製)
主要規格付き

復刻版

CQ出版社

最新 FET【電界効果トランジスタ】規格表

☆規格表ご利用の際のお願い

本規格表の仕様はメーカー発表の資料に基づき作成しておりますが，メーカーによって予告なく規格・外形等を変更する場合がありますので，量産品等，大量に素子を使用して製品を生産する必要のある際には，事前に該当メーカーにお問合わせの上，仕様をご確認ください。

規格表の使い方

FETを活用するための用語の説明

ＦＥＴ関係の記事、文献をはじめてみた場合、トランジスタでは見馴れない、また聞き馴れない用語が次から次へととびだし、誰でも少なからず、面くらうものです。

しかし、これだけで、ＦＥＴを難解なものであると決めつけ、敬遠してしまったのでは、例えばせっかく宝物の埋めてある場所につきながら、たまたま掘りおこす道具を持ち合わせなかったという理由だけで、すごすごと引き返えすようなもので、実に惜しむべきことといわねばなりません。用語というのは、ＦＥＴの本質を知るための道具、手段のようなものですから、一通りの知識を身につけておくことは、ぜひ必要です。

さて、ＦＥＴの用語、記号は、現在のところ統一されていないので、各社それぞれ独自のものを使っていますが、ここでは、これらのうち、主なものについて簡単に説明していきましょう。

まず、最大定格をあらわすものとして、耐圧関係がいくつかあります。

＊V_{GDS}（ドレイン－ソース短絡ゲート－ドレイン間電圧）

３文字の添字は、トランジスタの場合と同じで、１番目が起点となる電極、２番目が入出力の共通電極、最後は第３の電極が共通電極に対して、どういう状態にあるかを表わします。

３番目にくる添字としては、

S…短絡、*O*…開放

X…指定されたバイアス電圧を加える

R…指定された抵抗を接続する

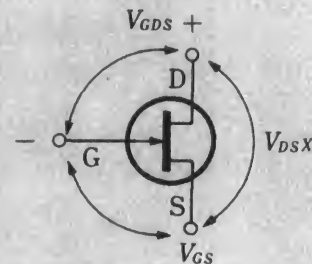
などがあります。

さて、ゲート－ドレイン間の耐圧は、普通、接合型ＦＥＴで用いられ、ゲート－ドレイン間のＰＮ接合のブレークダウン電圧に相当します。

この規格以上の逆電圧をかけて使った場合、素子のバラツキにより異なりますが、必ずある電圧でブレークダウン領域に入り逆電流が急増するためＰＮ接合が破壊される恐れがあります。したがって、メーカーで保証している最大定格内で使用するように設計することが望ましいわけで、定格オーバで使って、もしこわれたとしても文句はいえません。

このゲート－ドレイン間耐圧としては、V_{GDS}の他に、V_{GDO}、V_{GDX}がありますが、普通の接合型ＦＥＴでは、内部構造上、ゲートに対してドレイン－ソースは対称ですから、$V_{GDS} \simeq V_{GDO} \simeq V_{GDX}$になります。

＊V_{DSX}（ドレイン－ソース間電圧）

これは、主としてＭＯＳ型ＦＥＴの場合に使われます。というのは、ＭＯＳ型ではゲート－ドレイン間の耐圧は、酸化膜の耐圧そのものに相当し、実際回路で問題になるドレイン－ソース間の耐圧と直接関係がないためです。これに対し、接合型では、V_{GDS}とV_{DSX}の間に次のような関係式が成立します。

$V_{DSX} \simeq V_{GDS} - V_{GS}$

このことは、**図1**からも明らかで、ドレイン - ソース間に実際加えることができる電圧は、ゲート - ソース間のバイアス電圧により異なりますが、必ずV_{GDS}より小さな値になり、カットオフ時に最小になります。

$(V_{DSX})_{min} = V_{GDS} - |V_p|$

ここで、V_pというのは、ピンチオフ電圧とよばれる、カットオフ時のバイアス値を示します。普通V_{DSX}というのは、カットオフの時の耐圧で表わされますが、接合型の場合、いま述べたように、V_{DSX}に相当するものは、V_{GDS}ではなく、V_{GDS}からピンチオフ電圧を差引いたものになりますから、この点充分注意を要します。

＊V_{GSO}（ゲート - ソース間電圧）

これは、主としてＭＯＳ型で用いられ、トランジスタのV_{EBO}と同様に特にスイッチング回路などで問題になります。

＊I_G　（ゲート電流）

接合型で、ゲート - ソース間を順方向にバイアスするとゲート電流が流れはじめ、等価的にトランジスタと同じ動作をし、I_{DSS}よりはるかに大きいドレイン電流が流れます。したがって、ドレイン側の許容損失で普通押えられてしまいますが、ゲート側も一応の目安として最大順方向電流が決められています。これに対しＭＯＳでは、構造上、接合型のゲート順方向電流に相当するものは存在しないので、I_GのかわりにI_Dの最大値が規定されているのが普通です。

＊P_d（許容損失）

トランジスタのP_Cに相当し、周囲温度25℃の時の最大許容値で示されます。

また、実際のパワーは、チャンネルで消費されるので、P_{ch}（許容チャンネル損失）で表わされることもあります。

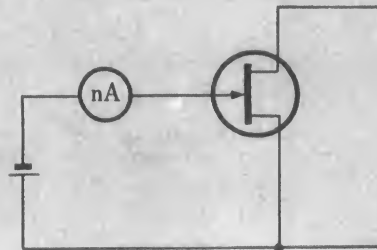
＊T_j（接合部温度）

接合型の場合、トランジスタと同様にT_jで、一方ＭＯＳ型では、T_{ch}（チャンネル温度）で表わされるのが普通です。

<電気的特性に関する用語>

次に電気的特性を表わすのに使われる用語に話を進めましょう。

＊I_{GSS}（ゲートしゃ断電流）

これは、入力インピーダンスの目安を与えるもので、ドレインとソースを短絡し、ゲート - ソース間に逆電圧を印加した時に流れるリーク電流です（**図2**参照）。

接合型の場合、I_{GSS}はＰＮ接合の逆方向電流に相当しますが、ＭＯＳ型では、酸化膜を通して流れる電流で、接合型とは桁が違います。したがって、ＭＯＳの場合、ＦＥＴの外囲器や、測定の際用いるソケットの漏洩電流の方が、素子自身を流れる電流より、むしろ大きい場合があります。

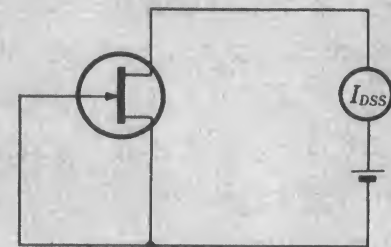
＊I_{DSS}（ドレイン電流）

ゲートとソースを短絡、すなわち零バイアスの時流れる電流で、この時のドレイン-ソース間電圧としては、ピンチオフ電圧の絶対値より充分大きく、ブレークダウン電圧より小さい、電流が充分飽和している電圧が選ばれます（**図3**）。

ＦＥＴを静特性で分類すると**図4**に示すように

(a)デプレッション型

<図2> I_{GSS}測定回路（Ｎチャンネル）

<図3> I_{DSS}測定回路

(b)デプレッション+エンハンスメント型
(c)エンハンスメント型
の3つに分けることができますが、(a)と(c)では、I_{DSS}の大きさがまったく対称的です。

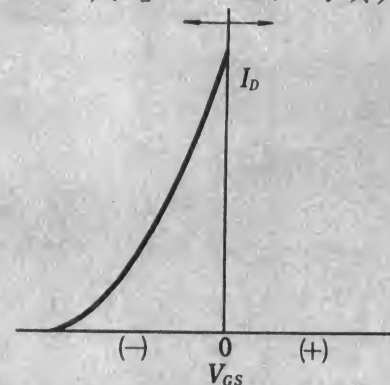
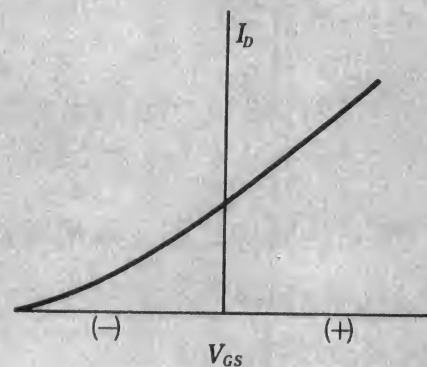
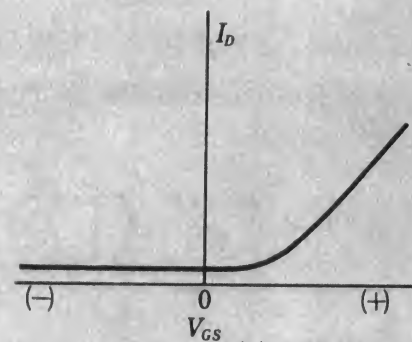
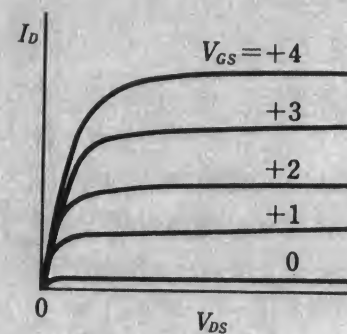
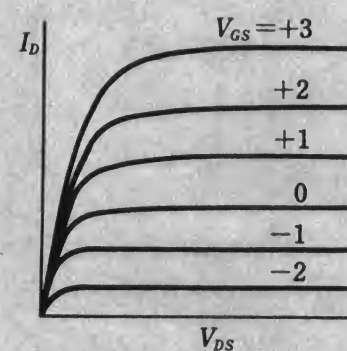
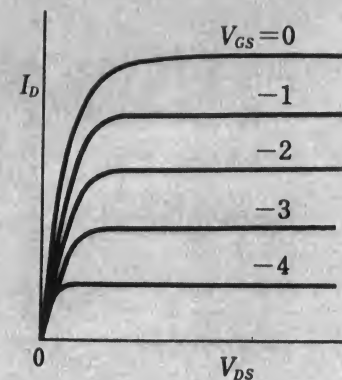
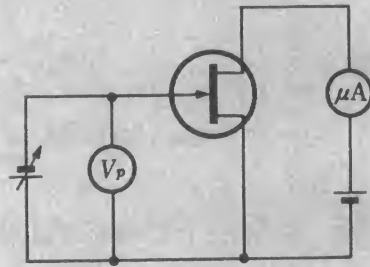
すなわち、デプレッション型では、I_{DSS}が、最大飽和電流に相当し、かなり大きな値を示しますが、エンハンスメント型の場合、カットオフ電流になりますから、非常に小さい値になるわけです。

＊ V_p（ピンチオフ電圧）

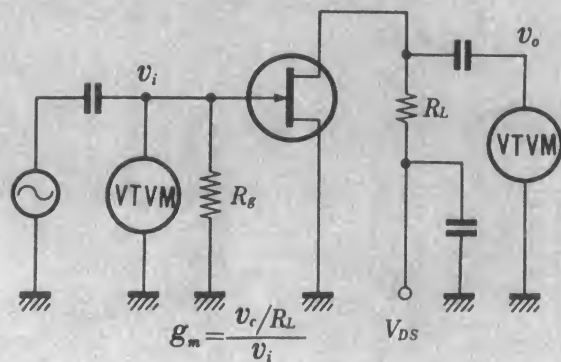
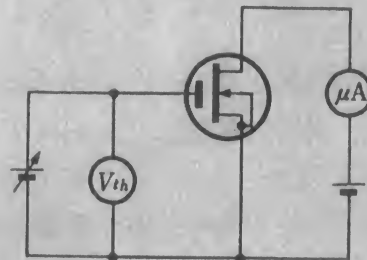
これは、I_{DSS}の説明文中の、(a)と(b)のタイプの場合に適用され、一定のドレイン-ソース間電圧のもとで、バイアスを深くしてゆき、電流が零になる時のゲート-ソース間電圧で、V_p以外にV_{GSC}，$V_{GS(off)}$（いずれもゲート-ソース・カットオフ電圧とよばれる）などが使われます。

しかし、実際の測定では、電流が零というのは、判定しにくいので、充分小さな規定電流値、メーカーによって違いますが、普通、I_D=0.1μA、1μA、10μAの時のバイアス値を読みとります（図5）。

一方、(c)のエンハンスメント型の場合は、電流が流れはじめる点ということでV_pではなくV_{th}（スレッシュホールド電圧）が用いられます（図6）。

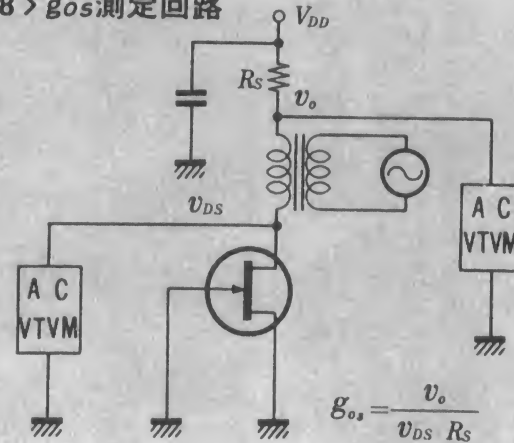
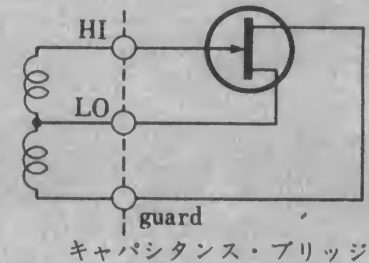
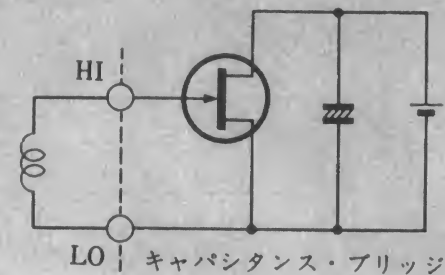
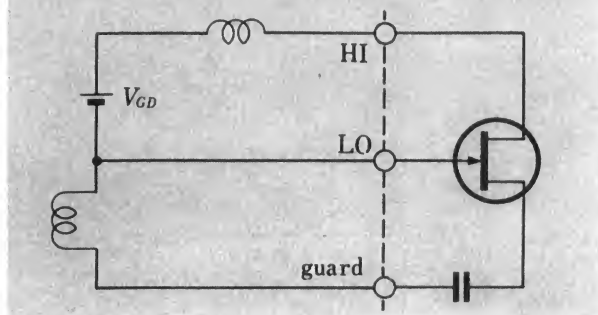
＊ g_m（相互コンダクタンス）

(a)デプレッション型
(b)デプレッション+エンハンスメント型
(c)エンハンスメント型

〈図4〉静特性によるFETの分類

g_mの定義は次式で与えられますが、g_mの他に｜Y_{fs}｜（ソース接地小信号順伝達アドミタンス）という記号が用いられることもあります。

$$g_m = \left.\frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}\right| V_{DS}=\text{一定}$$

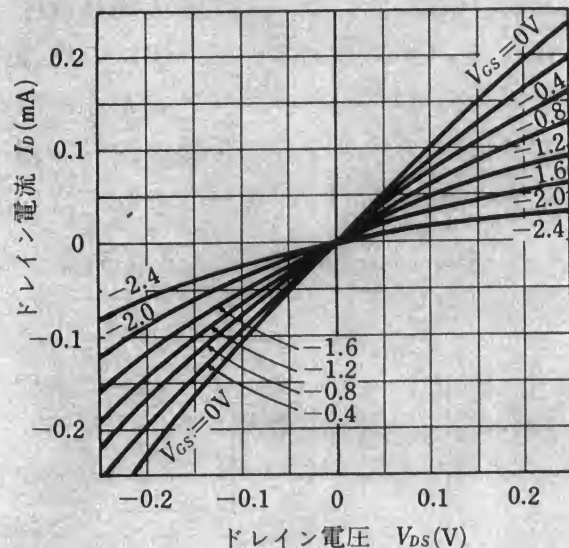
またバイアス条件としては、I_{DSS}と同じ条件が用いられることが多いようですが、ドレイン電流を規定する場合もあります。

測定回路としては、**図 7** が用いられ、普通、1kHz で測られます。

＊ g_{os}（出力コンダクタンス）

｜Y_{OS}｜と書かれる場合もありますが真空管でいえば、プレート抵抗 r_pの逆数に相当するものです。電流によって大きく変化しますが普通は、g_mと同じバイアス条件で測定されます（**図 8**）。

＊ C_{is}（ソース接地入力容量）

このC_{is}の測定条件は各社まちまちですが、特に接合型の場合、入力容量は、PNジャンクションの逆バイアス容量になりますから、バイアス条件で値は大きくも、小さくもなります。しかし、一般に零バイアス、すなわちC_{is}が最大になる点で測定することが多いようです。測定方法としては**図 9** のようにドレイン－ソース間に電圧をかけ、キャパシタンス・ブリッジの 2 端子法を用いたり、あるいは、ドレイン－ソース間には電圧をかけずに 3 端子法で純粋にゲート－ソース間の容量だけを測定する図

〈図11〉 C_{rs}測定回路（3端子法）

10の回路などがあります。

＊ C_{rs}（ソース接地帰還容量）

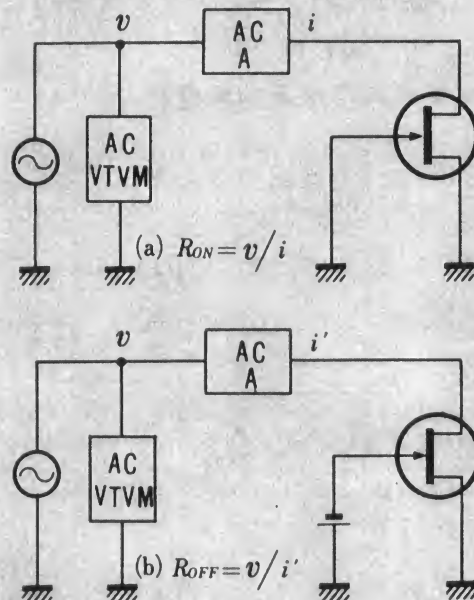
　低周波回路でも、この C_{rs} が大きいと、ミラー効果により、等価入力容量が増加し上限周波数が下がってしまい問題になりますが、高周波回路では、g_mと共に、C_{rs} の大きさが高周波特性の良さの一つの目安となります。すなわちg_m/C_{rs}は大きければ大きいほどよいわけです。

　C_{rs}の測定回路の一例を図11に示します。

〈図12〉 V_{DS}-I_D特性例

＊ R_{ON}（オン抵抗）、R_{OFF}（オフ抵抗）

　FETをチョッパに使う場合、この2つのパラメータが重要な意味をもってきます。

　FETの静特性の立ち上がりの部分（3極管領域）は、トランジスタとちがって、オフセット電圧が存在しなく、バイアス電圧により抵抗値が変化する可変抵抗と考えることができます（**図12参照**）。

　図12で、$V_{GS}=0$ の時の直線の傾きに相当するのがR_{ON}、カットオフ時がR_{OFF}というわけで、測定回路は**図13**になります。

〈図13〉 R_{ON}, R_{OFF}測定回路

■略称・記号の説明

（1）メーカー名（50音順）

富士通　富士通株式会社
三洋　東京三洋電機株式会社
東芝　株式会社 東 芝
日電　日本電気株式会社
日立　株式会社日立製作所
三菱　三菱電機株式会社
ソニー　ソニー株式会社
松下　松下電子工業株式会社

（2）構　造

J　Junction（接合）型
MOS（Metal Oxide Semiconductor）
V　Vertical（縦型）
GaAs　ガリウム砒素　J型
GaAsSB　ガリウム砒素　ショットキバリヤゲート型

（3）モード

D　デプレッション
E　エンハンスメント
D＋E　デプレッション＋エンハンスメント

（4）区　分

通工　通信工業用
一般　一般用

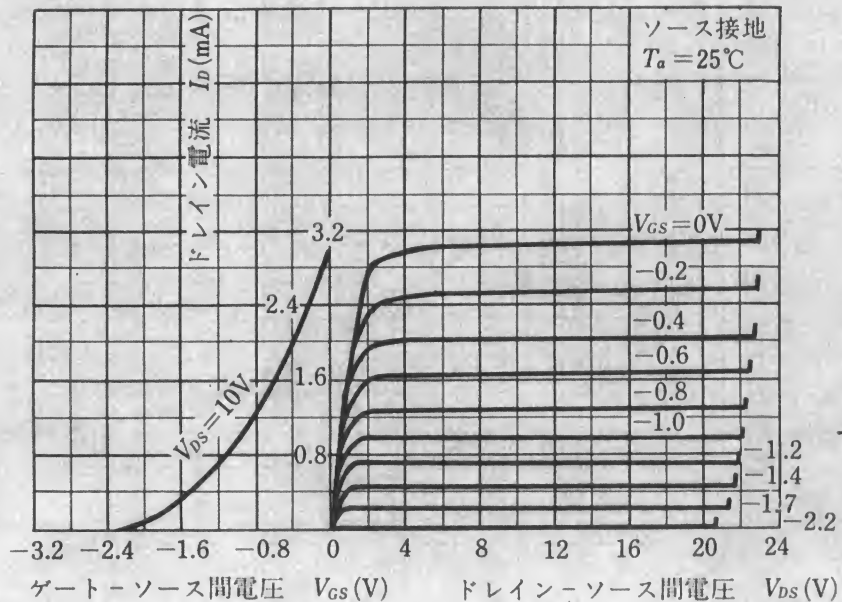
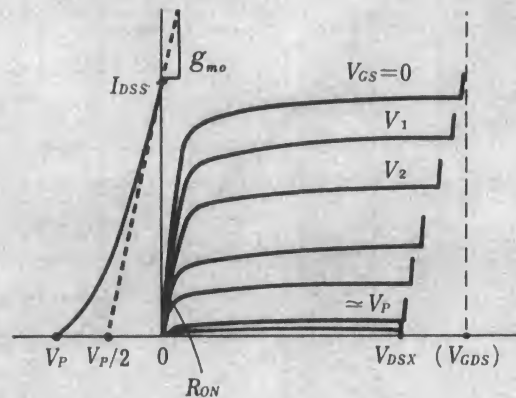
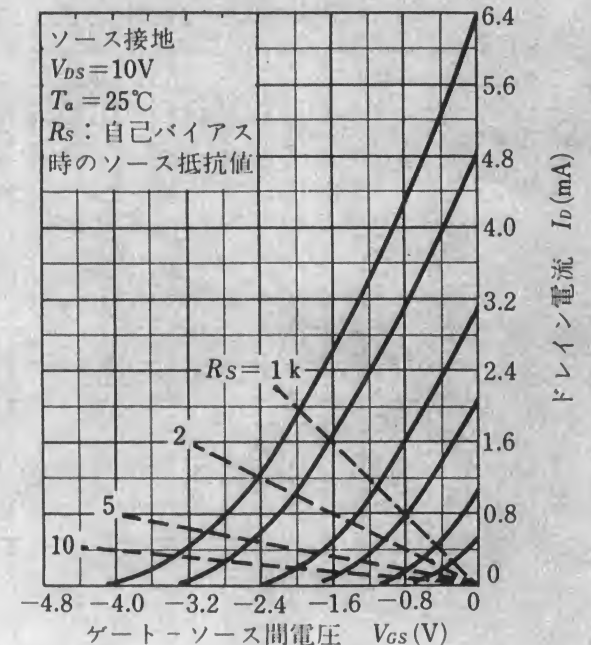
特性図の見方・使い方

ＦＥＴのカタログをみると、各種の特性グラフがのっていますが、ここでは、そのうちの主なものを用途別にいくつか選び、どういう点に注目すればよいか、またどのように活用すればよいか順を追って、みていきたいと思います。

1. 静特性の見方

ＦＥＴの基本特性である伝達特性と出力特性を表わしたもので、これ一つあれば低周波のパラメータは、ほとんどわかってしまうといっても決して過言ではありません。

まず、グラフから、I_{DSS}、ピンチオフ電圧、V_{GDS} (V_{DSX}) の標準値を知ることができます(**図1、2**)。

また、伝達特性の各点における傾きを計算すれば、任意のバイアスにおけるg_mが求

まります。このg_mは次に示すように近似式を用いても、簡単に計算できます。

FETの5極管領域（飽和領域）では、二乗近似が非常によくあてはまりますが、これを使うと、

$$I_D = I_{DSS}\ (1 - V_{GS}/V_p)^2 \quad V_{DS}=一定$$

$$g_m = \left.\frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}\right| V_{DS}=一定$$

$$= \frac{2\,I_{DSS}}{(-V_p)}\ (1 - V_{GS}/V_p)$$

$$= g_{mo}\ (1 - V_{GS}/V_p)$$

ここで、

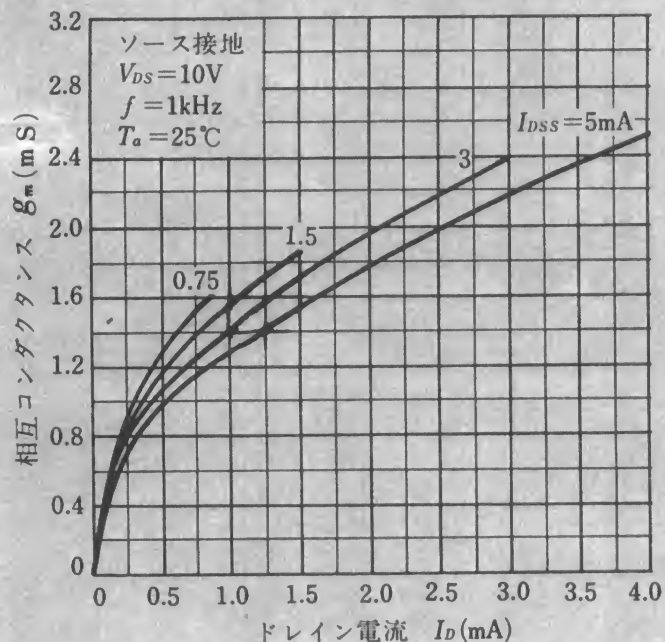
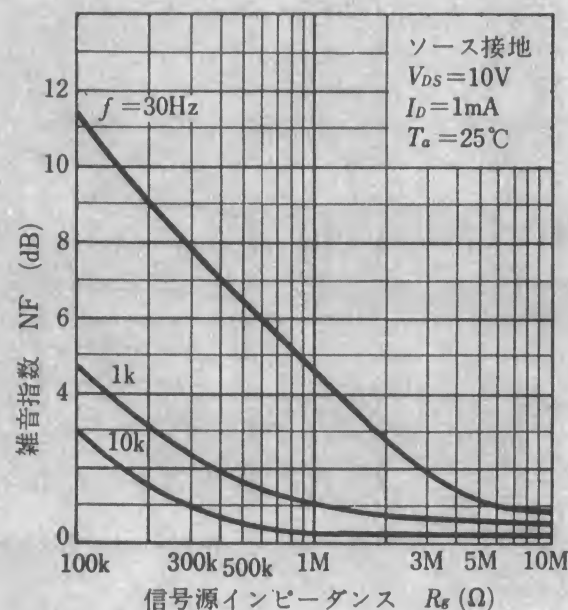
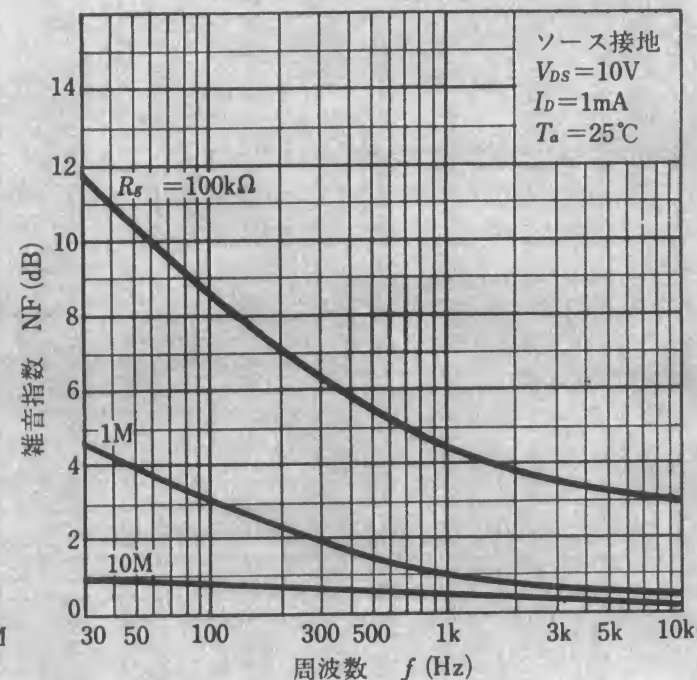
$$g_{mo} = \frac{2\,I_{DSS}}{(-V_p)}$$

すなわち、上式に、グラフから読みとった、I_{DSS}とV_pの値を代入すれば、よいわけです。

このようにして、各バイアスにおけるg_mが求まったら、次の関係式からオン抵抗も計算できます。

$$\left[R_{ON}\right]_{\substack{I_D=0\\V_{GS}=V_1}} = \left[1/g_m\right]_{V_{G\cdot}=V_1}$$

g_{OS}, R_{OFF}も静特性から求めようと思えば、求まりますが、誤差が大きく実用にはなりません。

また、出力特性のパラメータになっている、ゲート - ソース間のバイアスの符号をみれば、デプレッション、エンハンスメントのどのモードで働く素子か判断できます。

1. 用途別にわけた特性の見方

以上、示したように静特性というのは、ＦＥＴの特性の基礎となるもので、カタログには不可欠のものですが、他の特性は用途によって、当然かわってきます。そこで、次に各用途別に分けて主な特性をみていきましょう。

■直流、低周波増幅用

まず、**図3**のI_D-V_{GS}、**図4**のI_D-g_mのように素子のバラツキを併せ示したグラフがあれば、机上の計算だけで、簡単に回路の基本設計ができます。

次に、低信号レベル増幅回路としてどうしてもかかせないのが、雑音特性です。雑音特性は、一般に測定条件により大きく変化するので、雑音の対信号源インピーダンス、対周波数、対ドレイン－ソース間電圧、対ドレイン電流特性などが必要になります（**図5，6**）。

ＮＦ（雑音指数）の他に、入力換算雑音電圧で雑音特性を表わす方法がありますが、このうち、対信号源インピーダンス特性はＮＦ－R_g特性と形が違いますから、両者を単純に比較することはできません。

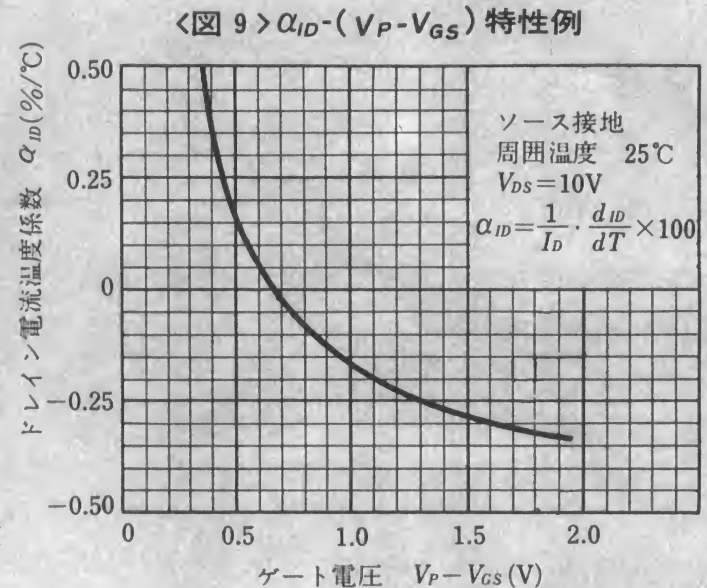
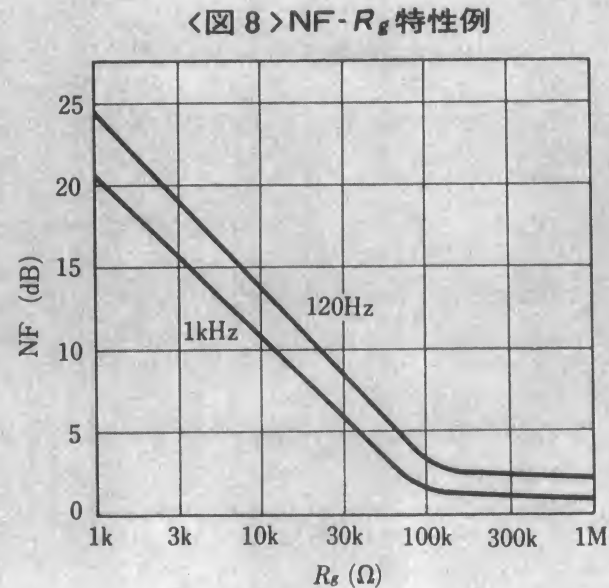
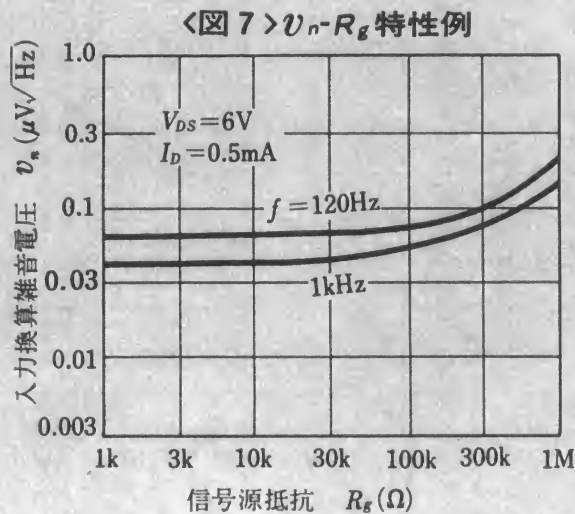
例えば、**図7**と**図5**をみると、**図7**の方が低信号源インピーダンスで雑音特性がよ

さそうですが、図7のv_nを信号源抵抗から発生する熱雑音電圧を計算し、ＮＦに換算すると図8になり、図5と同じ傾向になることがわかります。

図7では、v_nの単位として、$\mu V/\sqrt{\mathrm{Hz}}$が使われていますが、これは、帯域幅で規格化したもので、例えば、R_gの抵抗の熱雑音電圧はボルツマン定数をK、絶対温度をTとすれば

$$v_N=\sqrt{4KTR_g\Delta f}$$

で表わされますが、v_nと同じ単位に直せば、

$$v_n=\sqrt{4KTR_g}$$

になるわけです。

最後に直流増幅器の設計にぜひ必要なものとして、ＦＥＴの各パラメータの温度特性関係のグラフがあります。

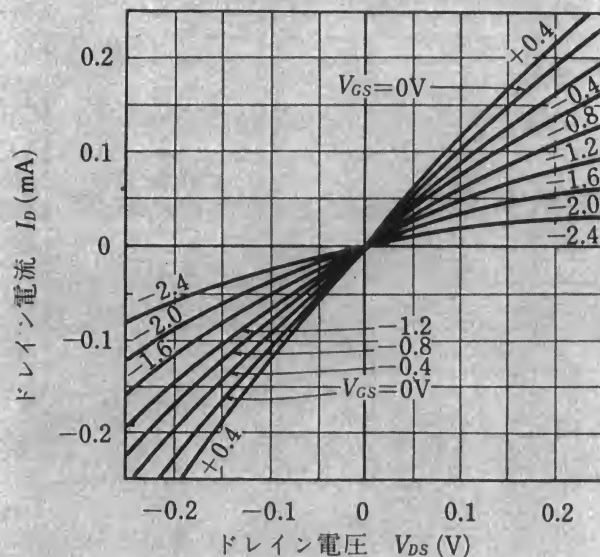
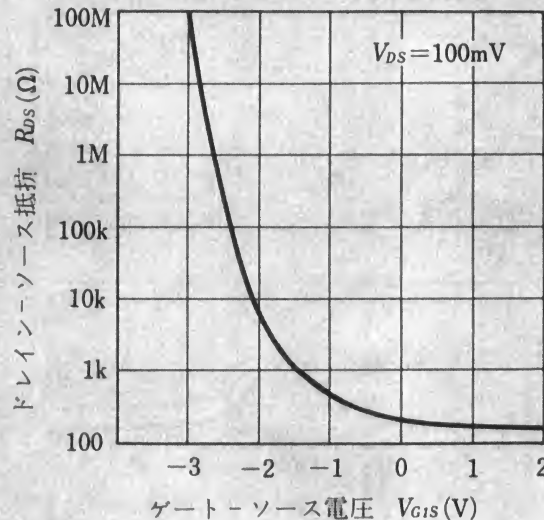
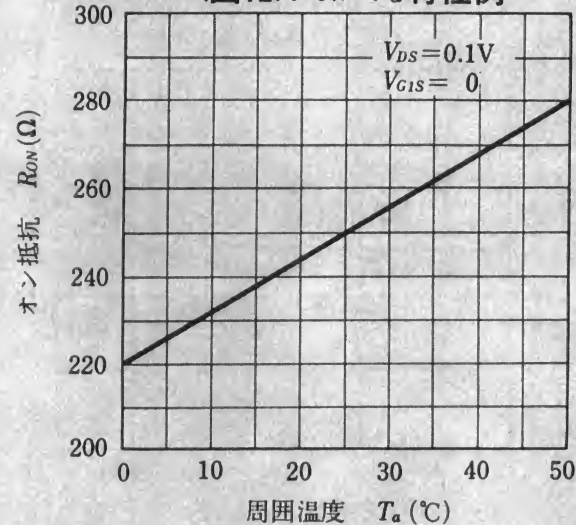
これには、I_D, g_m, I_{GSS}の標準値の温度特性を示したものと図9のように、バイアスと温度係数の関係を表わしたものがあります。

例えば図9の場合は、ピンチオフ電圧より約0.65V高いバイアスで使えば、ドレイン電流の温度係数を零に押えることができるということを意味しています。

■チョッパ用

ＦＥＴの立上がりの部分の特性が重要になってくるので、図10のような小レベルの出力特性が示されます。

ＦＥＴの種類は違いますが図10で、V_{DS}を一定にして、ドレイン－ソース抵抗－ゲー

〈図10〉V_{DS}-I_D特性例

〈図11〉R_{DS}-V_{GIS}特性例

〈図12〉R_{ON}-T_a特性例

トーソース電圧特性を求めたのが**図11**です。

またチョッパ用の場合、オン抵抗やオフ抵抗の温度特性を知る必要があり、一例を**図13**に示します。

■高周波用

普通、高周波回路の設計には、Yパラメータが一番使われるので、Yパラメータの周波数特性、電圧電流依存性などが中心になります。**図14**に、ソース接地、**図15**にゲート接地のYパラメータの一例を示します。

*　　　　*

特性グラフではありませんが、高周波用として、問題になるものとして、高周波電力利得、雑音指数があります。

雑音指数の方は、各素子の最適信号源インピーダンスに合わせて、入力側でノイズマッチングをとったような形で、普通測定されるので、それほど問題はありませんが、電力利得の方は、極端にいえば、測定回路によって、ある程度自由に利得の大きさが変えられるので、P.G.の絶対値だけを比較しても意味がありません。

すなわち各メーカーのカタログにのっているのは、それぞれの測定回路で測った場合に、それだけの利得が得られるということで、個々の素子の比較は、同一の測定回路で測るか、あるいは、Yパラメータから計算するよりしょうがありません。

〈図13〉R_{OFF}－T_a特性例

〈図14〉Y_{is}・Y_{os}－f 特性例

〈図15〉Y_{ig}－f 特性例

■用途別早見表＆索引 （注 DG：デュアルゲート，索引・特性図欄「'82年」とあるのは'82年版で収録）

型名	社名	構造	モード	区分	DC・AC高入力インピーダンス回路	コンデンサ・マイク	低雑音増幅回路	低周波 電圧増幅	低周波 ドライバ	低周波 出力	ビデオ増幅	チョッパ回路	SW回路	可変抵抗回路	高周波出力	VHF RF MIX	UHF RF MIX	SHF RF MIX	索引(頁) 規格一覧	索引(頁) 特性図	備考
2SJ17	ソニー	J	D	一般		●													34	—	
〃 18	〃	J(V)	〃	〃						●									34	—	
〃 22	〃	J	〃	〃		●													34	—	
〃 39	三菱	MOS	〃	〃	●		●												34	'83年	2SJ×2
〃 40	〃	J	〃	〃				●						●					34	134	
〃 43	松下	〃	〃	〃	●		●												34	135	
〃 44	日電	〃	〃	〃			●												34	—	
〃 45	〃	〃	〃	〃	●														34	—	
〃 48	日立	MOS	E	〃						●									34	'83年	
〃 49	〃	〃	〃	〃						●									34	'83年	
〃 50	〃	〃	〃	〃						●									34	'83年	
〃 55	〃	MOS	〃	〃						●									34	136	
〃 56	〃	〃	〃	〃						●									34	136	
〃 56Ⓗ	〃	〃	〃	通工									●		●				40	136	
〃 68	〃	J	D	一般			●												34	'84年	
〃 69	〃	〃	〃	〃			●												34	'84年	
〃 70	〃	〃	〃	〃			●												34	'84年	
〃 72	東芝	〃	〃	〃	●		●												36	'83年	
〃 73	〃	〃	〃	〃	●		●												36	'84年	2SJ×2
〃 74	〃	〃	〃	〃	●		●												36	'84年	
〃 75	〃	〃	〃	〃	●		●												36	'84年	2SJ×2
〃 76	日立	MOS	E	〃						●			●		●				36	137	
〃 77	〃	〃	〃	〃						●			●		●				36	137	
〃 77Ⓚ	〃	〃	〃	通工									●		●				40	137	
〃 78	〃	〃	〃	一般						●			●		●				36	137	
〃 79	〃	〃	〃	〃						●			●		●				36	137	
〃 79Ⓚ	〃	〃	〃	通工									●		●				40	137	
〃 81	〃	〃	〃	一般						●									36	'83年	
〃 82	〃	〃	〃	〃						●									36	'83年	

型名	用途 社名	構造	モード	区分	DC・AC高入力インピーダンス回路	コンデンサ・マイク	低雑音増幅回路	低周波 電圧増幅	低周波 ドライバ	低周波 出力	ビデオ増幅	チョッパ回路	SW回路	可変抵抗回路	高周波出力	VHF RF MIX	UHF RF MIX	SHF RF MIX	索引（頁） 規格一覧	索引（頁） 特性図	備考
2SJ 83	日立	MOS	E	一般						●									36	'83年	
〃 84	松下	J	D	〃	●														36	138	
〃 96	日立	MOS	E	〃						●			●		●				36	139	
〃 99	〃	〃	〃	〃						●			●		●				36	140	
〃 100	〃	〃	〃	〃						●			●		●				36	140	
〃 101	〃	〃	〃	〃						●			●		●				38	141	
〃 102	〃	〃	〃	〃						●			●		●				38	141	
〃 103	東芝	J	D	〃	●									●					38	142	
〃 104	〃	〃	〃	〃	●									●					38	143	
〃 105	〃	〃	〃	〃	●									●					38	142	
〃 106	〃	〃	〃	〃	●									●					38	142	
〃 107	〃	〃	〃	〃	●									●					38	143	
〃 108	〃	〃	〃	〃	●		●												38	'84年	
〃 109	〃	〃	〃	〃	●		●												38	144	2SJ×2
〃 110	〃	〃	〃	〃	●									●					38	145	
〃 111	〃	〃	〃	〃	●		●												38	145	
〃 112	日立	MOS	E	〃									●		●				38	146	
〃 113	〃	〃	〃	〃									●		●				38	146	
〃 114	〃	〃	〃	〃									●		●				38	147	
〃 115	東芝	〃	〃	〃						●									38	148	
〃 116	日立	〃	〃	〃									●		●				38	149	
〃 117	〃	〃	〃	〃									●		●				38	150	
〃 118	〃	〃	〃	〃									●		●				38	140	
〃 119	〃	〃	〃	〃									●		●				38	140	
〃 120	〃	〃	〃	〃									●		●				38	151	
〃 122	〃	〃	〃	〃									●		●				38	152	
〃 123	東芝	〃	〃	〃						●			●						38	153	
〃 125	三菱	J	D	〃				●						●					38	134	
〃 126	東芝	MOS	E	通工									●						40		
3SJ 11A	日電	〃	〃	〃	●								●						40	'82年	3SJ×2

型名	用途 社名	構造	モード	区分	DC・AC高入力インピーダンス回路	コンデンサ・マイク	低雑音増幅回路	低周波 電圧増幅	ドライバ	出力	ビデオ増幅	チョッパ回路	SW回路	可変抵抗回路	高周波出力	VHF RF MIX	UHF RF MIX	SHF RF MIX	索引(頁) 規格一覧	特性図	備考
2SK11	東芝	J	D	通工	●							●	●						42	'82年	
〃 12	〃	〃	〃	〃	●		●					●	●						42	'82年	
〃 15	〃	〃	〃	〃	●		●												42	'82年	
〃 16Ⓗ	日立	〃	〃	〃	●														42	'82年	
〃 18	東芝	〃	〃	〃	●														42	—	2SK×2
〃 18A	〃	〃	〃	〃	●														42	—	2SK×2
〃 23A	ソニー	〃	〃	一般			●					●		●		●			42	—	
〃 30ATM	東芝	〃	〃	〃	●		●												42	'83年	
〃 33	三菱	〃	〃	〃												●			42	'82年	
〃 34	〃	〃	〃	〃	●		●												42	'82年	
〃 37	日電	〃	〃	〃												●			42	'83年	
〃 38A	三菱	MOS	D+E	〃	●											●			42	'83年	
〃 40	日立	J	D	〃	●		●												42	'82年	
〃 42	ソニー	〃	〃	〃							●					●			44	'82年	
〃 43	〃	〃	〃	〃			●				●								44	'83年	
〃 43Ⓢ	〃	〃	〃	通工	●		●						●						44	'83年	
〃 43Ⓢ-D	〃	〃	〃	〃	●		●						●	●					44	'83年	
〃 46	三菱	〃	〃	一般	●	●	●												44	'82年	
〃 48	東芝	〃	〃	通工	●		●												44	'82年	
〃 49	日電	〃	〃	一般												●			44	'82年	
〃 54	日立	〃	〃	〃												●			44	'82年	
〃 55	〃	〃	〃	〃												●			44	'82年	
〃 57	日電	〃	〃	〃												●			44	'83年	
〃 58	ソニー	〃	〃	〃	●														44	—	2SK×2
〃 59	日立	〃	〃	〃		●													44	'83年	
〃 60	ソニー	J(V)	〃	〃															44	'83年	
〃 63	〃	〃	〃	〃	●								●						44	'83年	
〃 65	松下	J	〃	〃		●													44	'83年	
〃 66	〃	〃	〃	〃	●		●		●										44	'83年	
〃 67	日電	〃	〃	〃		●													44	-	

型名	用途 社名	構造	モード	区分	DC・AC高入力インピーダンス回路	コンデンサ・マイク	低雑音増幅回路	低周波 電圧増幅	低周波 ドライバ	低周波 出力	ビデオ増幅	チョッパ回路	SW回路	可変抵抗回路	高周波出力	VHF RF MIX	UHF RF MIX	SHF RF MIX	索引(頁) 規格一覧	索引(頁) 特性図	備考
2SK 67A	日電	J	D	一般		●													46	'83年	
〃 68	〃	〃	〃	〃	●									●					46	'83年	
〃 68A	〃	〃	〃	〃	●		●							●					46	'83年	
〃 72	東芝	〃	〃	通工	●		●												46	－	2SK×2
〃 73	松下	〃	〃	一般	●				●										46	－	
〃 79	ソニー	J(V)	〃	〃	●				●				●						46	'83年	
〃 83	松下	J	〃	〃												●			46	'83年	
〃 84	〃	〃	〃	〃	●		●												46	'83年	
〃 85	日電	GaAsSB	〃	通工														●	46	'83年	
〃 92	〃	J	〃	一般		●													46	'83年	
〃 93	ソニー	〃	〃	〃		●													46	'83年	
〃 94	日電	〃	〃	〃			●							●					46	'83年	
〃 97	ソニー	〃	〃	〃	●														46	'83年	2SK×2
〃 103	日電	〃	〃	〃		●													48	－	
〃 104	〃	〃	〃	〃			●							●					48	'83年	
〃 105	〃	〃	〃	〃			●							●					48	154	
〃 107	ソニー	〃	〃	〃	●		●					●		●		●			48	'83年	
〃 108	三菱	〃	〃	〃			●							●					48	155	
〃 109A	〃	〃	〃	〃	●		●												86	155	2SK×2
〃 110	〃	〃	〃	〃			●												48	156	
〃 111	〃	〃	〃	〃	●		●												48	'83年	2SK×2
〃 112	東芝	〃	〃	通工	●		●					●	●						48	'83年	
〃 113	〃	〃	〃	〃								●	●	●					48	'83年	
〃 117	〃	〃	〃	一般	●		●												48	'83年	
〃 118	〃	〃	〃	〃	●	●	●												48	'83年	
〃 119	日電	〃	〃	通工	●									●					48	'83年	
〃 120	ソニー	〃	〃	一般												●			48	'83年	
〃 121	〃	〃	〃	〃	●		●				●		●						48	－	
〃 123	松下	〃	〃	〃		●													48	157	
〃 124	日電	GaAsSB	〃	〃														●	48	'83年	

型名	社名	構造	モード	区分	用途 DC・AC高入力インピーダンス回路	コンデンサ・マイク	低雑音増幅回路	低周波 電圧増幅	低周波 ドライバ	低周波 出力	ビデオ増幅	チョッパ回路	SW回路	可変抵抗回路	高周波出力	VHF RF MIX	UHF RF MIX	SHF RF MIX	索引（頁） 規格一覧	索引（頁） 特性図	備考
2SK125	ソニー	J	D	一 般										●					48	'84年	
〃 127	松 下	〃	〃	〃	●		●												50	—	
〃 127A	〃	〃	〃	〃	●		●												86	—	
〃 128	〃	〃	〃	〃	●		●												50	158	
〃 130	日 電	〃	〃	〃			●							●					50	'83年	
〃 130A	〃	〃	〃	〃			●												86	'83年	
〃 131	〃	〃	〃	〃			●												50	159	2SK×2
〃 133	日 立	MOS	E	〃						●									50	'83年	
〃 134	〃	〃	〃	〃						●									50	'83年	
〃 135	〃	〃	〃	〃						●									50	'83年	
〃 136	松 下	J	D	〃	●		●												50	160	
〃 137	〃	〃	〃	〃			●												50	—	
〃 137A	〃	〃	〃	〃			●												50	—	
〃 138	日 電	GaAsSB	〃	〃														●	50	'84年	
〃 140	〃	〃	〃	〃														●	50	'84年	
〃 141	〃	J	〃	通 工	●									●					50	'83年	
〃 141A	〃	〃	〃	〃	●									●					50	'83年	
〃 146	東 芝	〃	〃	一 般	●		●												50	'84年	2SK×2
〃 147	〃	〃	〃	〃			●												50	'83年	
〃 148	松 下	〃	〃	〃												●			50	—	
〃 149	日 電	〃	〃	通 工												●	●		50	'84年	
〃 152	ソニー	〃	〃	一 般			●				●					●			52	'84年	
〃 154	松 下	〃	〃	〃												●			52	—	
〃 155	〃	〃	〃	〃	●														52	161	
〃 156	三 洋	〃	〃	〃		●													52	'83年	
〃 158	松 下	〃	〃	〃			●												52	—	
〃 160	日 電	〃	〃	〃			●							●		●			52	154	
〃 160A	〃	〃	〃	〃			●							●		●			86	154	
〃 161	東 芝	〃	〃	〃												●			52	'83年	
〃 162	日 電	〃	〃	〃			●												52	'84年	

型名	用途				DC・AC高入力インピーダンス回路	コンデンサ・マイク	低雑音増幅回路	低周波			ビデオ増幅	チョッパ回路	SW回路	可変抵抗回路	高周波出力	VHF RF MIX	UHF RF MIX	SHF RF MIX	索引（頁）		備考
	社名	構造	モード	区分				電圧増幅	ドライバ	出力									規格一覧	特性図	
2SK163	日電	J	D	一般			●												52	'84年	
〃 165	松下	〃	〃	〃							●								52	162	
〃 168	日立	〃	〃	〃												●			52	'83年	
〃 169	松下	〃	〃	〃	●		●												52	—	
〃 170	東芝	〃	〃	〃	●		●												52	'83年	
〃 171	三菱	〃	〃	〃	●		●												52	'83年	2SK×2
〃 175	日立	MOS	E	〃						●									52	163	
〃 176	〃	〃	〃	〃						●									54	163	
〃 176Ⓗ	〃	〃	〃	通工									●		●				86	163	
〃 184	東芝	J	D	一般	●		●												54	'83年	
〃 185	ソニー	〃	〃	〃	●		●												54	—	2SK×2
〃 186	日立	〃	〃	〃			●												54	'84年	
〃 187	〃	〃	〃	〃			●												54	164	
〃 190	〃	〃	〃	〃			●												54	'84年	
〃 191	〃	〃	〃	〃			●												54	'84年	
〃 192A	東芝	〃	〃	〃												●			54	'84年	
〃 193	日電	〃	〃	〃												●			54	'84年	
〃 194	〃	〃	〃	〃			●												54	'84年	2SK×2
〃 195	〃	〃	〃	〃												●			54	'84年	
〃 196Ⓗ	日立	MOS	E	通工									●		●				54	'84年	
〃 197	〃	J	D	一般												●			54	'84年	
〃 198	松下	〃	〃	〃	●														54	158	
〃 199	〃	〃	〃	〃												●			54	—	
〃 201	日電	GaAs	〃	〃														●	56	'84年	
〃 203	〃	〃	〃	〃														●	56	'84年	
〃 208	東芝	J	〃	〃		●													56	'83年	
〃 209	〃	〃	〃	〃	●														56	'83年	
〃 210	〃	〃	〃	〃												●			56	'84年	
〃 211	〃	〃	〃	〃												●			56	'83年	
〃 212	三洋	〃	〃	〃												●			56	'84年	

型名	用途				DC・AC高入力インピーダンス回路	コンデンサ・マイク	低雑音増幅回路	低周波			ビデオ増幅	チョッパ回路	SW回路	可変抵抗回路	高周波出力	VHF RF MIX	UHF RF MIX	SHF RF MIX	索引（頁）		備考
	社名	構造	モード	区分				電圧増幅	ドライバ	出力									規格一覧	特性図	
2SK213	日立	MOS	E	一般						●			●		●				56	165	
〃 214	〃	〃	〃	〃						●			●		●				56	165	
〃 214Ⓚ	〃	〃	〃	通工									●		●				86	165	
〃 215	〃	〃	〃	一般						●			●		●				56	165	
〃 216	〃	〃	〃	〃						●			●		●				56	165	
〃 216Ⓚ	〃	〃	〃	通工									●		●				86	165	
〃 217	〃	J	D	一般												●			56	'84年	
〃 218	松下	〃	〃	〃							●								56	166	
〃 220Ⓗ	日立	MOS	E	通工									●		●				56	'84年	
〃 221Ⓗ	〃	〃	〃	〃									●		●				56	'84年	
〃 222	三洋	J	D	一般			●												56	167	
〃 223	〃	〃	〃	〃					●										56	'84年	
〃 225	日立	MOS	E	〃						●									56	168	
〃 226	〃	〃	〃	〃						●									58	168	
〃 227	〃	〃	〃	〃						●									58	168	
〃 238	日電	J	D	〃												●			58	'84年	
〃 240	東芝	〃	〃	〃	●		●												58	'84年	2SK×2
〃 241	〃	MOS	D+E	〃												●			58	'84年	
〃 242	三洋	J	D	〃												●			58	169	
〃 246	東芝	〃	〃	〃	●														58	'84年	
〃 247	松下	〃	〃	〃	●														58	170	
〃 258Ⓗ	日立	MOS	E	通工									●		●				60	'84年	
〃 259Ⓗ	〃	〃	〃	〃									●		●				60	'84年	
〃 260Ⓗ	〃	〃	〃	〃									●		●				60	'84年	
〃 265	東芝	J	D	一般	●		●												—	—	2SK×2
〃 266	〃	〃	〃	〃		●													60	171	
〃 277	日電	MOS	E	通工									●						62	172	
〃 278	〃	〃	〃	〃									●						62	172	
〃 280	〃	GaAs	D	一般														●	62	'84年	
〃 281	〃	〃	〃	〃												●	●	●	62	'84年	

型名	用途				DC・AC高入力インピーダンス回路	コンデンサ・マイク	低雑音増幅回路	低周波			ビデオ増幅	チョッパ回路	SW回路	可変抵抗回路	高周波出力	VHF RF MIX	UHF RF MIX	SHF RF MIX	索引（頁）		備考
	社名	構造	モード	区分				電圧増幅	ドライバ	出力									規格一覧	特性図	
2SK283	三洋	J	D	一般					●										62	'84年	
〃 286	日立	MOS	E	〃						●			●		●				62	173	
〃 287Ⓚ	〃	〃	〃	通工									●		●				62	174	
〃 288Ⓚ	〃	〃	〃	〃									●		●				62	174	
〃 291	〃	J	D	一般	●														62	175	
〃 292	日電	〃	〃	〃												●			62	'84年	
〃 293	〃	MOS	E	通工									●						62	176	
〃 293A	〃	〃	〃	〃									●						62	176	
〃 294	日立	〃	〃	一般									●		●				62	177	
〃 295	〃	〃	〃	〃									●		●				62	177	
〃 296	〃	〃	〃	〃									●		●				62	'84年	
〃 298	〃	〃	〃	〃									●		●				62	178	
〃 299	〃	〃	〃	〃									●		●				62	178	
〃 301	松下	J	D	〃	●								●						64	179	
〃 302	東芝	MOS	D+E	〃												●			64	'84年	
〃 303	三洋	J	D	〃	●									●					64	180	
〃 304	〃	〃	〃	〃	●									●					64	180	
〃 308	日立	MOS	E	〃									●		●				64	'84年	
〃 310	〃	〃	〃	〃									●		●				64	181	
〃 311	〃	〃	〃	〃									●		●				64	181	
〃 312	〃	〃	〃	〃									●		●				64	182	
〃 313	〃	〃	〃	〃									●		●				64	182	
〃 314	日電	J	D	通工			●												64	183	
〃 315	三洋	〃	〃	一般												●			64	184	
〃 316	松下	〃	〃	〃							●								64	185	
〃 317	日立	MOS	E	〃											●				64	186	
〃 318	〃	〃	〃	〃											●				64	187	
〃 319	〃	〃	〃	〃									●		●				64	188	
〃 320	〃	〃	〃	〃									●		●				64	188	
〃 321	松下	J	D	〃	●						●								64	189	

型名	社名	構造	モード	区分	DC・AC高入力インピーダンス回路	コンデンサ・マイク	低雑音増幅回路	低周波			ビデオ増幅	チョッパ回路	SW回路	可変抵抗回路	高周波出力	VHF RF MIX	UHF RF MIX	SHF RF MIX	索引(頁)		備考
								電圧増幅	ドライバ	出力									規格一覧	特性図	
2SK322	日立	J	D	一般	●						●								64	190	
〃 323	〃	〃	〃	〃	●														64	191	
〃 324	東芝	MOS	E	通工									●						64	192	
〃 325	〃	〃	〃	〃									●						64	193	
〃 330	〃	J	D	一般	●									●					66	194	
〃 331	三洋	〃	〃	〃		●													66	'83年	
〃 332	〃	〃	〃	〃	●														66	195	2SK×2
〃 333	〃	〃	〃	〃	●														66	196	2SK×2
〃 334	〃	〃	〃	〃		●													66	'83年	
〃 336	〃	MOS	E	〃										●					66	197	
〃 337	日電	〃	〃	通工									●						66	198	
〃 343	日立	〃	〃	一般						●			●		●				66	199	
〃 344	〃	〃	〃	〃						●			●		●				66	199	
〃 345	〃	〃	〃	〃						●			●		●				66	200	
〃 346	〃	〃	〃	〃						●			●		●				66	200	
〃 347	〃	〃	〃	〃									●		●				66	201	
〃 349	〃	〃	〃	〃									●		●				66	202	
〃 350	〃	〃	〃	〃									●		●				66	202	
〃 351	〃	〃	〃	〃									●		●				68	203	
〃 352	〃	〃	〃	〃									●		●				68	204	
〃 353	日電	GaAs	D	〃														●	68	205	
〃 354	〃	〃	〃	〃														●	68	206	
〃 354 A	〃	〃	〃	〃														●	90	206	
〃 355	東芝	MOS	E	通工									●						68	207	
〃 356	〃	〃	〃	〃									●						68	208	
〃 357	〃	〃	〃	〃									●						68	209	
〃 358	〃	〃	〃	〃									●						68	210	
〃 359	日立	〃	D+E	一般												●			68	211	
〃 360	〃	〃	〃	〃												●			68	211	
〃 362	東芝	J	D	〃	●									●					68	212	

型名	社名	構造	モード	区分	DC・AC高入力インピーダンス回路	コンデンサ・マイク	低雑音増幅回路	低周波 電圧増幅	低周波 ドライバ	低周波 出力	ビデオ増幅	チョッパ回路	SW回路	可変抵抗回路	高周波出力	VHF RF MIX	UHF RF MIX	SHF RF MIX	索引(頁) 規格一覧	索引(頁) 特性図	備考
2SK363	東芝	J	D	一般	●									●					68	213	
〃 364	〃	〃	〃	〃	●									●					68	214	
〃 365	〃	〃	〃	〃	●									●					68	212	
〃 366	〃	〃	〃	〃	●									●					68	214	
〃 367	〃	〃	〃	〃	●														68	215	
〃 368	〃	〃	〃	〃	●														68	215	
〃 369	〃	〃	〃	〃			●												68	'83年	
〃 370	〃	〃	〃	〃			●												68	'83年	
〃 371	〃	〃	〃	〃			●												68	'83年	
〃 372	〃	〃	〃	〃	●									●					68	213	
〃 373	〃	〃	〃	〃	●														68	216	
〃 374	松下	〃	〃	〃	●								●						68	179	
〃 375	日立	MOS	E	〃									●		●				68	217	
〃 376	三洋	J	D	〃		●													70	218	
〃 377	〃	〃	〃	〃		●													70	218	
〃 378	松下	GaAs	〃	〃													●		70	219	
〃 379	〃	MOS	E	〃									●						70	220	
〃 380	〃	〃	〃	〃									●						70	221	
〃 381	三菱	J	D	〃				●						●					70	222	
〃 382	日立	MOS	E	〃									●		●				70	223	
〃 383	〃	〃	〃	〃									●		●				70	224	
〃 384	〃	〃	〃	〃									●		●				70	225	
〃 385	東芝	〃	〃	通工									●						70	226	
〃 386	〃	〃	〃	〃									●						70	227	
〃 387	〃	〃	〃	〃									●						70	228	
〃 388	〃	〃	〃	〃									●						70	229	
〃 389	〃	J	D	一般	●		●												70	230	2SK×2
〃 398	日立	MOS	E	〃									●		●				70	231	
〃 399	〃	〃	〃	〃									●		●				70	232	
〃 400	〃	〃	〃	〃									●		●				70	233	

型名	社名	構造	モード	区分	DC・AC高入力インピーダンス回路	コンデンサ・マイク	低雑音増幅回路	低周波 電圧増幅	低周波 ドライバ	低周波 出力	ビデオ増幅	チョッパ回路	SW回路	可変抵抗回路	高周波出力	VHF RF MIX	UHF RF MIX	SHF RF MIX	索引(頁) 規格一覧	索引(頁) 特性図	備考
2SK401	日立	MOS	E	一般									●		●				72	234	
〃 402	〃	〃	〃	〃									●		●				72	235	
〃 403	〃	〃	〃	〃									●		●				72	235	
〃 404	三洋	J	D	〃				●											72	236	
〃 405	東芝	MOS	E	〃						●									72	237	
〃 406	日電	GaAs	D	〃														●	72	238	
〃 407	〃	〃	〃	〃														●	72	238	
〃 408	日立	MOS	E	〃											●				72	239	
〃 409	〃	〃	〃	〃											●				72	239	
〃 410	〃	〃	〃	〃											●				72	240	
〃 411	〃	〃	〃	〃									●		●				72	241	
〃 412	〃	〃	〃	〃									●		●				72	242	
〃 413	〃	〃	〃	〃									●		●				72	243	
〃 414	〃	〃	〃	〃									●		●				72	243	
〃 415	〃	〃	〃	〃									●		●				72	244	
〃 416	〃	〃	〃	〃									●		●				72	245	
〃 417	東芝	〃	〃	通工									●						72	246	
〃 418	〃	〃	〃	〃									●						72	247	
〃 419	〃	〃	〃	〃									●						72	248	
〃 420	〃	〃	〃	〃									●						72	249	
〃 421	〃	〃	〃	〃									●						72	250	
〃 422	〃	〃	〃	〃									●						72	251	
〃 423	〃	〃	〃	〃									●						72	252	
〃 424	日電	〃	〃	〃									●						72	253	
〃 425	〃	J	D	一般			●												72	254	
〃 426	〃	〃	〃	〃			●												74	254	
〃 427	三洋	〃	〃	〃				●								●			74	255	
〃 428	日立	MOS	E	〃									●		●				74	256	
〃 429	〃	〃	〃	〃									●		●				74	257	
〃 430	〃	〃	〃	〃									●		●				74	258	

型名	社名	構造	モード	区分	DC・AC高入力インピーダンス回路	コンデンサ・マイク	低雑音増幅回路	低周波 電圧増幅	低周波 ドライバ	低周波 出力	ビデオ増幅	チョッパ回路	SW回路	可変抵抗回路	高周波出力	VHF RF MIX	UHF RF MIX	SHF RF MIX	索引(頁) 規格一覧	索引(頁) 特性図	備考
2SK431	日立	J	D	一般	●														74	164	
〃 433	三菱	〃	〃	〃				●						●					74	222	
〃 435	日立	〃	〃	〃	●		●												74	259	
〃 436	三洋	〃	〃	〃				●								●			74	255	
〃 437	松下	GaAs	〃	〃														●	74	260	
〃 437Ⓗ	〃	〃	〃	〃														●	90	260	
〃 438	〃	〃	〃	〃														●	74	260	
〃 439	日立	MOS	D+E	〃												●			74	211	
〃 440	〃	〃	E	〃									●		●				74	261	
〃 441	〃	〃	〃	〃									●		●				74	262	
〃 442	東芝	〃	〃	〃						●			●						74	263	
〃 443	三洋	J	D	〃							●								74	264	
〃 444	〃	〃	〃	〃							●								74	264	
〃 445	〃	〃	〃	〃							●								74	264	
〃 446	日電	MOS	E	〃									●						74	265	
〃 447	東芝	〃	〃	通工									●						74	266	
〃 448	日電	〃	〃	〃									●						74	267	
〃 449	〃	〃	〃	〃									●						74	268	
〃 453	〃	〃	〃	〃											●				76	—	
〃 454	〃	〃	〃	〃											●				76	—	
〃 455	東芝	J	D	一般		●													76	269	
〃 456	〃	〃	〃	〃		●													76	269	
〃 457	日立	GaAs	〃	〃													●	●	76	—	
〃 458	日電	MOS	E	通工									●						76	—	
〃 459	〃	〃	〃	〃									●						76	—	
〃 462	〃	〃	〃	一般									●						76	—	
〃 463	〃	〃	〃	通工									●						76	—	
〃 464	〃	〃	〃	〃									●						76	—	
〃 468	〃	〃	〃	一般									●						76	—	
〃 470	〃	〃	〃	〃									●						76	—	

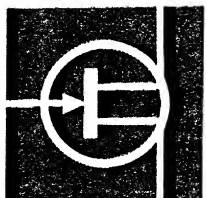
型名	社名	構造	モード	区分	DC・AC高入力インピーダンス回路	コンデンサ・マイク	低雑音増幅回路	低周波			ビデオ増幅	チョッパ回路	SW回路	可変抵抗回路	高周波出力	VHF RF MIX	UHF RF MIX	SHF RF MIX	索引（頁）		備考
								電圧増幅	ドライバ	出力									規格一覧	特性図	
2SK477	日電	MOS	E	通工									●						78	—	
〃 482	〃	〃	〃	〃									●						78	—	
〃 492	三菱	J	D	一般				●						●					78	155	
〃 493	三洋	〃	〃	〃							●								78	270	
〃 494	日立	〃	〃	〃	●		●													259	
〃 505	日電	〃	〃	〃	●						●								80	271	
〃 507	〃	〃	〃	〃	●						●								80	271	
〃 508	〃	〃	〃	〃	●						●								80	271	
〃 511	日立	MOS	E	〃									●		●				80	272	
〃 512	〃	〃	〃	〃									●						80	273	
〃 513	〃	〃	〃	〃									●		●				80	274	
〃 518	日電	J	D	〃										●					80	275	
〃 519	〃	〃	〃	〃										●					80	275	
〃 520	〃	〃	〃	〃										●					80	275	
〃 525	東芝	MOS	E	通工									●						80	—	
〃 526	〃	〃	〃	〃									●						82	—	
〃 527	〃	〃	〃	〃									●						82	—	
〃 528	〃	〃	〃	〃									●						82	—	
〃 529	〃	〃	〃	〃									●						82	—	
〃 530	〃	〃	〃	〃									●						82	—	
〃 531	〃	〃	〃	〃									●						82	—	
〃 532	〃	〃	〃	〃									●						82	—	
〃 534	日立	〃	〃	一般									●						82	276	
〃 535	〃	〃	〃	〃									●						82	277	
〃 537	東芝	〃	〃	通工									●						82	—	
〃 538	〃	〃	〃	〃									●						82	—	
〃 539	〃	〃	〃	〃									●						82	—	
〃 572	〃	〃	〃	一般									●						84		
〃 573	〃	〃	〃	〃									●						84		
2N4392	日電	J	D	通工								●	●						42	'83年	

型名	用途				DC・AC高入力インピーダンス回路	コンデンサ・マイク	低雑音増幅回路	低周波			ビデオ増幅	チョッパ回路	SW回路	可変抵抗回路	高周波出力	VHF RF MIX	UHF RF MIX	SHF RF MIX	索引(頁)		備考
	社名	構造	モード	区分				電圧増幅	ドライバ	出力									規格一覧	特性図	
2N4393	日電	J	D	通工								●	●						42	'83年	
3SK 14	〃	MOS	D+E	〃	●							●							92	'82年	
〃 20㊊	日立	〃	〃	〃	●														92	'83年	
〃 21㊊	〃	〃	〃	〃								●							92	'83年	
〃 22	東芝	J	D	一般												●			92	—	
〃 28	〃	〃	〃	通工	●		●				●					●			92	'83年	
〃 29	日電	MOS	D+E	〃	●							●							92	'83年	
〃 37	ソニー	〃	〃	一般												●			96	—	DG
〃 38A	東芝	〃	E	通工								●							92	'83年	
〃 39	松下	〃	D+E	一般												●			96	'83年	DG
〃 39Ⓩ	〃	〃	〃	通工												●			96	—	DG
〃 40	日電	〃	〃	一般												●			96	'83年	DG
〃 45	日立	〃	〃	〃												●			96	'83年	DG
〃 47	日電	〃	〃	通工										●		●			96	285	DG
〃 48	ソニー	〃	〃	一般													●		96	—	DG
〃 49	松下	〃	〃	〃												●			96	'83年	DG
〃 49NC	〃	〃	〃	〃												●			96	—	DG
〃 49Ⓩ	〃	〃	〃	通工												●			96	—	DG
〃 51	日立	〃	〃	一般												●			96	'83年	DG
〃 53	〃	〃	〃	〃													●		96	'83年	DG
〃 59	東芝	〃	〃	通工												●			96	—	DG
〃 60	日立	〃	〃	一般												●			96	286	DG
〃 61	ソニー	〃	〃	〃												●			96	—	DG
〃 63	東芝	〃	〃	通工												●			96		DG
〃 66	松下	〃	〃	一般													●		96	—	DG
〃 70	日立	〃	〃	〃													●		96	'83年	DG
〃 71	日電	J	D	〃		●													94	287	
〃 72	松下	MOS	D+E	〃												●			96	'84年	DG
〃 73	東芝	〃	〃	〃												●			96	'83年	DG
〃 74	日電	〃	〃	〃												●			96	'84年	DG

型名	用途 社名	構造	モード	区分	DC・AC高入力インピーダンス回路	コンデンサ・マイク	低雑音増幅回路	低周波 電圧増幅	低周波 ドライバ	低周波 出力	ビデオ増幅	チョッパ回路	SW回路	可変抵抗回路	高周波出力	VHF RF MIX	UHF RF MIX	SHF RF MIX	索引(頁) 規格一覧	索引(頁) 特性図	備考
3SK 77	東芝	MOS	D+E	一般												●			98	'83年	DG
〃 79	松下	〃	〃	〃													●		98	—	DG
〃 80	日立	〃	〃	〃													●		98	'84年	DG
〃 81	〃	〃	〃	〃												●			98	288	DG
〃 82	〃	〃	〃	〃													●		98	289	DG
〃 83	〃	〃	〃	〃												●			98	'84年	DG
〃 85	〃	〃	〃	〃												●			98	'84年	DG
〃 87	日電	〃	〃	〃													●		98	'84年	DG
〃 88	〃	〃	〃	〃													●		98	'84年	DG
〃 95	日立	〃	〃	〃													●		98	'84年	DG
〃 96	〃	〃	〃	〃												●			98	290	DG
〃 97	松下	GaAs	D	〃													●		98	'84年	DG
〃 100	〃	MOS	D+E	〃													●		98	291	DG
〃 101	東芝	〃	〃	〃												●			100	'84年	DG
〃 102	〃	〃	〃	〃													●		100	'84年	DG
〃 103	日立	〃	〃	〃													●		100	292	DG
〃 104	〃	〃	〃	〃													●		100	293	DG
〃 104 V	〃	〃	〃	〃												●			102	—	DG
〃 107	三洋	〃	〃	〃												●			100	315	DG
〃 108	〃	〃	E	〃												●			100	294	DG
〃 113	日立	GaAs	D+E	〃													●		100	295	DG
〃 114	東芝	MOS	〃	〃												●			100	296	DG
〃 115	〃	〃	〃	〃													●		100	—	DG
〃 116	松下	〃	〃	〃												●			100	297	DG
〃 121	東芝	GaAs	D	〃													●		100	298	DG
〃 123	日電	MOS	D+E	〃													●		100	299	DG
〃 126	東芝	〃	〃	〃												●			102	300	DG
〃 127	〃	〃	〃	〃													●		102	301	DG
〃 129	松下	GaAs	D	〃													●		102	—	
〃 131	日電	MOS	D+E	〃												●			102	302	DG

型名	用途				DC・AC高入力インピーダンス回路	コンデンサ・マイク	低雑音増幅回路	低周波			ビデオ増幅	チョッパ回路	SW回路	可変抵抗回路	高周波出力	VHF RF MIX	UHF RF MIX	SHF RF MIX	索引（頁）		備考
	社名	構造	モード	区分				電圧増幅	ドライバ	出力									規格一覧	特性図	
3SK132	日電	MOS	D+E	一般													●		102	303	DG
〃 133	〃	〃	〃	〃													●		102	304	DG
〃 136	日立	〃	〃	〃												●			102	288	DG
〃 137	〃	〃	〃	〃													●		102	—	DG
〃 138	〃	〃	〃	〃													●		102	292	DG
〃 140	東芝	GaAs	D	〃													●		102	305	DG
〃 141	松下	〃	〃	〃													●		102	—	
〃 145	東芝	MOS	D+E	〃													●		—	306	DG
〃 146	〃	〃	〃	〃													●		86	306	DG
〃 150	〃	〃	〃	〃												●			102	307	DG
〃 151	〃	〃	〃	〃												●			104	307	DG
FLC 08ME	富士通	GaAs	D	〃														●	86	278	
〃 15ME	〃	〃	〃	〃														●	86	278	
〃 30ME	〃	〃	〃	〃														●	86	278	
〃 081 WF	〃	〃	〃	〃														●	86	279	
〃 151WF	〃	〃	〃	〃														●	86	279	
〃 301MG	〃	〃	〃	〃														●	86	279	
FLM3472	〃	〃	〃	〃														●	86	—	
〃 4450	〃	〃	〃	〃														●	86	—	
〃 5964	〃	〃	〃	〃														●	86	—	
〃 6472	〃	〃	〃	〃														●	88	—	
〃 7177	〃	〃	〃	〃														●	88	—	
〃 7785	〃	〃	〃	〃														●	88	—	
FLS09/ME	〃	〃	〃	〃														●	88	280	
〃 16/ME	〃	〃	〃	〃														●	88	280	
〃 31/ME	〃	〃	〃	〃														●	88	280	
〃 50/ME	〃	〃	〃	〃														●	88	280	
FLX03MB	〃	〃	〃	〃														●	88	'84年	
〃 06MB	〃	〃	〃	〃														●	88	'84年	
〃 12MB	〃	〃	〃	〃														●	88	'84年	

型名	社名	構造	モード	区分	DC・AC高入力インピーダンス回路	コンデンサ・マイク	低雑音増幅回路	低周波			ビデオ増幅	チョッパ回路	SW回路	可変抵抗回路	高周波出力	VHF RF MIX	UHF RF MIX	SHF RF MIX	索引(頁)		備考
								電圧増幅	ドライバ	出力									規格一覧	特性図	
FSC05FA	富士通	GaAs	D	一般														●	—	—	
〃 06FA	〃	〃	〃	〃														●	—	—	
〃 07FA	〃	〃	〃	〃														●	—	—	
FSX51W/WF	〃	〃	〃	〃														●	88	'84年	
〃 52W/WF	〃	〃	〃	〃														●	88	'84年	
〃 53W/WF	〃	〃	〃	〃														●	88	'84年	
M21F	松下	MOS	—	〃		●													—	—	
〃 46F	〃	J	D	〃			●	●											40	—	2SJ×2
〃 47F	〃	〃	〃	〃	●														88	281	2SK×2
MGF-1100	三菱	GaAs	〃	〃													●	●	103	308	DG
〃 -1202	〃	〃	〃	〃														●	88	309	
〃 -1402	〃	〃	〃	〃														●	88	310	
〃 -1403	〃	〃	〃	〃														●	88	311	
〃 -1404	〃	〃	〃	〃														●	88	312	
〃 -1412	〃	〃	〃	〃														●	88	312	
〃 -1801	〃	〃	〃	〃														●	90	313	
〃 -1802	〃	〃	〃	〃														●	90	313	
〃 -2116	〃	〃	〃	〃														●	90	—	
〃 -2117	〃	〃	〃	〃														●	90	—	
〃 -2124	〃	〃	〃	〃														●	90	314	
〃 -2124F	〃	〃	〃	〃														●	90	314	
〃 -2124G	〃	〃	〃	〃														●	90	314	
〃 -2148	〃	〃	〃	〃														●	90	315	
〃 -2148F	〃	〃	〃	〃														●	90	315	
〃 -2148G	〃	〃	〃	〃														●	90	315	
〃 -2172	〃	〃	〃	〃														●	90	316	
〃 -2205	〃	〃	〃	〃														●	90	316	
〃 -X34M	〃	〃	〃	〃														●	90	316	
PM1210B	日立	MOS	E	〃									●						94	282	2SK×2モジュール
〃 1220B	〃	〃	〃	〃									●						94	283	2SK×2モジュール

型名	社名	構造	モード	区分	DC・AC高入力インピーダンス回路	コンデンサ・マイク	低雑音増幅回路	低周波			ビデオ増幅	チョッパ回路	SW回路	可変抵抗回路	高周波出力	VHF RF MIX	UHF RF MIX	SHF RF MIX	索引（頁）		備考
								電圧増幅	ドライバ	出力									規格一覧	特性図	
PM4550C	日立	MOS	E	一般									●						94	284	2SK×2モジュール
TX-429D	ソニー	〃	〃	〃													●		94	—	抵抗ゲート
μPA33A	日電	〃	〃	通工	●							●							94	'82年	3SJ×2
〃 34A	〃	〃	D+E	〃	●							●							94	'82年	3SK×2
〃 60A	〃	J	D	〃	●														90	'83年	2SK×2
〃 61A	〃	〃	〃	〃	●														90	'83年	2SK×2
〃 62C	〃	〃	〃	一般													●		90	'83年	2SK×2
〃 63H	〃	〃	〃	〃	●			●											90	'83年	2SK×2
〃 68H	〃	〃	〃	〃	●		●	●											90	'83年	2SK×2
〃 70A	〃	〃	〃	通工	●														90	'83年	2SK×2
〃 71A	〃	〃	〃	〃	●														90	'83年	2SK×2

規格一覧表
外形寸法図

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)						電気的特性 (Ta=25°C)															
					V_{GDS} V_{GDO}* V_{GDX}** (V)	V_{DSX} V_{DSS}* (V)	V_{GSO} V_{GSS}* V_{GSX}** (V)	I_G I_D* (mA)	P_d P_{ch}* (mW)	T_j T_{ch}* (°C)	I_{GSS} max (nA) (pA)*	V_{GS} (V)	I_{DSS} (mA) min	max	V_{DS} (V)	$V_{GS(off)}$, V_{th}*(V) min	max	V_{DS} (V)	I_D (μA)	g_m (mS) μ* min	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	g_{os} (mS) r_D* (Ω) typ	max
★	2SJ11	東　芝	DC，低周波 チョッパ	J	20			−10	100	150	1	10	−0.05	−0.9	−10	0.7	5.0	−10	−0.1	0.1		0.6	−10	I_{DSS}		
★	2SJ12	〃	〃	〃	20			−10	100	150	0.1	10	−0.09	−0.9	−10	0.7	5.0	−10	−0.1	0.1		0.6	−10	〃		
★	2SJ13	〃	〃	〃	20			−100	600	150	10	10	−1.0	−12	−10	1.0	6.0	−10	−0.1	1.5		6.0	−10	〃		
★	2SJ15	富士通	DC，低周波	〃	18*		15	−10	200	175	50	9	−1.5typ		−12		6.0	−10	−10	0.2	1.0	3.0	−12	〃		
★	2SJ16	〃	〃	〃	18*		15	−10	200	175	10	9	−1.5typ		−12		6.0	−10	−10	0.2	1.0	3.0	−12	〃		
	2SJ17	ソニー	コンデンサ・マイク	〃	20*		0.3	0.5 1*	10	85	0.1	0.1	I_{DSO} −0.11	−0.16	−9					0.2			−9			
	2SJ18	〃	低周波電力増幅	J(V)	170*		分類有	(A) −0.5，−5	63W	120	I_{DGO} −100μA	V_{DG} −100				7.5	25	−60	−100mA		4*		−20	−1A	16Ω*	
★	2SJ19	日　電	低周波ドライバ	〃	140*	−140	30	−20 −100*	800	150	10μA	20	−1.8	−48	−5						30*		−10	−10	1.5	
★	2SJ20	〃	低周波電力増幅	〃	100*	−100	40	−100 −10A*	100W	150	100μA	30	−3A	−8A	−5	5.5	16.5	−35	−50mA	2*	4*		−10	−1A	10*	
	2SJ22	ソニー	コンデンサ・マイク	J	80*		0.5	0.5 1*	50	85	I_{DGR} −0.05	V_{GD} 20	−0.3	−0.7	−20					0.2			−20			
	2SJ39	三　菱	低周波	〃	50*		50	−10 −20*	150 unit	125*	1	30	−1	−12	−10		6	−10	−10	1.5			−10	I_{DSS}		
	2SJ40	〃	低周波電圧増幅 アナログSW	〃	50*			−10	300	125*	1	30	−1	−12	−10	0.3	6	−10	−10	1.5	4		−10	〃		
	2SJ43	松　下	低周波	〃	50			20*	250	125	0.1μA	30	−0.5	−12	−10	0.2	3	−10	−10	3	9		−10	〃		
	2SJ44	日　電	低周波・低雑音	〃	40*	−40	40	−10 −30*	400	125	1	20	−1	−18	−10	0.2	1.5	−10	−10	7	9		−10	−1		
	2SJ45	〃	低周波	〃	40*	−40	40	−10 −30*	400	125	1	20	−1	−18	−10	0.2	1.5	−10	−10	7	9		−10	−1		
★	2SJ47	日　立	低周波電力増幅	MOS		−100	±14*	−7A*	100W*	150*						0*	−1.5*	−10	−100mA	0.6	(S) 1	1.3	−10	≃−3A		
	2SJ48	〃	〃	〃		−120	±14*	−7A*	100W*	150*						−0.15*	−1.45*	−10	−100mA	0.7	(S) 1	1.4	−10	−3A		
	2SJ49	〃	〃	〃		−140	±14*	−7A*	100W*	150*						−0.15*	−1.45*	−10	−100mA	0.7	(S) 1	1.4	−10	−3A		
	2SJ50	〃	〃	〃		−160	±14*	−7A*	100W*	150*						−0.15*	−1.45*	−10	−100mA	0.7	(S) 1	1.4	−10	−3A		
★	2SJ51	〃	低周波・低雑音	J	40*	−40	40*	−10 −200*	800*	125*	10	40	−6	−50	−10	0.2	1.1	−10	−10	33	40		−10	−5		
	2SJ55	〃	低周波電力増幅	MOS		−180	±20*	−8A*	125W*	150*						−0.15*	−1.45*	−10	−100mA	0.7	(S) 1	1.4				
	2SJ56	〃	〃	〃		−200	±20*	−8A*	125W*	150*						−0.15*	−1.45*	−10	−100mA	0.7	(S) 1	1.4				
	2SJ68	〃	低周波，低雑音	J		−40	40*	−10 −30*	300	150*	10	30	−1.6	−12	−10	0.13	1.5	−10	−10	8	12		−10	−3		
	2SJ69	〃	〃	〃		−40	40*	−10 −30*	300	150*	10	30	−2.5	−20	−10	0.13	1.5	−10	−10	18	21		−10	−3		
	2SJ70	〃	〃	〃		−40	40*	−10 −200*	800	150*	10	30	−6	−50	−10	0.13	1.5	−10	−10	35	45		−10	−5		

電気的特性 (T_a=25°C)																その他	代替品型名	外形	型名	
C_{is} (pF)				C_{rs} (pF)				NF (f=1kHz, R_g=1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)								
typ	max	V_{GS}(V) I_D(mA)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{GD}(V) V_{GS}(V)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)					
2	4	1	0					1		−10	I_{DSS}							2	2SJ11	★
2	4	1	0					0.5		−10								2	2SJ12	★
8	12	1	0					入力換算雑音電圧 5μVmax (V_{DS}=−10V, I_D=−1mA, Δf=10～100Hz, R_g=1MΩ)										35	2SJ13	★
6		1	0					4		−6	−0.5							1	2SJ15	★
6		1	0					4		−6	−0.5							1	2SJ16	★
																S/N=52dB		47	2SJ17	
190		15	0					V_{ON}=−10Vmax (I_G=−0.2A, I_D=−3A, t=100ms)								2SK60とコンプリメンタリ		45	2SJ18	
								μ=10min (V_{DS}=−10V, I_D=−10mA)								2SK69とコンプリメンタリ		41	2SJ19	★
710		−100*	−10													2SK70とコンプリメンタリ		42	2SJ20	★
																S/N=52dB		48	2SJ22	
20		0	−10					(f=100Hz, R_g=100kΩ)	5	−10	−1		I_{DSS}小/I_{DSS}大=0.85min (V_{DS}=−10V) ΔV_{GS}=50mVmax (V_{DS}=−10V, I_D=−1mA)					81	2SJ39	
18		0	−10					$R_{DS(ON)}$=220Ωtyp (f=1kHz, V_{DS}=10mVrms, V_{GS}=0, I_{DSS}=5mA)								2SK381とコンプリメンタリ		151	2SJ40	
22		0	−10	3.6		0*	−10	NV=80mVmax (R_g=100kΩ, Gv=80dB)										80A	2SJ43	
50		0	0	10		0*	−10	NV=20mVmax (指定回路による)										53A	2SJ44	
50		0	−10	10		0*	−10	NV=50mVmax (〃)										53A	2SJ45	
900		−5		40		5*		$V_{DS(sat)}$=−12Vmax (I_D=−7A, V_{GD}=0)								2SK132とコンプリメンタリ		28A	2SJ47	★
900		5	−10	40		5*	−10	〃								2SK133とコンプリメンタリ		28A	2SJ48	
900		5	−10	40		5*	−10	〃								2SK134とコンプリメンタリ		28A	2SJ49	
900		5	−10	40		5*	−10	〃								2SK135とコンプリメンタリ		28A	2SJ50	
								1	3	(R_g=1kΩ) −10	−5					2SK151とコンプリメンタリ	2SJ70	97	2SJ51	★
1,000		5	−10	50		5*	−10	$V_{DS(sat)}$=−12Vmax (I_D=−8A, V_{GD}=0)								2SK175とコンプリメンタリ		28A	2SJ55	
1,000		5	−10	50		5*	−10	〃								2SK176とコンプリメンタリ		28A	2SJ56	
32		0	−10	7.5		0*	−10	V_N=25mVmax										79	2SJ68	
82		0	−10	19		0*	−10	V_N=20mVmax										79	2SJ69	
150		−5*	−10					V_N=10mVmax										97	2SJ70	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)						電気的特性 (Ta=25°C)															
				V_{GDS} V_{GDO}* V_{GDX}** (V)	V_{DSX} V_{DSS}* (V)	V_{GSO} V_{GSS}* V_{GSX}** (V)	I_G I_D* (mA)	P_d P_{ch}* (mW)	T_j T_{ch}* (°C)	I_{GSS} (nA) (pA)* max	V_{GS} (V)	I_{DSS} (mA) min	max	V_{DS} (V)	$V_{GS(off)}$, V_{th}*(V) min	max	V_{DS} (V)	I_D (μA)	g_m (mS) μ* min	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	g_{os} (mS) r_D* (Ω) typ	max
2SJ72	東　芝	低周波，低雑音	J	25			−10	600	125	1	25	−5	−30	−10	0.3	2	−10	−0.1	(IDSS=−5mA) 30	40		10	IDSS		
2SJ73	〃	〃	〃	25			−10	600 unit	125	1	25	−5	−30	−10	0.3	2.0	−10	−0.1	25	40		−10	〃		
2SJ74	〃	〃	〃	25			−10	400	125	1	25	−1	−20	−10	0.15	2.0	−10	−0.1	8	22		−10	〃		
2SJ75	〃	〃	〃	25			−10	400 unit	125	1	25	−2.6	−20	−10	0.15	2.0	−10	−0.1	15	22		−10	〃		
2SJ76	日　立	低高周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		−140	±15*	−500*	30W*	150*						−0.2	−1.5	−10	−10mA	20	35		−20	−10		
2SJ77	〃	〃	〃		−160	±15*	−500*	30W*	150*						−0.2	−1.5	−10	−10mA	20	35		−20	−10		
2SJ78	〃	〃	〃		−180	±15*	−500*	30W*	150*						−0.2	−1.5	−10	−10mA	20	35		−20	−10		
2SJ79	〃	〃	〃		−200	±15*	−500*	30W*	150*						−0.2	−1.5	−10	−10mA	20	35		−20	−10		
2SJ81	〃	低周波電力増幅	〃		−120	±15*	−7A*	100W*	150*						−0.15	−1.45	−10	−100mA	0.7	(S) 1	1.4	−10	−3A		
2SJ82	〃	〃	〃		−140	±15*	−7A*	100W*	150*						−0.15	−1.45	−10	−100mA	0.7	(S) 1	1.4	−10	−3A		
2SJ83	〃	〃	〃		−160	±15*	−7A*	100W*	150*						−0.15	−1.45	−10	−100mA	0.7	(S) 1	1.4	−10	−3A		
2SJ84	松　下	低周波	J	15			−10, −20	200	125	0.1μA	15	−0.5	−12	−10	0.2	3	−10	−10		9		−10	IDSS		
2SJ88																									
2SJ89																									
★2SJ90	東　芝	低周波，低雑音	J	30			−10	200 unit	125	10	30	−2.6	−20	−10	0.2	2.0	−10	−0.1	8	22		−10	IDSS		
★2SJ91	〃	低周波電力増幅	MOS		−140	±8*	−8A*	120W	150*	±1μA	±8				−0.8	−2.4	−10	−100mA	(S) 1	1.5		−10	−2A		
★2SJ92	〃	〃	〃		−140	±8*	−7A	100W	150*	±1μA	±8				−0.8	−2.4	−10	−100mA	(S) 1	1.5		−10	−2A		
2SJ93																									
2SJ94																									
2SJ95																									
2SJ96	日　立	低高周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		−60	±20*	−8A*	100W*	150*	±1μA	±20				−0.2	−1.5	−10	−10mA	1	(S) 1.6	2.5	−10	−3A		
2SJ97																									
2SJ98																									
2SJ99	日　立	低高周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		−140*	±20*	−8A*	100W*	150*	±1μA	±20		−1	−120	−2	−5	−10	−1mA	1	(S) 1.8		−10	−4A		
2SJ100	〃	〃	〃		−160*	±20*	−8A*	100W*	150*	±1μA	±20		−1	−140	−2	−5	−10	−1mA	1	(S) 1.8		−10	−4A		

電気的特性 (Ta=25°C)																その他	代替品型名	外形	型名	
C_{iss} (pF)				C_{rss} (pF)				NF (f=1kHz, R_g=1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)								
typ	max	V_{GS}(V) I_D(mA)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{GD}(V) V_{GS}(V)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)					
185		0	−10	55		10	I_D=0	(R_g=100Ω) 1	2	−10	−5	NF=10dBmax (V_{DS}=−10V, I_D=−5mA, R_g=100Ω, f=100Hz)				2SK147とコンプリメンタリ		74A	2SJ72	
185		0	−10	55		10	I_D=0	1	2	(R_g=100Ω) −10	−5	ΔV_{GS}=20mVmax				2SK146とコンプリメンタリ		98	2SJ73	
105		0	−10	32		10	I_D=0	0.5	2	(R_g=1kΩ) −10	−1					2SK170とコンプリメンタリ		90	2SJ74	
105		0	−10	32		10	I_D=0	0.5	2	(R_g=1kΩ) −10	−1	ΔV_{GS}=20mVmax				2SK240とコンプリメンタリ		99	2SJ75	
120		−10*	−10	4.8		−10mA	−10	$V_{DS(sat)}$=−2Vmax (I_D=−10mA, V_{GD}=0)								2SK213とコンプリメンタリ		116A	2SJ76	
120		−10*	−10	4.8		−10mA	−10	〃								2SK214とコンプリメンタリ		116A	2SJ77	
120		−10*	−10	4.8		−10mA	−10	〃								2SK215とコンプリメンタリ		116A	2SJ78	
120		−10*	−10	4.8		−10mA	−10	〃								2SK216とコンプリメンタリ		116A	2SJ79	
900		5	−10	40		5*	−10	$V_{DS(sat)}$=−12Vmax (I_D=−7A, V_{GD}=0)								2SK225とコンプリメンタリ		117A	2SJ81	
900		5	−10	40		5*	−10	〃								2SK226とコンプリメンタリ		117A	2SJ82	
900		5	−10	40		5*	−10	〃								2SK227とコンプリメンタリ		117A	2SJ83	
22		0	−10															103A	2SJ84	
																			2SJ88	
																			2SJ89	
95		0	−10	29		10			2	(R_g=1kΩ) −10	−1						2SJ109	75	2SJ90	★
1,500		0	−10	90		0*	−10	C_{DS}=460pFtyp (V_{DS}=−10V, V_{GS}=0)									2SJ115	118	2SJ91	★
1,500		0	−10	90		0*	−10	〃									2SJ115	119	2SJ92	★
																			2SJ93	
																			2SJ94	
																			2SJ95	
850		5	−10					$V_{DS(ON)}$=−4Vmax (I_D=−5A, V_{GS}=−15V)								2SK286とコンプリメンタリ		117A	2SJ96	
																			2SJ97	
																			2SJ98	
1,050		0	−10	80		0*	−10	$V_{DS(ON)}$=−2Vmax (I_D=−4A, V_{GS}=−15V)								2SK343とコンプリメンタリ		117B	2SJ99	
1,050		0	−10	80		0*	−10	〃								2SK344とコンプリメンタリ		117B	2SJ100	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C) V_{GDS} V_{GDO}* V_{GDX}** (V)	V_{DSX} V_{DSS}* (V)	V_{GSO} V_{GSS}* V_{GSX}** (V)	I_G I_D* (mA)	P_d P_{ch}* (mW)	T_j T_{ch}* (°C)	電気的特性 (Ta=25°C) I_{GSS} max (nA) (pA)*	V_{GS} (V)	I_{DSS} (mA) min	max	V_{DS} (V)	$V_{GS(off)}$, V_{th}*(V) min	max	V_{DS} (V)	I_D (μA)	g_m (mS) μ* min	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	g_{os} (mS) r_D* (Ω) typ	max
2SJ101	日立	低高周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		−40*	±20*	−5A*	30W*	150*	±1μA	±20		−1	−30	−2	−5	−10	−1mA	0.5	(S) 1		−10	−3A		
2SJ102	〃	〃	〃		−60*	±20*	−5A*	30W*	150*	±1μA	±20		−1	−50	−2	−5	−10	−1mA	0.5	(S) 1		−10	−3A		
2SJ103	東芝	低周波, アナログSW	J	50			−10	300	125	1	30	−1.2	−14	−10	0.3	6	−10	−0.1	1	4		−10	I_{DSS}		
2SJ104	〃	〃	〃	25			−10	400	125	1	25	−2.6	−20	−10	0.2	2	−10	−0.1	(I_{DSS}=−5mA) 12	30		−10	〃		
2SJ105	〃	〃	〃	50			−10	200	125	1	30	−1.2	−14	−10	0.3	6	−10	−0.1	1	4		−10	〃		
2SJ106	〃	〃	〃	50			−10	150	125	1	30	−1.2	−14	−10	0.3	6	−10	−0.1	1	4		−10	〃		
2SJ107	〃	〃	〃	25			−10	200	125	1	25	−2.6	−20	−10	0.2	2	−10	−0.1	(I_{DSS}=−5mA) 12	30		−10	〃		
2SJ108	〃	低周波, 低雑音	〃	25			−10	200	125	1	25	−2.6	−20	−10	0.15	2	−10	−0.1	8	22		−10	〃		
2SJ109	〃	〃	〃	30			−10	200	125	1	30	−2.6	20	−10	0.2	2	−10	−0.1	(I_{DSS}=−3mA) 8	22		−10	〃		
2SJ110	〃	低周波増幅 アナログSW	〃	25			−10	400	125	1	25	−5	−30	−10	0.3	2	−10	−0.1	(I_{DSS}=−15mA) 25	60		−10	〃		
2SJ111	〃	低周波, 低雑音	〃	25			−10	400	125	1	25	−5	−30	−10	0.3	2	−10	−0.1	(I_{DSS}=−5mA) 30	40		−10	〃		
2SJ112	日立	高速度電力SW 高周波電力増幅	MOS		−100*	±20*	−10A*	100W*	150*	±1μA	±20		−1	−80	−2	−5	−10	−1mA	1.5	(S) 2		−10	−5A		
2SJ113	〃	〃	〃		−100*	±20*	−10A*	100W*	150*	±1μA	±20		−1	−80	−2	−5	−10	−1mA	1.5	(S) 2		−10	−5A		
2SJ114	〃	〃	〃		−200*	±20*	−8A*	100W*	150*	±1μA	±20		−1	−160	−2	−5	−10	−1mA	1	(S) 1.8		−10	−4A		
2SJ115	東芝	低周波電力増幅	〃		−160*	±20*	−8A*	100W	150	±1	±20				−0.8	−2.8	−10	100mA	1	(S) 2		−10	−2A		
2SJ116	日立	高速度電力SW 高周波電力増幅	〃		−400*	±20*	−8A*	125W*	150*	±1μA	±20		−1	−320	−2	−5	−10	−1mA	1	(S) 1.6		−20	−4A		
2SJ117	〃	〃	〃		−400*	±20*	−2A*	40W*	150*	±1μA	±20		−1	−320	−2	−5	−10	−1mA	0.4	(S) 0.7		−20	−1A		
2SJ118	〃	〃	〃		−140*	±20*	−8A*	100W*	150*	±1μA	±20		−1	−120	−2	−5	−10	−1mA	1	(S) 1.8		−10	−4A		
2SJ119	〃	〃	〃		−160*	±20*	−8A*	100W*	150*	±1μA	±20		−1	−140	−2	−5	−10	−1mA	1	(S) 1.8		−10	−4A		
2SJ120	〃	〃	〃		−40*	±20*	−2A*	10W*	150*	±1μA	±20		−1	−35	−1	−4	−10	−1mA	0.1	(S) 0.25		−10	−1A		
2SJ121																									
2SJ122	日立	高速度電力SW 高周波電力増幅	MOS		−60*	±20*	−10A*	50W*	150*	±1μA	±20		−1	−50	−2	−5	−10	−1mA	1.5	(S) 2.2		−10	−5A		
2SJ123	東芝	低周波電力増幅 高速SW	〃		−70*	±20*	−10A*	30W	150	±1	±20		−1	−70	−1	−3	−5	−1mA	1	(S) 1.7		−5	−2A		
2SJ124																									
2SJ125	三菱	低周波電力増幅 アナログSW	J	50*			−10	150	125*	1	30	−1	−12	−10	0.3	6	−10	−10	1.5	4		−10	I_{DSS}		

電気的特性 (Ta=25°C)																その他	代替品型名	外形	型名
C_{iss} (pF)				C_{rss} (pF)				NF (f=1kHz, R_g=1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)							
typ	max	V_{GS}(V) I_D(mA)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{GD}(V) V_{GS}(V)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)				
660		0	−10	140		0*	−10	$V_{DS(ON)}$=−1.2Vmax (I_D=−3A, V_{GS}=−15V)								2SK345とコンプリメンタリ		116B	2SJ101
660		0	−10	140		0*	−10	〃								2SK346とコンプリメンタリ		116B	2SJ102
18		0	−10	3.6		10	I_D=0	$R_{DS(ON)}$=270Ω typ (V_{DS}=−10mV, V_{GS}=0, I_{DSS}=−5mA)								2SK246とコンプリメンタリ		82B	2SJ103
105		0	−10	32		10	I_D=0	$R_{DS(ON)}$= 40Ω typ (〃)								2SK364とコンプリメンタリ		82C	2SJ104
18		0	−10	3.6		10	I_D=0	$R_{DS(ON)}$=270Ω typ (〃)								2SK330とコンプリメンタリ		70A	2SJ105
18		0	−10	3.6		10	I_D=0	$R_{DS(ON)}$=270Ω typ (〃)										105A	2SJ106
105		0	−10	32		10	I_D=0	$R_{DS(ON)}$= 40Ω typ (〃)								2SK366とコンプリメンタリ		70B	2SJ107
105		0	−10	32		10	I_D=0	(f=10Hz, R_g=1kΩ) 1	10	−10	−1					2SK370とコンプリメンタリ		70B	2SJ108
95		0	−10	25		10	I_D=0	(f=10Hz, R_g=1kΩ) 1.5	11	−10	−1	ΔV_{GS}=20mVmax				2SK389とコンプリメンタリ		148	2SJ109
185		0	−10	55		10	I_D=0	$R_{DS(ON)}$=20Ω typ (V_{DS}=10mV, V_{GS}=0, I_{DSS}=−15mA)								2SK363とコンプリメンタリ		82C	2SJ110
185		0	−10	55		10	I_D=0	(R_g=100Ω) 1	2	−10	−5					2SK369とコンプリメンタリ		82C	2SJ111
1,100		0	−10	90		0*	−10	$V_{DS(ON)}$=−1.75Vmax (I_D=−5A, V_{GS}=−15V)								2SK398とコンプリメンタリ		28B	2SJ112
1,100		0	−10	90		0*	−10	〃								2SK399とコンプリメンタリ		149	2SJ113
1,000		0	−10	70		0*	−10	$V_{DS(ON)}$=−3.2Vmax (I_D=−4V, V_{GS}=−15V)								2SK400とコンプリメンタリ		149	2SJ114
800		0	−10	110		0*	−10	$V_{DS(ON)}$=−7Vmax (I_D=−5A, V_{GS}=−10V)								2SK405とコンプリメンタリ		119	2SJ115
1,400		0	−10	25		0*	−10	$V_{DS(ON)}$=−9Vmax (I_D=−4A, V_{GS}=−15V)								2SK298とコンプリメンタリ		28B	2SJ116
520		0	−10	15		0*	−10	$V_{DS(ON)}$=−7Vmax (I_D=−1A, V_{GS}=−15V)								2SK310とコンプリメンタリ		116B	2SJ117
1,050		0	−10	80		0*	−10	$V_{DS(ON)}$=−2Vmax (I_D=−4A, V_{GS}=−15V)								2SK413とコンプリメンタリ		149	2SJ118
1,050		0	−10	80		0*	−10	〃								2SK414とコンプリメンタリ		149	2SJ119
150		0	−10	25		0*	−10	$V_{DS(ON)}$=−1.5Vmax (I_D=−1A, V_{GS}=−15V)								2SK416とコンプリメンタリ		150	2SJ120
																			2SJ121
1,200		0	−10	170		0*	−10	$V_{DS(ON)}$=−1Vmax (I_D=−5A, V_{GS}=−15V)								2SK428とコンプリメンタリ		116B	2SJ122
650		0	−10	250		0*	−10	$V_{DS(ON)}$=−2.8Vmax (I_D=−7A, V_{GS}=−15V)								2SK442とコンプリメンタリ		138	2SJ123
																			2SJ124
18		0	−10					$R_{DS(ON)}$=220Ω typ (f=1kHz, V_{DS}=10mVrms, V_{GS}=0, I_{DSS}=5mA)										152	2SJ125

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)						電気的特性 (Ta=25°C)															
				V_{GDS} V_{GDO}* V_{GDX}** (V)	V_{DSX} V_{DSS}* (V)	V_{GSO} V_{GSS}* V_{GSX}** (V)	I_G I_D* (mA)	P_d P_{ch}* (mW)	T_j T_{ch}* (°C)	I_{GSS} (nA) (pA)* max		I_{DSS} (mA)			$V_{GS(off)}$, V_{th}*(V)				g_m (mS) μ*				g_{os} (mS) r_D* (Ω)		
											V_{GS} (V)	min	max	V_{DS} (V)	min	max	V_{DS} (V)	I_D (μA)	min	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	typ	max
2SJ126	東芝	DC-DCコンバータ	MOS		−60*		−10A*	40W							(V_{th}) −1.5	−3.5		−1mA		(S) 2.5		−10	−5A		
2SJ127																									
2SJ128																									
2SJ129																									
2SJ130																									
2SJ131																									
2SJ132																									
2SJ133																									
2SJ134																									
2SJ135																									
2SJ136																									
2SJ137																									
2SJ138																									
2SJ139																									
2SJ140																									
2SJ141																									
2SJ142																									
2SJ143																									
2SJ144																									
★ 2SJ49Ⓗ	日立	高速度電力SW	MOS		−140	±14*	−7A*	100W*	150*						−0.15	−1.45	−10	−100mA	0.7	(S) 1	1.4				
★ 2SJ50Ⓗ	〃	〃	〃		−160	±14*	−7A*	100W*	150*						−0.15	−1.45	−10	−100mA	0.7	(S) 1	1.4				
2SJ56Ⓗ	〃	高周波電力増幅 高速度電力SW	〃		−200	±20*	−8A*	125W*	150*				−3	−160	−0.55	−3	−10	−100mA	0.7	(S) 1	1.4	−10	−3A		
2SJ77Ⓚ	〃	〃	〃		−160	±15*	−500*	30W*	150*						−0.2*	−1.5*	−10	−10mA	20	35		−20	−10		
2SJ79Ⓚ	〃	〃	〃		−200	±15*	−500*	30W*	150*						−0.2*	−1.5*	−10	−10mA	20	35		−20	−10		
M46F	松下	低周波	J	30	−30		−30*	250	125				−20	−10						8		10	I_{DSS}		

電気的特性 (Ta=25°C)																その他	代替品型名	外形	型名	
C_{iss} (pF)				C_{rss} (pF)				NF (f=1kHz, R_g=1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)								
typ	max	V_{GS}(V) I_D(mA)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{GD}(V) V_{GS}(V)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)					
								$R_{DS(ON)}$=0.4Ω max (I_D=−5A, V_{GS}=−10V)											2SJ126	
																			2SJ127	
																			2SJ128	
																			2SJ129	
																			2SJ130	
																			2SJ131	
																			2SJ132	
																			2SJ133	
																			2SJ134	
																			2SJ135	
																			2SJ136	
																			2SJ137	
																			2SJ138	
																			2SJ139	
																			2SJ140	
																			2SJ141	
																			2SJ142	
																			2SJ143	
																			2SJ144	
900		5	−10	40		5*	−10	$V_{DS(sat)}$=−12Vmax (I_D=−7A, V_{GD}=0)								2SK134Ⓗとコンプリメンタリ		28A	2SJ49Ⓗ	★
900		5	−10	40		5*	−10	〃								2SK135Ⓗとコンプリメンタリ		28A	2SJ50Ⓗ	★
1,200		5	−10	60		5		$V_{DS(ON)}$=−6Vmax (I_D=−4A, V_{GS}=−15V)										28A	2SJ56Ⓗ	
120		−10*	−10	4.8		−10mA	−10	$V_{DS(sat)}$=−2Vmax (I_D=−10mA, V_{GD}=0)										116A	2SJ77Ⓚ	
120		−10*	−10	4.8		−10mA	−10	〃										116A	2SJ79Ⓚ	
								2.5		(R_g=1kΩ) 10	−1					M47Fとコンプリメンタリ			M46F	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C) V_{GDS} V_{GDO}* V_{GDX}** (V)	V_{DSX} V_{DSS}* (V)	V_{GSO} V_{GSS}* V_{GSX}** (V)	I_G I_D* (mA)	P_d P_{ch}* (mW)	T_j T_{ch}* (°C)	電気的特性 (Ta=25°C) I_{GSS} max (nA) (pA)*	V_{GS} (V)	I_{DSS} (mA) min	max	V_{DS} (V)	$V_{GS(off)}$, V_{th}*(V) min	max	V_{DS} (V)	I_D (μA)	g_m (mS) μ* min	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	g_{os} (mS) r_D* (Ω) typ	max
2N4392	日　電	SW，チョッパ	J	−40*	40	−40	50	300	200	−100*	−20	(パルス測定) 25	75	20	−2	−5	20	1nA							
2N4393	〃	〃	〃	−40*	40	−40	50	300	200	−100*	−20	(パルス測定) 5	30	20	−0.5	−3	20	1nA							
2SK11	東　芝	DC，低周波チョッパ	〃	−20			10	100	150	−1	−10	0.3	6.5	10	−0.5	−6.0	10	0.1	0.7		3.2	10	IDSS		
2SK12	〃	〃	〃	−20			10	100	150	−0.1	−10	0.45	5.0	10	−0.65	−4.5	10	0.1	0.8		3.2	10	〃		
★2SK13	〃	DC，低周波チョッパ	〃	−12			10	100	150	−0.1	−10	0.45	5.0	10	−0.65	−4.5	10	0.1	0.8		3.2	10	〃		
2SK15	〃	DC，低周波，低雑音	〃	−20			10	100	150	−0.1	−10	0.45	5.0	10	−0.65	−5.0	10	0.1	0.8		3.2	10	〃		
2SK16Ⓗ	日　立	高入力インピーダンス増幅	〃			−20*	10，10*	100*	150*	−1	−6	0.5	7.0	6	−0.5	−5.0	6	0.1	1	3	6	6	〃		
★2SK17	東　芝	オーディオ	〃	−20			10	100	125	−1	−10	0.3	6.5	10	−0.5	−6.0	10	0.1	0.7	2.0		10	〃		
2SK18	〃	DC	〃	−40			10	200	150	IG −0.1	VDS=10V ID=0.4mA	0.45	2.8	10	−0.65	−3.5	10	0.1	0.8		3	10	〃		
2SK18A	〃	〃	〃	−40			10	200	150	IG −0.1	VDS=10V ID=0.4mA	0.45	2.8	10	−0.65	−3.5	10	0.1	0.8		3	10	〃		
★2SK19TM	〃	FM，VHF	〃	−18*			10	200	125	−10	−1	3	24	10	−1.2		10	1		7		10	〃		
2SK23A-8 2SK23A-9	ソニー	DC，VHF	〃	−27* −40*		−9	10，20*	250	100	−10	−6	2.7	12.1	10	−0.45	−3.85	10	30	2.7			10	〃	(100MHz) 0.05	
★2SK24	三　洋	低周波 AM/RF	〃	−40	40*	−40	10	100	125	−10	−10	0.6	24	10		−6	10	10	1.5		12	10	〃		
★2SK25	〃	FM，RF，MIX	〃	−18	18*	−18	10	100	125	−100	−10	0.6	24	10		−7.2	10	10		6		10	〃		
★2SK30	東　芝	低周波	〃	−50			10	100	125	−1	−30	0.3	6.5	10	−0.4	−5.0	10	0.1	1.5			10	〃		
2SK30ATM	〃	低周波，低雑音	〃	−50			10	100	125	−1	−30	0.3	6.5	10	−0.4	−5.0	10	0.1	1.2			10	〃		
2SK33	三　菱	FM，VHF	〃	−20*			10	150	125*	−100	−1	2.5	20	10	−1	−8	10	10	4.5	7		10	〃		
2SK34	〃	低周波，低雑音	〃	−50*			10	150	125*	−10	−10	0.3	12	10	−0.3	−6.0	10	10	1.0	3		10	〃	0.01	
2SK37	日　電	FM，RF/MIX	〃	−20*		−15	10，20*	100	125*	−10	−10	0.5	6	5	−0.3	−4.5	5	10	1.5	2		5	0.5		
★2SK38	三　菱	煙感知器，DC	MOS		20	±10	20*	100	100*	−1*	−10	0.4	5	10		−9	10	10	0.5	0.8		10	1	0.01	
2SK38A	〃	〃	〃		20	±10	20*	100	100*	−1*	−10	0.1	7	10		−5	10	10	1	1.5		10	1	0.02	
★2SK39	ソニー	エレクトレットマイクロフォン	J	−20*						−0.25	−0.1	〔IDSO〕 0.035	0.564	9					0.09		0.55	9			
★2SK39A	〃	コンデンサ・マイク	〃	−20*		−0.5	0.5，1*	10	85	−0.25	0.1	〔IDSO〕 0.048	0.564	9					0.11		0.67	9			
2SK40	日　立	低周波，低雑音	〃	−50		−50*	10	100*	150*	−10	−30	0.6	6.5	15	−0.4	−5.0	15	0.1	1			15			
2SK41	三　洋	FM，RF/MIX	〃	−18			10	200	125	−10	−1	0.6	24	10			10	10		7		10	IDSS		

電気的特性 (T_a=25°C)																その他	代替品型名	外形	型名	
C_{iss} (pF)				C_{rss} (pF)				NF (f=1kHz, R_g=1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)								
typ	max	V_{GS}(V) I_D(mA)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{GD}(V) V_{GS}(V)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)					
9	14	0	20	2.7	3.5	−7*	0	$r_{DS(ON)}$=60Ω max (V_{GS}=0, I_D=6mA)										73	2N4392	
10	14	0	20	3	3.5	−5*	0	$r_{DS(ON)}$=100Ω max (V_{GS}=0, I_D=1mA)										73	2N4393	
3	5	−10	0															2	2SK11	
3	5	−10	0						3	10	0.45							2	2SK12	
2.3	3.5	−10	0						2	10	0.45						2SK12	2	2SK13	★
3	5	−10	0					(R_g=10kΩ)	3	10	0.45	$V_{N(P.P)}$=4μVmax (V_{DS}=5V, I_D=0.45mA, R_g=10kΩ, Δf=5~50Hz)						2	2SK15	
9		−1	6	2		−6	0	0.15μV/√Hz		6	0.5					R_{ON}=350Ω typ (V_{DS}=0.1V, V_{GS}=0)		3	2SK16⊕	
4	6	0	0	1.2	2.0	−10	0	1		10	I_{DSS}						2SK30ATM	7	2SK17	★
4.5	6	V_{GD}=0		2.0	2.5	−10	0	Δ|V_{GS1}−V_{GS2}|/ΔTa=100μV/°C max (V_{DS}=10V, I_D=200μA, Ta=0~60°C)										19	2SK18	
4.5	6			2	2.5	−10	0	Δ|V_{GS1}−V_{GS2}|/ΔTa=20μV/°C max (V_{DS}=10V, I_D=200μA, Ta=0~60°C)										19	2SK18A	
4		0	0	0.45	0.65	−10						2.0	3.5	10 (V_{DD})		PG=20dB typ (f=100MHz)	2SK192A	82A	2SK19TM	★
5		0	10	1.8		0*	10	13nV/√Hz		10	I_{DSS}	2		10	I_{DSS}	PG=18dB typ (f=100MHz)		5	2SK23A-8 2SK23A-9	
7.4			10	2.0			10	1	2.5	10		NF=10dB max (f=30Hz, R_g=1MΩ, V_{DS}=10V)					2SK44SP	6	2SK24	★
				1.1		0*	10					2.5		10	3	PG=21dB typ (f=100MHz)	2SK41NP	6	2SK25	★
8.2		0	0	2.6		−10	0	(f=120Hz, R_g=100kΩ) 0.5	5.0	15	I_{DSS}						2SK30ATM	7	2SK30	★
8.2		0	0	2.6		−10	0	(f=120Hz, R_g=100kΩ) 0.5	5.0	15	I_{DSS}							82B	2SK30ATM	
				0.5		0*	10					2.5		10	I_{DSS}	PG=20dB typ (f=100MHz)		153A	2SK33	
8		0	10	1.5		0*	10	(f=100Hz, R_g=100kΩ) 3.0	6.0	10	0.1							153B	2SK34	
				1	1.5	0*	5											10	2SK37	
6		0	0																2SK38	★
8		0	0															11	2SK38A	
																		12	2SK39	★
								S/N=50dB min (V_{DS}=9V, C_{in}=100pF, V_{in}=−60dBS, f=1kHz)									2SK93	12	2SK39A	★
6.7		0	15	1.6		0*	15	(f=120Hz, R_g=100kΩ) 1	5	15	I_{DSS}							13	2SK40	
				0.35	0.75	0*	10						3.5	10	3	PG=22dB typ (f=100MHz) (2SK41NPを名称変更したため同型名で旧タイプのものがある。45ページ参照)		57A	2SK41	

	型　名	社 名	用　　途	構造	最大定格 (Ta=25°C) V_{GDS} V_{GDO}* V_{GDX}** (V)	V_{DSX} V_{DSS}* (V)	V_{GSO} V_{GSS}* V_{GSX}** (V)	I_G I_D* (mA)	P_d P_{ch}* (mW)	T_j T_{ch}* (°C)	電気的特性 (Ta=25°C) I_{GSS} max (nA) (pA)*	V_{GS} (V)	I_{DSS} (mA) min	max	V_{DS} (V)	$V_{GS(off)}$, V_{th}*(V) min	max	V_{DS} (V)	I_D (μA)	g_m (mS) μ* min	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	g_{os} (mS) r_D* (Ω) typ	max
★	(旧)2SK41	三　洋	FM, RF/MIX	J	−18*			10	150	125	−10	−1	0.6	24	10			10	10		7		10	IDSS		
	2SK42	ソニー	FM/AM, RF	〃	−10*	10		10 (IS)	50	65			1	5	4	−0.3		4	100	3.5	5.5		4	〃		
	2SK43	〃	低周波, 低雑音	〃	−30*		−30	5,20*	300	100*	−1	−15	0.9	14.3	10	−0.18	−1.49	10	30	6.3			10	〃		
	2SK43Ⓢ	〃	DC, 低周波	〃	−30*		−30	5,20*	300	100	−0.1	−15	0.9	14.3	10	−0.18	−1.49	10	30	6.3			10	〃		
	2SK43Ⓢ-D	〃	DC, アナログSW	〃	−30*		−30	5,20*	300	100	−0.1	−15	8.1	14.3	10	−0.72	−1.49	10	30	14			10	〃		
	2SK44	三　洋	低周波, 低雑音	〃	−20	20*		10	100	125	−1	−10	0.06	3	10		−4	10	1	0.6	2		10	〃		
★	(旧)2SK44	〃	低周波, 低雑音	〃	−20	20*		10	100	125	−1	−3	0.06	3	10		−4	10	1	0.6	2		10	〃		
★	2SK45	日　電	DC, 高周波	〃	−22*	20	−22	10,20*	100	150	−10	−10	0.5	6	5	−0.3	−4.5	5	10	1.5	2		5	0.5		
	2SK46	三　菱	コンデンサ・マイク	〃	−30*			10	150	125	−10	−10	0.3	3	10	−0.3	−5	10	10	1	3		10	IDSS	0.01	
★	2SK47	日　電	低周波・高周波	〃	−20*		−15	10,20*	200	125	−10	−10	0.5	6	5	−0.3	−4.5	5	10	1.5	2		5	0.5		
	2SK48	東　芝	低周波, 低雑音	〃	−20			10	100	150	−0.1	−10	0.3	3	10	−0.35	−2.3	10	0.1	1		5	10	IDSS		
	2SK49	日　電	FM, RF	〃	−20*			10,10*	72 (60°C)	80	−50	−0.5	0.5	6	5		−2.5	5	10	1.9	5.5		5	〃		
★	2SK50	松　下	エレクトレット コンデンサ・マイク	〃	−10*	10		2, 2*	20	80			0.07 (RL=2.2kΩ)	1.0	4.5					0.35 (RL=2.2kΩ)			4.5	0 (VGS)		
	2SK54	日　立	VHF, RF/MIX	〃	−15*			10	150*	125*	−10	−0.5	0.8	5	10	−0.3	−5.5	10	10	3	6		10	IDSS		
	2SK55	〃	〃	〃	−18*			10	150*	125*	−10	−0.5	3	14	10	−0.3	−5.5	10	10	3	8		10	〃		
★	2SK56	松　下	VHF, RF	〃	−10	10		10,10*	100	125	−0.5μA	−1	0.7	10	5		−4	5	10		4		5	〃		
	2SK57	日　電	高周波増幅	〃	−20*		−15	10,20*	100	125	−10	−10	0.5	6	5	−0.3	−4	5	10	1.5	2		5	0.5		
	2SK58	ソニー	DC, VHF	〃	−27*		−9	10,20*	270	100	−10	−6	1	16.5	10	−0.45	−4.95	10	30	2.7			10	IDSS		
★	2SK59	日　立	エレクトレット コンデンサ・マイク	〃	−30		−30*	10	50	125*	−1	−10	0.3	1.4	10	−0.4	−5	10	0.1	1			10	〃		
	2SK60	ソニー	低周波電力増幅	J(V)	−170*		分類有	(A)* 0.5, 5	63W	120	IDGO 100μA	VDG 100				−7.5	−25	60	100mA		4*		20	1A	16Ω*	
	2SK61-LV	東　芝	FM, VHF	J	−18*			10	200	125	−10	−0.5	1	6	10	−0.4	−4	10	1		9		10	IDSS		
	2SK63	ソニー	小信号電圧増幅	J(V)	−120*		−10	20 200*	470	120	−200	−6					−9.5	100	300		14		50	4	0.5	
	2SK65	松　下	低周波インピーダンス変換	J	−12*	12		2, 2*	20	80			(RS=2.2kΩ) 0.04	0.8	4.5					(RS=2.2kΩ) 0.3	0.5		4.5	VGS 0		
	2SK66	〃	低周波, 低雑音	〃	−55*			10	100	125	−100	−30	0.3	6.5	10	−0.4	−5	10	0.1	1.2			10	IDSS		
	2SK67	日　電	エレクトレット コンデンサ・マイク	〃	−20*	20		10,10*	80	100			0.02	1			−0.8	5	1		1.5		5	〃		

電気的特性 (T_a=25℃)																その他	代替品型名	外形	型名	
C_{is} (pF)				C_{rs} (pF)				NF (f=1kHz, R_g=1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)								
typ	max	V_{GS}(V) I_D(mA)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{GD}(V) V_{GS}(V)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)					
				0.35	0.75	0*	10						3.5	10	3	PG=22dB typ (f=100MHz)	2SK41	14	(旧)2SK41	★
				0.085	0.12		4						2.5	4	I_{DSS}	PG=12dB min (f=100MHz)		15	2SK42	
13		0	10	2.4		0*	10	13nV/$\sqrt{Hz}$		(R_g=10kΩ) 10	I_{DSS}							16	2SK43	
13		0	10	2.4		0*	10	13nV/$\sqrt{Hz}$		(R_g=10kΩ) 10	I_{DSS}							16	2SK43Ⓢ	
13		0	10	2.4		0*	10	13nV/$\sqrt{Hz}$		(R_g=10kΩ) 10	I_{DSS}					R_{ON}=80Ω max (V_{DS}=0.1V, V_{GS}=0)		16	2SK43Ⓢ-D	
																(2SK44SPを名称変更したため同型名で旧タイプのものがある。)		58A	2SK44	
																	2SK44	28	(旧)2SK44	★
4	5.5	0	5	1	1.5	0*	5	(f=1MHz) 1.5		5	0.5							30	2SK45	★
8		0	10	1.5		0*	10	(f=100Hz, R_g=100kΩ) 3	6	10	0.1							20	2SK46	
4.5		0	5	1.5	2	0*	5											18	2SK47	★
5	8	−10	0					(f=120Hz, R_g=100kΩ) 0.5	5	10	0.45		$V_{N(P.P)}$=4μVmax (V_{DS}=5V, I_D=0.45mA, R_g=10kΩ, Δf=5～50Hz)					2	2SK48	
5	6.5	0	5	0.07	0.25	0*	5					3.5	6	5	I_{DSS}	PG=18dB typ (f=100MHz)		40	2SK49	
								V_N=4μVmax (V_{DS}=4.5V, R_L=2.2kΩ, C_O=7oF)									2SK65	80D	2SK50	★
3		0	10	0.4	0.6	0*	10					2.0	3.5	10 (V_{DD})		PG=15dB typ (f=100MHz)		37A	2SK54	
3		0	10	0.4	0.6	0*	10					2.0	3.5	10 (V_{DD})		PG=18dB typ (f=100MHz)		37A	2SK55	
4		0	5	0.1		0*	5						4.5	5	1	PG=12dB min (f=100MHz)	2SK83	80D	2SK56	★
																			2SK57	
				2		0*	10			ΔV_GS=100mVmax (V_{DS}=10, I_D=1mA)								49	2SK58	
								(f=120Hz, R_g=100kΩ) 0.5	3	10	I_{DSS}							50	2SK59	★
190		−15	0					V_{ON}=10Vmax (I_G=0.2A, I_D=3A, t=100ms)								2SJ18とコンプリメンタリ		45	2SK60	
				0.1	0.25	−5						2.5	3.5	(V_{DD}) 10		PG=18dB typ (f=100MHz)		82A	2SK61-LV	
16		4	50					(f=10Hz, R_g=500kΩ)	30	50	4	μ=15min 30typ (V_{DS}=50V, I_D=40mA)						51	2SK63	
								NV=4μVmax (V_{DS}=4.5V, Rs=2.2kΩ, C_G=10pF)										52	2SK65	
8.2		0	0	2.6		−10	0	(f=120Hz, R_g=100kΩ) 0.5	5	15								80D	2SK66	
5.5		0	5					C_{OS}=2.7pF typ (V_{DS}=5V, V_{GS}=0)										60	2SK67	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)						電気的特性 (Ta=25°C)															
					V_{GDS} V_{GDO}* V_{GDX}** (V)	V_{DSX} V_{DSS}* (V)	V_{GSO} V_{GSS}* V_{GSX}** (V)	I_G I_D* (mA)	P_d P_{ch}* (mW)	T_j T_{ch}* (°C)	I_{GSS} (nA) (pA)*	max V_{GS} (V)	I_{DSS} (mA) min	max	V_{DS} (V)	$V_{GS(off)}$, V_{th}*(V) min	max	V_{DS} (V)	I_D (μA)	g_m (mS) μ* min	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	g_{os} (mS) r_D* (Ω) typ	max
	2SK67A	日電	エレクトレットコンデンサ・マイク	J	−20*	20		10,10*	80	100			0.02	0.54	5		−0.8	5	1		1.5		5	I_{DSS}		
	2SK68	〃	低周波	〃	−50*		−50	10,20*	250	125	−1	−20	0.5	12	10	−0.13	−1.5	10	10	4	12		10	〃		
	2SK68A	〃	低周波，低雑音	〃	−50*		−50	10,20*	250	125	−1	−20	0.5	12	10	−0.13	−1.5	10	10	4	12		10	〃		
★	2SK69	〃	低周波ドライバ	J(V)	−140*	140	−30	20,100*	800	150	−10μA	−20	1.8	48	5						30*		10	10	1.5	
★	2SK70	〃	低周波電力増幅	〃	−100*	100	−40	100 10A*	100W	150	−100μA	−30	3A	8A	5	−5.5	−16.5	35	50mA	2*	4*		10	1A	6*	
	2SK72	東芝	DC	J	−20			10	200	150	I_G −0.1	V_{DS}=10V I_D=0.4mA	0.6	6.5	10	−0.5	−3.3	10	0.1	1.5		6.5	10	I_{DSS}		
	2SK73	松下	低周波(高電圧)	〃	−200*	50		100*	5W	150				100	30					8			30	〃		
	2SK79	ソニー	小信号電圧増幅	J(V)	−120*		−10	20,200*	750	120	−200	−6					−9.5	100	300		14		50	4	0.5	
	2SK83	松下	VHF/RF	J	−25*	23		15,15*	100	150	−50	−1	0.5	12	5		−3	5	10	1.9	4		5	I_{DSS}		
	2SK84	〃	低周波，低雑音	〃	−55*			10	100	125	−100	−30	0.3	6.5	10	−0.4	−5	10	0.1	1.2			10	〃		
	2SK85	日電	Xバンド低雑音増幅・発振	GaAs SB	−10*	5		100*	500	125			30	100	3	−1.5		3	100					fosc		
★	2SK87Ⓗ	日立	低周波，低雑音	J	−50		−50*	10	100*	150*	−10	−30	0.3	6.5	15	−0.4	−5	15	0.1	1			15	I_{DSS}(max)=5.5GHz (typ)		
	2SK88																									
★	2SK89	日立	低周波電力増幅																							
	2SK90																									
	2SK91																									
	2SK92	日電	エレクトレットコンデンサ・マイク	J	−20*	20		10,10*	80	100			0.02	1			−0.8	5	1		1.5		5	I_{DSS}(max)=5.5GHz (typ)		
	2SK93	ソニー	〃	〃	−20*		−0.5	0.5	10	85	−0.25	−0.1	(I_{DSO}) 0.018	0.564	9					0.11		0.67	9			
	2SK94	日電	低周波，アナログSW	〃	−50*	50	−50	10,20*	150	125	−5	−20	0.5	12	10	−0.13	−1.5	10	10	4	12		10	I_{DSS}		
	2SK95																									
	2SK96																									
	2SK97	ソニー	DC，低周波	J	−30*		−30	5,20*	210	100*	−1	−15	0.9	14.3	10	−0.18	−1.49	10	30	6.3			10	I_{DSS}		
	2SK98																									
	2SK99																									
	2SK100																									

電気的特性 (Ta=25°C)																その他	代替品型名	外形	型名	
C_{is} (pF)				C_{rs} (pF)				NF (f=1kHz, R_g=1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)								
typ	max	V_{GS}(V) I_D(mA)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{GD}(V) V_{GS}(V)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)					
5.5		0	5					C_{OS}=2.7pF typ (V_{DS}=5V, V_{GS}=0)										60	2SK67A	
13		0	10	2.6		0*	10											53A	2SK68	
13		0	10	2.6		0*	10	(R_g=1kΩ) 0.6	1.5	10	I_{DSS}					NF=5dB typ (V_{DS}=10V, V_{GS}=0, R_g=1kΩ, f=10Hz)		53A	2SK68A	
								μ=10min(V_{DS}=10V, I_D=10mA)								2SJ19とコンプリメンタリ		41	2SK69	★
430		100*	10													2SJ20とコンプリメンタリ	2SK389	42	2SK70	★
	9	−10	0					(f=120Hz, R_g=100kΩ) 0.5	5	10	0.45	ΔV_{GS}=10mVmax (V_{DS}=10V, I_D=0.05, 0.2, 0.4mA)						43	2SK72	
																		54	2SK73	
16		4*	50					(f=10Hz, R_g=500kΩ)	30	50	4	μ=15min 30typ (V_{DS}=50V, I_D=4mA)						55	2SK79	
4		0	5	0.07	0.15	0*	5						3.5	5	1	PG=12dB min (f=100MHz)		80B	2SK83	
8.2		0	0	2.6		−10	0	(f=120Hz, R_g=100Ω) 0.5	5	15								52	2SK84	
												(f=8GHz) 3.5	4.5	3	10	MAG=11dB typ (f=8GHz)		56	2SK85	
7.2		0	15	2.1		0*	15	(f=120Hz, R_g=100kΩ) 1	5	15	I_{DSS}							61	2SK87Ⓗ	★
																			2SK88	
																			2SK89	★
																			2SK90	
																			2SK91	
5.5		0	5					C_{OS}=2.7pF typ (V_{DS}=5V, V_{GS}=0)										18	2SK92	
								S/N=50dB min (V_{DS}=9V, Cg=100pF, 1kHz, V_{IN}=−60dB)										62	2SK93	
13		0	10	2.6		0*	10											78	2SK94	
																			2SK95	
																			2SK96	
				2.4			10											49	2SK97	
																			2SK98	
																			2SK99	
																			2SK100	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C) V_{GDS} V_{GDO}* V_{GDX}** (V)	V_{DSX} V_{DSS}* (V)	V_{GSO} V_{GSS}* V_{GSX}** (V)	I_G I_D* (mA)	P_d P_{ch}* (mW)	T_j T_{ch}* (°C)	電気的特性 (Ta=25°C) I_{GSS} (nA) (pA)* max	V_{GS} (V)	I_{DSS} (mA) min	max	V_{DS} (V)	$V_{GS(off)}$, V_{th}*(V) min	max	V_{DS} (V)	I_D (μA)	g_m (mS) μ* min	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	g_{os} (mS) r_D* (Ω) typ	max
2SK101																									
2SK102																									
2SK103	日電	エレクトレットコンデンサ・マイク	J	−20*	20		10,10*	80	100			0.02	1			−0.8	5	1		1.5		5	I_{DSS}		
2SK104	〃	高周波，低周波	〃	−30*		−30	10,20*	250	125	−10	−30	0.5	12	5	−0.25	−4.5	5	10	1.5	4.1		5	〃		
2SK105	〃	低周波	〃	−50*	50	−50	10,20*	250	125	−1	−30	0.5	12	5	−0.25	−4.5	5	10	1.5	2.1		5	0.5		
★ 2SK106	日立	低周波，低雑音	〃			−50*	10,20*	300*	125*	−10	−30	0.5	12	10	−0.13	−1.5	10	10	4.5	13		10	I_{DSS}		
2SK107	ソニー	DC，VHF	〃	−27*		−9	10,20*	250	100	−10	−6	2.7	12.1	10	−0.45	−3.85	10	30	2.7			10	〃		
2SK108	三菱	低周波，低雑音 アナログSW	〃	−50*		−50	10,20*	300	125*	−1	−30	1	12	10		−3	10	10	6	15		10	〃		
★ 2SK109	〃	低周波，低雑音	〃	−50*		−50	10,20*	150 unit	125*	−1	−30	1	12	10		−3	10	10	6	12		10	〃	0.01	
2SK110	〃	〃	〃	−30*		−30	10,50*	900	125*	−1	−20	2.5	35	5		−2	5	10	35	45		5	5		
2SK111	〃	〃	〃	−30*		−30	10,50*	200 unit	125*	−1	−20	2.5	35	5		−2	5	10	35	45		5	5		
2SK112	東芝	DC，低雑音 チョッパSW	〃	−50			10	250	150	−0.1	−30	1.2	9	15	−0.25	−1.2	15	0.1	7		34	15	I_{DSS}		
2SK113	〃	アナログSW チョッパSW	〃	−50			10	250	150	−0.1	−20	5	150	20	−0.3	−10	20	0.1							
2SK114																									
2SK115																									
2SK116																									
2SK117	東芝	低周波，低雑音	J	−50			10	300	125	−1	−30	1.2	14	10	−0.2	−1.5	10	0.1	4	15		10	I_{DSS}		
2SK118	〃	コンデンサ・マイク	〃	−50			10	100	125	−1	−30	0.3	6.5	10	−0.4	−5.0	10	0.1	1.2			10	〃		
2SK119	日電	DC，アナログSW	〃	−30*	30	−30	10,20*	250	150	−0.1	−20	0.5	12	10	−0.2	−4.5	10	10	1.0	4.2		10	〃		
2SK120	ソニー	VHF, RF, MIX	〃	−15*			10*	200	85			1	5	4	−0.3		4	100	3.5	5.5		4	〃		
2SK121	〃	DC，低雑音 SW	〃	−30*		−50	5,20*	300	100	−1	−15	0.9	14.3	10	−0.18	−1.49	10	30	6.3			10	〃		
2SK122																									
2SK123	松下	エレクトレットコンデンサ・マイク	J	−20*	20		2.2*	200	100			0.13	0.47	4.5					0.9	1.6		4.5	I_{DSS}		
2SK124	日電	Xバンド 低雑音増幅・発振	GaAs SB	−8*	5		100*	500	125			30	100	3	−1		3	100							
2SK125	ソニー	UHF, RF, MIX	J	−25*		−25	10,100*	500*	120*	−10	−15	30	75	10	−2	−6	10	100	10	14		10	10		

電気的特性 (Ta=25°C)																その他	代替品型名	外形	型名	
C_{iss} (pF)				C_{rss} (pF)				NF (f=1kHz, R_g=1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)								
typ	max	V_{GS}(V) I_D(mA)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{GD}(V) V_{GS}(V)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)					
																			2SK101	
																			2SK102	
5.5		0	5					C_{OS}=2.7pF typ (V_{DS}=5V, V_{GS}=0)										63	2SK103	
4.1	6	0	10	0.9	1.3	0*	10											40	2SK104	
4.1	6.0	0	10	0.9	1.3	0*	10											53A	2SK105	
								V_N=−130dB max								2SK106Aも廃止	2SK186	79	2SK106	★
5		0	10	1.8			10	(R_g=10kΩ) 0.1		10	I_{DSS}	2		10	I_{DSS}	PG=18dB typ (f=100MHz)		62	2SK107	
20		0	10					(f=100Hz, R_g=1kΩ) 1	2.5	10	1					$R_{DS(ON)}$=70Ω typ (f=1kHz, V_{GS}=10mVrms / V_{GS}=0, I_{DSS}=5mA)		153B	2SK108	
20		0	10	(f=100Hz, R_g=10kΩ)	1	10	1	ΔVGS=50mVmax (V_{DS}=10V, I_D=1mA)						84	2SK109	★
55		5*	5					1	(R_g=100Ω) 2	5	5					$R_{DS(ON)}$=18Ω typ (f=1kHz, V_{DS}=10mVrms / V_{GS}=0, I_{DSS}=10mA)		154	2SK110	
55		5*	5					(R_g=100Ω) 1	2	5	5	ΔVGS=30mVmax (V_{DS}=5V, I_D=5mA)						84	2SK111	
12		0	15	3		0*	15	(R_g=1kΩ) 1	2	15	1					NF=10dB max (V_{DS}=15V, I_D=1mA / f=10Hz, R_g=1kΩ)		69	2SK112	
10	14	0	20	3	5		0									$R_{DS(ON)}$=100Ω max (V_{GS}=0, I_D=1mA)		69	2SK113	
																			2SK114	
																			2SK115	
																			2SK116	
13		0	10	3		−10	I_D=0	(R_g=1kΩ) 1	2	10	0.5					NF=10dB max (V_{DS}=10V, I_D=0.5mA / R_g=1kΩ, f=10Hz)		82C	2SK117	
8.2		0	10		2.6	−10	I_D=0	(f=120Hz, R_g=100kΩ) 0.5	5	15	I_{DSS}							70A	2SK118	
4.8	6.0	0	10	1.2	1.5	0*	10											71	2SK119	
4.6		0	4	0.14	0.17		4					1.9	2.5	4	I_{DSS}	PG=16dB typ (f=100MHz)		64	2SK120	
13		0	10	2.4		0*	10	0.1	(R_g=10kΩ)	10	I_{DSS}							62	2SK121	
																			2SK122	
												NV=4μVmax (V_D=4.5V, R_L=2.2kΩ, C_o=10pF)						131	2SK123	
(f_{osc}) max=80GHz typ												(f=12GHz) 3	4	3	10	MAG=11dB typ (f=12GHz)		56	2SK124	
				2.6	3	−10						(ゲート接地) 1.8	2.5	10 (V_{DG})	10	PG=12.5dB typ ゲート接地 (f=100MHz)		72	2SK125	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)						電気的特性 (Ta=25°C)																
				V_{GDS} V_{GDO}* V_{GDX}** (V)	V_{DSX} V_{DSS}* (V)	V_{GSO} V_{GSS}* V_{GSX}** (V)	I_G I_D* (mA)	P_d P_{ch}* (mW)	T_j T_{ch}* (°C)	I_{GSS} max (nA) (pA)*	V_{GS} (V)	I_{DSS} (mA) min	I_{DSS} (mA) max	V_{DS} (V)	$V_{GS(off)}$, V_{th}*(V) min	max	V_{DS} (V)	I_D (μA)	g_m (mS) μ* min	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	g_{os} (mS) r_D* (Ω) typ	max
2SK126																									
2SK127	松 下	低周波	J	−50*		−50	20*	250	125			0.5	12	10					3			10	I_{DSS}		
2SK128	〃	低周波，低雑音	〃	−30*	30	−30	10, 20*	250	125	−100	−30	0.5	12	10	−0.1	−1.5	10	10	4	12		10	〃		
2SK129																									
2SK130	日 電	低周波，アナログSW	J	−30*	30	−30	10, 50*	250	125	−1	−20	5	30	5		−1.5	5	10	28			5	I_{DSS}		
2SK131	〃	低周波，低雑音	〃	−30*	30	−30	10, 50*	250 unit	125	−1	−20	5	30	5		−1.5	5	10	28	32		5	5		
★ 2SK132	日 立	低周波電力増幅	MOS		100	±14*	7A*	100W*	150*						0	1.5	10	100mA	0.6	(S) 1	1.3	10	3A		
2SK133	〃	〃	〃		120	±14*	7A*	100W*	150*						0.15*	1.45*	10	100mA	0.7	(S) 1	1.4	10	3A		
2SK134	〃	〃	〃		140	±14*	7A*	100W*	150*						0.15*	1.45*	10	100mA	0.7	(S) 1	1.4	10	3A		
2SK135	〃	〃	〃		160	±14*	7A*	100W*	150*						0.15*	1.45*	10	100mA	0.7	(S) 1	1.4	10	3A		
2SK136	松 下	低周波，低雑音	J	−30*	30	−30	10, 20*	250	125	−100	−20	0.5	20	10	−0.1	−2	10	10	5	21		10	I_{DSS}		
2SK137 2SK137A	〃	〃	〃	−15*	15		50*	100	125				40	5						80		5	I_{DSS}		
2SK138	日 電	Xバンド，RF，OSC	GaAs SB		5	−10	100*	300	125*	−1μA	−5	30	100	3	−1.5		3	100	15	27		3	10		
2SK139											−20														
2SK140	日 電	Xバンド，RF，OSC	GaAs SB		5	−8	100*	300	125	−10μA	−5	30	100	3	−1.0		3	100	20	35		3	10		
2SK141 2SK141A	〃	DC，アナログSW	J	−30*	30	−30	10, 20*	250	150	−100* / −5*	−20	0.5	12	10	−0.2	−4.5	10	10	1.0	4.2		10	I_{DSS}		
2SK142																									
2SK143																									
2SK144																									
2SK145																									
2SK146	東 芝	低周波，低雑音	J	−40			10	600 unit	125	−1	−30	5	30	10	−0.3	−1.2	10	0.1	(I_{DSS}=5mA) 30	40		10	5		
2SK147	〃	〃	〃	−40			10	600	125	−1	−30	5	30	10	−0.3	−1.2	10	0.1	(I_{DSS}=5mA) 30	40		10	I_{DSS}		
2SK148	松 下	VHF，RF	〃	−25	23		10, 10*	100	125				12	5					1.9			5	〃		
2SK149	日 電	UHF, RF, MIX	〃	−20*		−10	10, 35*	350	150	−50	−8	8	32	10	−0.35	−2.2	10	10		30		10	〃		
★ 2SK150	東 芝	低周波，低雑音	〃	−50			10	200 unit	125	−1	−30	1	14	10	−0.3	−2	10	0.1	5	12		10	3		

電気的特性 (Ta=25°C)																その他	代替品型名	外形	型名	
C_{is} (pF)				C_{rs} (pF)				NF (f=1kHz, R_g=1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)								
typ	max	V_{GS}(V) I_D(mA)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{GD}(V) V_{GS}(V)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)					
																			2SK126	
9		0	10	2		−3*	10	NV=80mVmax (V_{DS}=10V, I_D=1mA, R_g=100kΩ)								2SJ43とコンプリメンタリ		80	2SK127	
14		0	10	3.5		0*	10	0.6	(R_g=1kΩ) 1.5	10	I_{DSS}							80A	2SK128	
																			2SK129	
55		5*	10	10		5mA	10											53A	2SK130	
55		5*	10	10		5mA	10	NV=35mVmax, I_{DSS}小/I_{DSS}大=0.9min, ΔV_{GS}=20mVmax										109	2SK131	
600		5		10		−5*		$V_{DS(sat)}$=12Vmax (I_D=7A, V_{GD}=0)								2SJ47とコンプリメンタリ		28A	2SK132	★
600		−5	10	10		−5*	10	〃								2SJ48とコンプリメンタリ		28A	2SK133	
600		−5	10	10		−5*	10	〃								2SJ49とコンプリメンタリ		28A	2SK134	
600		−5	10	10		−5*	10	〃								2SJ50とコンプリメンタリ		28A	2SK135	
13		−3	10	5		−3*	10		(R_g=1kΩ) 1	10	I_{DSS}							80A	2SK136	
																		83	2SK137 2SK137A	
(fosc) max=55GHz typ												2.6	(f=8GHz) 3.5	3	10	MAG=12dB typ (f=8GHz)		100	2SK138	
																			2SK139	
(fosc) max=80GHz typ												2.7	(f=12GHz) 3.5	3	10	MAG=11dB typ (f=12GHz)		100	2SK140	
4.8	6.0	0	10	1.2	1.5	0	10											73	2SK141 2SK141A	
																			2SK142	
																			2SK143	
																			2SK144	
																			2SK145	
75		0	10	15		−10	I_D=0	1	(R_g=100Ω) 2	10	5	ΔV_{GS}=20mVmax (V_{DS}=10V, I_D=5mA) 2SJ73とコンプリメンタリ						85	2SK146	
75		0	10	15		−10	I_D=0	1	(R_g=100Ω) 2	10	5	NF=10dB max (V_{DS}=10V, I_D=5mA, R_g=100Ω, f=100Hz) 2SJ72とコンプリメンタリ						74A	2SK147	
												2.5		5	1			101	2SK148	
7.5		3*	10	2		3mA	10					(ゲート接地, f=400MHz) 2		10	3	(ゲート接地) PG=12dB typ (f=400MHz)		102A	2SK149	
15		0	10	3		−10			(R_g=1kΩ) 2		1	ΔV_{GS}=30mVmax				NF=10dB max (V_{DS}=10V, I_D=1mA, R_g=1kΩ, f=10Hz)	2SK272	75	2SK150	★

型　名	社 名	用　途	構造	最大定格 (Ta=25°C) V_{GDS} V_{GDO}^* V_{GDX}^{**} (V)	V_{DSX} V_{DSS}^* (V)	V_{GSO} V_{GSS}^* V_{GSX}^{**} (V)	I_G I_D^* (mA)	P_d P_{ch}^* (mW)	T_j T_{ch}^* (°C)	電気的特性 (Ta=25°C) I_{GSS} (nA) (pA)*	max V_{GS} (V)	I_{DSS} (mA) min	max	V_{DS} (V)	$V_{GS(off)}$, V_{th}^* (V) min	max	V_{DS} (V)	I_D (μA)	g_m (mS) μ^* min	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	g_{os} (mS) r_D^* (Ω) typ	max
★ 2SK151	日　立	低周波，低雑音	J	−40*	40	−40*	10, 200*	800*	125	−10	−40	6	50	10	−0.2	−1.1	10	10	33	40		10	5		
2SK152	ソニー	高周波/低周波，低雑音	〃	−15*		−15	5,50*	300	100	−2	−7	9.5	42	5	−0.55	−2	5	100	21	30		5	I_{DSS}		
2SK153																									
2SK154	松　下	VHF，RF	J	−20*	20		10,30*	350	125				18	10					2.5			10	I_{DSS}		
2SK155	〃	低周波，低雑音	〃	−20*		−20	30*	400	125	−100	−20	0.5	30	10	−0.1	−1.5	10	10	8	45		10	〃		
2SK156	三　洋	コンデンサ・マイク	〃	−20*			10	100	125			0.06	1.5	10											
★ 2SK157	日　立	低周波	〃			−50*	10,20*	150*	125*	−10	−30	0.5	12	10	−0.13	−1.5	10	10	4.5	10		10	I_{DSS}		
2SK158	松　下	〃	〃	−55			10	70	125				6.5	10						1.2		10	〃		
2SK159																									
2SK160	日　電	低周波，VHF	J	−30*		−30	10,20*	150	125	−10	−30	0.5	12	5	−0.25	−4.5	5	10	1.5	2.1		5	0.5		
2SK161	東　芝	FM，VHF	〃	−18*			10	200	125	−10	−0.5	1	10	10	−0.4	−4	10	1		9		10	I_{DSS}		
2SK162	日　電	低周波，低雑音	〃	−40*	40	−40	10,50*	400	125	−1	−20	5	30	5		−1.2	5	10	40	45		5	5		
2SK163	〃	〃	〃	−50*	50	−50	10,30*	400	125	−1	−20	1	18	10	−0.2	−1.2	10	10	7	9		10	1		
2SK164																									
2SK165	松　下	広帯域低雑音ビデオカメラ	J	−15*		−15	5,50*	300	100*	−2	−7	8	32	5		−3	5	100	3	14		5	I_{DSS}		
2SK166																									
2SK167																									
2SK168	日　立	VHF，RF，MIX，OSC	J	−30*		−1*	10,20*	200*	150*	−10	−0.5	4	20	5		−3	5	10	8	10		5	I_{DSS}		
2SK169	松　下	低周波，低雑音	〃	−15	15		50*	400	125				50	5											
2SK170	東　芝	〃	〃	−40			10	400	125	−1	−30	2.6	20	10	−0.2	−1.5	10	0.1		22		10	I_{DSS}		
2SK171	三　菱	〃	〃	−20*		−20	10,80*	200 unit	125*	−1	−10	5	60	5		−2	5	10		10		5	8		
2SK172																									
2SK173																									
2SK174																									
2SK175	日　立	低周波電力増幅	MOS		180	±20*	8A*	125W*	150*						0.15*	1.45*	10	100mA	0.7	(S) 1	1.4	10	3A		

電気的特性 (Ta=25°C)																その他	代替品型名	外形	型名	
C_{is} (pF)				C_{rs} (pF)				NF (f=1kHz, R_g=1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)								
typ	max	V_{GS}(V) I_D(mA)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{GD}(V) V_{GS}(V)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)					
								(R_g=200Ω) 0.5	1	10	5					2SJ51とコンプリメンタリ	2SK190	97	2SK151	★
8	9	0	5					e_n (R_g=0) 1.2nV/√Hz		5	10	(ゲート接地) 1.8		5	10			57A	2SK152	
																			2SK153	
												1.5		10				80B	2SK154	
40		−3	10	17		−3*	10					e_n=0.7nV/√Hz typ (V_{DS}=10V, V_{GS}=0, f=1kHz)						80A	2SK155	
	Z_{in}=20MΩ min (f=1kHz)							V_{NO}=−110dB (V_{IN}=0)										58A	2SK156	
																	2SK323	87A	2SK157	★
								(f=120Hz)	5	15								103	2SK158	
																			2SK159	
4.1		0	10	0.9		0*	10											78A	2SK160	
					0.15	−10						2.5	3.5	10 (V_{DD})		PG=18dB typ (f=100MHz)		70C	2SK161	
55		0	10	10		0*	10	(f=100Hz, R_g=100Ω) 1.1	2.5	5	5							53A	2SK162	
13		0	10	3.2		0*	10	NV=20mVmax (指定回路による)										53A	2SK163	
																			2SK164	
7.5		0	5															80C	2SK165	
																			2SK166	
																			2SK167	
6.8		0	5	0.1		0*	5					1.7		5	I_{DSS}	PG=27dB typ (f=100MHz)		89	2SK168	
																			2SK169	
30		0	10	6		I_D=0	10	0.5	(R_g=1kΩ) 2	10	1	NF=10dB max (V_{DS}=10V, I_D=1mA, R_g=1kΩ, f=10Hz)						82C	2SK170	
200		5*	5					(f=100Hz, R_g=100Ω)	1	5	5	ΔV_{GS}=50mVmax (V_{DS}=5V, I_D=5mA)						84	2SK171	
																			2SK172	
																			2SK173	
																			2SK174	
700		−5	10	8		−5*	10	$V_{DS(sat)}$=12Vmax (I_D=8A, V_{GD}=0)								2SJ55とコンプリメンタリ		28A	2SK175	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)						電気的特性 (Ta=25°C)															
				V_{GDS} V_{GDO}* V_{GDX}** (V)	V_{DSX} V_{DSS}* (V)	V_{GSO} V_{GSS}* V_{GSX}** (V)	I_G I_D* (mA)	P_d P_{ch}* (mW)	T_j T_{ch}* (°C)	I_{GSS} (nA) (pA)* max	V_{GS} (V)	I_{DSS} (mA) min	I_{DSS} (mA) max	V_{DS} (V)	$V_{GS(off)}$, V_{th}*(V) min	max	V_{DS} (V)	I_D (μA)	g_m (mS) μ* min	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	g_{os} (mS) r_D* (Ω) typ	max
2SK176	日　立	低周波電力増幅	MOS		200	±20*	8A*	125W*	150*						0.15*	1.45*	10	100mA	0.7	(S) 1	1.4	10	3A		
2SK177																									
2SK178																									
2SK179																									
2SK180																									
2SK181																									
2SK182																									
2SK183																									
2SK184	東　芝	低周波，低雑音	J	−50			10	200	125	−1	−30	0.6	14	10	−0.2	−1.5	10	0.1	4	15		10	I_{DSS}		
2SK185	ソニー	低周波，低雑音 RF	〃	−30*		−30	5，20*	320	100*	−1	−15	0.9	14.3	10	−0.18	−1.49	10	30	6.3			10	〃		
2SK186	日　立	低周波，低雑音	〃		40	−40*	10，30*	300*	150*	−10	−30	1.6	12	10	−0.13	−1.5	10	10	8	12		10	3		
2SK187	〃	〃	〃		40	−40*	10，30*	300*	150*	−10	−30	2.5	20	10	−0.13	−1.5	10	10	18	21		10	3		
2SK188																									
★2SK189	日　立	低周波，低雑音																							
2SK190	〃	〃	J	−40*	40	−40*	10 200*	800*	150*	−10	−30	6	50	10	−0.13	−1.5	10	10	37	45		10	5		
2SK191	〃	〃	〃	−15*	15	−15*	10 500*	1W*	150*	−1	−8	10	200	5		−3	10	10	75	100		10	8		
2SK192A	東　芝	FM，VHF，RF	〃	−18*			10	200	125	−10	−1	3	24	10	−1.2	−3	10	1		7		10	I_{DSS}		
2SK193	日　電	FM，RF	〃	−20*	20		10，10*	250	150	−100	−0.5	0.5	8	5		−2.5	5	10	2.3	3.5		5	0.5		
2SK194	〃	低周波，低雑音	〃	−40*	40	−40	10，50*	400 unit	125	−1	−20	5	24	5		−1.2	5	10	40	45		5	5		
2SK195	〃	FM，RF	〃	−20*	20		10，10*	250	125	−100	−0.5	0.5	8	5		−2.5	5	10	2.3	3.5		5	0.5		
2SK196Ⓗ	日　立	高周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		160*	±14	500*	800*	150*				2	120	0.2*	2*	10	10mA	50			10	200		
2SK197	〃	VHF，RF，MIX	J	−18*			10，20*	150*	150*	−10	−0.5	2	14	10	−0.3	−4	10	10	3	8		10	I_{DSS}		
2SK198	松　下	低周波	〃	−30*	30		10，20*	150	125	−100	−30	0.5	12	10	−0.1	−1.5	10	10	4	12		10	〃		
2SK199	〃	VHF，RF	〃		15		15，15*	100	125				12	5					1.9			5	〃		
2SK200																									

電気的特性（Ta=25°C）																その他	代替品型名	外形	型名
C_{iss} (pF)				C_{rss} (pF)				NF (f=1kHz, R_g=1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)							
typ	max	V_{GS}(V) I_D(mA)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{GD}(V) V_{GS}(V)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)				
700		−5	10	8		−5*	10	$V_{DS(sat)}$=12Vmax (I_D=8A, V_{GD}=0)								2SJ56とコンプリメンタリ		28A	2SK176
																			2SK177
																			2SK178
																			2SK179
																			2SK180
																			2SK181
																			2SK182
																			2SK183
13		0	10	3		−10	I_D=0	(f=10Hz, R_g=1kΩ) 5	10	10	0.5							70B	2SK184
				2.4		0*	10	e_m=13nV/$\sqrt{Hz}$ typ (V_{DS}=10V, V_{GS}=0, R_g=10kΩ, f=1kHz), ΔV_{GS}=30mVmax (V_{DS}=10V, I_D=1mA)										86	2SK185
20		0	10	3.7		0*	10	e_n=1.3nV/$\sqrt{Hz}$ typ (V_{DS}=10V, I_D=3mA, R_g=0, f=1kHz)										79	2SK186
41		0	10	8		0*	10	e_n=1nV/$\sqrt{Hz}$ typ (V_{DS}=10V, I_D=3mA, R_g=0, f=1kHz)										79	2SK187
																			2SK188
																	2SK190		2SK189 ★
75		5*	10					e_n=0.75nV/$\sqrt{Hz}$ typ (V_{DS}=10V, I_D=5mA, R_g=0, f=1kHz)										97	2SK190
								1.1		(R_g=20Ω) 10	8							97	2SK191
					0.65	−10						1.8	3.5	10 (V_{DD})		PG=24dB typ (f=100MHz)		70C	2SK192
5	6.5	0	5	0.07	0.25	0*	5					3	6	5 (V_{DD})		PG=21dB typ (f=100MHz)		104A	2SK193
55		0	10	10		0*	10	NV=35mVmax（指定回路）				ΔV_{GS}=20mVmax (V_{DS}=5V, I_D=5mA)						109	2SK194
5	6.5	0	5	0.07	0.25	0*	5					3	6	5 (V_{DD})		PG=21dB typ (f=100MHz)		40	2SK195
90		10*	10					t_{on}=20ns typ, t_{off}=30ns typ (V_{GS}=10V, I_D=200mA, R_L=150Ω)										121A	2SK196㊥
3.4		0	10	0.38		0*	10											87B	2SK197
14		0	10	3.5		0*	10											103A	2SK198
																		103	2SK199
																			2SK200

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)						電気的特性 (Ta=25°C)															
				V_{GDS} V_{GDO}* V_{GDX}** (V)	V_{DSX} V_{DSS}* (V)	V_{GSO} V_{GSS}* V_{GSX}** (V)	I_G I_D* (mA)	P_d P_{ch}* (mW)	T_j T_{ch}* (°C)	I_{GSS} (nA) (pA)*	max V_{GS} (V)	I_{DSS} (mA) min	max	V_{DS} (V)	$V_{GS(off)}$, V_{th}* (V) min	max	V_{DS} (V)	I_D (μA)	g_m (mS) μ* min	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	g_{os} (mS) r_D* (Ω) typ	max
2SK201	日電	C～Xバンド中出力増幅発振	GaAs		10	−10	400*	1.3W	175	−3μA	−5	180	400	3	−3	−7	3	1mA	35	50		3	100		
2SK202																									
2SK203	日電	C～Xバンド中出力増幅発振	GaAs		10	−10	180*	0.8W	175	−1.5μA	−5	90	180	3	−3	−7	3	500	18	30		3	50		
2SK204																									
2SK205																									
2SK206																									
2SK207																									
2SK208	東芝	コンデンサ・マイク	J	−50			10	100	125	−1	−30	0.3	6.5	10	−0.4	−5	10	0.1	1.2			10	I_{DSS}		
2SK209	〃	低周波	〃	−50			10	150	125	−1	−30	0.6	14	10	−0.2	−1.5	10	0.1	4	15		10	〃		
2SK210	〃	VHF, RF	〃	−18			10	100	125	−10	−1	3	24	10	−1.2	−3	10	1		7		10	〃		
2SK211	〃	FMチューナ VHF, RF	〃	−18*			10	150	125	−10	−0.5	1	10	10	−0.4	−4	10	1		9		10	〃		
2SK212	三洋	FM, RF	〃	−20*			10,20*	200	125	−10	−0.5	0.6	12	5		−2.5	5	10	2	6		5	〃		
2SK213	日立	低/高周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		140	±15*	500*	30W*	150*						0.2*	1.5*	10	10mA	20	40		20	10		
2SK214	〃	〃	〃		160	±15*	500*	30W*	150*						0.2*	1.5*	10	10mA	20	40		20	10		
2SK215	〃	〃	〃		180	±15*	500*	30W*	150*						0.2*	1.5*	10	10mA	20	40		20	10		
2SK216	〃	〃	〃		200	±15*	500*	30W*	150*						0.2*	1.5*	10	10mA	20	40		20	10		
2SK217	〃	VHF, RF	J	−30*			10,20*	150*	150*	−10	−0.5	2.5	12	5		−2.5	5	10		8		5	I_{DSS}		
2SK218	松下	ビデオカメラ	〃	−15*		−15	5,50*	300	100	−2	−7	5	42	5		−3	5	100	15	30		5	〃		
2SK219																									
2SK220Ⓗ	日立	高周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		160*	±20*	8A*	100W*	150*				1	120	0.4*	3*	10	10mA	600	900		10	3A		
2SK221Ⓗ	〃	〃	〃		200*	±20*	8A*	100W*	150*				1	160	0.4*	3*	10	10mA	600	900		10	3A		
2SK222	三洋	低周波・低雑音	J	−40	40*		10	300	125	−1	−20	0.6	12	10		(typ) −0.5	10	10		17		10	I_{DSS}		
2SK223	〃	高電圧ドライブ	〃	−80	80*		10	400	125	−1	−30	1.2	24	30	(typ) −0.75		30	10		20		30	〃		
2SK224																									
2SK225	日立	低周波電力増幅	MOS		120	±15*	7A*	100W*	150*						0.15*	1.45*	10	100mA	0.7	(S) 1	1.4	10	3A		

電気的特性 (Ta=25°C)																その他	代替品型名	外形	型名
C_{iss} (pF)				C_{rss} (pF)				NF (f=1kHz, R_g=1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)							
typ	max	V_{GS}(V) I_D(mA)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{GD}(V) V_{GS}(V)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)				
												(f=8GHz) 3		4	15	MAG=9dB typ (f=8GHz)		120	2SK201
																			2SK202
												(f=8GHz) 2.6		4	10	MAG=11dB typ (f=8GHz)		120	2SK203
																			2SK204
																			2SK205
																			2SK206
																			2SK207
8.2		0	10	2.6		−10	I_D=0	0.5	(f=120Hz, R_g=100kΩ)	15	I_{DSS}							105A	2SK208
13		0	10	3		−10	I_D=0	1	(R_g=1kΩ)	10	0.5							105A	2SK209
					0.65	−10						1.8	3.5	(V_{DD}) 10		PG=24dB typ (f=100MHz)		105B	2SK210
					0.15	−10						2.5	3.5	(V_{DD}) 10		PG=18dB typ (f=100MHz)		105B	2SK211
4		0	5	0.04	0.15	0*	5					3.5	6	(V_{DD}) 5	I_{DSS}	PG=21dB typ (f=100MHz)		58B	2SK212
90		10*	10	2.2		10mA	10	$V_{DS(sat)}$=2Vmax (I_D=10mA, V_{GD}=0)								2SJ76とコンプリメンタリ		116A	2SK213
90		10*	10	2.2		10mA	10	〃								2SJ77とコンプリメンタリ		116A	2SK214
90		10*	10	2.2		10mA	10	〃								2SJ78とコンプリメンタリ		116A	2SK215
90		10*	10	2.2		10mA	10	〃								2SJ79とコンプリメンタリ		116A	2SK216
				0.1		0*	5											87B	2SK217
8		0	5															80C	2SK218
																			2SK219
600		−5	10		(I_D=2A, V_{GS}=15V, R_L=15Ω) t_{on}=25ns typ, t_{off}=45ns typ													28A	2SK220Ⓗ
600		−5	10		〃													28A	2SK221Ⓗ
14		0	10	3.5		0*	10	1	(f=100Hz, R_g=1kΩ) 3	10	I_{DSS}							57B	2SK222
12		0	30	2.5		0*	30	1	(R_g=10kΩ)	10	3							57B	2SK223
																			2SK224
600		−5	10	10		−5*	10	t_{on}=180ns typ, t_{off}=60ns typ (V_{DD}=20V, I_D=4A)								2SJ81とコンプリメンタリ		117A	2SK225

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)						電気的特性 (Ta=25°C)															
				V_{GDS} V_{GDO}* V_{GDX}** (V)	V_{DSX} V_{DSS}* (V)	V_{GSO} V_{GSS}* V_{GSX}** (V)	I_G I_D* (mA)	P_d P_{ch}* (mW)	T_j T_{ch}* (°C)	I_{GSS} (nA) (pA)* max	V_{GS} (V)	I_{DSS} (mA) min	max	V_{DS} (V)	$V_{GS(off)}$, V_{th}*(V) min	max	V_{DS} (V)	I_D (μA)	g_m (mS) μ* min	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	g_{os} (mS) r_D* (Ω) typ	max
2SK226	日立	低周波電力増幅	MOS		140	±15*	7A*	100W*	150*						0.15*	1.45*	10	100mA	0.7	(S) 1	1.4	10	3A		
2SK227	〃	〃	〃		160	±15*	7A*	100W*	150*						0.15*	1.45*	10	100mA	0.7	(S) 1	1.4	10	3A		
2SK228																									
2SK229																									
2SK230																									
2SK231																									
2SK232																									
2SK233																									
2SK234																									
2SK235																									
2SK236																									
2SK237																									
2SK238	日電	FMチューナ	J	−20*	20		10, 10*	150	125	−100	−0.5	0.5	8	5		−2.5	5	10	2.3	3.5		5	0.5		
2SK239																									
2SK240	東芝	低周波，低雑音	J	−40			10	400 unit	125	−1	−30	2.6	20	10	−0.2	−1.5	10	0.1	15	22		10	I_{DSS}		
2SK241	〃	FM，VHF	MOS		20	±5	30*	200	125*	±50	±5	1.5	14	10		−2.5	10	100	1.5	10		10	〃		
2SK242	三洋	高周波電力増幅	J	−20*			10, 20*	150	125	−10	−0.5	0.6	12	5		−2.5	5	10	2	6		5	〃		
2SK243																									
2SK244																									
2SK245																									
2SK246	東芝	DC,インピーダンス変換，定電流回路	J	−50			10	300	125	−1	−30	1.2	14	10	−0.7	−6	10	0.1	1.5			10	I_{DSS}		
2SK247	松下	広帯域低雑音増幅	〃	−15*		−15	5, 20*	150	100*	−2	−7	0.5	12	5		−3	5	100	3			5	〃		
2SK248																									
2SK249																									
2SK250																									

電気的特性 (Ta=25°C)																	代替品型名	外形	型名
C_{is} (pF)				C_{rs} (pF)				NF (f=1kHz, R_g=1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)				その他			
typ	max	V_{GS}(V) I_D(mA)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{GD}(V) V_{GS}(V)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)				
600		−5	10	10		−5*	10	t_{on}=180ns typ, t_{off}=60ns typ (V_{DD}=20V, I_D=4A)								2SJ82とコンプリメンタリ		117A	2SK226
600		−5	10	10		−5*	10	〃								2SJ83とコンプリメンタリ		117A	2SK227
																			2SK228
																			2SK229
																			2SK230
																			2SK231
																			2SK232
																			2SK233
																			2SK234
																			2SK235
																			2SK236
																			2SK237
5	6.5	0	5	0.07	0.25	0*	5					3		5		PG=21dB typ (f=100MHz)		78B	2SK238
																			2SK239
30		0	10	6		−10	I_D=0	(f=10Hz, R_g=1kΩ) 1	10	10	1					2SJ75とコンプリメンタリ		110	2SK240
3		0	10	0.035	0.05	0*	10					1.7	3	10	I_{DSS}	PG=28dB typ (f=100MHz)		70C	2SK241
4		0	5	0.04	0.15	0*	5					3.5	6	5	I_{DSS}	PG=24dB typ (f=100MHz)		126B	2SK242
																			2SK243
																			2SK244
																			2SK245
9		0	10	2.5		−10	I_D=0											82B	2SK246
7.5		0	5															103A	2SK247
																			2SK248
																			2SK249
																			2SK250

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)						電気的特性 (Ta=25°C)															
				VGDS VGDO* VGDX** (V)	VDSX VDSS* (V)	VGSO VGSS* VGSX** (V)	IG ID* (mA)	Pd Pch* (mW)	Tj Tch* (°C)	IGSS (nA) (pA)* max	VGS (V)	IDSS (mA) min	IDSS (mA) max	VDS (V)	VGS(off), Vth*(V) min	max	VDS (V)	ID (μA)	gm (mS) μ* min	typ	max	VDS (V)	ID (mA)	gos (mS) rD* (Ω) typ	max
2SK251																									
2SK252																									
2SK253																									
2SK254																									
2SK255																									
2SK256																									
2SK257																									
2SK258Ⓗ	日立	高周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		250*	±20*	8A*	125W*	150*				1	200	0.4*	3*	10	10mA	0.9	1.3 (S)		10	3A		
2SK259Ⓗ	〃	〃	〃		350*	±20*	5A*	125W*	150*				1	280	0.4*	3*	10	10mA	0.6	1 (S)		20	3A		
2SK260Ⓗ	〃	〃	〃		400*	±20*	5A*	125W*	150*				1	320	0.4*	3*	10	10mA	0.6	1 (S)		20	3A		
★ 2SK261	〃	低周波電力増幅																							
★ 2SK262	〃	〃																							
★ 2SK263	〃	〃																							
★ 2SK264	〃	〃																							
2SK265																									
2SK266	東芝	コンデンサ・マイク インピーダンス変換	J	−15*			10	100	125	ID=0.6mAmax (VDD=6V, RL=1kΩ, ゲート, ソース；15pF ショート)															
2SK267																									
2SK268																									
2SK269																									
★ 2SK270	東芝	低周波，低雑音	J	−40			10	300 unit	125	−10	−30	1	20	10	−0.2	−2	10	0.1	8	20		10	3		
★ 2SK271	〃	低周波電力増幅	MOS		140	±8	8A*	120W	150*	±1μA	±8				0.8	2.4	10	0.1A	1	1.5 (S)		10	2A		
★ 2SK272	〃	〃	〃		140	±8	7A*	100W	150*	±1μA	±8				0.8	2.4	10	0.1A	1	1.5 (S)		10	2A		
★ 2SK273	三菱	S～Xバンド 低雑音増幅	GaAs		8	−6	100*	300	150			30	100	3	−1	−5	3	100	20	30		3	30		
★ 2SK274	〃	〃	〃		8	−6	100*	300	150			30	100	3	−1	−5	3	100	25	35		3	30		
★ 2SK275	〃	〃	〃		8	−6	100*	300	150			30	100	3	−1	−5	3	100	25	35		3	30		

電気的特性 (Ta=25°C)																					
C_{iss} (pF)				C_{rss} (pF)				NF (f=1kHz, R_g=1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)				その他	代替品型名	外形	型名	
typ	max	V_{GS}(V) I_D(mA)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{GD}(V) V_{GS}(V)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)					
																			2SK251	
																			2SK252	
																			2SK253	
																			2SK254	
																			2SK255	
																			2SK256	
																			2SK257	
800		−5	10					t_{on}=25ns typ, t_{off}=140ns typ (I_D=2A, V_{GS}=15V)										28A	2SK258Ⓗ	
800		−5	10	15		−5		〃										28A	2SK259Ⓗ	
800		−5	10	15		−5		〃										28A	2SK260Ⓗ	
																	2SK213/214		2SK261	★
																	〃		2SK262	★
																	〃		2SK263	★
																	〃		2SK264	★
																			2SK265	
Z_{in}=200MΩ min (V_{DD}=6V, C_g=15pF, R_L=1kΩ, f=50Hz)								V_N=40mVmax (V_{DD}=6V, R_L=1kΩ, G_V=80dB, C_g=15pF)										155	2SK266	
																			2SK267	
																			2SK268	
																			2SK269	
25		0	10	5.5		−10		(R_g=1kΩ)	2	10	1	ΔV_{GS}=30mVmax (V_{DS}=10V, I_D=1mA)						75	2SK270	★
800		0	10	60		0*	10	$V_{DS(sat)}$=8Vmax (I_D=5A, V_{GS}=8V)								2SJ91とコンプリメンタリ	2SK405	118	2SK271	★
800		0	10	60		0*	10	〃								2SJ92とコンプリメンタリ	2SK405	119	2SK272	★
最大発振周波数 50GHz typ												(f=12GHz) 4.5		3	10	(MGF-1400)		122	2SK273	★
〃 70GHz typ												(f=12GHz) 3		3	10	(MGF-1402)		122	2SK274	★
〃 70GHz typ												(f=4GHz) 0.8	1	3	10	(MGF-1412)		122	2SK275	★

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C) V_{GDS} V_{GDO}* V_{GDX}** (V)	V_{DSX} V_{DSS}* (V)	V_{GSO} V_{GSS}* V_{GSX}** (V)	I_G I_D* (mA)	P_d P_{ch}* (mW)	T_j T_{ch}* (°C)	電気的特性 (Ta=25°C) I_{GSS} max (nA) (pA)*	V_{GS} (V)	I_{DSS} (mA) min	max	V_{DS} (V)	$V_{GS(off)}$, V_{th}*(V) min	max	V_{DS} (V)	I_D (μA)	g_m (mS) μ* min	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	g_{os} (mS) r_D* (Ω) typ	max
★ 2SK276	三菱	S～Xバンド低雑音増幅	GaAs		6	−6	80*	200	150			30	80	3	−1	−5	3	100	20	30		3	30		
2SK277	日電	大電流SW	MOS		350*	±20*	7A*	100W	150	±100	±20		10	350	0.4	3	10	50mA	0.6	(S) 1		10	3A		
2SK278	〃	〃	〃		400*	±20*	7A*	100W	150	±100	±20		10	400	0.4	3	10	50mA	0.6	(S) 1		10	3A		
★ 2SK279	三菱	S～Xバンド中電力増幅	GaAs		8	−6	250*	1W	150			150	250	3	−2	−6	3	100	70	90		3	100		
2SK280	日電	X～Kuバンド低雑音増幅	〃		5	−6	100*	270	125*	−10μA	−5	20	100	3	−0.5	−6	3	100	20	40	100	3	10		
2SK281	〃	VHF～Cバンド低雑音増幅	〃		5	−6	120*	300	125	−10μA	−5	30	120	3	−0.8	−6	3	100	20	40	100	3	10		
2SK282																									
2SK283	三洋	高電圧ドライバ	J	−80	80*		10	150	125	−1	−30	1.2	17	30	(typ) −0.75		30	10		20		30	I_{DSS}		
2SK284																									
2SK285																									
2SK286	日立	低高周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		60	±20*	8A*	100W*	150*	±1μA	±20				0.2*	1.5*	10	10mA	1	(S) 1.4		10	3A		
2SK287Ⓚ	〃	高周波電力増幅	〃		60*	±20*	8A*	100W	150				1	50	0.4	3	10	10mA	1	(S) 1.4		10	3A		
2SK288Ⓚ	〃	〃	〃		80*	±20*	8A*	100W	150				1	60	0.4	3	10	10mA	1	(S) 1.4		10	3A		
★ 2SK289Ⓗ	〃	〃	〃		80*	±20*	8A*	100W	150				1	60	0.2	3	10	10mA	1	(S) 1.4		10	3A		
★ 2SK290Ⓗ	〃	〃	〃		100*	±20*	8A*	100W	150				1	60	0.2	3	10	10mA	1	(S) 1.4		10	3A		
2SK291	〃	高周波低雑音増幅	J	−15*		−15	5,50*	300*	150*	−10	−7	6	50	5		−3	5	100	25	45		5	I_{DSS}		
2SK292	日電	FMチューナ	〃	−20*	20		10,10*	200	125	−100	−0.5	0.5	8	5		−2.5	5	10	2.3	3.5		5	0.5		
2SK293	〃	高耐圧高速度大電流SW	MOS		300*	±20*	7A*	100W	150*	±100	±20		5	300	0.4	3	10	50mA	0.6	(S) 1		10	3A		
2SK294	日立	高周波電力増幅 高速度電力SW	〃		80*	±20*	5A*	30W*	150*	±1μA	±20		1	65	1*	5*	10	1mA	0.5	(S) 0.8		10	3A		
2SK295	〃	〃	〃		100*	±20*	5A*	30W*	150*	±1μA	±20		1	80	1*	5*	10	1mA	0.5	(S) 0.8		10	3A		
2SK296	〃	〃	〃		300*	±20*	1A*	30W*	150*	±1μA	±20		1	240	1*	4.5*	10	1mA	0.2	(S) 0.4		10	500		
2SK297																									
2SK298	日立	高周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		400*	±20*	8A*	100W*	150*	±1μA	±20		1	320	1*	5*	10	1mA	1.2	(S) 1.7		10	4A		
2SK299	〃	〃	〃		450*	±20*	8A*	100W*	150*	±1μA	±20		1	360	1*	5*	10	1mA	1.2	(S) 1.7		10	4A		
2SK300																									

電気的特性 (T_a=25°C)																その他	代替品型名	外形	型名	
C_{iss} (pF)				C_{rss} (pF)				NF (f=1kHz, R_g=1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)								
typ	max	V_{GS}(V) I_D(mA)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{GD}(V) V_{GS}(V)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)					
最大発振周波数 90GHz typ												(f=18GHz) 2.8		3	10	(MGF-1403)		122	2SK276	★
950	1,500	−5	10	10		−5*	10	$V_{DS(ON)}$=6Vmax, $R_{DS(ON)}$=1.5Ω max (V_{GS}=15V, I_D=4A)										108	2SK277	
950	1,500	−5	10	10		−5*	10	〃										108	2SK278	
最大発振周波数 45GHz typ								直線電力利得 9dB typ (f=8GHz)								(MGF-1801)		122	2SK279	★
												(f=15GHz) 2.3		3	10	MAG=8dB typ (f=15GHz)		123	2SK280	
												(f=8GHz) 1.8		3	10	MAG=10dB typ (f=8GHz)		123	2SK281	
																			2SK282	
12		0	30	2.5		0*	30											126	2SK283	
																			2SK284	
																			2SK285	
500		−5	10					$V_{DS(ON)}$=4Vmax (I_D=5A, V_{GS}=15V)								2SJ96とコンプリメンタリ		117A	2SK286	
500		−5	10					t_{on}=25ns typ, t_{off}=350ns typ (I_D=2A, V_{GS}=15V)										117A	2SK287Ⓚ	
500		−5	10					〃										117A	2SK288Ⓚ	
500		−5	10					〃										28A	2SK289Ⓗ	★
500		−5	10					〃										28A	2SK290Ⓗ	★
8.5		0	5					e_n=1.2nV/$\sqrt{Hz}$ typ (V_{DS}=5V, I_D=5mA, R_g=0, f=100kHz)										37B	2SK291	
5	6.5	0	5	0.07	0.25	0*	5					3	6	5	I_{DSS}	PG=21dB typ (f=100MHz)		104A	2SK292	
950	1,500	−5	10	10		−5*	10	$V_{DS(ON)}$=5.2Vmax, $R_{DS(ON)}$=1.3Ω max (V_{GS}=15V, I_D=4A)										108	2SK293	
450		0	10	140		0*	10	$V_{DS(ON)}$=1.7Vmax (I_D=3A, V_{GS}=15V)										116B	2SK294	
450		0	10	140		0*	10	〃										116B	2SK295	
140		0	10	23		0*	10	$V_{DS(ON)}$=4Vmax (I_D=1A, V_{GS}=15V)										116B	2SK296	
																			2SK297	
800		0	10	20		0*	10	$V_{DS(ON)}$=7Vmax (I_D=4A, V_{GS}=15V)								2SJ116とコンプリメンタリ		28B	2SK298	
800		0	10	20		0*	10	〃										28B	2SK299	
																			2SK300	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)						電気的特性 (Ta=25°C)																
				V_{GDS} V_{GDO}* V_{GDX}** (V)	V_{DSX} V_{DSS}* (V)	V_{GSO} V_{GSS}* V_{GSX}** (V)	I_G I_D* (mA)	P_d P_{ch}* (mW)	T_j T_{ch}* (°C)	I_{GSS} max (nA) (pA)*	V_{GS} (V)	I_{DSS} (mA) min	max	V_{DS} (V)	$V_{GS(off)}$, V_{th}*(V) min	max	V_{DS} (V)	I_D (μA)	g_m (mS) μ* min	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	g_{os} (mS) r_D* (Ω) typ	max
2SK301	松　下	低周波増幅,SW	J	−55*	55	−55	10,30*	250	125	−10	−30	0.5	20	10		−5	10	10	2.5	7.5		10	I_{DSS}		
2SK302	東　芝	VHF, RF	MOS		20	±5	30*	150	125	±50	±5	1.5	14	10		−2.5	10	100		10		10	〃		
2SK303	三　洋	低周波電力増幅	J	−30	30*		10,20*	150	125	−1	−20	0.6	12	10		−4	10	1	2.5	6		10	〃		
2SK304	〃	〃	〃	−30	30*		10,20*	150	125	−1	−20	0.6	12	10		−4	10	1	2.5	6		10	〃		
2SK305																									
2SK306																									
2SK307																									
2SK308	日　立	高周波電力増幅	MOS		120*	±20*	10A*	100W*	150*	±1μA	±20		1	100	1*	4.5*	10	1mA	1.5	(S) 2		10	5A		
2SK309																									
2SK310	日　立	高周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		400*	±20*	3A*	40W*	150*	±1μA	±20		1	320	1*	5*	10	1mA	0.6	(S) 1		10	2A		
2SK311	〃	〃	〃		450*	±20*	3A*	40W*	150*	±1μA	±20		1	360	1*	5*	10	1mA	0.6	(S) 1		10	2A		
2SK312	〃	〃	〃		400*	±20*	12A*	125W*	150*	±1μA	±20		1	320	1*	5*	10	1mA	1.5	(S) 2.5		10	6A		
2SK313	〃	〃	〃		450*	±20*	12A*	125W*	150*	±1μA	±20		1	360	1*	5*	10	1mA	1.5	(S) 2.5		10	6A		
2SK314	日　電	低周波, 低雑音	J	−40*	40	−40	10,50*	250	150	−100*	−20	5	30	10	−0.5	−3	10	10	8	12		10	5		
2SK315	三　洋	FMチューナ	〃	−20*			10,25*	200	125	−10	−0.5	2.5	24	5		−3.5	5	10	6	12		5	I_{DSS}		
2SK316	松　下	ビデオカメラ	〃	−10*		−10	5,50*	200	100*	−2	−7	5	24	5		−3	5	100	15			5	〃		
2SK317	日　立	HF, VHF 電力増幅	MOS		180*	±20*	8A*	120W*	150*				1	140	0.5*	3*	10	1mA	0.9	(S) 1.25		20	3A		
2SK318	〃	〃	〃		180*	±20*	4A*	70W*	150*				1	140	0.5*	3*	10	1mA	0.4	(S) 0.6		20	1.5A		
2SK319	〃	高周波電力増幅 高速度電力SW	〃		400*	±20*	5A*	50W*	150*	±1μA	±20		1	320	1*	5*	10	1mA	1	(S) 1.5		10	3A		
2SK320	〃	〃	〃		450*	±20*	5A*	50W*	150*	±1μA	±20		1	360	1*	5*	10	1mA	1	(S) 1.5		10	3A		
2SK321	松　下	広帯域低雑音増幅 ビデオカメラ	J	−15*		−15	5,50*	200	100*	−2	−7	5	42	5		−3	5	100	15	30		5	I_{DSS}		
2SK322	日　立	HF広帯域増幅	〃	−15*		−15	5,50*	150*	150*	−10	−7	6	50	5		−3	5	100	25	45		5			
2SK323	〃	低周波増幅	〃			−40*	10,30*	150*	150*	−10	−30	1.6	12	10	−0.13	−1.5	10	10	8	12		10	3		
2SK324	東　芝	高速高電圧SW	MOS		400	±20*	10A*	120W	150*	±100	±20		1	400	1.5	3.5	10	1mA	3	(S) 5		10	5A		
2SK325	〃	〃	〃		450	±20*	10A*	120W	150*	±100	±20		1	450	1.5	3.5	10	1mA	3	(S) 5		10	5A		

電気的特性 (Ta=25°C)																その他	代替品型名	外形	型名
C_{iss} (pF)				C_{rss} (pF)				NF (f=1kHz, R_g=1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)							
typ	max	V_{GS}(V) I_D(mA)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{GD}(V) V_{GS}(V)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)			形	
6.5		0	10	1.9		0*	10	(f=120Hz, R_g=100kΩ) 0.5		10	I_{DSS}							80A	2SK301
3		0	10	0.035	0.05	0*	10					1.7	3	10	I_{DSS}	PG=28dB typ (f=100MHz)		105B	2SK302
5		0	10	1.5		0*	10											126A	2SK303
5		0	10	1.5		0*	10											58A	2SK304
																			2SK305
																			2SK306
																			2SK307
1,130		0	10	80		0*	10	$V_{DS(ON)}$=1.5Vmax (I_D=5A, V_{GS}=15V)										28B	2SK308
																			2SK309
440		0	10	13		0*	10	$V_{DS(ON)}$=8Vmax (I_D=2A, V_{GS}=15V)								2SJ117とコンプリメンタリ		116B	2SK310
440		0	10	13		0*	10	〃										116B	2SK311
1,500		0	10	35		0*	10	$V_{DS(ON)}$=5.4Vmax (I_D=6A, V_{GS}=15V)										28B	2SK312
1,500		0	10	35		0*	10	〃										28B	2SK313
9		0	10	2.6		0*	10	0.6	(R_g=1kΩ) 1.5	10	5	NF=10dB max (V_{DS}=10V, I_D=5mA, R_g=1kΩ, f=10Hz)						73	2SK314
8		0	5	0.08	0.3	0*	5					2.2	4	5	I_{DSS}	PG=23dB typ (f=100MHz)		58B	2SK315
	5	5*	5															103A	2SK316
600		5	0	0.5		−50		$V_{DS(ON)}$=6Vmax (I_D=4A, V_{GS}=10V)								P_O=120W min (f=100MHz)		129	2SK317
300		5	0	0.3		−50		$V_{DS(ON)}$=6Vmax (I_D=2A, V_{GS}=10V)								P_O=90W typ (f=100MHz)		129	2SK318
800		0	10	20		0*	10	$V_{DS(ON)}$=5.5Vmax (I_D=3A, V_{GS}=15V)										116B	2SK319
800		0	10	20		0*	10	〃										116B	2SK320
8		0	5															103A	2SK321
																		87A	2SK322
																		87A	2SK323
1,500	2,000	0	10	150	300	0*	10	$V_{DS(ON)}$=7Vmax (I_D=10A, V_{GS}=10V)										134	2SK324
1,600	2,000	0	10	140	300	0*	10	$V_{DS(ON)}$=8Vmax (I_D=10A, V_{GS}=10V)										134	2SK325

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)						電気的特性 (Ta=25°C)															
				V_{GDS} V_{GDO}* V_{GDX}** (V)	V_{DSX} V_{DSS}* (V)	V_{GSO} V_{GSS}* V_{GSX}** (V)	I_G I_D* (mA)	P_d P_{ch}* (mW)	T_j T_{ch}* (°C)	I_{GSS} max (nA) (pA)*	V_{GS} (V)	I_{DSS} (mA) min	max	V_{DS} (V)	$V_{GS(off)}$, V_{th}*(V) min	max	V_{DS} (V)	I_D (μA)	g_m (mS) μ* min	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	g_{os} (mS) r_D* (Ω) typ	max
2SK326																									
2SK327																									
2SK328																									
2SK329																									
2SK330	東　芝	低周波,定電流回路,アナログSW	J	−50			10	200	125	−1	−30	1.2	14	10	−0.7	−6	10	0.1	1.5	4		10	I_{DSS}		
2SK331	三　洋	コンデンサ・マイク	〃	−20*			10	100	125			0.06	1.5	10											
2SK332	〃	差動増幅	〃	−40	40*		10,20*	200 unit	125	−1	−20	1.2	12	10	(typ) −0.5		10	10		17		10	I_{DSS}		
2SK333	〃	〃	〃	−80	80*		10,20*	200 unit	125	−1	−30	1.2	12	30		−3	30	10	5	15		30	〃		
2SK334	〃	コンデンサ・マイク	〃	−20*			10	100	125			0.06	1.5	10											
2SK335																									
2SK336	三　洋	アナログSW	MOS		50*	±12	400*	600	125	10	10		1μA	20	0.3	2.5	10	100	20	35		10	50		
2SK337	日　電	高耐圧SW	〃		500*	±20*	±100*	10W	150*	±100	±20		10μA	500	1	5	10	1mA	10	30		10	20		
2SK338																									
2SK339																									
2SK340																									
2SK341																									
2SK342																									
2SK343	日　立	低高周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		140*	±20*	8A*	100W*	150*	±1μA	±20		1	120	2*	5*	10	1mA	1	(S) 2		10	4A		
2SK344	〃	〃	〃		160*	±20*	8A*	100W*	150*	±1μA	±20		1	140	2*	5*	10	1mA	1	(S) 2		10	4A		
2SK345	〃	〃	〃		40*	±20*	5A*	30W*	150*	±1μA	±20		1	30	2*	5*	10	1mA	0.5	(S) 0.9		10	3A		
2SK346	〃	〃	〃		60*	±20*	5A*	30W*	150*	±1μA	±20		1	50	2*	5*	10	1mA	0.5	(S) 0.9		10	3A		
2SK347	〃	高周波電力増幅 高速度電力SW	〃		400*	±20*	1A*	10W*	150*	±1μA	±20		1	320	1*	5*	10	1mA	0.1	(S) 0.3		10	0.5A		
2SK348																									
2SK349	日　立	高周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		400*	±20*	10A*	100W*	150*	±1μA	±20		1	320	1*	5*	10	1mA	1.3	(S) 2.5		10	5A		
2SK350	〃	〃	〃		450*	±20*	10A*	100W*	150*	±1μA	±20		1	360	1*	5*	10	1mA	1.3	(S) 2.5		10	5A		

電気的特性 (Ta=25°C)																	代替品型名	外形	型名
C_{iss} (pF)				C_{rss} (pF)				NF (f=1kHz, R_g=1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)				その他			
typ	max	V_{GS}(V) I_D(mA)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{GD}(V) V_{GS}(V)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)				
																			2SK326
																			2SK327
																			2SK328
																			2SK329
9		0	10	2.5		−10	I_D=0			$R_{DS(ON)}$=320Ω typ (V_{DS}=10mV, V_{GS}=0, I_{DSS}=5mA) 2SJ105とコンプリメンタリ								70A	2SK330
Z_{in}=20MΩ min (f=1kHz)								V_{NO}=−110dB max (V_{IN}=0)										127	2SK331
13		0	10	3		0*	10	0.6	(R_g=1kΩ) 1.5	10	I_{DSS}	ΔV_{GS}=30mVmax (V_{DS}=10V, I_D=1mA)						107	2SK332
11		0	30	2		0*	30	1	(R_g=10kΩ)	30	3	ΔV_{GS}=30mVmax (V_{DS}=30V, I_D=1mA)						107	2SK333
Z_{in}=20MΩ min (f=1kHz)								V_{NO}=−110dB max (V_{IN}=0)										106	2SK334
																			2SK335
17		0	10	2.2		0*	10									$R_{DS(ON)}$=12Ω typ (V_{DS}=10V, I_D=10mA)		57A	2SK336
20	100	0	10	1		0*	10	$R_{DS(ON)}$=100Ω max (V_{GS}=10V, I_D=20mA)										135	2SK337
																			2SK338
																			2SK339
																			2SK340
																			2SK341
																			2SK342
800		0	10	60		0*	10	$V_{DS(ON)}$=2Vmax (I_D=4A, V_{GS}=15V)								2SJ99とコンプリメンタリ		117B	2SK343
800		0	10	60		0*	10	〃								2SJ100とコンプリメンタリ		117B	2SK344
350		0	10	80		0*	10	$V_{DS(ON)}$=1.2Vmax (I_D=3A, V_{GS}=15V)								2SJ101とコンプリメンタリ		116B	2SK345
350		0	10	80		0*	10	〃								2SJ102とコンプリメンタリ		116B	2SK346
125		0	10	6		0*	10	$V_{DS(ON)}$=6Vmax (I_D=0.5A, V_{GS}=15V)										150	2SK347
																			2SK348
1,500		0	10	35		0*	10	$V_{DS(ON)}$=4.5Vmax (I_D=5A, V_{GS}=15V)										149	2SK349
1,500		0	10	35		0*	10	〃										149	2SK350

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)						電気的特性 (Ta=25°C)																
				V_{GDS} V_{GDO}* V_{GDX}** (V)	V_{DSX} V_{DSS}* (V)	V_{GSO} V_{GSS}* V_{GSX}** (V)	I_G I_D* (mA)	P_d P_{ch}* (mW)	T_j T_{ch}* (°C)	I_{GSS} max (nA) (pA)*	V_{GS} (V)	I_{DSS} (mA) min	max	V_{DS} (V)	$V_{GS(off)}$, V_{th}*(V) min	max	V_{DS} (V)	I_D (μA)	g_m (mS) μ* min	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	g_{os} (mS) r_D* (Ω) typ	max
2SK351	日立	高周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		800*	±20*	5A*	125W*	150*	±1μA	±20		1	640	1*	5*	10	1mA	1	(S) 2		10	3A		
2SK352	〃	〃	〃		250*	±9*	300*	8W*	150*	±1μA	±9		1	200	1	5	10	1mA	50	80		20	150		
2SK353	日電	C~Kuバンド 低雑音増幅	GaAs		5	−6	120*	270	125*	−10μA	−5	20	120	3	−0.5	−6	3	100	20	40	100	3	10		
2SK354	〃	VHF~Cバンド 低雑音増幅	〃		5	−6	150*	300	125*	−10μA	−5	30	150	3	−0.8	−6	3	100	20	40	100	3	10		
2SK355	東芝	高速高電圧SW	MOS		150	±20*	12A*	120W	150*	±100	±20		1	150	1.5	3.5	10	1mA	3	(S) 6		10	10A		
2SK356	〃	〃	〃		250	±20*	12A*	120W	150*	±100	±20		1	250	1.5	3.5	10	1mA	3	(S) 6		10	10A		
2SK357	〃	〃	〃		150	±20*	5A*	40W	150*	±100	±20		1	150	1.5	3.5	10	1mA	0.8	(S) 1.8		10	3A		
2SK358	〃	〃	〃		250	±20*	5A*	40W	150*	±100	±20		1	250	1.5	3.5	10	1mA	1	(S) 2.3		10	3A		
2SK359	日立	VHF, RF	〃		20	±5	±1,30*	400*	150*	±20	±5	4	12	10	0	−2	10	10	8	14		10	IDSS		
2SK360	〃	〃	〃		20	±5	±1,30*	150*	150*	±20	±5	4	12	10	0	−2	10	10	8	14		10	IDSS		
2SK361																									
2SK362	東芝	低周波, アナログSW	J	−50			10	300	125	−1	−30	1.2	14	10	−0.25	−1.5	10	0.1	(IDSS=5mA) 5	19		10	IDSS		
2SK363	〃	〃	〃	−40			10	400	125	−1	−30	5	30	10	−0.3	−1.2	10	0.1	(IDSS=15mA) 25	60		10	〃		
2SK364	〃	〃	〃	−40			10	400	125	−1	−30	2.6	20	10	−0.2	−1.5	10	0.1	(IDSS=5mA) 12	28		10	〃		
2SK365	〃	〃	〃	−50			10	200	125	−1	−30	1.2	14	10	−0.25	−1.5	10	0.1	(IDSS=5mA) 5	19		10	〃		
2SK366	〃	〃	〃	−40			10	200	125	−1	−30	2.6	20	10	−0.2	−1.5	10	0.1	(IDSS=5mA) 12	28		10	〃		
2SK367	〃	低周波高電圧増幅 定電流回路	〃	−100			10	200	125	−1	−80	0.6	6.5	10	−0.4	−3.5	10	0.1	1.5	4.6		10	〃		
2SK368	〃	〃	〃	−100			10	150	125	−1	−80	0.6	6.5	10	−0.4	−3.5	10	0.1	1.5	4.6		10	〃		
2SK369	〃	低周波, 低雑音	〃	−40			10	400	125	−1	−30	5	30	10	−0.3	−1.2	10	0.1	(IDSS=5mA) 25	40		10	〃		
2SK370	〃	〃	〃	−40			10	200	125	−1	−30	2.6	20	10	−0.2	−1.5	10	0.1	(IDSS=3mA) 8	22		10	〃		
2SK371	〃	〃	〃	−40			10	200	125	−1	−30	5	30	10	−0.3	−1.5	10	0.1	(IDSS=5mA) 25	40		10	〃		
2SK372	〃	低周波, アナログSW	〃	−40			10	200	125	−1	−30	5	30	10	−0.3	−1.2	10	0.1	(IDSS=15mA) 25	60		10	〃		
2SK373	〃	低周波高電圧増幅 低電流回路	〃	−100			10	400	125	−1	−80	0.6	6.5	10	−0.4	−3.5	10	0.1	1.5	4.6		10	〃		
2SK374	松下	低周波増幅,SW	〃	−55*	55	−55	10,30*	200	125	−10	−30	1	20	10		−5	10	10	2.5	7.5		10	5		
2SK375	日立	高周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		300*	±20*	1A*	10W*	150*	±1μA	±20		1	240	1*	5*	10	1mA	200	400		10	500		

電気的特性 (Ta=25°C)																その他	代替品型名	外形	型名
C_{iss} (pF)				C_{rss} (pF)				NF (f=1kHz, R_g=1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)							
typ	max	V_{GS}(V) I_D(mA)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{GD}(V) V_{GS}(V)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)				
1,900		0	10	40		0*	10	$V_{DS(ON)}$=9Vmax (I_D=3A, V_{GS}=15V)										28B	2SK351
20		0	10	2.5		0*	10	$V_{DS(ON)}$=5Vmax (I_D=100mA, V_{GS}=9V)										136	2SK352
最大発振周波数 90GHz typ												2.3 (f=15GHz)		3	10	MAG=8dB typ (f=15GHz)		123	2SK353
最大発振周波数 60GHz typ												2 (f=8GHz)		3	10	MAG=10dB typ (f=8GHz)		137	2SK354
1,600	2,200	0	10	350	600	0*	10	$V_{DS(ON)}$=1.8Vmax (I_D=40A, V_{GS}=10V)										134	2SK355
1,600	2,000	0	10	220	320	0*	10	$V_{DS(ON)}$=2.5Vmax (I_D=30A, V_{GS}=10V)										134	2SK356
260	350	0	10	50	100	0*	10	$V_{DS(ON)}$=9.5Vmax (I_D=8A, V_{GS}=10V)										138	2SK357
380	500	0	10	60	120	0*	10	$V_{DS(ON)}$=12Vmax (I_D=8A, V_{GS}=10V)										138	2SK358
2.5		0	10	0.03		0*	10					2		10	I_{DSS}	PG=30dB typ (f=100MHz)		37A	2SK359
2.5		0	10	0.03		0*	10					2		10	I_{DSS}	PG=30dB typ (f=100MHz)		87D	2SK360
																			2SK361
13		0	10	3		−10	I_D=0									$R_{DS(ON)}$=80Ω typ (V_{DS}=10mV, V_{GS}=0, I_{DSS}=5mA)		82C	2SK362
75		0	10	15		−10	I_D=0									$R_{DS(ON)}$=20Ω typ (V_{DS}=10mV, V_{GS}=0, I_{DSS}=15mA)		82C	2SK363
30		0	10	6		−10	I_D=0	$R_{DS(ON)}$=50Ω typ (V_{DS}=10mV, V_{GS}=0, I_{DSS}=5mA)								2SJ104とコンプリメンタリ		82C	2SK364
13		0	10	3		−10	I_D=0									$R_{DS(ON)}$=80Ω typ (V_{DS}=10mV, V_{GS}=0, I_{DSS}=5mA)		70B	2SK365
30		0	10	6		−10	I_D=0	$R_{DS(ON)}$=50Ω typ (V_{DS}=10mV, V_{GS}=0, I_{DSS}=5mA)								2SJ107とコンプリメンタリ		70B	2SK366
13		0	10	3		I_D=0	10	0.5 (f=100Hz, R_g=100kΩ)		10	I_{DSS}							70A	2SK367
13		0	10	3		I_D=0	10	0.5 (f=100Hz, R_g=100kΩ)		10	I_{DSS}							105A	2SK368
75		0	10	15		−10	I_D=0	5 (f=100Hz, R_g=100kΩ)	10	10	5							82C	2SK369
30		0	10	6		−10	I_D=0	1 (f=10Hz, R_g=1kΩ)	10	10	10				1	2SJ108とコンプリメンタリ		70B	2SK370
75		0	10	15		−10	I_D=0	5 (f=100Hz, R_g=100Ω)	10	10	5							70B	2SK371
75		0	10	15		−10	I_D=0									$R_{DS(ON)}$=20Ω typ (V_{DS}=10mV, V_{GS}=0, I_{DSS}=15mA)		70B	2SK372
13		0	10	3		I_D=0	10	0.5 (f=100Hz, R_g=100kΩ)		10	I_{DSS}							82B	2SK373
6.5		0	10	1.9		0*	10	0.5 (f=100Hz, R_g=100kΩ)		10	I_{DSS}							103A	2SK374
140		0	10	23		0*	10	$V_{DS(ON)}$=4Vmax (I_D=1A, V_{GS}=15V)										150	2SK375

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)						電気的特性 (Ta=25°C)																
				V_{GDS} V_{GDO}* V_{GDX}** (V)	V_{DSX} V_{DSS}* (V)	V_{GSO} V_{GSS}* V_{GSX}** (V)	I_G I_D* (mA)	P_d P_{ch}* (mW)	T_j T_{ch}* (°C)	I_{GSS} (nA) (pA)* max	V_{GS} (V)	I_{DSS} (mA) min	max	V_{DS} (V)	$V_{GS(off)}$, V_{th}*(V) min	max	V_{DS} (V)	I_D (μA)	g_m (mS) μ* min	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	g_{os} (mS) r_D* (Ω) typ	max
2SK376	三洋	コンデンサ·マイク	J	−20*			10	100	125			0.06	0.8	5											
2SK377	〃	〃	〃	−20*			10	100	125			0.06	0.8	5											
2SK378	松下	UHF 広帯域低雑音	GaAs		5	−4	1,130*	350	125	−80μA	−4	15	130	3		−4	3	500	40	75		3	30		
2SK379	〃	SW電源 DC-DCコンバータ	MOS		400*	±20*	8A*	100W	150*				1	400	1*	5*	V_{GS}	1mA	2.5	(S) 4		25	5A		
2SK380	〃	〃	〃		450*	±20*	8A*	100W	150*				1	400	1*	5*	V_{GS}	1mA	2.5	(S) 4		25	5A		
2SK381	三菱	低周波電圧増幅 アナログSW	J	−50*			10	300	125*	−1	−30	0.3	12	10	−0.3	−6	10	10	1	3		10	I_{DSS}		
2SK382	日立	高周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		500*	±20*	2A*	30W*	150*	±1μA	±20		1	400	2*	5*	10	1mA	400	700		10	1A		
2SK383	〃	〃	〃		100*	±20*	10A*	50W*	150*	±1μA	±20		1	80	2*	5*	10	1mA	1.5	(S) 2.8		10	5A		
2SK384	〃	〃	〃		500*	±20*	300*	10W*	150*	±1μA	±20		1	400	1*	5*	10	1mA	60	100		10	200		
2SK385	東芝	高速高電圧SW	〃		400	±20*	10A*	120W	150*	±100	±20		1	400	1.5	3.5	10	1mA	3	(S) 5		10	5A		
2SK386	〃	〃	〃		450	±20*	10A*	120W	150*	±100	±20		1	450	1.5	3.5	10	1mA	3	(S) 5		10	5A		
2SK387	〃	〃	〃		150	±20*	12A*	150W	150*	±100	±20		1	150	1.5	3.5	10	1mA	3	(S) 6		10	10A		
2SK388	〃	〃	〃		250	±20*	12A*	150W	150*	±100	±20		1	250	1.5	3.5	10	1mA	3	(S) 6		10	10A		
2SK389	〃	低周波低雑音 差動増幅	J	−50			10	200	125	−1	−30	2.6	20	10	−0.15	−2	10	0.1	(I_{DSS}=3mA) 8	20		10	I_{DSS}		
2SK390																									
2SK391																									
2SK392																									
2SK393																									
2SK394																									
2SK395																									
2SK396																									
2SK397																									
2SK398	日立	高周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		100*	±20*	10A*	100W*	150*	±1μA	±20		1	80	2*	5*	10	1mA	1.5	(S) 2		10	5A		
2SK399	〃	〃	〃		100*	±20*	10A*	100W*	150*	±1μA	±20		1	80	2*	5*	10	1mA	1.5	(S) 2		10	5A		
2SK400	〃	〃	〃		200*	±20*	8A*	100W*	150*	±1μA	±20		1	160	2*	5*	10	1mA	1	(S) 1.8		10	4A		

電気的特性 (T_a=25°C)																その他	代替品型名	外形	型名
C_{iss} (pF)				C_{rss} (pF)				NF (f=1kHz, R_g=1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)							
typ	max	V_{GS}(V) I_D(mA)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{GD}(V) V_{GS}(V)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)				
Z_{in}=18MΩ min (f=1kHz)								V_{NO}=−110dBmax (V_{IN}=0)										156	2SK376
〃								〃										127	2SK377
													(f=800MHz) 3	3	30	PG=10dBtyp (f=800MHz)		91A	2SK378
800		0	20	30		0*	20	$R_{DS(ON)}$=1.5Ω max (V_{GS}=10V, I_D=5A)										140	2SK379
800		0	20	30		0*	20	$R_{DS(ON)}$=2Ω max (V_{GS}=10V, I_D=5A)										140	2SK380
8		0	10	1.5		0*	10	$R_{DS(ON)}$=250Ω typ (f=1kHz, V_{DS}=10mVrms, V_{GS}=0, I_{DSS}=5mA)								2SJ40とコンプリメンタリ		151	2SK381
440		0	10	13		0*	10	$V_{DS(ON)}$=4Vmax (I_D=1A, V_{GS}=15V)										116B	2SK382
1,100		0	10	80		0*	10	$V_{DS(ON)}$=0.9Vmax (I_D=5A, V_{GS}=15V)										116B	2SK383
70		0	10	5		0*	10	$V_{DS(ON)}$=10Vmax (I_D=200mA, V_{GS}=15V)										150	2SK384
1,500	2,000	0	10	140	300	0*	10	$V_{DS(ON)}$=7Vmax (I_D=10A, V_{GS}=10V)										141	2SK385
1,500	2,000	0	10	140	300	0*	10	$V_{DS(ON)}$=8Vmax (I_D=10A, V_{GS}=10V)										141	2SK386
1,600	2,200	0	10	350	600	0*	10	$V_{DS(ON)}$=1.8Vmax (I_D=10A, V_{GS}=10V)										141	2SK387
1,600	2,000	0	10	220	320	0*	10	$V_{DS(ON)}$=2.5Vmax (I_D=10A, V_{GS}=10V)										141	2SK388
25		0	10	5.5		−10	I_D=0	0.5	(R_g=1kΩ) 2	10	1	|V_{GS}|=20mVmax				2SJ109とコンプリメンタリ		148	2SK389
																			2SK390
																			2SK391
																			2SK392
																			2SK393
																			2SK394
																			2SK395
																			2SK396
																			2SK397
800		0	10	70		0*	10	$V_{DS(ON)}$=1.25Vmax (I_D=5A, V_{GS}=15V)								2SJ112とコンプリメンタリ		28B	2SK398
800		0	10	70		0*	10	〃								2SJ113とコンプリメンタリ		149	2SK399
750		0	10	60		0*	10	$V_{DS(ON)}$=2.8Vmax (I_D=4A, V_{GS}=15V)								2SJ114とコンプリメンタリ		149	2SK400

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)						電気的特性 (Ta=25°C)															
				V_{GDS} V_{GDO}* V_{GDX}** (V)	V_{DSX} V_{DSS}* (V)	V_{GSO} V_{GSS}* V_{GSX}** (V)	I_G I_D* (mA)	P_d P_{ch}* (mW)	T_j T_{ch}* (°C)	I_{GSS} (nA) (pA)* max	V_{GS} (V)	I_{DSS} (mA) min	max	V_{DS} (V)	$V_{GS(off)}$, V_{th}*(V) min	max	V_{DS} (V)	I_D (μA)	g_m (mS) μ* min	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	g_{os} (mS) r_D* (Ω) typ	max
2SK401	日立	高周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		250*	±20*	10A*	100W*	150*	±1μA	±20		1	200	2*	5*	10	1mA	1.6	(S) 2.5		10	5A		
2SK402	〃	〃	〃		400*	±20*	8A*	100W*	150*	±1μA	±20		1	320	2*	5*	10	1mA	1.2	(S) 1.7		10	4A		
2SK403	〃	〃	〃		450*	±20*	8A*	100W*	150*	±1μA	±20		1	360	2*	5*	10	1mA	1.2	(S) 1.7		10	4A		
2SK404	三洋	低周波，高周波増幅	J	−20	20*		10,20*	200	125	−1	−10	1.2	12	5		−2	5	10	5	10		5	IDSS		
2SK405	東芝	低周波電力増幅	MOS		160*	±20*	8A*	100W	150	±1	±20				0.8	2.8	10	100mA	1	(S) 2		10	2A		
2SK406	日電	C～Kuバンド低雑音増幅	GaAs		5	−6	120*	270	120*	−10μA	−5	20	120	3	−0.5	−3.5	3	100	20	50	100	3	10		
2SK407	〃	〃	〃		5	−6	120*	270	120*	−10μA	−5	20	120	3	−0.5	−3.5	3	100	20	50	100	3	10		
2SK408	日立	HF，VHF電力増幅	MOS		180*	±20*	2A*	30W*	150*				1	140	0.5*	3*	10	1mA	200	300		20	1A		
2SK409	〃	〃	〃		180*	±20*	2A*	30W*	150*				1	140	0.5*	3*	10	1mA	200	300		20	1A		
2SK410	〃	〃	〃		180*	±20*	8A*	120W*	150*				1	140	0.5*	3*	10	1mA	0.9	(S) 1.25		20	3A		
2SK411	〃	高周波電力増幅 高速度電力SW	〃		600*	±20*	5A*	100W*	150*	±1μA	±20		1	500	2	5	10	1mA	1.5	(S) 2.3		10	3A		
2SK412	〃	〃	〃		250*	±20*	10A*	100W*	150*	±1μA	±20		1	200	2*	5*	10	1mA	1.6	(S) 2.5		10	5A		
2SK413	〃	〃	〃		140*	±20*	8A*	100W	150*	±1μA	±20		1	120	2*	5*	10	1mA	1	(S) 2		10	4A		
2SK414	〃	〃	〃		160*	±20*	8A*	100W	150*	±1μA	±20		1	140	2*	5*	10	1mA	1	(S) 2		10	4A		
2SK415	〃	〃	〃		800*	±20*	3A*	80W	150*	±1μA	±20		1	640	2*	5*	10	1mA	0.4	(S) 0.7		20	2A		
2SK416	〃	〃	〃		40*	±20*	2A*	10W	150*	±1μA	±20		1	35	1*	4*	10	1mA	0.2	(S) 0.4		10	1A		
2SK417	東芝	高速大電流SW	〃		60	±20*	10A*	60W	150*	±100	±20		1	60	1.5	3.5	10	1mA	2	(S) 4		10	5A		
2SK418	〃	高速度電圧SW	〃		400	±20*	2A*	50W	150*	±100	±20		1	400	1.5	3.5	10	1mA	0.6	(S) 1.2		10	1A		
2SK419	〃	〃	〃		450	±20*	2A*	50W	150*	±100	±20		1	450	1.5	3.5	10	1mA	0.6	(S) 1.2		10	1A		
2SK420	〃	〃	〃		400	±20*	5A*	60W	150*	±100	±20		1	400	1.5	3.5	10	1mA	1	(S) 2.5		10	3A		
2SK421	〃	〃	〃		450	±20*	5A*	60W	150*	±100	±20		1	450	1.5	3.5	10	1mA	1	(S) 2.5		10	3A		
2SK422	〃	高速SW	〃		60	±20*	0.7A*	900	150*	±100	±20		1	60	1.5*	3.5*	10	1mA	80	220		10	500		
2SK423	〃	〃	〃		100	±20*	0.5A*	900	150*	±100	±20		1	100	1.5*	3.5*	10	1mA	50	150		10	300		
2SK424	日電	高耐圧大電流SW	〃		600*	±20	3A*	100W	150*	±100	±20		5	600	0.5	5	10	10mA	0.5	(S) 2	5	25	3A		
2SK425	〃	低周波	J	−50*		−50	10,30*	200	150	−1	−20	1	18	10	−0.2	−1.2	10	10	7	9		10	1		

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)						電気的特性 (Ta=25°C)															
				V_{GDS} V_{GDO}* V_{GDX}** (V)	V_{DSX} V_{DSS}* (V)	V_{GSO} V_{GSS}* V_{GSX}** (V)	I_G I_D* (mA)	P_d P_{ch}* (mW)	T_j T_{ch}* (°C)	I_{GSS} (nA) (pA)* max	V_{GS} (V)	I_{DSS} (mA) min	max	V_{DS} (V)	$V_{GS(off)}$, V_{th}*(V) min	max	V_{DS} (V)	I_D (μA)	g_m (mS) μ* min	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	g_{os} (mS) r_D* (Ω) typ	max
2SK426	日電	低周波	J	−50*	50	−50	10,30*	200	150	−1	−20	1	18	10	−0.2	−1.2	10	10	7	9		10	1		
2SK427	三洋	AMチューナ RF	〃	−15	15*		10,20*	200	125	−1	−10	1.2	12	5		−1.5	5	100	8	17		5	IDSS		
2SK428	日立	高速度電力SW 高周波電力増幅	MOS		60*	±20*	10A*	50W*	150*	±1μA	±20		1	50	2*	5*	10	1mA	1.5	(S) 2.2		10	5A		
2SK429	〃	〃	〃		100*	±20*	3A*	20W*	150*	±1μA	±20		1	80	1*	4*	10	1mA	0.5	(S) 0.9		10	2A		
2SK430	〃	〃	〃		150*	±20*	3A*	20W*	150*	±1μA	±20		1	120	1*	4*	10	1mA	0.5	(S) 0.9		10	2A		
2SK431	〃	低周波低雑音	J		40	−40*	10,30*	150*	150*	−10	−30	2.5	20	10	−0.13	−1.5	10	10	18	21		10	3		
2SK432																									
2SK433	三菱	低周波電圧増幅 アナログSW	J	−50*			10	150	125*	−1	−30	0.3	12	10	−0.3	−6	10	10	1	3		10	IDSS		
2SK434																									
2SK435	日立	低周波，高周波増幅	J		22	−22	10,100*	300*	150*	−10	−15	6	40	5		−2.5	5	10	20			5	10		
2SK436	三洋	高周波，低周波増幅	〃	−15	15*		10,20*	150	125	−1	−10	1.2	12	5		−1.5	5	100	8	17		5	IDSS		
2SK437	松下	SHFチューナ 低雑音増幅		−6*	5	−6	120*	270	125*	−10μA	−3	20	120	3		−3.5	3	100	20	50	100	3	10		
2SK438	〃	〃		−6*	6	−6	150	300	125*	−10μA	−3	20	120	3		−3.5	3	100	20	50	100	3	10		
2SK439	日立	VHF，RF増幅	MOS		20	±5	±1,30*	300*	150*	±20	±5	4	12	10	0	−2	10	10	8	14		10	IDSS		
2SK440	〃	高速度電力SW 高周波電力増幅	〃		200*	±20*	6A*	40W*	150*	±1μA	±20		1	160	2*	5*	10	1mA	1	(S) 1.8		10	3A		
2SK441	〃	〃	〃		500*	±20	300*	750*	150*	±1μA	±20		1	400	2*	5*	10	1mA	60	100		10	200		
2SK442	東芝	低周波電力増幅 高速SW	〃		70*	±20*	10A*	30W	150	±1	±20		1	70	1	3	5	1mA	1	(S) 1.9		5	2A		
2SK443	三洋	ビデオカメラ初段	J	−15	15*		10,50*	200	125	−1	−10	5	38	5		−2	5	100	20	30		5	IDSS		
2SK444	〃	〃	〃	−15	15*		10,50*	200	125	−1	−10	5	38	5		−2	5	100	20	30		5	〃		
2SK445	〃	〃	〃	−15	15*		10,50*	300	125	−1	−10	5	38	5		−2	5	100	20	30		5	〃		
2SK446	日電	SW	MOS		20*	±20*	±2A*	20W	150*	±100	±20		50μA	20	1.5	4	10	10mA	0.5	(S) 1.2		10	1A		
2SK447	東芝	高速大電力SW モータドライブ	〃		250*	±20*	±15A*	150W	150	±100	±20		1	250	(V_{th}) 1.5	3.5	10	1mA	4	(S) 7		10	15A		
2SK448	日電	大電流SW	〃		250*	±20*	±10A*	120W	150*	±100	±20		1	200	1	5	10	1mA	(S) 1			10	3A		
2SK449	〃	〃	〃		450*	±20*	±8A*	120W	150*	±100	±20		0.1	400	1	5	10	1mA	(S) 1			10	3A		
2SK450																									

電気的特性 (Ta=25°C)																	代替品型名	外形	型名
C_{is} (pF)				C_{rs} (pF)				NF (f=1kHz, R_g=1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)				その他			
typ	max	V_{GS}(V) I_D(mA)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{GD}(V) V_{GS}(V)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)				
13		0	10	3.2		0*	10	NV=20mV (max)										78A	2SK426
7		0	5	2		0*	5	1.5	(R_g=1kΩ)	5	1							157	2SK427
900		0	10	120		0*	10	$V_{DS(ON)}$=0.75Vmax (I_D=5A, V_{GS}=15V)								2SJ122とコンプリメンタリ		116B	2SK428
280		0	10	24		0*	10	$V_{DS(ON)}$=1.4Vmax (I_D=2A, V_{GS}=15V)										150	2SK429
260		0	10	14		0*	10	$V_{DS(ON)}$=2Vmax (I_D=2A, V_{GS}=15V)										150	2SK430
28		0	10	5.6		0*	10	e_n=1nV/$\sqrt{Hz}$ typ (V_{DS}=10V, I_D=3mA, R_g=0, f=1kHz)										87E	2SK431
																			2SK432
8		0	10	1.5		0*	10	$R_{DS(ON)}$=250Ω typ (f=1kHz, V_{DS}=10mVrms, V_{GS}=0, I_{DSS}=5mA)										152	2SK433
																			2SK434
9	11	0	5	2.8	3.5	0*	5	0.5	(R_g=1kΩ) 3	5	1							37B	2SK435
7		0	5	2		0*	5	1.5	(R_g=1kΩ)	5	1							126A	2SK436
												1.8	(f=12GHz) 2.3	3	10	雑音最小電力利得 10.5dB typ (f=12GHz)		103	2SK437
																雑音最小電力利得 10.5dB typ (f=12GHz)		103	2SK438
2.5		0	10	0.03		0*	10					2		10	I_{DSS}	PG=30dB typ (f=100MHz)		8A	2SK439
750		0	10	60		0*	10	$V_{DS(ON)}$=1.5Vmax (I_D=3A, V_{GS}=15V)										116B	2SK440
70		0	10	5		0*	10	$R_{DS(ON)}$=50Ω max (I_D=0.2A, V_{GS}=15V)										121B	2SK441
330		0	10	130		0*	10	$V_{DS(ON)}$=2.8Vmax (I_D=7A, V_{GS}=15V)								2SJ123とコンプリメンタリ		138	2SK442
9		0	5	2.8		0*	5	1.5	(R_g=1kΩ)	5	1							126A	2SK443
9		0	5	2.8		0*	5	1.5	(R_g=1kΩ)	5	1							157	2SK444
9		0	5	2.8		0*	5	1.5	(R_g=1kΩ)	5	1							57A	2SK445
150		0	10	150		0*	10									$R_{DS(ON)}$=0.4Ω max (V_{GS}=12V, I_D=1A)		158	2SK446
2,000		0	10					$R_{DS(ON)}$=0.24Ω max (I_D=15A, V_{GS}=10V)										141	2SK447
1,500	3,000	0	10	50		0*	10									$R_{DS(ON)}$=0.5Ω max (V_{GS}=10V, I_D=3A)		108	2SK448
1,500	3,000	0	10	50		0*	10									$R_{DS(ON)}$=1.25Ω max (V_{GS}=10V, I_D=3A)		108	2SK449
																			2SK450

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C) V_{GDS} V_{GDO}* V_{GDX}** (V)	V_{DSX} V_{DSS}* (V)	V_{GSO} V_{GSS}* V_{GSX}** (V)	I_G I_D* (mA)	P_d P_{ch}* (mW)	T_j T_{ch}* (°C)	電気的特性 (Ta=25°C) I_{GSS} max (nA) (pA)*	V_{GS} (V)	I_{DSS} (mA) min	max	V_{DS} (V)	$V_{GS(off)}$, V_{th}*(V) min	max	V_{DS} (V)	I_D (μA)	g_m (mS) μ* min	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	g_{os} (mS) r_D* (Ω) typ	max
2SK451																									
2SK452																									
2SK453	日　電	高周波電力増幅	MOS		100*	±20*	10A*	120W	150*											(S) 1.8		7	3A		
2SK454	〃	〃	〃		200*	±20*	8A*	120W	150*											(S) 1.5		7	2A		
2SK455	東　芝	コンデンサ・マイクインピーダンス変換	J	−20*			10	100	125	(I_{GSO}) −50	−10	(μA) 60	500	5	−0.15	−0.8	5	0.1	(I_{DSS}=200μA) 0.5	2		5	I_{DSS}		
2SK456	〃	〃	〃	−20*			10	100	125	(I_{GSO}) −50	−10	(μA) 60	500	5	−0.15	−0.8	5	0.1	(I_{DSS}=200μA) 0.5	2		5	〃		
2SK457	日　立	SHF, UHF 低雑音増幅	GaAs		6	+0.5 −6	100*	200*	125*	−10μA	−5	30	100	5		−5	5	100		40		5	30		
2SK458	日　電	SW	MOS		150*	±20*	±1A*	16W	150*	±100	±20		50μA	100	1	5	10	1mA	0.5	(S) 0.6		10	0.5A		
2SK459	〃	〃	〃		200*	±20*	±10A*	60W	150*	±100	±20		100μA	200	1	5	10	1mA	1	(S) 3		10	3A		
2SK460																									
2SK461																									
2SK462	日　電	SW	MOS		60*	±20*	±2A*	20W	150*	±100	±20		50μA	60	1	5	10	1mA	(S) 0.5			10	1A		
2SK463	〃	〃	〃		60*	±20*	±5A*	40W	150*	±100	±20		100μA	60	1	5	10	1mA	(S) 1			10	3A		
2SK464	〃	〃	〃		60*	±20*	±8A*	50W	150*	±100	±20		50μA	60	1	5	10	1mA	(S) 1			10	4A		
2SK465																									
2SK466																									
2SK467																									
2SK468	日　電	SW	MOS		100*	±20*	±2A*	20W	150*	±100	±20		50μA	100	1	5	10	1mA	(S) 0.5			10	1A		
2SK469																									
2SK470	日　電	SW	MOS		100*	±20*	±8A*	50W	150*	±100	±20		50μA	100	1	5	10	1mA	(S) 1			10	4A		
2SK471																									
2SK472																									
2SK473																									
2SK474																									
2SK475																									

電気的特性 ($T_a=25^{\circ}C$)																	代替品型名	外形	型名
C_{iss} (pF)				C_{rss} (pF)				NF ($f=1kHz, R_g=1M\Omega$) (dB)				NF ($f=100MHz$) (dB)				その他			
typ	max		V_{DS} (V)	typ	max	V_{GD}(V) V_{GS}(V)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)				
																			2SK451
																			2SK452
350		0	10	10		−50, 0*		$P_O=120W$ typ ($V_{DS}=50V$, $P_{in}=5W$, $f=100MHz$, $I_{DD}=0.1A$)								$R_{ON}=0.5\Omega$ max ($V_{GS}=20V$, $I_D=3A$)		159	2SK453
350		0	10	10		−50, 0*		$P_O=140W$ typ ($V_{DS}=80V$, $P_{in}=5W$, $f=100MHz$, $I_{DD}=0.1A$)								$R_{ON}=1\Omega$ max ($V_{GS}=20V$, $I_D=2A$)		159	2SK454
7.2		0	5	2.3		−5	$I_D=0$	$V_N=40mV$max ($V_{DD}=5V$, $R_L=1k\Omega$, $A_v=80dB$, $C_g=10pF$)										160	2SK455
7.2		0	5	2.3		−5	$I_D=0$	〃										155	2SK456
												2.2 (f=3GHz)		5	10	PG=10dB typ (f=3GHz)		175B	2SK457
300		0	10	50		0*	10									$R_{DS(ON)}=1.5\Omega$ max ($V_{GS}=10V$, $I_D=0.5A$)		161	2SK458
900		0	10	60		0*	10									$R_{DS(ON)}=0.5\Omega$ max ($V_{GS}=10V$, $I_D=3A$)		162	2SK459
																			2SK460
																			2SK461
300		0	10	100		0*	10									$R_{DS(ON)}=0.5\Omega$ max ($V_{GS}=10V$, $I_D=1A$)		163	2SK462
500		0	10	100		0*	10									$R_{DS(ON)}=0.3\Omega$ max ($V_{GS}=10V$, $I_D=3A$)		164	2SK463
600		0	10	20		0*	10									$R_{DS(ON)}=0.2\Omega$ max ($V_{GS}=10V$, $I_D=4A$)		162	2SK464
																			2SK465
																			2SK466
																			2SK467
300		0	10	100		0*	10									$R_{DS(ON)}=1\Omega$ max ($V_{GS}=10V$, $I_D=1A$)		163	2SK468
																			2SK469
900		0	10	120		0*	10									$R_{DS(ON)}=0.3\Omega$ max ($V_{GS}=10V$, $I_D=4A$)		162	2SK470
																			2SK471
																			2SK472
																			2SK473
																			2SK474
																			2SK475

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C) V_{GDS} V_{GDO}* V_{GDX}** (V)	V_{DSX} V_{DSS}* (V)	V_{GSO} V_{GSS}* V_{GSX}** (V)	I_G I_D* (mA)	P_d P_{ch}* (mW)	T_j T_{ch}* (°C)	電気的特性 (Ta=25°C) I_{GSS} (nA) (pA)* max	V_{GS} (V)	I_{DSS} (mA) min	max	V_{DS} (V)	$V_{GS(off)}$, V_{th}*(V) min	max	V_{DS} (V)	I_D (μA)	g_m (mS) μ* min	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	g_{os} (mS) r_D* (Ω) typ	max
2SK476																									
2SK477	日電	SW	MOS		250*	±20*	±8A*	60W	150*	±100	±20		100μA	250	1	5	10	1mA	1	(S) 3		10	3A		
2SK478																									
2SK479																									
2SK480																									
2SK481																									
2SK482	日電	SW	MOS		450*	±20*	±5A*	50W	150*	±100	±20		100μA	450	1	5	10	1mA	(S) 1			10	2A		
2SK483																									
2SK484																									
2SK485																									
2SK486																									
2SK487																									
2SK488																									
2SK489																									
2SK490																									
2SK491																									
2SK492	三菱	低周波電圧増幅 アナログSW	J	−50*			10	150	125*	−1	−30	1	12	10		−3	10	10	6	15		10	I_{DSS}		
2SK493	三洋	ビデオカメラ初段	〃	−15	15*		10,50*	300	125	−1	−10	5	38	5		−2.2	5	100	15	27		5	〃		
2SK494	日立	低周波高周波増幅	〃		22	−22	10,100*	300*	150*	−10	−15	6	40	5		−2.5	5	10	20			5	10		
2SK495																									
2SK496																									
2SK497																									
2SK498																									
2SK499																									
2SK500																									

電気的特性 ($T_a=25°C$)																その他	代替品型名	外形	型名
C_{iss} (pF)				C_{rss} (pF)				NF ($f=1kHz$, $R_g=1M\Omega$) (dB)				NF ($f=100MHz$) (dB)							
typ	max	V_{GS}(V) I_D(mA)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{GD}(V) V_{GS}(V)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)				
																			2SK476
600		0	10	40		0*	10									$R_{DS(ON)}=0.8\Omega$ max ($V_{GS}=10V$, $I_D=3A$)		162	2SK477
																			2SK478
																			2SK479
																			2SK480
																			2SK481
600		0	10	20		0*	10									$R_{DS(ON)}=2\Omega$ max ($V_{GS}=10V$, $I_D=2A$)		162	2SK482
																			2SK483
																			2SK484
																			2SK485
																			2SK486
																			2SK487
																			2SK488
																			2SK489
																			2SK490
																			2SK491
20		0	10					($f=100Hz$, $R_g=1k\Omega$) 1		10	1					$R_{DS(ON)}=70\Omega$ typ ($f=1kHz$, $V_{DS}=10mVrms$, $V_{GS}=0$, $I_{DSS}=5mA$)		152	2SK492
7		0	5	2		0*	5	($R_g=1k\Omega$) 1.5		5	1							165	2SK493
9	11	0	5	2.8	3.5	0*	5	($R_g=1k\Omega$) 0.5	3	5	1							8B	2SK494
																			2SK495
																			2SK496
																			2SK497
																			2SK498
																			2SK499
																			2SK500

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C) V_{GDS} V_{GDO}* V_{GDX}** (V)	V_{DSX} V_{DSS}* (V)	V_{GSO} V_{GSS}* V_{GSX}** (V)	I_G I_D* (mA)	P_d P_{ch}* (mW)	T_j T_{ch}* (°C)	電気的特性 (Ta=25°C) I_{GSS} (nA) (pA)* max	V_{GS} (V)	I_{DSS} (mA) min	max	V_{DS} (V)	$V_{GS(off)}$, V_{th}*(V) min	max	V_{DS} (V)	I_D (μA)	g_m (mS) μ* min	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	g_{os} (mS) r_D* (Ω) typ	max
2SK501																									
2SK502																									
2SK503																									
2SK504																									
2SK505	日　電	ビデオ帯，高周波増幅	J	−15*	15	−15	5, 50*	400	125	−1	−10	10	50	5	−0.6	−3.5	5	10	14	26		5	I_{DSS}		
2SK506																									
2SK507	日　電	ビデオ帯，高周波増幅	J	−15*	15	−15	5, 50*	350	150	−1	−10	10	50	5	−0.6	−3.5	5	10	14	26		5	I_{DSS}		
2SK508	〃	〃	〃	−15*	15	−15	5, 50*	200	150	−1	−10	10	50	5	−0.6	−3.5	5	10	14	26		5	I_{DSS}		
2SK509																									
2SK510																									
2SK511	日　立	高速度電力SW 高周波電力増幅	MOS		250*	±9*	300*	8W*	150*	±1μA	±9		1	200	1*	5*	10	1mA	50	80		20	500		
2SK512	〃	高速度電力SW	〃		500*	±20*	12A*	125W*	150*	±1μA	±20		1	400	2*	4*	10	1mA	2.5	(S) 3.5		10	6A		
2SK513	〃	高速度電力SW 高周波電力増幅	〃		800*	±20	3A*	60W*	150*	±1μA	±20		1	640	2*	4*	10	1mA	0.4	(S) 0.7		20	2A		
2SK514																									
2SK515																									
2SK516																									
2SK517																									
2SK518	日　電	高周波増幅	J	−30*	30	−30	10, 50*	400	150	−1	−20	30	110	10	−1.5	−9	10	10		22		10	I_{DSS}		
2SK519	〃	〃	〃	−30*	30	−30	10, 50*	350	150	−1	−20	30	110	10	−1.5	−9	10	10		22		10	I_{DSS}		
2SK520	〃	〃	〃	−30*	30	−30	10, 50*	200	150	−1	−20	30	110	10	−1.5	−9	10	10		22		10	I_{DSS}		
2SK521																									
2SK522																									
2SK523																									
2SK524																									
2SK525	東　芝	DC-DCコンバータ	MOS		150*		10A*	40W							(V_{th}) 1.5	3.5		1mA		(S) 4		10	5A		

電気的特性 (Ta=25°C)																その他	代替品型名	外形	型名
C_{iss} (pF)				C_{rss} (pF)				NF (f=1kHz, R_g=1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)							
typ	max	V_{GS}(V) I_D(mA)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{GD}(V) V_{GS}(V)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)				
																			2SK501
																			2SK502
																			2SK503
																			2SK504
4.8		10*	5	1.6		10mA	5											53B	2SK505
																			2SK506
4.8		10*	5	1.6		10mA	5											104B	2SK507
4.8		10*	5	1.6		10mA	5											78A	2SK508
																			2SK509
																			2SK510
20		0	10	2.5		0*	10		$V_{DS(ON)}$=5Vmax (I_D=100mA, V_{GS}=9V)									136	2SK511
1,800		0	10	50		0*	10		$V_{DS(ON)}$=3.9Vmax (I_D=6A, V_{GS}=15V)									28B	2SK512
470		0	10	22		0*	10	$R_{DS(ON)}$=6Ω max (I_D=2A, V_{GS}=15V)										116B	2SK513
																			2SK514
																			2SK515
																			2SK516
																			2SK517
6		10*	10	2		10mA	10											53A	2SK518
6		10*	10	2		10mA	10											104B	2SK519
6		10*	10	2		10mA	10											78A	2SK520
																			2SK521
																			2SK522
																			2SK523
																			2SK524
								$R_{DS(ON)}$=0.28Ω max (I_D=5A, V_{GS}=10V)											2SK525

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C) V_{GDS} V_{GDO}* V_{GDX}** (V)	V_{DSX} V_{DSS}* (V)	V_{GSO} V_{GSS}* V_{GSX}** (V)	I_G I_D* (mA)	P_d P_{ch}* (mW)	T_j T_{ch}* (°C)	電気的特性 (Ta=25°C) I_{GSS} (nA) (pA)* max	V_{GS} (V)	I_{DSS} (mA) min	I_{DSS} (mA) max	V_{DS} (V)	$V_{GS(off)}$, V_{th}*(V) min	max	V_{DS} (V)	I_D (μA)	g_m (mS) μ* min	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	g_{os} (mS) r_D* (Ω) typ	max
2SK526	東　芝	DC-DCコンバータ	MOS		250*		10A*	40W							(V_{th}) 1.5	3.5		1mA		(S) 4		10	5A		
2SK527	〃	〃	〃		60*		10A*	40W							(V_{th}) 1.5	3.5		1mA		(S) 4		10	5A		
2SK528	〃	SWレギュレータ	〃		400*		2A*	30W							(V_{th}) 1.5	3.5		1mA		(S) 1		10	1A		
2SK529	〃	〃	〃		450*		2A*	30W							(V_{th}) 1.5	3.5		1mA		(S) 1		10	1A		
2SK530	〃	〃	〃		400*		5A*	40W							(V_{th}) 1.5	3.5		1mA		(S) 2.5		10	3A		
2SK531	〃	〃	〃		450*		5A*	40W							(V_{th}) 1.5	3.5		1mA		(S) 2.5		10	3A		
2SK532	〃	〃	〃		60*		12A*	40W							(V_{th}) 1.5	3.5		1mA		(S) 5		10	6A		
2SK533																									
2SK534	日　立	高速度電力SW	MOS		800*	±20*	5A*	100W*	150*	±1μA	±20		1	640	2*	4*	10	1mA	0.8	(S) 1.2		20	3A		
2SK535	〃	〃	〃		400*	±20*	1.5A*	20W*	150*	±1μA	±20		0.1	320	2*	4*	10	1mA	0.2	(S) 0.4		20	1A		
2SK536																									
2SK537	東　芝	SWレギュレータ	MOS		900*		1A*	60W							(V_{th}) 1.5	3.5		1mA		(S) 0.45		10	0.5A		
2SK538	〃	〃	〃		900*		3A*	100W							(V_{th}) 1.5	3.5		1mA		(S) 1		10	1.5A		
2SK539	〃	〃	〃		900*		5A*	150W							(V_{th}) 1.5	3.5		1mA		(S) 2		10	3A		
2SK540																									
2SK541																									
2SK542																									
2SK543																									
2SK544																									
2SK545																									
2SK546																									
2SK547																									
2SK548																									
2SK549																									
2SK550																									

電気的特性 ($T_a=25°C$)																その他	代替品型名	外形	型名
C_{is} (pF)				C_{rs} (pF)				NF ($f=1kHz, R_g=1MΩ$) (dB)				NF ($f=100MHz$) (dB)							
typ	max	V_{GS}(V) I_D(mA)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{GD}(V) V_{GS}(V)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)				
								$R_{DS(ON)}=0.6Ω$ max ($I_D=5A$, $V_{GS}=10V$)											2SK526
								$R_{DS(ON)}=0.14Ω$ max ($I_D=5A$, $V_{GS}=10V$)											2SK527
								$R_{DS(ON)}=2.2Ω$ max ($I_D=1A$, $V_{GS}=10V$)											2SK528
								$R_{DS(ON)}=2.5Ω$ max ($I_D=1A$, $V_{GS}=10V$)											2SK529
								$R_{DS(ON)}=1.4Ω$ max ($I_D=3A$, $V_{GS}=10V$)											2SK530
								$R_{DS(ON)}=1.6Ω$ max ($I_D=3A$, $V_{GS}=10V$)											2SK531
								$R_{DS(ON)}=0.07Ω$ max ($I_D=6A$, $V_{GS}=10A$)											2SK532
																			2SK533
850		0	10	40		0*	10	$V_{DS(ON)}=12V$max ($I_D=3A$, $V_{GS}=10V$)										149	2SK534
250		0	10	10		0*	10	$V_{DS(ON)}=6V$max ($I_D=1A$, $V_{GS}=15V$)										150	2SK535
																			2SK536
								$R_{DS(ON)}=9Ω$ max ($I_D=0.5A$, $V_{GS}=10V$)											2SK537
								$R_{DS(ON)}=4.5Ω$ max ($I_D=1.5A$, $V_{GS}=10V$)											2SK538
								$R_{DS(ON)}=2.5Ω$ max ($I_D=3A$, $V_{GS}=10V$)											2SK539
																			2SK540
																			2SK541
																			2SK542
																			2SK543
																			2SK544
																			2SK545
																			2SK546
																			2SK547
																			2SK548
																			2SK549
																			2SK550

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)						電気的特性 (Ta=25°C)															
				V_{GDS} V_{GDO}* V_{GDX}** (V)	V_{DSX} V_{DSS}* (V)	V_{GSO} V_{GSS}* V_{GSX}** (V)	I_G I_D* (mA)	P_d P_{ch}* (mW)	T_j T_{ch}* (°C)	I_{GSS} max (nA) (pA)*	V_{GS} (V)	I_{DSS} (mA) min	max	V_{DS} (V)	$V_{GS(off)}$, V_{th}* (V) min	max	V_{DS} (V)	I_D (μA)	g_m (mS) μ* min	typ	max	V_{DS} (V)	g_{os} (mS) r_D* (Ω) I_D (mA)	typ	max
2SK551																									
2SK552																									
2SK553																									
2SK554																									
2SK555																									
2SK556																									
2SK557																									
2SK558																									
2SK559																									
2SK560																									
2SK561																									
2SK562																									
2SK563																									
2SK564																									
2SK565																									
2SK566																									
2SK567																									
2SK568																									
2SK569																									
2SK570																									
2SK571																									
2SK572	東芝	DC-DCコンバータ	MOS		150*			100W							1.5*	3.5*		1mA		(S) 6.5		10	10A		
2SK573	〃	〃	〃		250*			100W							1.5*	3.5*		1mA		(S) 6.5		10	10A		
2SK574																									
2SK575																									

電気的特性 (Ta=25°C)																その他	代替品型名	外形	型名
C_{is} (pF)				C_{rs} (pF)				NF (f=1kHz, R_g=1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)							
typ	max	V_{GS}(V) I_D(mA)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{GD}(V) V_{GS}(V)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)				
																			2SK551
																			2SK552
																			2SK553
																			2SK554
																			2SK555
																			2SK556
																			2SK557
																			2SK558
																			2SK559
																			2SK560
																			2SK561
																			2SK562
																			2SK563
																			2SK564
																			2SK565
																			2SK566
																			2SK567
																			2SK568
																			2SK569
																			2SK570
																			2SK571
								$R_{DS(ON)}$=0.18Ω max (I_D=10A, V_{GS}=10V)											2SK572
								$R_{DS(ON)}$=0.3Ω max (I_D=10A, V_{GS}=10V)											2SK573
																			2SK574
																			2SK575

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)						電気的特性 (Ta=25°C)															
					V_{GDS} V_{GDO}* V_{GDX}** (V)	V_{DSX} V_{DSS}* (V)	V_{GSO} V_{GSS}* V_{GSX}** (V)	I_G I_D* (mA)	P_d P_{ch}* (mW)	T_j T_{ch}* (°C)	I_{GSS} max (nA) (pA)*	V_{GS} (V)	I_{DSS} (mA) min	max	V_{DS} (V)	$V_{GS(off)}$, V_{th}* (V) min	max	V_{DS} (V)	I_D (μA)	g_m (mS) μ* min	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	g_{os} (mS) r_D* (Ω) typ	max
	2SK109A	三　菱	低周波，低雑音	J	−50*		−50	10,20*	150 unit	125	−1	−30	1	12	10		−3	10	10	6	15		10	IDSS		
	2SK127A	松　下	低周波	〃	−80			10,20*	250	125			0.5	12	10					3			10	〃		
	2SK130A	日　電	低周波，低雑音	〃	−30*	30	−30	10,50*	250	125	−1	−20	5	30	5		−1.5	5	10	28			5	〃		
★	2SK134Ⓗ	日　立	高速度電力SW	MOS		140	±15*	7A	100W*	150*						0.15	1.45	10	100mA	0.7	(S) 1	1.4	10	3A		
★	2SK135Ⓗ	〃	〃	〃		160	±14*	7A*	100W*	150*						0.15	1.45	10	100mA	0.7	(S) 1	1.4	10	3A		
	2SK160A	日　電	低周波，VHF	J	−50*		−50	10,20*	150	125	−1	−30	0.5	12	5	−0.25	−4.5	5	10	1.5	2.1		5	0.5		
	2SK176Ⓗ	日　立	高周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		200*	±20	8A*	125W	150				3	160	0.55*	3*	10	100mA	0.7	(S)	1.4	10	3A		
★	2SK192A	東　芝	FM，VHF	J	−18*			10	200	125	−10	−1	3	24	10	−1.2		10	1		7		10	IDSS		
	2SK214Ⓚ	日　立	高周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		160	±15*	500*	30W*	150*						0.2*	1.5*	10	10mA	20	40		20	10		
	2SK216Ⓚ	〃	〃	〃		216	±15*	500*	30W*	150*						0.2*	1.5*	10	10mA	20	40		20	10		
	2SK293A	日　電	高耐圧高速度 大電流SW	〃		300*	±20*	7A*	100W	150*	±100	±20		1	300	0.4	3	10	50mA	0.6	(S) 1		10	3A		
	FLC08ME	富士通	Cバンド高出力	GaAs		15	−5		3W	175*				450	5	−2		3	10mA		100		5	160		
	FLC15ME	〃	〃	〃		15	−5		6W	175*				900	5	−2		3	20mA		200		5	300		
	FLC30ME	〃	〃	〃		15	−5		11.5W	175*				1.8A	5	−2		3	40mA		400		5	600		
	FLC081WF	〃	〃	〃		15	−5		3.3W	175*				550	5	−2		3	10mA		130		5	200		
	FLC151WF	〃	〃	〃		15	−5		6.5W	175*				1.1A	5	−2		3	20mA		250		5	400		
	FLC301MG-4	〃	〃	〃		15	−5		15W	175*				2.2A	5	−2		3	40mA		500		5	800		
	FLC301MG-6	〃	〃	〃		15	−5		15W	175*				2.2A	5	−2		3	40mA		500		5	800		
	FLC301MG-8	〃	〃	〃		15	−5		15W	175*				2.2A	5	−2		3	40mA		500		5	800		
	FLM3742-3	〃	〃	〃		15	−5		18.8W	175*				2.4A	5	−2		3	50mA		500		5	800		
	FLM3742-5	〃	〃	〃		15	−5		26.3W	175*				4.4A	5	−2		3	80mA		(S) 1		5	1.6A		
	FLM4450-3	〃	〃	〃		15	−5		18.8W	175*				2.4A	5	−2		3	50mA		500		5	800		
	FLM4450-5	〃	〃	〃		15	−5		26.3W	175*				4.4A	5	−2		3	80mA		(S) 1		5	1.6A		
	FLM5964-3	〃	〃	〃		15	−5		18.8W	175*				2.4A	5	−2		3	50mA		500		5	800		
	FLM5964-5	〃	〃	〃		15	−5		26.3W	175*				4.4A	5	−2		3	80mA		(S) 1		5	1.6A		

電気的特性 (Ta=25°C)																その他	代替品型名	外形	型名	
C_{iss} (pF)				C_{rss} (pF)				NF (f=1kHz, R_g=1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)								
typ	max	V_{GS}(V) I_D(mA)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{GD}(V) V_{GS}(V)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)					
20		0	10					(f=100Hz, R_g=1kΩ) 1	2.5	10	1	ΔV_{GS}=30mVmax (V_{DS}=10V, I_D=1mA)						84	2SK109A	
								NV=80mVmax (V_{DS}=10V, I_D=1mA, R_g=100kΩ)										80	2SK127A	
55		5*	10	10		5mA	10	1.2	(R_g=100Ω) 2	5	5					NF=3dB max (V_{DS}=5V, I_D=5mA / f=100Hz, R_g=100Ω)		53A	2SK130A	
600		−5	10	10		−5*	10	$V_{DS(sat)}$=12Vmax (I_D=7A, V_{GD}=0)								2SJ49Ⓗとコンプリメンタリ		28A	2SK134Ⓗ	★
600		−5	10	10		−5*	10	〃								2SJ50Ⓗとコンプリメンタリ		28A	2SK135Ⓗ	★
4.1		0	10	0.9		0*	10											78A	2SK160A	
800		−5	10					t_{on}=60ns typ, t_{off}=200ns typ (I_D=2A, V_{GS}=15V, R_L=15Ω)										28A	2SK176Ⓗ	
					0.65	−10						2	3.5	10 (V_{DD})		PG=20dBtyp (f=100MHz)		88	2SK192A	★
90		10*	10	2.2		10mA	10	$V_{DS(sat)}$=2Vmax (I_D=10mA, V_{GD}=0)										116A	2SK214Ⓚ	
90		10*	10	2.2		10mA	10	〃										116A	2SK216Ⓗ	
950	1,500	−5	10	10		−5*	10	$V_{DS(ON)}$=5.2Vmax, $R_{DS(ON)}$=1.3Ωmax (V_{GS}=15V, I_D=4A)										108	2SK293A	
		P_{out}=28dBm typ, Gp=9dB typ (V_{DS}=8.5V, I_{DS}≒I_{DSS}/2, f=4GHz, P_{in}=19dBm)																145	FLC08ME	
		P_{out}=31dBm typ, Gp=7.5dB typ (V_{DS}=8.5V, I_{DS}≒I_{DSS}/2, f=4GHz, P_{in}=23.5dBm)																145	FLC15ME	
		P_{out}=34dBm typ, Gp=6.5dB typ (V_{DS}=8.5V, I_{DS}≒I_{DSS}/2, f=4GHz, P_{in}=27.5dBm)																145	FLC30ME	
		P_{out}=28.5dBm typ, Gp=6.5dB typ (V_{DS}=10V, I_{DS}≒I_{DSS}/2, f=8GHz, P_{in}=22dBm)																143	FLC081WF	
		P_{out}=30.5dBm typ, Gp=5.5dB typ (V_{DS}=10V, I_{DS}≒I_{DSS}/2, f=8GHz, P_{in}=25dBm)																143	FLC151WF	
		P_{out}=33dBm typ, Gp=8dB typ (V_{DS}=10V, I_{DS}≒I_{DSS}/2, f=4.2GHz, P_{in}=25dBm)																144	FLC301MG-4	
		P_{out}=33dBm typ, Gp=7dB typ (V_{DS}=10V, I_{DS}≒I_{DSS}/2, f=7.2GHz, P_{in}=26dBm)																144	FLC301MG-6	
		P_{out}=33dBm typ, Gp=6dB typ (V_{DS}=10V, I_{DS}≒I_{DSS}/2, f=8.5GHz, P_{in}=27dBm)																144	FLC301MG-8	
		P_{out}=35dBm typ (V_{DS}=10V, I_{DS}≒I_{DSS}/2, f=3.7~4.2GHz, P_{in}=28.5dBm)																146	FLM3742-3	
		P_{out}=37dBm typ (V_{DS}=10V, I_{DS}≒I_{DSS}/2, f=3.7~4.2GHz, P_{in}=28.5dBm)																146	FLM3742-5	
		P_{out}=35dBm typ (V_{DS}=10V, I_{DS}≒I_{DSS}/2, f=4.4~5.0GHz, P_{in}=29dBm)																146	FLM4450-3	
		P_{out}=37dBm typ (V_{DS}=10V, I_{DS}≒I_{DSS}/2, f=4.4~5.0GHz, P_{in}=29dBm)																146	FLM4450-5	
		P_{out}=35dBm typ (V_{DS}=10V, I_{DS}≒I_{DSS}/2, f=5.9~6.4GHz, P_{in}=30dBm)																146	FLM5964-3	
		P_{out}=37dBm typ (V_{DS}=10V I_{DS}≒I_{DSS}/2, f=5.9~6.4GHz, P_{in}=31dBm)																146	FLM5964-5	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)						電気的特性 (Ta=25°C)																
				V_{GDS} V_{GDO}* V_{GDX}** (V)	V_{DSX} V_{DSS}* (V)	V_{GSO} V_{GSS}* V_{GSX}** (V)	I_G I_D* (mA)	P_d P_{ch}* (mW)	T_j T_{ch}* (°C)	I_{GSS} (nA) (pA)* max	V_{GS} (V)	I_{DSS} (mA) min	max	V_{DS} (V)	$V_{GS(off)}$, V_{th}*(V) min	max	V_{DS} (V)	I_D (μA)	g_m (mS) μ* min	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	g_{os} (mS) r_D* (Ω) typ	max
FLM6472-5	富士通	Cバンド,高出力	GaAs		15	−5		26.3W	175*				4.4A	5	−2		3	80mA		(S) 1		5	1.6A		
FLM7177-5	〃	〃	〃		15	−5		26.3W	175*				4.4A	5	−2		3	80mA		(S) 1		5	1.6A		
FLM7785-4	〃	〃	〃		15	−5		26.3W	175*				4.4A	5	−2		3	80mA		(S) 1		5	1.6A		
★ FLS02W	〃	Sバンド,高出力	GaAs SB		12	−5		1.5W	175*				250	5	−2		3	1mA	22	50		5	50		
FLS09	〃	〃	〃		15	−5		3W	175*				450	5	−2		3	10mA	45	90		5	160		
FLS09ME	〃	〃	GaAs		15	−5		3W	175*				450	5	−2		3	10mA		90		5	160		
FLS16	〃	〃	〃		15	−5		6W	175*				900	5	−2		3	20mA		180		5	300		
FLS16ME	〃	〃	〃		15	−5		6W	175*				900	5	−2		3	20mA		180		5	300		
FLS31	〃	〃	〃		15	−5		11.5W	175*				1.8A	5	−2		3	40mA		350		5	600		
FLS31ME	〃	〃	〃		15	−5		11.5W	175*				1.8A	5	−2		3	40mA		350		5	600		
FLS50	〃	〃	GaAs SB		15	−5		15W	175*				2400	5	−2		3	50mA	250	500		5	800		
FLS50ME	〃	〃	GaAs		15	−5		15W	175*				2.4A	5	−2		3	50mA		500		5	800		
FLX03MB	〃	Xバンド 高出力，発振	〃		12	−5		2.5W	175*			typ 290		5						80		5	150		
FLX06MB	〃	〃	〃		12	−5		5W	175*			typ 650		5						150		5	300		
FLX12MB	〃	〃	〃		12	−5		8.8W	175*			typ 1500		5						300		5	700		
★ FLX30MB	〃	〃	〃		12	−5		15W	175*			typ 2500		5						500		5	1200		
FSX51W/WF	〃	Sバンド,低雑音	〃		5	−5		1W	175*			30	120	3	−1	−5	3	1mA	10	25		3	30		
FSX52W/WF	〃	Cバンド,低雑音	〃		12	−5		1.5W	175*			100	220	3	−2		3	2mA		50		3	60		
FSX53W/WF	〃	〃	〃		12	−5		3W	175*			200	450	3	−2		3	5mA		100		3	120		
M47F	松下	低周波，低雑音	J	−30	30	−30	30*	250	125	−1	−20	0.5	20	10	−0.1	−2	10	10	4	8		10	1		
MGF1202	三菱	L帯～C帯 低雑音増幅	GaAs	−6*	8	−6	100*	300	150*	−10μA	−3	30	100	3	−0.5	−5	3	100	25	35		3	30		
MGF1402	〃	S帯～X帯 低雑音増幅	〃	−6*	8	−6	100*	300	150*	−10μA	−3	30	100	3	−0.3	−5	3	100	25	35		3	30		
MGF1403	〃	S帯～Ku帯 低雑音増幅	〃	−6*	6	−6	80*	200	150*	−10μA	−3	20	80	3	−0.3	−5	3	100	20	30		3	30		
MGF1404	〃	〃	〃	−6*	6	−6	80*	200	150*	−10μA	−3	15	80	3	−0.3	−5	3	100	20	30		3	15		
MGF1412	〃	S帯～X帯 低雑音増幅	〃	−6*	8	−6	100*	300	150*	−10μA	−3	30	100	3	−0.3	−5	3	100	25	35		3	30		

電気的特性 (Ta=25°C)																その他	代替品型名	外形	型名	
C_{is} (pF)				C_{rs} (pF)				NF (f=1kHz, R_g=1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)								
typ	max	V_{GS}(V) I_D(mA)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{GD}(V) V_{GS}(V)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)					
		P_{out}=37dBm typ (V_{DS}=10V, I_{DS}≃I_{DSS}/2, f=6.4~7.2GHz, P_{in}=32dBm)																146	FLM6472-5	
		P_{out}=37dBm typ (V_{DS}=10V, I_{DS}≃I_{DSS}/2, f=7.1~7.7GHz, P_{in}=33dBm)																146	FLM7177-5	
		P_{out}=36dBm typ (V_{DS}=10V, I_{DS}≃I_{DSS}/2, f=7.7~8.5GHz, P_{in}=32dBm)																146	FLM7785-4	
		P_{out}=22dBm min, Gp=12dB typ (V_{DS}=10V, I_D=1/2 I_{DSS}, f=4GHz, P_{in}=11dBm)																93	FLS02W	★
		P_{out}=28dBm typ, Gp=9dB typ (V_{DS}=10V, I_D≃1/2 I_{DSS}, f=4GHz, P_{in}=19dBm)																94	FLS09	
		P_{out}=28dBm typ, Gp=9dB typ (V_{DS}=10V, I_{DS}≃I_{DSS}/2, f=4GHz, P_{in}=19dBm)																145	FLS09ME	
		P_{out}=31dBm typ, Gp=7.5dB typ (V_{DS}=10V, I_{DS}≃I_{DSS}/2, f=4GHz, P_{in}=23.5dBm)																94	FLS16	
		P_{out}=31dBm typ, Gp=7.5dB typ (V_{DS}=10V, I_{DS}≃I_{DSS}/2, f=4GHz, P_{in}=23.5dBm)																145	FLS16ME	
		P_{out}=34dBm typ, Gp=6.5dB typ (V_{DS}=10V, I_{DS}≃I_{DSS}/2, f=4GHz, P_{in}=27.5dBm)																94	FLS31	
		P_{out}=34dBm typ, Gp=6.5dB typ (V_{DS}=10V, I_{DS}≃I_{DSS}/2, f=4GHz, P_{in}=27.5dBm)																145	FLS31ME	
		P_{out}=36dBm typ, Gp=5.5dB typ (V_{DS}=10V, I_D≃1/2 I_{DSS}, f=4GHz, P_{in}=30.5dBm)																94	FLS50	
		P_{out}=36dBm typ, Gp=5.5dB typ (V_{DS}=10V, I_{DS}≃I_{DSS}/2, f=4GHz, P_{in}=30.5dBm)																145	FLS50ME	
		P_{out}=23dBm min, Gp=8dB typ (V_{DS}=10V, I_D=1/2 I_{DSS}, f=12GHz, P_{in}=16dBm)																95	FLX03MB	
		P_{out}=26dBm min, Gp=7dB typ (V_{DS}=10V, I_D=1/2 I_{DSS}, f=12GHz, P_{in}=20dBm)																95	FLX06MB	
		P_{out}=29.5dBm min, Gp=5.5dB typ (V_{DS}=10V, I_D=1/2 I_{DSS}, f=12GHz, P_{in}=25dBm)																95	FLX12MB	
		P_{out}=34dBm min, Gp=5dB typ (V_{DS}=10V, I_D=1/2 I_{DSS}, f=8GHz, P_{in}=30dBm)																95	FLX30MB	★
		P_{out}=18dBm typ, Gp=10dB typ (V_{DS}=8V, I_D≃1/2 I_{DSS}, f=8GHz, P_{in}=8dBm)																96 (W) 130 (WF)	FSX51W/WF	
		P_{out}=23dBm typ, Gp=10dB typ (V_{DS}=8V, I_D≃1/2 I_{DSS}, f=8GHz, P_{in}=13dBm)																	FSX52W/WF	
		P_{out}=25dBm typ, Gp=8dB typ (V_{DS}=8V, I_D≃1/2 I_{DSS}, f=8GHz, P_{in}=17dBm)																	FSX53W/WF	
		e_n=1.9nV/$\sqrt{Hz}$ typ (V_{DS}=10V, I_D=1mA, f=1kHz)																38	M47F	
												(f=4GHz) 1.4	1.8	3	10	Gs=11dB typ (f=4GHz)		166	MGF1202	
				最大発振周波数 70GHz typ								(f=4GHz) 1.1	1.4	3	10	Gs=13dB typ (f=4GHz)		122	MGF1402	
				〃 90GHz typ								(f=12GHz) 1.8	2.3	3	10	Gs=10.5dB typ (f=12GHz)		122	MGF1403	
												(f=12GHz) 1.6	1.7	3	10	Gs=10.5dB typ (f=12GHz)		122	MGF1404	
				最大発振周波数 70GHz typ								(f=4GHz) 0.8	1.0	3	10	Gs=13dB typ (f=4GHz)		122	MGF1412	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C) V_{GDS} V_{GDO}* V_{GDX}** (V)	V_{DSX} V_{DSS}* (V)	V_{GSO} V_{GSS}* V_{GSX}** (V)	I_G I_D* (mA)	P_d P_{ch}* (mW)	T_j T_{ch}* (°C)	電気的特性 (Ta=25°C) I_{GSS} max (nA) (pA)*	V_{GS} (V)	I_{DSS} (mA) min	max	V_{DS} (V)	$V_{GS(off)}$, V_{th}*(V) min	max	V_{DS} (V)	I_D (μA)	g_m (mS) μ* min	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	g_{os} (mS) r_D* (Ω) typ	max
MGF1801	三菱	S帯～X帯 中電力増幅	GaAs	−8*	8	−8	250*	1W	150*	−20μA	−3	150	250	3	−1.5	−6	3	100	70	90		3	100		
MGF1802	〃	C帯～X帯 中電力増幅	〃		8	−8	250*	1.5W	150*			150	250	3	−2	−6	3	100	70	90		3	100		
MGF2116	〃	S帯～X帯 中電力増幅	〃		11	−10	550*	3W	150*			300	550	3	−2	−7	3	1mA		175		3	200		
MGF2117	〃	C帯～X帯 中電力増幅	〃		11	−10	550*	3W	150*			300	550	3	−2	−7	3	1mA		175		3	200		
MGF2124	〃	C帯～Ku帯 電力増幅	〃		11	−11	800*	4.2W	150*			450	800	3	−2	−7	3	1mA	180	250		3	300		
MGF2124F	〃	～Ku帯 電力増幅	〃		11	−11	800*	4W	150*			450	800	3	−2	−7	3	1mA	180	250		3	300		
MGF2124G	〃	〃	〃		11	−11	800*	4W	150*			450	800	3	−2	−7	3	1mA	180	250		3	300		
MGF2148	〃	C帯～Ku帯 電力増幅	〃		11	−11	1.6A*	8.3W	150*			(A) 0.9	1.6	3	−2	−7	3	1mA	360	500		3	600		
MGF2148F	〃	～Ku帯 電力増幅	〃		11	−11	1.6A*	8W	150*			(A) 0.9	1.6	3	−2	−7	3	1mA	360	500		3	600		
MGF2148G	〃	〃	〃		11	−11	1.6A*	8W	150*			(A) 0.9	1.6	3	−2	−7	3	1mA	360	500		3	600		
MGF2172	〃	S帯～X帯 電力増幅	〃		11	−11	2.3A*	12.5W	150*			(A) 1.5	2.3	3	−2	−7	3	1mA	540	750		3	900		
MGF2205	〃	S帯～C帯 電力増幅	〃		11	−11	3.6A*	12.5W	150*			(A) 2	3.6	3	−2	−7	3	10mA		800		3	1.4A		
MGF-X34M	〃	10GHz 電力増幅	〃		11	−11	2.3A*	12.5W	150*			(A) 1.5	2.3	3	−2	−7	3	1mA	540	750		3	900		
★ MK10	〃	DC～VHF	J	−30*	20	−10	10, 20*	150	125	−100	−10	1	20	10		−8	10	10	1.9	4		10	I_{DSS}	0.05	
★ μPA50A	日電	低周波	〃	−60*	60	±60	10, 20*	200 unit	150	−10	−10	(Q_1, 1.5	Q_2) 18	10	−0.3	−2.4	10	10	2	4	8	10	1		
μPA60A	〃	差動増幅	〃	−40*	40	−40	50	250 unit	175	−0.1	−20	0.5	5	10	−0.2	−2.5	10	10	1	2		10	0.5	0.015	
μPA61A	〃	〃	〃	−40*	40	−40	50	250 unit	175	−0.1	−20	0.5	5	10	−0.2	−2.5	10	10	1	2		10	0.5	0.015	
μPA62C	〃	差動増幅 バランスMIX	〃	−20*		−10	10, 32*	350	125	−50	−8	8	32	10	−0.35	−2.2	10	10	12.5	15		10	3		
μPA63H	〃	低周波	〃	−60*	60	−60	10, 30*	250 unit	125	−1	−20	1.5	20	10	−0.3	−4.2	10	10	2	4	8	10	1		
μPA68H	〃	低周波，低雑音	〃	−50*	50	−50	10, 30*	250 unit	125	−1	−20	1	18	10	−0.15	−2.5	10	10	5	7		10	1		
μPA70A	〃	DC	〃	−40*	40	−40	50	250	175	−0.1	−20	0.5	5	10	−0.2	−2.5	10	10	1	2		10	0.5	4	
μPA71A	〃	〃	〃	−40*	40	−40	50	250	175	−0.1	−20	0.5	5	10	−0.2	−2.5	10	10	1	2		10	0.5	4	
2SK437Ⓗ	松下	SHFチューナ 低雑音増幅		−6*	5	−6	120*	270	125*	−10μA	−3	20	120	3		−3.5	3	100	20	50	100	3	10		
2SK354A	日電	VHF～Cバンド 低雑音増幅	GaAs	−6*	5	−6	150*	300	125*	−10μA	−5	30	100	3	−0.8	−6	3	100	20	40	100	3	10		

電気的特性 (Ta=25°C)																その他	代替品型名	外形	型名	
C_{iss} (pF)				C_{rss} (pF)				NF (f=1kHz, R_g=1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)								
typ	max	V_{GS}(V) I_D(mA)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{GD}(V) V_{GS}(V)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)					
				最大発振周波数 45GHz typ												Gp=9dB typ (f=8GHz)		167	MGF1801	
																Gp=7dB typ (f=12GHz)		170	MGF1802	
				最大発振周波数 40GHz typ												Gp=7dB typ (f=12GHz)		169	MGF2116	
																Gp=7dB typ (f=12GHz)		170	MGF2117	
				最大発振周波数 35GHz typ												Gp=6dB typ (f=12GHz)		124	MGF2124	
																Gp=5.5dB typ (f=14GHz)		171	MGF2124F	
																Gp=5.5dB typ (f=14GHz)		172	MGF2124G	
				最大発振周波数 30GHz typ												Gp=5dB typ (f=12GHz)		124	MGF2148	
																Gp=4.7dB typ (f=14GHz)		171	MGF2148F	
																Gp=4.7dB typ (f=14GHz)		172	MGF2148G	
				最大発振周波数 25GHz typ												Gp=5.5dB typ (f=8GHz)		124	MGF2172	
																Gp=6.5dB typ (f=6GHz)		173	MGF2205	
																Gp=6dB typ (f=9.6~10.2GHz)		174	MGF-X34M	
				1.3				2		10	0.5	3.0		10	5	PG=20dB typ (f=100MHz)		9	MK10	★
(Q1, Q2) 5	7	1*	10	(Q1, Q2) 1.3	2	1mA	10	(f=10Hz) 60nV/√Hz 30		10	1	ΔIDSS=10%max (V_{DS}=10V)						44	μPA50A	★
2.5	5	0	10	0.5	1.5	0*	10					ΔV_{GS}=5mVmax (V_{DS}=10V, I_D=0.2mA)						111	μPA60A	
2.5	5	0	10	0.5	1.5	0*	10					ΔV_{GS}=40mVmax (V_{DS}=10V, I_D=0.2mA)						111	μPA61A	
7.5		3*	10	2.5		3mA	10					2	(f=400MHz)	10	3	PG=12dB typ (f=400MHz)		76	μPA62C	
6	8	1*	10	1.6	2.5	1mA	10	(f=10Hz, nV√Hz) 10	30	10	1	ΔV_{GS}=60mVmax (V_{DS}=10V, I_D=1mA)						66	μPA63H	
15		0	10	3		0*		NV=35mVmax (V_{DD}=15V, R_g=1kΩ), ΔV_{GS}=20mVmax (V_{GS}=10V, I_D=1mA)										66	μPA68H	
	5	0	10		1.5	0*	10	ΔV_{GS}=5mVmax (V_{DS}=10V, I_D=200μA)								e_n=10nV√Hz max (V_{DS}=10V, I_D=200μA, f=1kHz)		77	μPA70A	
	5	0	10		1.5	0*	10	ΔV_{GS}=40mVmax (V_{DS}=10V, I_D=200μA)								e_n=20nV√Hz max (V_{DS}=10V, I_D=200μA, f=10Hz)		77	μPA71A	
												1.6	(f=12GHz) 1.8	3	10	雑音最小電力利得 10.5dB typ (f=12GHz)		103	2SK437㊊	
								NF=2dB typ (f=8GHz)								MAG=10dB typ (f=8GHz), 7.5dB typ (f=12GHz)		9	2SK354A	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)						電気的特性 (Ta=25°C)															
					V_{GDS} V_{GDO}* V_{GDX}** (V)	V_{DSX} V_{DSS}* (V)	V_{GSO} V_{GSS}* V_{GSX}** (V)	I_G I_D* (mA)	P_d P_{ch}* (mW)	T_j T_{ch}* (°C)	I_{GSS} (nA) (pA)* max	V_{GS} (V)	I_{DSS} (mA) min	max	V_{DS} (V)	$V_{GS(off)}$, V_{th}*(V) min	max	V_{DS} (V)	I_D (μA)	g_m (mS) μ* min	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	g_{os} (mS) r_D* (Ω) typ	max
★	3SJ11	日　電	スイッチング	MOS		−30*	−30*	−10*	100	100*	−100	−10		−0.1μA	−10	−3.0	−6.5	−10	−10		0.8		−10	−10V (V_{GS})		
	3SJ11A	〃	DC スイッチング	〃		−30*	±40*	−50*	225*	75*	−10*	−10		−10μA	−10	−1.5	−3.5	−10	−10	0.5	1		−10	−1	0.07	
★	3SK11Ⓗ	日　立	小信号増幅	〃																						
★	3SK12Ⓗ	〃	チョッパ	〃																						
★	3SK13Ⓗ	〃	DC	〃																						
	3SK14	日　電	DC, チョッパ	〃		20	±30*	10*	100	100*	2*	10		3	10		−5	10	10	0.5	0.8		10	−1	0.01	
★	3SK15	三　菱	DC	〃		25	+2 −10	10*	100	100*	−10*	−10		10	6		−9	6	10	0.5	1.0		6	1	0.04	
★	3SK15A	〃	〃	〃		25	+2 −10	10*	100	100*	−10*	−10		10	6		−9	6	10	0.5	1.0		6	1	0.04	
★	3SK16	〃	チョッパ スイッチング	〃		25	+2 −10	10*	100	100*	−10*	−10		10	6		−9	6	1	0.5	1.0		6	1	0.04	
★	3SK17	〃	低周波	〃		25	+2 −10	10*	100	100*	−1	−10		10	6		−9	6	10	0.5	1.0		6	1	0.04	
★	3SK18	〃	チョッパ スイッチング	〃		15	±10*	10*	100	100*	−10*	−10		5	6		−6	6	10	0.5	1.0		6	1		0.3
★	3SK19	〃	VHF	〃		15	±10*	10*	100	100*	−10*	−10		5	6		−6	6	10	0.5	1.0		0	1	0.05	0.1
	3SK20Ⓓ	日　立	DC, 低周波	〃		20	+5** −20	10*	100*	150*	−1*	−6	0.4	5.0	6		−3.5	6	10	0.4			6	I_{DSS}		0.18
	3SK21Ⓓ	〃	チョッパ	〃		20	+5** −20	10*	100*	150*	−1*	−6	3	16	6		−6	6	10	2.5			6	〃		
	3SK22	東　芝	FM, VHF	J	−18*			10	200	150	−100	−10	3	24	10	−1.2		10	1		7.0		10	〃		
★	3SK23	〃	ビジコンカメラ ヘッドアンプ	〃	−15*			10	200	150	−100	−10	6	24	10	−1.8		−5.5	1	6		12	10			
★	3SK24	松　下		MOS																						
★	3SK25	〃		〃																						
	3SK28	東　芝	ビデオ, VHF	J	−18			10	200	150	−10	−15	3.7	22	10	−1.2	−5.5	10	1	4.5		13.0	10	I_{DSS}		
	3SK29	日　電	低周波	MOS		20	±30*	10*	80	100*	10*	10	1 (typ)		10		−5	10	10	0.5	0.8		10	1	0.01	
★	3SK30	日　立	FM/AM RF, MIX	J			−15*	10	200*	150*	−100	−10	3	20	10		−5	10	20	4	7.5		10	I_{DSS}		
★	3SK30A	〃	〃	〃			−18*	10	200*	150*	−100	−10	3	20	10		−6	10	20	4	7.5		10	〃		
★	3SK33	日　電	FM, VHF	MOS		25	±30*	20*	250	150*	−1	−10	4	15	10		−4	10	50	4	6		10	5		
★	3SK38	東　芝	チョッパ	〃	10	20*	10*	10*	200	125	200	10		50nA	6	0*	3*	6	50nA	0.35			6	3 (V_{GS})		
	3SK38A	〃	〃	〃	±12	20*	±12*	10*	200	125	±25	±12		50nA	6	0*	3*	6	50nA	0.35			6	3 (V_{G1S})		

電気的特性 (T_a=25°C)																		代替品型名	外形	型名	
C_{is} (pF)				C_{rs} (pF)				NF (f=1kHz, R_g=1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)				その他					
typ	max	V_{GS}(V) I_D(mA)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{GD}(V) V_{GS}(V)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)						
5		−10						R_{ON}=1kΩ max (V_{DS}=−1V, V_{GS}=−10V) $t_{ph(ON)}$=0.4μs typ $t_{ph(OFF)}$=0.4μs typ										3SJ11A	23	3SJ11	★
8		0	−10					R_{ON}=500Ωmax (V_{DS}=−1V, V_{GS}=−10V)											23	3SJ11A	
																		3SK20Ⓗ	26	3SK11Ⓗ	★
																		3SK21Ⓗ	26	3SK12Ⓗ	★
																		3SK20Ⓗ	26	3SK13Ⓗ	★
3		0	10					5		10	1								23	3SK14	
4		0	0																24	3SK15	★
4		0	0																24	3SK15A	★
4		0	0					R_{ON}=1kΩmax(V_{DS}=0.1V, V_{GS}=0), R_{OFF}=10MΩmin(V_{DS}=0.1V, V_{GS}=−6V)											24	3SK16	★
4		0	0																24	3SK17	★
0.3		1*	6	0.1		1mA	6	R_{ON}=1.2kΩmax(V_{DS}=0.1V, V_{G1S}=V_{G2S}=0) t_{ON}=20ns max t_{OFF}=25ns max											25	3SK18	★
0.3		1*	6	0.1		1mA	6					(200MHz) 4		6	1	PG=20dBtyp (f=200MHz)			25	3SK19	★
5		0	6																26	3SK20Ⓗ	
5		0	6					R_{ON}=300Ωmax (V_{DS}=0.1V, V_{G1S}=V_{G2S}=0), R_{OFF}=100MΩmin (V_{DS}=0.1V, V_{G1S}=−6V, V_{G2S}=0)											26	3SK21Ⓗ	
					0.6	−10						2	3.5	10 (V_{DD})		PG=20dBtyp (f=100MHz)			27	3SK22	
	3	0	0	0.4		−10												3SK28	27	3SK23	★
																			39	3SK24	★
																			39	3SK25	★
	6	0	10		0.6	−10			2.5	10	I_{DSS}		2.5	10 (V_{DD})		PG=17dBmin (f=100MHz)			27	3SK28	
3		0	10																23	3SK29	
5		0	10	0.4	0.6	0*	10					2.0	3.5	10 (V_{DD})		PG=17dBtyp (f=100MHz)		2SK54	29	3SK30	★
5		0	10	0.4	0.6	0*	10					2.0	3.5	10 (V_{DD})		PG=17dBtyp (f=100MHz)		2SK55	29	3SK30A	★
3		5*	10		0.3	5mA	10						3	10	5	PG=15dBmin (f=100MHz)			30	3SK33	★
	4.5	0	0		4.5	0	0	R_{ON}=500Ωmax (V_{DS}=10mV, V_{GS}=3V), R_{OFF}=100MΩmin (V_{DS}=±10nV, V_{GS}=0)										3SK38A	31	3SK38	★
	2.5	0	0		2.5	0*	0	ΔC_G=0.3pFmax, $R_{DS(ON)}$=500Ωmax (V_{DS}=10mV, V_{G1S}=3V, V_{G2S}=0)											31	3SK38A	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)						電気的特性 (Ta=25°C)															
				V_{GDS} V_{GDO}* V_{GDX}** (V)	V_{DSX} V_{DSS}* (V)	V_{GSO} V_{GSS}* V_{GSX}** (V)	I_G I_D* (mA)	P_d P_{ch}* (mW)	T_j T_{ch}* (°C)	I_{GSS} max (nA) (pA)*	V_{GS} (V)	I_{DSS} (mA) min	I_{DSS} (mA) max	V_{DS} (V)	$V_{GS(off)}$, V_{th}*(V) min	$V_{GS(off)}$, V_{th}*(V) max	V_{DS} (V)	I_D (μA)	g_m (mS) μ* min	g_m (mS) μ* typ	g_m (mS) μ* max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	g_{os} (mS) r_D* (Ω) typ	g_{os} (mS) r_D* (Ω) max
3SK71	日 電	エレクトレットコンデンサ・マイク	J		20		5,10*	150	125				I_D 0.5	(V_{DD}) 5					A_{vl}=−10.5dB min(V_{DD}=5V, C_{in}=10pF, f=1kHz)						
μPA33A	〃	DC, チョッパ	MOS		−30*	±30*	−20* unit	100 unit	100	−10	−10				−2.5	−5.5	−10	−10	1	2		−10	−1		
μPA34A	〃	〃	〃		20*	±30*	10* unit	100	75	10*	10		2.5	10		−5	10	50	0.3	0.6		10	I_{DSS}		
TX-429D	ソニー	可変抵抗	〃	(V_{DB}) −25	−20	(V_{GB}) −25	±15*	100	80	−0.2μA	−5	−6		−2	(V_{tho}) −0.4	−2.5	−1	−1		0.8		−1			
PM1210B	日 立	高速度電力SW	〃		120*	±20*	10A*	50W*	150*	±1μA	±20		1	100	1*	4.5*	10	1mA	1.5	(S) 2		10	5A		
PM1220B	〃	〃	〃		120*	±20*	20A*	80W*	150*	±1μA	±20		1	100	1*	4.5*	10	1mA	2.5	(S) 4		10	10A		
PM4550C	〃	〃	〃		450*	±20*	50A*	350W*	150*	±1μA	±20		1	350	2*	4*	10	1mA	8	(S) 12		10	25A		

電気的特性 (Ta=25°C)																その他	代替品型名	外形	型名
C_{is} (pF)				C_{rs} (pF)				NF (f=1kHz, R_g=1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)							
typ	max	V_{GS}(V) I_D(mA)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{GD}(V) V_{GS}(V)*	V_{DS} (V)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)	typ	max	V_{DS} (V)	I_D (mA)				
																		112	3SK71
15	20	0	0	R_{ON}=500Ωmax (V_{DS}=−0V, V_{GS}=−6V) ΔV_{th}=0.2V (V_{DS}=−10V, I_D=−10μA) Δg_m=10%max (V_{DS}=−10V, I_D=−1mA)														22	μPA33A
4		0	10					ΔI_{DSS}=0.1mAmax (V_{DS}=10V, V_{G1S}=0)										22	μPA34A
									R_{cho}=150～300Ω ($V_{GS}-V_{the}$=−100V, V_S=0, V_{BG}=10V, V_{DS}=−1V)									68	TX-429D
1,130		0	10	80		0*	10		$R_{DS(ON)}$=0.3Ω max (I_D=5A, V_{GS}=15V)									133	PM1210B
2,200		0	10	200		0*	10		$R_{DS(ON)}$=0.15Ω max (I_D=10A, V_{GS}=15V)									133	PM1220B
7,500		0	10	175		0*	10		$R_{DS(ON)}$=0.18Ω max (I_D=25A, V_{GS}=15V)									36	PM4550C

	型　名	社名	用　途	構造	最大定格 (Ta=25°C) V_{GDS} (V)	V_{DS} (V)	V_{GSO} (V)	I_D (mA)	P_d (mW)	T_{ch} (°C)	電気的特性 (Ta=25°C) I_{G1SS} I_{G2SS} max (nA)	V_{GS} (V)	I_{DSS} (mA) min	I_{DSS} (mA) max	V_{DS} (V) / V_{G2S} (V)	V_{P1} (V) max	V_{DS} (V) / V_{G2S} (V)	V_{P2} (V) max	V_{DS} (V) / V_{G1S} (V)	g_m (mS) min	g_m (mS) typ	g_m (mS) max	V_{DS} (V) / V_{G2S} (V)	I_D (mA) / V_{G1S}* (V)	g_{os} (mS) typ	g_{os} (mS) max
★	(デュアルゲート) 3SK32	松　下		MOS																						
★	3SK35	東　芝	VHF, RF, MIX	〃		20	±6	30	300	150	±100	±6	3	24	15/4	−4	15/4	−2	15/0		10		15/4	10		
	3SK37	ソニー	VHF, RF/MIX	〃		20	±8	25	230	120	±100	±8	4	20	10/5	−3	10/5	−3	10/0	7.5	9.5		10/5	5	(200MHz) 0.5	
	3SK39, 39Ⓩ	松　下	〃	〃		20	±8	24	250	150	±20	±8	1	24	10/5	−3	10/5	−3	10/0	7		18	10/5	5		
	3SK40	日　電	〃	〃		20	±7	25	250	150	±100	±5	4	25	10/4	−4	15/0	−4	15/0	8	10		15/4	5		
★	3SK41	〃	〃	〃		20	±7	25	250	150	±100	±5	4	25	10/4	−4	15/0	−4	15/0	8	10		15/4	5		
★	3SK44	東　芝	〃	〃		20	±6	45	300	150	±100	±6	3	40	15/4	−3.3	15/4	−3.3	15/0		13		15/4	10		
	3SK45	日　立	VHF, RF, MIX	〃		22	±7	35	330	150	±20	±7	4	32	15/4	−3	15/4	−2	15/0		14		15/4	10		
	3SK47	日　電	VHF, RF, MIX 可変抵抗用	〃		20	±7	25	300	150	±100	±5	4	25	10/4	−3	10/0	−3	10/0	8	16		10/4	5		
	3SK48	ソニー	UHF, RF/MIX	〃		18	+6 −4	30	240	110	±1μA	+6 −4	2	11	10/5	−3	10/5	−3	10/0		11		10/5	10		
	3SK49	松　下	VHF, RF/MIX	〃		20	±8	30	350	150	±20	±8	2.5	30	10/5	−3	10/5	−3	10/0		15		10/5	5		
	3SK49NC	〃	〃	〃		20	±8	30	350	150	±20	±8	2.5	30	10/5	−3	10/5	−2	10/0	8	15		10/5	5		
	3SK49Ⓩ	〃	〃	〃		20	±8	30	350	150	±20	±8	2.5	30	10/5	−3	10/5	−3	10/0	8		18	10/5	5		
	3SK51	日　立	VHF, RF, MIX	〃		20	±7	35	330	150	±20	±7	7	25	15/4	−3	15/4	−2.5	15/0		17		15/4	10		
	3SK53	〃	UHF, RF	〃		15	±8	33	330	150	±20	±8	0.1	30	10/5	−1.7	10/5	−1.1	10/0	11			10/5	20		
★	3SK55	東　芝	VHF, RF, MIX	〃		20	±9	30	300	150	±50	±7	3	24	15/4	−2.5	15/4	−2.5	15/0		16		15/4	10		
	3SK59	〃	〃	〃		20	±9	30	300	150	±50	±7	3	24	15/4	−2.5	15/4	−2.5	15/0		20		15/4	10		
	3SK60	日　立	VHF, RF	〃		15	±8	33	330	150	±20	±8		12	6/3	−1.7	10/3	−1.1	10/3	11	16		6/3	10		
	3SK61	ソニー	VHF, RF/MIX	〃		20	±8	25	230	120	±100	±8	4	20	10/5	−3	10/5	−3	10/0		9.5		10/5	5		
	3SK63	東　芝	VHF, RF	〃		20	±9	30	300	150	±50	±7	3	24	15/4	−2.5	15/4	−2.5	15/0		20		15/4	10		
	3SK66	松　下	UHF, RF	〃		20	±8	30	350	150	±20	±8	0.5	12	10/5	−3	10/5	−3	10/0	8			10/5	10		
	3SK70	日　立	〃	〃		20	±8	50	360	150	±20	±5	1	20	15/4	−3	15/4	−3	15/0	7	12		15/4	7		
	3SK72	松　下	VHF, RF	〃		20	±8	30	350	135	±20	±8	2.5	80	10/5	−3	10/5	−3	10/0	8	12	18	10/5	5		
	3SK73	東　芝	VHF, RF/MIX	〃		20	±9	30	300	125	±50	±7	3	14	15/4	−2.5	15/4	−2.5	15/0		20		15/4	10		
	3SK74	日　電	〃	〃		20	±10	25	200	125	±100	±10	7	25	6/3	−3	6/0	−3	6/0	17	20		6/3	10		

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C) V_{GDS} (V)	V_{DS} (V)	V_{GSO} (V)	I_D (mA)	P_d (mW)	T_{ch} (°C)	電気的特性 (Ta=25°C) I_{G1SS} I_{G2SS} max (nA)	V_{GS} (V)	I_{DSS} (mA) min	I_{DSS} (mA) max	V_{DS} (V) / V_{G2S} (V)	V_{P1} (V) max	V_{DS} (V) / V_{G2S} (V)	V_{P2} (V) max	V_{DS} (V) / V_{G1S} (V)	g_m (mS) min	g_m (mS) typ	g_m (mS) max	V_{DS} (V) / V_{G2S} (V)	I_D (mA) / V_{G1S}* (V)	g_{os} (mS) typ	g_{os} (mS) max
3SK76																									
3SK77	東芝	VHF, RF	MOS		20	±9	30	300	125	±50	±7	3	24	15/4	−2.5	15/4	−2.5	15/0		20		15/4	10		
★ 3SK78	〃	UHF, RF	〃		20	±9	30	300	150	±50	±7	3	24	15/4	−3.5	15/4	−3.5	15/0	8			15/4	10		
3SK79	松下	〃	〃		20	±8	30	350	135						−3	10/5	−3	10/0	8			10/5	10		
3SK80	日立	〃	〃		20	±8	50	200	125	±20	±5	1	20	15/4	−3	15/4	−3	15/0	7			15/4	7		
3SK81	〃	VHF, RF	〃		20	±8	35	200	125	±50	±8	5	25	15/4	−3	15/4	−2	15/0	8			15/4	10		
3SK82	〃	UHF, RF	〃		15	±8	33	200	125	±20	±8		20	6/3	−1.7	10/3	−1.1	10/3	13			6/3	10		
3SK83	〃	VHF, RF	〃		15	±8	33	200	125	±20	±8		20	6/3	−1.7	10/3	−1.1	10/3	13			6/3	10		
3SK84																									
3SK85	日立	VHF, RF	MOS		22	±8	35	200	125	±50	±8	4	32	15/4	−3	15/4	−2	15/0	10			15/4	10		
3SK86																									
3SK87	日電	UHF, RF	MOS		20	±10	25	200	125	±100	±10	0.5	8	10/4	−2	10/4	−0.7	10/4	18	22		10/4	10		
3SK88	〃	〃	〃		20	±10	25	200	125	±20	±10	0.01	6	10/4	−2	10/4	−0.7	10/4	14	17		10/4	10		
3SK89																									
3SK90																									
3SK91																									
3SK92																									
3SK93																									
3SK94																									
3SK95	日立	UHF, RF	MOS		15	±10	35	200	125	±100	±8		20	6/8	−2	10/3	−2	10/3	14			6/3	10		
3SK96	〃	VHF, RF	〃		15	±8	35	200	125	±100	±8	—	30	6/3	−2	10/3	−2	10/3	15			6/3	10		
3SK97	松下	UHF, RF	GaAs		13	−6	80	350	125	−20μA	−6	8.5	45	5/0	−6	5/0	−6	5/0	10	20		5/2	10		
3SK98																									
3SK99																									
3SK100	松下	UHF高利得低雑音増幅	MOS		15	±8	30	250	125	±20	±8	0.5	8	10/4	−3	10/4	−1.3	10/4	8	12.5		10/4	10		

電気的特性 (Ta=25°C)																その他	代替品型名	外形	型名	
C_{iss} (pF)		I_D (mA)	V_{DS} (V)	C_{rss} (pF)		I_D (mA)	V_{DS} (V)					NF (dB) (200MHz)		V_{DS} (V)	I_D (mA)					
typ	max	V_{G1S}* (V)	V_{G2S} (V)	typ	max	V_{G1S}* (V)	V_{G2S} (V)					typ	max	V_{G2S} (V)	V_{G1S}* (V)					
																			3SK76	
4.25		10	15/4	0.03	0.05	10	15/4					2.2	3.2	V_{DD}=15V		PG=20dB typ (f=200MHz)		92	3SK77	
					0.03	10	15/4					(f=800MHz) 4.5	5.5	15/4	10	PG=16dB typ (f=800MHz)	3SK102, 115	93	3SK78	★
												(f=800MHz)	5	15/10	10	PG=10dB min (f=800MHz)		91	3SK79	
	5	7	15/4	0.02		7	15/4					(f=900MHz)	6	15/4	7	PG=10dB min (f=900MHz)		115	3SK80	
5		10	15/4	0.03		10	15/4						3.3	15/4	10	PG=17dB min (f=200MHz)		115	3SK81	
	5	10	6/3	0.02		10	6/3					(f=900MHz)	5.5	6/3	10	PG=10dB min (f=900MHz)		115	3SK82	
	5	10	6/3	0.02		10	6/3						3	6/3	10	PG=20dB min (f=200MHz)		115	3SK83	
																			3SK84	
3.3		10	15/4	0.03		10	15/4						3.2	15/4	10	PG=18dB typ (f=200MHz)		115	3SK85	
																			3SK86	
2.5	3.5	10	10/4	0.02	0.03	10	10/4					(f=900MHz) 3.8	5.5	10/4	10	PG=18dB typ (f=900MHz)		114	3SK87	
2.0	2.5	10	10/4	0.02	0.03	10	10/4					(f=900MHz) 3.8	5.5	10/4	10	PG=16dB typ (f=900MHz)		114	3SK88	
																			3SK89	
																			3SK90	
																			3SK91	
																			3SK92	
																			3SK93	
																			3SK94	
2.6		10	6/3	0.02		10	6/3					(f=900MHz)	5.5	6/3	10	PG=10dB min (f=900MHz)		115	3SK95	
4.5		10	6/3	0.03		10	6/3						3	6/3	10	PG=22dB min (f=200MHz)		115	3SK96	
1.2	2	−6*	5/−6	0.02	0.04	−6*	5/−6					(f=1GHz) 1.7	2.8	5/2	10	PG=16dB typ (f=1GHz)		91B	3SK97	
																			3SK98	
																			3SK99	
1.6	2.5	−5*	10/−5	0.02		−5*	10/−5					(f=800MHz) 2.6	4	10/4	10	PG=14.5dB typ (f=800MHz)		91B	3SK100	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)						電気的特性 (Ta=25°C)															
				V_{GDS} (V)	V_{DS} (V)	V_{GSO} (V)	I_D (mA)	P_d (mW)	T_{ch} (°C)	I_{G1SS} I_{G2SS} max (nA)	V_{GS} (V)	I_{DSS} (mA) min	I_{DSS} (mA) max	V_{DS} (V) / V_{G2S} (V)	V_{P1} (V) max	V_{DS} (V) / V_{G2S} (V)	V_{P2} (V) max	V_{DS} (V) / V_{G1S} (V)	g_m (mS) min	g_m (mS) typ	g_m (mS) max	V_{DS} (V) / V_{G2S} (V)	I_D (mA) / V_{G1S}* (V)	g_{os} (mS) typ	g_{os} (mS) max
3SK101	東芝	VHF, RF, MIX	MOS		20	±9	30	200	125	±50	±7	3	24	15/4	−2.5	15/4	−2.5	15/0		20		15/4	10		
3SK102	〃	〃	〃		20	±9	30	200	125	±50	±7	3	24	15/4	−3.5	15/4	−3.5	15/0	8			15/4	10		
3SK103	日立	UHF, RF	〃		15	±10	35	200	125	±100	±8	—	10	6/3	−1	10/3	−1	10/3	10	15		6/3	10		
3SK104	〃	UHF, TVチューナ RF	〃		15	±10	35	200	125	±100	±8		20	6/3	−2	10/3	−2	10/3	14			6/3	10		
3SK105																									
3SK106																									
3SK107	三洋	VHF, RF	MOS		20	±7	30	250	125	±50	±7	2.5	24	10/4	−3	10/4	−2.5	10/0		17		10/4	10		
3SK108	〃	〃	〃		20	±15	30	250	125	50	V_{G1S}5V V_{G2S}10V	I_{DSX}(V_{G1S}=2V) 3	21	10/10	1.5	10/10	1.5	10/5	11	15		10/10	10		
3SK109																									
3SK110																									
3SK111																									
3SK112																									
3SK113	日立	UHF, TVチューナ RF	GaAs		12	±0.5 −6	80	200	125	−20μA	−6	10	80	5/0	−6	5/0	−6	5/0	10			5/0	10		
3SK114	東芝	TV, FMチューナ VHF, RF, MIX	MOS		15	±9	30	200	125	±50	±7	0	6	6/3	−1	6/3	−0.5	6/3	13	20		6/3	10		
3SK115	〃	TVチューナ UHF, RF, MIX	〃		15	±8	30	200	125	±50	±6	0	6	6/3	−1.5	6/3	−1	6/3		17		6/3	10		
3SK116	松下	VHF, RF	〃		20	±8	30	200	125	±20	±8	2.5	30	10/5	−3	10/5	−3	10/0	8	15		10/5	5		
3SK117																									
3SK118																									
3SK119																									
3SK120																									
3SK121	東芝	TVチューナ UHF, RF, MIX	GaAs		10	−6	50	200	125	−20μA	−5	20	45	5/0	−4	5/0	−4	5/0		17		5/0	10		
3SK122																									
3SK123	日電	UHF, TVチューナ RF	MOS		18	±10	25	200	125	±20	±8	0.01	6	10/4	−2	10/4	−0.7	10/4	14	18		10/4	10		
3SK124																									
3SK125																									

電気的特性 (Ta=25°C)																その他	代替品型名	外形	型名
C_{iss} (pF)		I_D (mA) / V_{G1S}* (V)	V_{DS} (V) / V_{G2S} (V)	C_{rss} (pF)		I_D (mA) / V_{G1S}* (V)	V_{DS} (V) / V_{G2S} (V)					NF (dB) (200MHz)		V_{DS} (V) / V_{G2S} (V)	I_D (mA) / V_{G1S}* (V)				
typ	max			typ	max							typ	max						
4.25		10	15 / 4	0.03	0.05	10	15 / 4					2.2	3.2	V_{DD}=15V		PG=20dB typ (f=200MHz)		125	3SK101
1.7		10	15 / 4		0.03	10	15 / 4					(f=800MHz) 4	5	15 / 4	10	PG=16dB typ (f=800MHz)		125	3SK102
2		10	6 / 3	0.02		10	6 / 3					(f=900MHz)	5	6 / 3	10	PG=10dB min (f=900MHz)		115	3SK103
2.6		10	6 / 3	0.02		10	6 / 3					(f=900MHz)	5	6 / 3	10	PG=10dB min (f=900MHz)		175A	3SK104
																			3SK105
																			3SK106
5.5		0*	10 / 4	0.02	0.05	0*	10 / 4					(f=100MHz) 2.2	3.5	10 / 4	10	PG=20dB min (f=100MHz)		128	3SK107
3		0*	10 / 10	0.02	0.05	0*	10 / 10					(f=100MHz) 1.8	2.5	10 / 10	10	PG=23dB min (f=100MHz)		128	3SK108
																			3SK109
																			3SK110
																			3SK111
																			3SK112
1.2		−6*	5 / −6	0.02		−6*	5 / −6					(f=900MHz) 1.5	3	5 / 0	10	PG=15dB typ (f=900MHz)		175A	3SK113
4.25	5.5	10	6 / 3	0.03	0.05	10	6 / 3					1.4	2.8	6 / 3	10	PG=25dB typ (f=200MHz)		125	3SK114
2		10	6 / 3	0.02		10	6 / 3					(f=800MHz) 3.2		6 / 3	10	PG=16dB typ (f=800MHz)		125	3SK115
4		−8*	10 / −8	0.01		−8*	10 / −8					2	3	15 / 7		PG=20dB typ (f=200MHz)		147A	3SK116
																			3SK117
																			3SK118
																			3SK119
																			3SK120
0.9	2	10	5 / 0	0.02	0.05	10	5 / 0					(f=800MHz) 1.5	2.5	5 / 1	10	PG=20.5dB typ (f=800MHz)		125	3SK121
																			3SK122
1.9	2.5	10	10 / 4	0.02	0.03	10	10 / 4					(f=900MHz) 2.8	4.5	10 / 4	10	PG=17dB typ (f=900MHz)		114	3SK123
																			3SK124
																			3SK125

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)						電気的特性 (Ta=25°C)																
				V_{GDS}	V_{DS}	V_{GSO}	I_D	P_d	T_{ch}	I_{G1SS} I_{G2SS} max		I_{DSS} (mA)		V_{DS} (V)	V_{P1} (V)	V_{DS} (V)	V_{P2} (V)	V_{DS} (V)	g_m (mS)			V_{DS} (V)	I_D (mA)	g_{os} (mS)	
				(V)	(V)	(V)	(mA)	(mW)	(°C)	(nA)	V_{GS} (V)	min	max	V_{G2S} (V)	max	V_{G2S} (V)	max	V_{G1S} (V)	min	typ	max	V_{G2S} (V)	V_{G1S}* (V)	typ	max
3SK126	東芝	TV, FMチューナ VHF, RF, MIX	MOS		15	±9	30	150	125	±50	±7	0	6	6/3	−1	6/3	−0.5	6/3	13	20		6/3	10		
3SK127	〃	UHF, TVチューナ RF, MIX	〃		15	±8	30	150	125	±50	±6	0	6	6/3	−1.5	6/3	−1	6/3		17		6/3	10		
3SK128																									
3SK129	松下	UHF, RF	GaAs		13	−3.5	50	350	125	±20	±3.5	8.5	40	5/0	−3.5	5/0	−3.5	5/0	18	25		5/1.5	10		
3SK130																									
3SK131	日電	VHF, TVチューナ RF, MIX	MOS		20	±8	25	200	125	±20	±8	7	25	6/3	−2	8/0	−1.5	8/0	22	28		6/3	10		
3SK132	〃	UHF チューナ RF	〃		20	±10	25	200	125	±20	±10	0.5	8	10/4	−2	10/4	−0.7	10/4	18	22		10/4	10		
3SK133	〃	UHF, TVチューナ RF	〃		20	±10	25	200	125	±20	±10	0.01	6	10/4	−2	10/4	−0.7	10/4	14	17		10/4	10		
3SK134																									
3SK135																									
3SK136	日立	VHF, TVチューナ RF	MOS		20	±8	35	150	125	±100	±8	5	25	15/4	−3	15/4	−2	15/0	8			15/4	10		
3SK137	〃	UHF, TVチューナ RF	〃		15	±10	35	150	125	±100	±8		20	6/3	−2	10/3	−2	10/3	14			6/3	10		
3SK138	〃	UHF, TVチューナ RF	〃		15	±10	35	150	125	±100	±8		10	6/3	−1	10/3	−1	10/3	10	15		6/3	10		
3SK139																									
3SK140	東芝	TVチューナ UHFRF, MIX	GaAs		10	−6	50	150	125	−20μA	−5	20	45	5/0	−4	5/0	−4	5/0		17		5/0	10		
3SK141	松下	UHF, RF	〃		13	−3.5	50	200	125	±20	±3.5	8.5	40	5/0	−3.5	5/0	−3.5	5/0	18	25		5/1.5	10		
3SK144																									
3SK145	東芝	TVチューナ UHFRF, MIX	MOS		13.5	±8	30	200	125	±50	±6	0	6	6/3	−1.5	6/3	−1	6/3		16		6/3	10		
3SK146	〃	〃	〃		13.5	±8	30	150	125	±50	±6	0	6	6/3	−1.5	6/3	−1	6/3		16		6/3	10		
3SK147																									
3SK148																									
3SK149																									
3SK150	東芝	TVチューナ UHFRF, MIX	MOS		15	±8	30	200	125	±50	±6	3	14	6/3	−1.5	6/3	−1	6/0	22	27		6/3	10		
3SK104V	日立	VHF, TVチューナ RF	〃		15	±10	35	200	125	±100	±8		20	6/3	−2	10/3	−2	10/3	14			6/3	10		
MGF1100	三菱	UHF, SHF 低雑音増幅	GaAs		8	−6	60	150	150			15	60	3/0	−5	3/0	−5	3/0	10	15		3/0	15		

電気的特性 (Ta=25°C)																その他	代替品型名	外形	型名
C_{is} (pF)		I_D (mA)	V_{DS} (V)	C_{rs} (pF)		I_D (mA)	V_{DS} (V)					NF (dB) (200MHz)		V_{DS} (V)	I_D (mA)				
typ	max	V_{G1S}* (V)	V_{G2S} (V)	typ	max	V_{G1S}* (V)	V_{G2S} (V)					typ	max	V_{G2S} (V)	V_{G1S}* (V)				
4.25	5.5	10	6/3	0.03	0.05	10	6/3					1.4	2.8	6/3	10	PG=25dB typ (f=200MHz)		176	3SK126
2		10	6/3		0.03	10	6/3					(f=800MHz) 3.2		6/3	10	PG=16dB typ (f=800MHz)		176	3SK127
																			3SK128
0.6	1.5	−3.5*	5/−3.5	0.02	0.04	−3.5*	5/−3.5					(f=1GHz) 1.2	2	5/1.5	10	PG=17dB typ (f=1GHz)		91B	3SK129
																			3SK130
5	6.5	10	6/3	0.05	0.08	10	6/3					1.3	2.5	10/5	10	PG=24dB typ (f=200MHz)		177	3SK131
2.5	3.5	10	10/4	0.02	0.03	10	10/4					(f=900MHz) 3.8	5.5	10/4	10	PG=18dB typ (f=900MHz)		177	3SK132
2	2.5	10	10/4	0.02	0.03	10	10/4					(f=900MHz) 3.8	5.5	10/4	10	PG=16dB typ (f=900MHz)		177	3SK133
																			3SK134
																			3SK135
5		10	15/4	0.03		10	15/4						3.3	15/4	10	PG=17dB min (f=200MHz)		176	3SK136
2.6		10	6/3	0.02		10	6/3					(f=900MHz)	5	6/3	10	PG=10dB min (f=900MHz)		176	3SK137
2		10	6/3	0.02		10	6/3					(f=900MHz)	5	6/3	10	PG=10dB min (f=900MHz)		176	3SK138
																			3SK139
0.9	2	10	5/0	0.02	0.05	10	5/0					(f=800MHz) 1.5	2.5	5/1	10	PG=20.5dB typ (f=800MHz)		176	3SK140
0.6	1.5	−3.5*	5/−3.5	0.02	0.04	−3.5*	5/−3.5					(f=1GHz) 1.2	2	5/1.5	10	PG=17dB typ (f=1GHz)		147B	3SK141
																			3SK144
1.8		10	6/3	0.02	0.03	10	6/3					(f=800MHz) 2.6	4	6/3	10	PG=17.5dB typ (f=800MHz)		125	3SK145
1.8		10	6/3	0.02	0.03	10	6/3					(f=800MHz) 2.6	4	6/3	10	PG=17.5dB typ (f=800MHz)		176	3SK146
																			3SK147
																			3SK148
																			3SK149
2.7	3.6	10	6/3	0.025	0.04	10	6/3	変換雑音指数 NFcs=5.5dB max (200/245MHz)								変換利得 Gcs=24.5dB typ(200/245MHz)		125	3SK150
2.6		10	6/3	0.02		10	6/3						3	6/3	10	PG=20dB min (f=200MHz)		175A	3SK104V
												(f=4GHz) 2.5	3.3	3/0	10	Gs=9dB typ (f=4GHz)		168	MGF1100

型　名	社名	用　　途	構造	最大定格 (Ta=25°C)						電気的特性 (Ta=25°C)															
				V_{GDS} (V)	V_{DS} (V)	V_{GSO} (V)	I_D (mA)	P_d (mW)	T_{ch} (°C)	I_{G1SS} I_{G2SS} max (nA)	V_{GS} (V)	I_{DSS} (mA) min	I_{DSS} (mA) max	V_{DS} (V) / V_{G2S} (V)	V_{P1} (V) max	V_{DS} (V) / V_{G2S} (V)	V_{P2} (V) max	V_{DS} (V) / V_{G1S} (V)	g_m (mS) min	g_m (mS) typ	g_m (mS) max	V_{DS} (V) / V_{G2S} (V)	I_D (mA) / V_{G1S}* (V)	g_{os} (mS) typ	g_{os} (mS) max
3SK151	東　芝	TVチューナ VHFRF, MIX	MOS		15	±8	30	150	125	±50	±6	3	14	6 / 3	−1.5	6 / 3	−1	6 / 0	22	27		6 / 3	10		

電気的特性 (T_a=25°C)													その他	代替品型名	外形	型名
C_{iss} (pF)		I_D (mA)	V_{DS} (V)	C_{rss} (pF)		I_D (mA)	V_{DS} (V)		NF (dB) (200MHz)		V_{DS} (V)	I_D (mA)				
typ	max	V_{G1S}* (V)	V_{G2S} (V)	typ	max	V_{G1S}* (V)	V_{G2S} (V)		typ	max	V_{G2S} (V)	V_{G1S}* (V)				
2.7	3.6	10	6 / 3	0.025	0.04	10	6 / 3	変換雑音指数 NF_{CS}=5.5dB max (200/245MHz)					変換利得 G_{CS}=24.5dB typ(200/245MHz)		176	3SK151

外形寸法図

	1	2	3
A	ゲート	ソース	ドレイン
B	ドレイン	ゲート	ソース

《寸法図単位：mm》

⑨
電極接続
1. ソース 3. ソース
2. ドレイン 4. ゲート
⑩
ソース
ドレイン
ゲート
マーク捺印面
⑪
電極接続
① ドレイン
② ソース
③ NC
④ ゲート
EIAJ:
JEDEC:
(注1) 公差指定のない寸法は代表値を示す。
⑫
電極接続
1.ゲート
2.ソース
3.ドレイン
⑬
電極接続
1.ソース
2.ゲート
3.ドレイン
⑭
電極接続
1.ソース
2.ゲート
3.ドレイン
⑮
電極接続
1.ゲート
2.ソース
3.ドレイン
⑯
電極接続
1. ドレイン
2. ソース
3. ゲート

《寸法図単位：mm》

⑰
4.2MAX
3.0
4.2MAX
電極接続
1.ソース
2.ドレイン
3.ゲート2
4.ゲート1
5.6±0.5
0.9
1.5
5.4MIN
3.4MIN
0.35
2.54
2.5
0.5
0.4
⑱
5.2MAX
5.5MAX
0.5ϕ
14MIN
1.77MAX
1.27
2.54
4.2MAX
電極接続
1．ソース
2．ゲート
3．ドレイン
⑲
9.40ϕMAX
8.50ϕMAX
1.02MAX
4.20~4.69
0.45ϕ
12.7MIN
CASE
S2
S1
G2
G1
D2
D1
底面図
5.08
1.14M
45°
0.86MAX
⑳
9.0MIN
4.0MAX
3.55
±0.05 ±0.05
1.25 1.25
0.45ϕ±0.05
0.9 ±0.1
2.5MAX
2.0
電極接続
1.ソース
2.ゲート
3.ドレイン
㉑
5. 4ϕMAX
4.95ϕ MAX
0.25
5.33MAX
12.5MIN
0.45ϕ
1.0
1.05
45°
2.54ϕ
電極接続
1．ドレイン
2．ゲート2
3．ゲート1
4．ソース・サブストレート ケース
㉒
9.40ϕMAX
8.50ϕMAX
0.38
0.2MIN
1.5MAX
4.50MAX
12.5MIN
0.45ϕ
4.5ϕMAX
D1 2 6 D2
G1 3
G2 5
S1 1 7 S2
4
Sub(Case)
45°
0.8
0.8
5.08ϕ

《寸法図単位：mm》

外形番号	1	2	3
28A	ゲート	ドレイン	ソース（ケース）
28B	ゲート	ソース	ドレイン（ケース）

〈寸法図単位：mm〉

	1	2	3
37A	ゲート	ソース	ドレイン
37B	ドレイン	ソース	ゲート

《寸法図単位：mm》

38
6.3MAX
18.5MAX
2.4±0.3
3.0MIN
0.6±0.15
1.5±0.25
2.54±0.25
2.0MAX
1.4
30°
3.0±0.3
電極接続
1. D1　5. D2
2. G1　6. G2
3. S1　7. S2
4. Sub
39
4.95φMAX
5.3MAX
12.7MIN
0.45φ
1MAX
1.05
45°
2.54φ
5.83φMAX
電極接続
1.ドレイン
2.ゲート2
3.ゲート1
4.ソース
40
5.2MAX
5.5MAX
14MIN
0.5
2.54
1.27
1.27
マーク
捺印面
1.77MAX
4.2MAX
電極接続
1．ゲート
2．ソース
3．ドレイン
41
9.5MAX
8.5MAX
0.38
6.6MAX
19.0MIN
0.45φ
45°
0.8
0.8
5.08φ
電極接続
1．ソース
2．ゲート
3．ドレイン(ケース)
42
22.22φMAX
1.5±0.3
11.0MAX
11.7±0.5
0.25Ⓜ
1.0φ +0.08 −0.03
39.94MAX
13R
4.5R
4.0φ±0.15
0.2Ⓜ
10.9
26.66MAX
16.89
30.2
電極接続
1.ゲート
2.ソース
3.ドレイン(ケース)
43
9.40φMAX
8.50φMAX
1.02MAX
4.20～4.69
0.45φ
12.7MIN
5.08
45°
0.86MAX
1.14MAX
電極接続
1．S1　4．S2
2．D1　5．D2
3．G1　6．G2
7．Case
44
9.40φMAX
8.50φMAX
0.2MIN
1.5MAX
4.50MAX
0.38
.45φ
12.5MIN
5 MAX
36°
0.8
0.8
36°
5.84φ
電極接続
1.D3 2.S1 3.G1 4.D1 5.D2
6.G2 7.S2 8.G3 9.S3 10.Sub
(ケース)
45
19φ±0.5
1.2±0.2
9.2±0.5
11.5±0.5
1φ±0.05
2-4φ ±0.1
ケース
10.9±0.3
26MAX
16.9±0.3
30.2±0.2
4
電極接続
1．ゲート
2．ソース
ケース：ドレイン

《寸法図単位：mm》

46
電極接続
1. ドレイン
2. ゲート2
3. ゲート1
4. ソース
（ケース）
47
JEDEC
電極接続
1. ゲート
2. ソース
3. ドレイン
48
JEDEC TO-18
電極接続
1. ゲート
2. ドレイン
3. ソース
49
JEDEC
電極接続
1. ドレイン2
2. ゲート2
3. ソース2
4. ソース1
5. ゲート1
6. ドレイン1
50
電極接続
1. ソース
2. ゲート
3. ドレイン
51
電極接続
1.ソース
2.ゲート
3.ドレイン
52
電極接続
1.ドレイン
2.ゲート
3.ソース
53
マーク捺印面
電極接続 A
1. ドレイン
2. ゲート
3. ソース
電極接続 B
1. ドレイン
2. ソース
3. ゲート

《寸法図単位：mm》

57 電極接続

	1	2	3
A	ドレイン	ソース	ゲート
B	ソース	ゲート	ドレイン

58 電極接続

	1	2	3
A	ソース	ゲート	ドレイン
B	ドレイン	ソース	ゲート

《寸法図単位：mm》

端子No.	機　能	端子No.	機　能
1	1D	5	2S
2	1G	6	2G
3	1S	7	2D
4	Sub		

《寸法図単位：mm》

69
5.8φMAX
4.95φMAX
0.5
5.2MAX
0.45φ
12.7MIN
2.54φ
45°
1.0
1.0
電極接続
1.ソース
2.ドレイン
3.ゲート(ケース)
70
4.2MAX
3.2MAX
0.55MAX
1.8
0.8
12.7MIN
0.4
1.27
1.27
0.95
1.15
0.4
2.6MAX
25°
電極接続
| | 1 | 2 | 3 |
A ソース ゲート ドレイン
B ドレイン ゲート ソース
C ドレイン ソース ゲート
71
5.84φMAX
4.95φMAX
5.33MAX
0.25
12.5MIN
0.45φ
45°
1.05
2.54φ
1.0
電極接続
1.ソース
2.ゲート(ケース)
3.ドレイン
72
4.5MAX
5.8MAX
1.5
0.8MAX
0.6MAX
10MIN
1.35
1.35
2.25R
0.5MAX
3.8MAX
1.1
2-0.3R
電極接続
1.ドレイン
2.ゲート
3.ソース
73
5.84φMAX
4.95φMAX
5.33MAX
0.25
12.5MIN
0.45φ
45°
1.05
2.54φ
1.0
電極接続
1.ソース
2.ドレイン
3.ゲート(ケース)
74
5.1MAX
8.2MAX
0.75MAX
1.0MAX
0.80MAX
0.60MAX
2.2MAX
1.0
10.5MIN
1.27
1.27
2.54
4.1MAX
0.6MAX
電極接続
| | 1 | 2 | 3 |
A ドレイン ゲート ソース
B ソース ドレイン ゲート
75
1.0C
17.8MAX
1.0C
1.5MIN
8.2MAX
2.5MIN
1.2±0.25
0.5±0.15
0.25±0.15
2.54±0.25
1.8
3.2±0.3
電極接続
1.ドレイン1
2.ゲート1
3.ソース1
4.サブストレート
5.ソース2
6.ゲート2
7.ドレイン

《寸法図単位：mm》

⑦⑧ 電極接続

	1	2	3
A	ドレイン	ソース	ゲート
B	ドレイン	ゲート	ソース

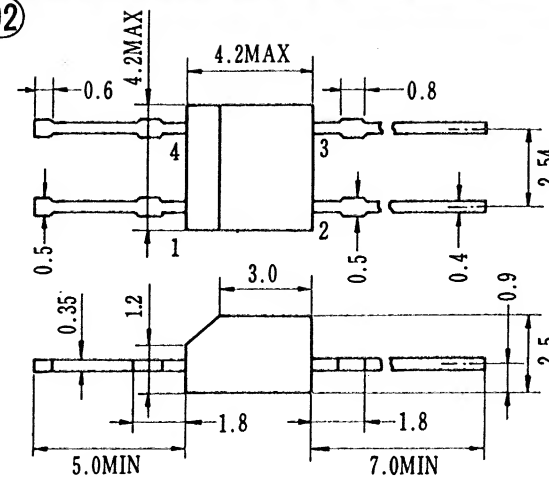
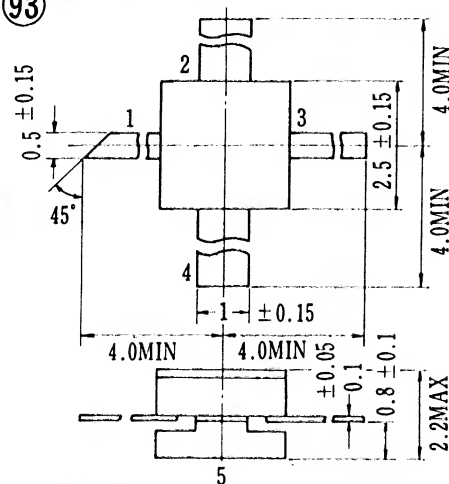
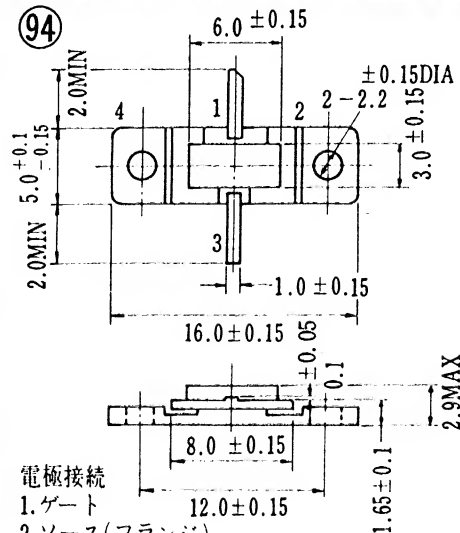
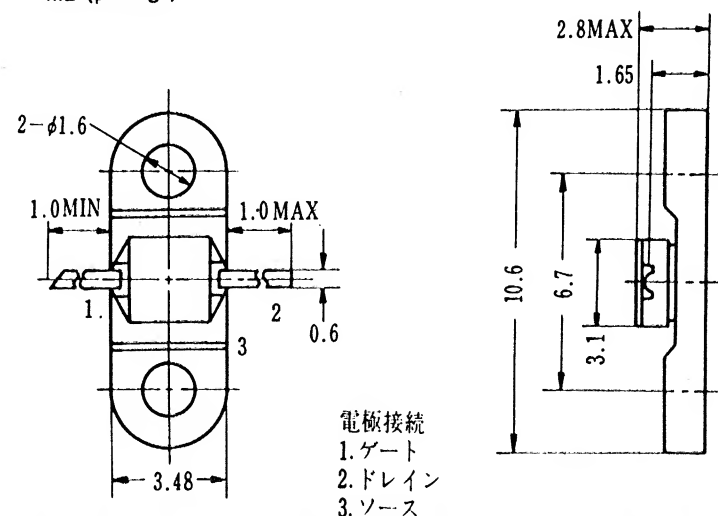
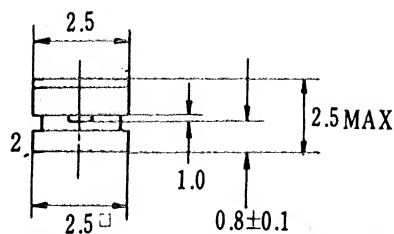
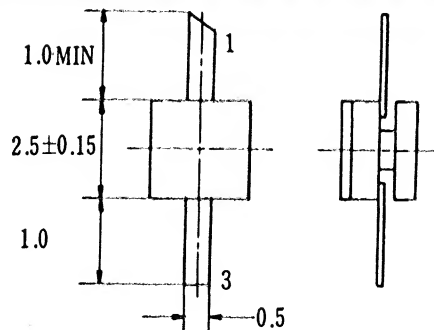
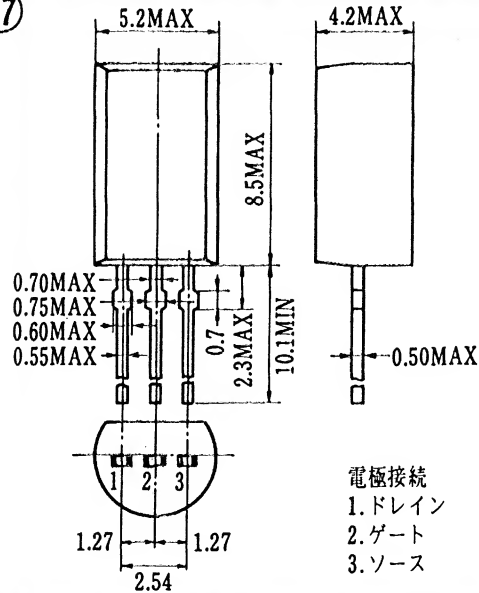
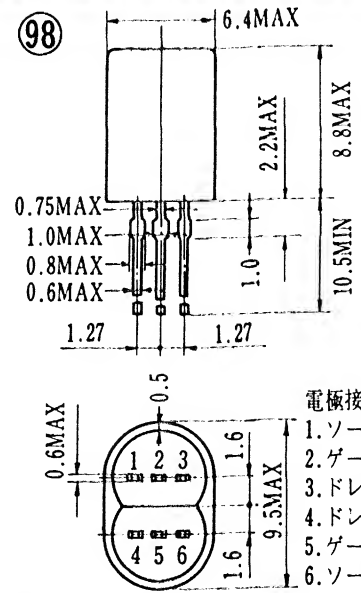
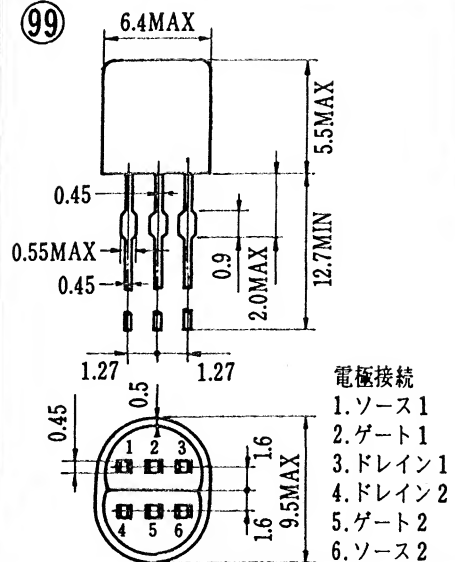
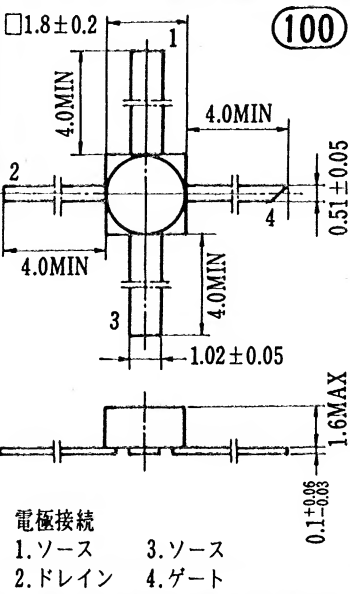
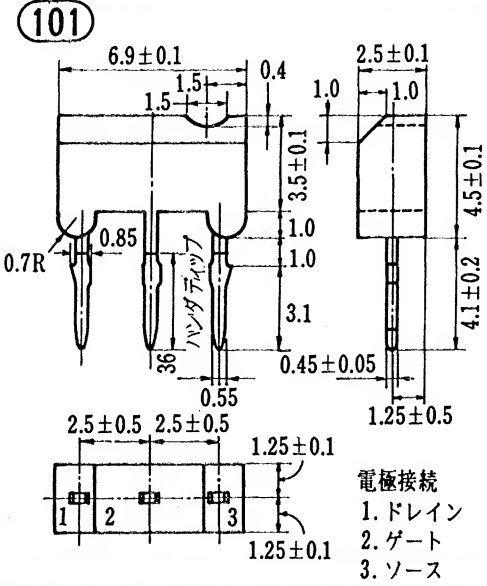
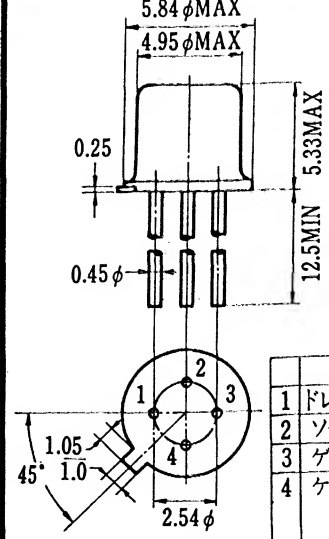
⑧⓪ 電極接続

	1	2	3
A	ドレイン	ゲート	ソース
B	ゲート	ソース	ドレイン
C	ドレイン	ソース	ゲート
D	ソース	ゲート	ドレイン

⑧② 電極接続

	1	2	3
A	ドレイン	ソース	ゲート
B	ソース	ゲート	ドレイン
C	ドレイン	ゲート	ソース

《寸法図単位：mm》

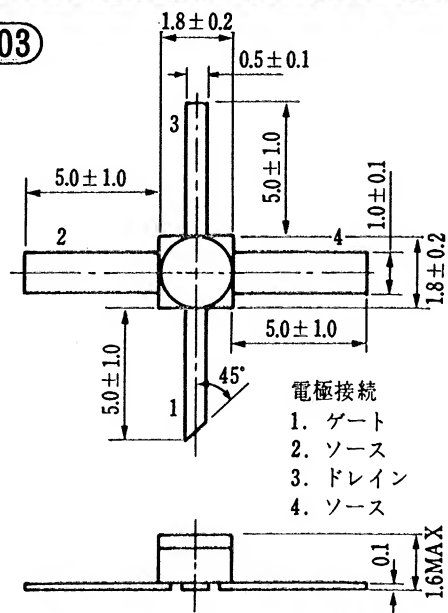
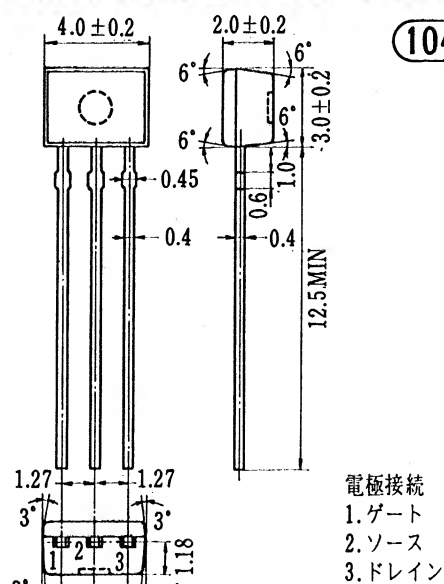
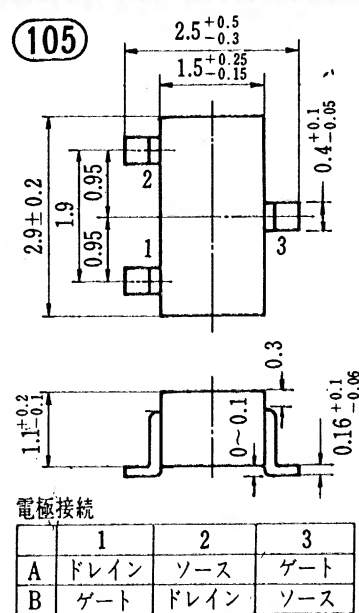
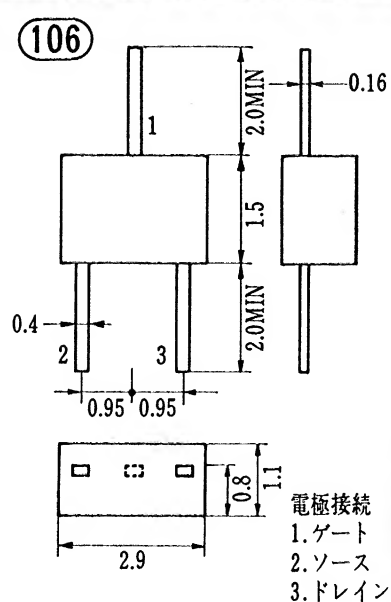
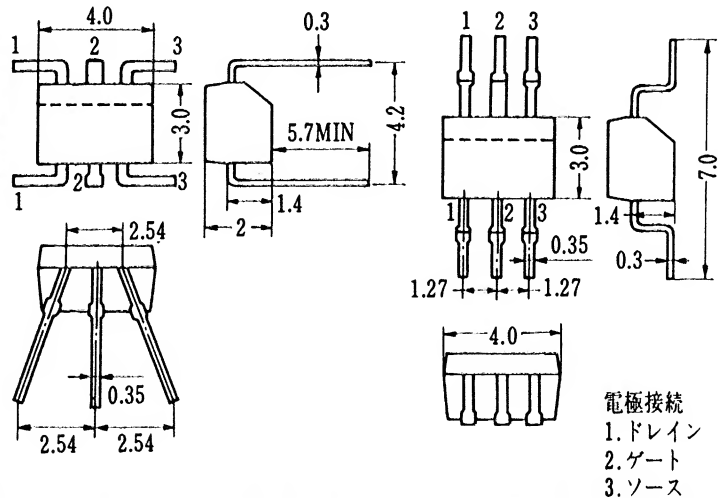
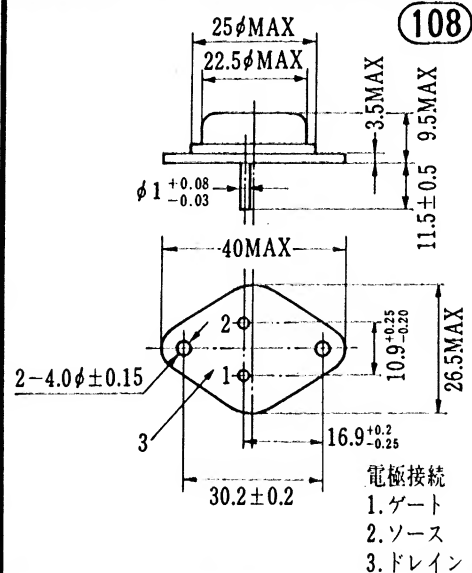
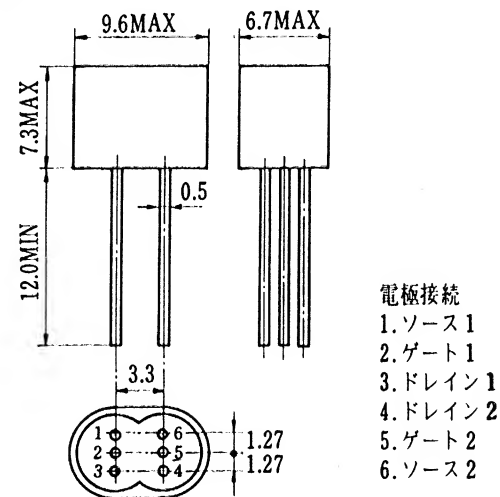
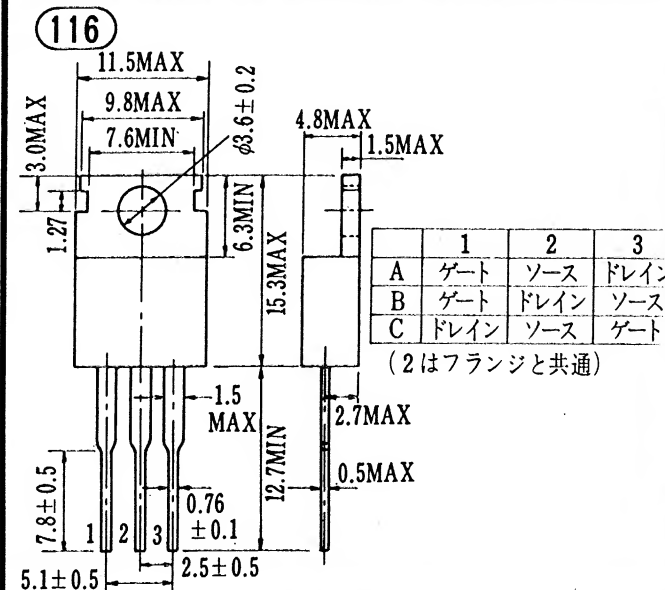
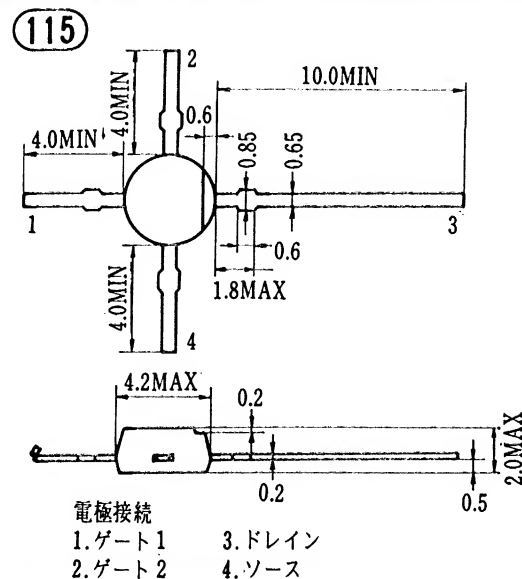
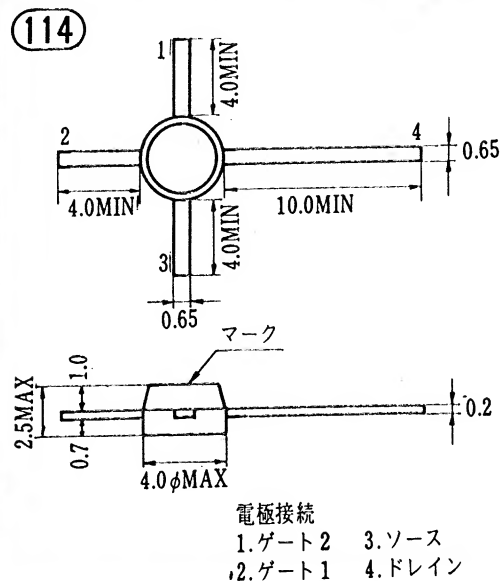
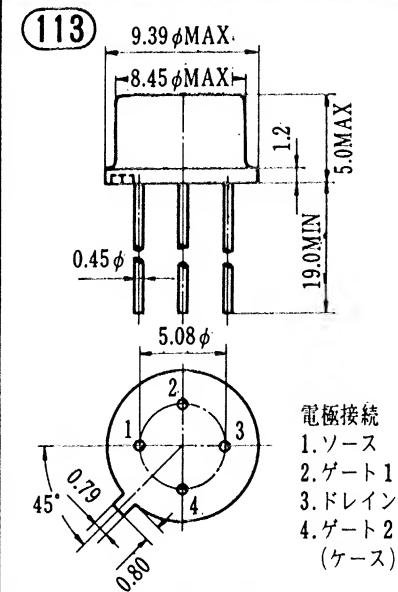
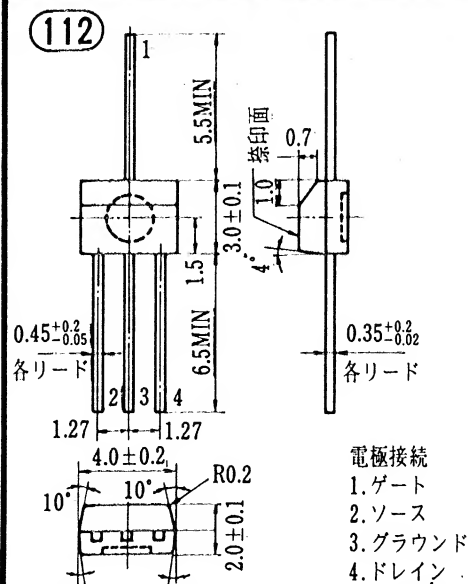
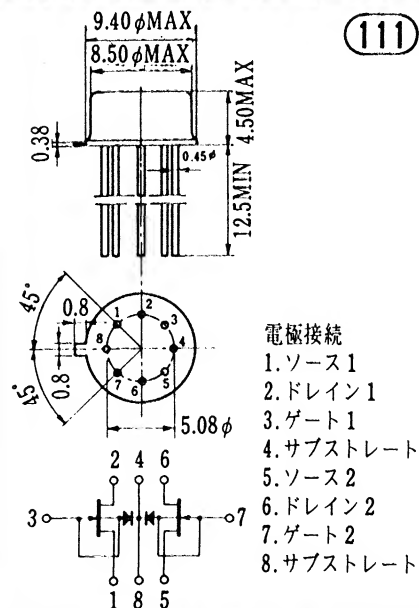
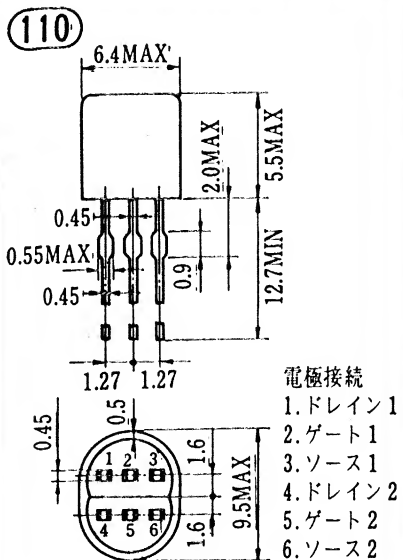
90
5.1MAX
4.7MAX
0.45
0.55
0.45
0.9
2.0MAX
12.7MIN
1.27
1.27
0.45
4.2MAX
1 2 3
電極接続
1.ドレイン
2.ゲート
3.ソース
91
0.65
4.0MIN
1.4
0.8
1.4
0.65
0.8
4.0MIN
0.65
4.0MIN
0.8
1.4
10.0MIN
0.65
Marking
0.1~0.3 R
1.2
1.9
0.5
0.2
3.8φ
電極接続
A
1.ドレイン
2.ソース
3.ゲート
4.NC
B
1.ドレイン
2.ソース
3.ゲート1
4.ゲート2
92
4.2MAX
0.6
4.2MAX
0.8
2.54
0.5
0.5
0.4
3.0
0.35
1.2
0.9
2.5
1.8
1.8
5.0MIN
7.0MIN
電極接続
1.ソース
2.ドレイン
3.ゲート2
4.ゲート1
93
0.5 ±0.15
45°
2.5 ±0.15
4.0MIN
4.0MIN
1 ±0.15
4.0MIN
4.0MIN
±0.05
0.1
0.8 ±0.1
2.2MAX
電極接続
1.ゲート
2.ソース
3.ドレイン
4.ソース
5.ソース
94
6.0 ±0.15
±0.15DIA
2 − 2.2
2.0MIN
5.0 +0.1 −0.15
3.0 ±0.15
2.0MIN
1.0 ±0.15
16.0±0.15
0.05
±0.1
2.9MAX
8.0 ±0.15
12.0±0.15
1.65±0.1
電極接続
1.ゲート
2.ソース(フランジ)
3.ドレイン
4.ソース(フランジ)
95
MB (package)
2−φ1.6
1.0MIN
1.0MAX
0.6
3.48
2.8MAX
1.65
10.6
6.7
3.1
電極接続
1.ゲート
2.ドレイン
3.ソース

《寸法図単位：mm》

	A	B
1	ドレイン	ドレイン
2	ソース	ゲート2
3	ゲート	ゲート1
4	ケース	ソース カプストレート (ケース)

《寸法図単位：mm》

	1	2	3
A	ドレイン	ソース	ゲート
B	ゲート	ドレイン	ソース

《寸法図単位：mm》

	1	2	3
A	ゲート	ソース	ドレイン
B	ゲート	ドレイン	ソース
C	ドレイン	ソース	ゲート

《寸法図単位：mm》

117
32MAX
24.4±0.2
15.2MAX
φ4.1±0.15
7.5±0.2
2.6MAX
2.7MAX
1.2MAX
4.5±0.5
19.5±0.5
5.45±0.3
10.9±0.5
5.8MAX
1.8MAX
(1.6typ)
15.0±0.3
0.7MAX
(0.5typ)
1.0MAX
3.6MAX
(3.2typ)
電極接続
	1	2	3
A	ゲート	ソース(フランジ)	ドレイン
B	ゲート	ドレイン(フランジ)	ソース
118
φ25.0MAX
φ21.0MAX
3.8MAX
2.8MAX
11.4MAX
φ1.0+0.09−0.03
11.6±0.5
30.2±0.2
16.9±0.2
φ4.0+0.08−0.15
10.90±0.2
26.0MAX
40.0MAX
電極接続
1.ゲート
2.ソース
ドレイン
(ケース)
119
15.9MAX
φ3.2±0.2
2.0
1.0
4.5
3.3MAX
2.0
9.0
20.0±0.3
13.5±0.5
2.0±0.3
1.0+0.3−0.25
5.45±0.2
5.45±0.2
1.8MAX
0.4+0.3−0.1
2.8
4.8MAX
電極接続
1.ゲート
2.ドレイン
(放熱板)
3.ソース
120
□2.03±0.2
4.0MIN
4.0MIN
4.0MIN
4.0MIN
0.51TYP
1.02TYP
1.6MAX
0.1TYP
電極接続
1.ソース
2.ドレイン
3.ソース
4.ゲート
121
φ9.4MAX
φ8.5MAX
電極接続
	A	B
1	ドレイン	ソース
2	ゲート	ゲート
3	ソース(ケース)	ドレイン(ケース)
0.4
6.6MAX
19.0MIN
φ0.46
90°
φ1.6
90°
45°
1.0
0.8
φ5.0
122
4MIN
4MIN
4MIN
4MIN
1±0.2
0.5±0.15
1±0.2
0.5±0.15
電極接続
①ゲート
②ソース
③ドレイン
0.1+0.1−0.05
□1.8±0.2*
1.1±0.3
*2SK279は□2.5±0.2

《寸法図単位：mm》

	1	2	3
A	ゲート	ソース	ドレイン
B	ソース	ゲート	ドレイン

《寸法図単位：mm》

129
18.6MAX
4.1MAX
φ3.3MAX
24.5MAX
5.1MAX 5.7MAX 5.1MAX
24.8MAX
φ12.8MAX
2.2MAX
4.4 MAX
2.7 MAX
電極接続
1.ソース
2.ソース
3.ソース
4.ソース
5.ドレイン
6.ゲート
130
1.0MIN
2.5±0.15
1.0MIN
2-φ1.6±0.1
0.6
2.5
0.1
2.5 MAX
0.8±0.1
6.1±0.1
8.5±0.2
電極接続
1.ゲート
2.ソース(フランジ)
3.ドレイン
4.ソース(フランジ)
131
5.8±0.2
2.4±0.1 1.5±0.2 1.9±0.1
0.95
0.95
1.90
1.45±0.2
2.9±0.2
0.8
電極接続
1.ソース
2.ドレイン
3.ゲート
132
5.0±0.2
4.0±0.2
5.1±0.2
13.5±0.5
2.54
2.3±0.2
電極接続
1.ドレイン
2.ゲート
3.ソース
133
50±0.5
(5)
2-5.4φ±0.2
13.5±0.5
29MAX
(13)
(3)
(12) (12)
3±0.3
17MAX
28MAX
62MAX
134
φ25.0MAX
φ21.0MAX
3.3MAX
2.8MAX
9.5MAX
30.2±0.2
16.9±0.24
40.0MAX
26.0MAX
電極接続
1.ゲート
2.ソース
ドレイン(ケース)

〈寸法図単位：mm〉

135
8.5MAX
φ3.2±0.2
3.8±0.2
12.0MAX
1 2 3
1.2
2.5±0.2
13.0MIN
0.8 +0.08 -0.05
2.3 2.3
2.8MAX
φ3.2±0.2
0.55 +0.08 -0.05
1.2
電極接続
1.ソース
2.ドレイン(ケース)
3.ゲート
136
8.5MAX
φ3.0±0.25
3.7±0.7
11.0±0.5
120°
2.3±0.3
1.1
15.6±0.5
0.75
2.29±0.5
4.58±0.5
3.1MAX
0.5
1.2
電極接続
1.ソース
2.ドレイン
3.ゲート
137
2.03±0.2
4.0MIN
4.0MIN
0.51
4.0MIN
4.0MIN
1.02
1.6MAX
0.1
電極接続
1.ソース
2.ドレイン
3.ソース
4.ゲート
138
10.3MAX
φ3.6±0.2
3.0
6.7MAX
15.3MAX
5.6MAX
13.0MIN
1.5MAX
0.76
2.54
2.54
4.7MAX
1.32
0.5
2.6
電極接続
1.ゲート
2.ドレイン(放熱板)
3.ソース
139
0.65
1.4
0.8
1.4
1.4
0.65
0.65
0.8
0.8
4.0MIN
4.0MIN
1.4
0.8
10.0MIN
marking
0.65
1.2
0.1~0.3R
1.9
0.5
0.2
φ3.8
電極接続
1.ドレイン
2.ソース
3.ゲート
4.NC
140
39.0±0.5
φ20.6MAX
2.5±0.2
10.7MAX
11.0±0.5
φ1.0±0.1
2-φ4.0±0.2
10.9±0.3
26.5MAX
16.9±0.3
30.2±0.25
電極接続
1.ゲート
2.ソース
3.ドレイン

〈寸法図単位：mm〉

141
20.5MAX.
φ3.3±0.2
電極接続
1.ゲート
2.ドレイン(放熱板)
3.ソース
142
10.3MAX
φ3.2±0.2
電極接続
1.ゲート
2.ドレイン(放熱板)
3.ソース
143
2-φ1.6
電極接続
1.ゲート
2.ソース(フランジ)
3.ドレイン
4.ソース(フランジ)
144
2-2.5±0.15
電極接続
1.ゲート
2.ソース(フランジ)
3.ドレイン
4.ソース(フランジ)
145
2-2.2±0.15DIA
電極接続
1.ゲート
2.ソース(フランジ)
3.ドレイン
4.ソース(フランジ)

〈寸法図単位：mm〉

146
2-R1.6±0.15
2.0MIN
12.9±0.2
2.0MIN
0.6
0.1
2.6±0.15
5.2MAX
10.7
1.6
12.0
17.0±0.15
21.0±0.5
0.2MAX
電極接続
1.ゲート
2.ドレイン
3.ソース
147
2.8 +0.2 −0.3
1.5
0.65±0.15
0.65±0.15
2.9±0.2
1.9±0.2
0.95
0.95
0.5R
(0.5R)
1.45±0.2
0.4 +0.1 −0.05
1.1 +0.2 −0.1
0.8
0.16 +0.1 −0.06
0.4±0.2
0~0.1
0.4±0.2
電極接続
| 1 | 2 | 3 | 4
A | ソース | ドレイン | ゲート1 | ゲート2
B | ソース | ドレイン | ゲート2 | ゲート1
148
9.5±0.3
5.5±0.30
0.50
0.45 +0.15 −0.10
5.0MIN
7.0MIN
1.27±0.20
1.5
0.65
0.45 +0.15 −0.10
2.54
1.50±0.30
2.50±0.30
1 2 3 4 5 6 7
電極接続
1.ドレイン1
2.ゲート1
3.ソース1
4.サーブストレート
5.ソース2
6.ゲート2
7.ドレイン2
149
16.0MAX
3.2φ±0.2
0.5
1.0
5.0±0.3
14.9±0.2
1.1TYP
2.7
1.6TYP
1.4MAX
1.4MAX
2.0TYP
18±0.5
1.0±0.2
5.45±0.2
5.45±0.2
5.0MAX
1.5
2.8
0.6±0.2
電極接続
1.ゲート
2.ドレイン(フランジ)
3.ソース
150
6.5
5.4
2.0MAX
5.5
2.5
0.75
0.8
1.1
0.75
2.29
2.29
Ⓢ Type
2.3
0.5
9.5
2.0
0.5
1.2
Ⓛ Type
16.3
電極接続
1.ゲート
2,4.ドレイン
3.ソース
151
4.3MAX
3.3MAX
12.5MIN
φ0.45
1.25
1.25
3.55
2.5MAX
0.9
電極接続
1.ソース
2.ゲート
3.ドレイン

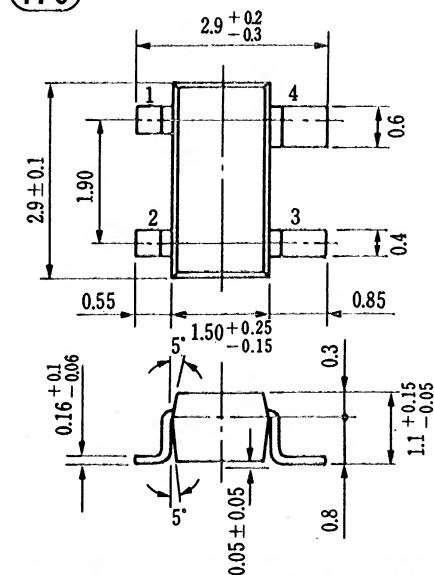
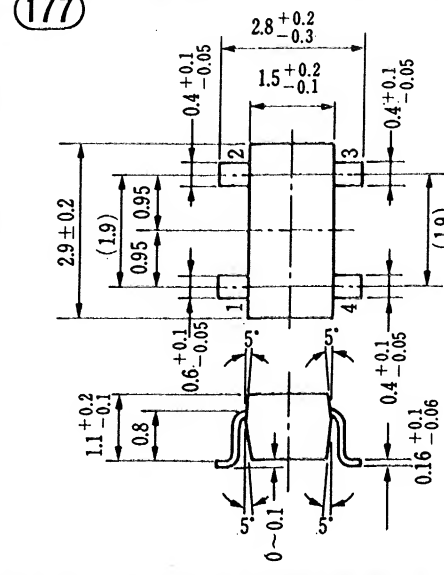
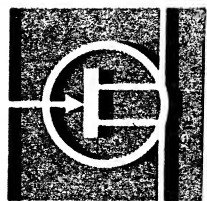
《寸法図単位：mm》

160
電極接続
1. ソース
2. ドレイン
3. ゲート
161
電極接続
1. ソース
2. ゲート
3. ドレイン
(ケース)
162
電極接続
1. ゲート
2. ドレイン
(フィン)
3. ソース
4. フィン
163
電極接続
1. ゲート
2. ドレイン
3. ソース
4. ドレイン
(ケース)
164
ドレイン(D)
ゲート(G)
ソース(S)
電極接続
1. ゲート
2. ドレイン
3. ソース
4. ドレイン(ケース)
165
電極接続
1. ゲート
2. ソース
3. ドレイン

《寸法図単位：mm》

166
4MIN
4MIN
0.5±0.15
0.5±0.15
0.5±0.15
0.5±0.15
φ1.8±0.3
1±0.3
電極接続
1. ゲート
2. ソース
3. ドレイン
167
4MIN
4MIN
0.5±0.15
1±0.2
1±0.2
0.5±0.15
□2.5±0.2
1.1±0.3
電極接続
1. ゲート
2. ソース
3. ドレイン
168
4MIN
4MIN
0.5±0.15
0.5±0.15
φ1.8±0.3
0.5±0.15
1±0.3
電極接続
1. ゲート 1
2. ゲート 2
3. ドレイン
4. ソース
169
10.6±0.3
R0.25
0.6±0.2
φ1.6
2MIN
3.6
2.6
R0.3
0.6±0.2
3.8
6.7±0.2
2.4±0.4
0.75±0.2
1.65±0.2
電極接続
1. ゲート
2. ソース
3. ドレイン
170
0.6±0.2
φ1.6
R0.25
2MIN
2.5±0.3
5.4±0.2
8.3±0.3
0.5±0.2
0.7±0.2
1.6±0.4
電極接続
1. ゲート
2. ソース
3. ドレイン
171
6.9±0.2
5.3±0.2
3.3
2MIN
0.6±0.2
0.4
R0.8
0.6±0.2
1.3±0.2
0.5±0.2
1.1±0.2
電極接続
1. ゲート
2. ソース
3. ドレイン

《寸法図単位：mm》

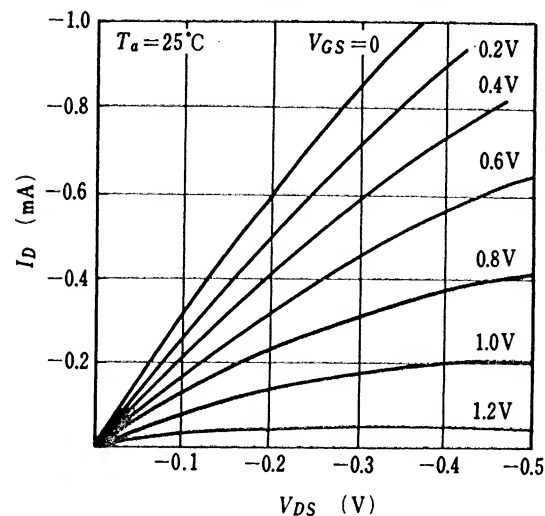
172
ゲートマーク
R0.8
電極接続
1. ゲート
2. ソース
3. ドレイン
173
φ2.2
電極接続
1. ゲート
2. ソース
3. ドレイン
174
R0.9
電極接続
1. ゲート
2. ソース
3. ドレイン
175
電極接続
A B
1. ゲート 1 ゲート
2. ゲート 2 ソース
3. ドレイン ドレイン
4. ソース ソース
176
電極接続
1. ゲート 1
2. ゲート 2
3. ドレイン
4. ソース
177
電極接続
1. ソース
2. ドレイン
3. ゲート 2
4. ゲート 1

《寸法図単位：mm》

個別特性図

2SJ40, 125

Si 接合型
P チャンネル

三　菱

アイテム	C	D	E
I_{DSS} (mA)	1.0～3.0	2.5～6.0	5.0～12

ソース接地出力特性

ソース接地伝達特性

I_{DGS} - V_{DD} 特性

$|y_{fs}|$ - I_D 特性

$R_{DS(on)}$ - I_{DSS} 特性

2SJ43

Si 接合型
Pチャンネル

松　下

I_{DSS} ランク分類

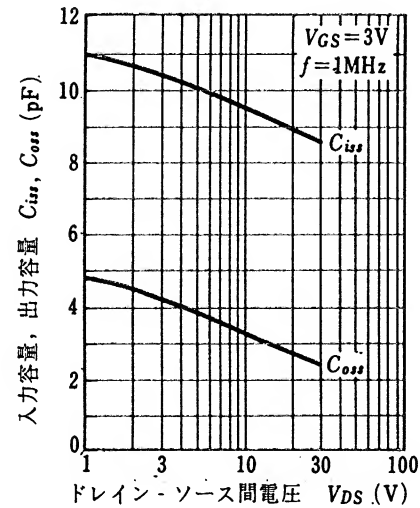
Class	P	Q	R
I_{DSS} (mA)	0.5～3	2～6	4～12

2SJ55, 56, 56Ⓗ

Si MOS型 Pチャンネル **日立**

2SJ76, 77, 77Ⓚ, 78, 79, 79Ⓚ

Si MOS型 Pチャンネル

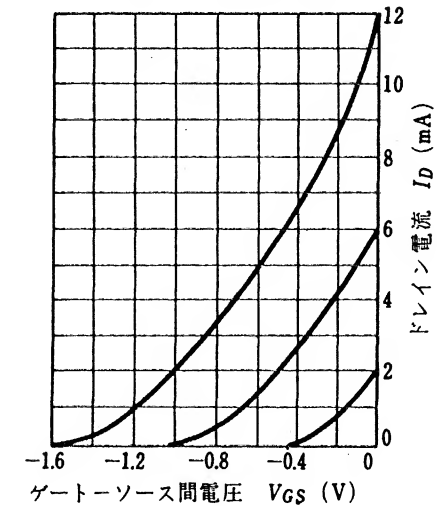
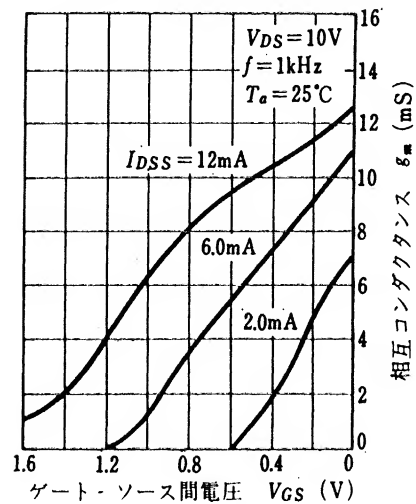
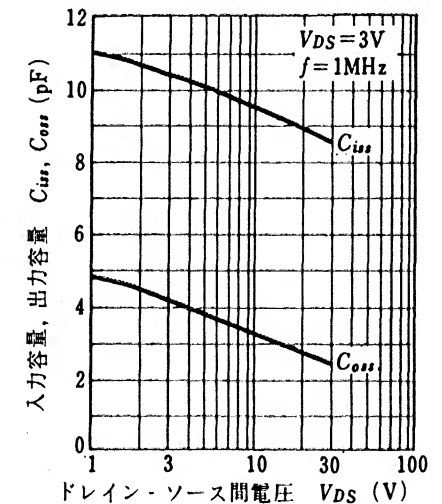
日立

2SJ84

Si 接合型 Pチャンネル 松 下

I_{DSS} ランク分類

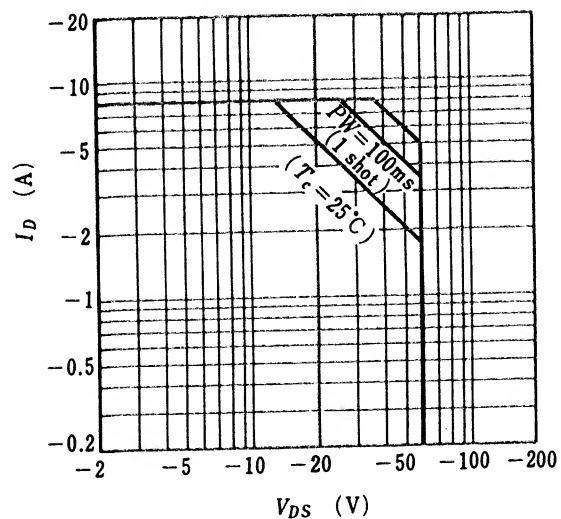
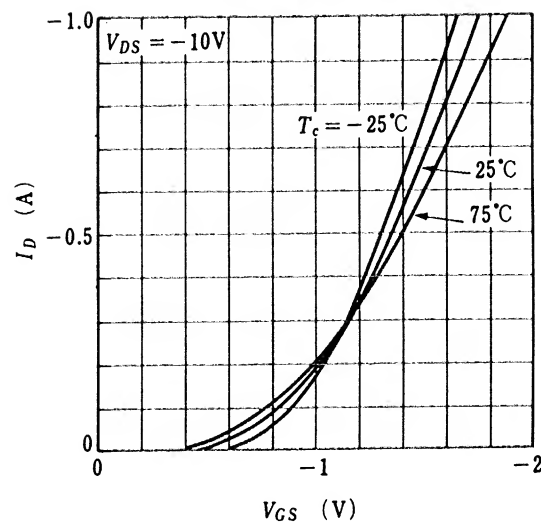
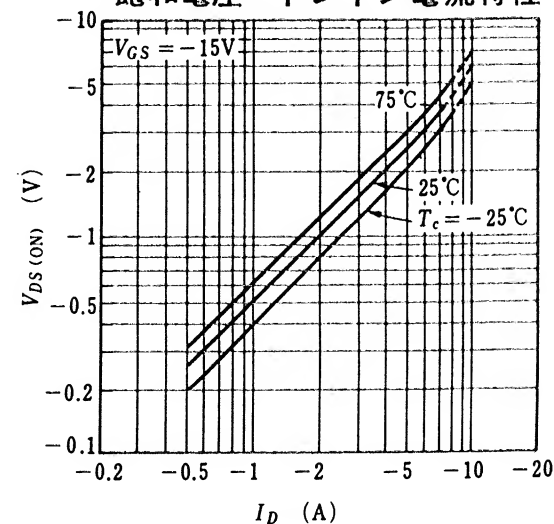
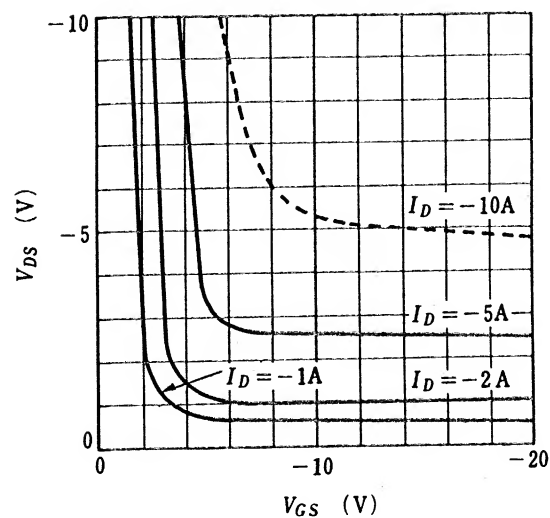
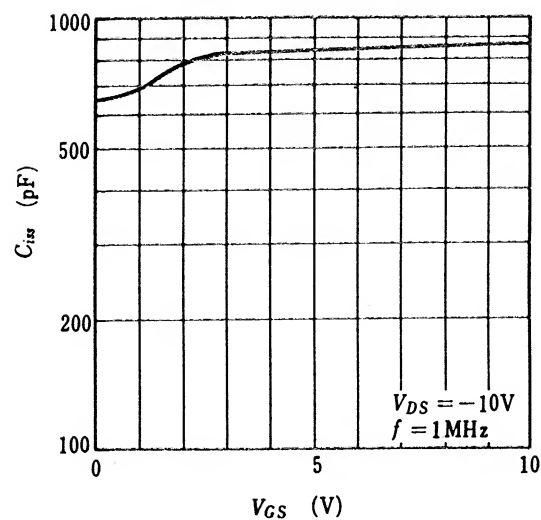
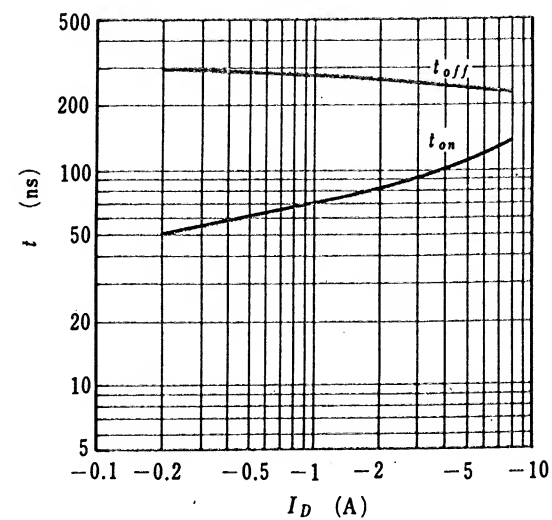
Class	P	Q	R
I_{DSS} (mA)	0.5～3	2～6	4～12
Marking Symbol	1MP	1MQ	1MR

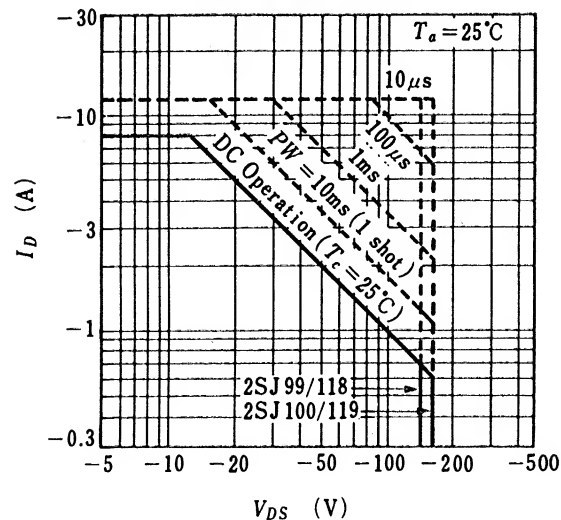
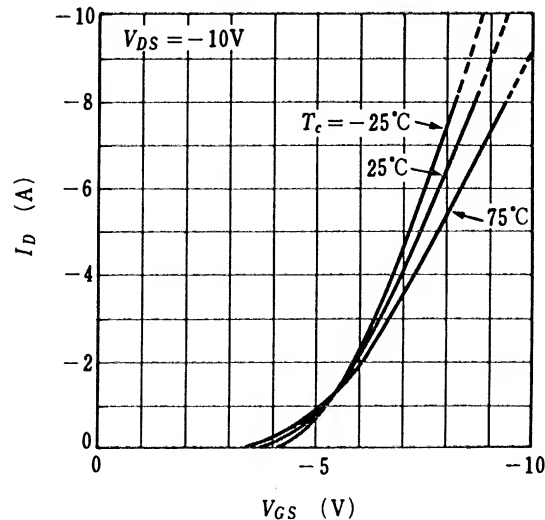
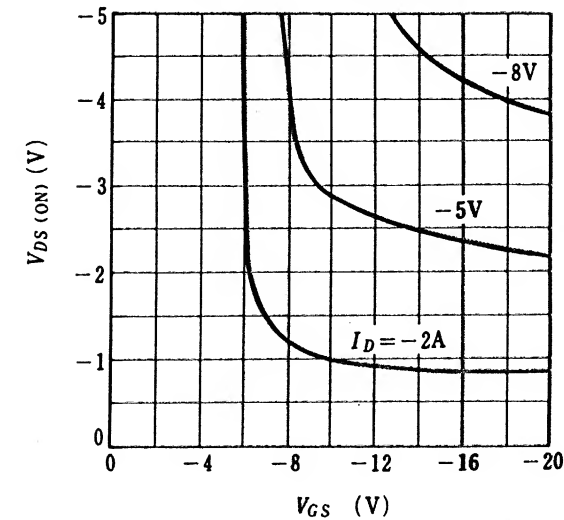
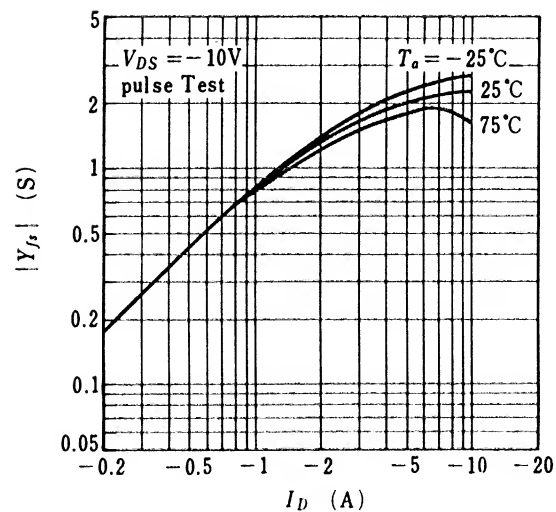
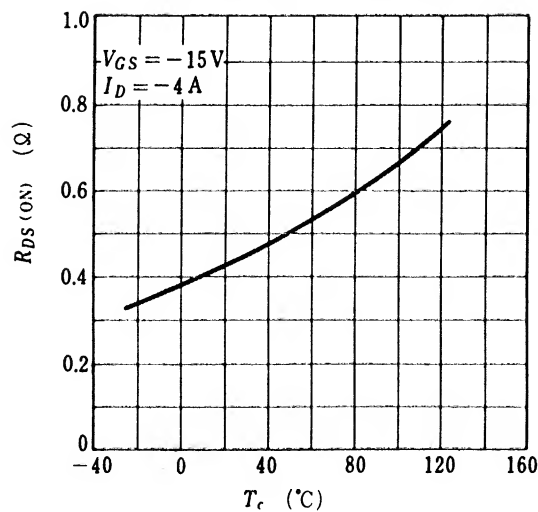
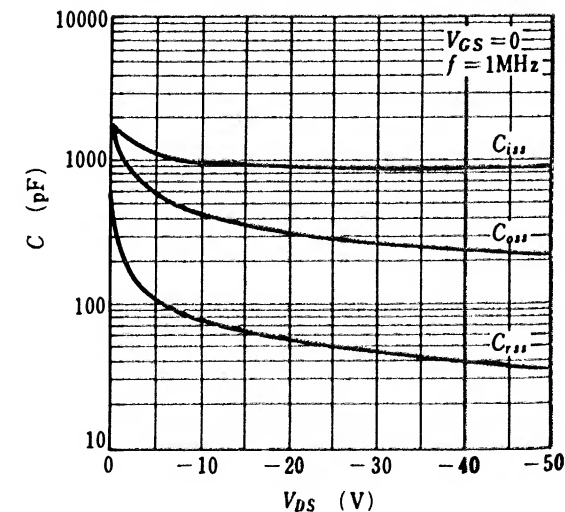
I_D - V_{DS} 特性

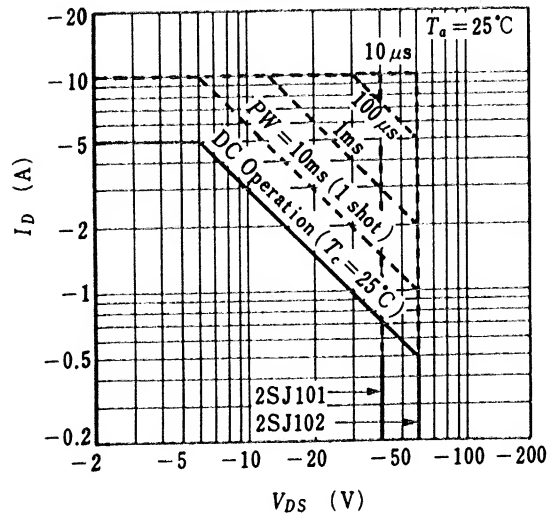
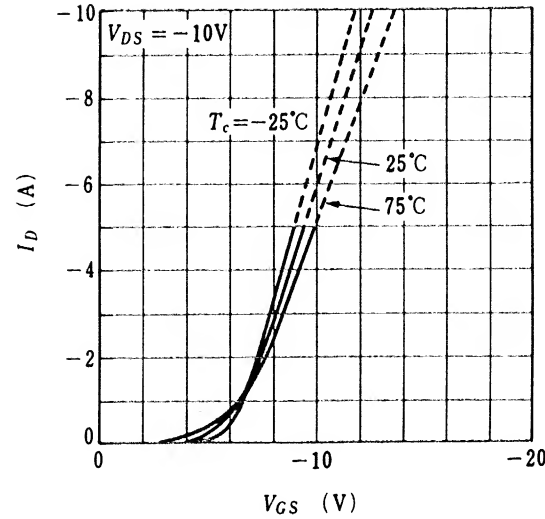
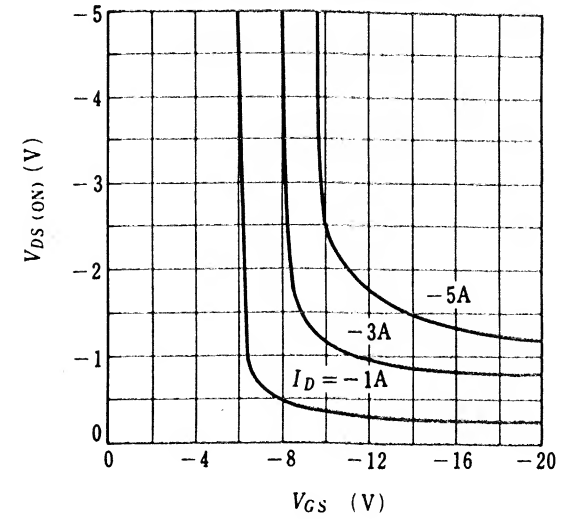
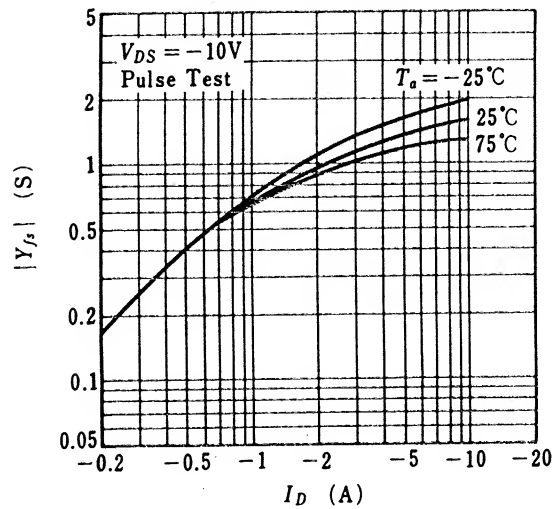
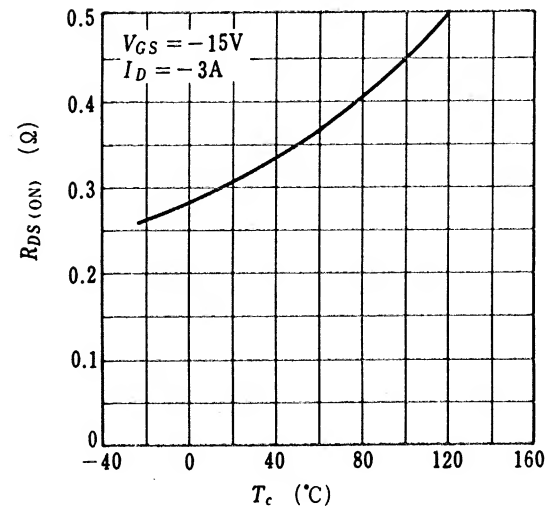
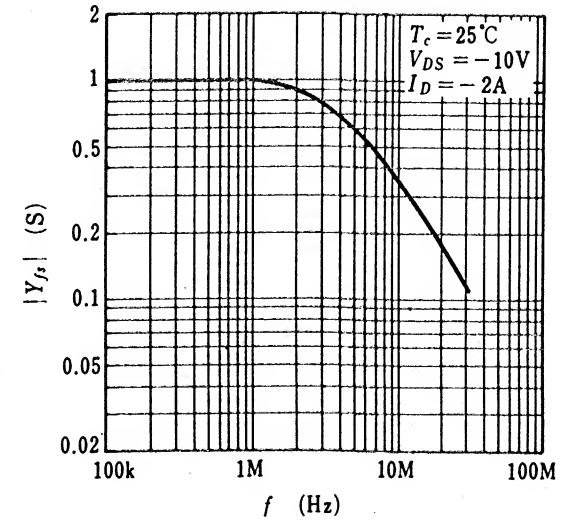
I_D - V_{GS} 特性

g_m - V_{GS} 特性

g_m - I_D 特性

C_{iss}, C_{oss} - V_{DS} 特性

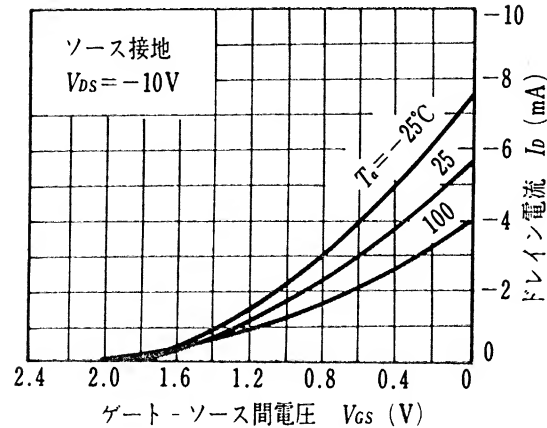
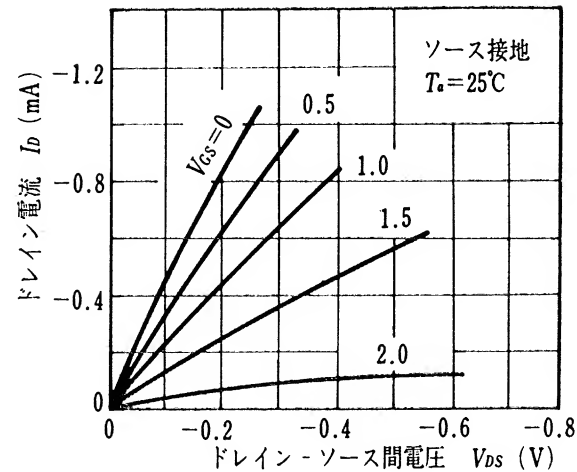
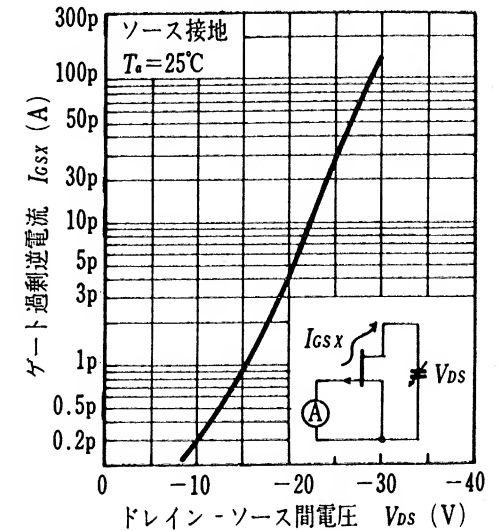
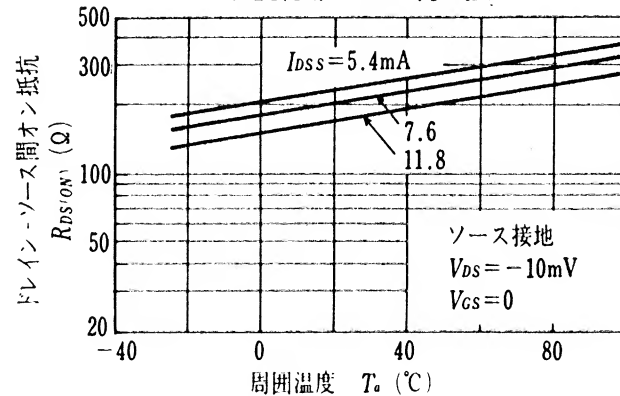
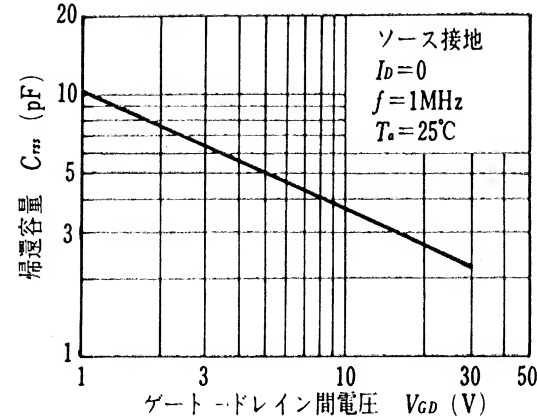
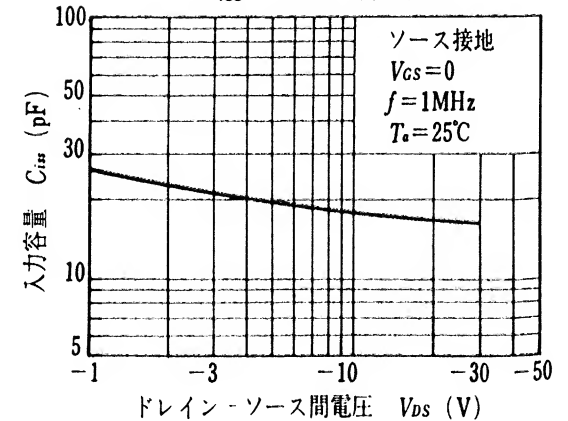
2SJ96

Si MOS型 Pチャンネル　日　立

2SJ99, 100, 118, 119

Si MOS型 Pチャンネル　日立

2SJ101, 102

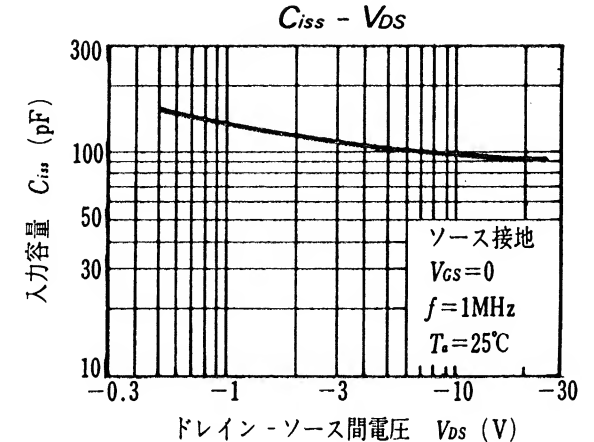
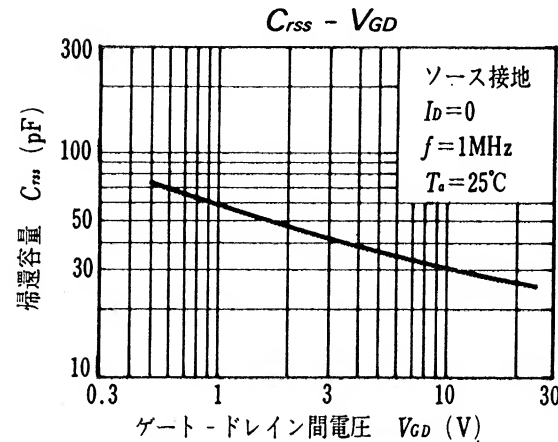
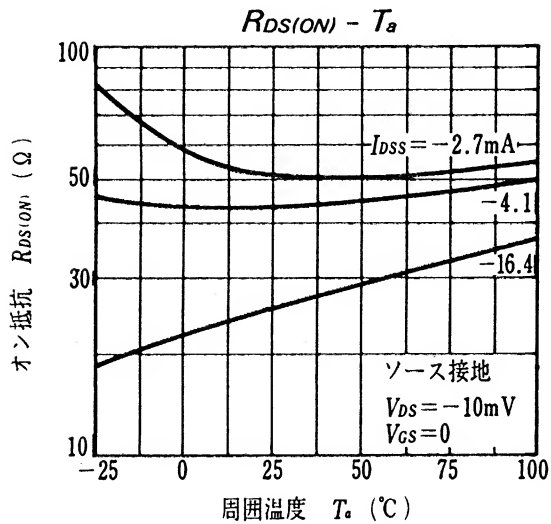
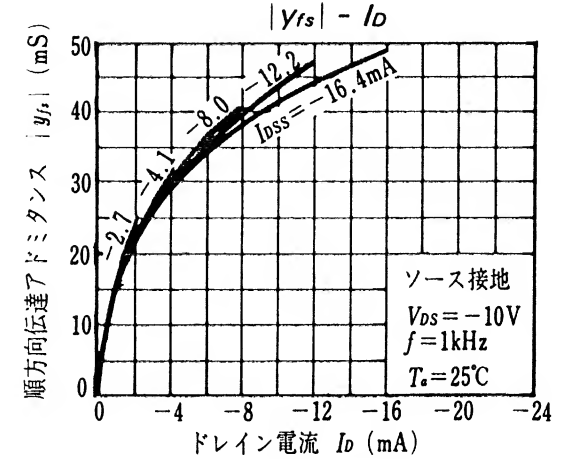
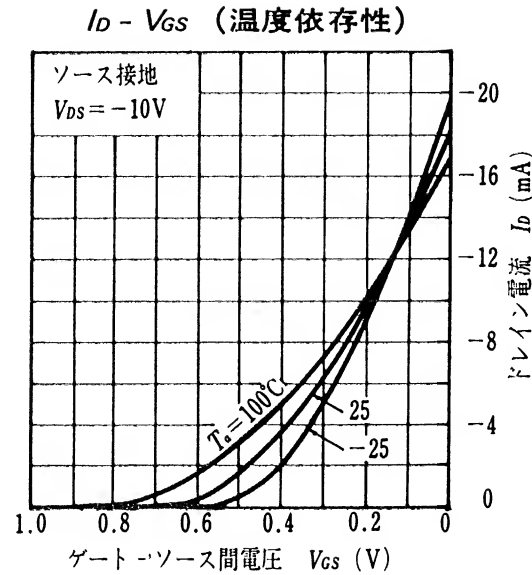
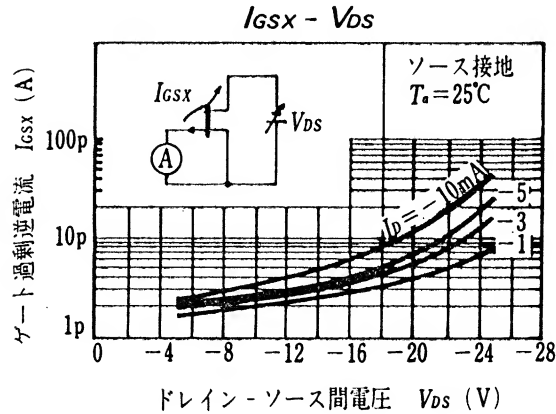
Si MOS型 Pチャンネル　　日立

2SJ103, 105, 106

Si 接合型 Pチャンネル　東　芝

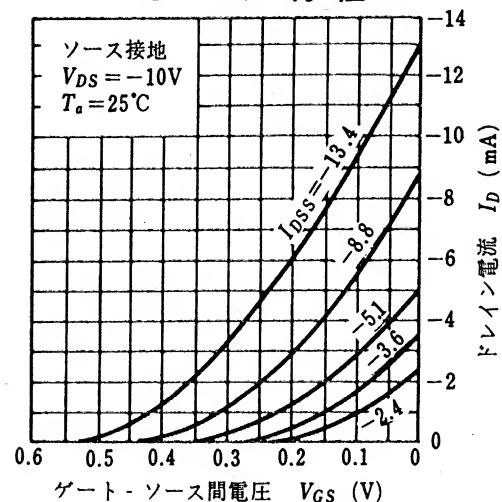
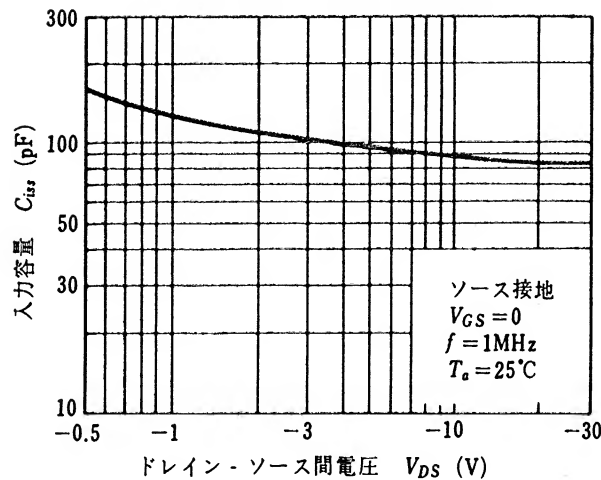
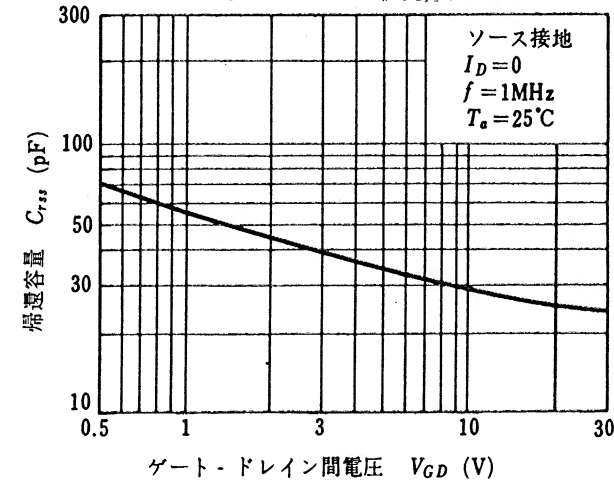
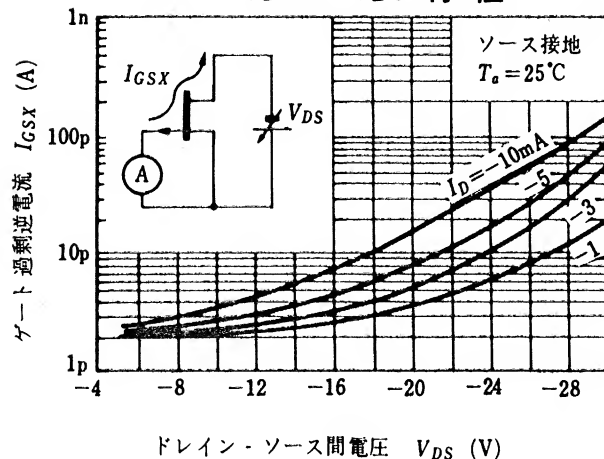
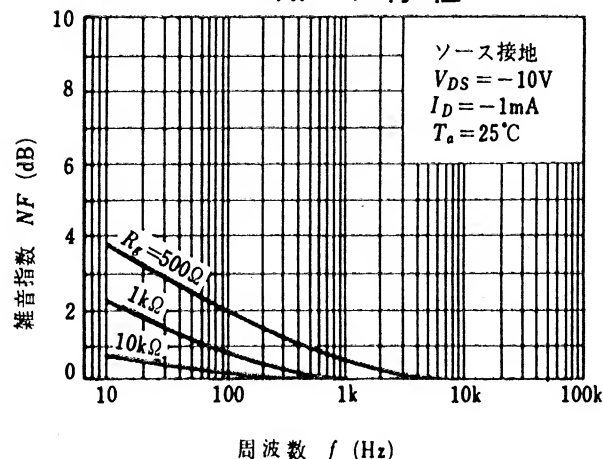
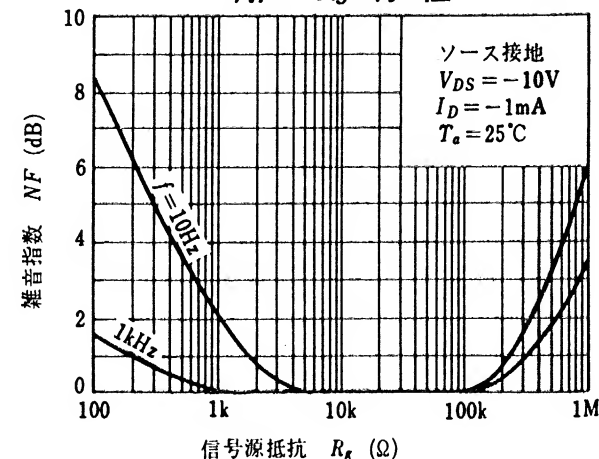
I_{DSS}分類　Y：−1.2〜−3.0mA
GR：−2.6〜−6.5mA
BL：−6〜−14mA

2SJ104, 107

Si 接合型
Pチャンネル

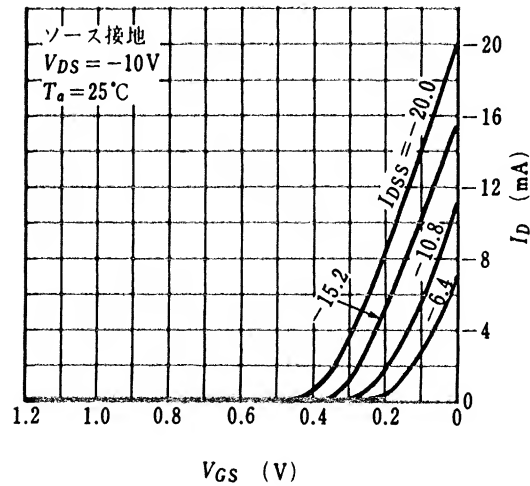
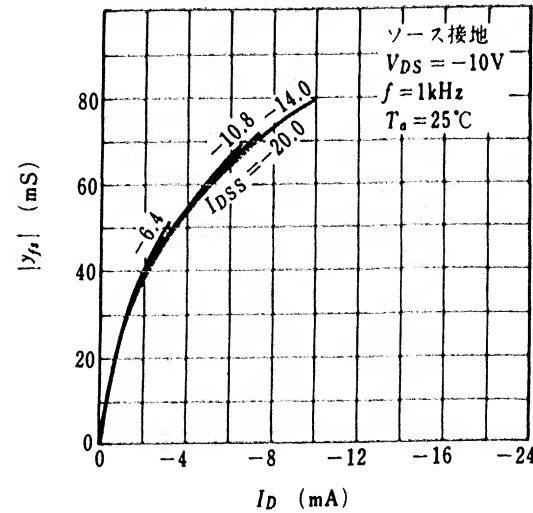
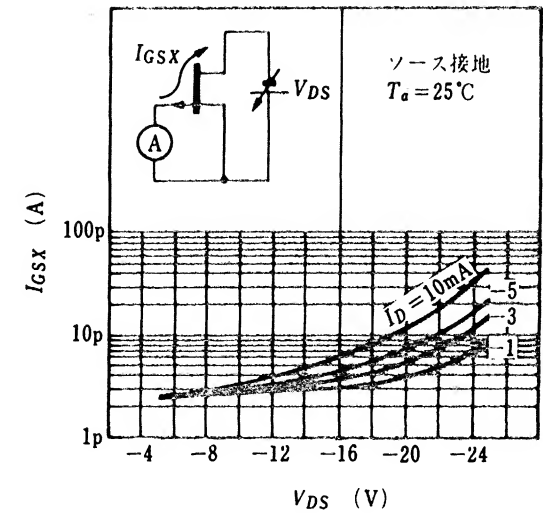
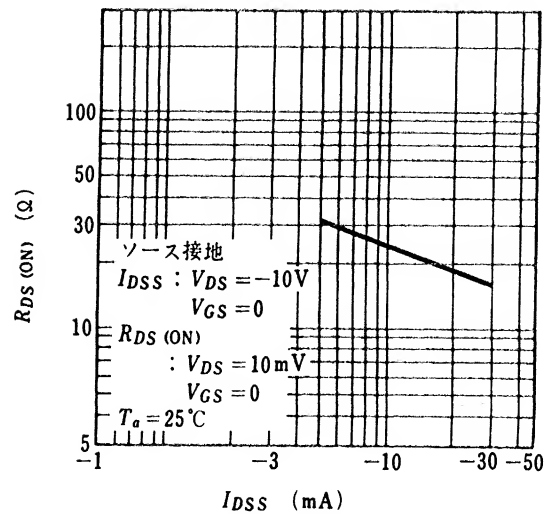
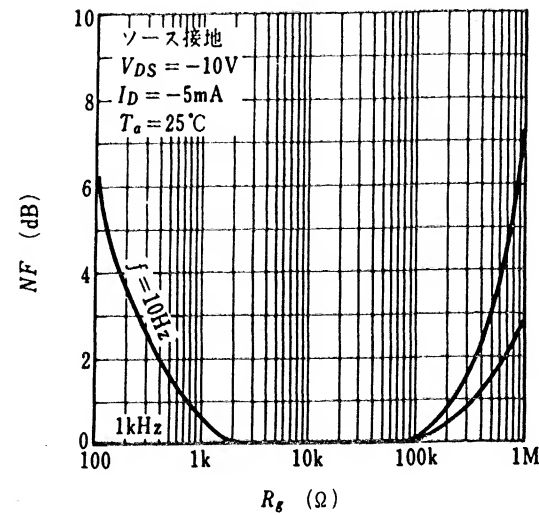
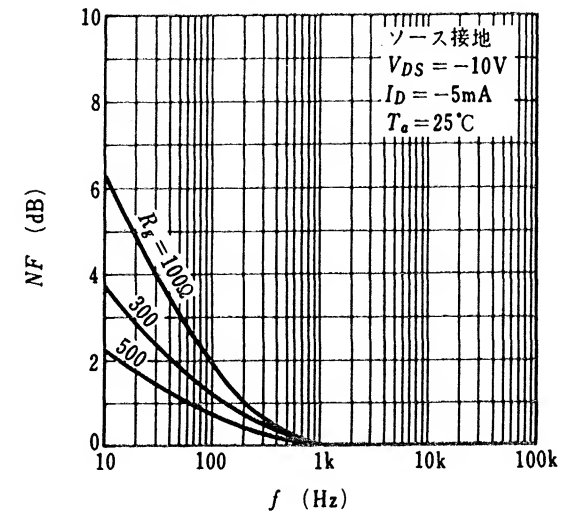
東　芝

I_{DSS}分類　GR：−2.6～−6.5，BL：−6～−12，
V：−10～−20

2SJ109

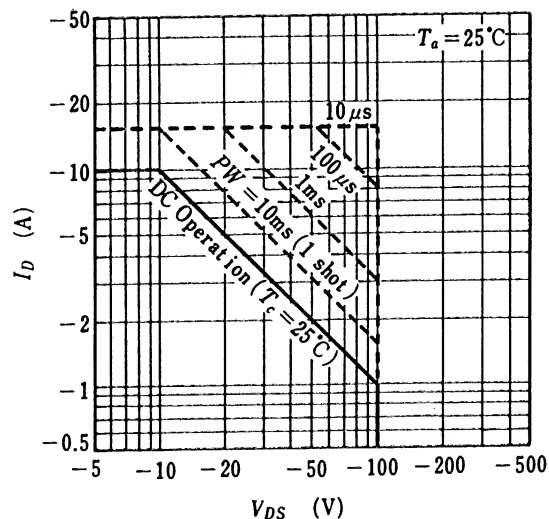
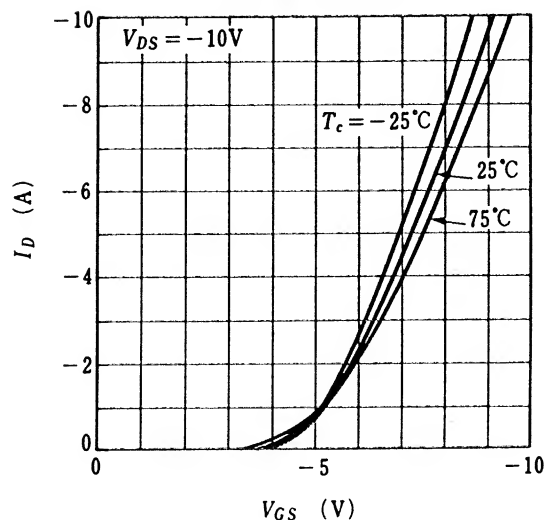
Si 接合型
Pチャンネル

東芝

2SJ110, 111

Si 接合型 Pチャンネル　東芝

I_{DSS} 分類　GR：−5.0〜−10.0，BL：−8.0〜−16.0，V：−14.0〜−30.0

2SJ112, 113

Si MOS型
Pチャンネル

日　立

2SJ114

Si MOS型
Pチャンネル

日　立

2SJ115

Si MOS型
Pチャンネル

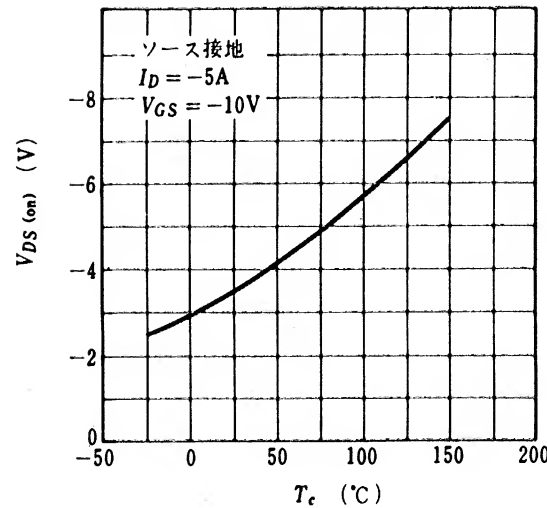
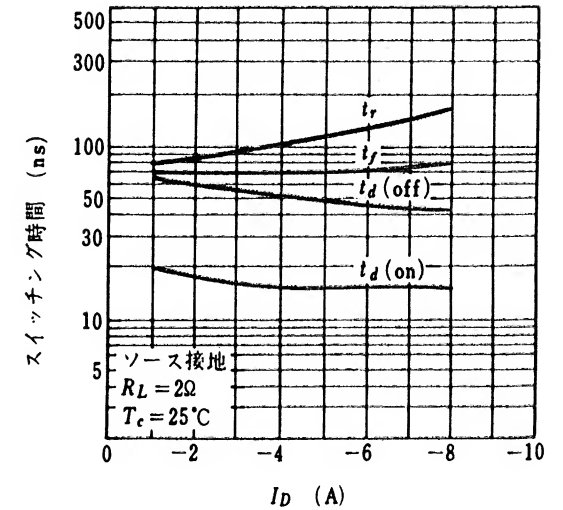
東　芝

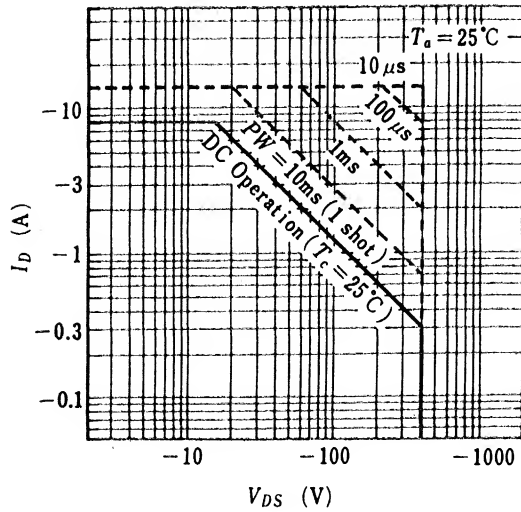
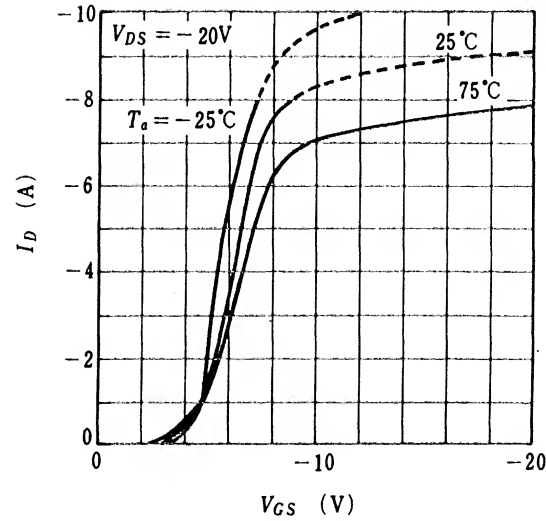
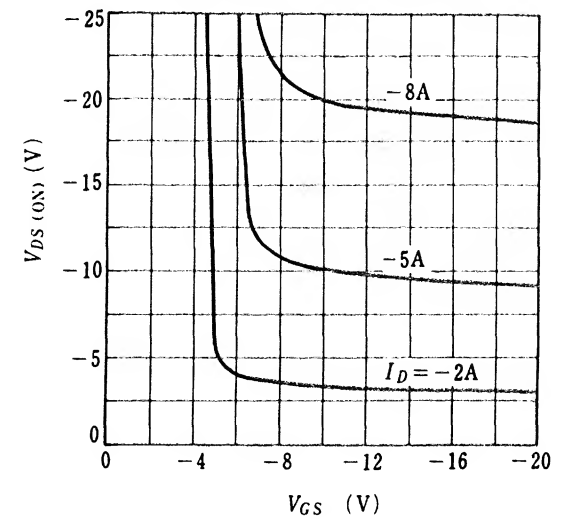
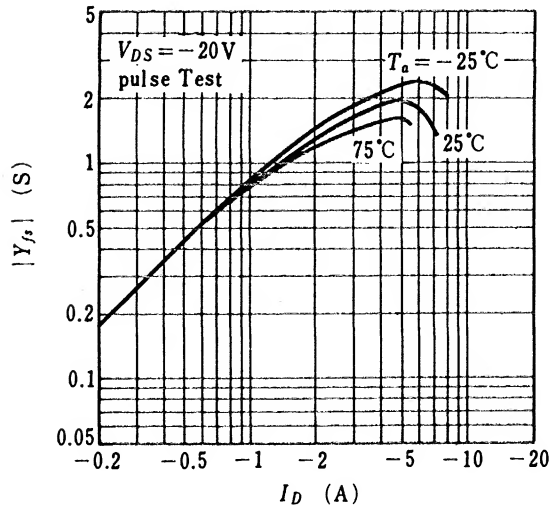
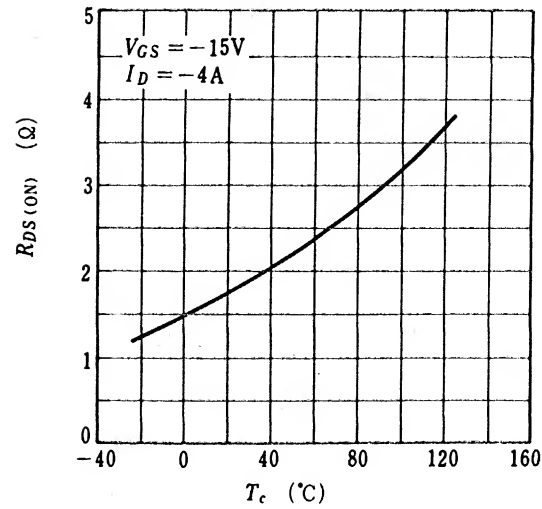
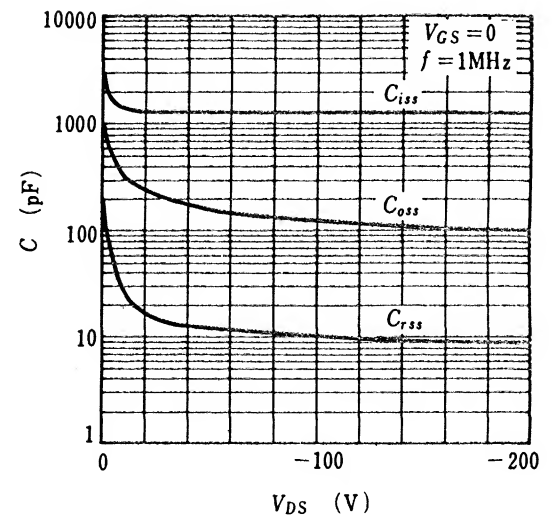
安全動作領域

I_D - V_{GS} 特性

|Y_{fs}| - I_D 特性

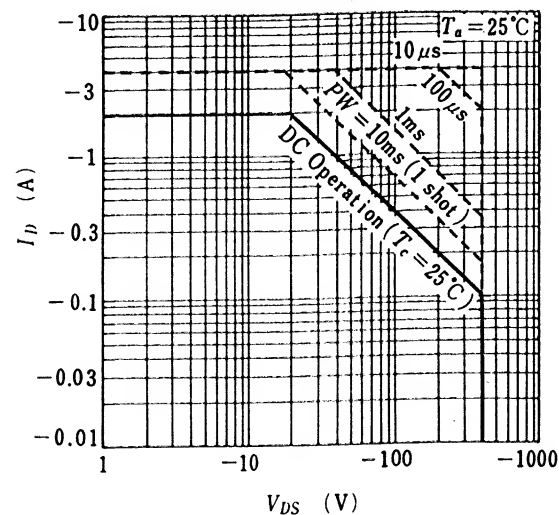
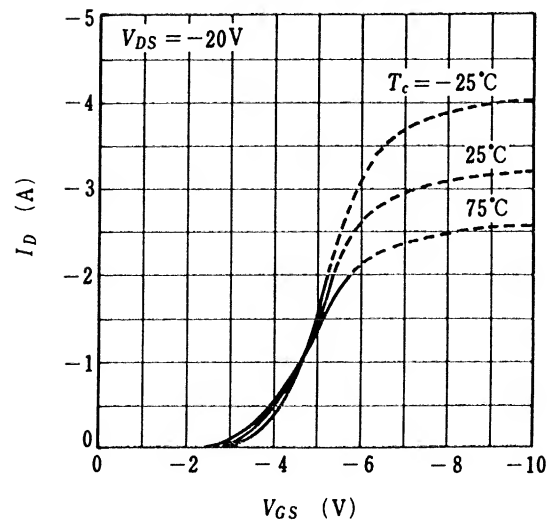
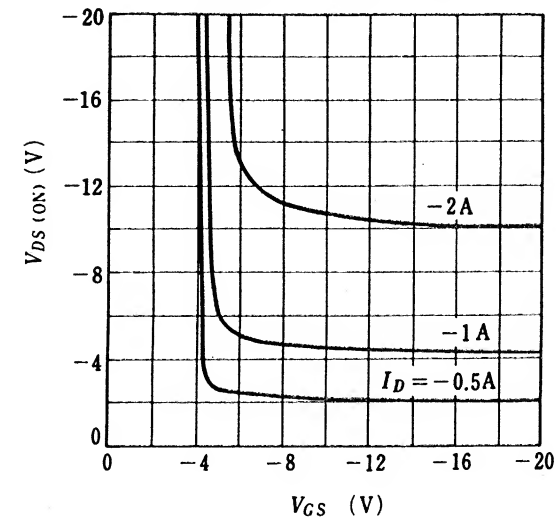
静電容量 - V_{DS} 特性

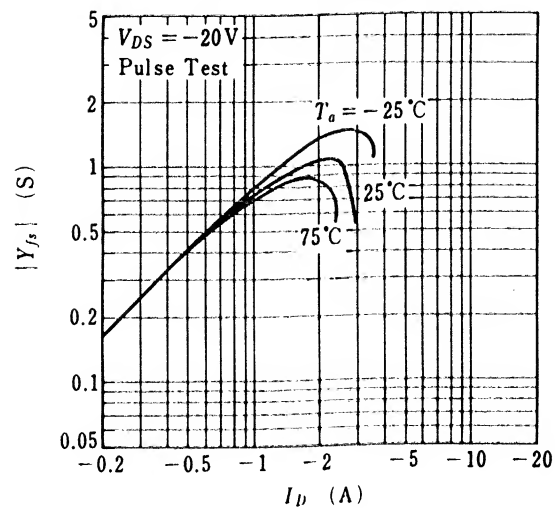
$V_{DS(on)}$ - T_C 特性

スイッチング特性

2SJ116

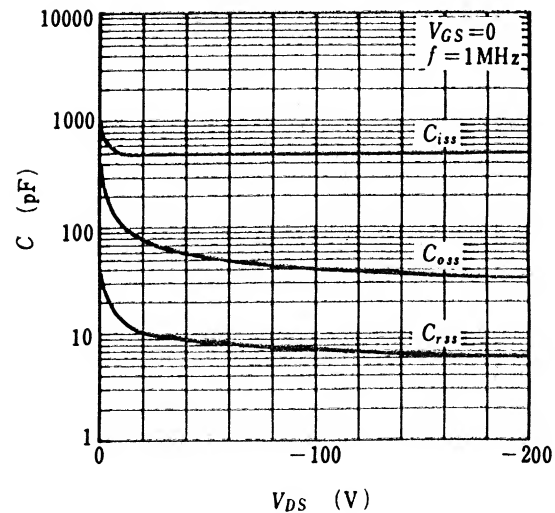
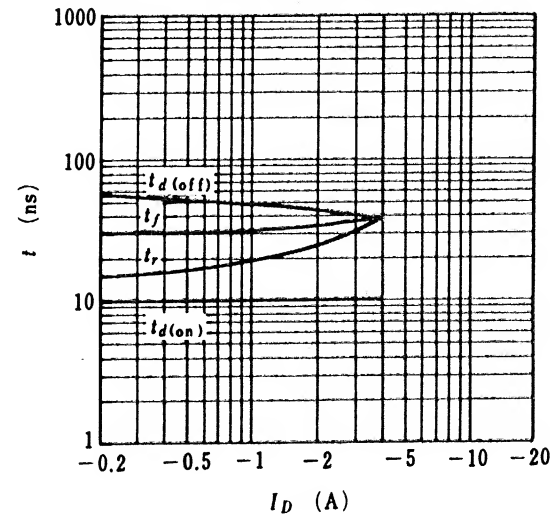
Si MOS型 Pチャンネル　日立

2SJ117

Si MOS型
Pチャンネル

日 立

安全動作領域

伝達特性

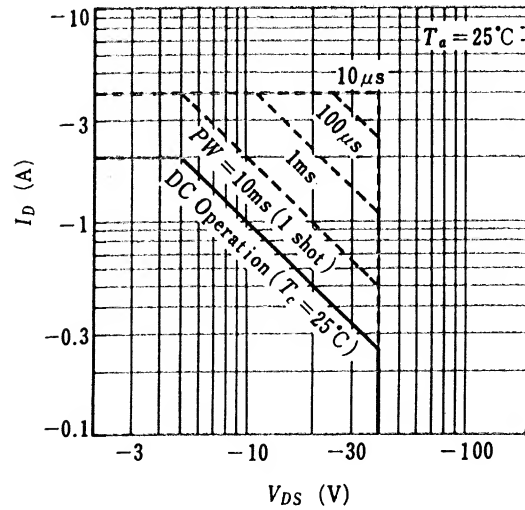
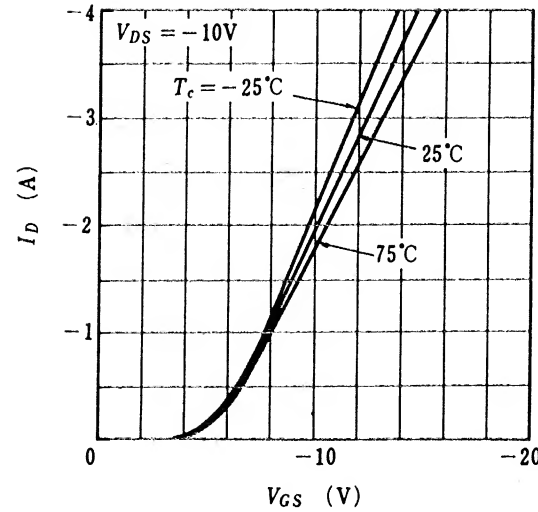
$V_{DS(ON)}$ - V_{GS} 特性

$|Y_{fs}|$ - I_D 特性

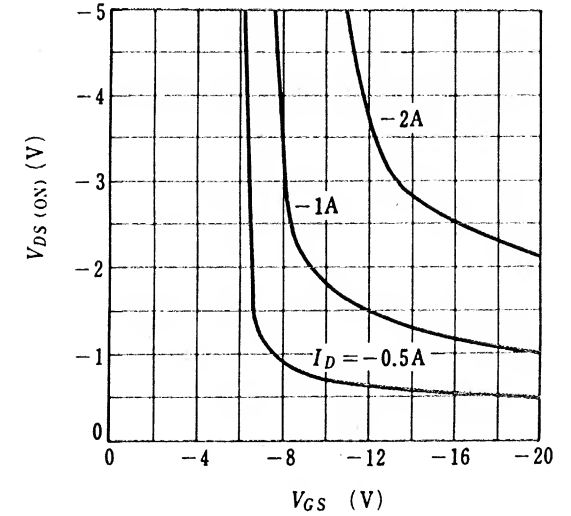
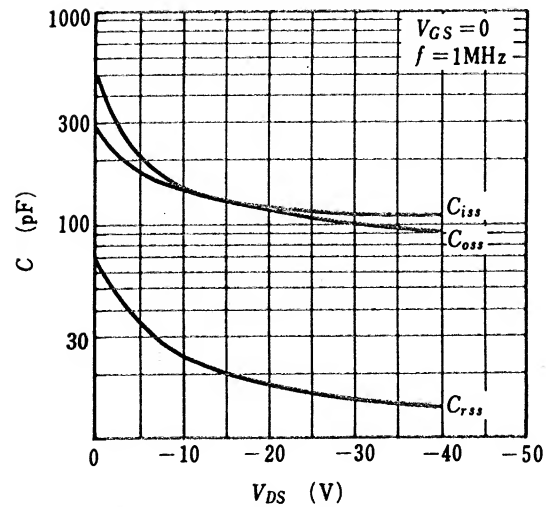
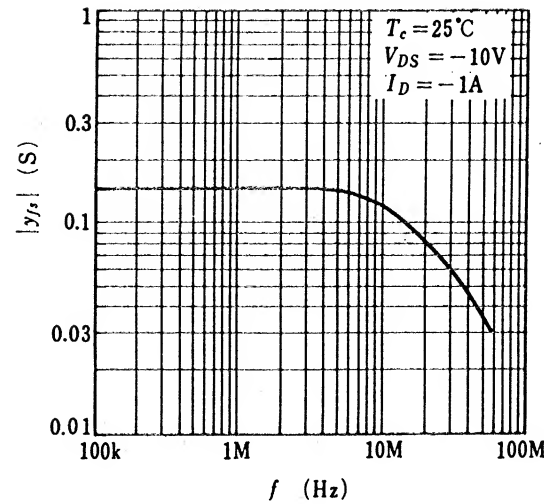
Ciss, Coss, Crss - V_{DS} 特性

スイッチング特性

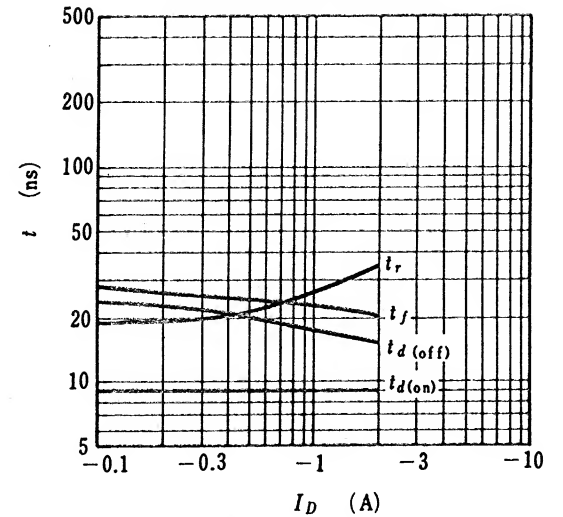
2SJ120

Si MOS 型
Pチャンネル

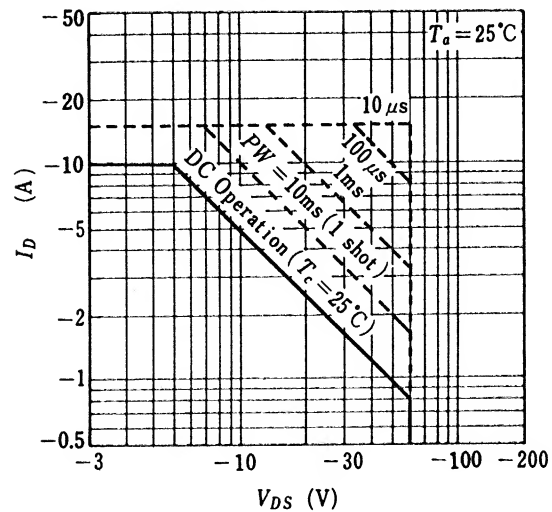
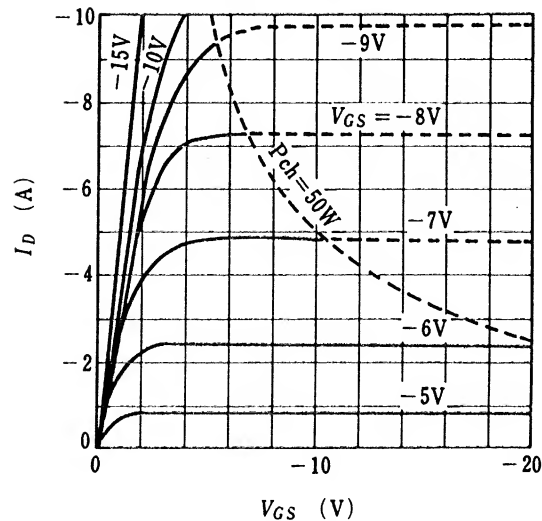
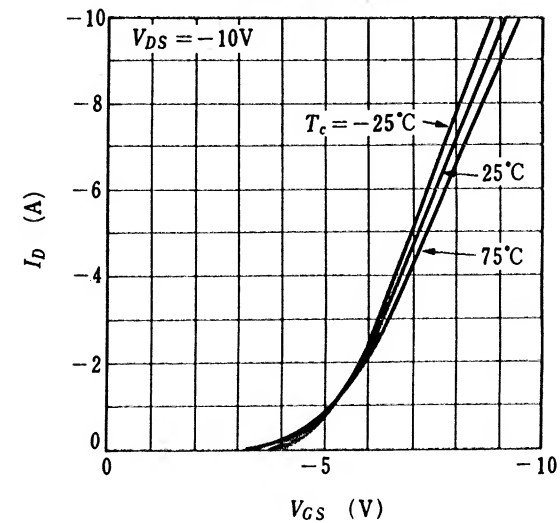
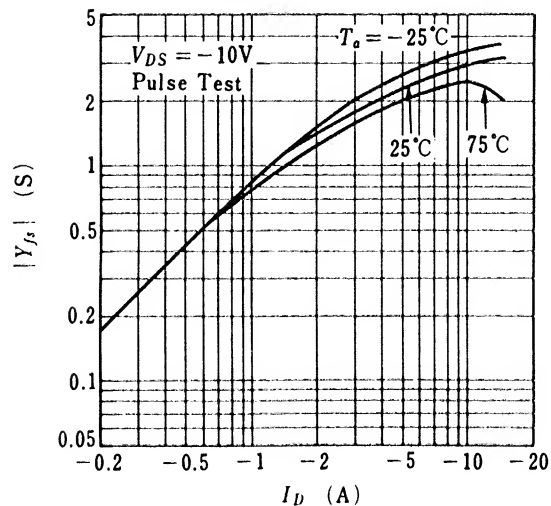
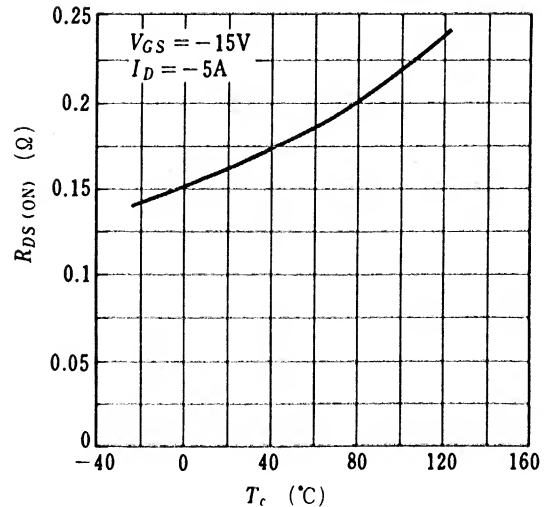
日 立

安全動作領域

伝達特性

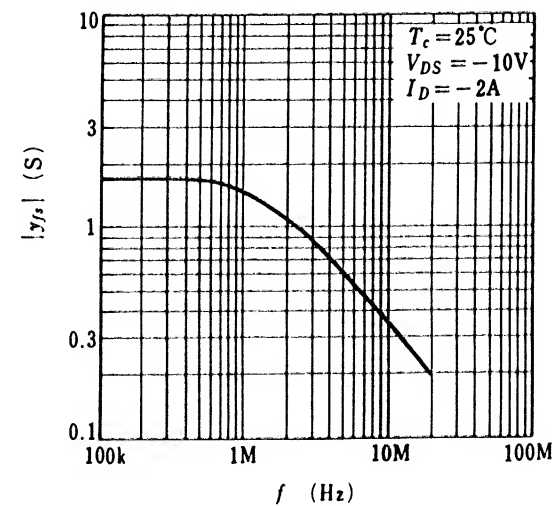
$V_{DS(ON)}$ - V_{GS} 特性

Ciss, Coss, Crss - V_{DS} 特性

|Y_{fs}| - f 特性

スイッチング特性

2SJ122

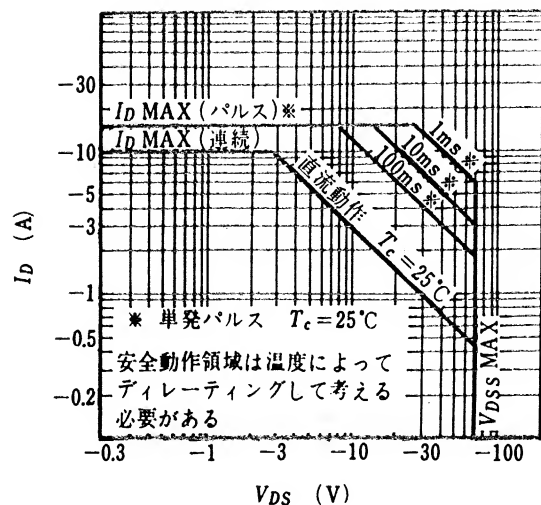
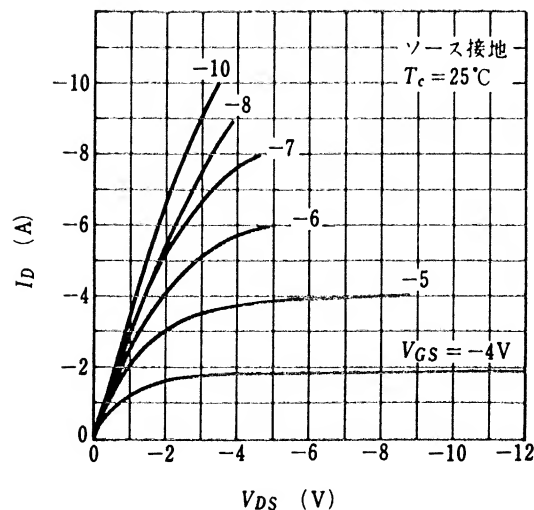
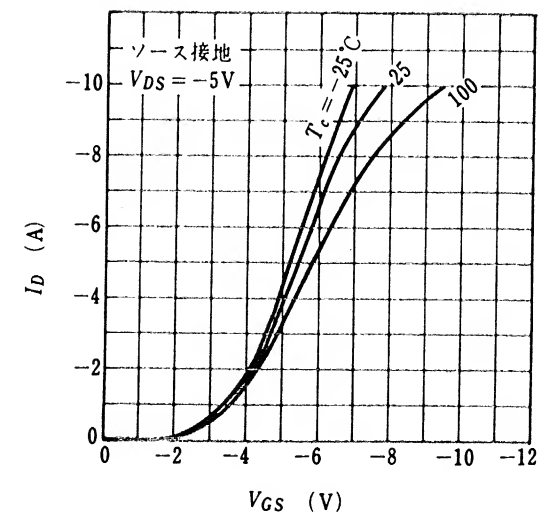
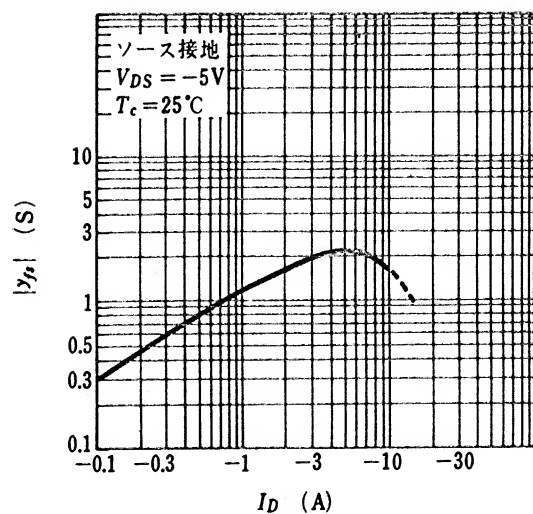
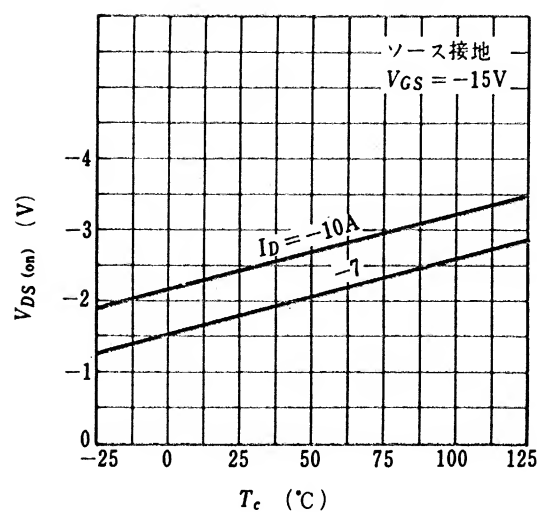
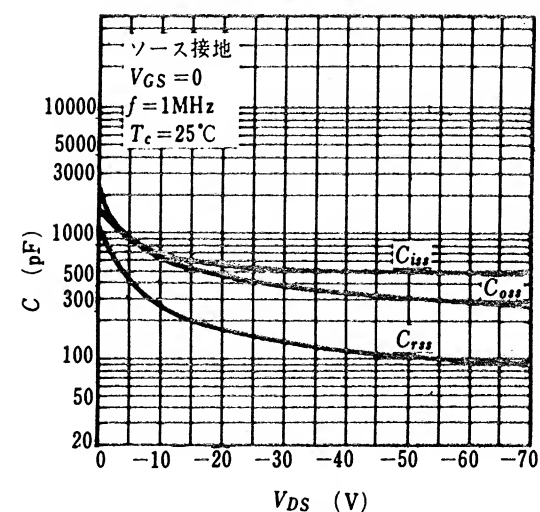
Si MOS型
Pチャンネル

日　立

伝達特性

$|y_{fs}|$ - I_D 特性

$R_{DS(on)}$ - T_c 特性

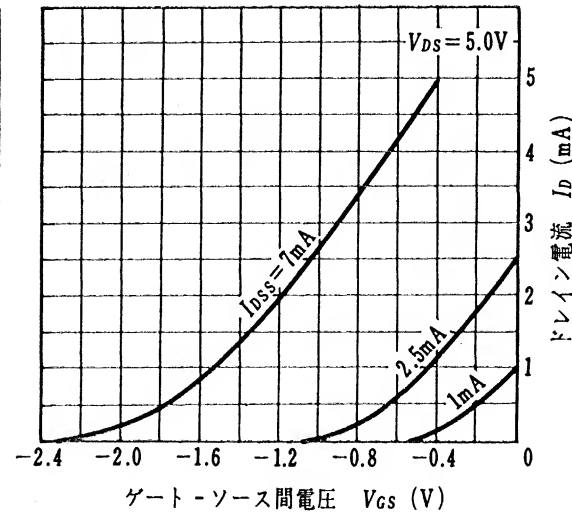
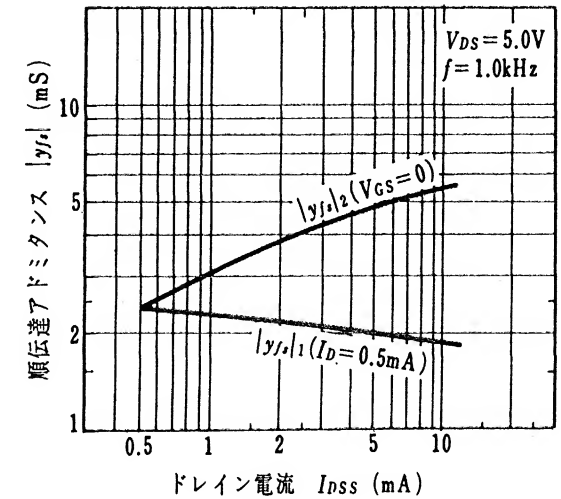
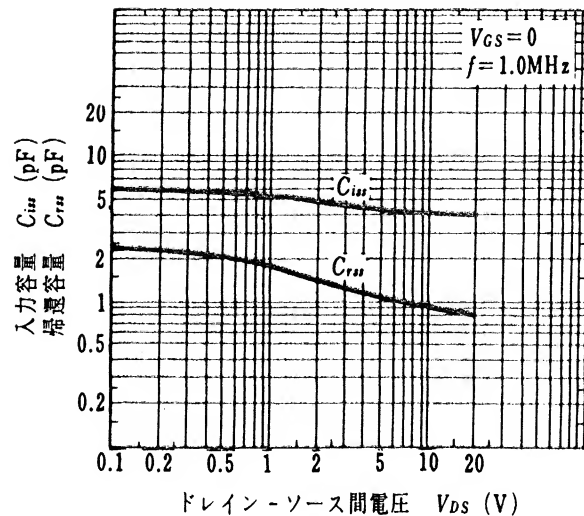
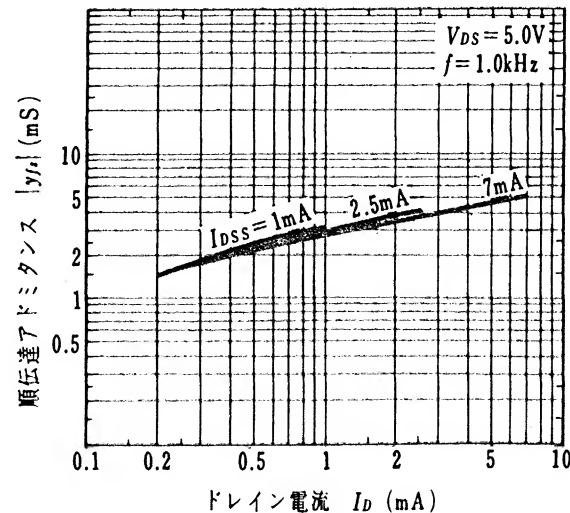
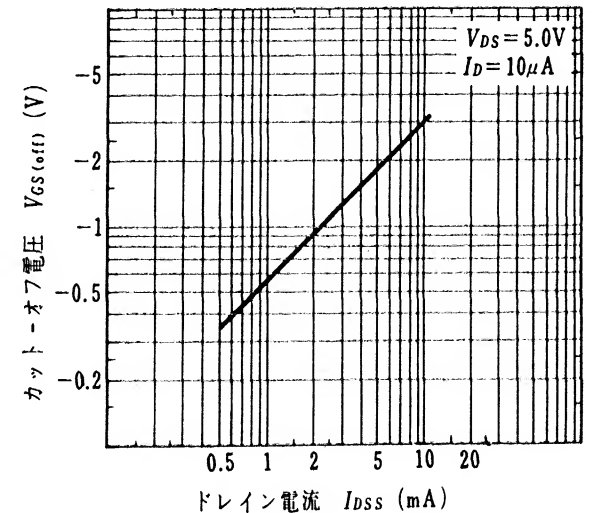
$|y_{fs}|$ - f 特性

2SJ123

Si MOS型 Nチャンネル　東　芝

安全動作領域

I_D - V_{DS} 特性

I_D - V_{GS} 特性

$|Y_{fs}|$ - I_D 特性

$V_{DS(on)}$ - T_C 特性

静電容量 - V_{DS} 特性

2SK105, 2SK160, 160A Si接合型 Nチャンネル

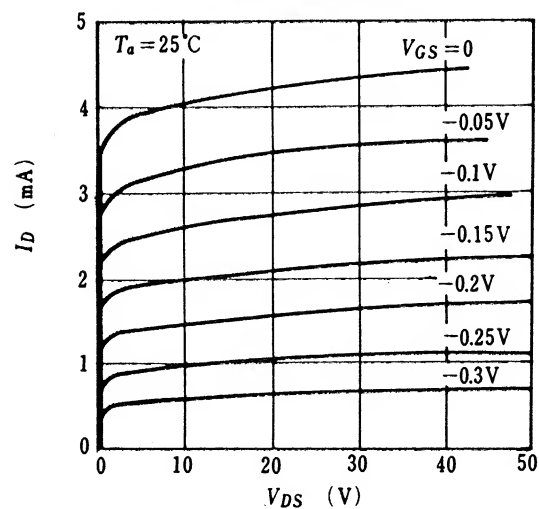
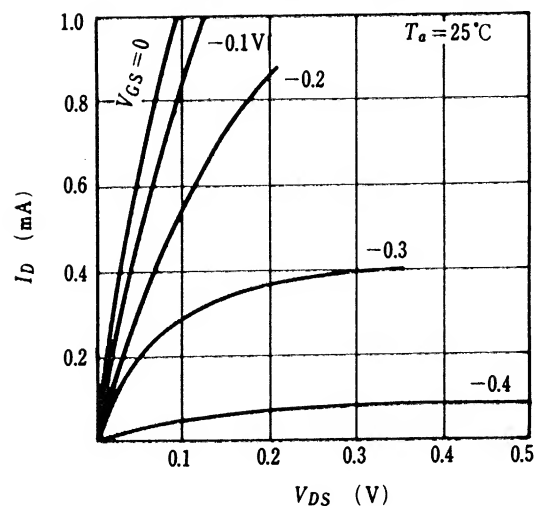
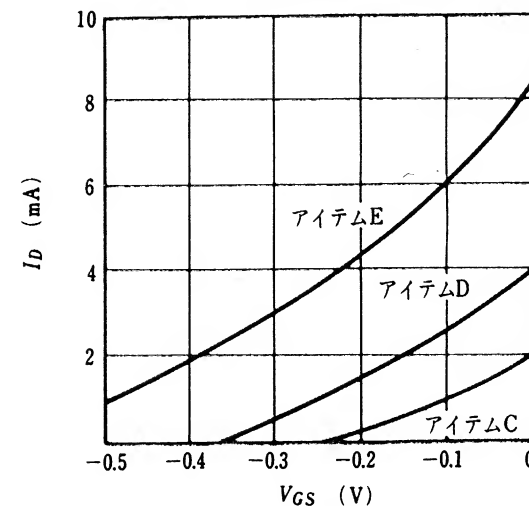
日本電気

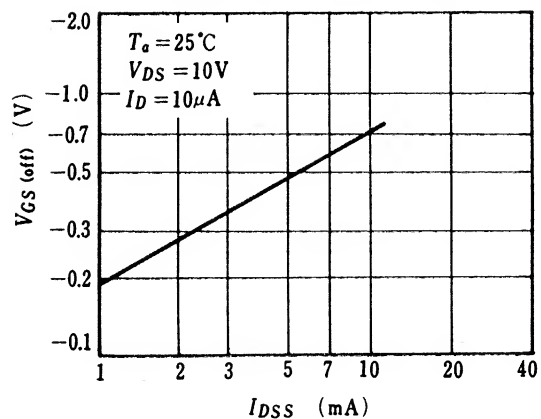
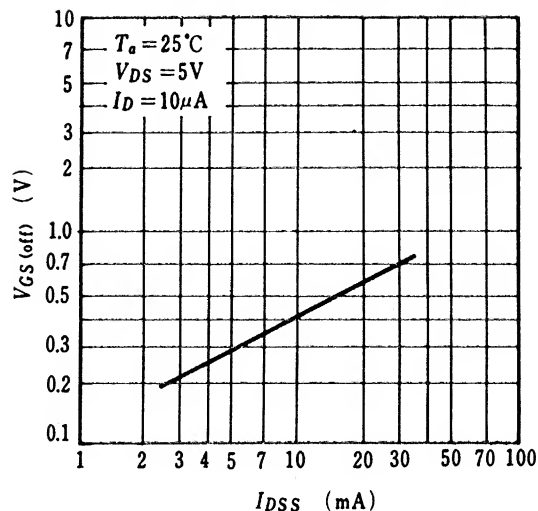
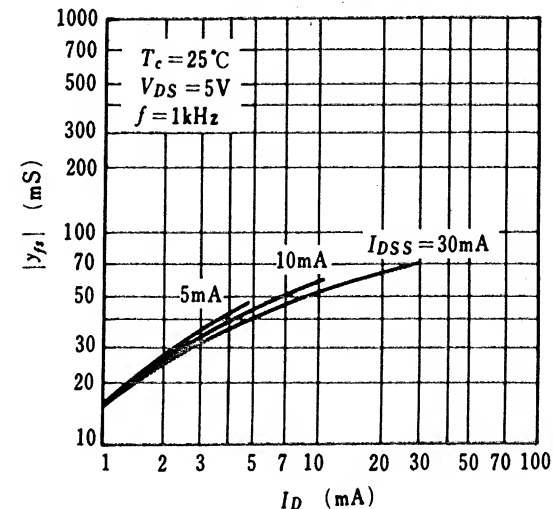
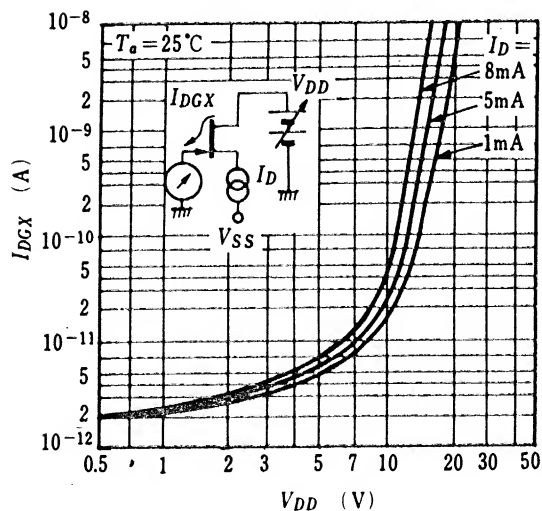
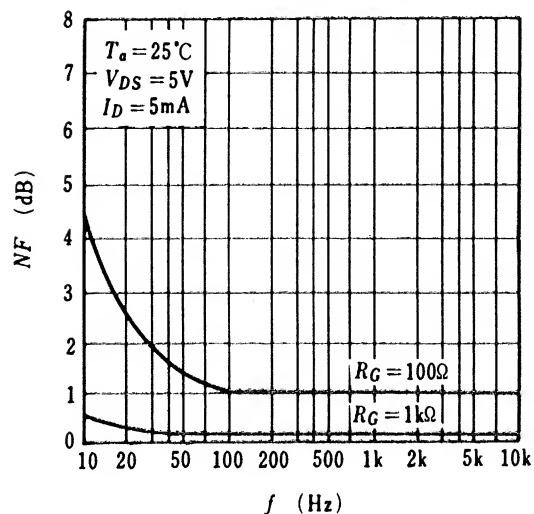
I_{DSS}区分	0.5～1.5	1.0～3.0	2.0～6.0	4.0～12
2SK105	E	F	H	J
2SK160	K4	K5	K6	K7
2SK160A	K24	K25	K26	K27

I_D - V_{GS} 特性

$|y_{fs}|$ - I_{DSS} 特性

C_{iss}, C_{rss} - V_{DS} 特性

$|y_{fs}|$ - I_D 特性

$V_{GS(off)}$ - I_{DSS} 特性

2SK108, 492

Si 接合型
Nチャンネル

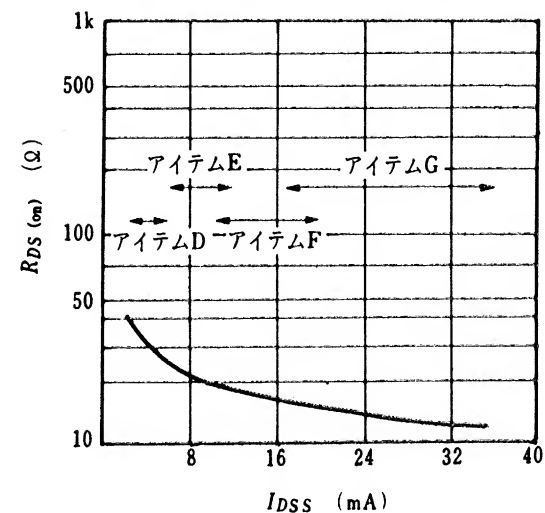
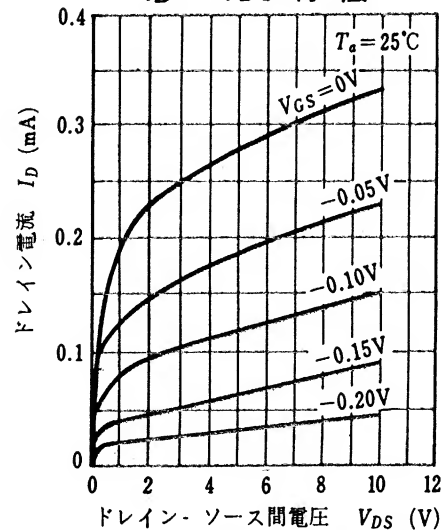
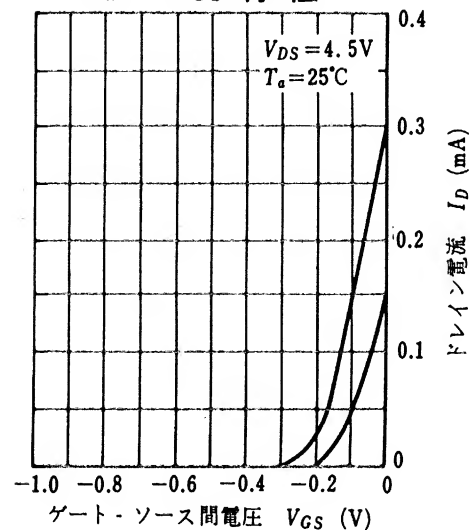
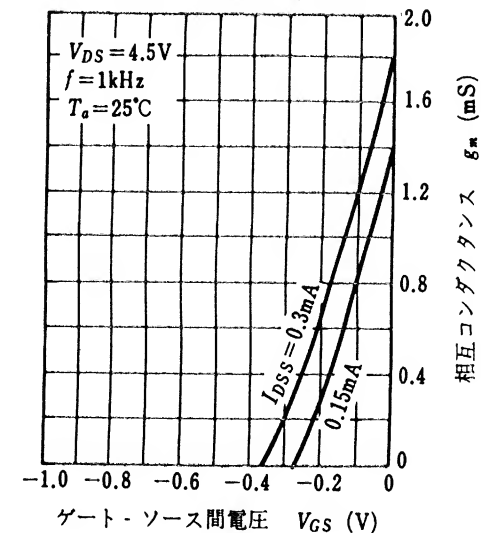
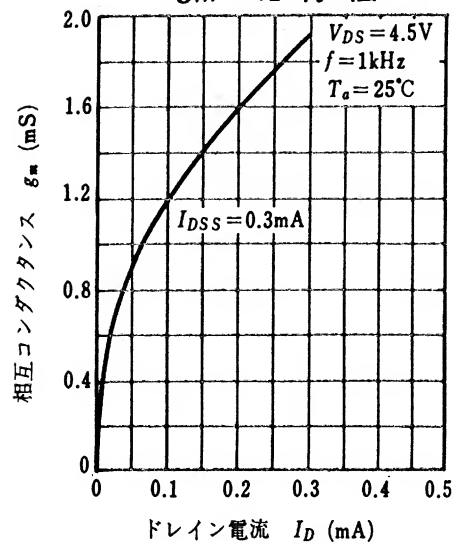
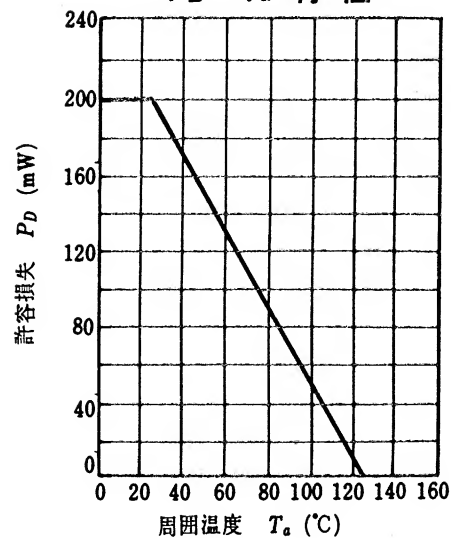
三　菱

アイテム	C	D	E
I_{DSS} (mA)	1~3	2.5~6	5~12

ソース接地出力特性

ソース接地伝達特性

$V_{GS(off)}$ - I_{DSS} 特性

$|y_{fs}|$ - I_{DSS} 特性

$R_{DS(on)}$ - I_{DSS} 特性

2SK110

Si 接合型 Nチャンネル　　三　菱

アイテム	D	E	F	G
I_{DSS} (mA)	2.5～6	5～12	10～20	17～36

2SK123

Si 接合型 Nチャンネル　松下

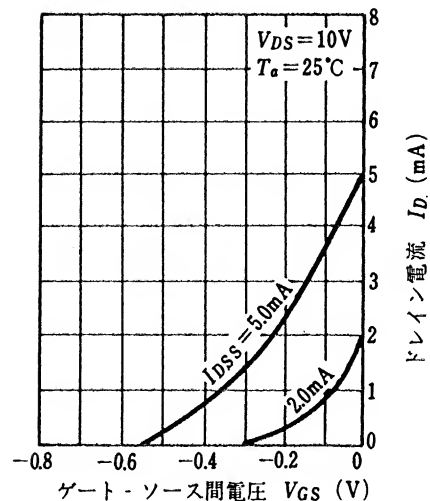
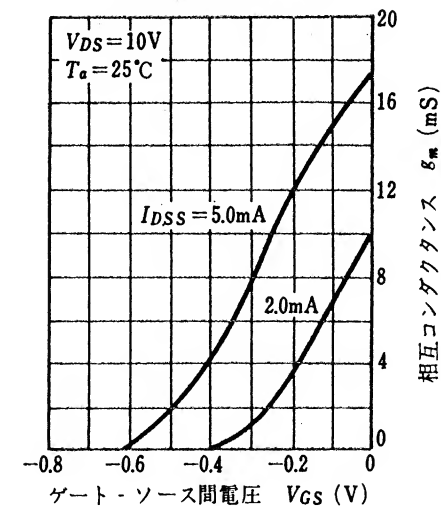
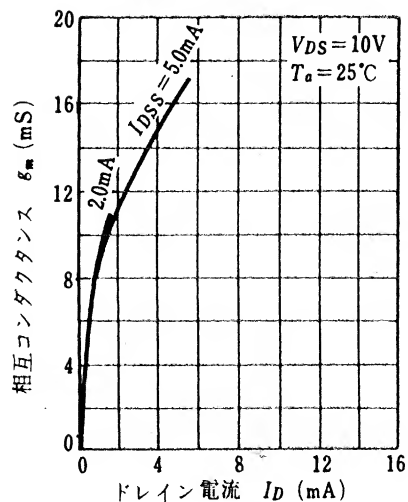
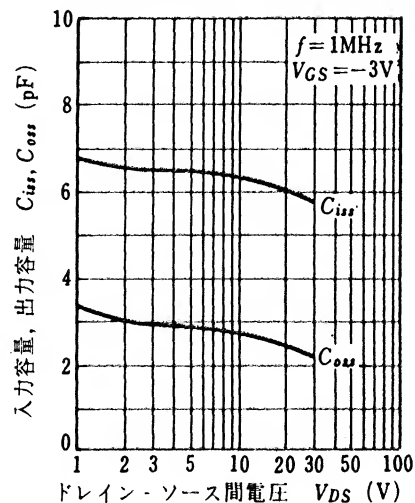
2SK128, 198

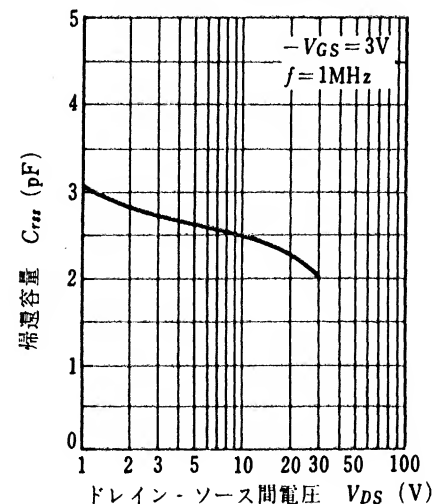
Si 接合型
Nチャンネル

松　下

I_{DSS} ランク分類

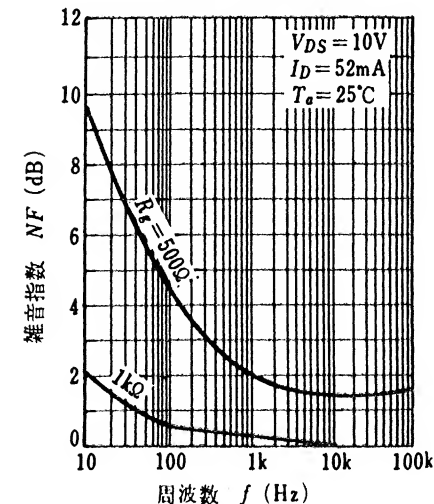
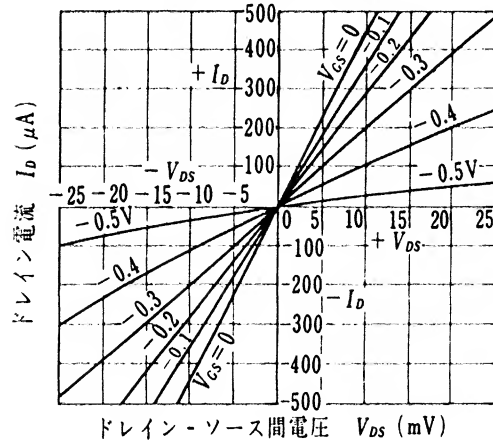
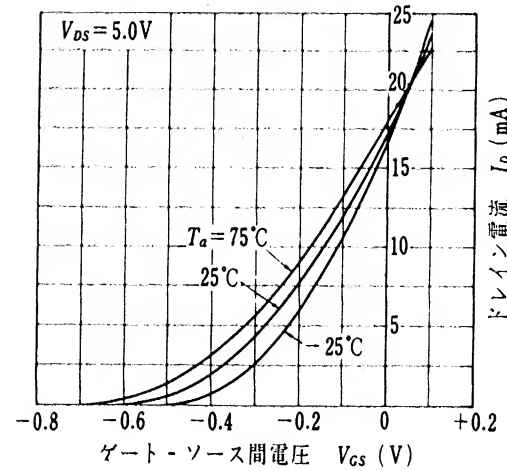
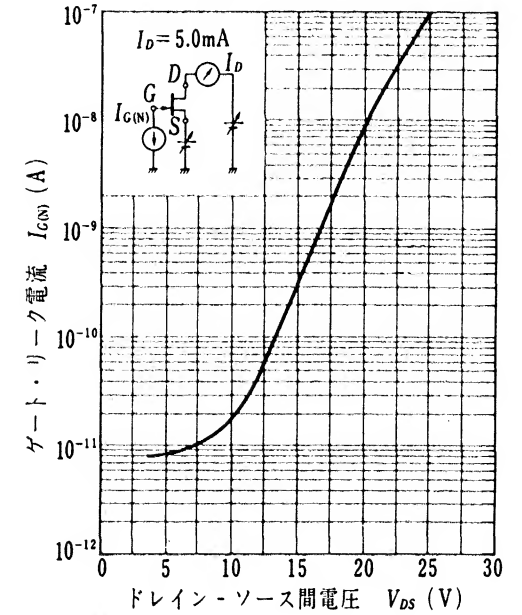
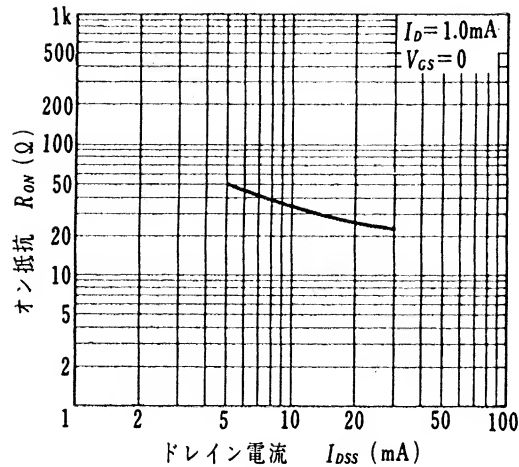
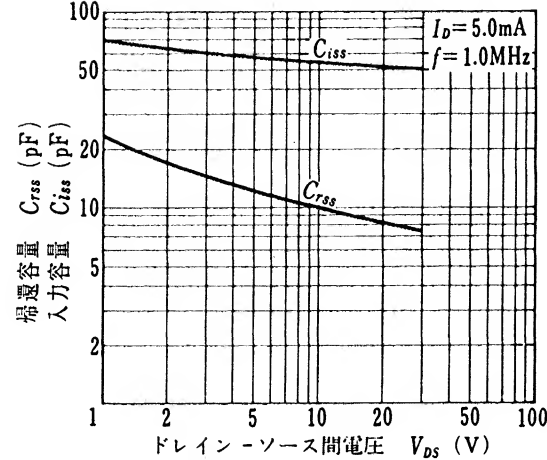
Class	P	Q	R
I_{DSS} (mA)	0.5〜3	2〜6	4〜12

I_D - V_{GS} 特性

g_m - V_{GS} 特性

g_m - I_D 特性

C_{iss}, C_{oss} - V_{DS} 特性

C_{rss} - V_{DS} 特性

NF - f 特性

2SK131

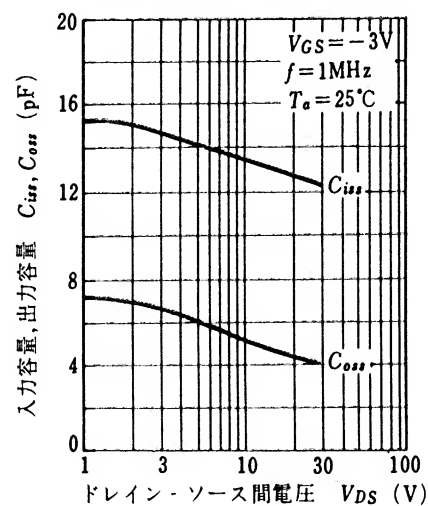
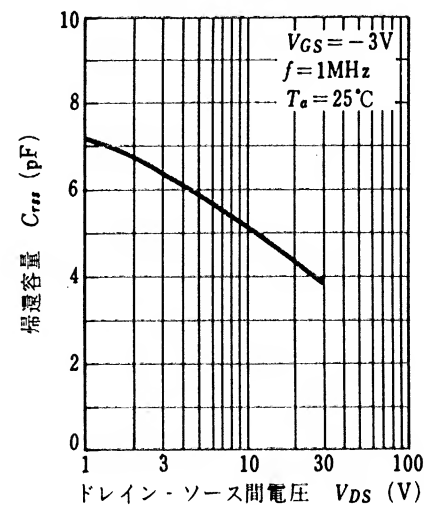
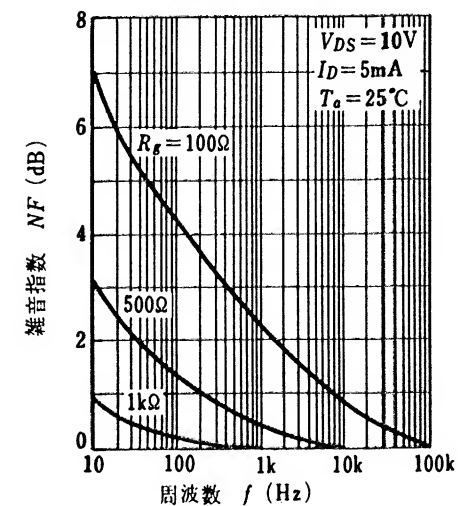
Si 接合型
Nチャンネル

日　　電

2SK136

Si 接合型
Nチャンネル

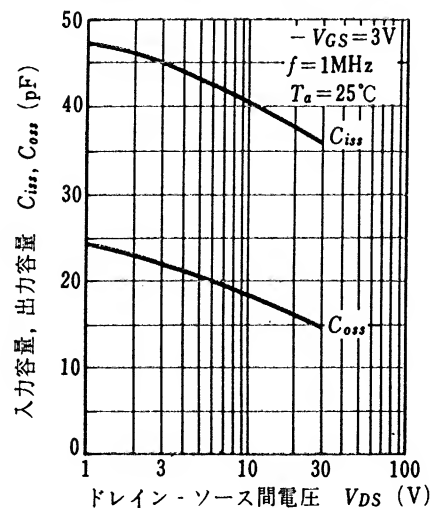
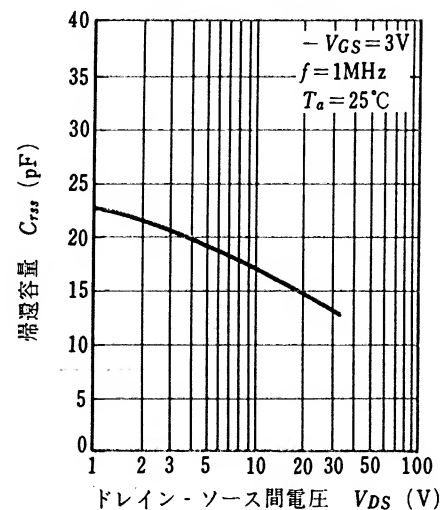
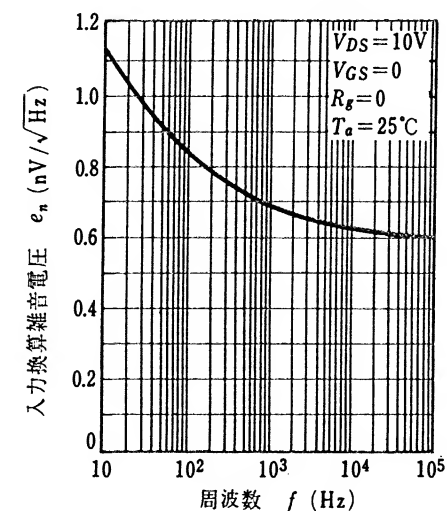
松　　下

I_{DSS} ランク分類

Class	P	Q	R	S
I_{DSS} (mA)	0.5～3	2～6	4～12	10～20

2SK155

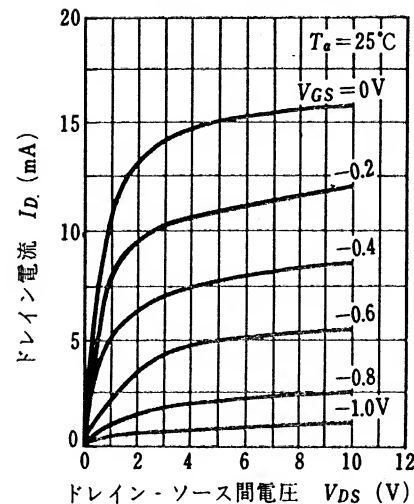
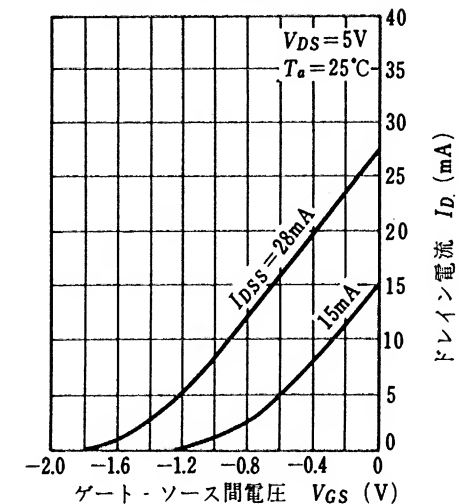
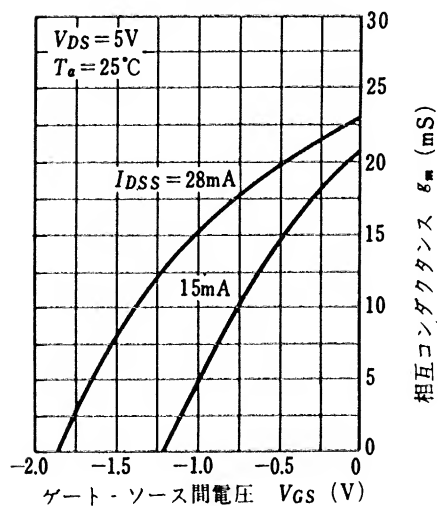
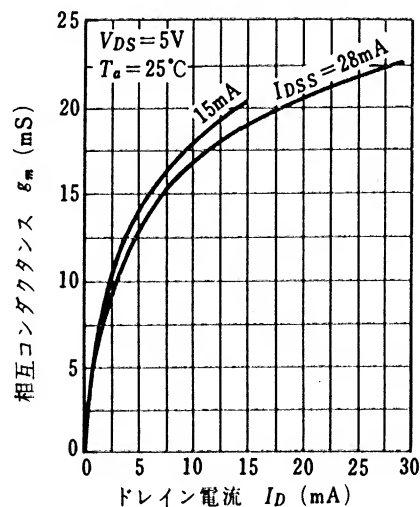
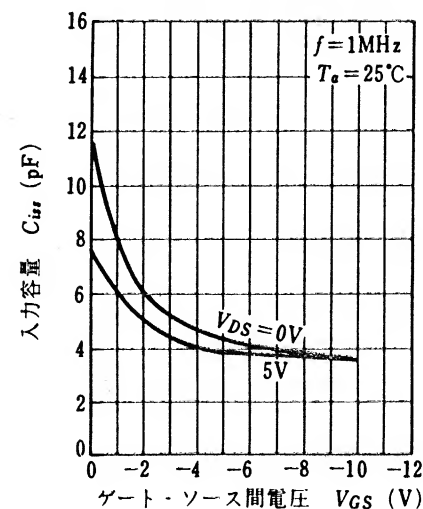
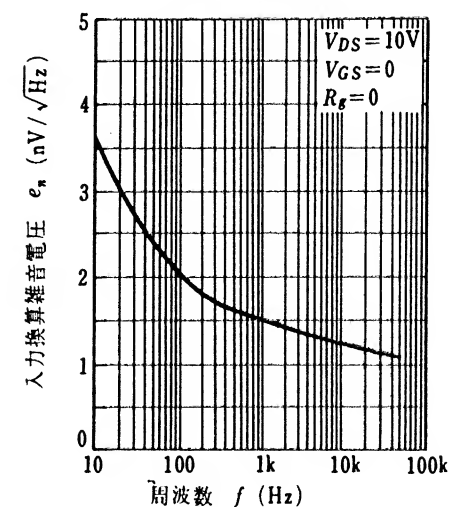
Si 接合型 Nチャンネル　　　　**松　下**

I_{DSS} ランク分類

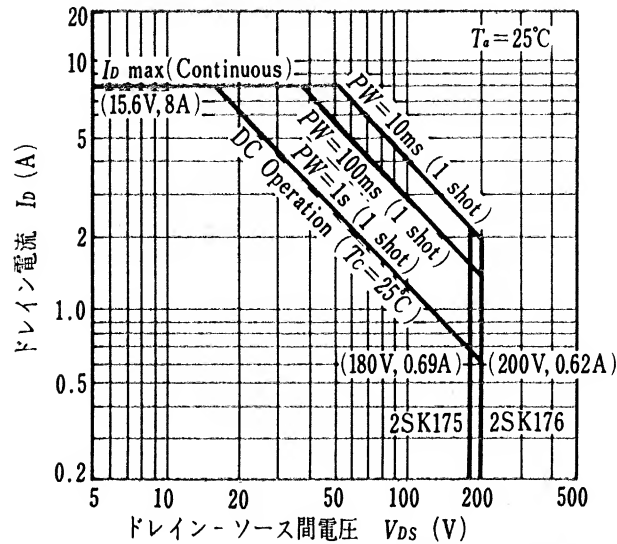
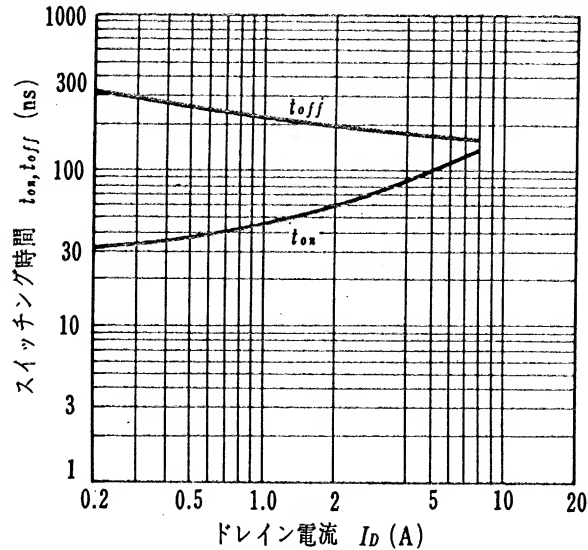
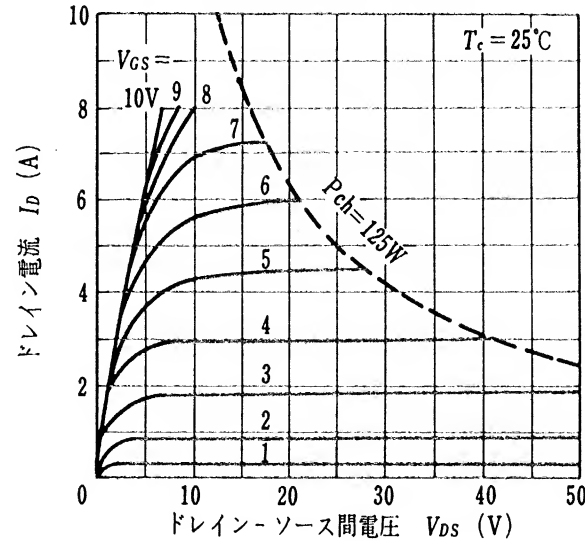
Class	P	Q	R	S	T
I_{DSS} (mA)	0.5～4	2～6	4～12	10～20	18～30

2SK165

Si 接合型 Nチャンネル 松 下

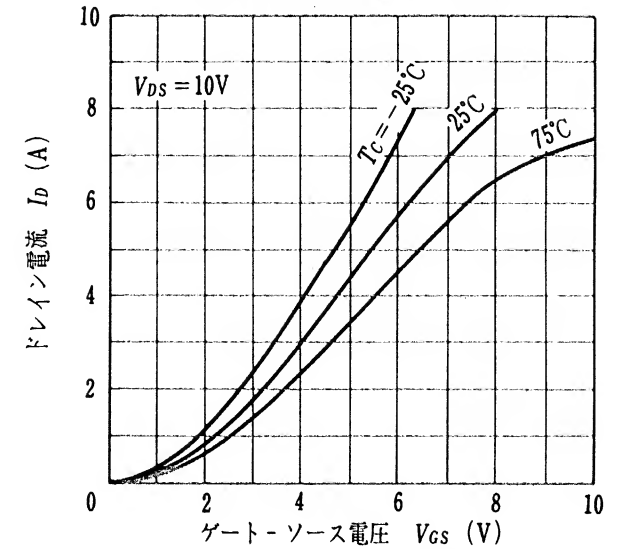
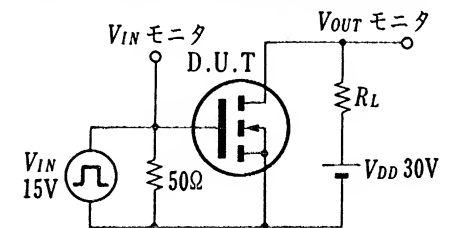
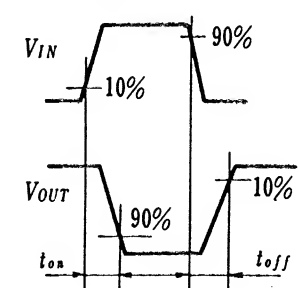
I_{DSS} ランク分類

Class	P	Q	R
I_{DSS} (mA)	8～16	14～24	20～32

2SK175, 176, 176Ⓗ

Si MOS型 Nチャンネル　日立

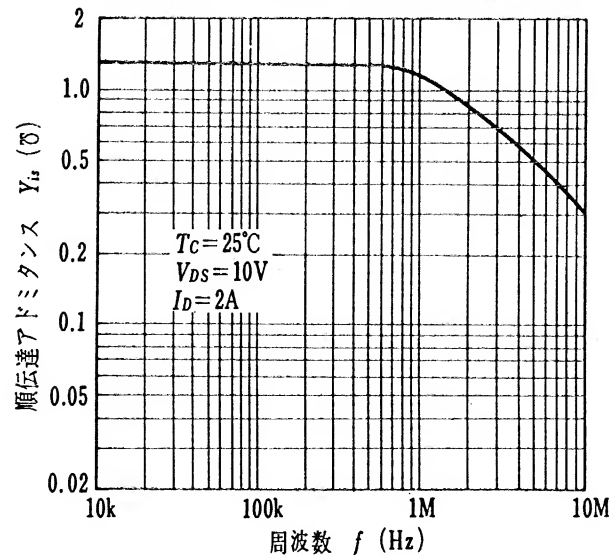
安全動作領域（A.S.O.）

ソース接地出力静特性

ソース接地伝達静特性

(2SK176Ⓗ)

スイッチング時間対ドレイン電流特性

順伝達アドミタンス対周波数特性

(2SK176Ⓗ)

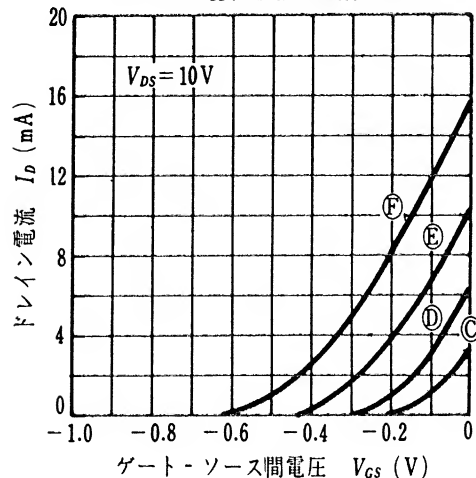
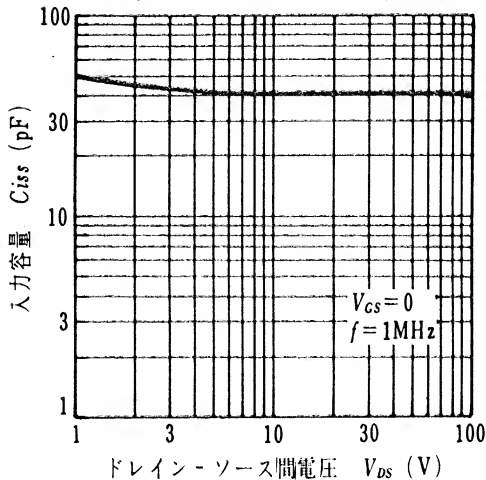
スイッチング時間測定回路

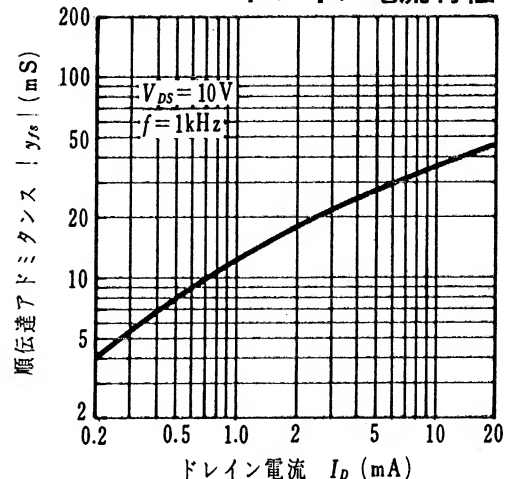
応答波形

2SK187, 431

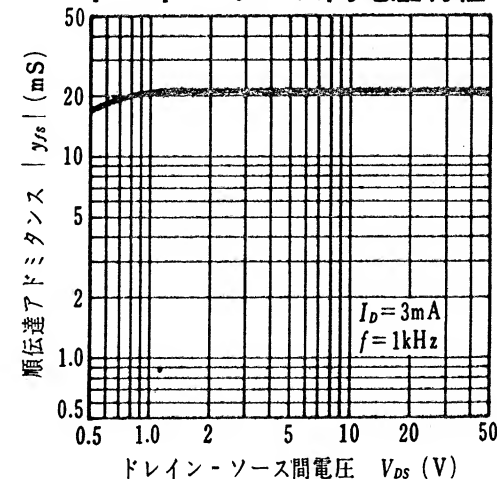
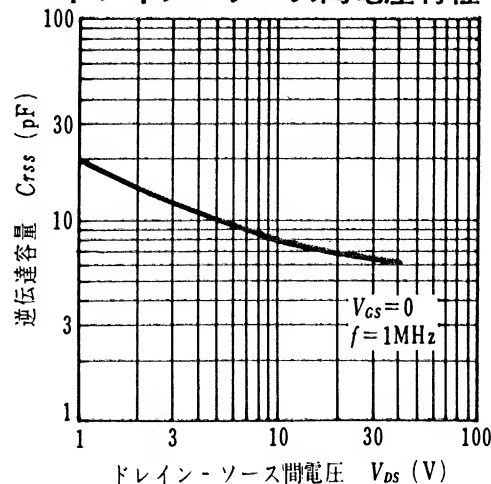
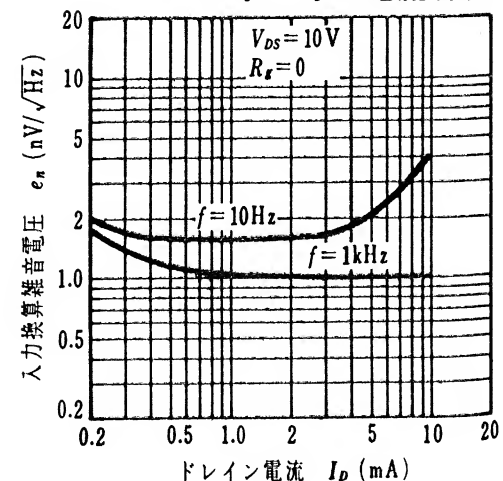
Si 接合型 Nチャンネル

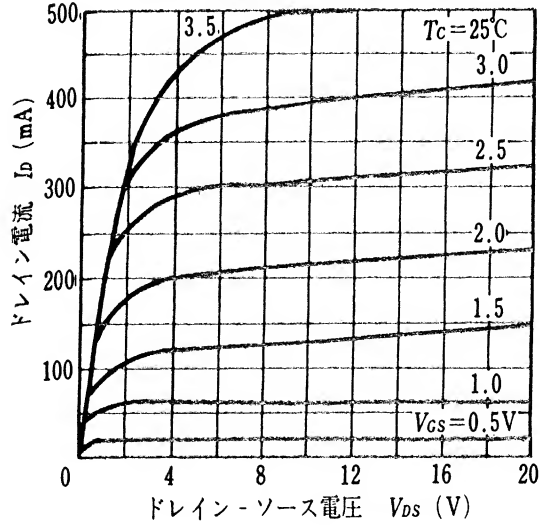
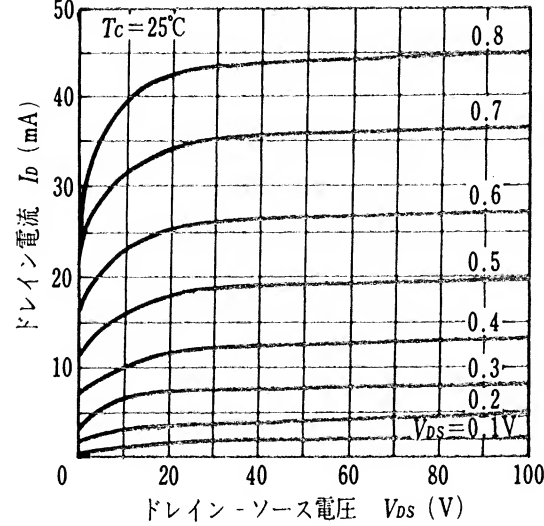
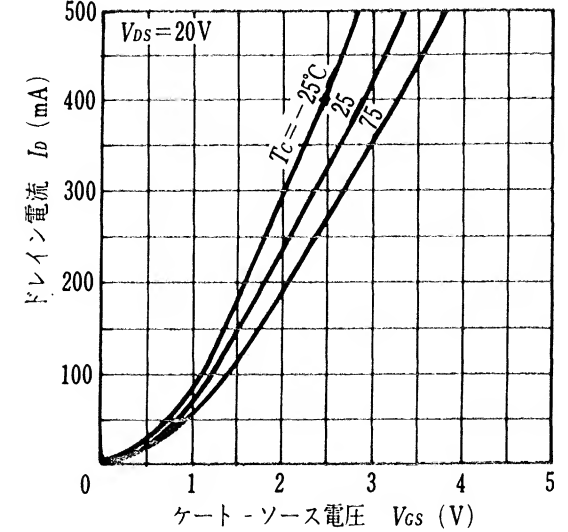
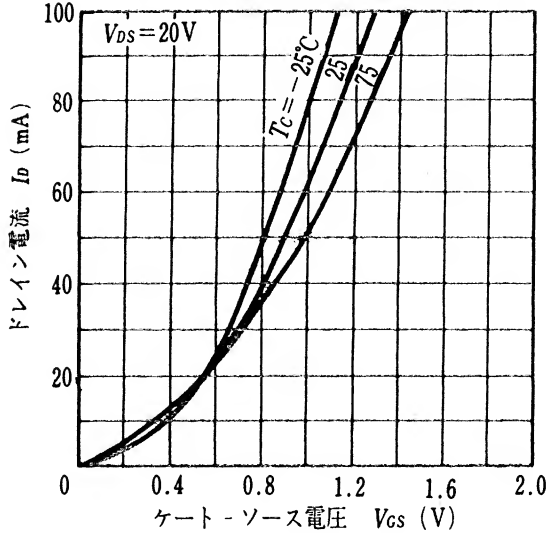
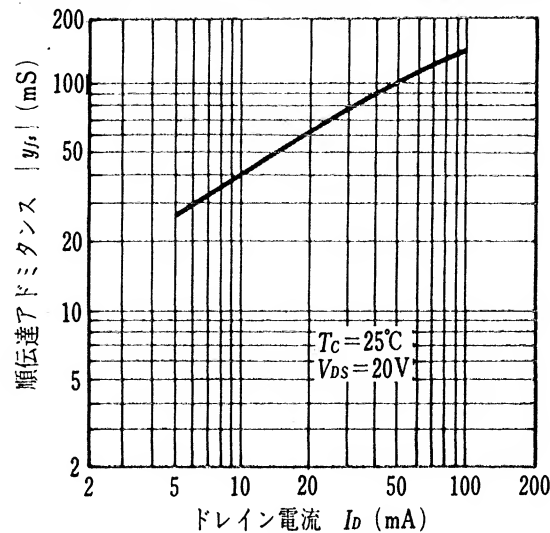
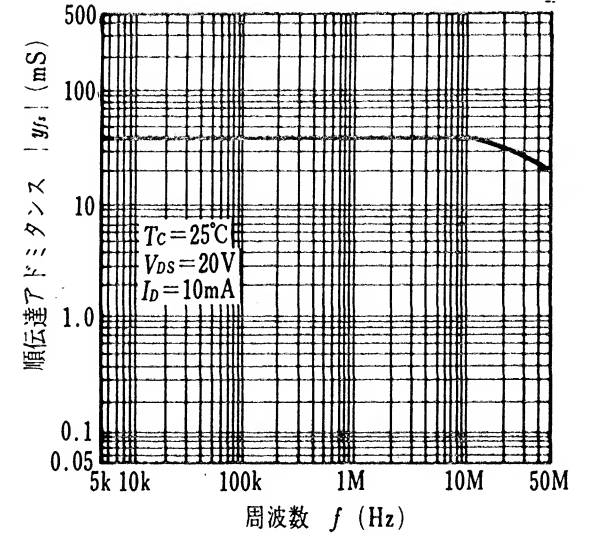
日 立

I_{DSS}の値により下記のように4区分し，現品に表示してある．

Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ
2.5～5	4～8	6～12	10～20

ソース接地伝達静特性

順伝達アドミタンス-ドレイン電流特性

V_{DS}=10V
f=1kHz
順伝達アドミタンス $|y_{fs}|$ (mS)
ドレイン電流 I_D (mA)

順伝達アドミタンス対ドレイン-ソース間電圧特性

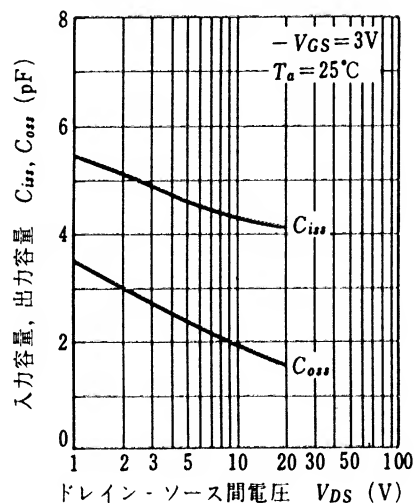
入力容量対ドレイン - ソース間電圧特性

逆伝達容量対ドレイン - ソース間電圧特性

入力換算雑音電圧-ドレイン電流特性

2SK213, 214, 214Ⓚ, 215, 216, 216Ⓚ Si MOS型 Nチャンネル 日立

ソース接地出力静特性(1)

ソース接地出力静特性(2)

ソース接地伝達静特性(1)

ソース接地伝達静特性(2)

順伝達アドミタンス対ドレイン電流特性

順伝達アドミタンス対周波数特性

2SK218

Si 接合型
Nチャンネル

松　下

IDSS ランク分類

Class	P	Q	R	S
I_{DSS} (mA)	5～16	14～24	20～32	28～42

2SK222

Si 接合型
Nチャンネル

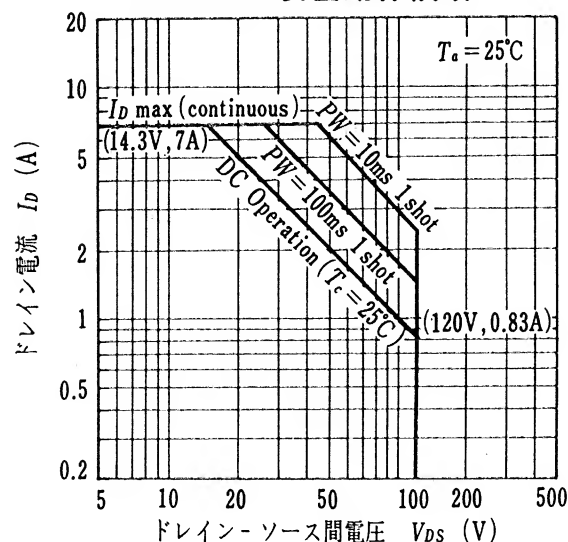
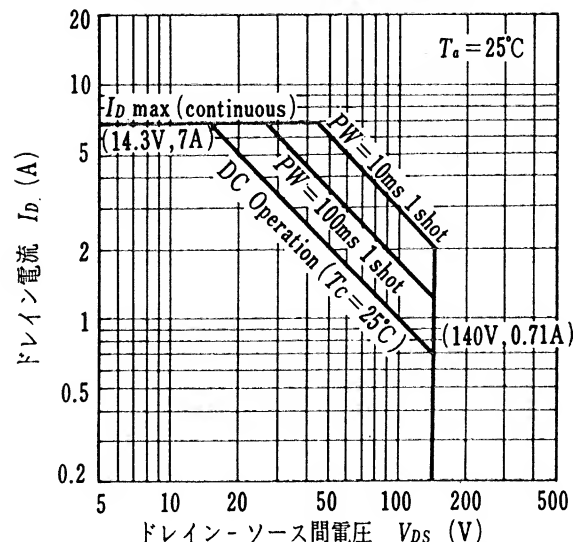
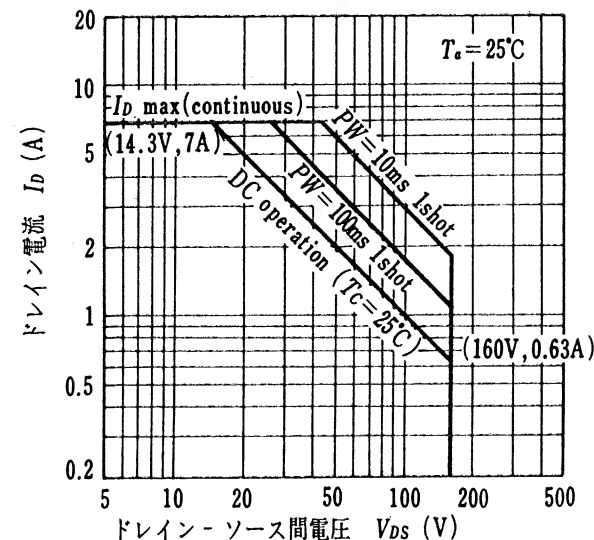
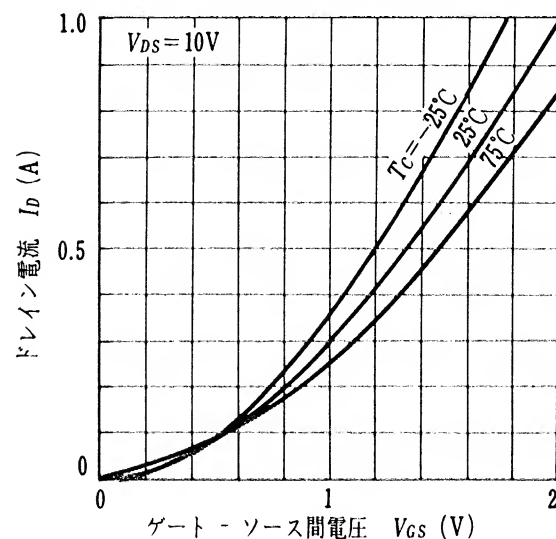
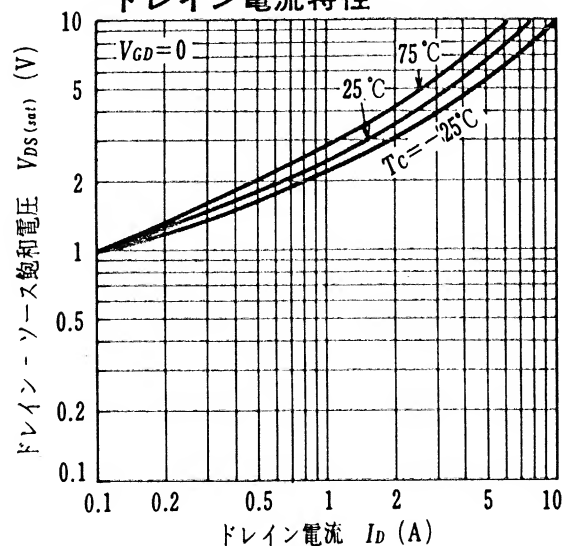
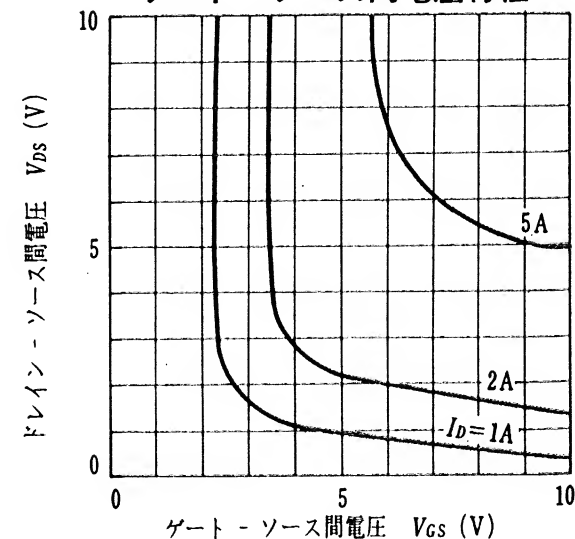
三洋

I_{DSS}により次のように分類している.（単位 mA）

0.6 C 1.5	1.2 D 3.0	2.5 E 6.0	5.0 F 12.0

2SK225, 226, 227

Si MOS型
Nチャンネル

日　立

2SK242

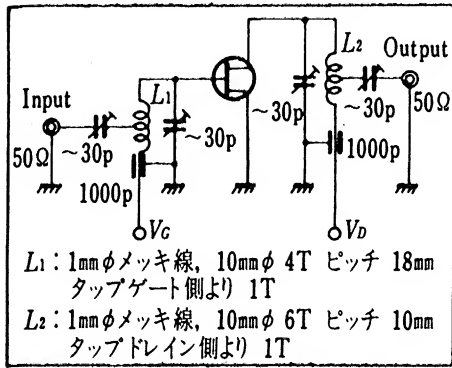
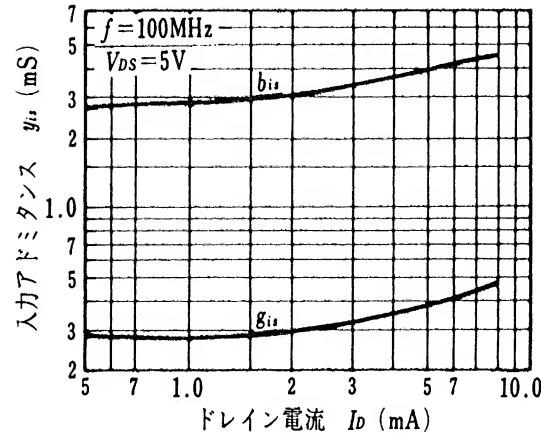
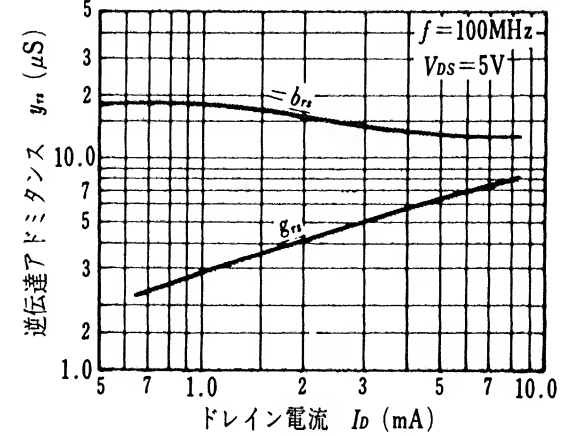
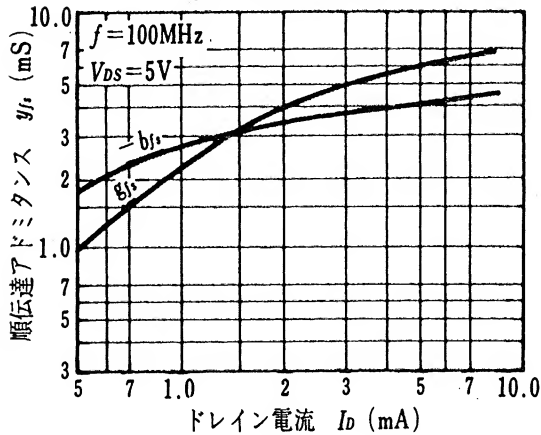
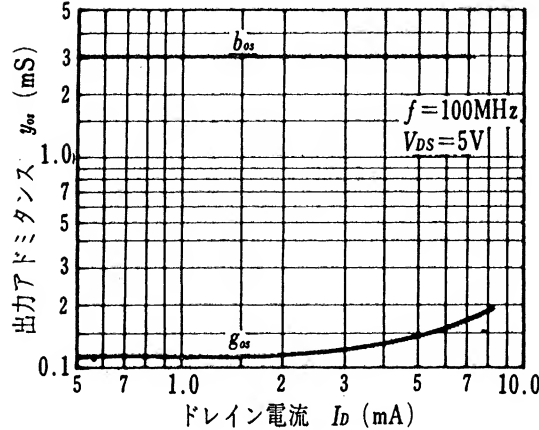
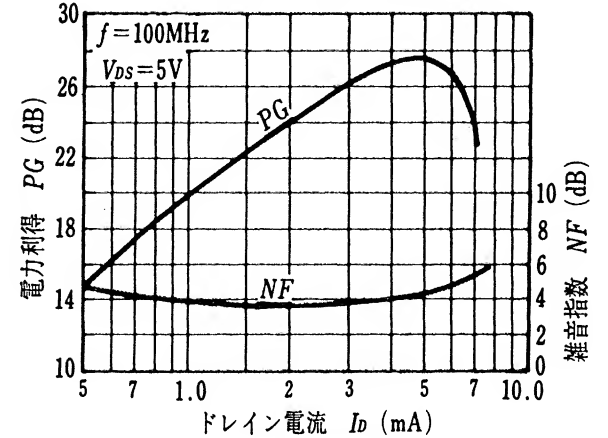
Si 接合型 Nチャンネル ——— 三　洋

I_{DSS}により次のように分類している。(単位 mA)

0.6 C 1.5	1.2 D 3.0	2.5 E 6.0	5.0 F 12.0

PG, NF 測定回路

L_1：1mmφメッキ線，10mmφ 4T ピッチ 18mm タップゲート側より 1T

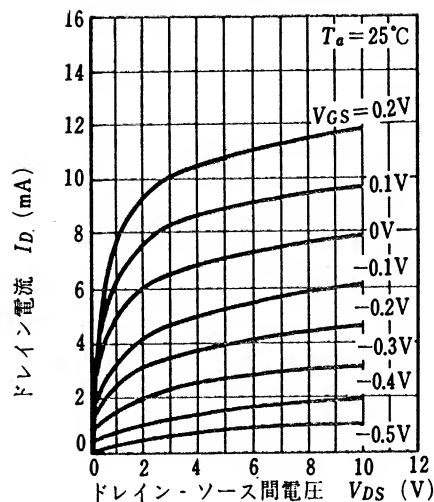
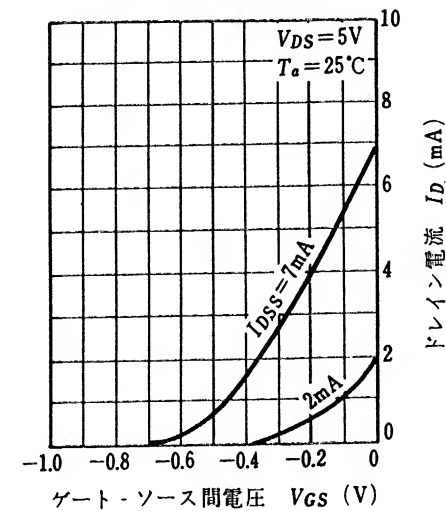
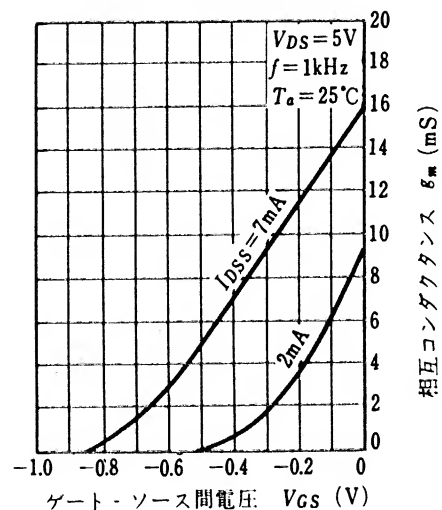
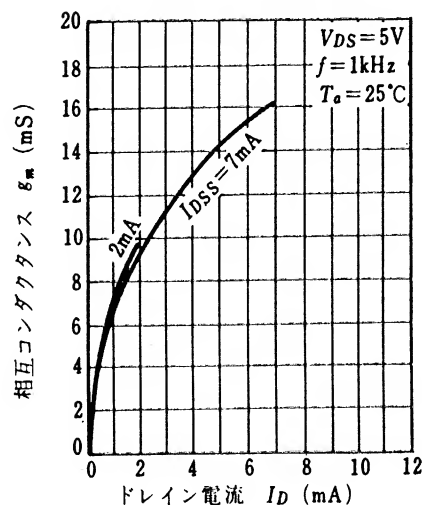
L_2：1mmφメッキ線，10mmφ 6T ピッチ 10mm タップドレイン側より 1T

2SK247

Si 接合型
Nチャンネル

松　下

I_{DSS} ランク分類

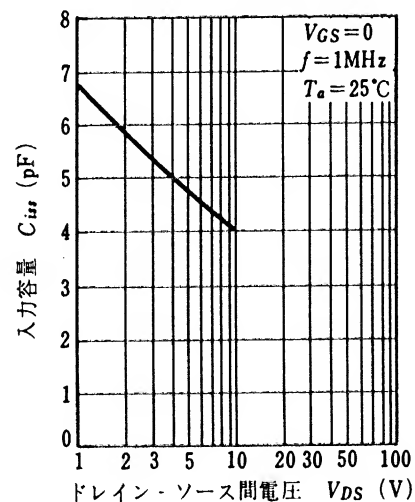
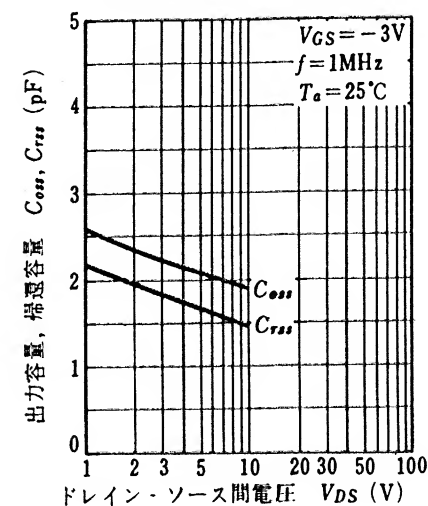
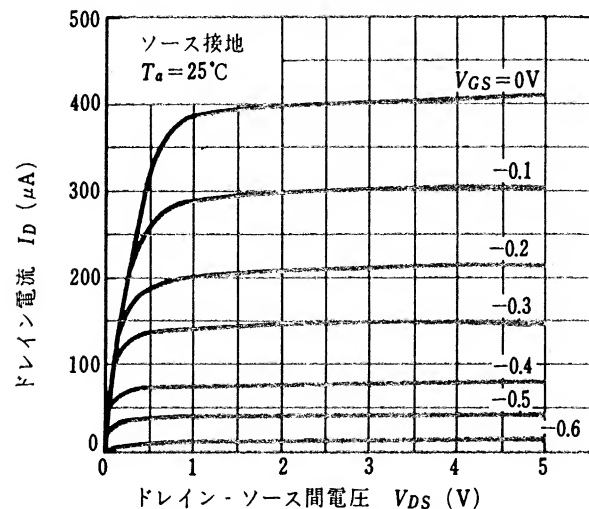
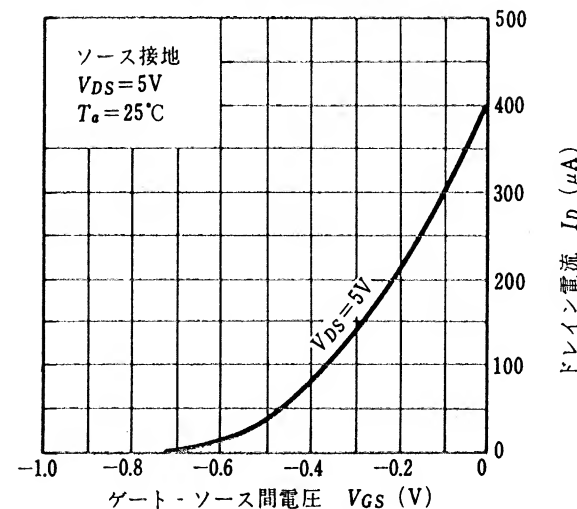
Class	P	Q	R	S
I_{DSS} (mA)	0.5～1.5	1～3	2～6	4～12

I_D - V_{DS} 特性

I_D - V_{GS} 特性

g_m - V_{GS} 特性

g_m - I_D 特性

C_{iss} - V_{DS} 特性

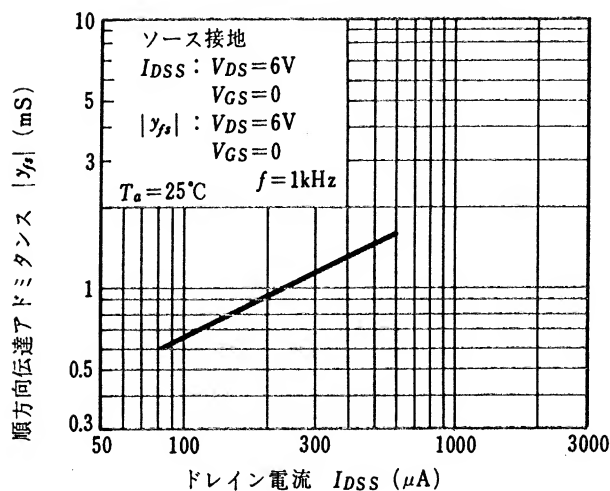
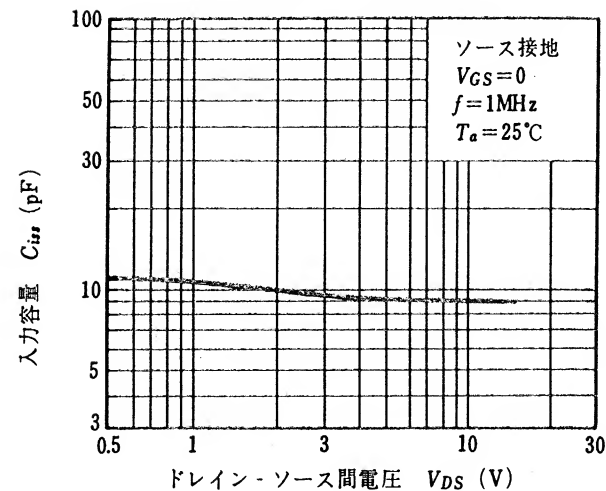
C_{oss}, C_{rss} - V_{DS} 特性

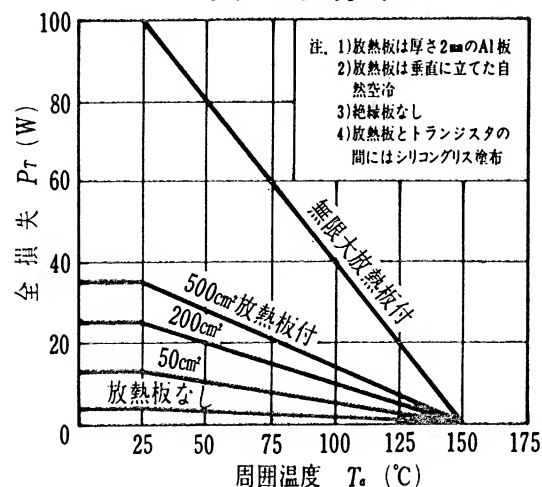
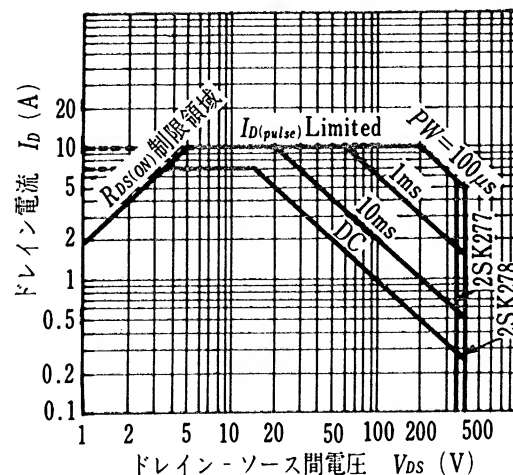
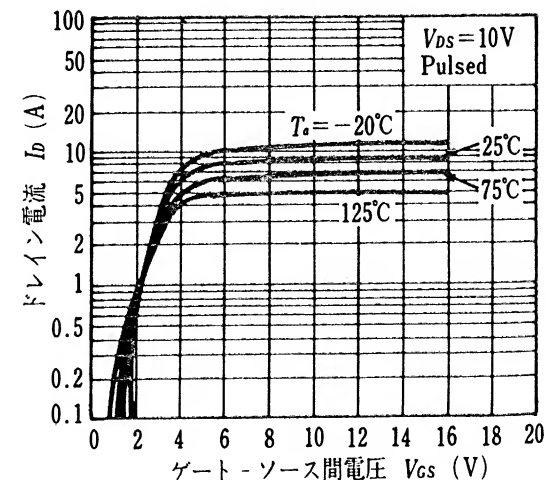
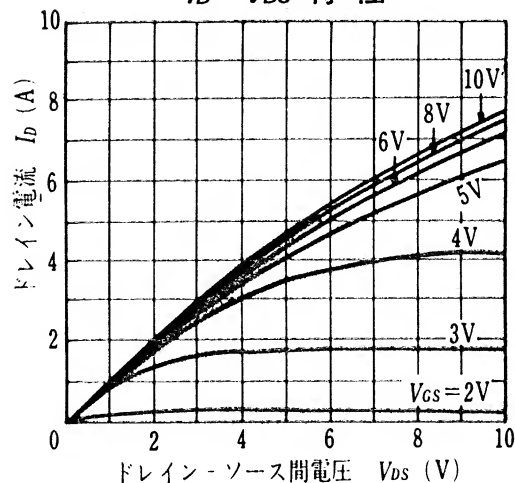
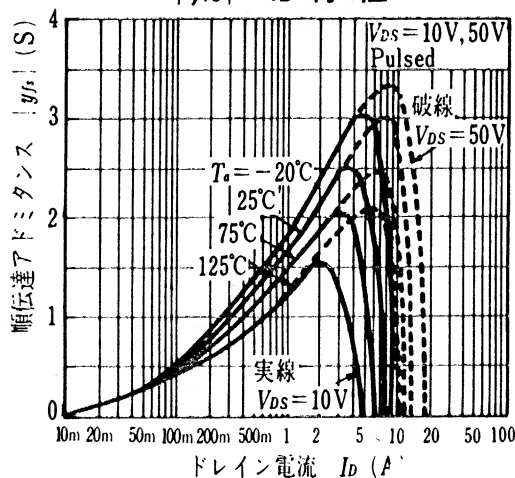
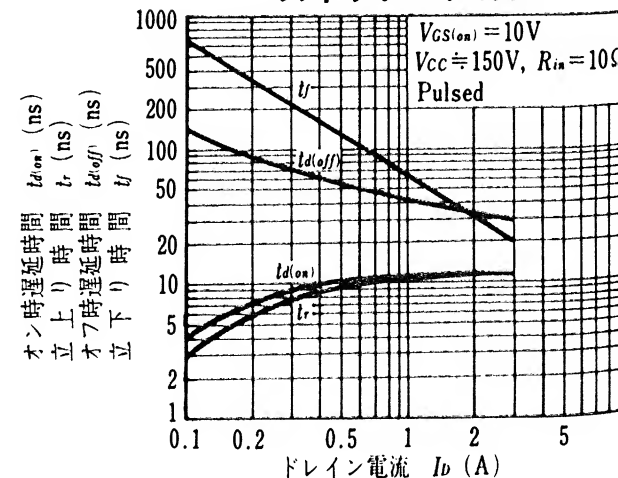
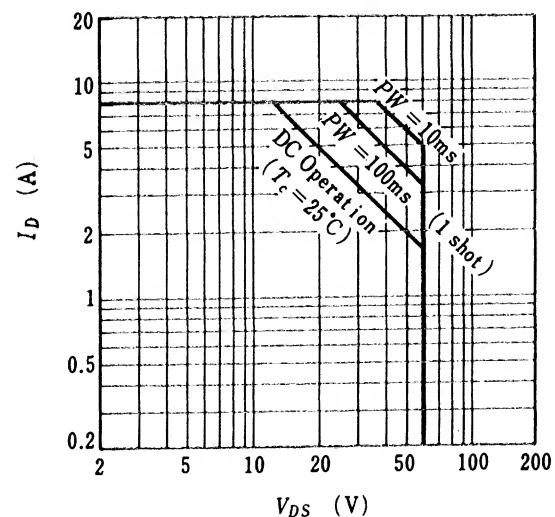
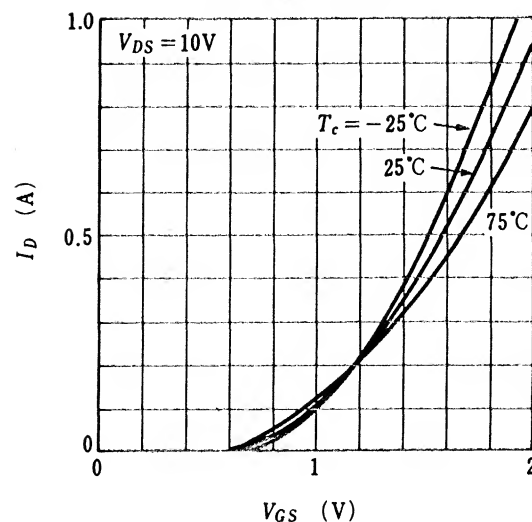
2SK266

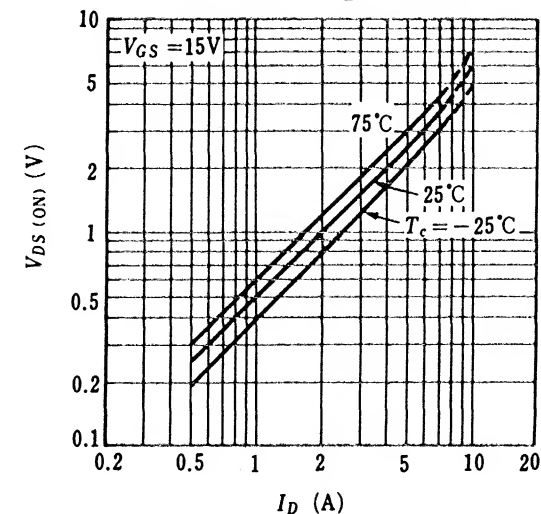
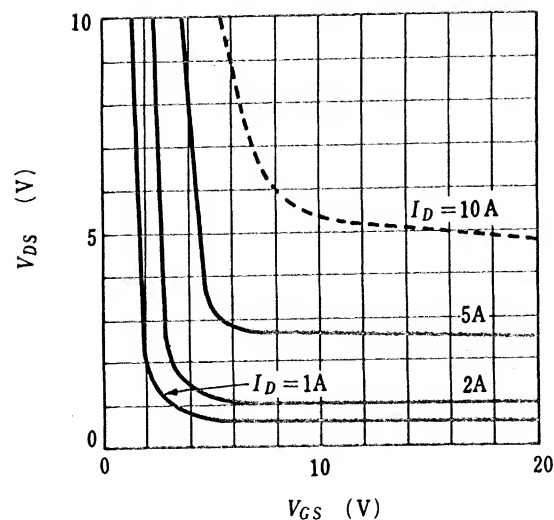
Si 接合型
Nチャンネル

東　芝

I_D - V_{DS} 特性

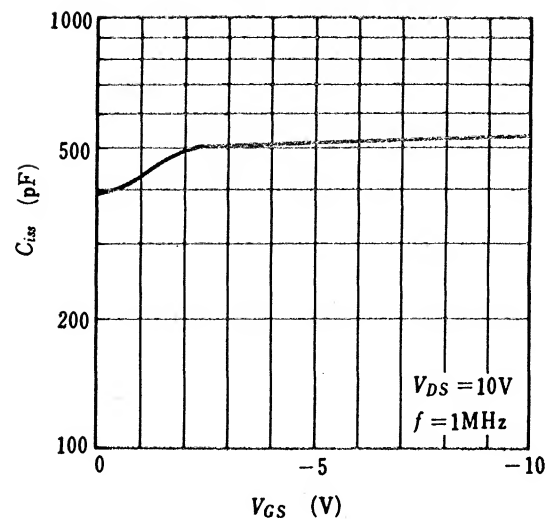
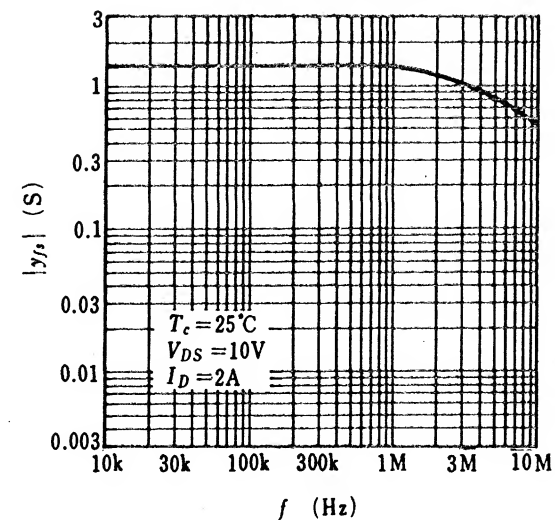
I_D - V_{GS} 特性

$|y_{fs}|$ - I_{DSS} 特性

C_{iss} - V_{DS} 特性

2SK277, 278

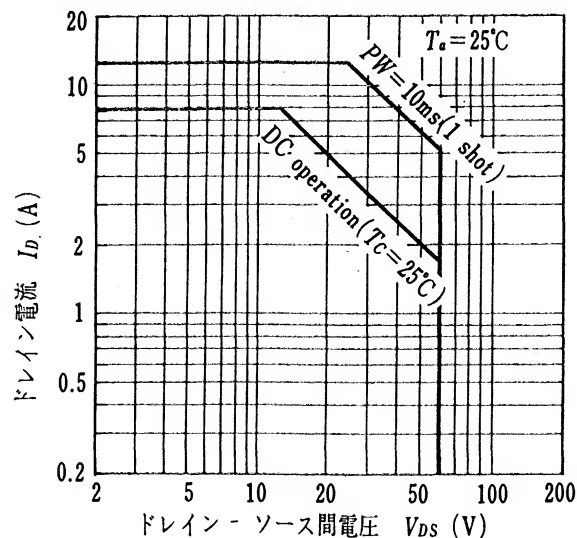
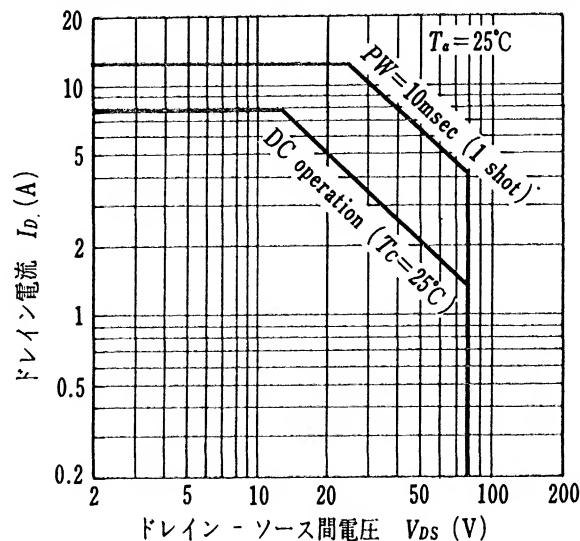
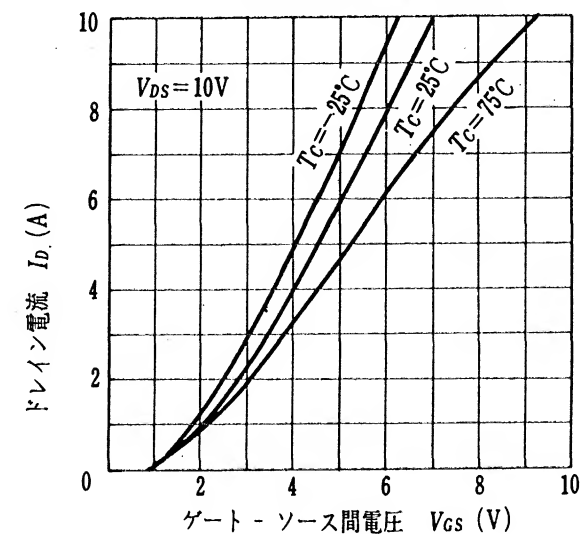
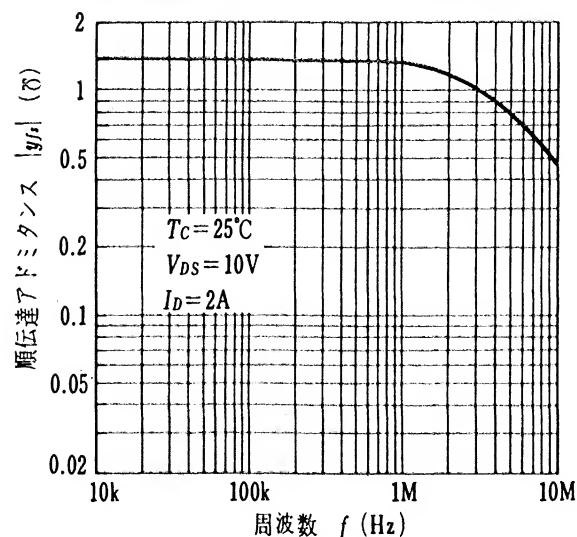
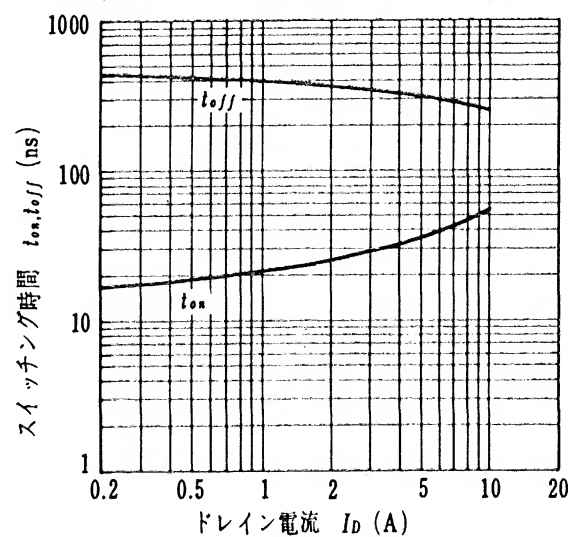
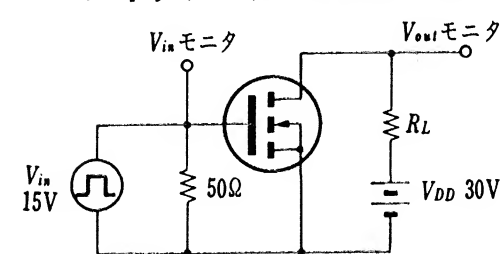
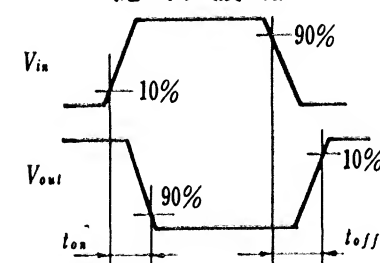
Si MOS型 Nチャンネル　日　電

2SK286

Si MOS型 Nチャンネル　　日　立

$V_{DS(ON)}$ - I_D 特性

V_{DS} - V_{GS} 特性

C_{iss} - V_{GS} 特性

$|y_{fs}|$ - f 特性

2SK287Ⓚ, 288Ⓚ

Si MOS型 Nチャンネル

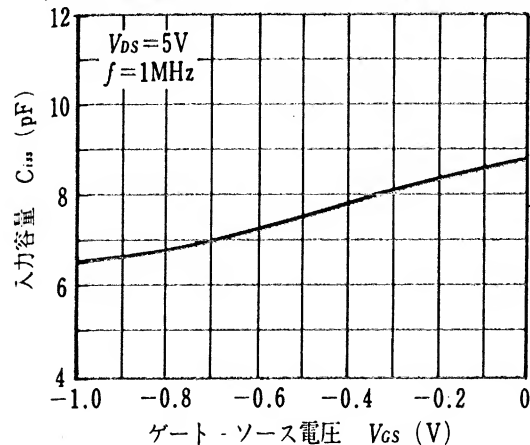
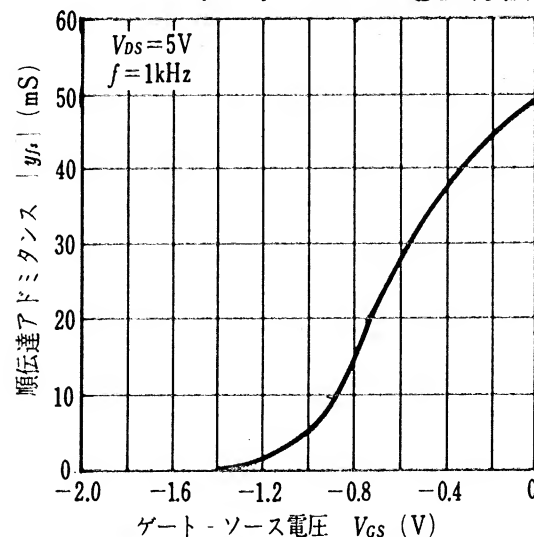
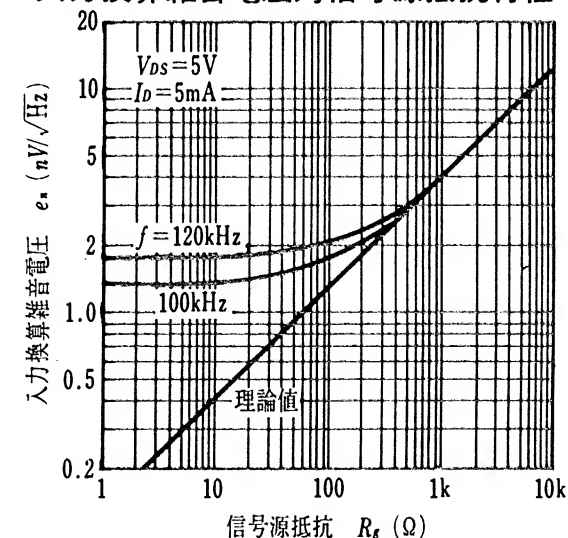
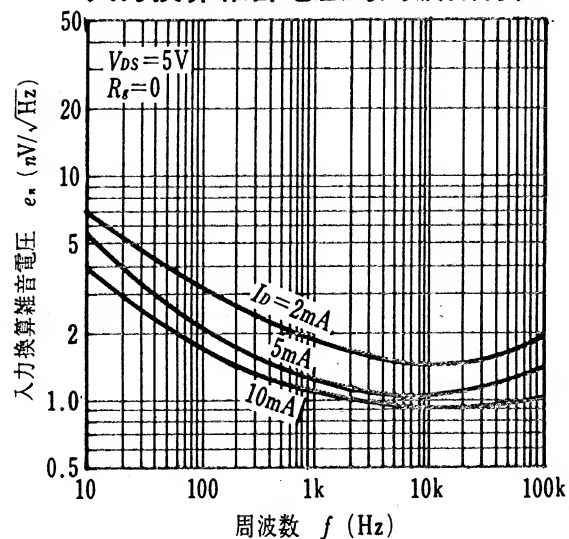
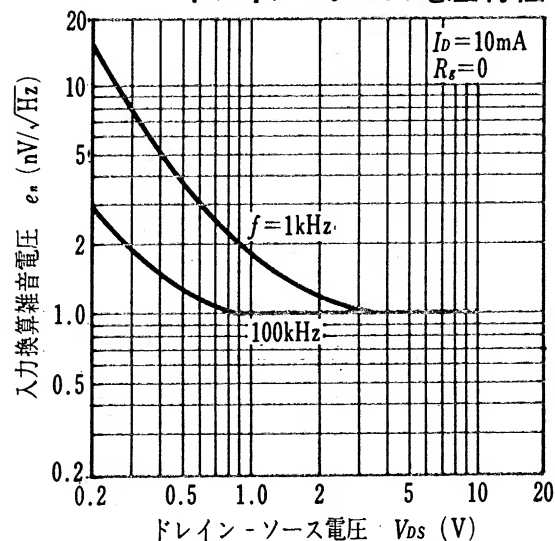
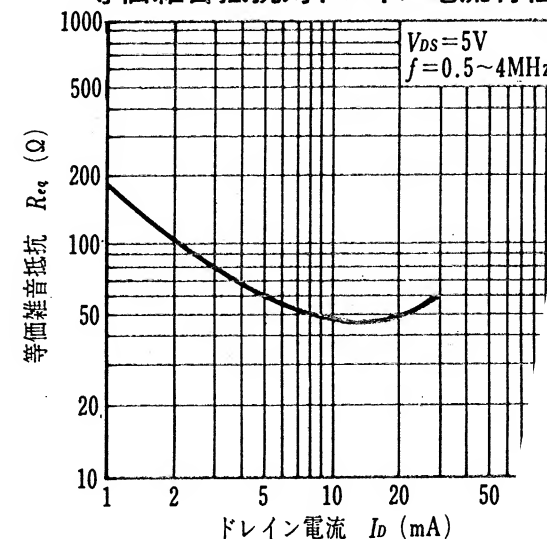
日立

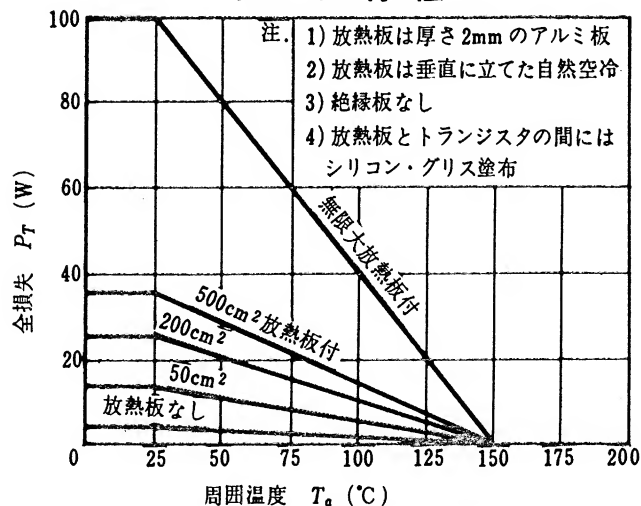
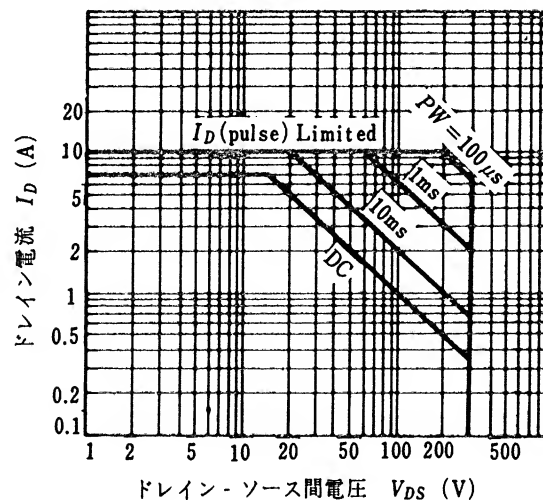
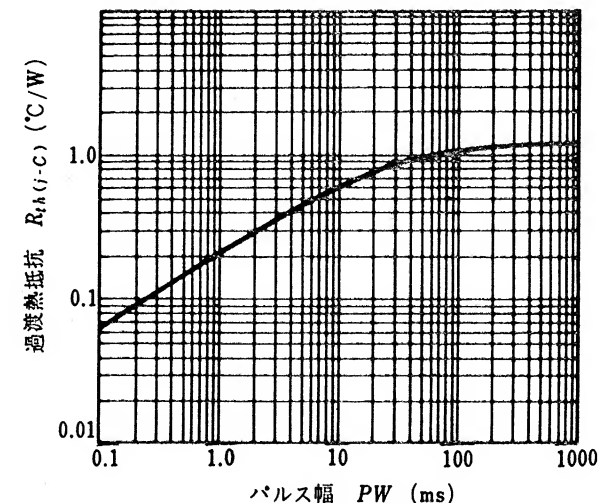
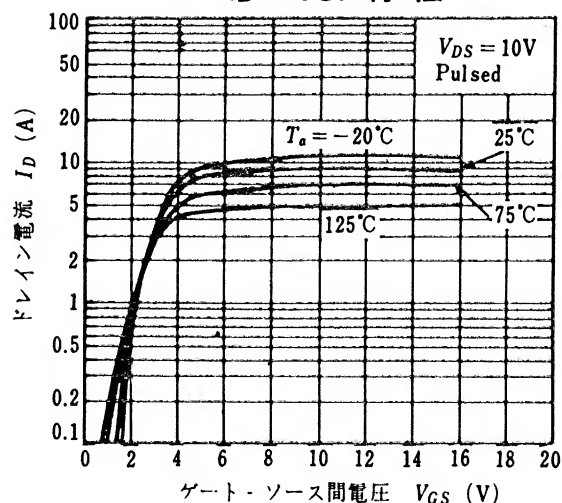
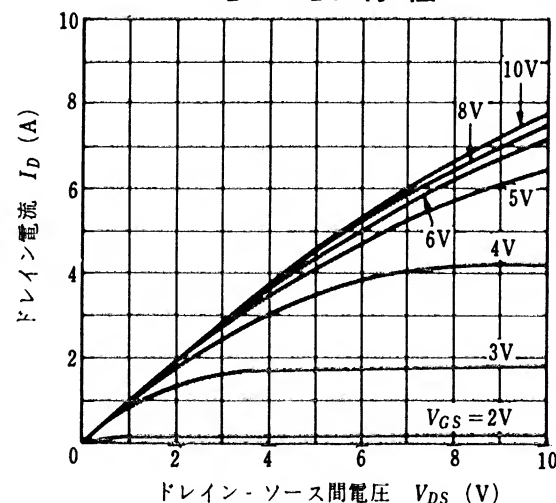
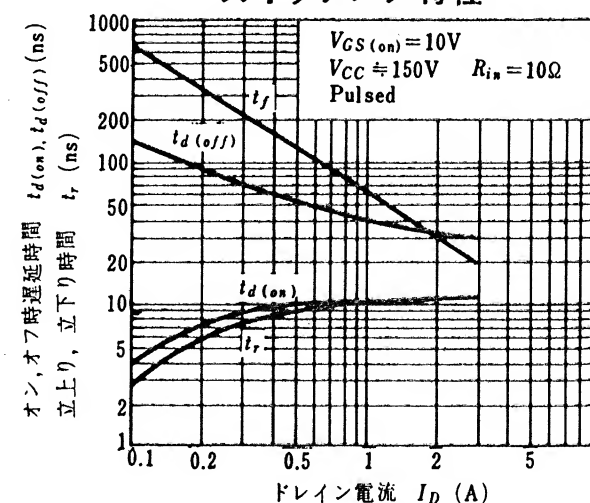
2SK287Ⓚ安全動作領域（A.S.O.）

2SK288Ⓚ安全動作領域（A.S.O.）

ソース接地伝達静特性

順伝達アドミタンス対周波数特性

スイッチング時間対ドレイン電流特性

スイッチング時間測定回路

2SK291

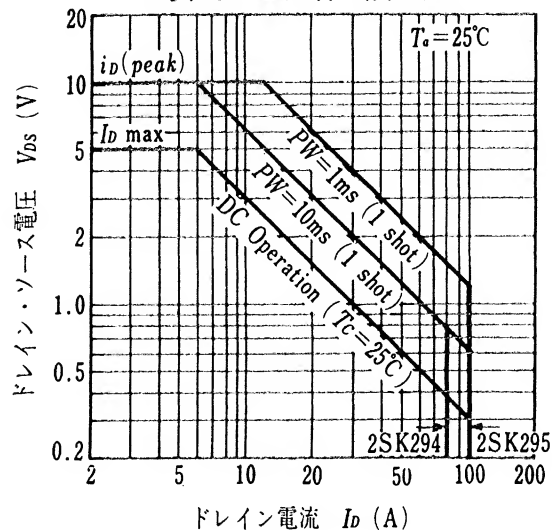
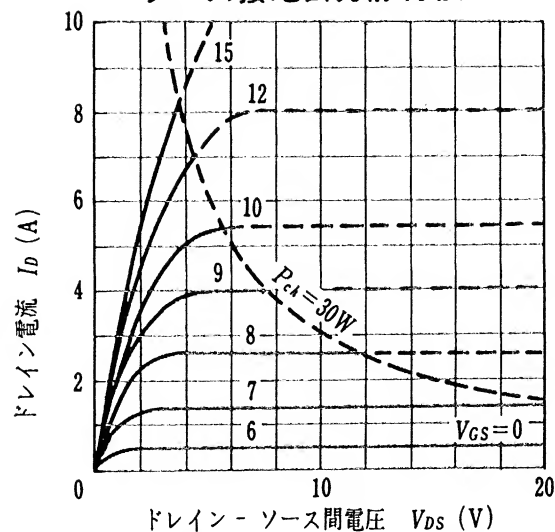
Si 接合型 Nチャンネル 　　　　　　　　**日　立**

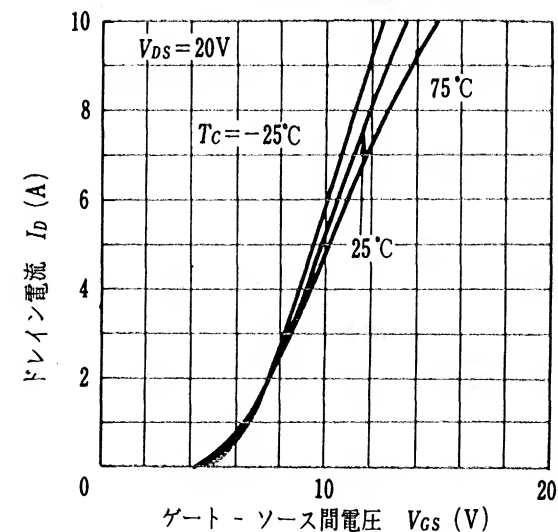
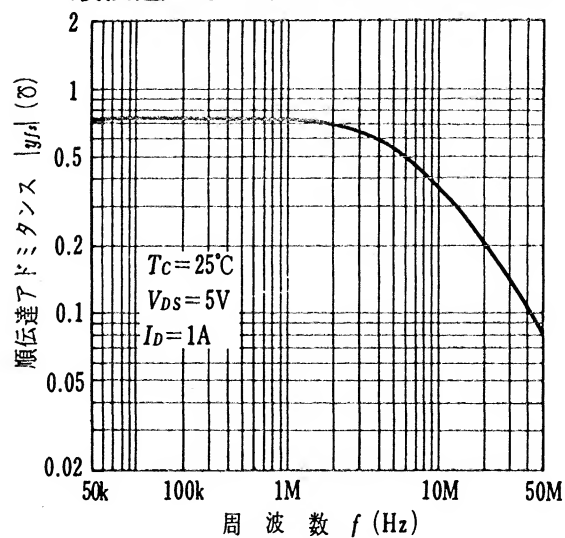
I_{DSS}区分

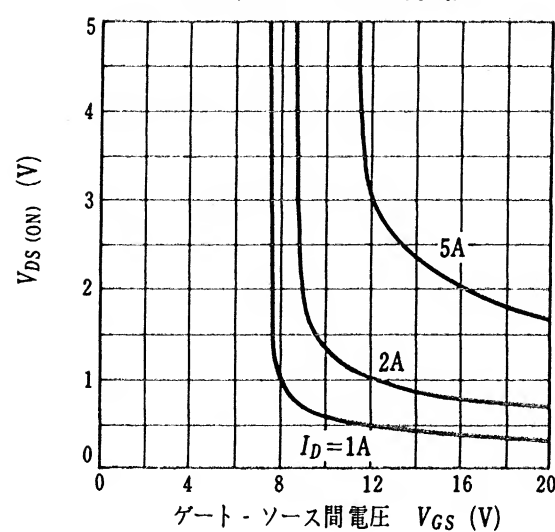
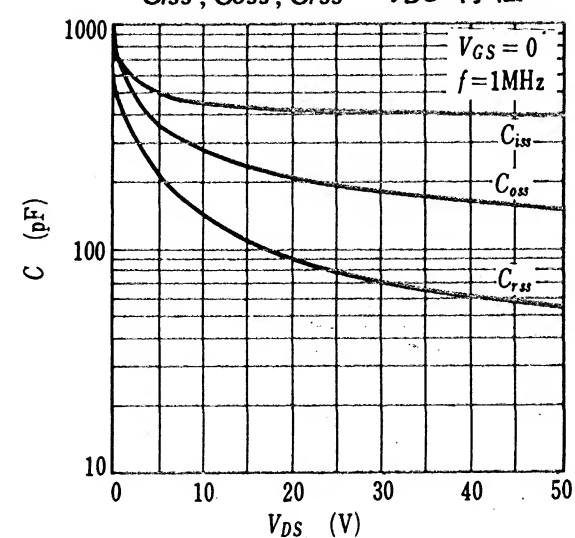
E	F	G	H
6～12	10～20	16～32	25～50

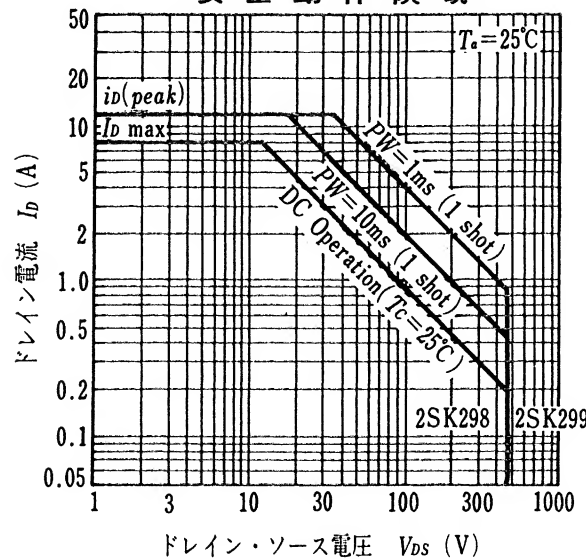
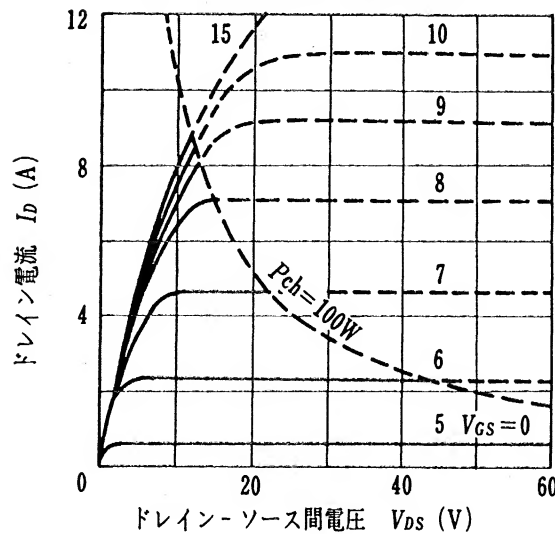
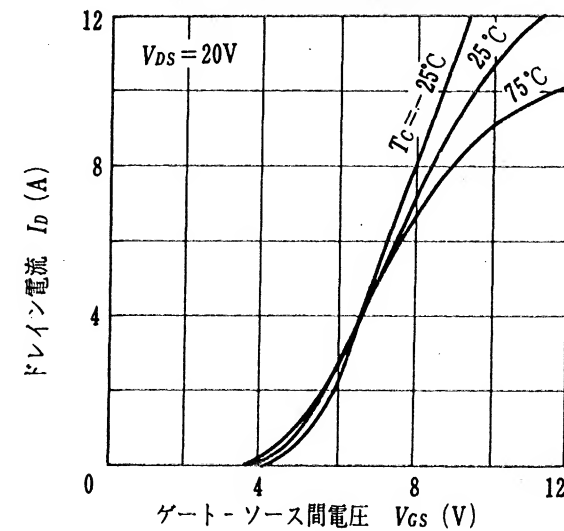
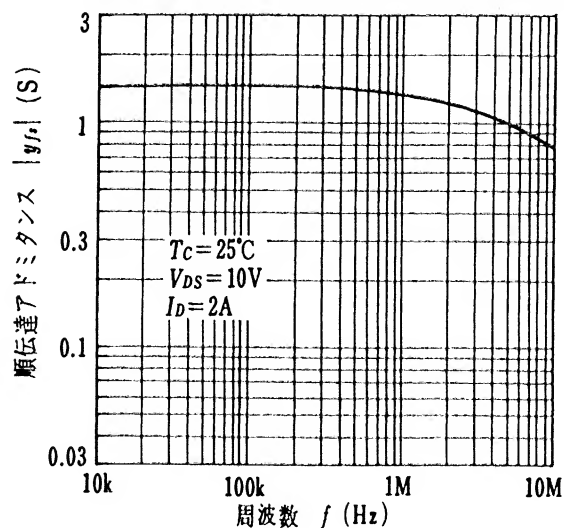
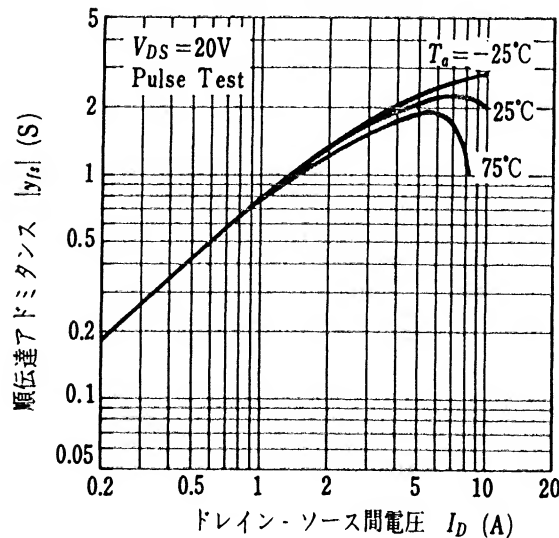
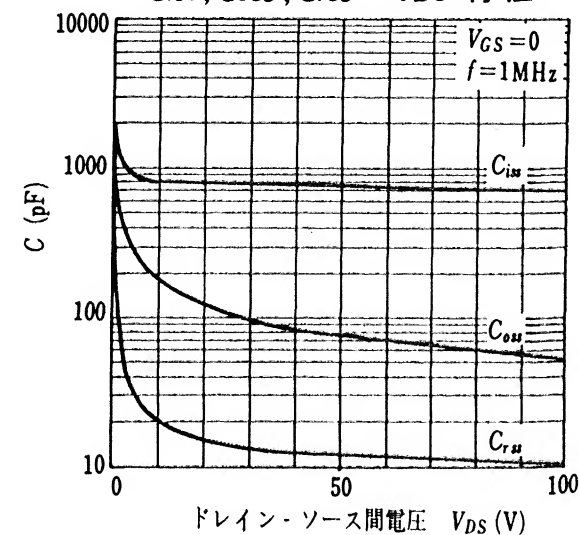
入力容量対ゲート・ソース電圧特性

順伝達アドミタンス対ゲート・ソース電圧特性

入力換算雑音電圧対信号源抵抗特性

入力換算雑音電圧対周波数特性

入力換算雑音電圧対ドレイン・ソース電圧特性

等価雑音抵抗対ドレイン電流特性

2SK293, 293A

Si MOS型 Nチャンネル　　日電

2SK294, 295

Si MOS型 Nチャンネル　日立

安全動作領域

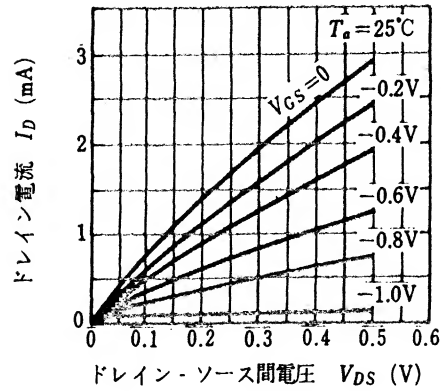
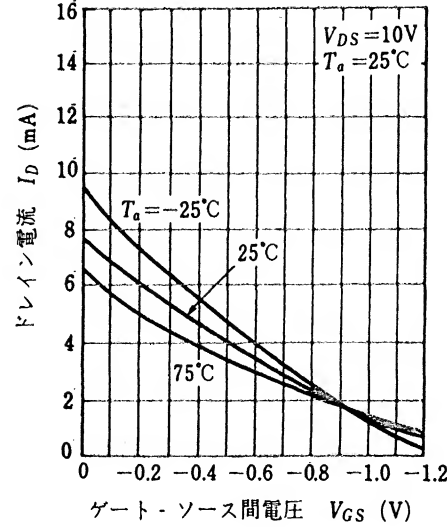
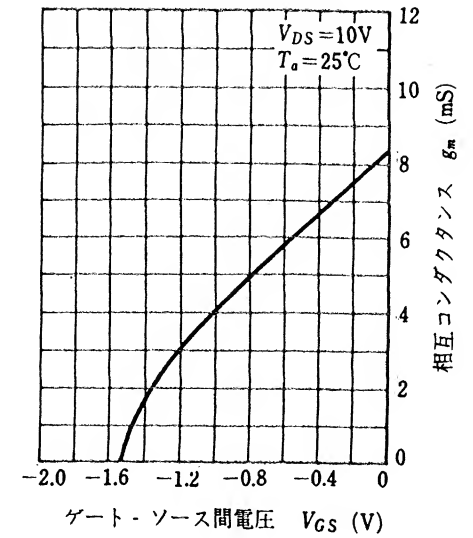
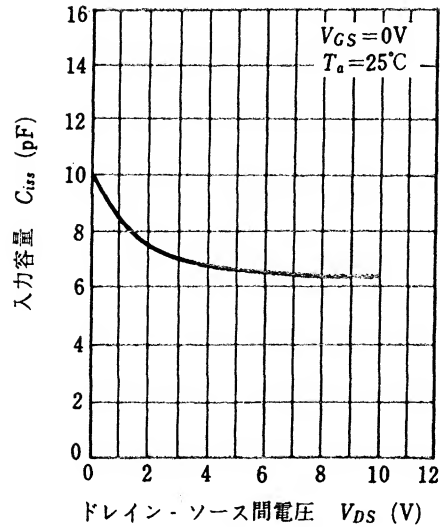
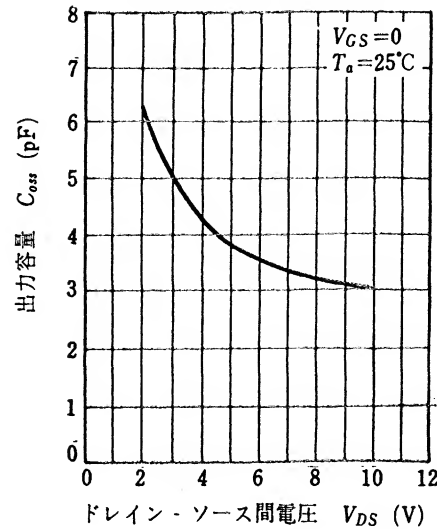
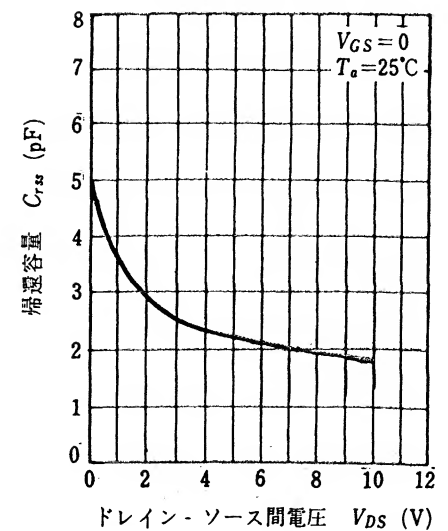
ソース接地出力静特性

ソース接地伝達静特性

順伝達アドミタンス対周波数特性

$V_{DS(ON)}$ - V_{GS} 特性

C_{iss}, C_{oss}, C_{rss} - V_{DS} 特性

2SK298, 299

Si MOS型 Nチャンネル　日立

2SK301, 374

Si 接合型 Nチャンネル　　松　下

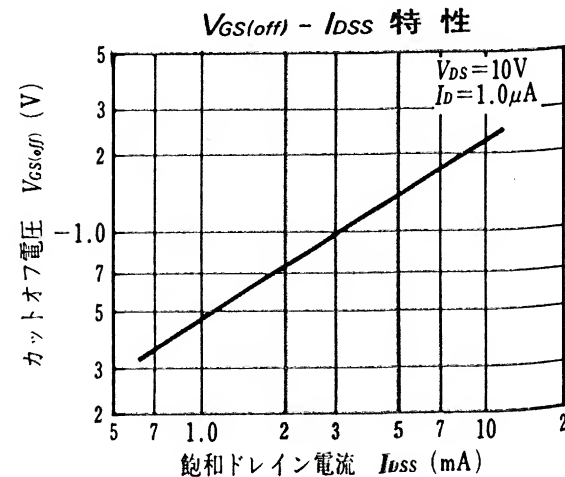
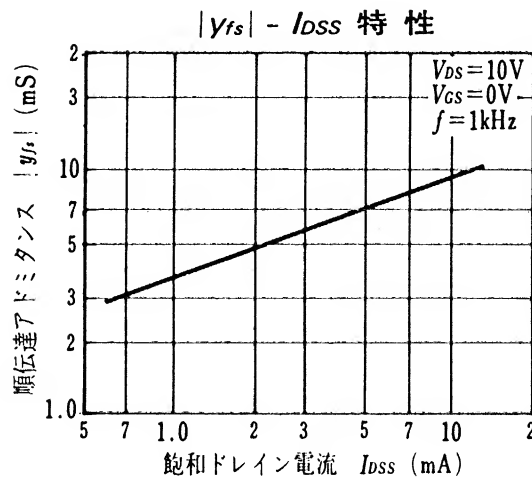
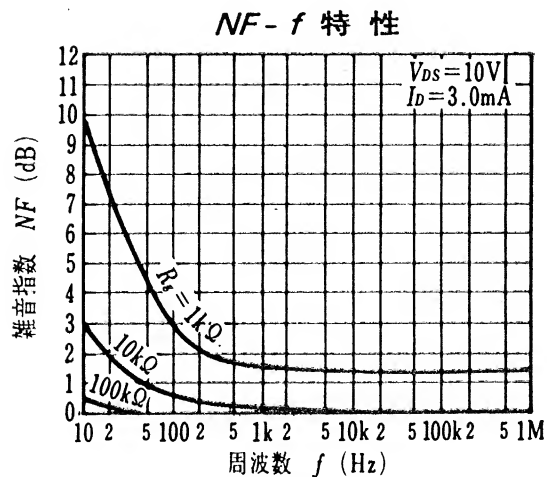
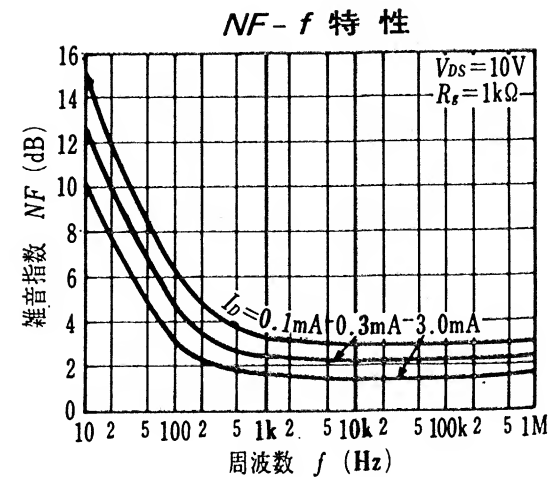
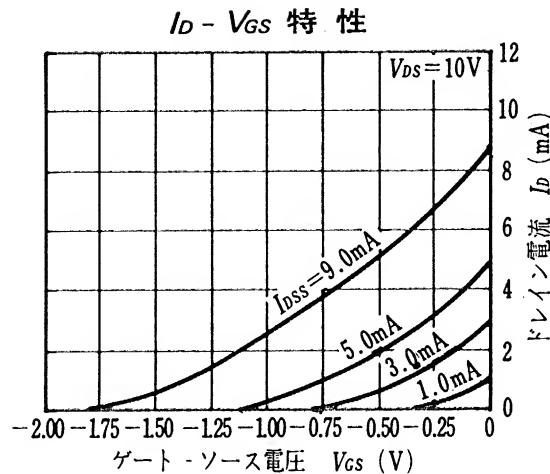
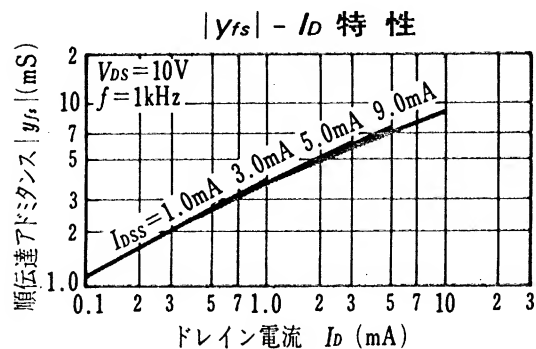
I_{DSS} ランク分類

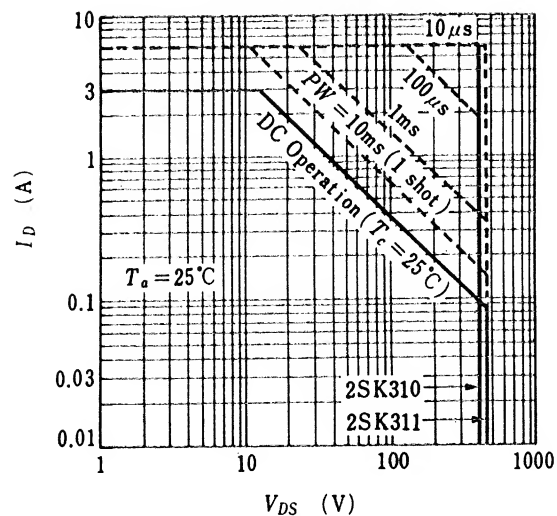
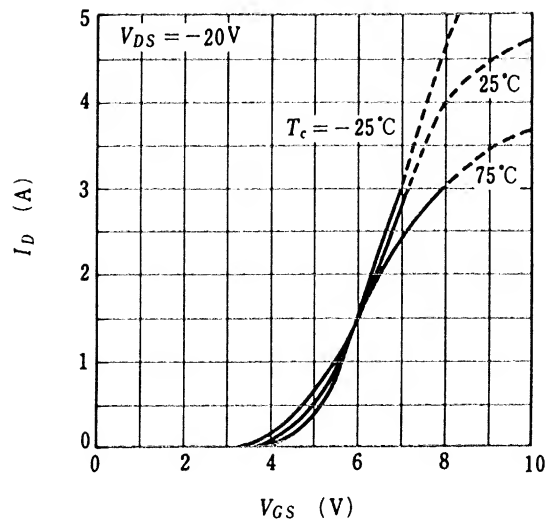
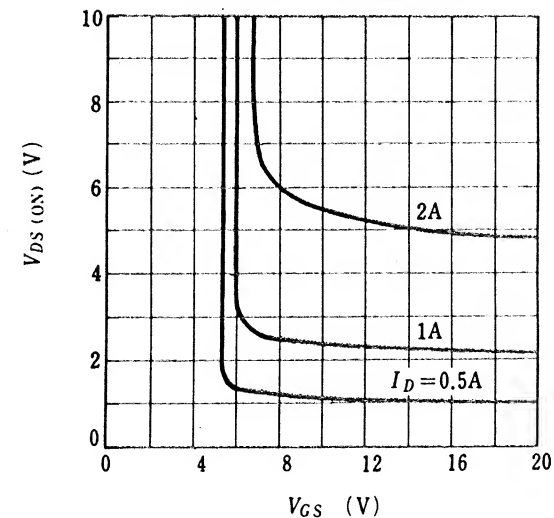
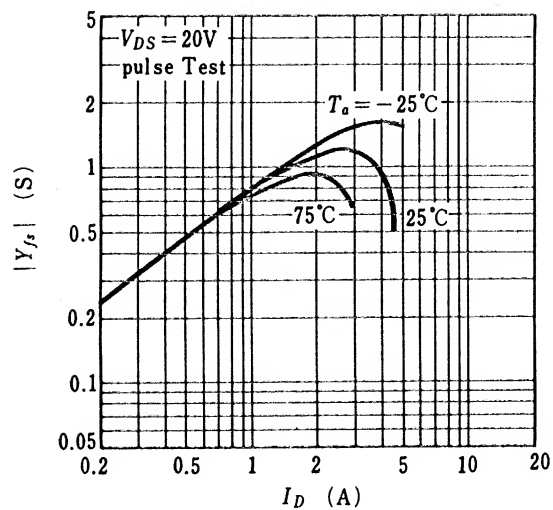
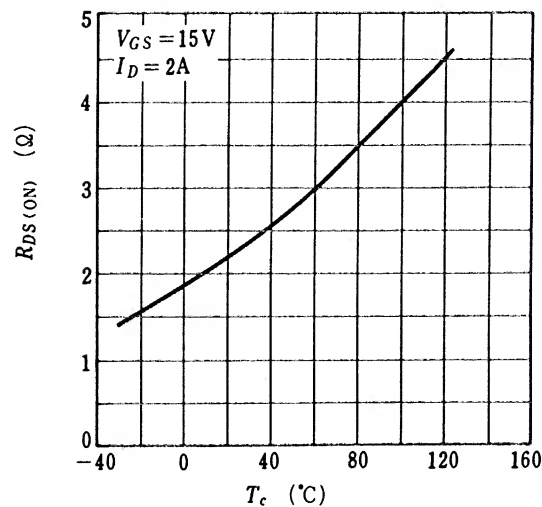
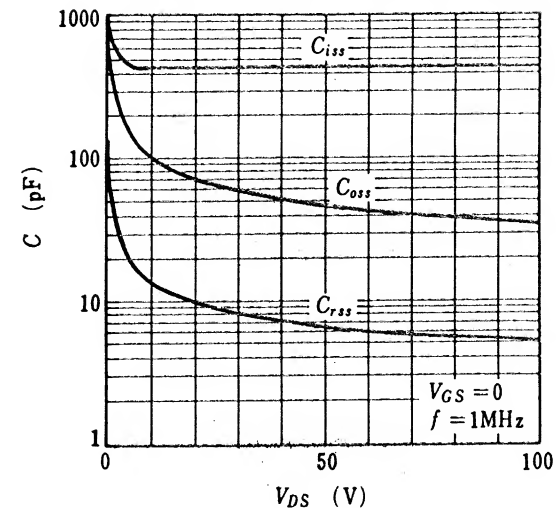
	P	Q	R	S
I_{DSS} (mA)	1～3	2～6.5	5～12	10～20

2SK303, 304

Si 接合型
Nチャンネル

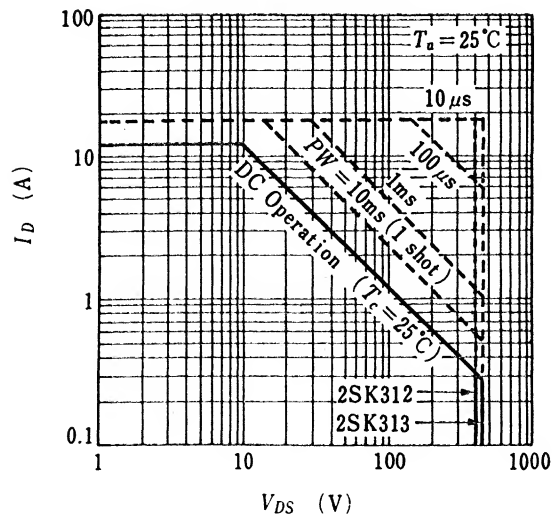
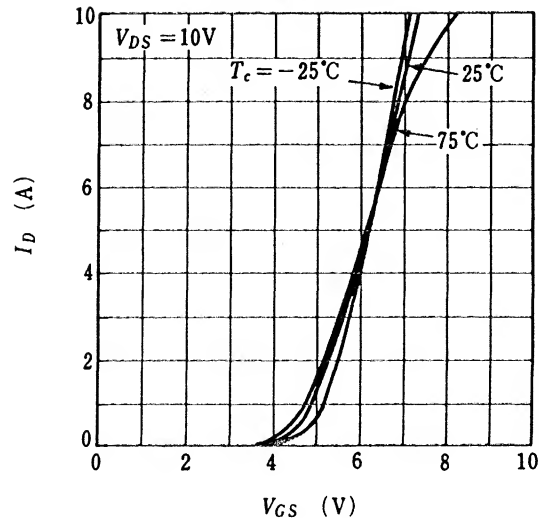
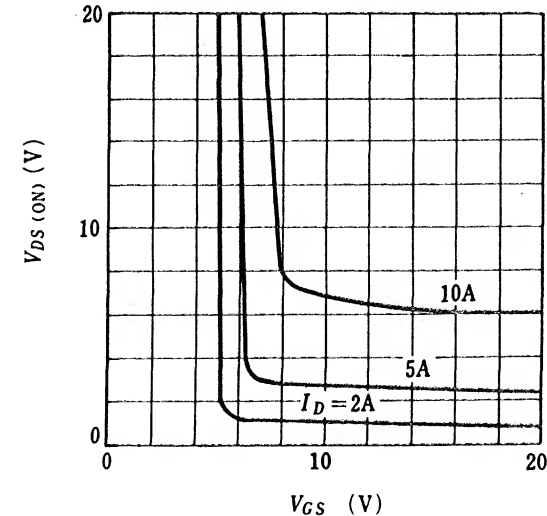
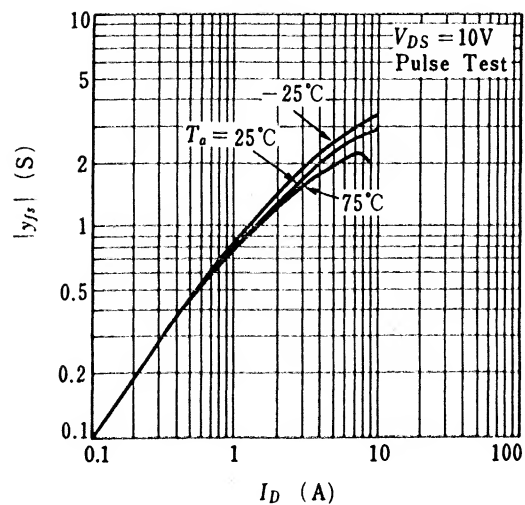
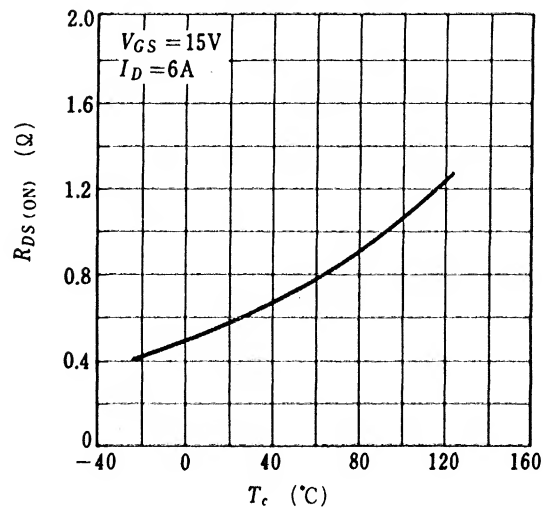
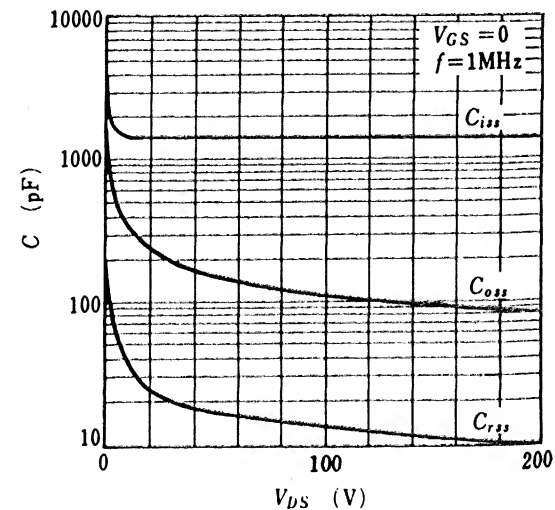
三　洋

I_{DSS}により次のように分類している.（単位 mA）

0.6 C 1.5	1.2 D 3.0	2.5 E 6.0	5.0 F 12.0

2SK310, 311

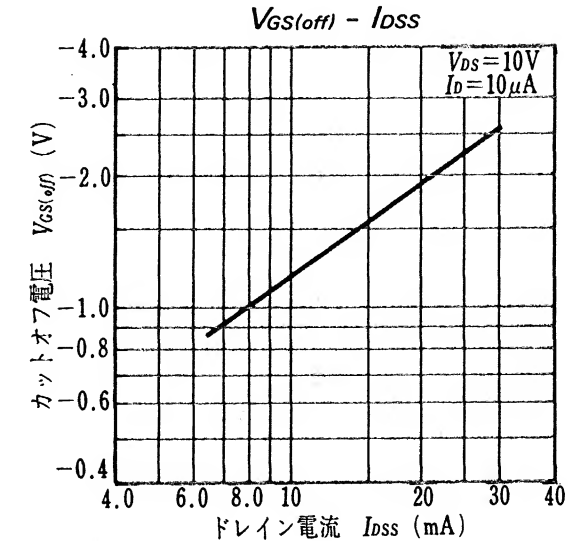
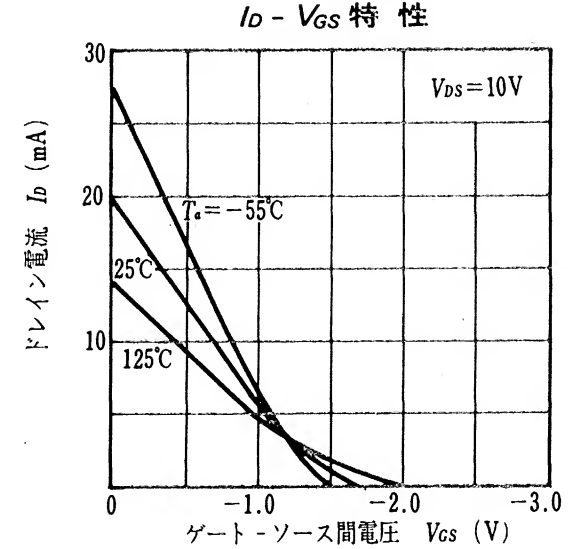
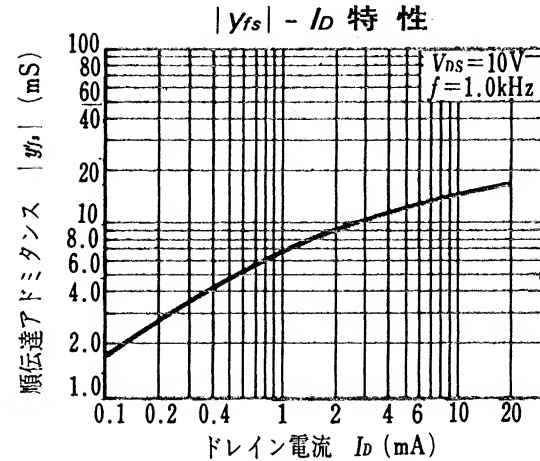
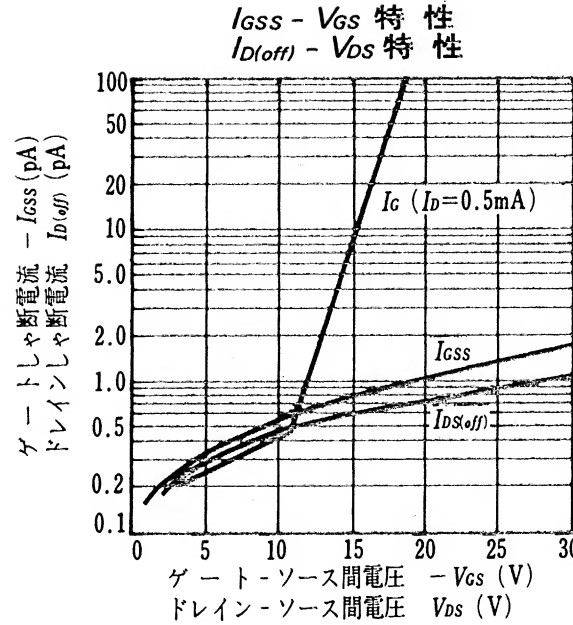
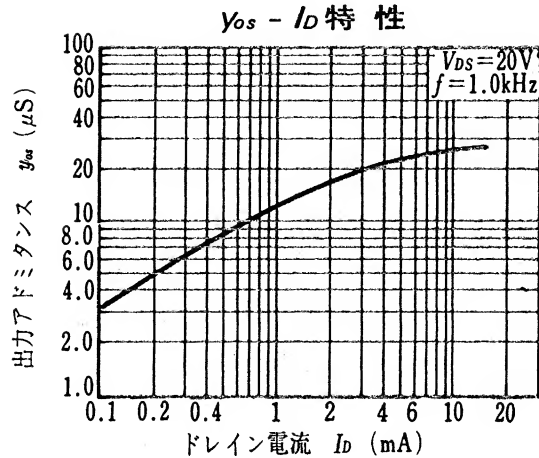
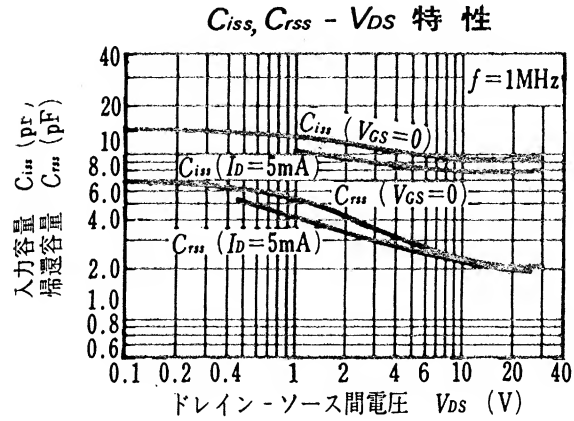
Si MOS型 Nチャンネル　　日　立

2SK312, 313

Si MOS型 Nチャンネル

日立

2SK314

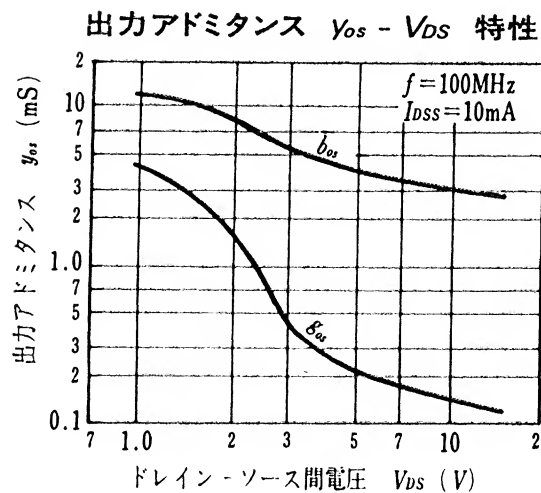
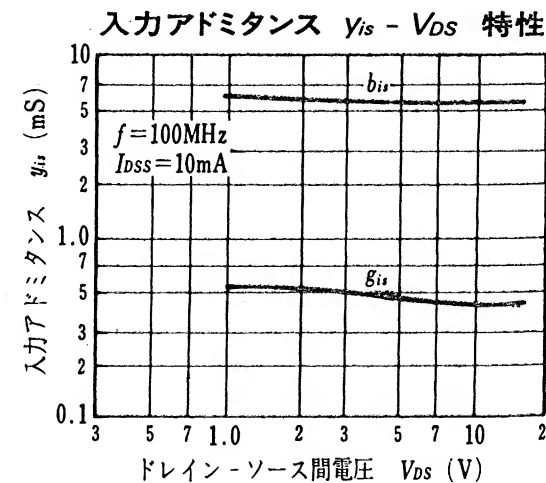
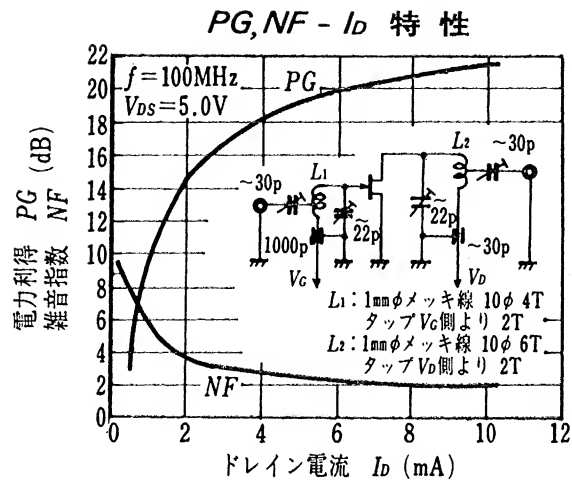
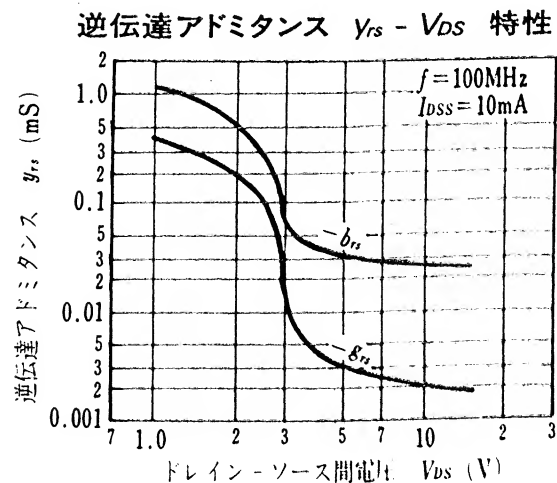
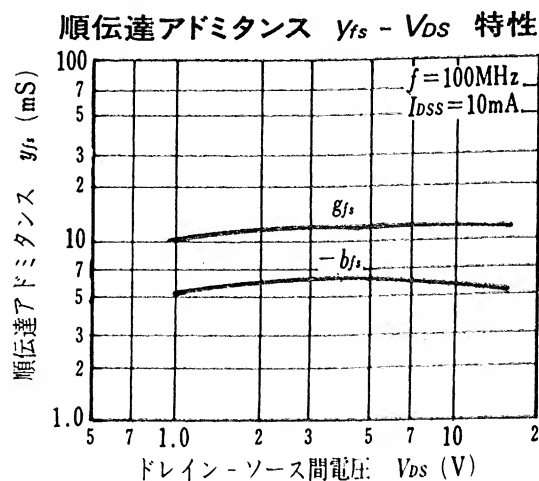
Si 接合型
Nチャンネル

日電

I_{DSS}区分　K：5～12mA　L：11～18mA
M：17～24mA　N：23～30mA

2SK315

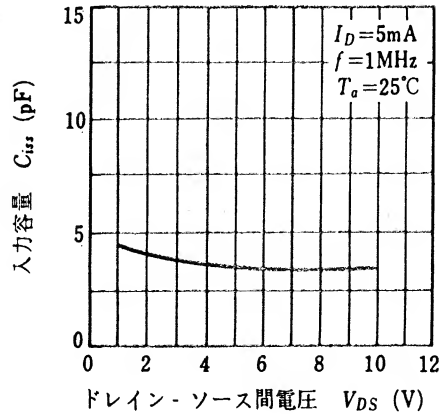
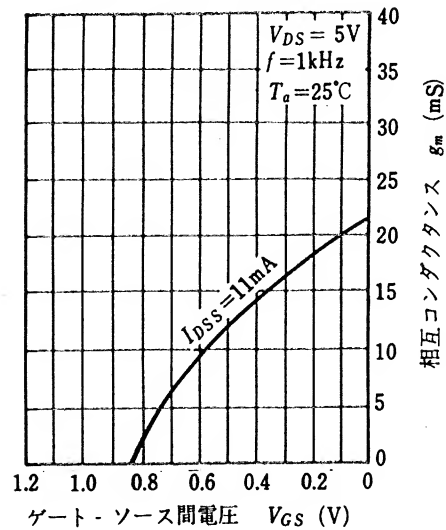
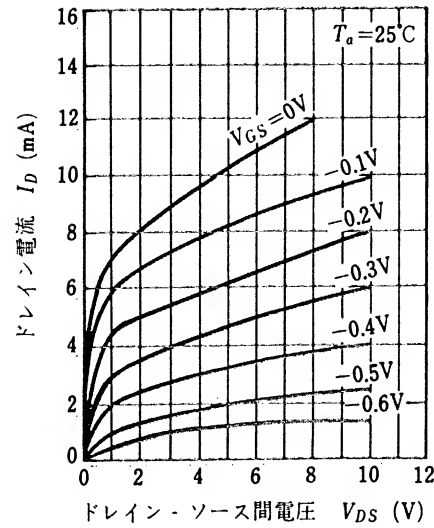
Si 接合型 Nチャンネル　三洋

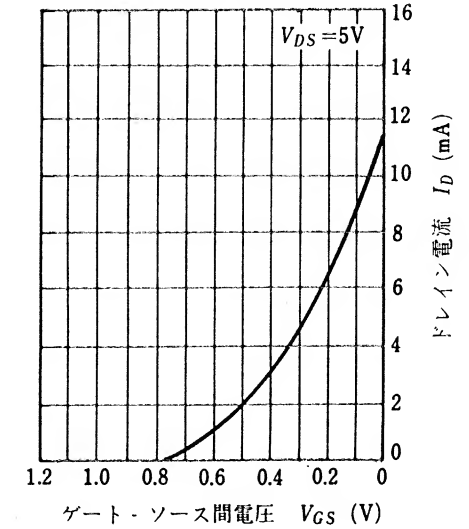
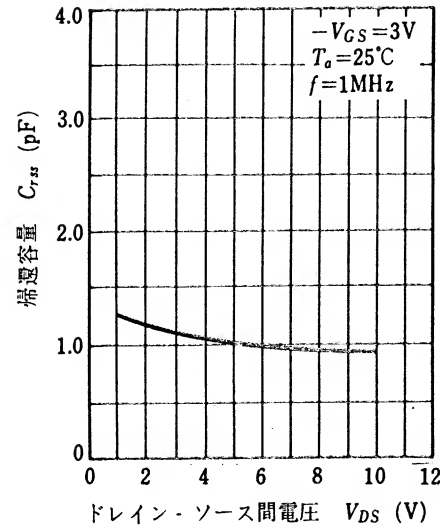
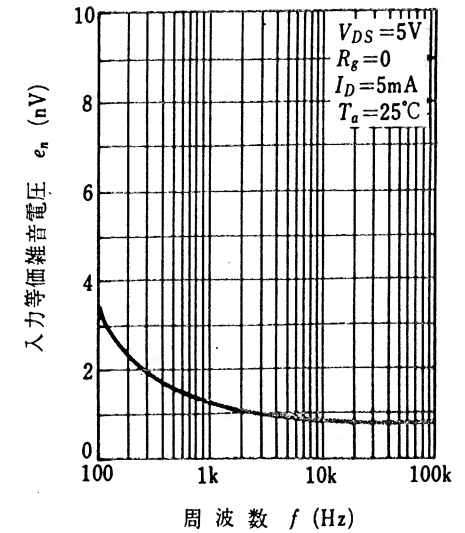
I_{DSS}により次のように分類している。(単位 mA)

2.5 E 6.0	5.0 F 12.0	10.0 G 24.0

2SK316

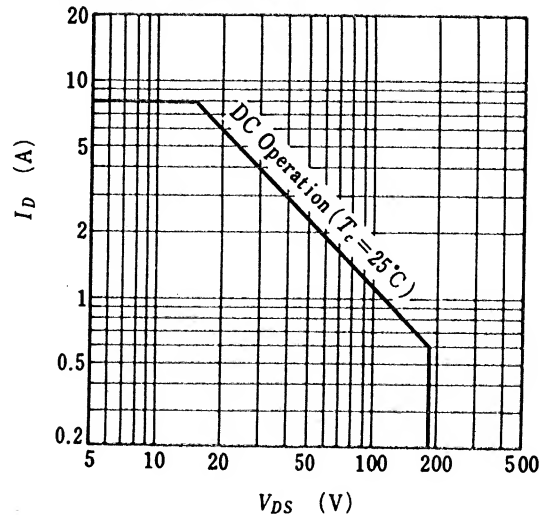
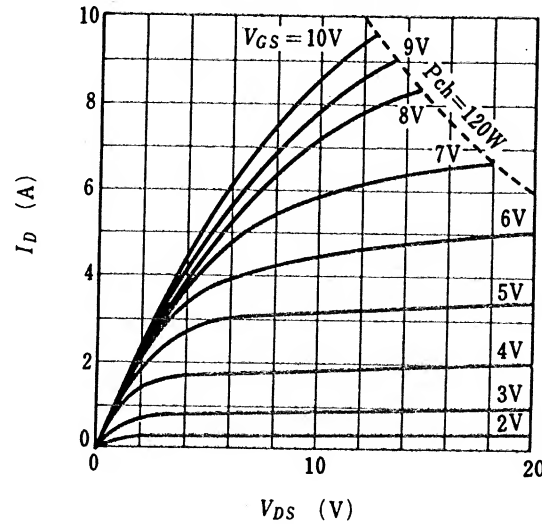
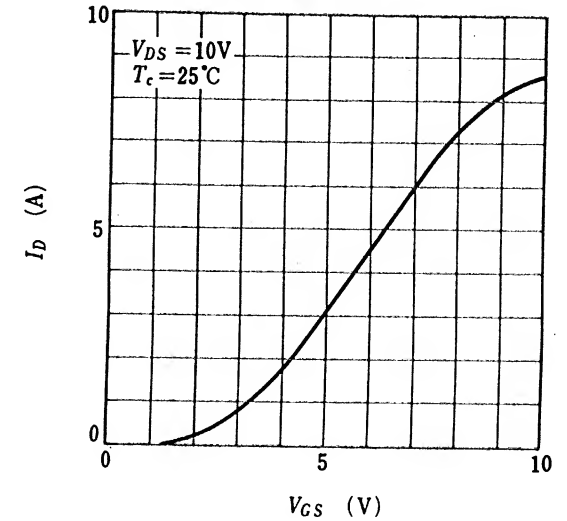
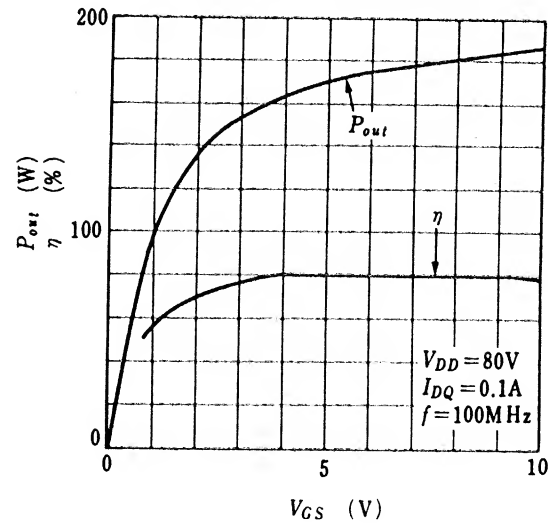
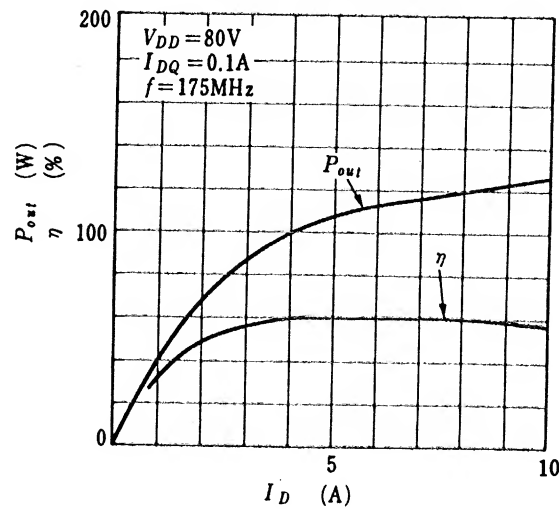
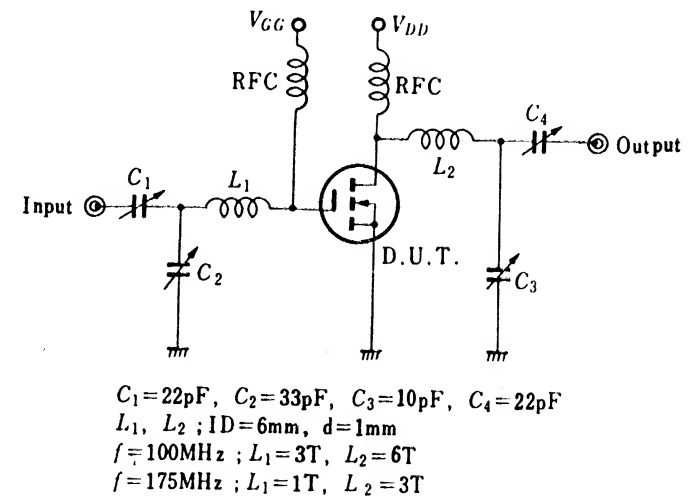
Si 接合型 Nチャンネル 松　下

I_{DSS} ランク分類

	P	Q
I_{DSS} (mA)	5～16	14～24

C_{iss} - V_{DS} 特性

I_D - V_{DS} 特性

I_D - V_{GS} 特性

g_m - V_{GS} 特性

C_{rss} - V_{DS} 特性

e_n - f 特性

2SK317

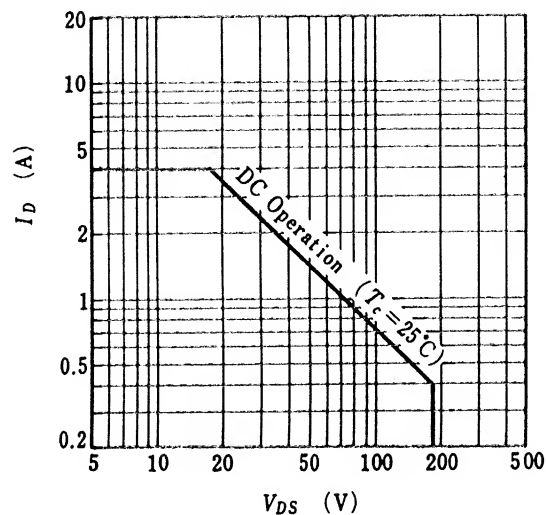
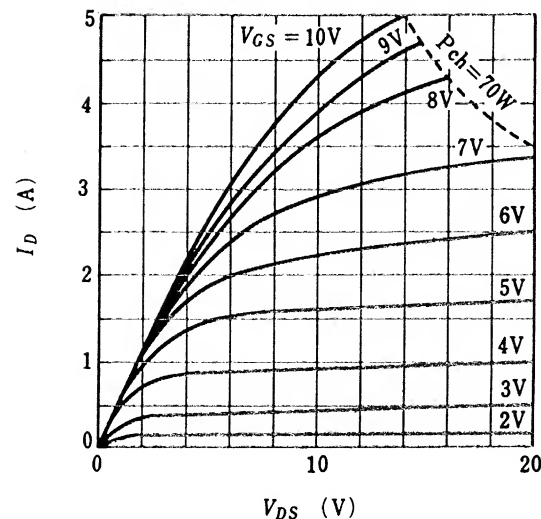
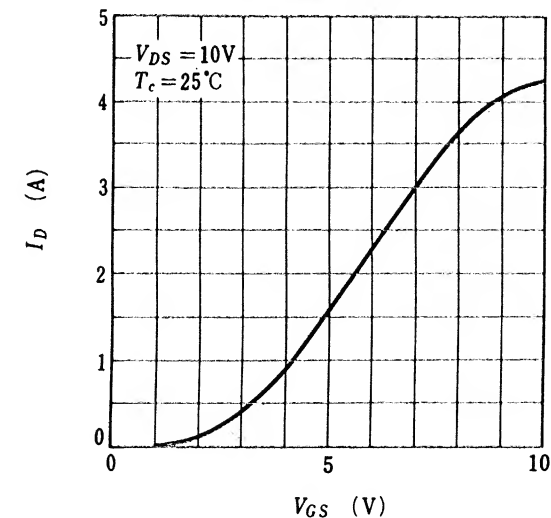
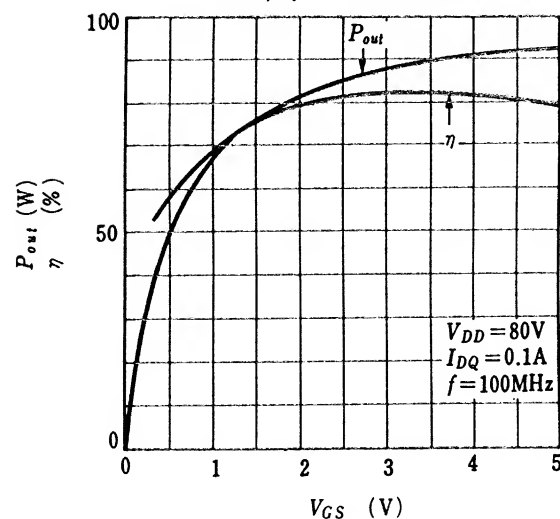
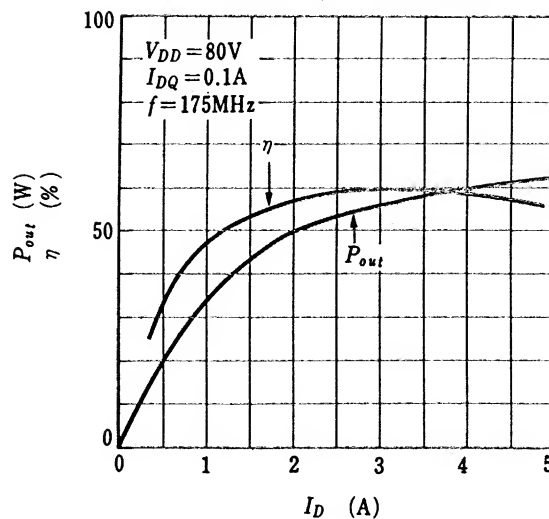
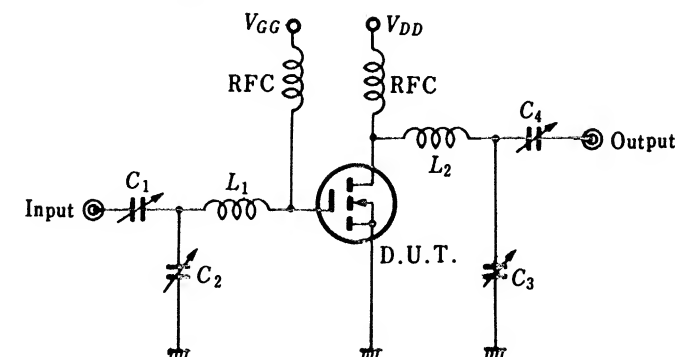
Si MOS型 Nチャンネル　日立

C_1=22pF, C_2=33pF, C_3=10pF, C_4=22pF
L_1, L_2 ; ID=6mm, d=1mm
f=100MHz ; L_1=3T, L_2=6T
f=175MHz ; L_1=1T, L_2=3T

2SK318

安全動作領域

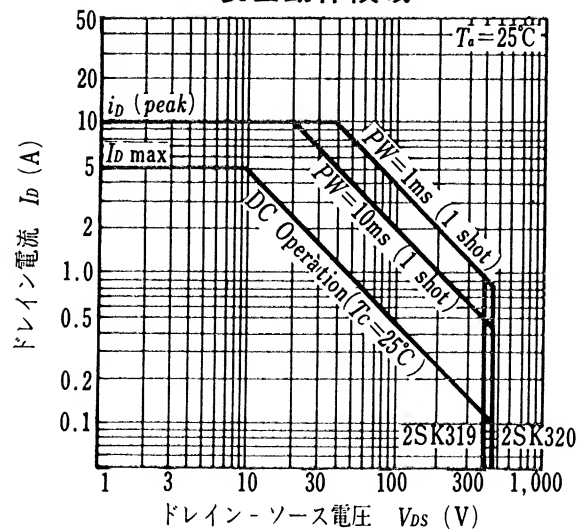
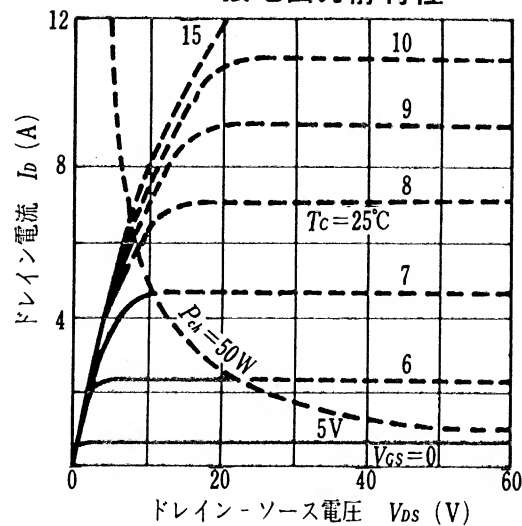
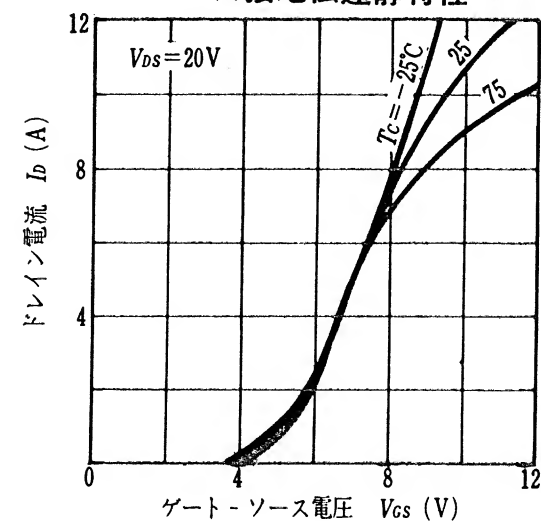
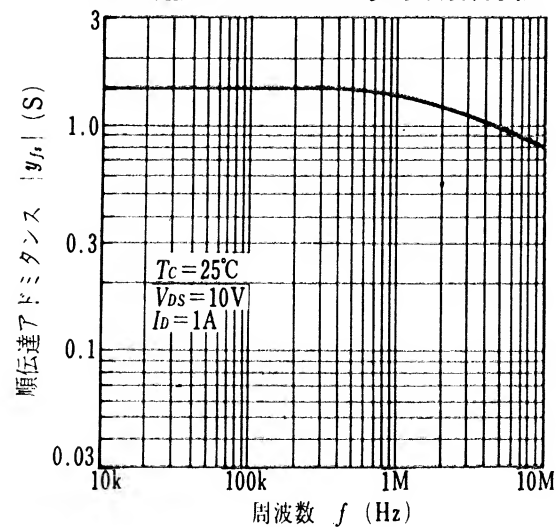
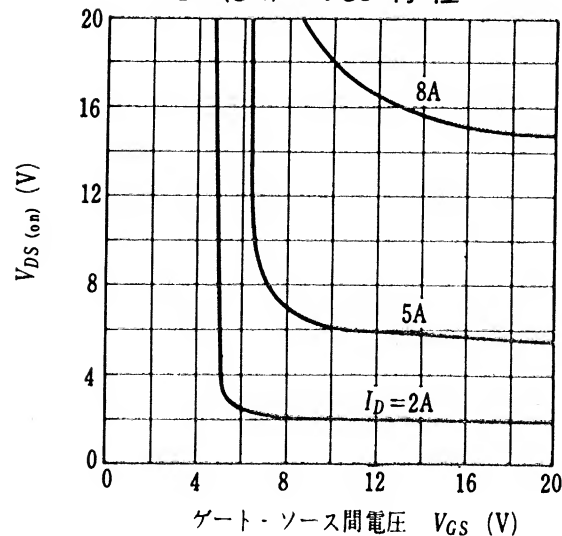
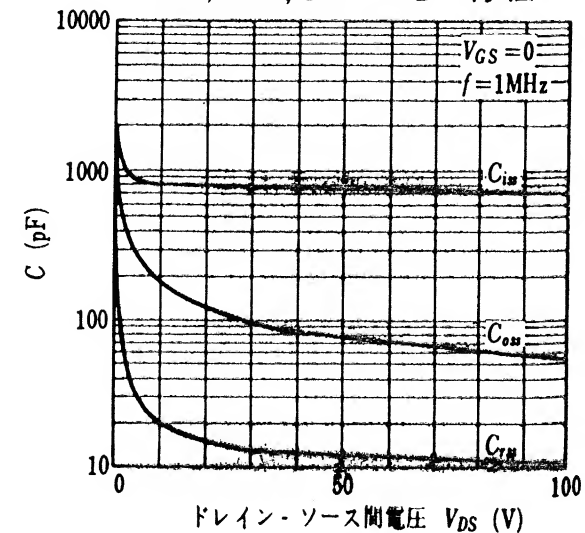
出力特性

伝達特性

P_{out}, η - V_{GS} 特性

P_{out}, η - I_D 特性

電力測定回路

C_1=22pF, C_2=33pF, C_3=25pF, C_4=50pF
L_1, L_2 ; ID=6mm, d=1mm
f=100MHz ; L_1=3T, L_2=5T
f=175MHz ; L_1=1T, L_2=3T

2SK319, 320

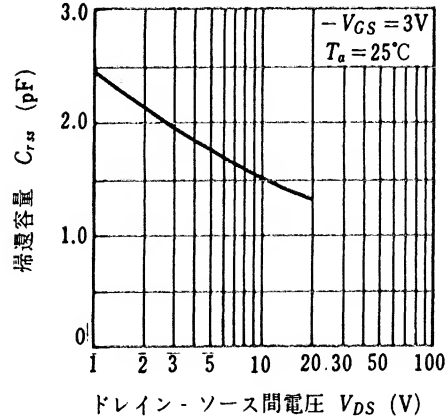
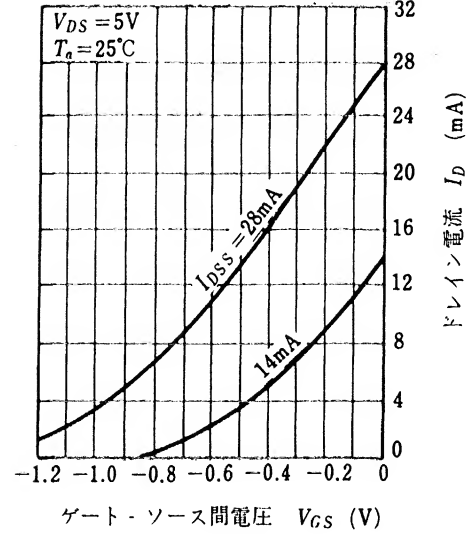
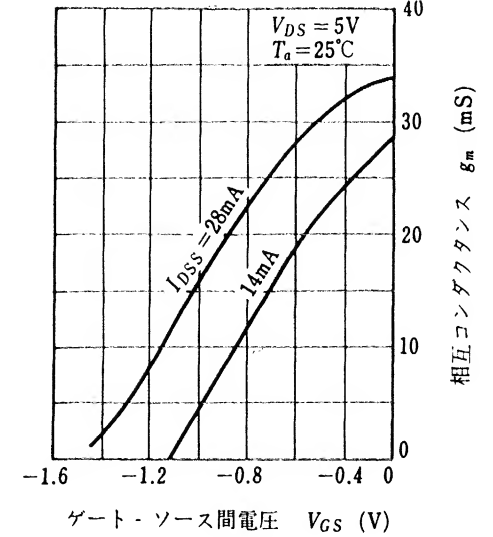
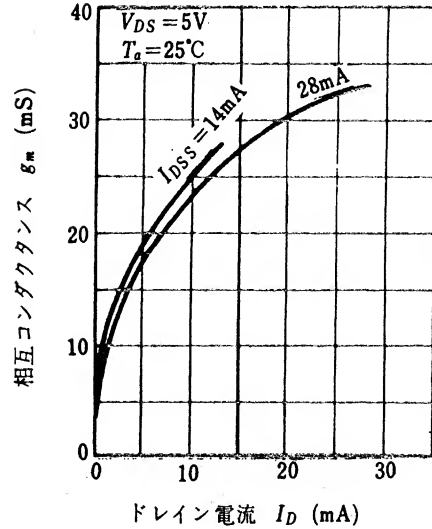
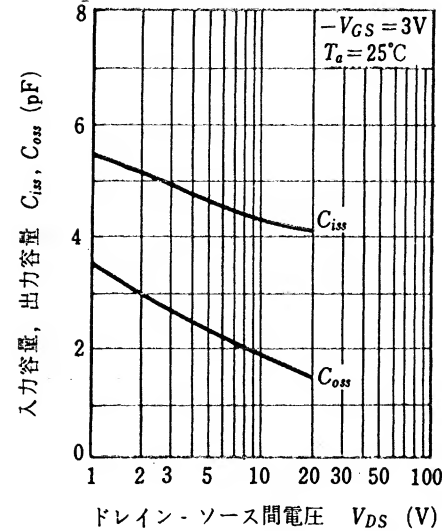
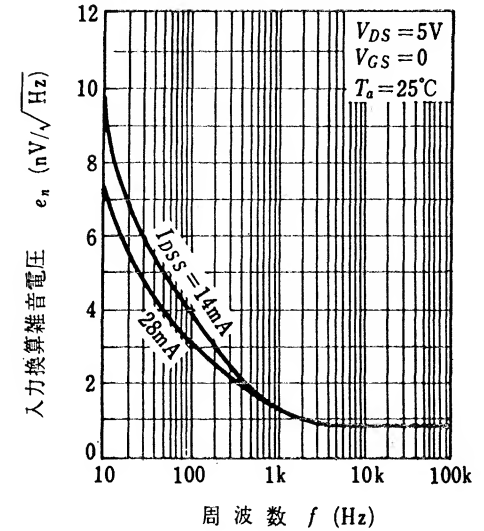
Si MOS型 Nチャンネル 日立

安全動作領域

ソース接地出力静特性

ソース接地伝達静特性

順伝達アドミタンス対周波数特性

VDS (ON) - VGS 特性

Ciss, Coss, Crss - VDS 特性

2SK321

Si 接合型
Nチャンネル

松　下

I_{DSS} ランク分類

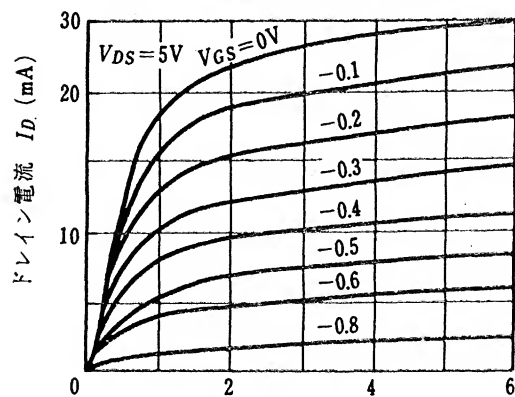
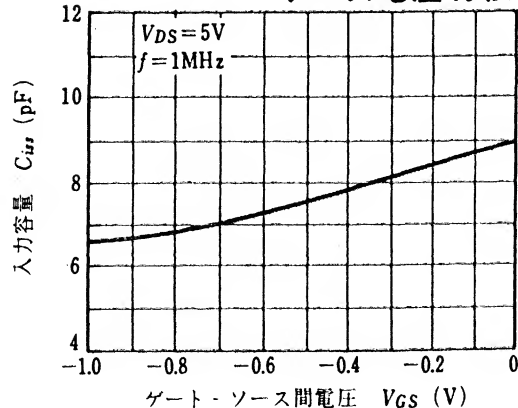
	P	Q	R	S
I_{DSS} (mA)	5～16	14～24	20～32	28～42

2SK322

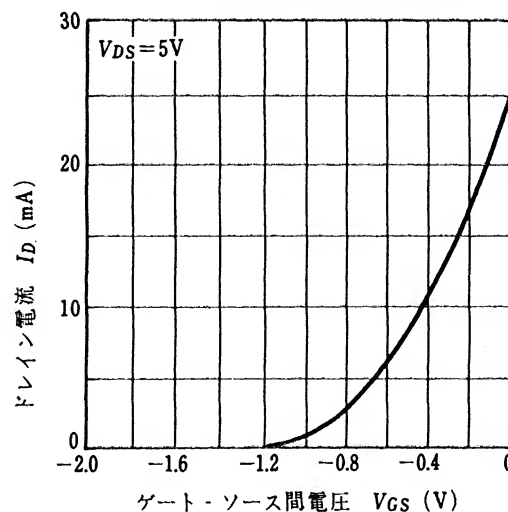
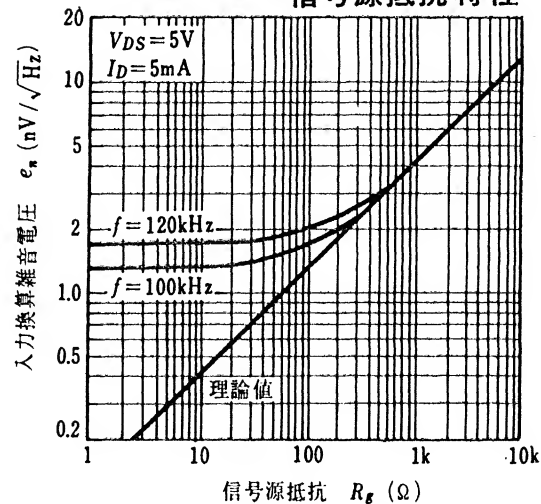
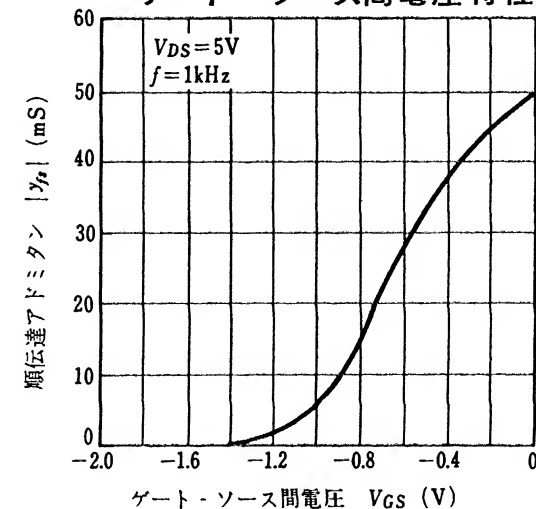
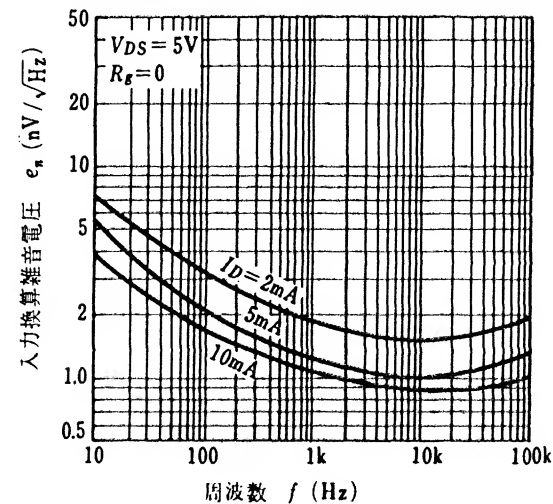
Si 接合型
Nチャンネル

日　立

I_{DSS} ランク分類

Grade	P	Q	R	S	T
Mark	WP	WQ	WR	WS	WT
I_{DSS}	5～16	14～24	20～32	28～42	36～50

ソース接地出力静特性

入力容量対ゲート − ソース電圧特性

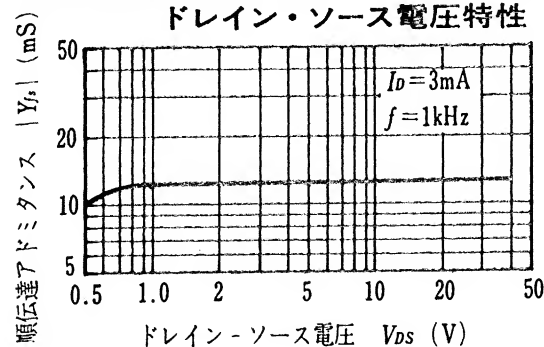
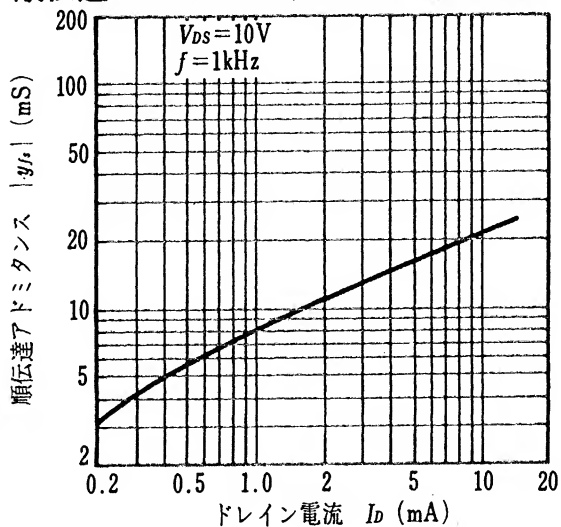
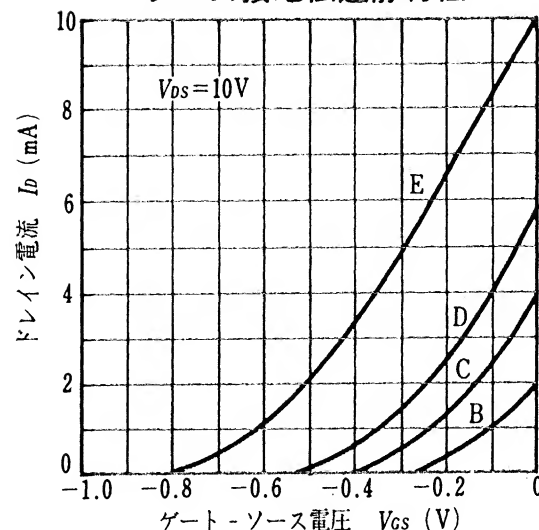
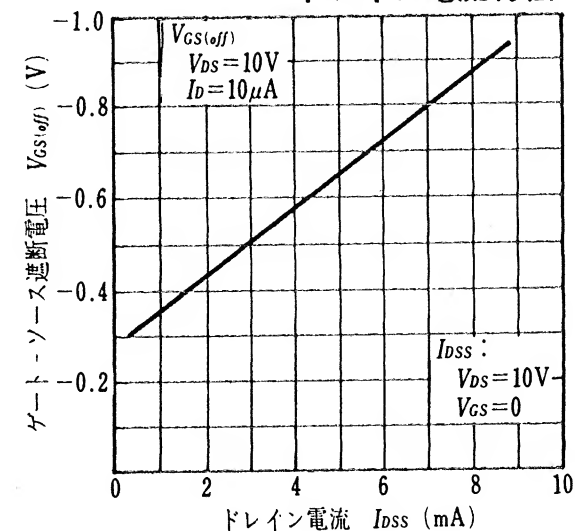
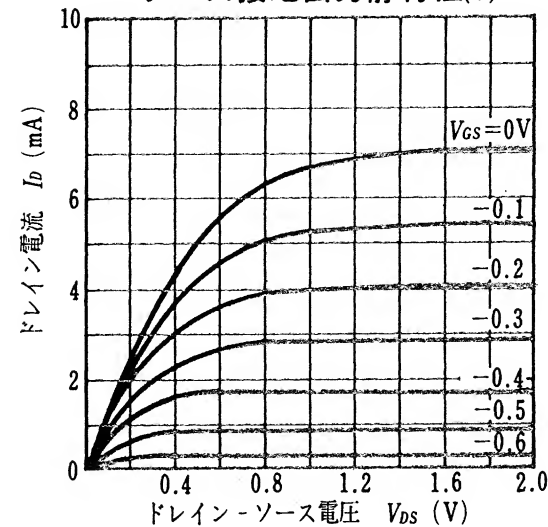
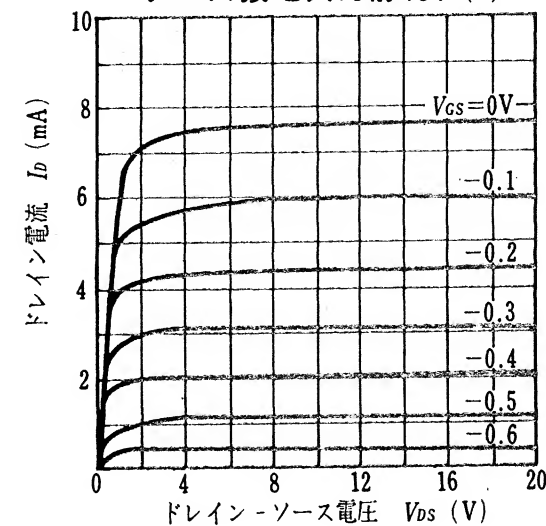
ソース接地伝達静特性

入力換算雑音電圧対信号源抵抗特性

順伝達アドミタンス対ゲート − ソース間電圧特性

入力換算雑音電圧対周波数特性

2SK323

Si 接合型
Nチャンネル

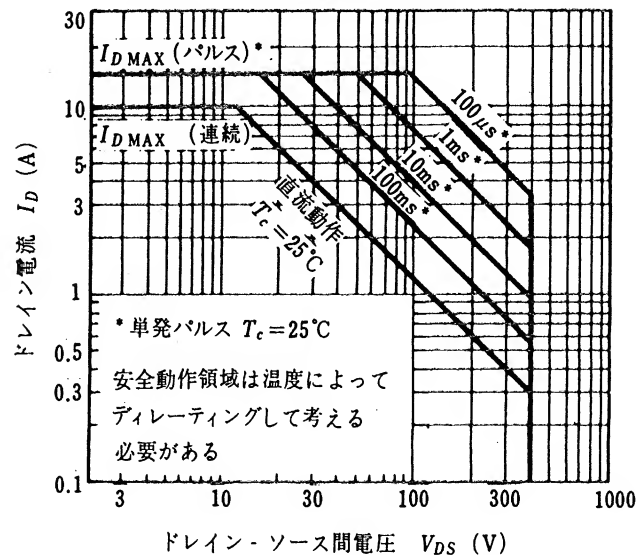
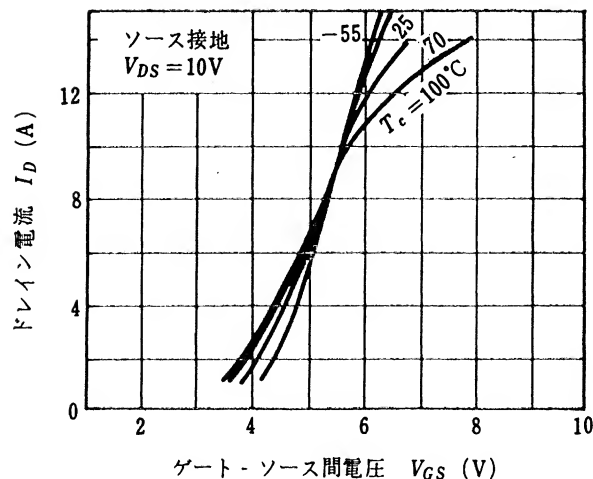
日　立

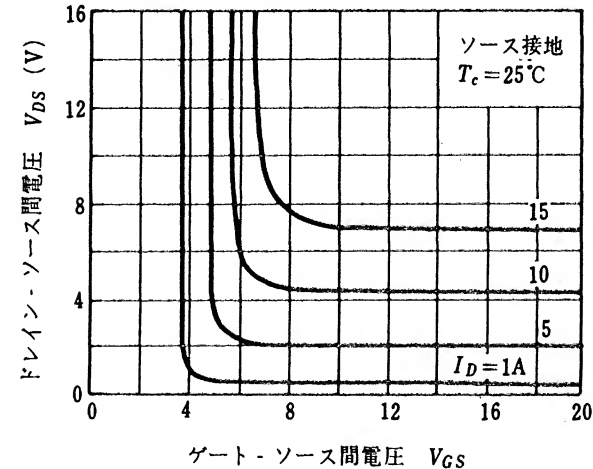
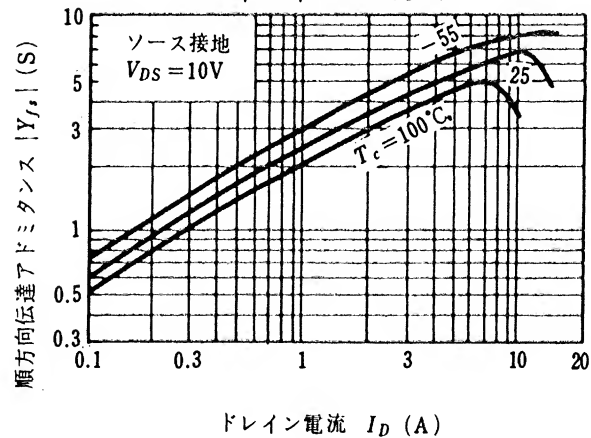
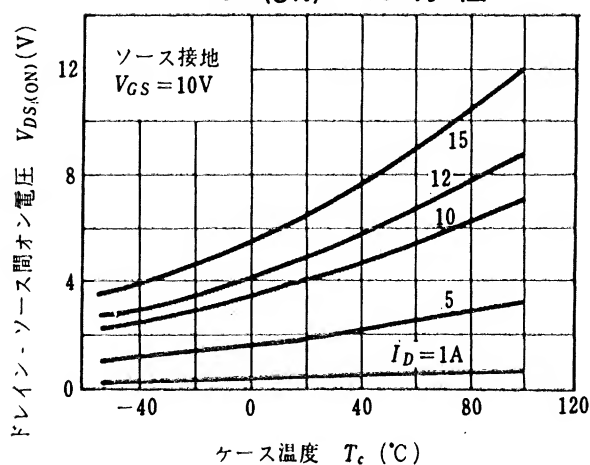
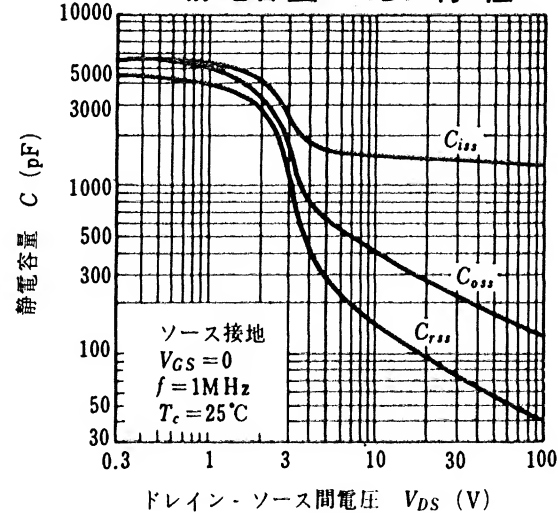
I_{DSS}区分

Grade	B	C	D	E
Mark	KB	KC	KD	KE
I_{DSS}	1.6～3.2	2.5～5	4～8	6～12

順伝達アドミタンス対ドレイン・ソース電圧特性

順伝達アドミタンス対ドレイン電流特性

ソース接地出力静特性(1)

ゲート・ソース遮断電圧対ドレイン電流特性

ソース接地出力静特性(2)

2SK324

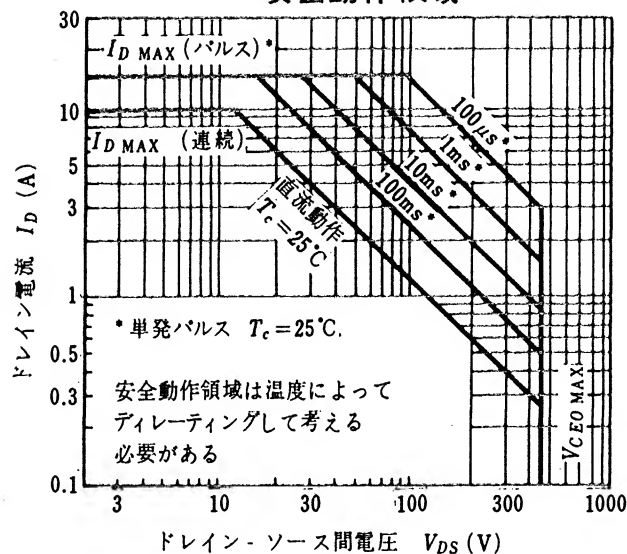
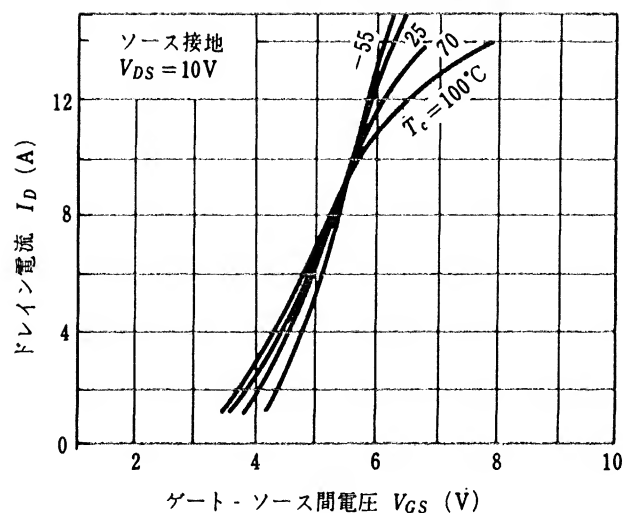
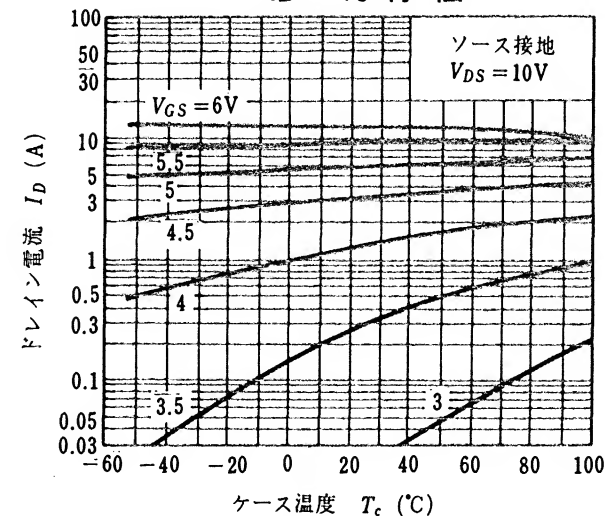
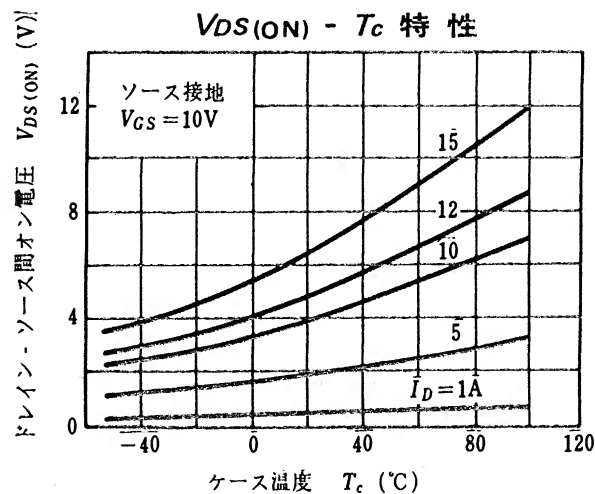
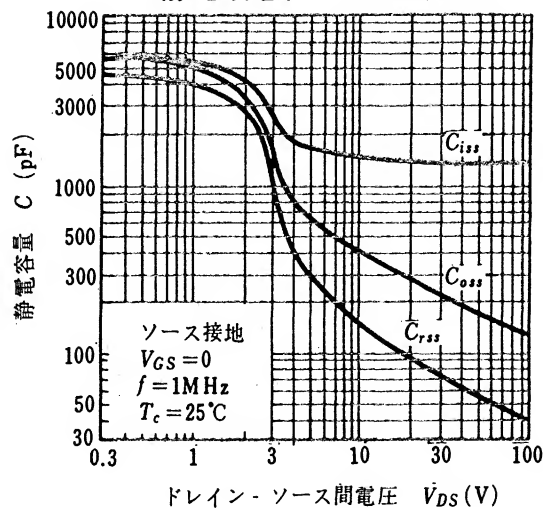
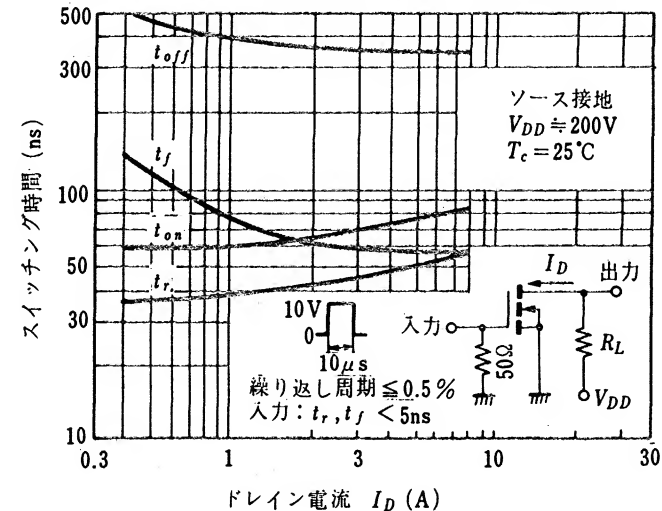
Si MOS型 Nチャンネル　　東芝

安全動作領域

I_D - V_{GS} 特性

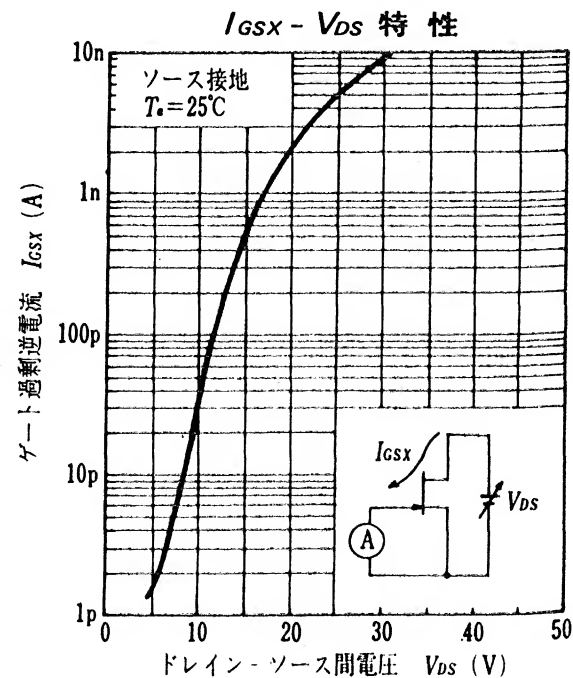
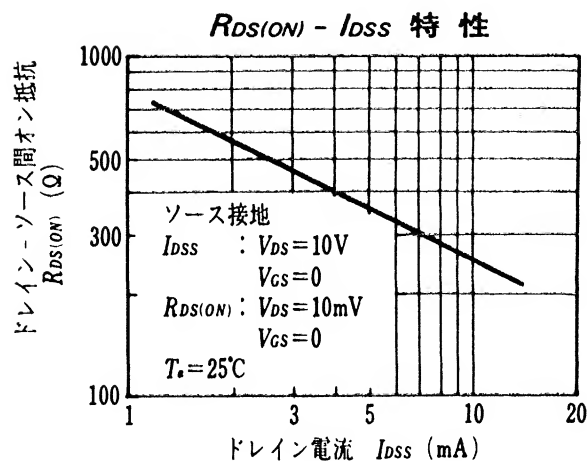
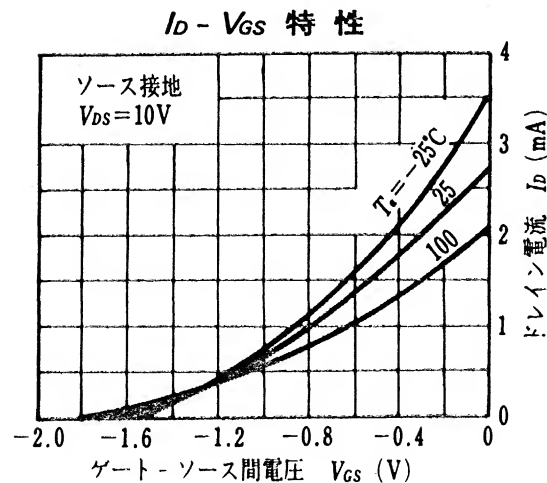
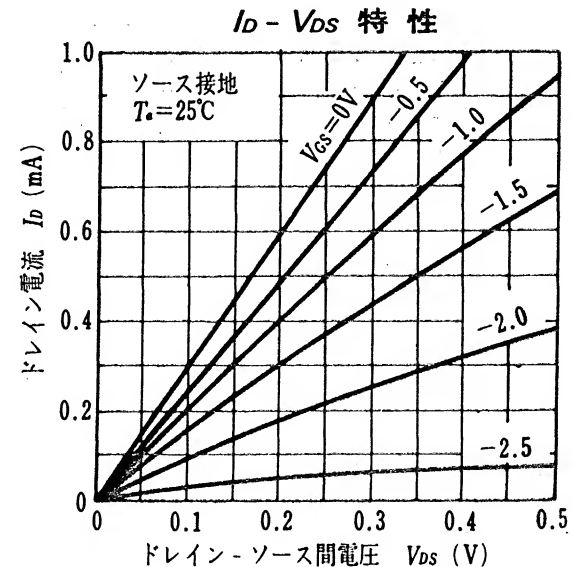
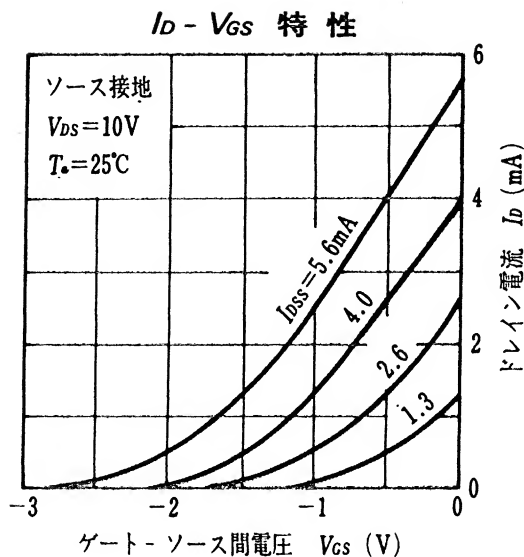
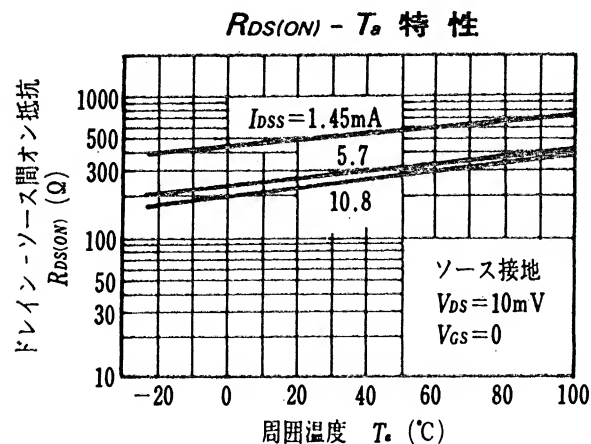
V_{DS} - V_{GS} 特性

$|Y_{fs}|$ - I_D 特性

$V_{DS(ON)}$ - T_c 特性

静電容量 - V_{DS} 特性

2SK325

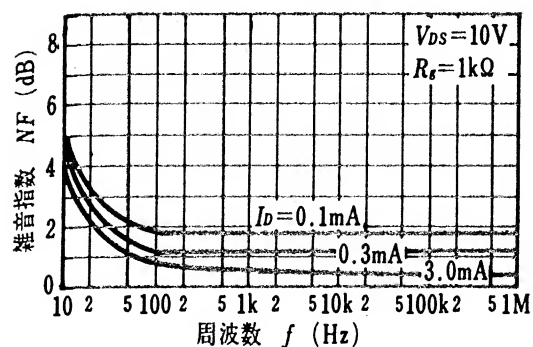
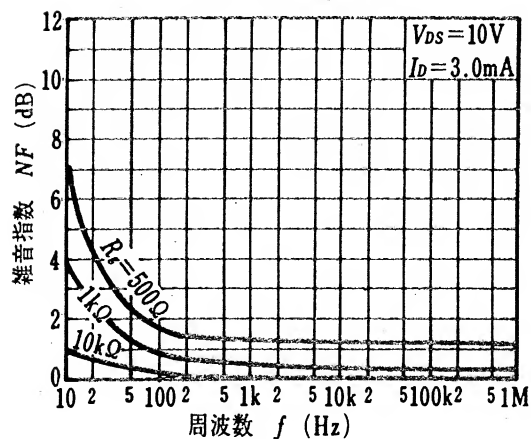
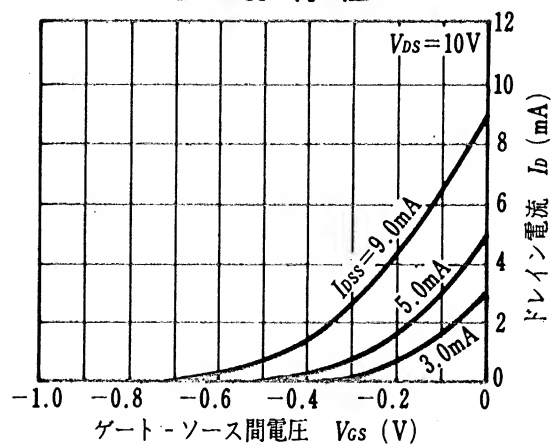
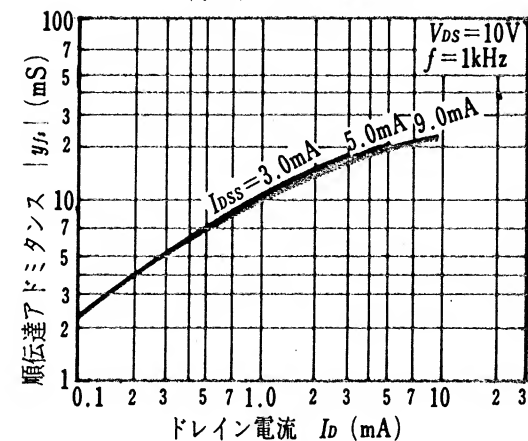
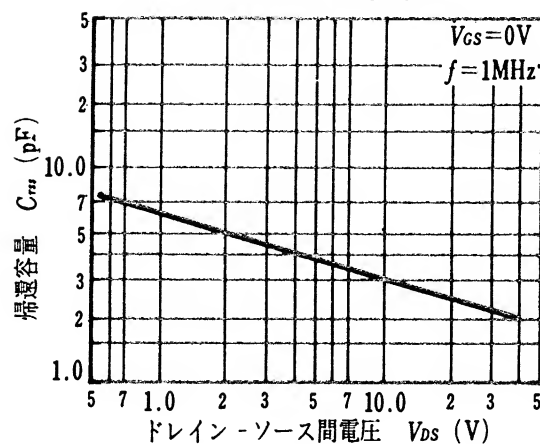
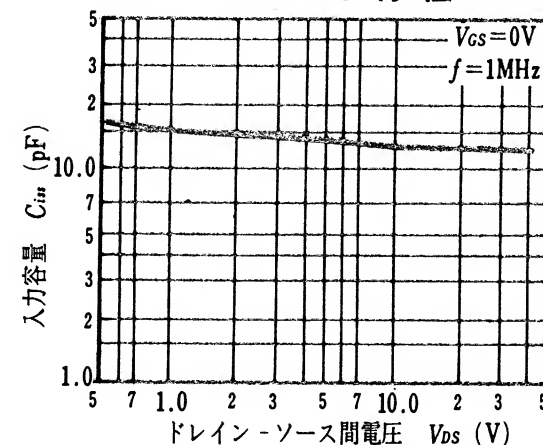
Si MOS型
Nチャンネル

東　芝

2SK330

Si 接合型 Nチャンネル　　東　芝

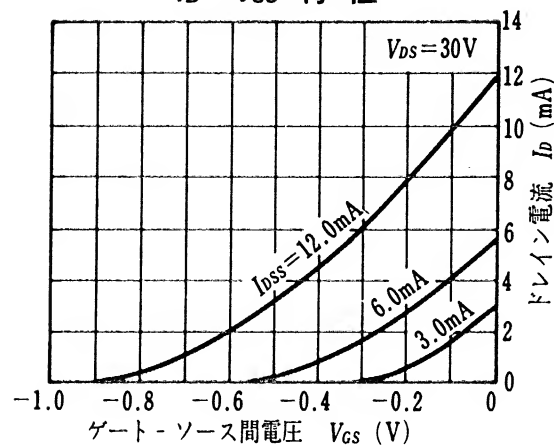
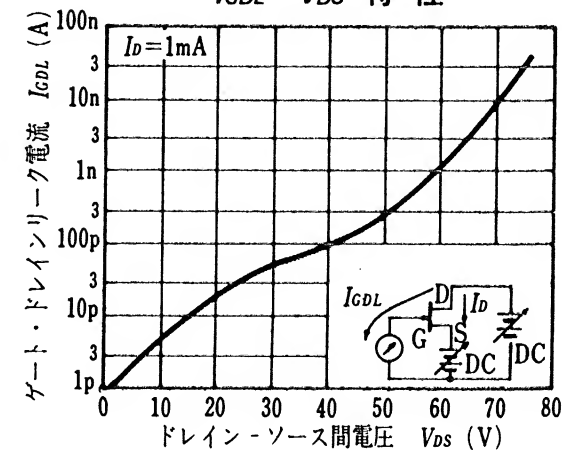
I_{DSS}分類　Y：1.2～3.0mA, GR：2.6～6.5mA, BL：6～14mA

2SK332

Si 接合型
複合Nチャンネル

三　洋

I_{DSS}により次のように分類している。(単位 mA)

1.2	D	3.0	2.5	E	6.0	5.0	F	12.0

2SK333

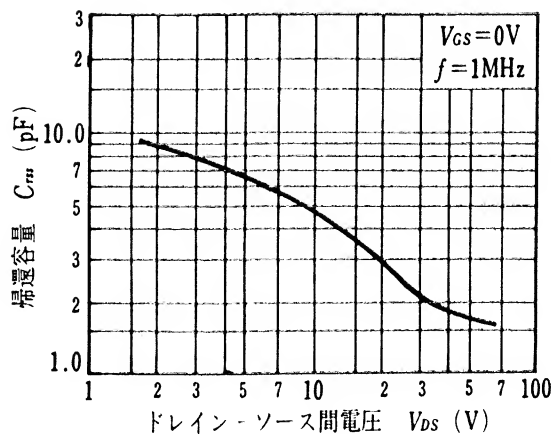
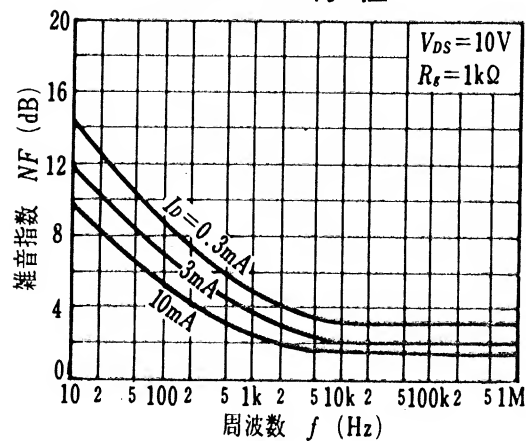
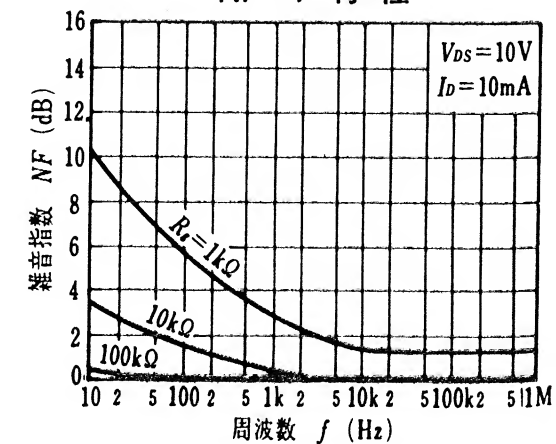
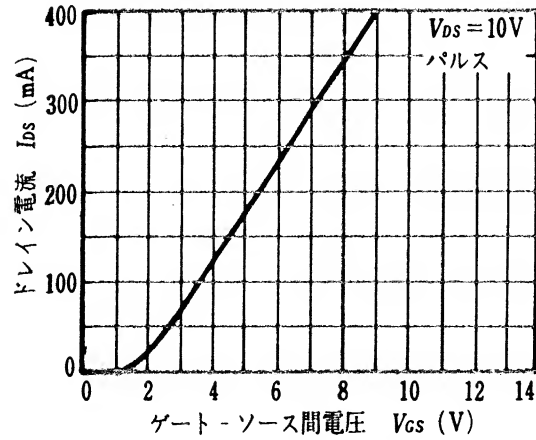
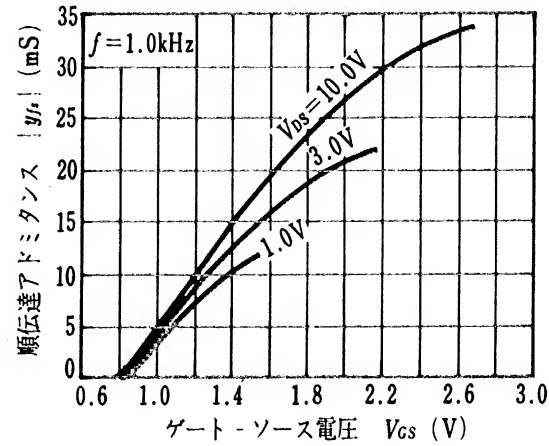
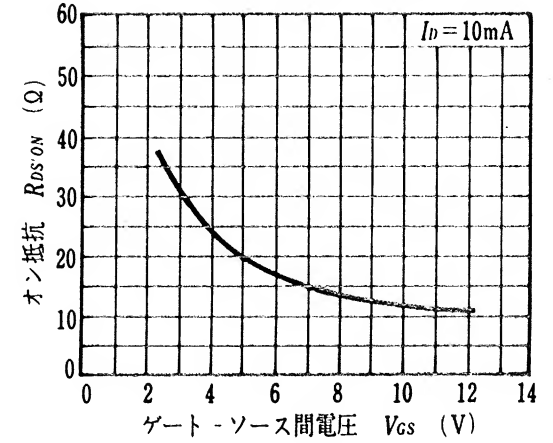
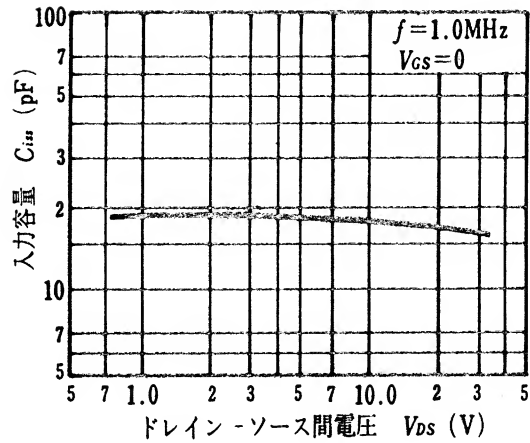
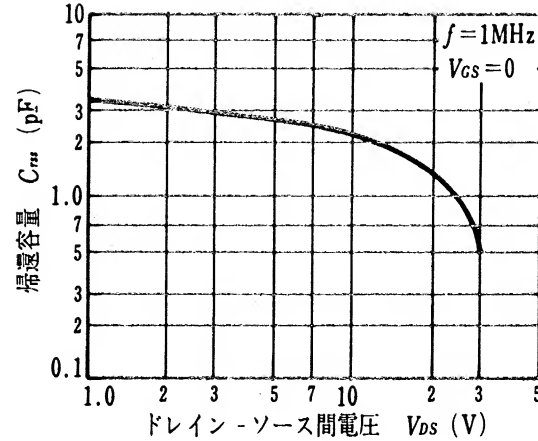
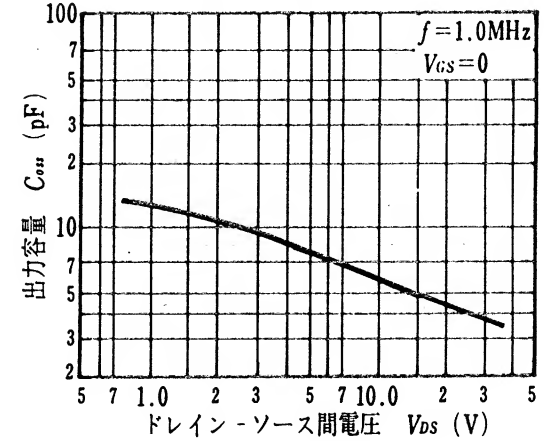
Si 接合型
複合Nチャンネル

三　洋

I_{DSS}により次のように分類している.（単位 mA）

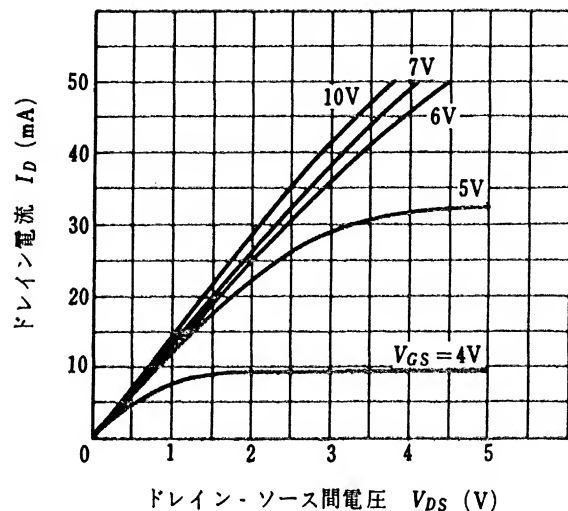
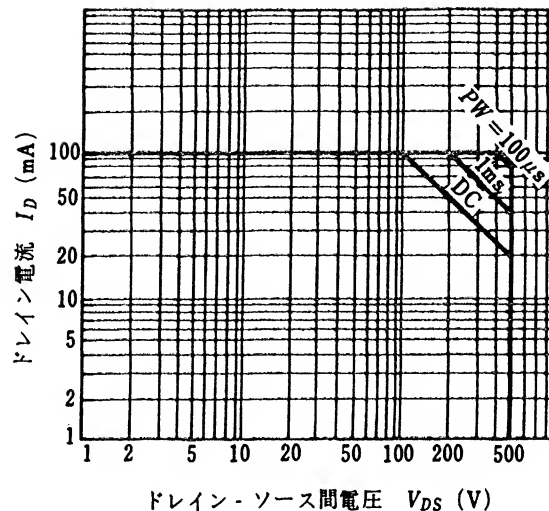
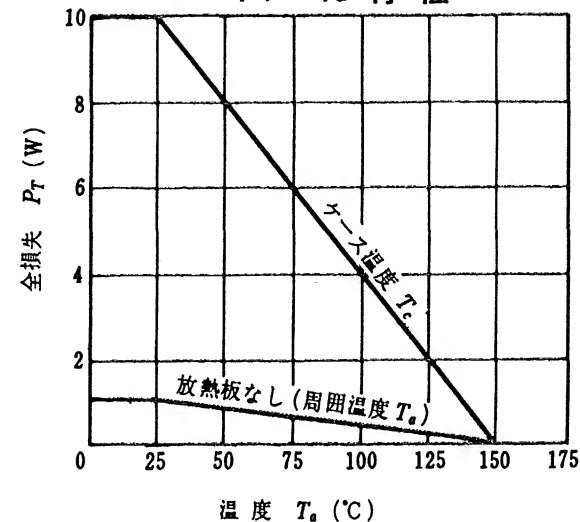
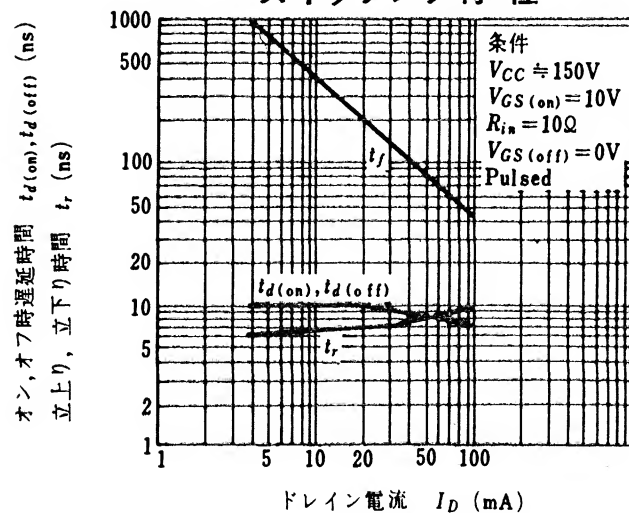
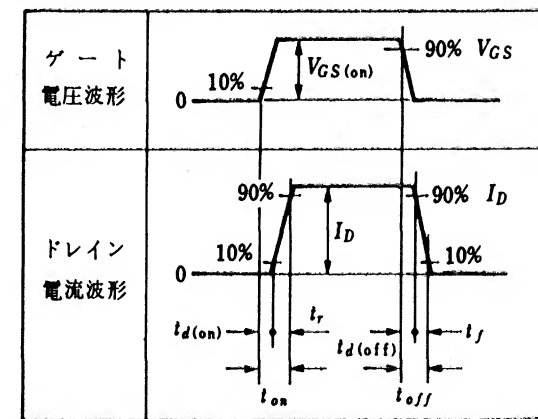
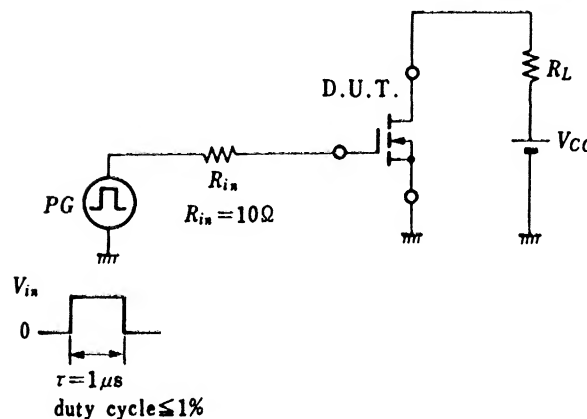
1.2 D 3.0	2.5 E 6.0	5.0 F 12.0

2SK336

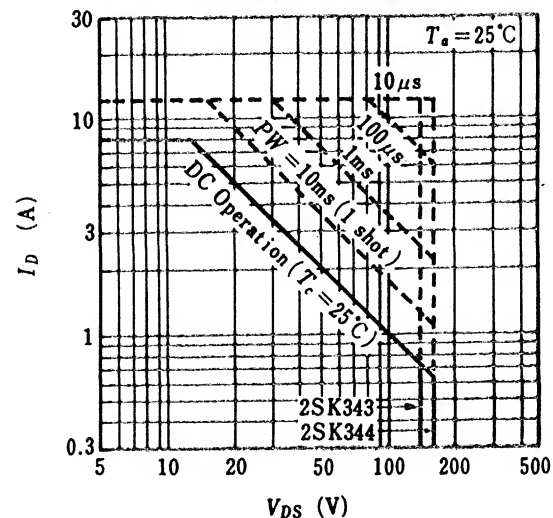
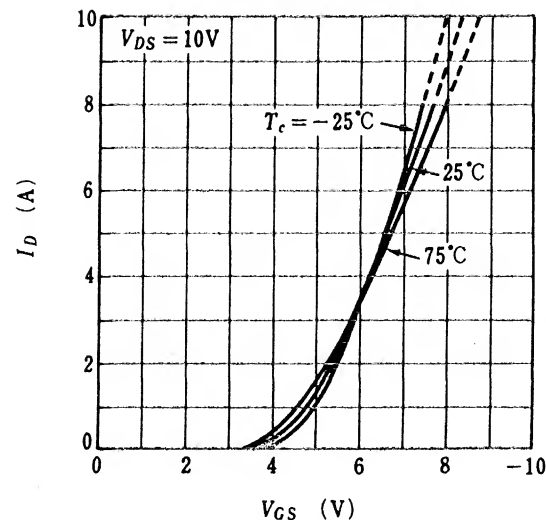
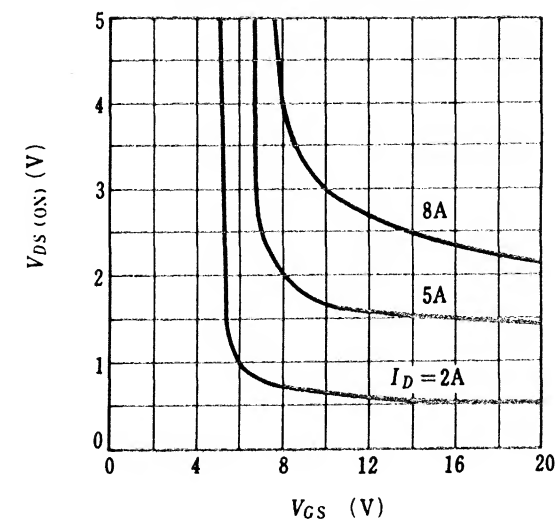
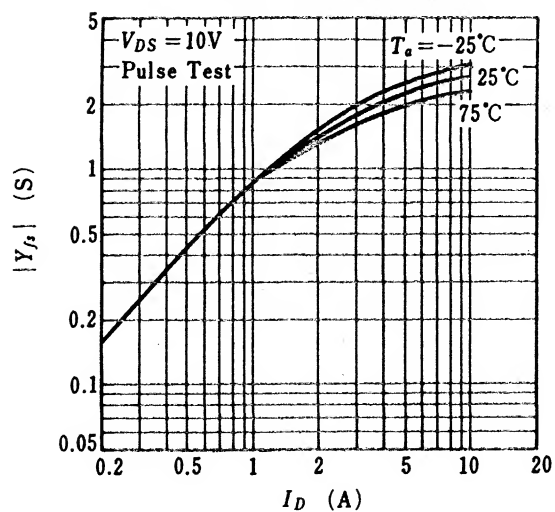
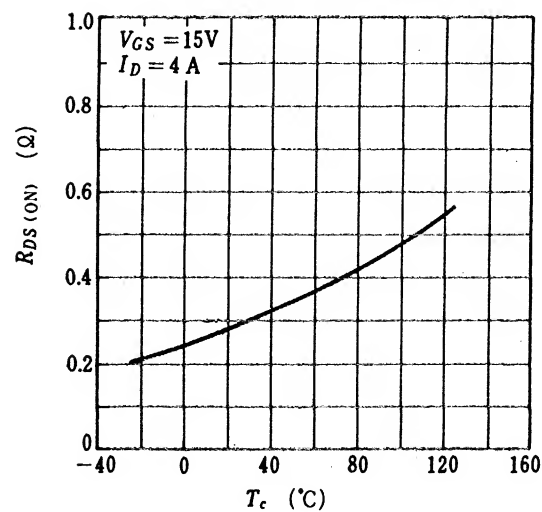
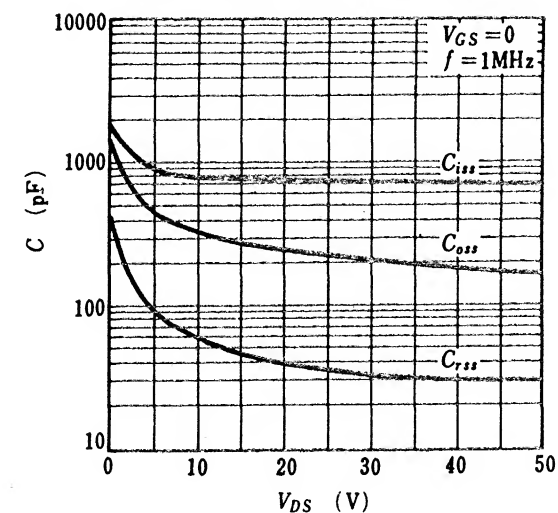
Si MOS型
Nチャンネル

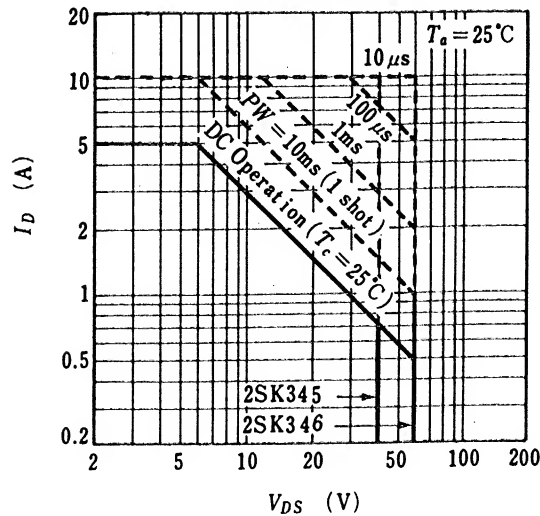
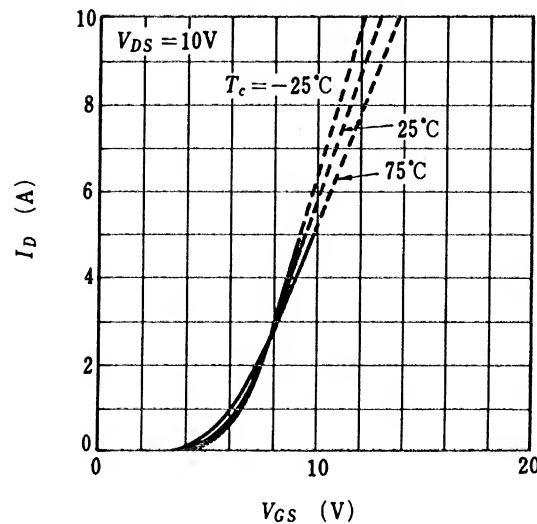
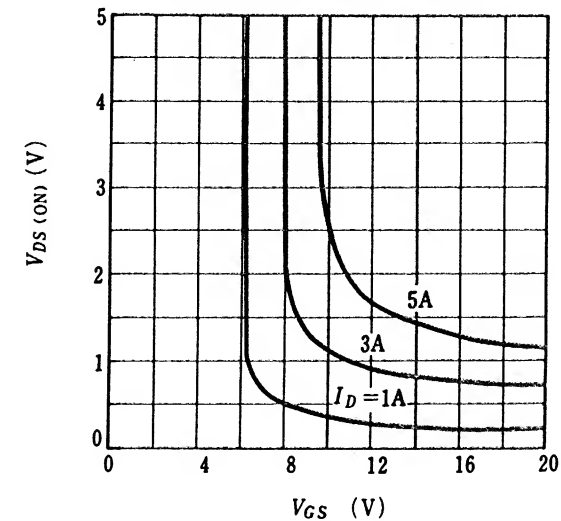
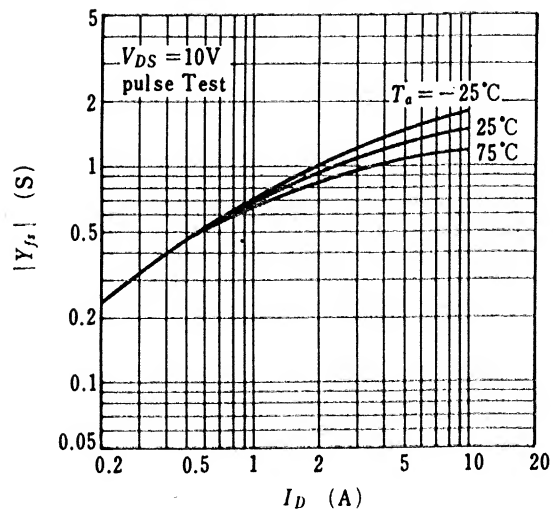
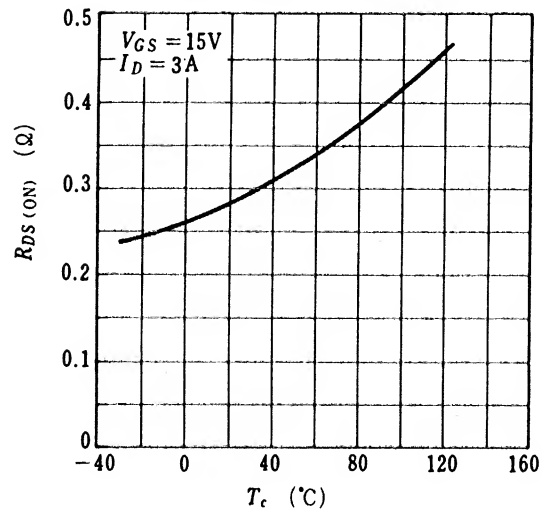
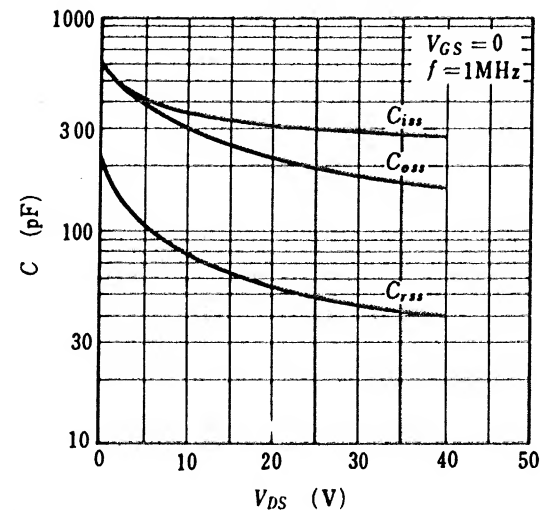
三　洋

2SK337

Si MOS型
Nチャンネル

日　電

スイッチングタイム測定回路，測定条件（抵抗負荷）

2SK343, 344

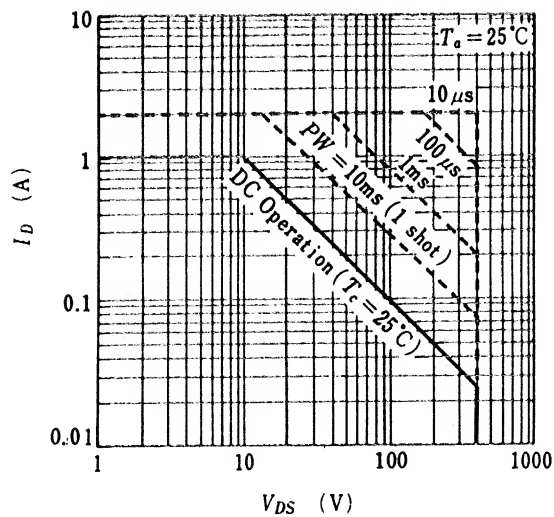
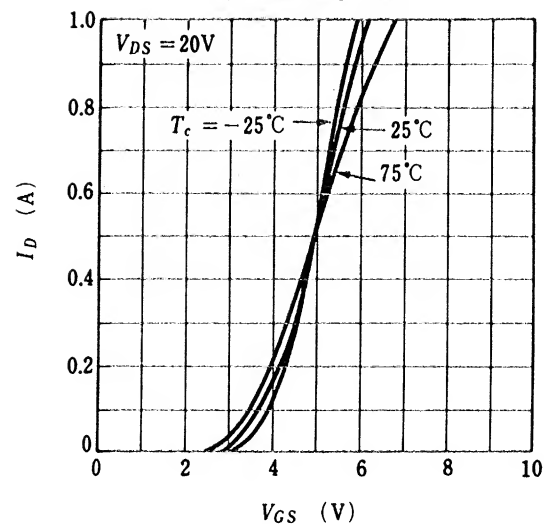
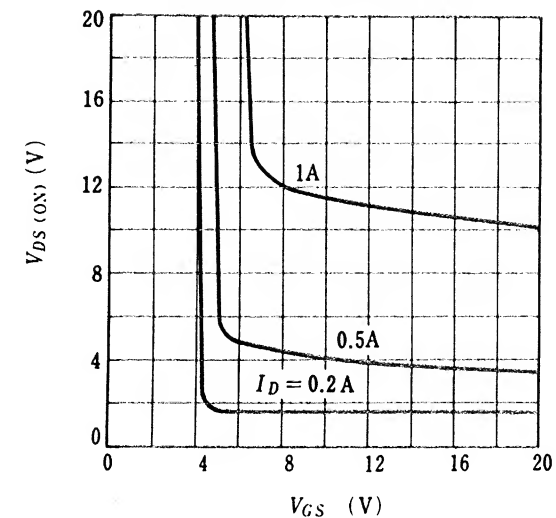
Si MOS型
Nチャンネル

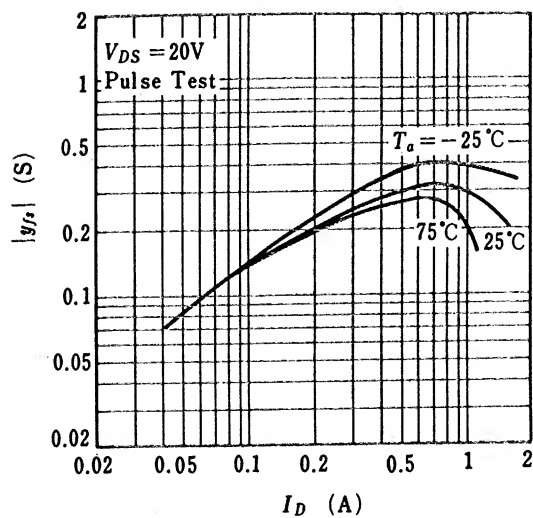
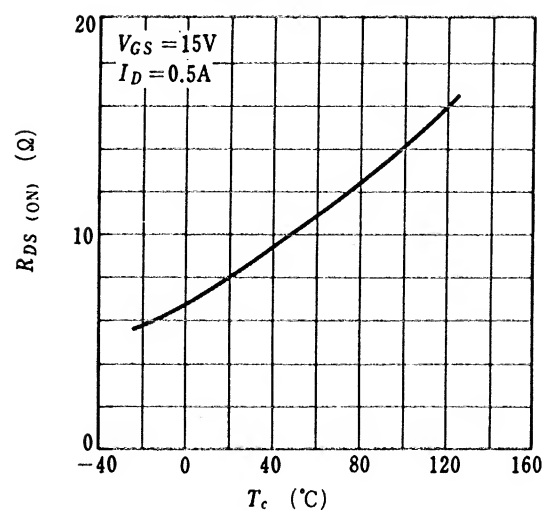
日 立

2SK345, 346

Si MOS型 Nチャンネル 日立

2SK347

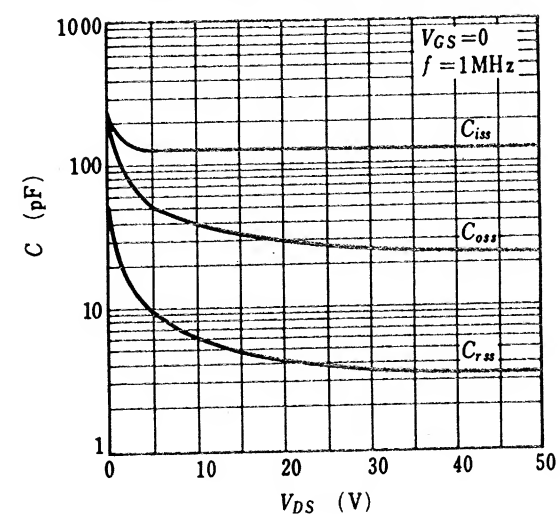
Si MOS型
Nチャンネル

日立

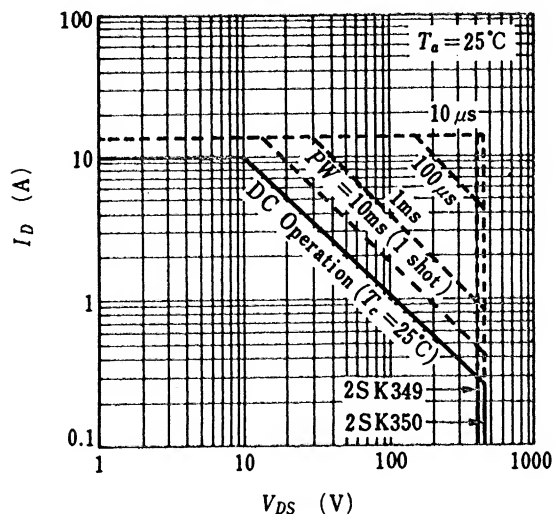
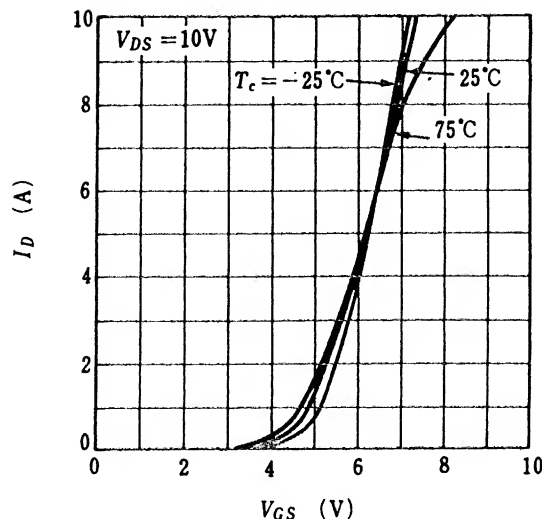
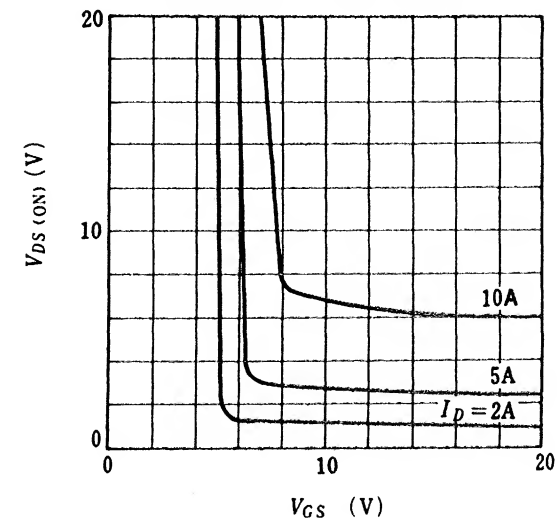
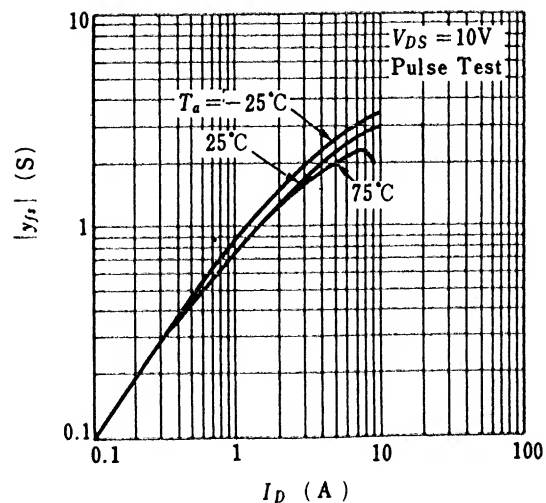
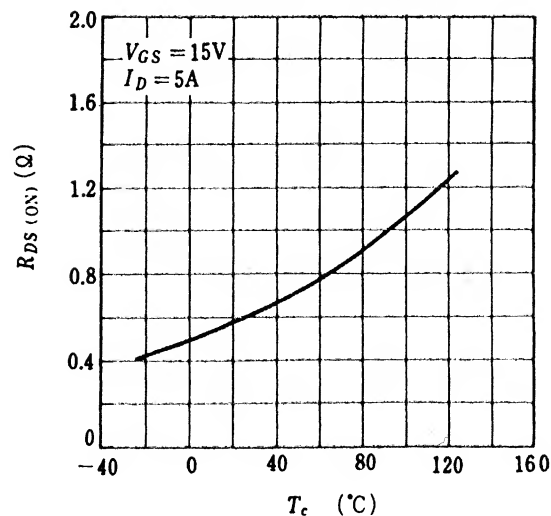
安全動作領域

伝達特性

$V_{DS(ON)}$ - V_{GS} 特性

$|y_{fs}|$ - I_D 特性

$R_{DS(ON)}$ - T_c 特性

C_{iss}, C_{oss}, C_{rss} - V_{DS} 特性

2SK349, 350

Si MOS型
Nチャンネル

日　立

$V_{DS(ON)}$ - V_{GS} 特 性

$|Y_{fs}|$ - I_D 特 性

$R_{DS(ON)}$ - T_c 特 性

C_{iss}, C_{oss}, C_{rss} - V_{DS} 特 性

2SK351

Si MOS型 Nチャンネル

日立

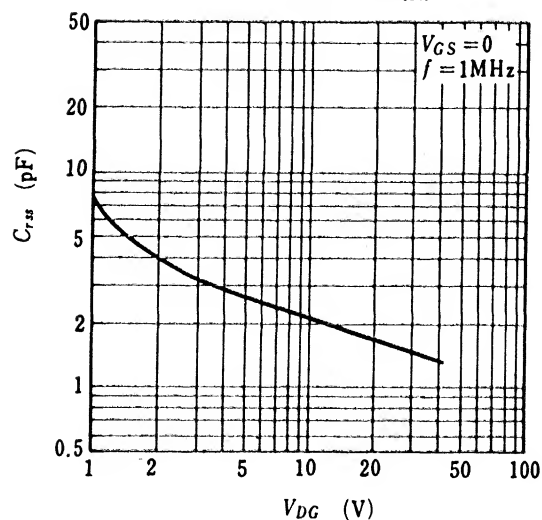
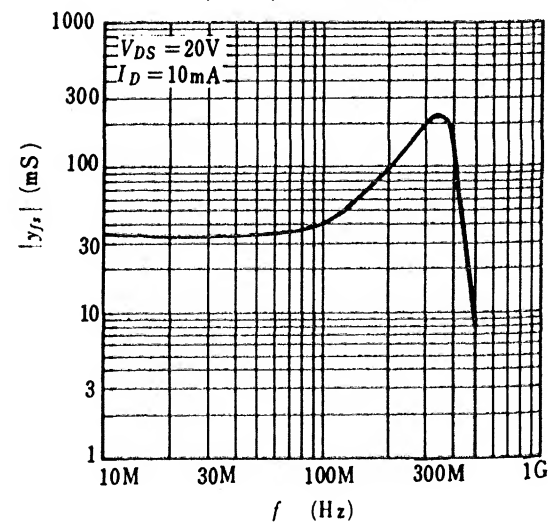
$|Y_{fs}|-I_D$ 特性

$R_{DS(ON)}-T_c$ 特性

$C_{iss}, C_{oss}, C_{rss}-V_{DS}$ 特性

2SK352

Si MOS型
Nチャンネル

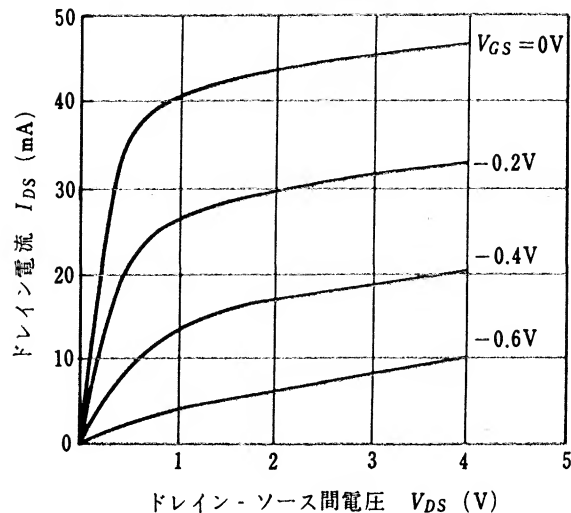
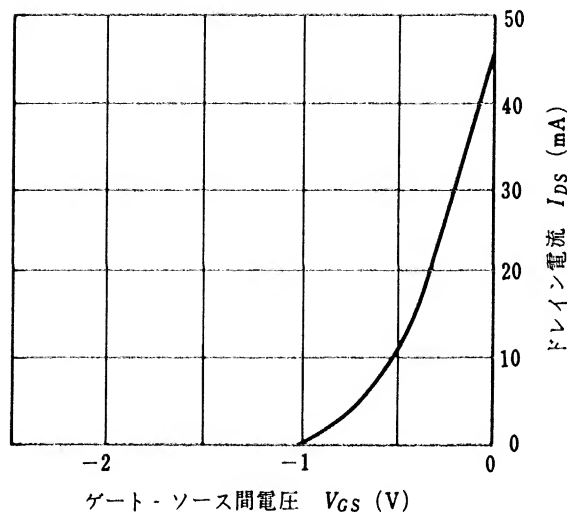
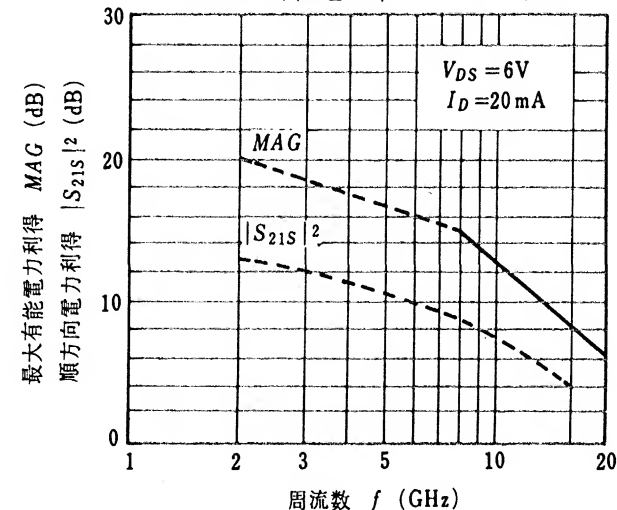
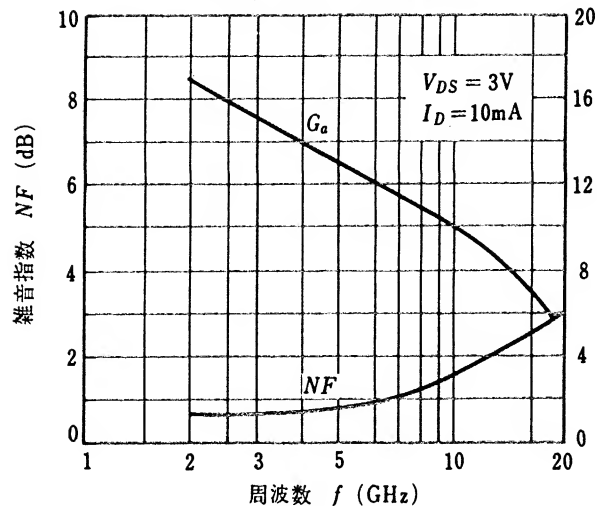
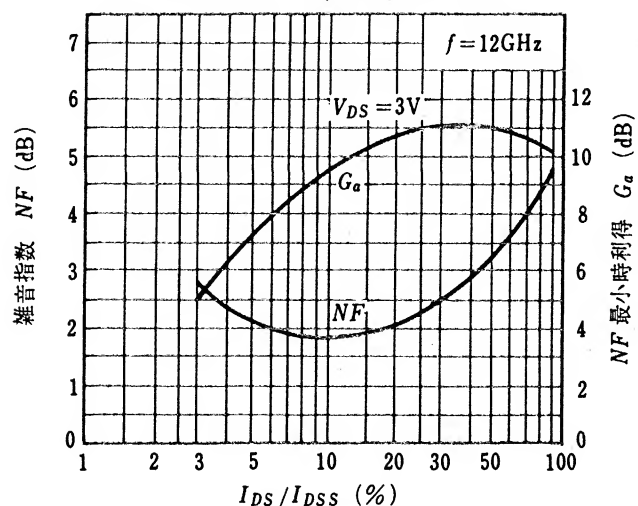
日　立

2SK353

GaAs型
Nチャンネル
日 電

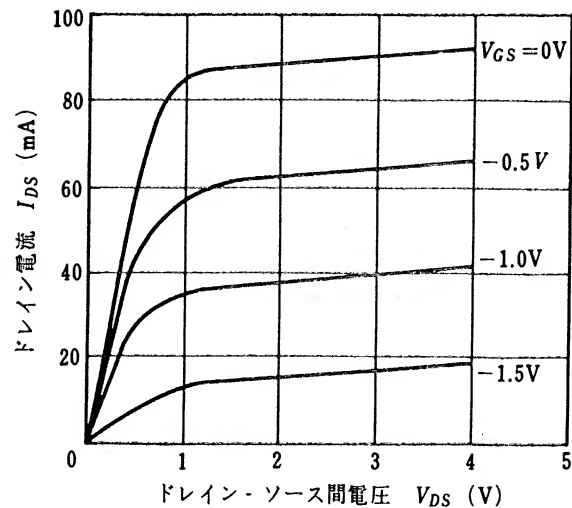
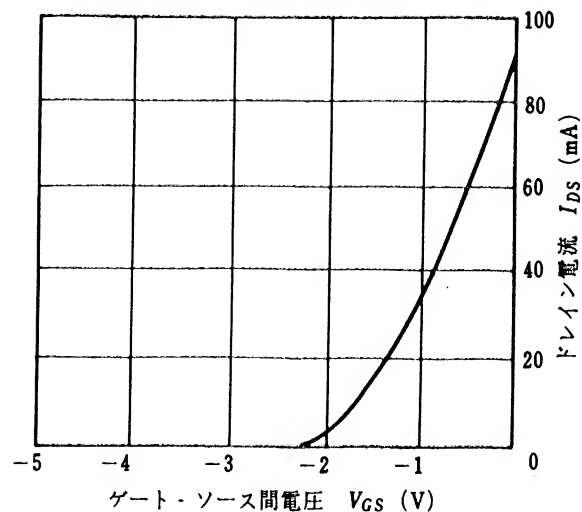
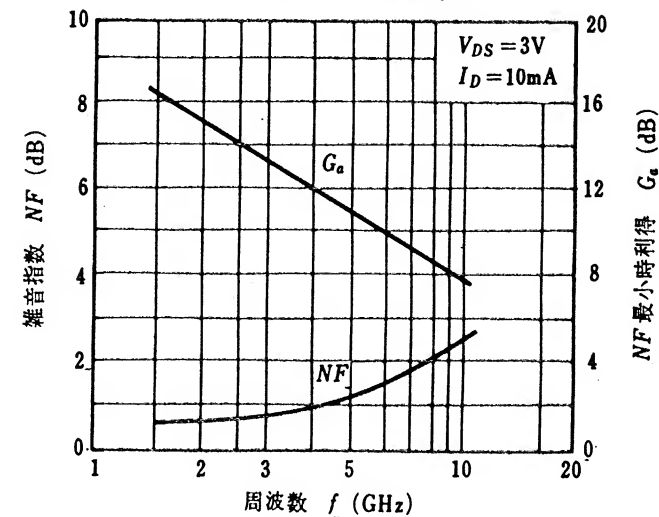
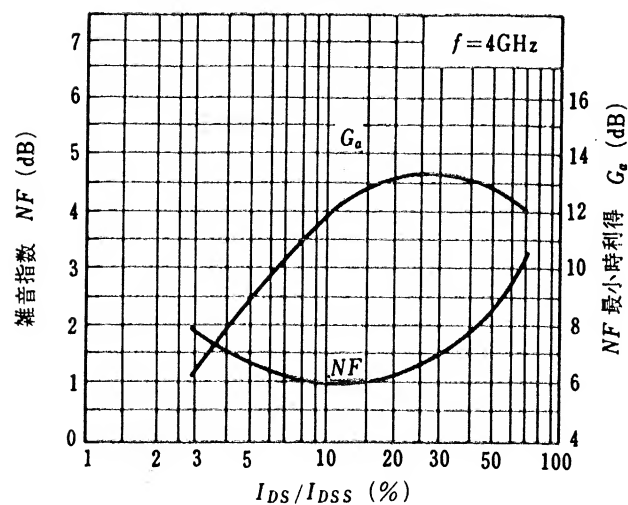
IDS - VDS 特性
VGS＝0V
−0.2V
−0.4V
−0.6V
ドレイン電流 IDS (mA)
ドレイン-ソース間電圧 VDS (V)

IDS - VGS 特性
ドレイン電流 IDS (mA)
ゲート-ソース間電圧 VGS (V)

MAG, |S21S|2 - f 特性
VDS＝6V
ID＝20mA
MAG
|S21S|2
最大有能電力利得 MAG (dB)
順方向電力利得 |S21S|2 (dB)
周流数 f (GHz)

NF, Ga - f 特性
VDS＝3V
ID＝10mA
Ga
NF
雑音指数 NF (dB)
周波数 f (GHz)

NF, Ga - ID/IDSS 特性
f＝12GHz
VDS＝3V
Ga
NF
雑音指数 NF (dB)
NF 最小時利得 Ga (dB)
IDS/IDSS (%)

2SK354, 354A

GaAs型
Nチャンネル

日　電

2SK355

Si MOS型
Pチャンネル

東　芝

安全動作領域

I_D - V_{GS} 特性

|Y_{fs}| - I_D 特性

I_D - T_C 特性

$R_{DS\,(on)}$ - I_D 特性

静電容量 - V_{DS} 特性

2SK356

Si MOS型 Nチャンネル　　東芝

安全動作領域

I_D - V_{GS} 特性

$|Y_{fs}|$ - I_D 特性

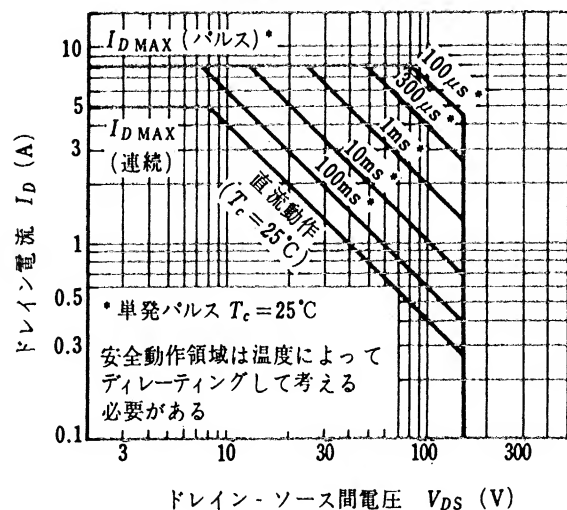
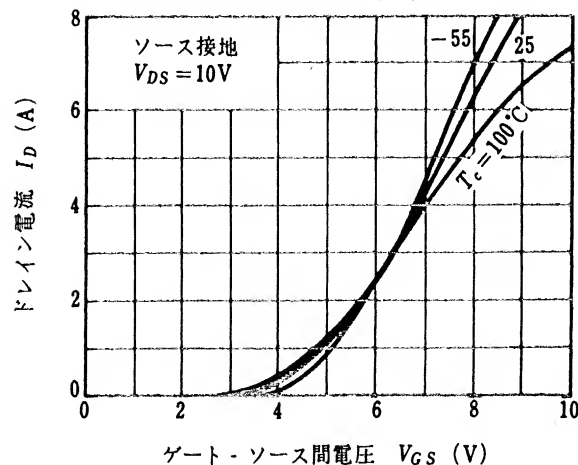
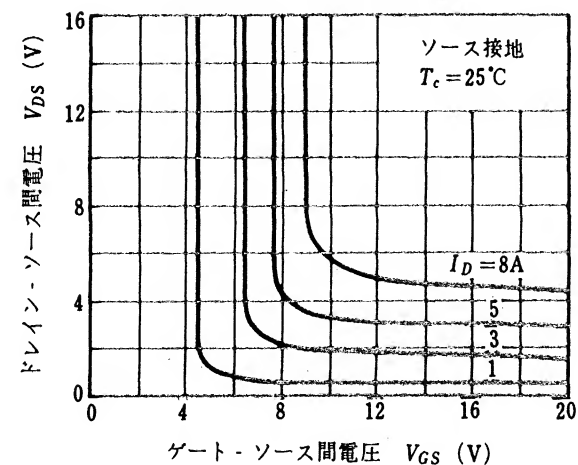
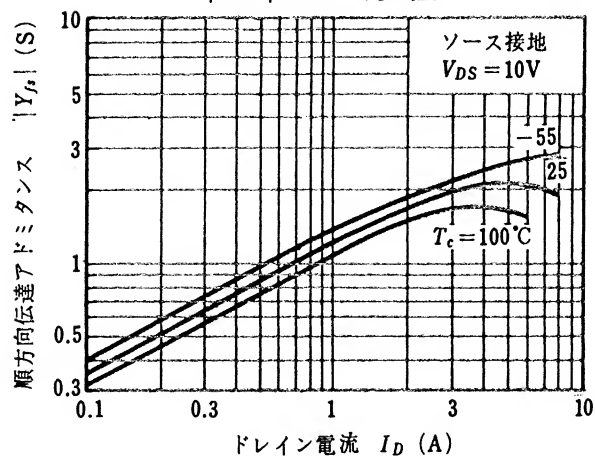
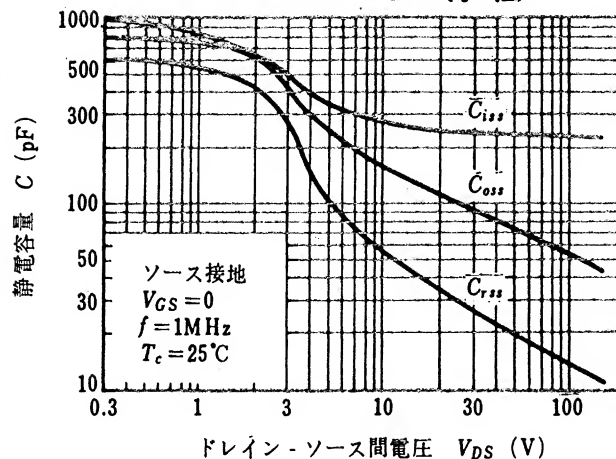
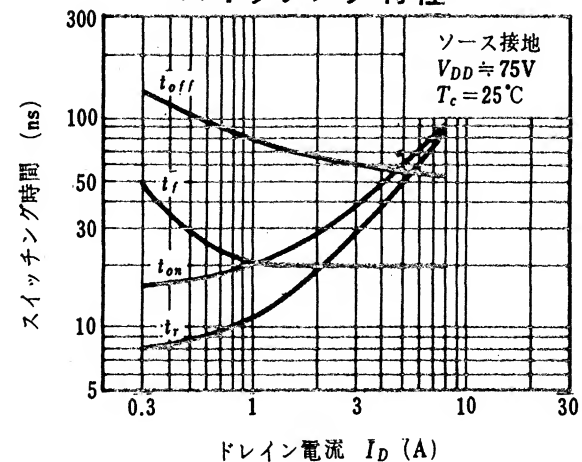
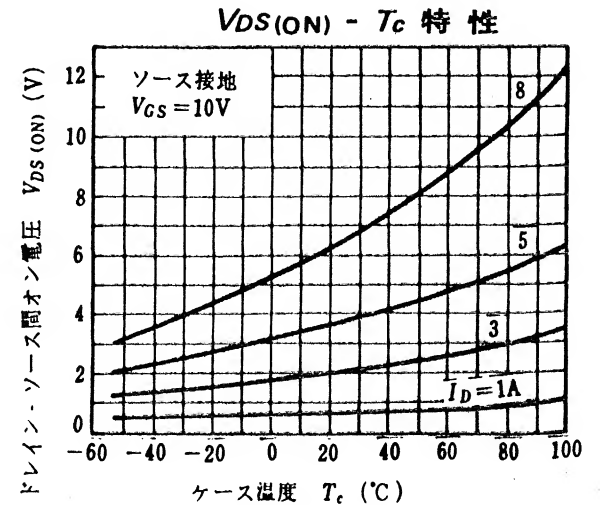
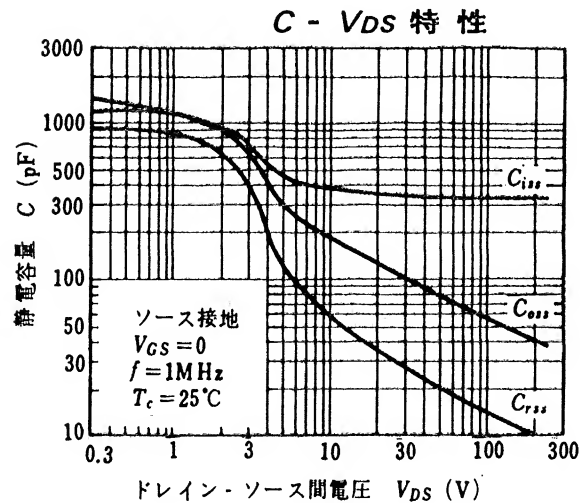
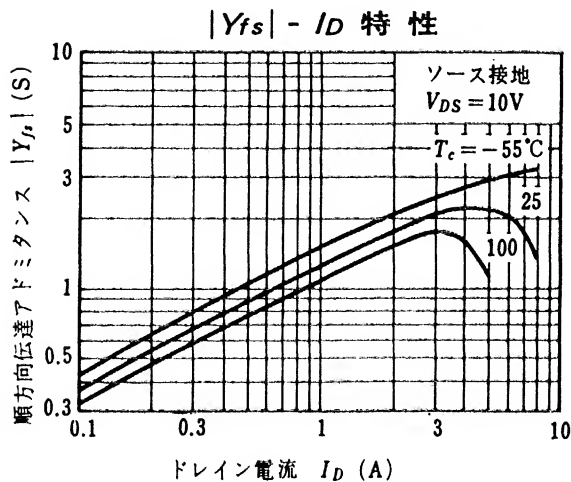
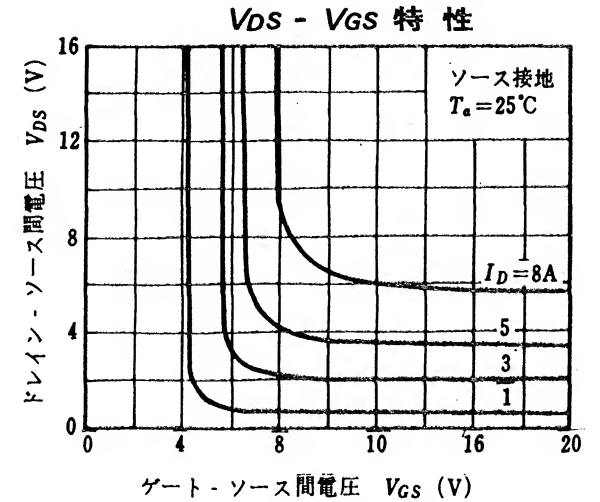
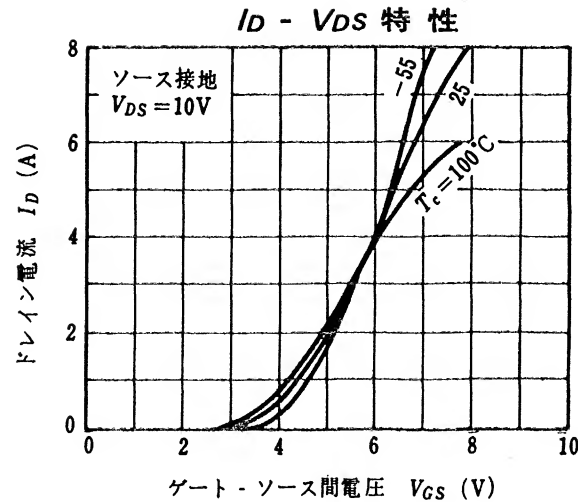
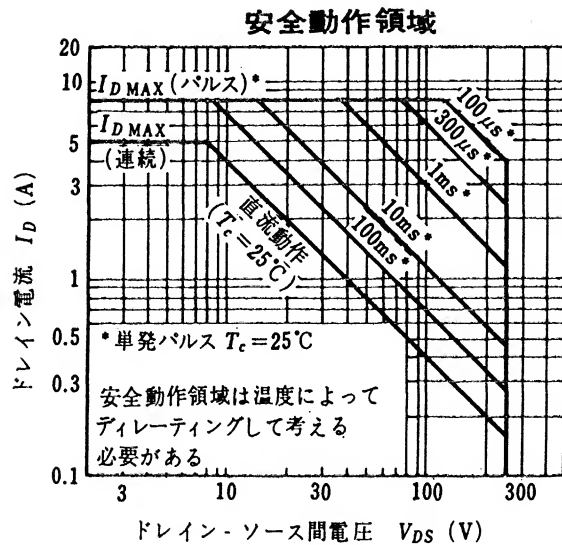
I_D - T_C 特性

$R_{DS(on)}$ - I_D 特性

静電容量 - V_{DS} 特性

2SK357

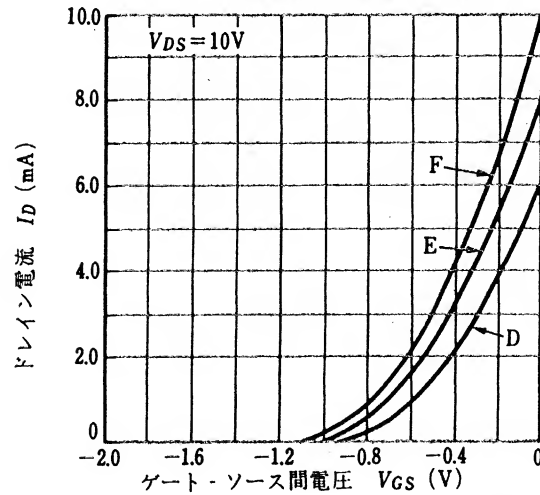
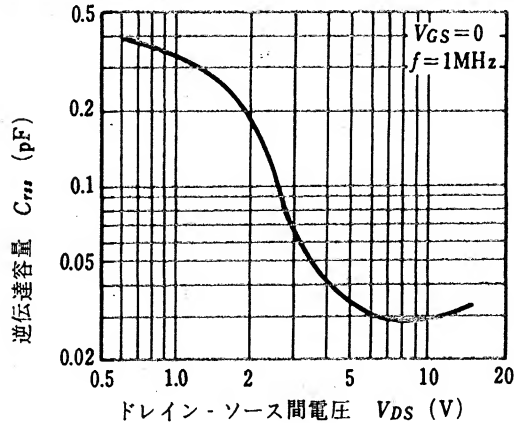
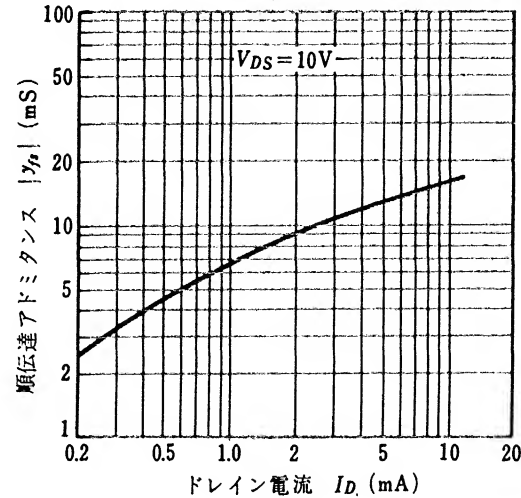
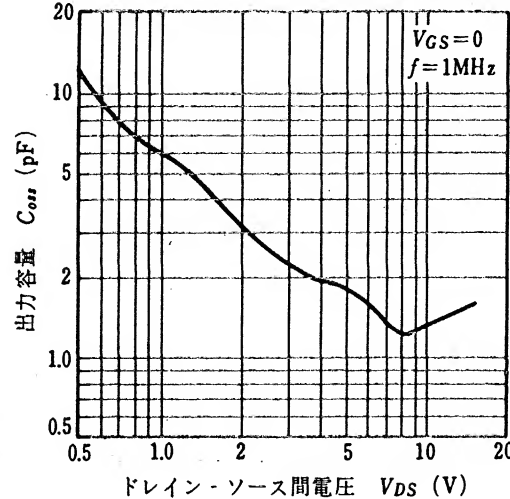
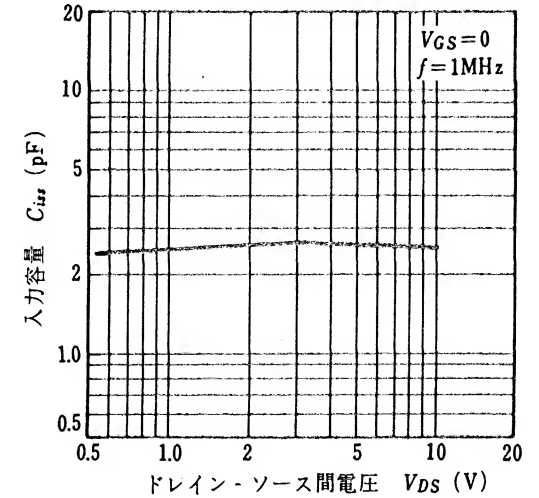
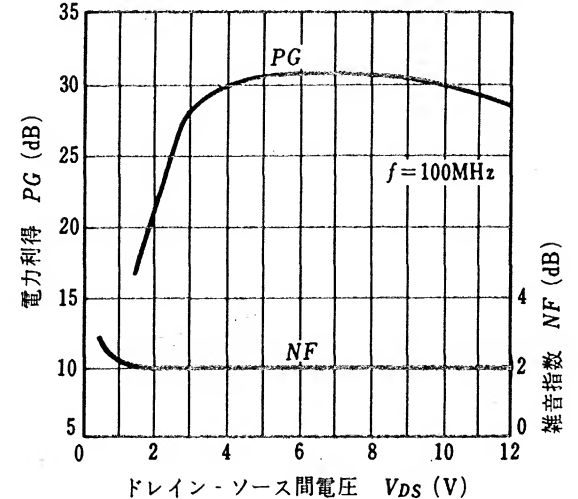
Si MOS型 Nチャンネル

東芝

2SK358

Si MOS型 Nチャンネル　東　芝

2SK359, 360, 439 Si MOS型 Nチャンネル 日立

2SC360/439 I_{DSS} 分類

	D	E	F
I_{DSS} (mA)	4～8	6～10	8～12

ソース接地伝達静特性

逆伝達容量対ドレイン - ソース間電圧特性

順伝達アドミタンス対ドレイン電流特性

出力容量対ドレイン - ソース間電圧特性

入力容量対ドレイン - ソース間電圧特性

電力利得, 雑音指数対ドレイン - ソース間電圧特性

2SK362,365

Si 接合型 Nチャンネル 東芝

I_{DSS}分類　Y：1.2～3.0,　GR：2.6～6.5,　BL：6～14

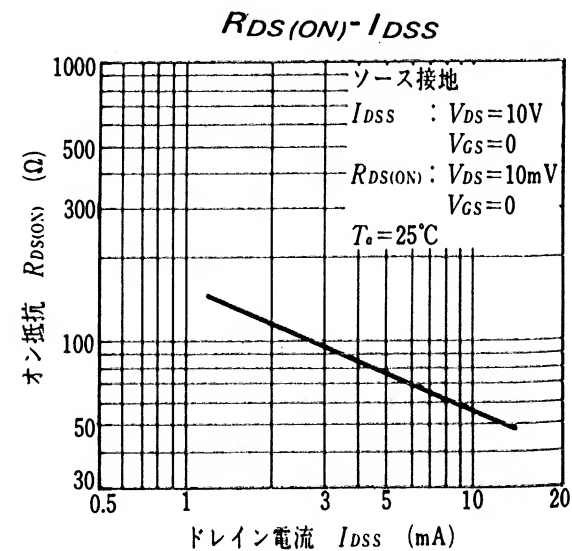
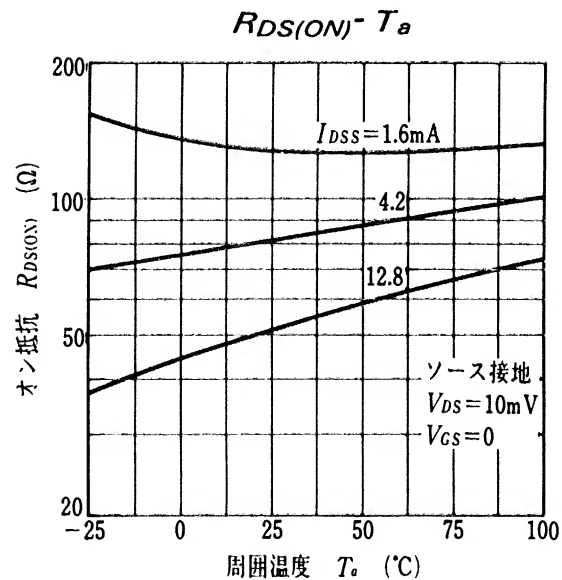
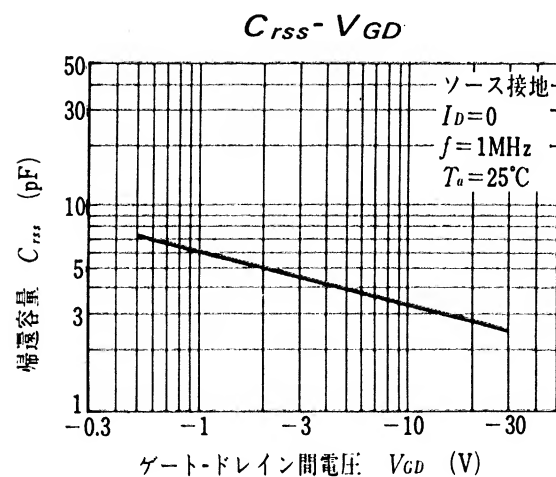
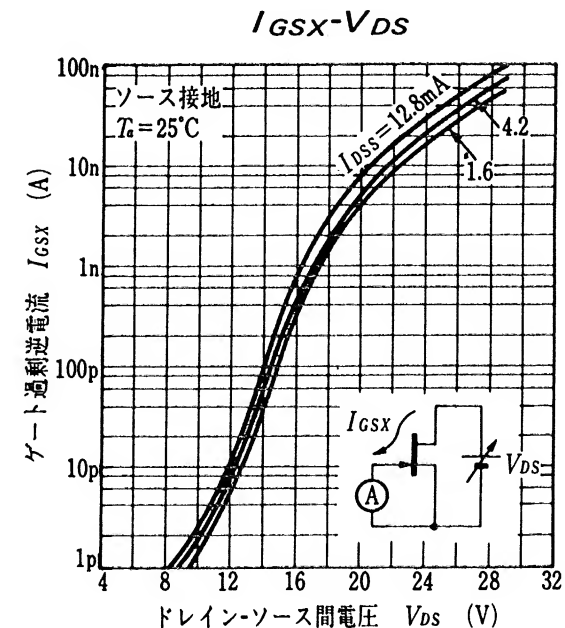
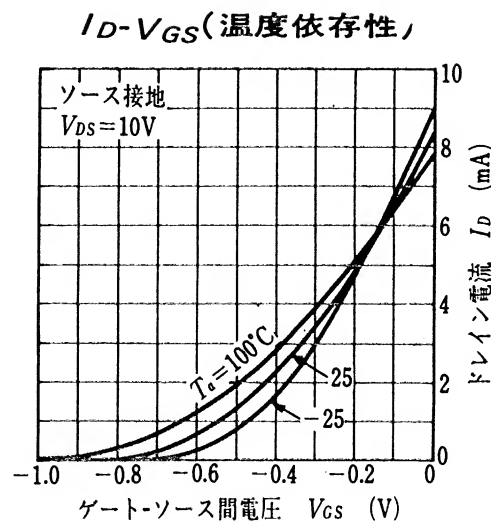
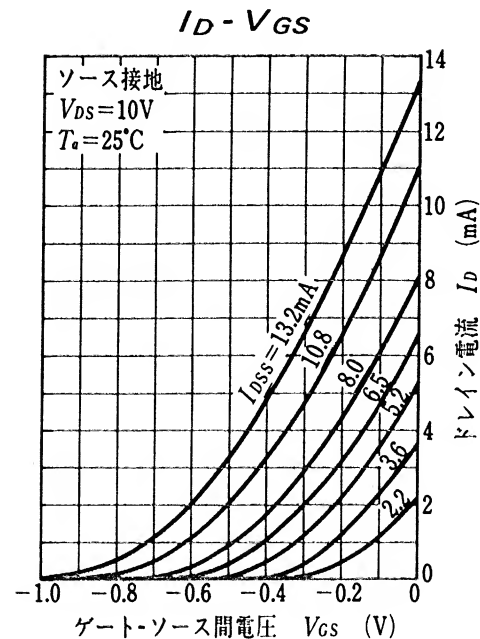
I_D - V_{GS}

C_{rss} - V_{GD}

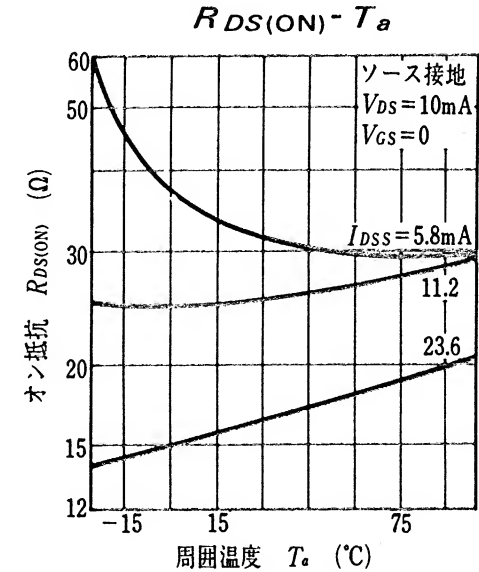
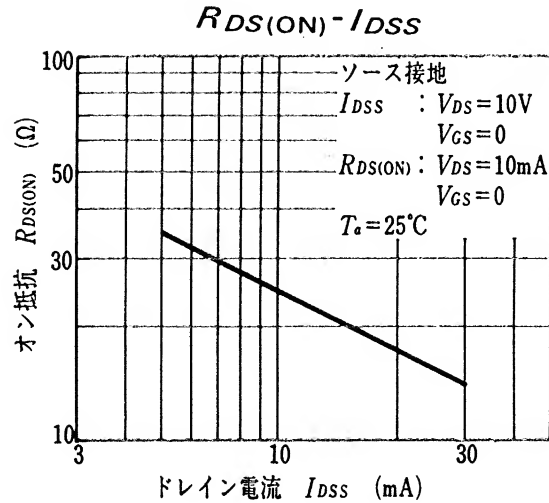
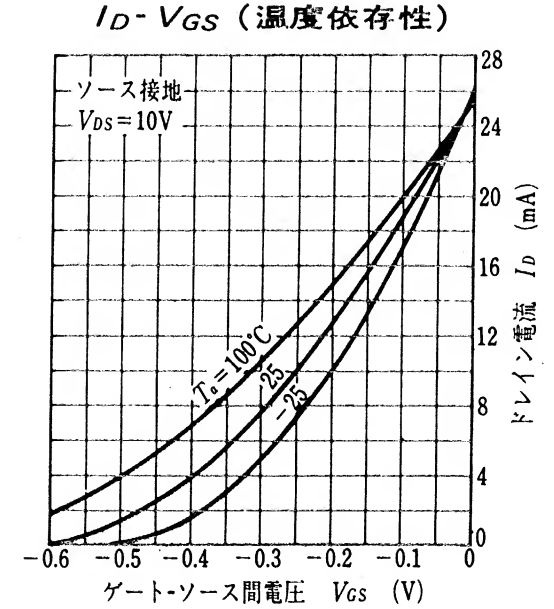
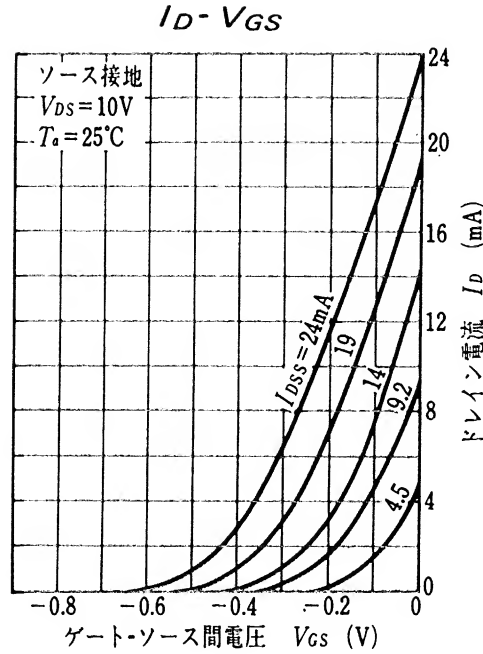
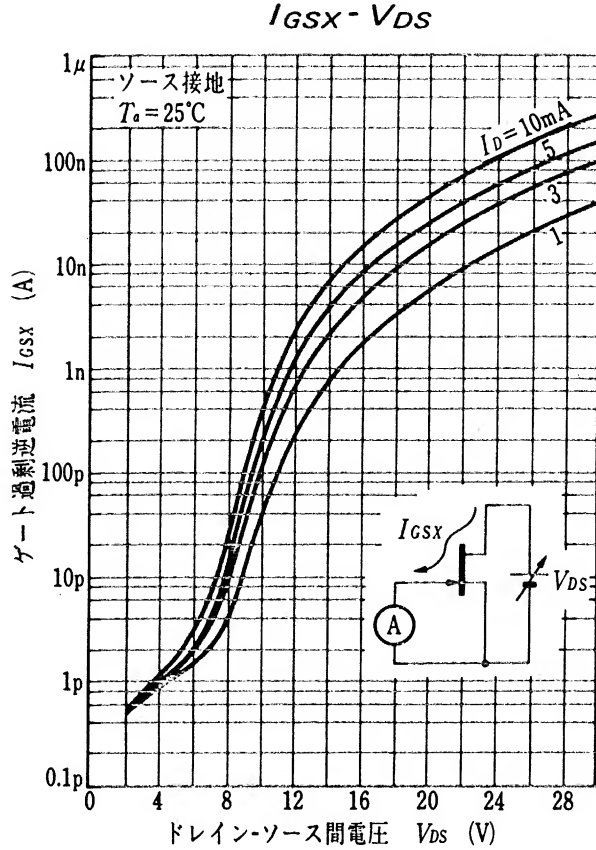
I_D - V_{GS}（温度依存性）

$R_{DS(ON)}$ - T_a

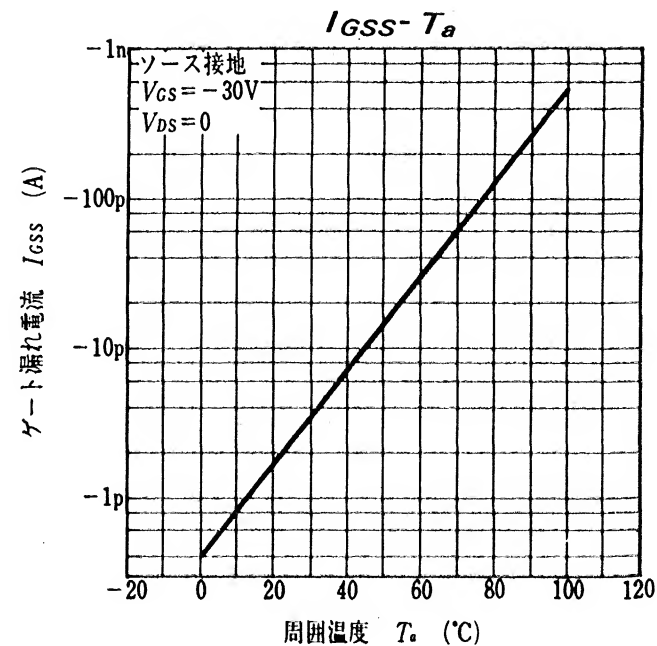
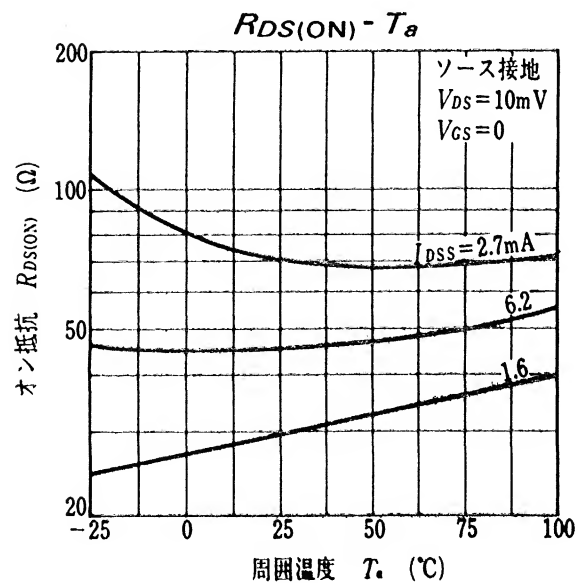
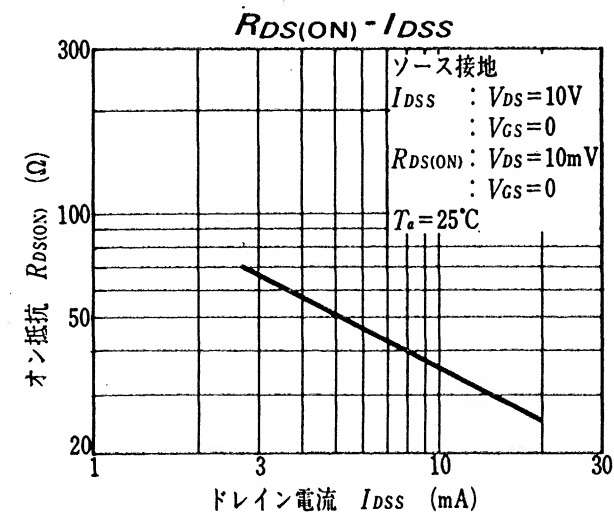
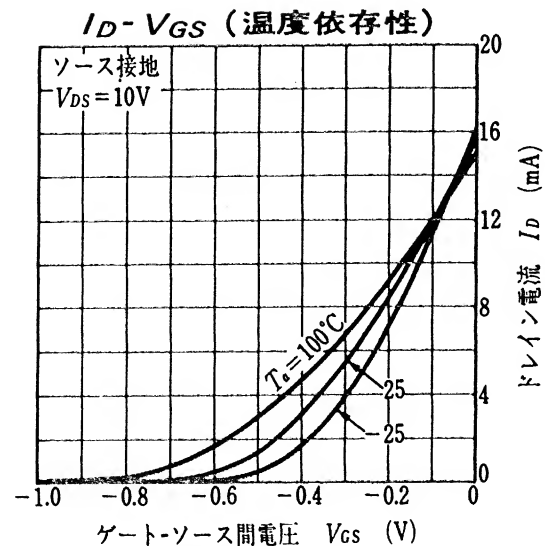
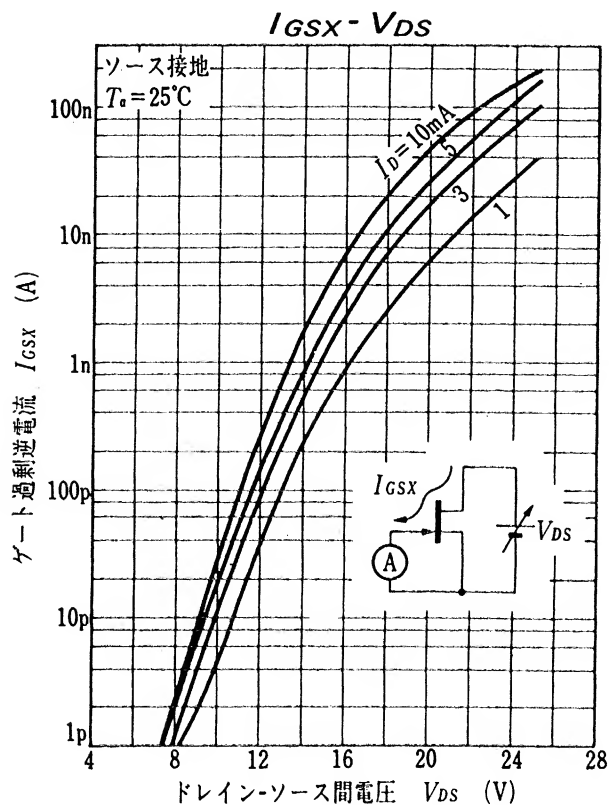
I_{GSX} - V_{DS}

$R_{DS(ON)}$ - I_{DSS}

2SK363,372

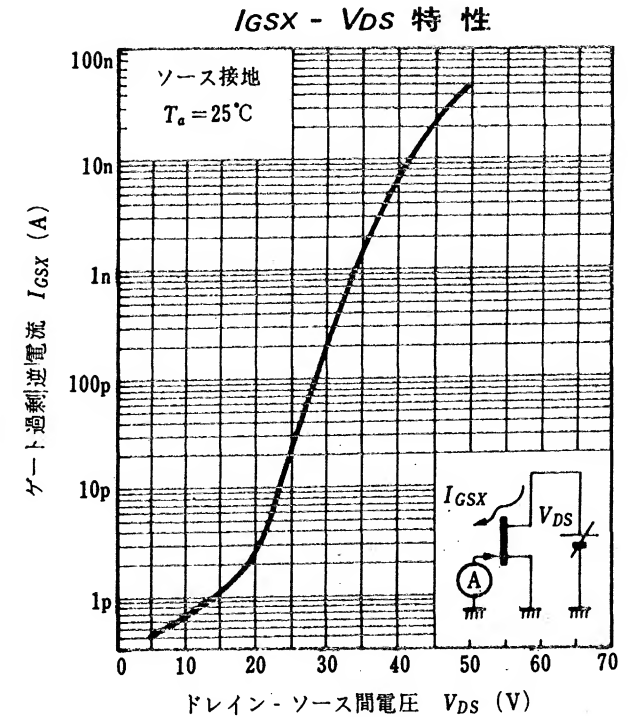
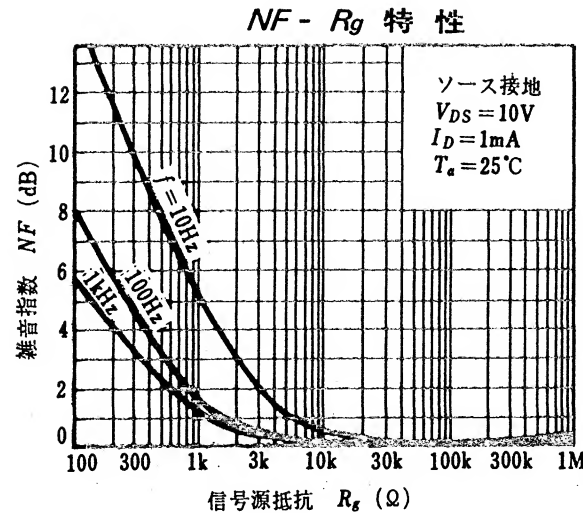
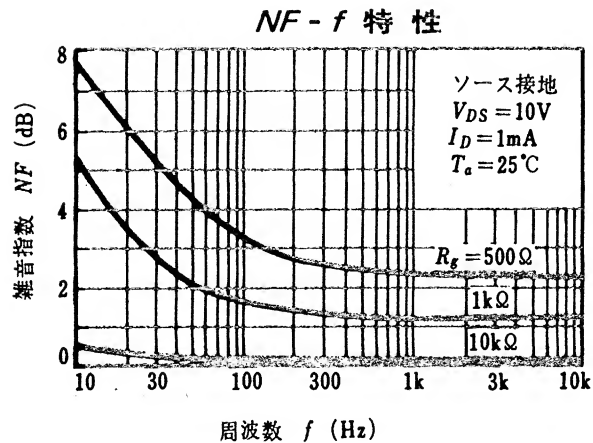
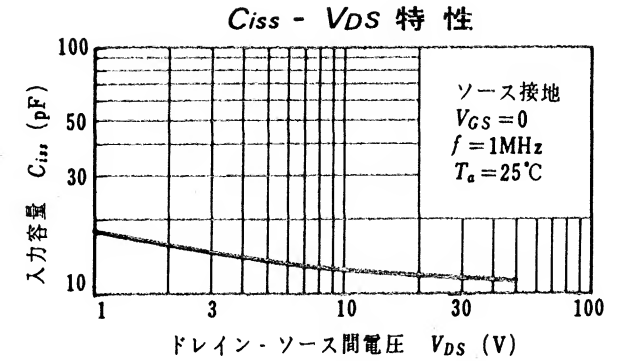
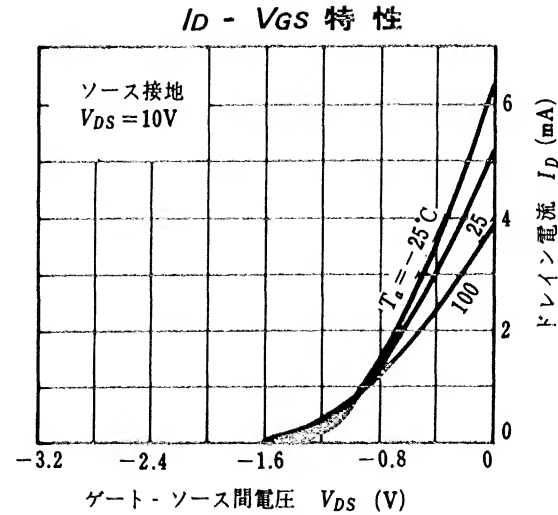
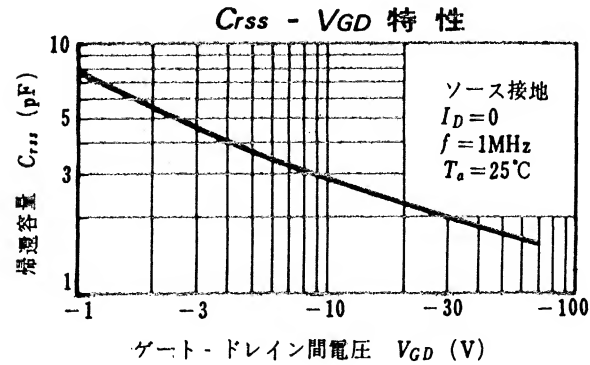
Si 接合型 Nチャンネル 東芝

I_{DSS}分類 GR：5.0～10.0，BL：8.0～16.0，V：14.0～30.0

2SK364, 366

Si 接合型 Nチャンネル　　東　芝

I_{DSS}分類　GR：2.6～6.5, BL：6～12, V：10～20

2SK367, 368

Si 接合型 Nチャンネル　東芝

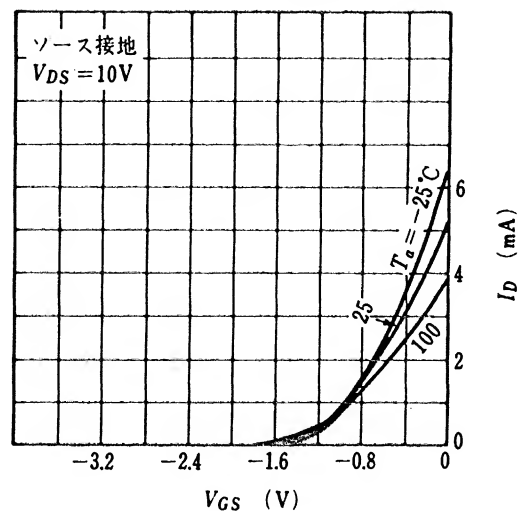
I_{DSS} 分類　O：0.6～1.4, Y：1.2～3.0, GR：2.6～6.5 (mA)

2SK373

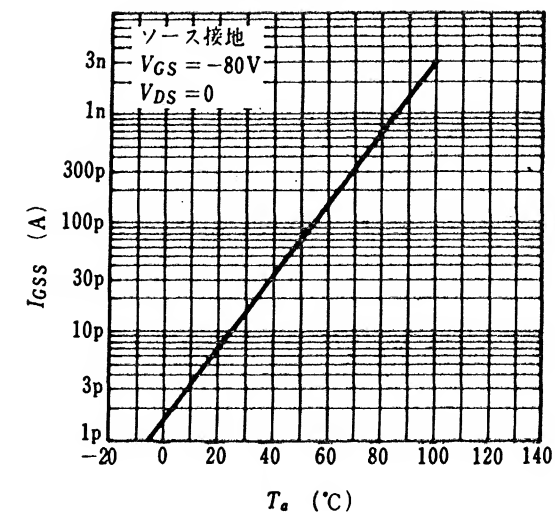
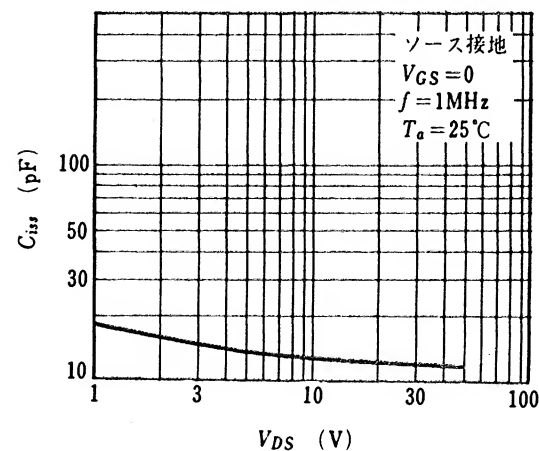
Si 接合型
Nチャンネル
東　芝

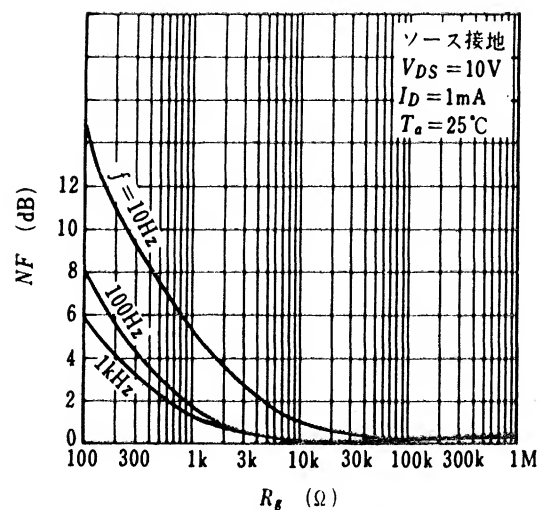
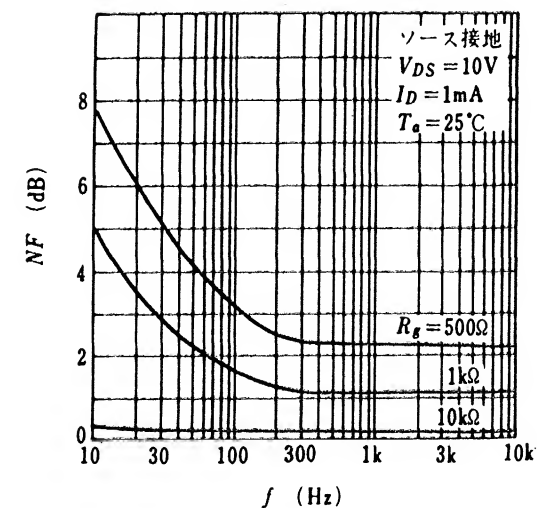
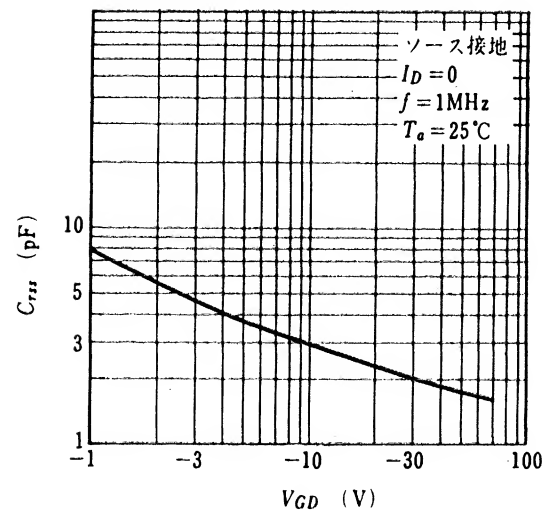
I_{DSS} 分類　O：0.6～1.4mA，Y：1.2～3.0mA，GR：2.6～6.5mA

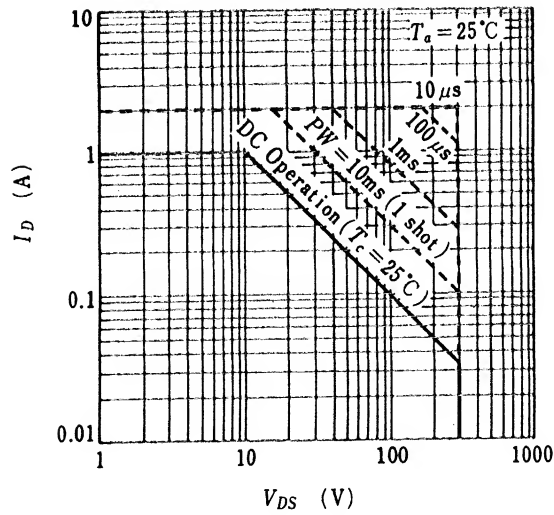
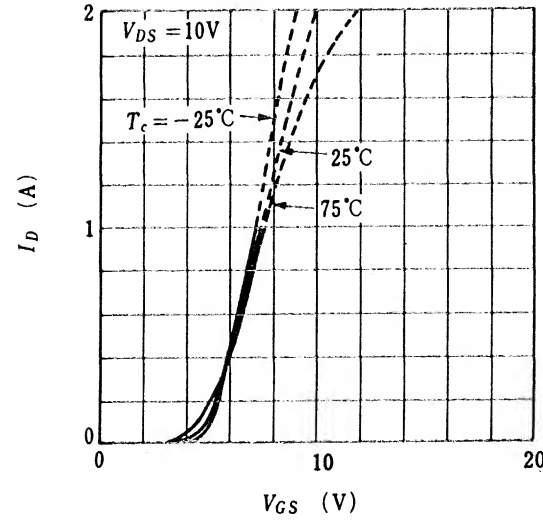
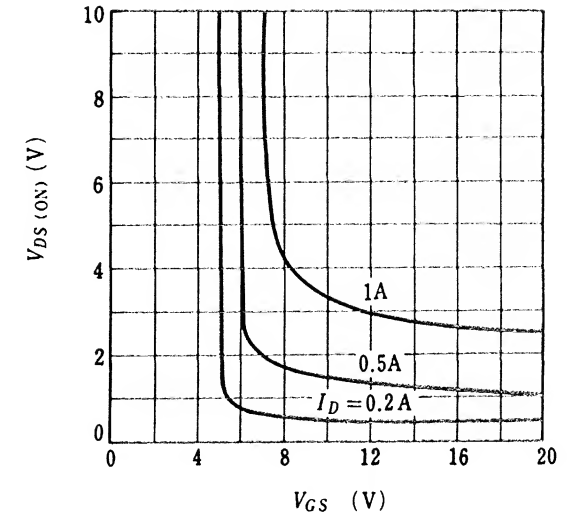
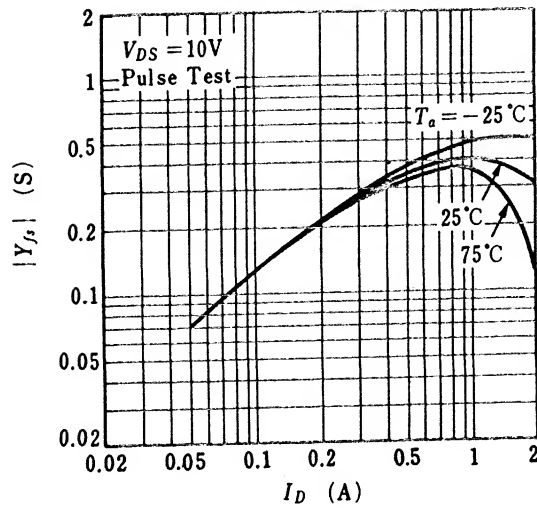
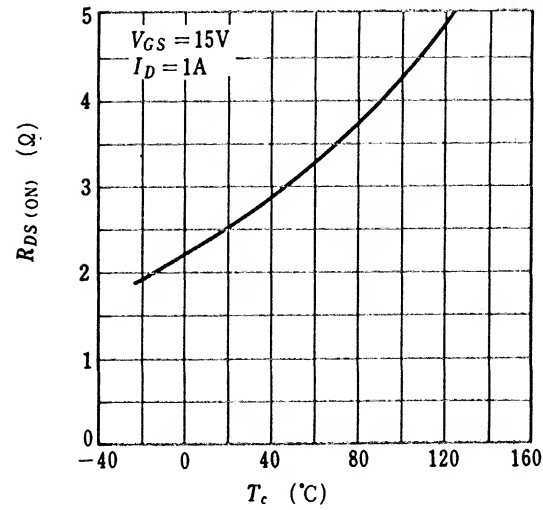
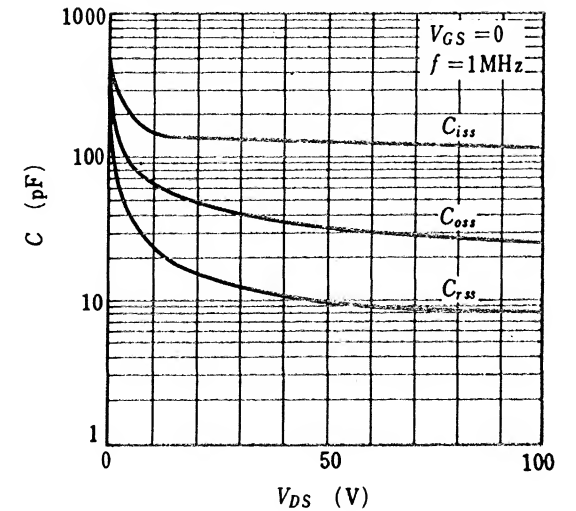
C_{iss} - V_{DS} 特性

ソース接地
$V_{GS}=0$
$f=1\text{MHz}$
$T_a=25$°C

C_{iss} (pF)　10　30　50　100
V_{DS} (V)　1　3　10　30　100

I_D - V_{GS} 特性

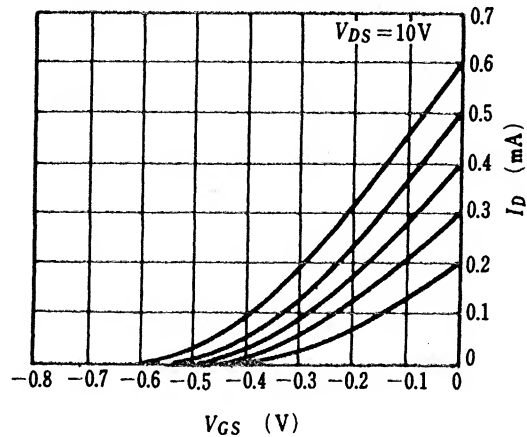
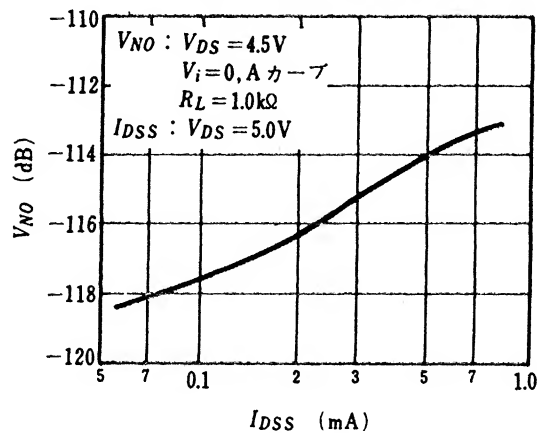
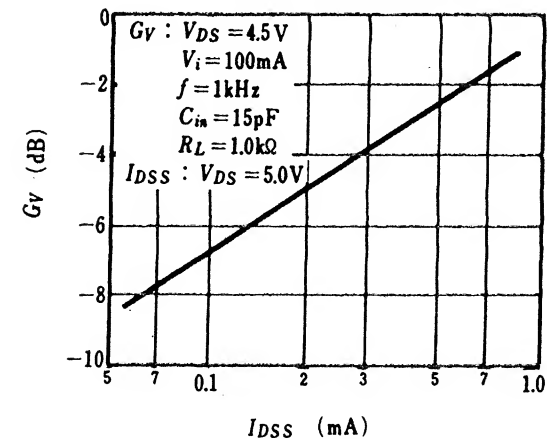
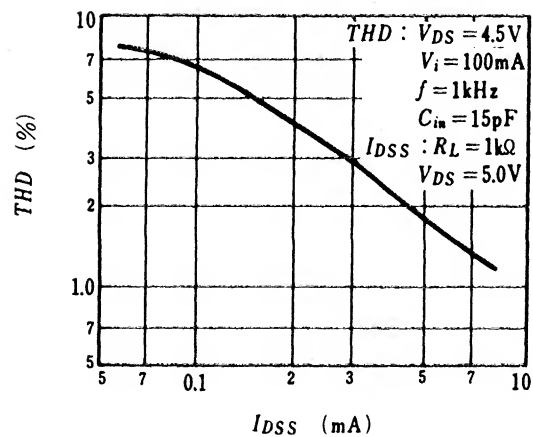
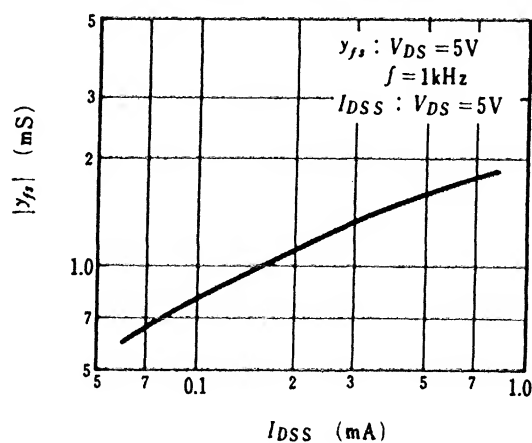
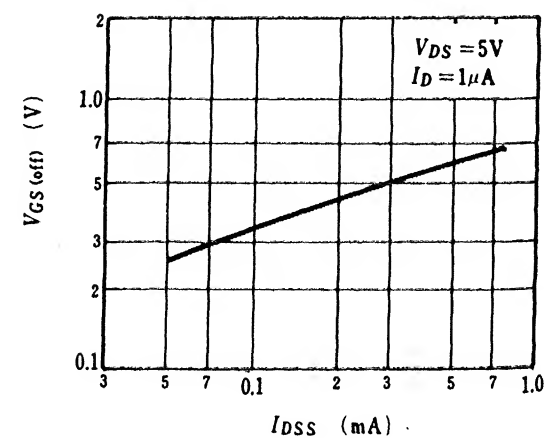
I_{GSS} - V_{GS} 特性

C_{rss} - V_{GD} 特性

NF - R_g 特性

NF - f 特性

2SK375

Si MOS型 Nチャンネル　日立

$V_{DS(ON)}$ - V_{GS} 特性

$|Y_{fs}|$ - I_D 特性

$R_{DS(ON)}$ - T_c 特性

C_{iss}, C_{oss}, C_{rss} - V_{DS} 特性

2SK376, 377

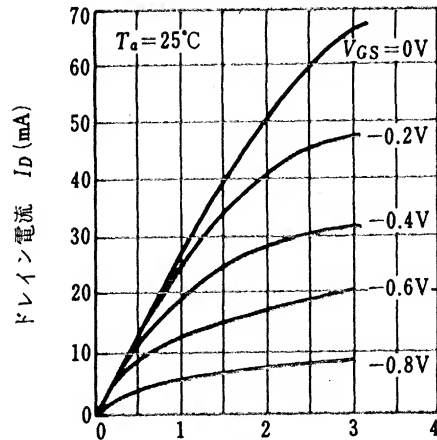
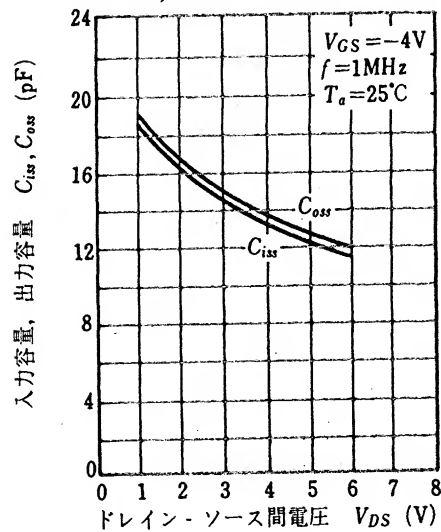
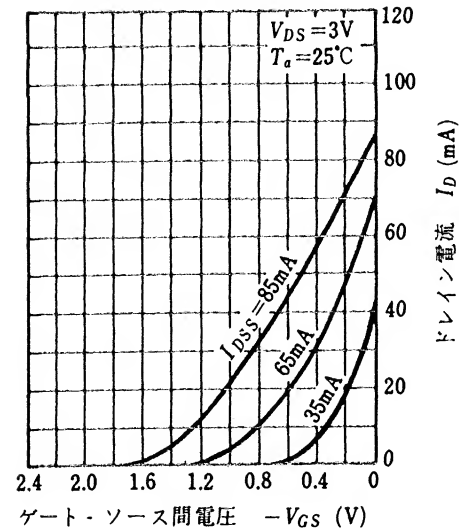
Si 接合型 Nチャンネル　三洋

I_{DSS} により次のように分類する（単位：μA）

60 J 180	150 K 300	250 L 500	400 M 800

2SK378

GaAs 型
Nチャンネル

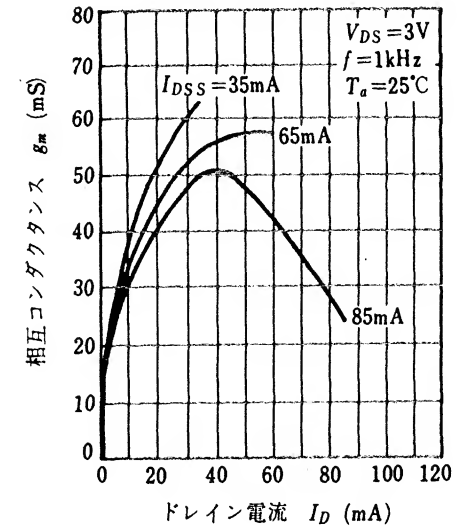
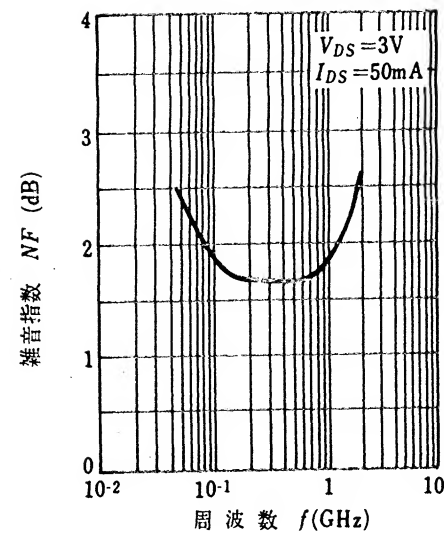
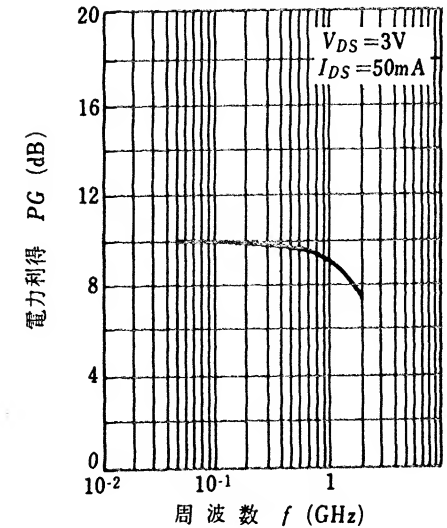
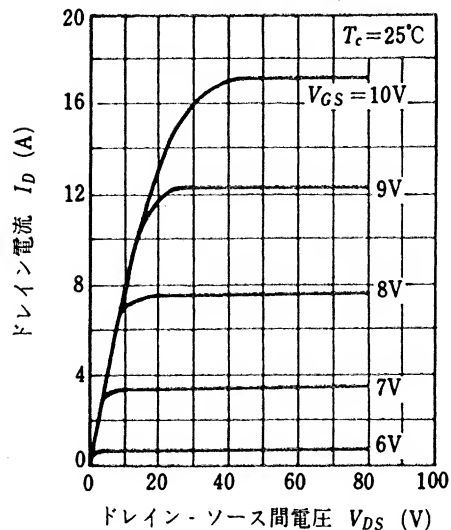
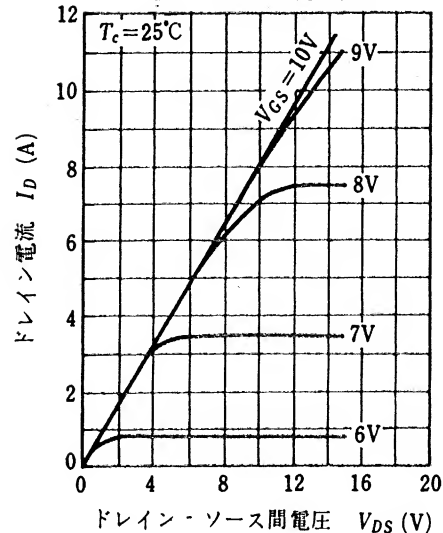
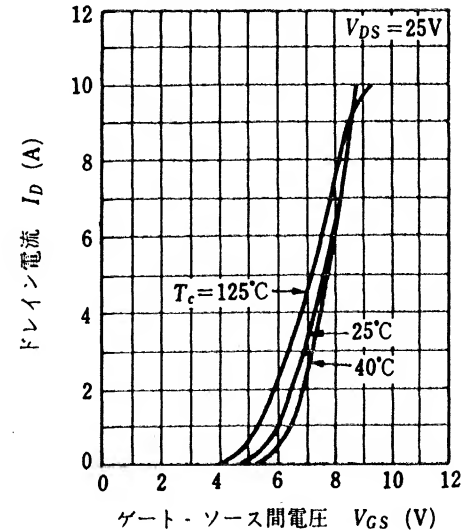
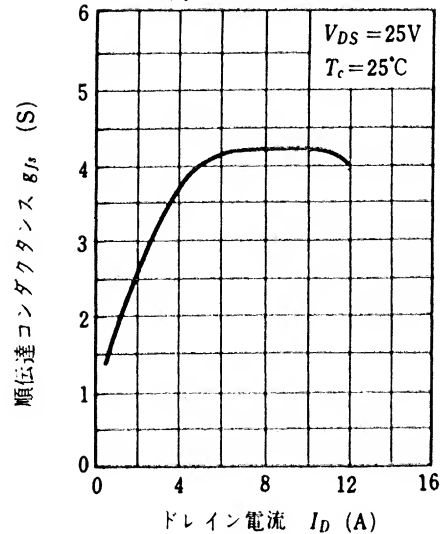
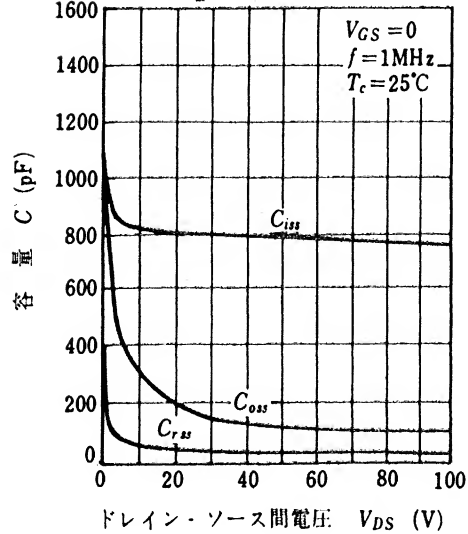
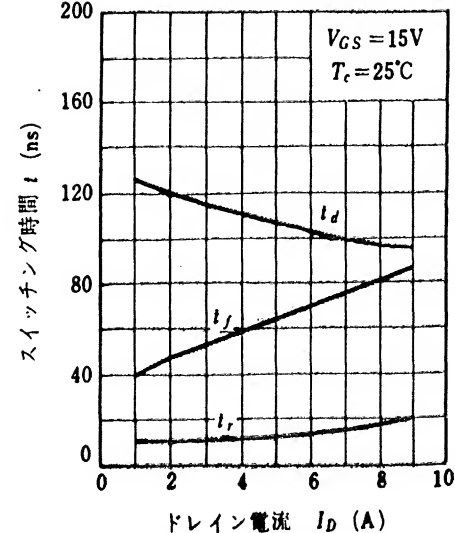
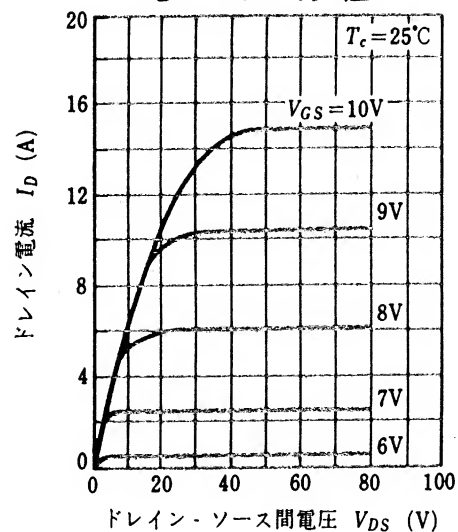
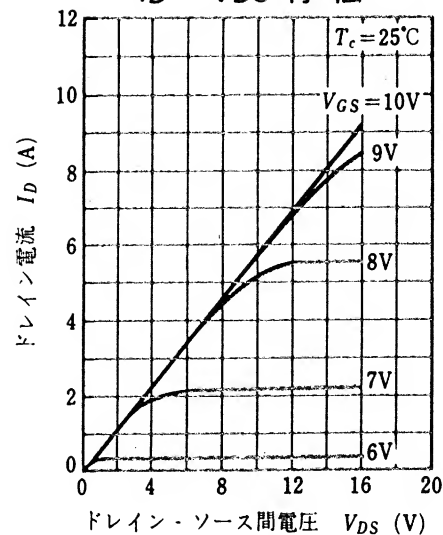
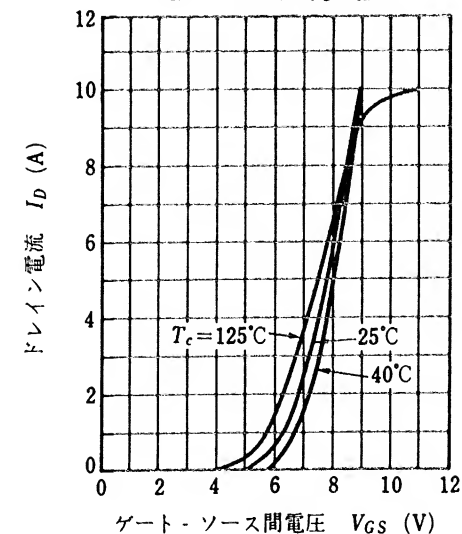
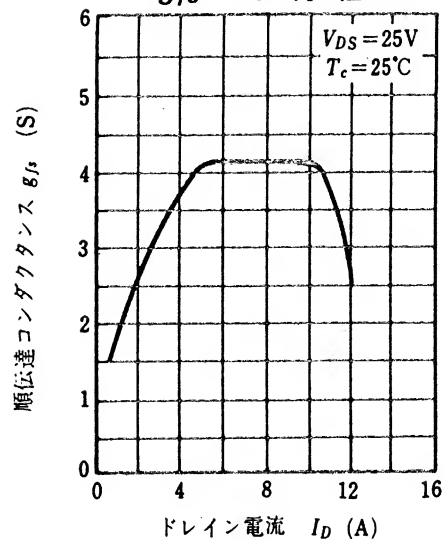
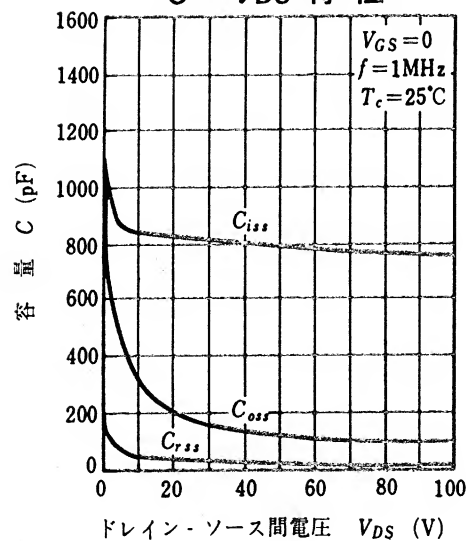
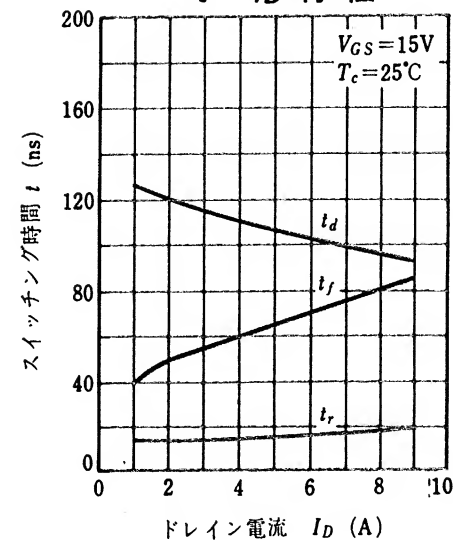
I_{DSS} ランク分類

	P	Q	R
I_{DSS} (mA)	15～50	40～80	70～130

C_{iss}, C_{oss} - V_{DS} 特 性

V_{GS}=−4V
f=1MHz
T_a=25°C
C_{oss}
C_{iss}
入力容量, 出力容量 C_{iss}, C_{oss} (pF)
ドレイン - ソース間電圧 V_{DS} (V)

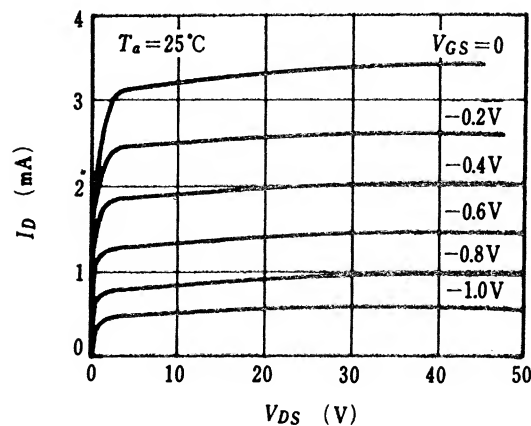
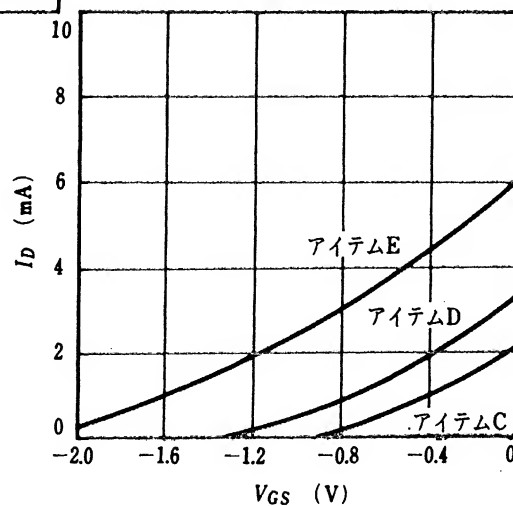
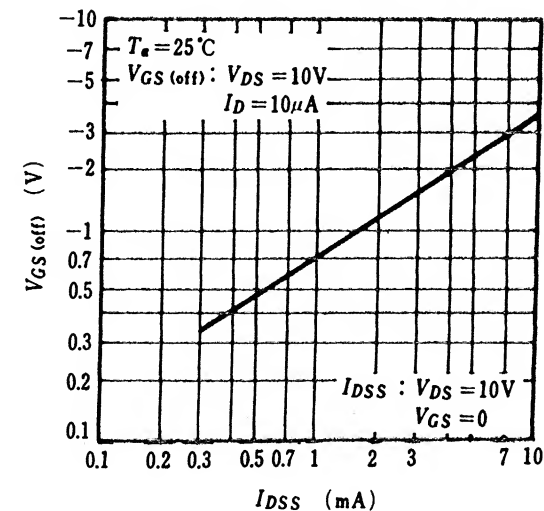
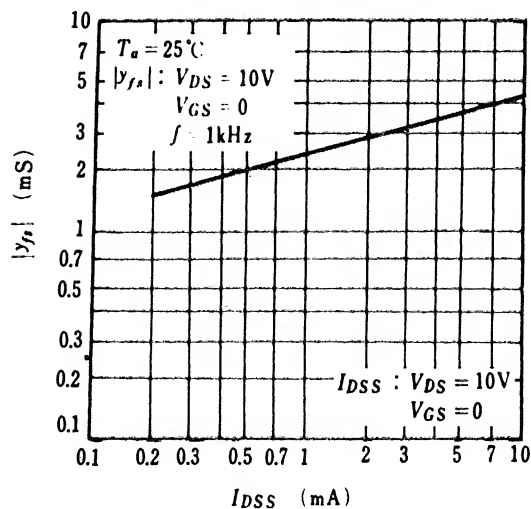
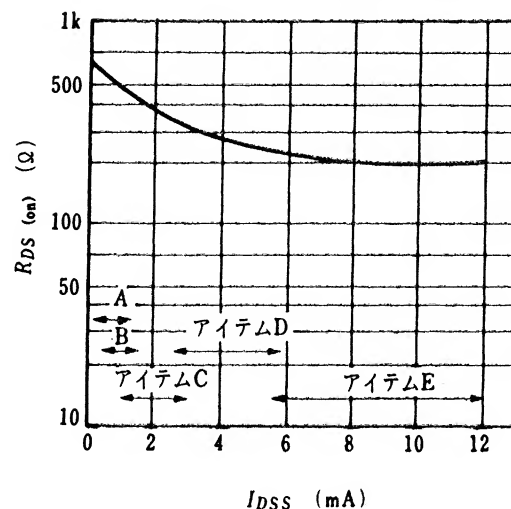
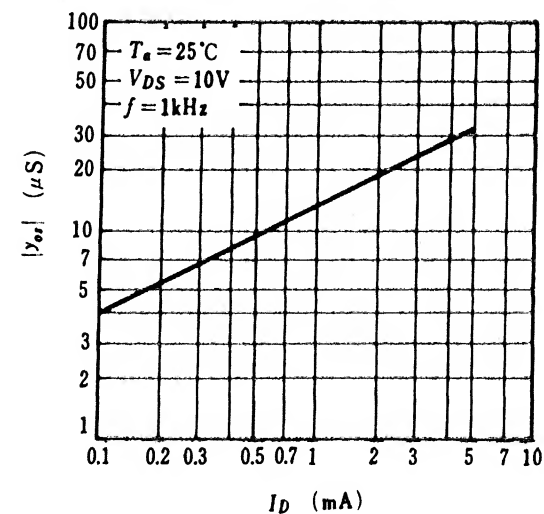
2SK379

Si MOS型 Nチャンネル

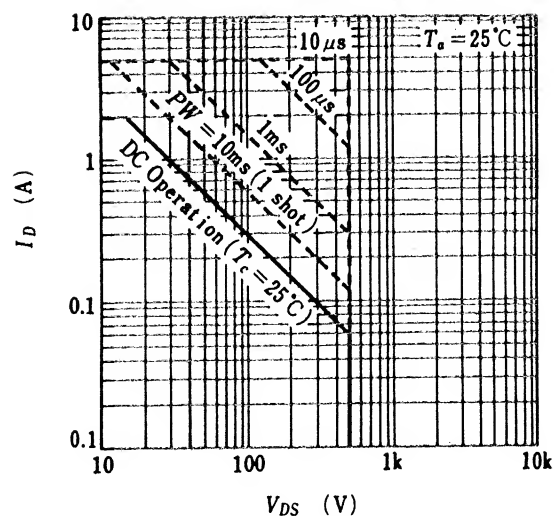
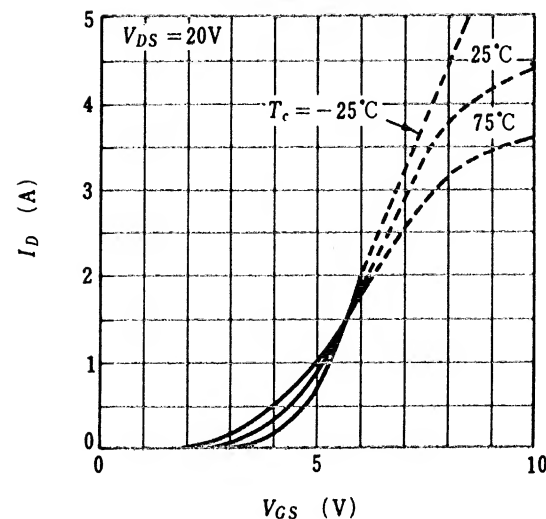
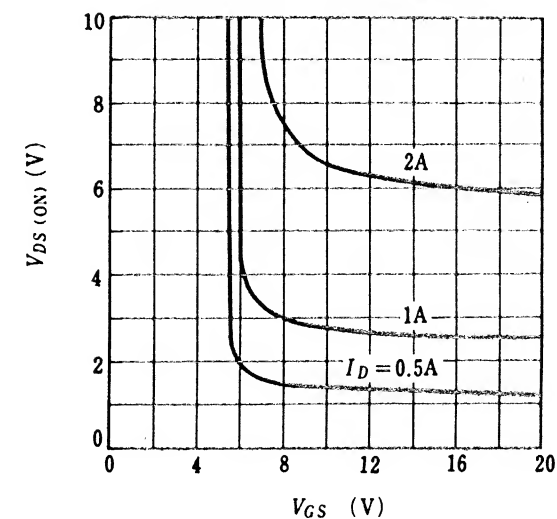
松　下

2SK380

Si MOS型 Nチャンネル 松下

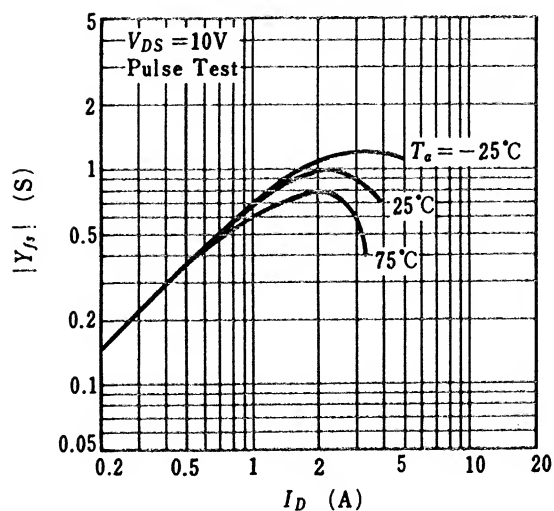
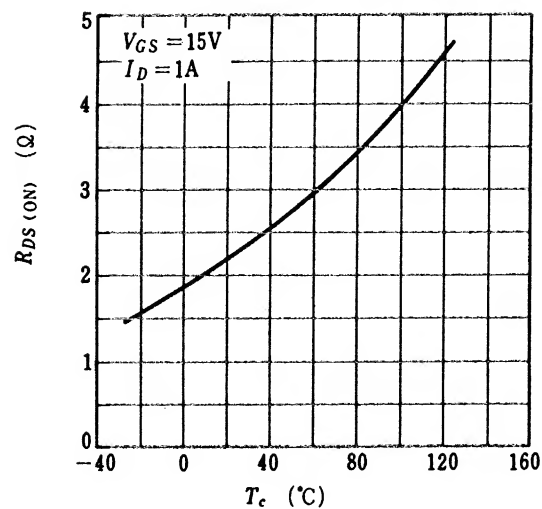
2SK381, 433

Si 接合型
Nチャンネル　　　　三　菱

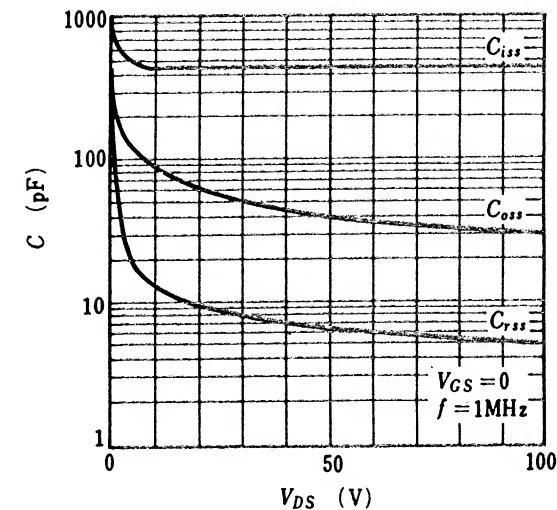
アイテム	A	B	C	D	E
I_{DSS} (mA)	0.3～0.8	0.6～1.5	1.0～3.0	2.5～6.0	5.0～12

2SK382

Si MOS型
Nチャンネル

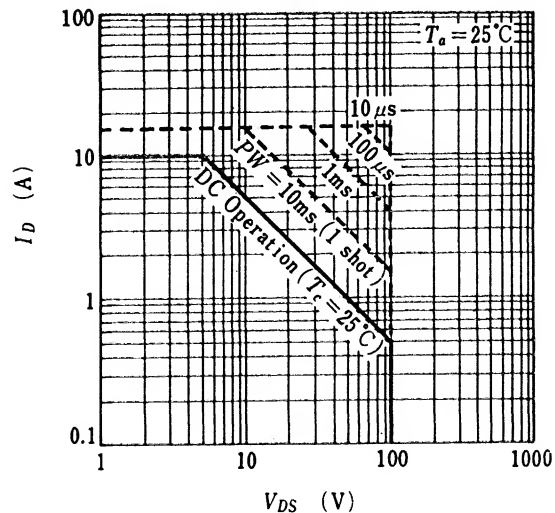
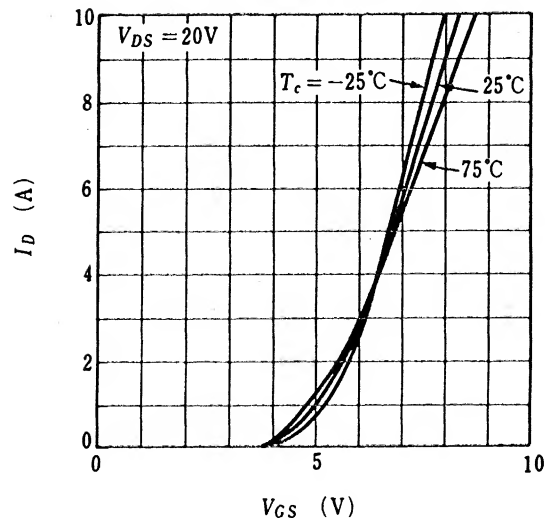
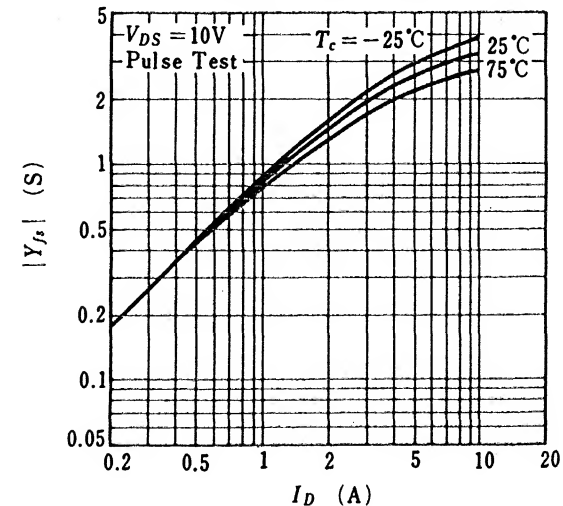
日　立

安全動作領域

伝達特性

$V_{DS(ON)}$ - V_{GS} 特性

$|Y_{fs}|$ - I_D 特性

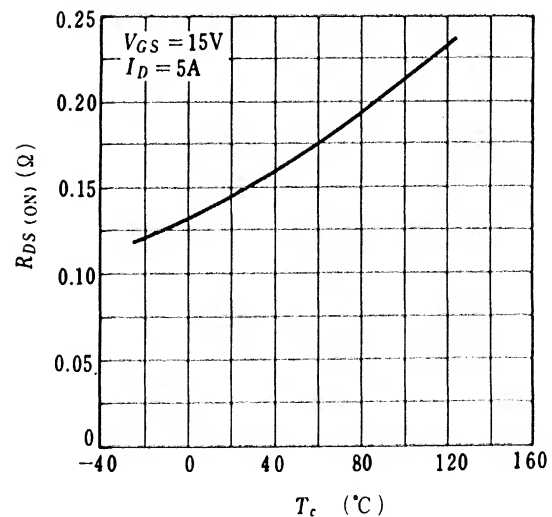
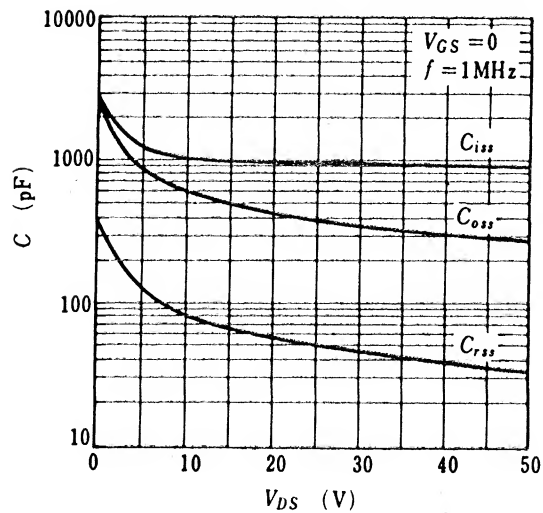
$R_{DS(ON)}$ - T_c 特性

C_{iss}, C_{oss}, C_{rss} - V_{DS} 特性

2SK383

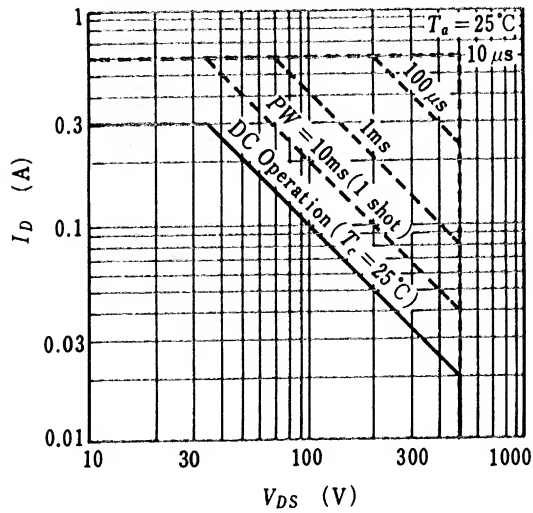
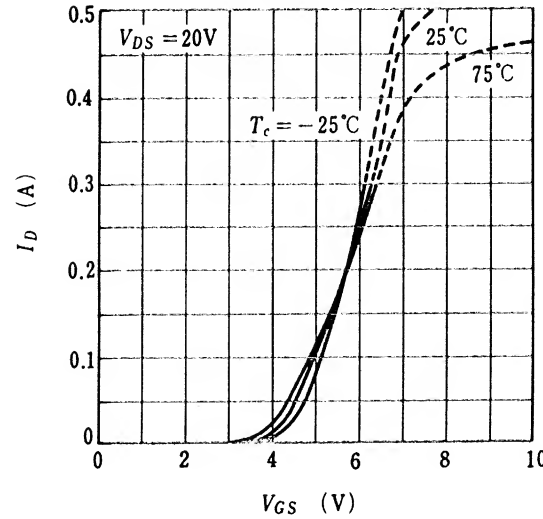
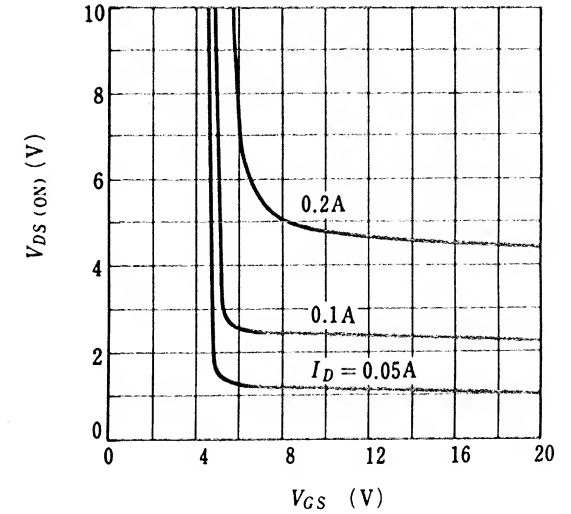
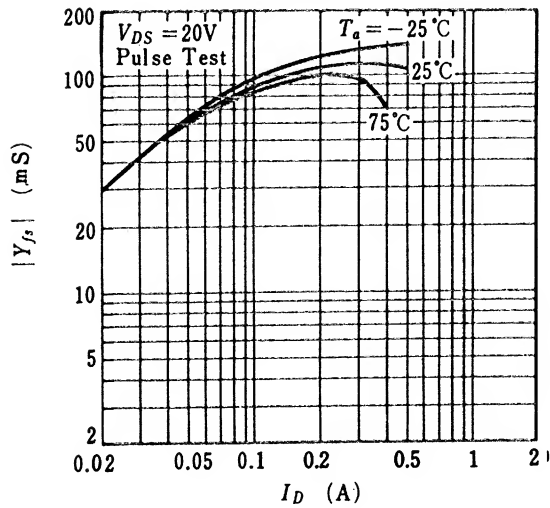
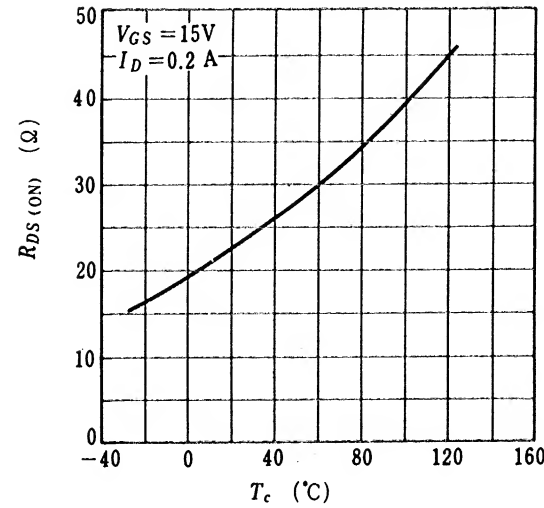
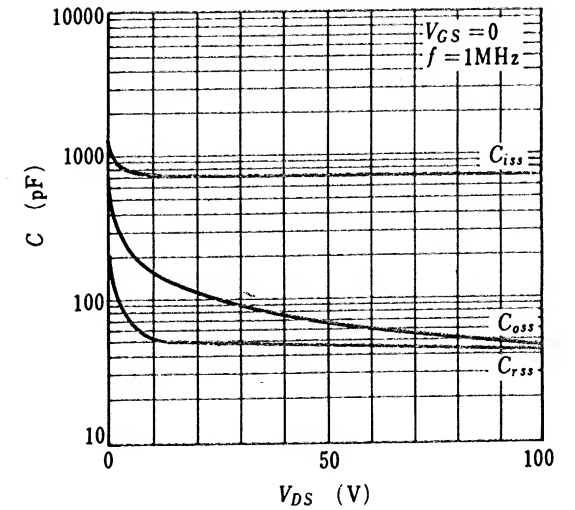
Si MOS型
Nチャンネル

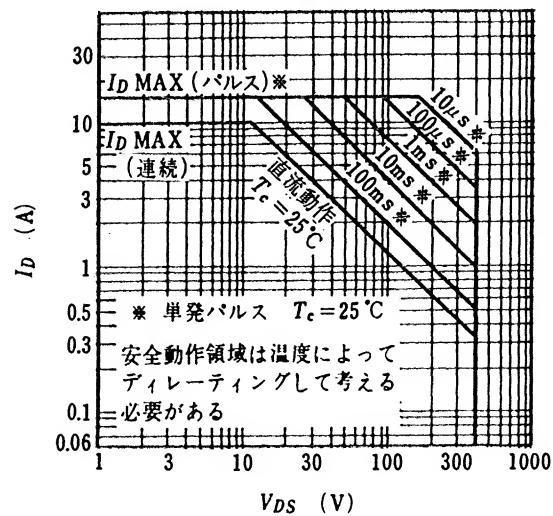
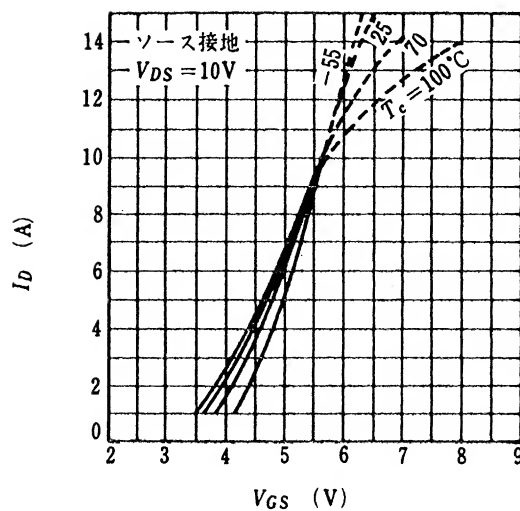
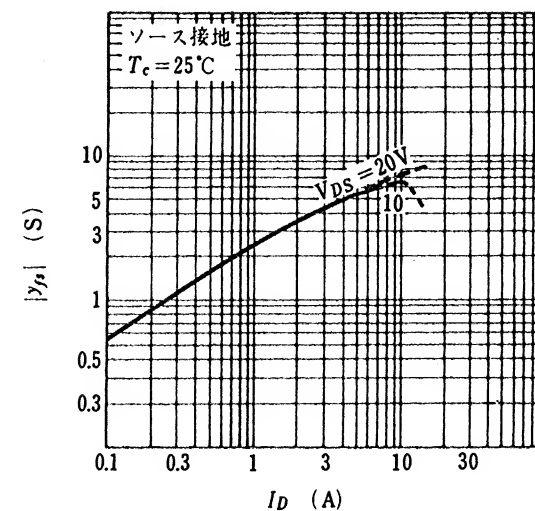
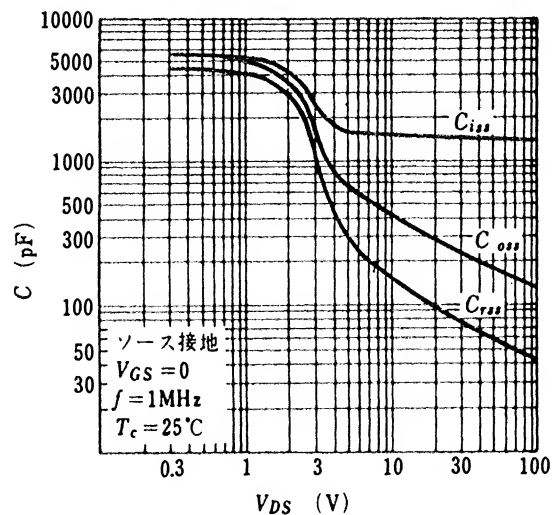
日　立

安全動作領域

伝達特性

$|Y_{fs}|$ - I_D 特性

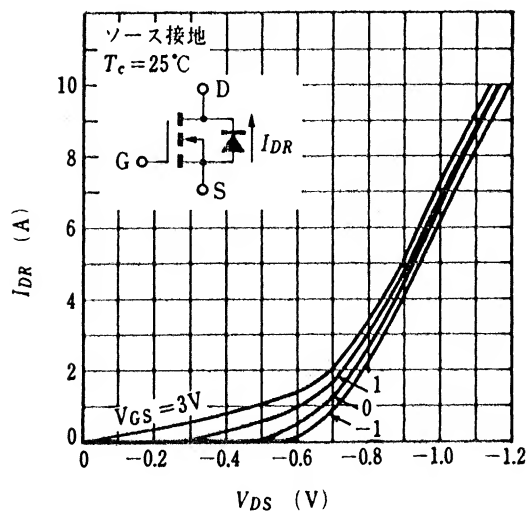
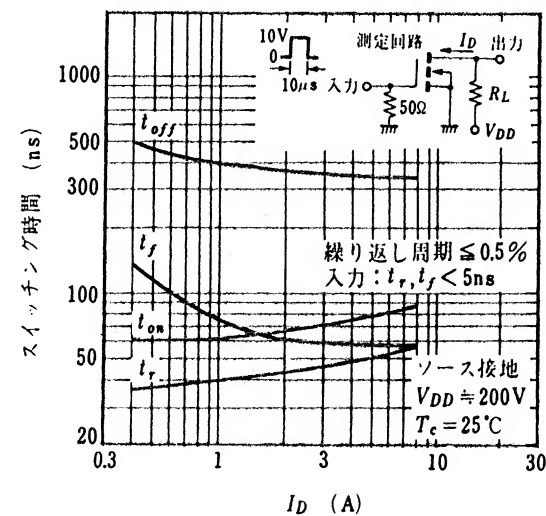
R_{DS}(ON) - T_c 特性

Ciss, Coss, Crss - V_{DS} 特性

$|Y_{fs}|$ - f 特性

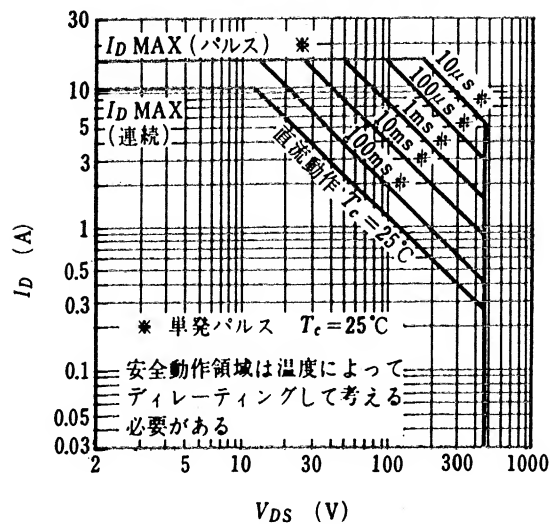
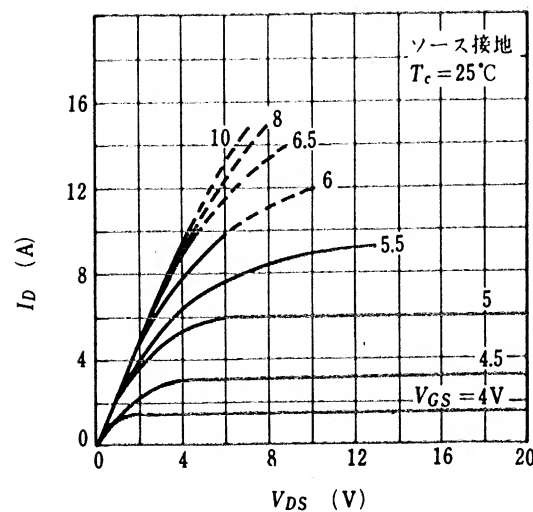
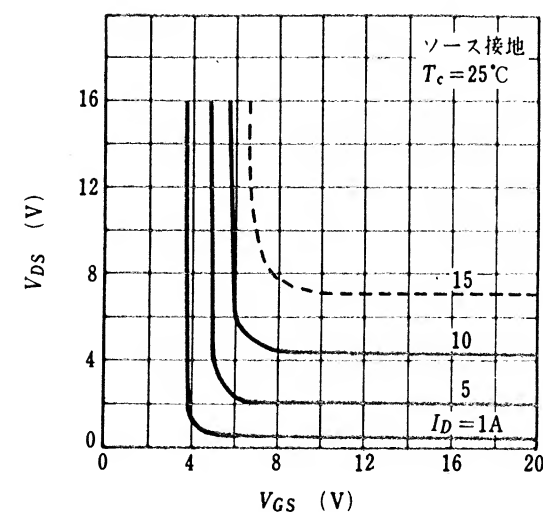
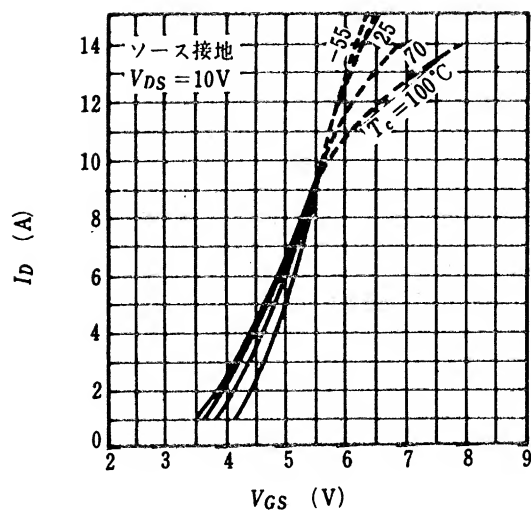
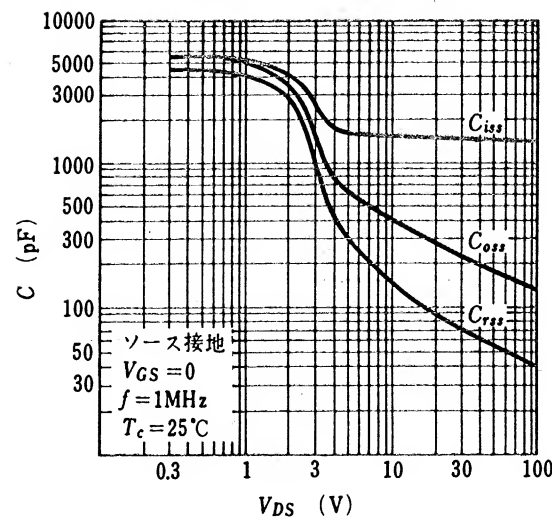
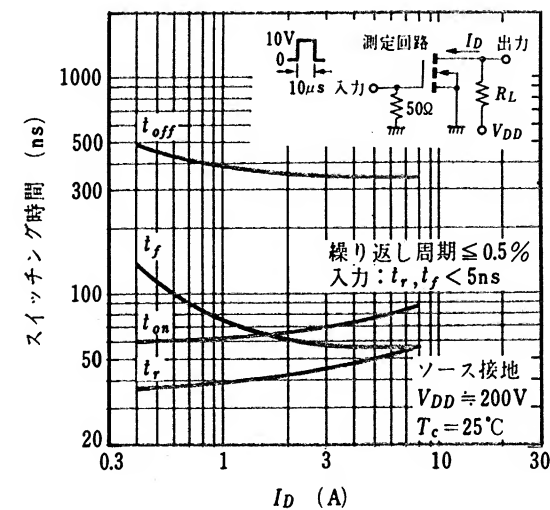
2SK384

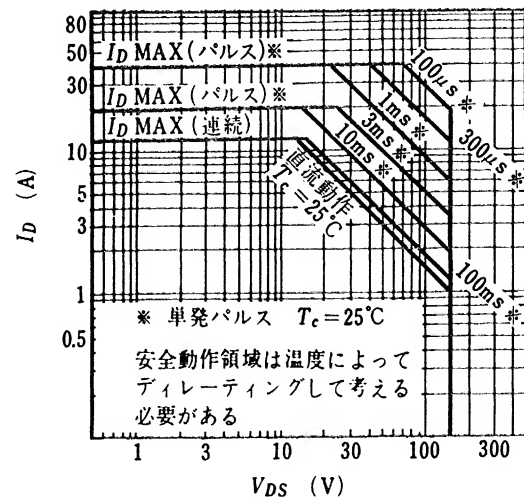
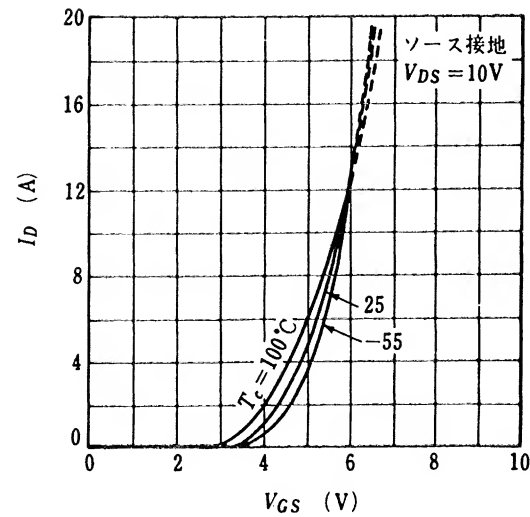
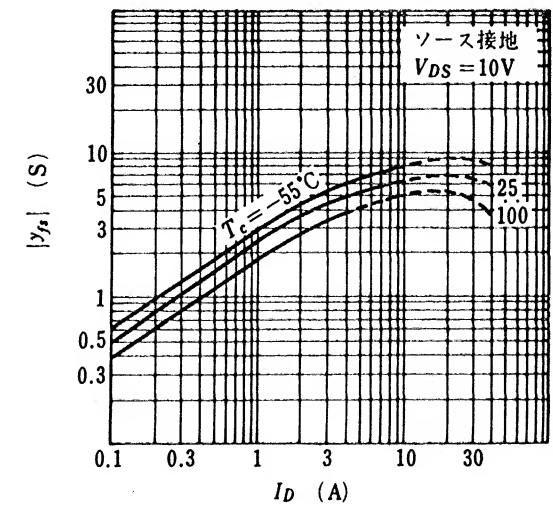
Si MOS型 Nチャンネル 日立

2SK385

Si MOS型 Nチャンネル　東　芝

安全動作領域

I_D - V_{GS} 特性

$|Y_{fs}|$ - I_D 特性

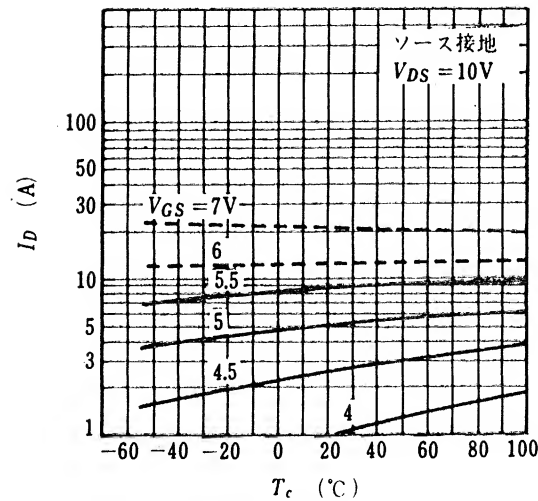
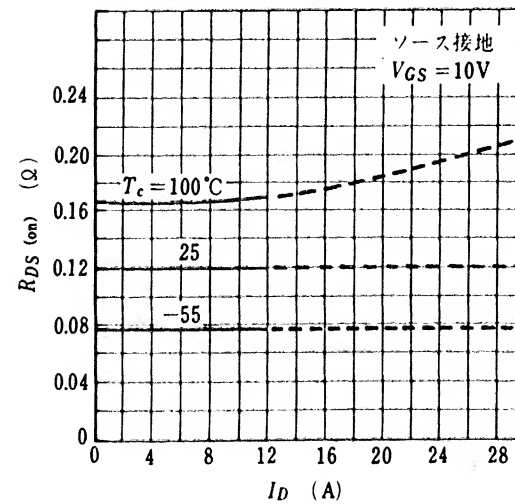
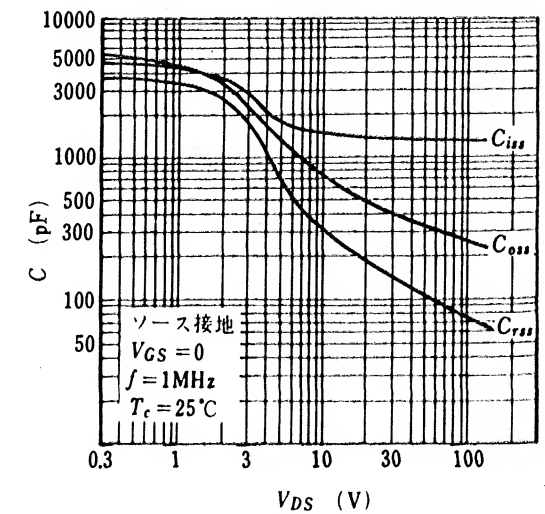
静電容量 - V_{DS} 特性

I_{DR} - V_{DS} 特性

スイッチング特性

2SK386

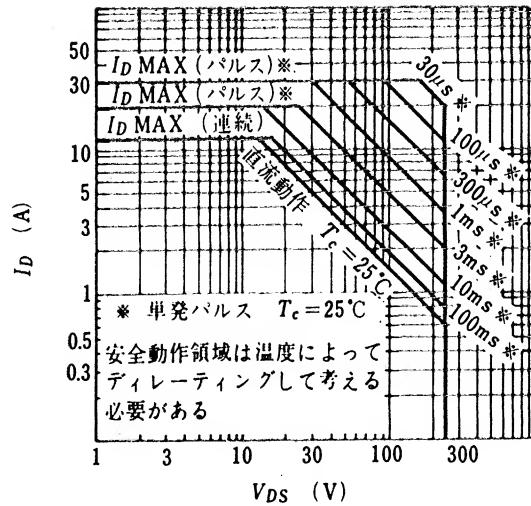
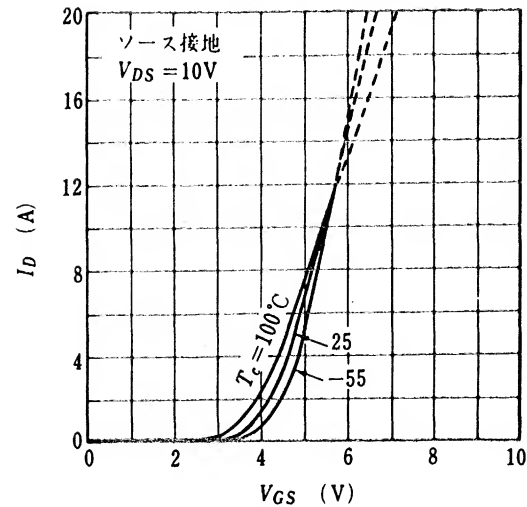
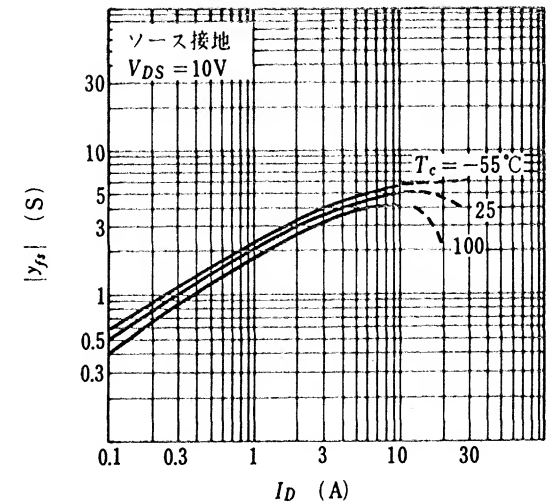
Si MOS型
Nチャンネル
東　芝

2SK387

Si MOS型 Nチャンネル　東芝

安全動作領域

I_D - V_{GS} 特性

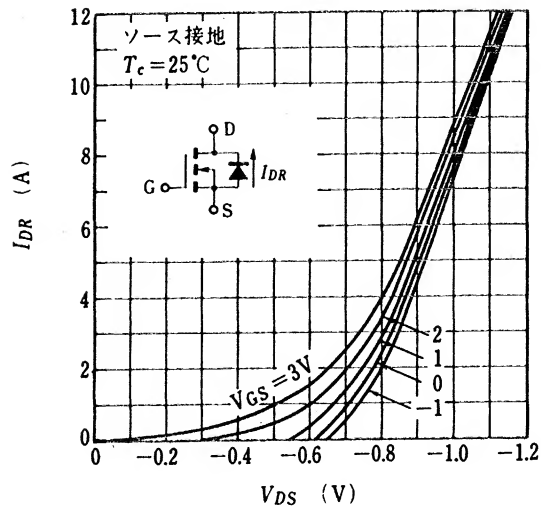
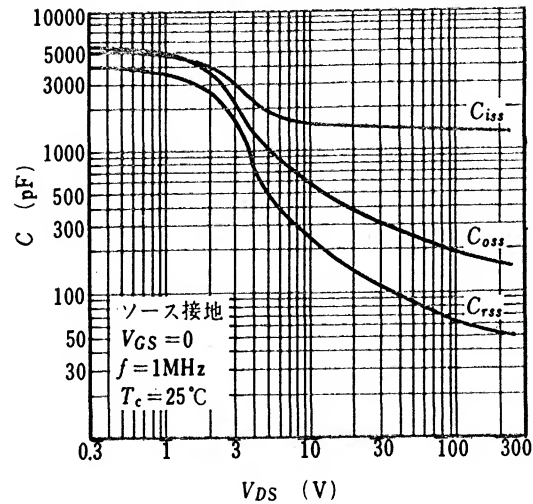
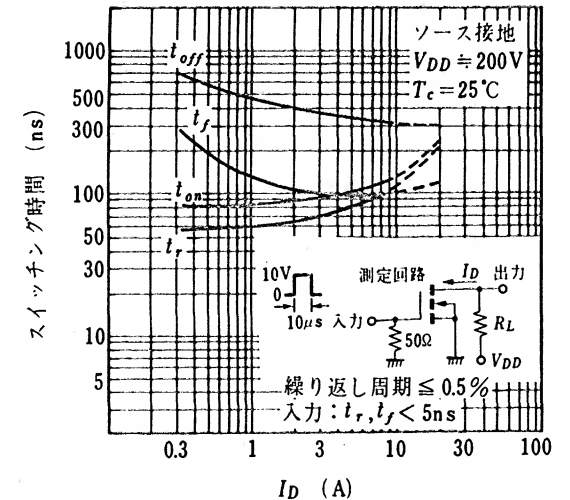
|Y_{fs}| - I_D 特性

I_D - T_C 特性

$R_{DS\,(on)}$ - I_D 特性

静電容量 - V_{DS} 特性

2SK388

Si MOS型 Nチャンネル　東　芝

安全動作領域

I_D - V_{GS} 特性

$|Y_{fs}|$ - I_D 特性

I_{DR} - V_{DS} 特性

静電容量 - V_{DS} 特性

スイッチング特性

2SK389

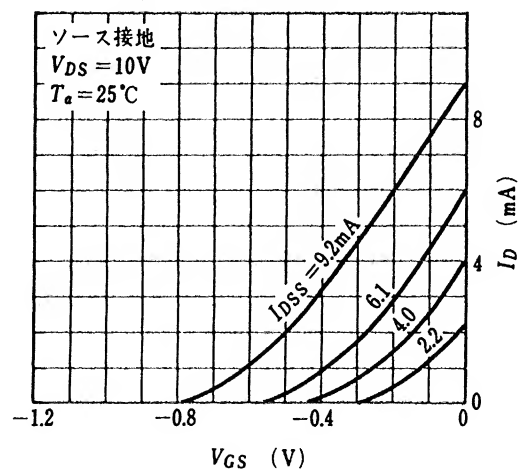
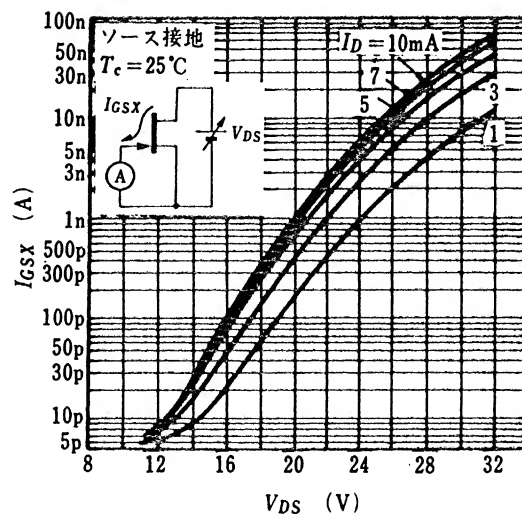
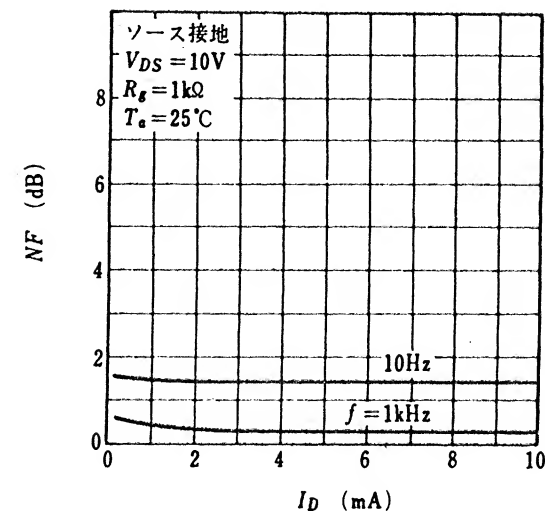
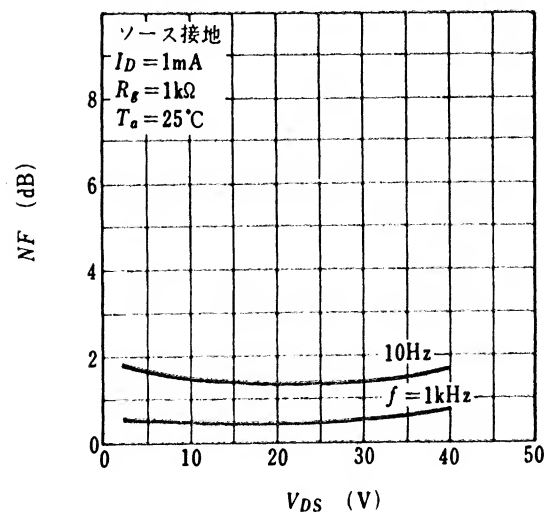
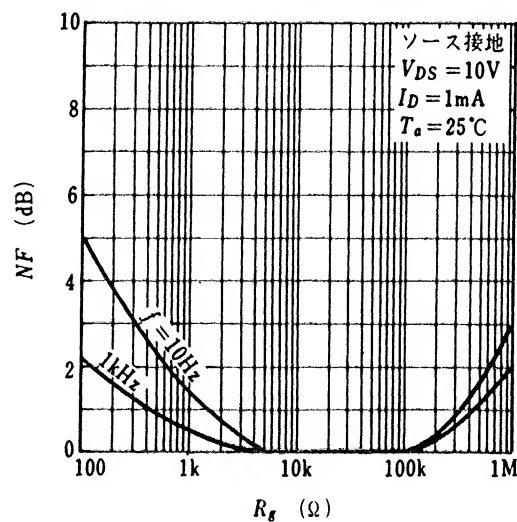
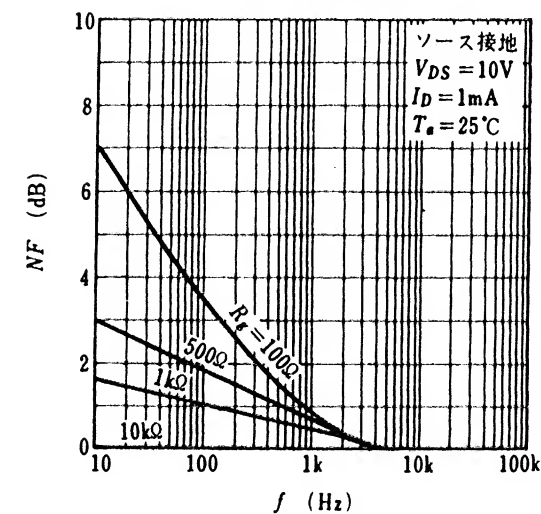
Si MOS型 複合Nチャンネル

東　芝

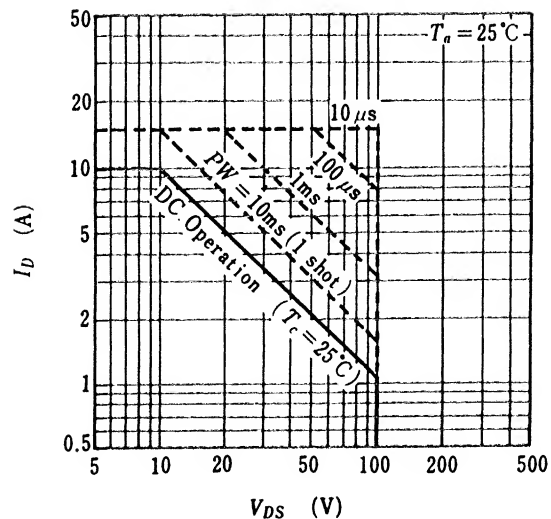
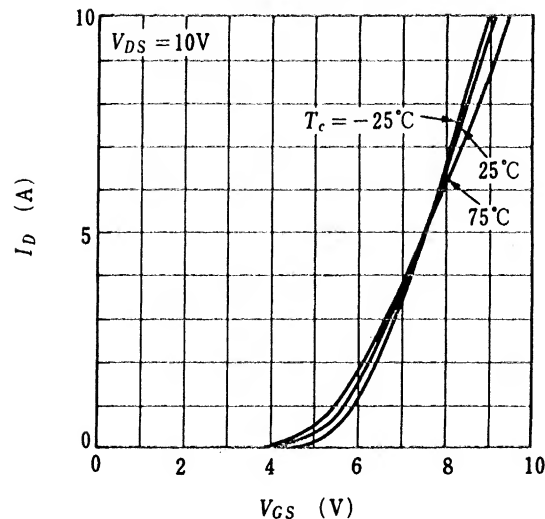
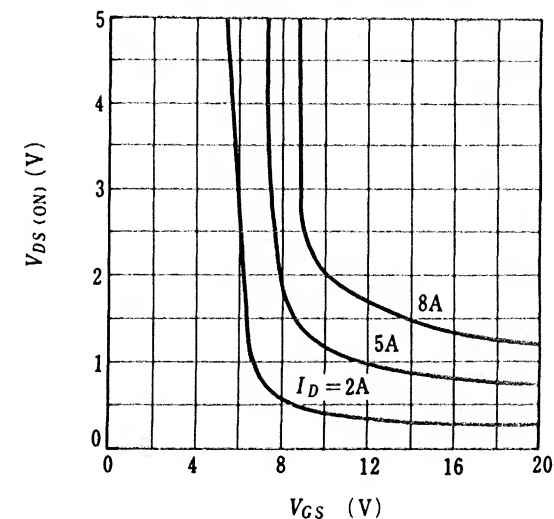
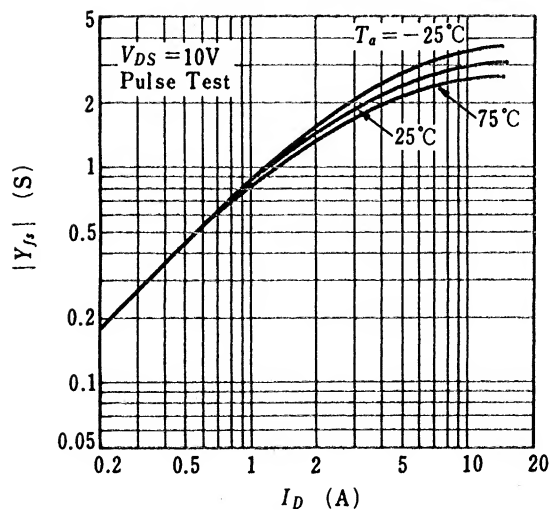
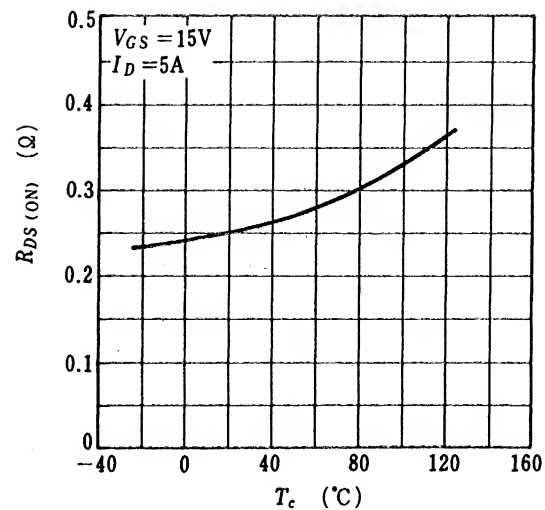
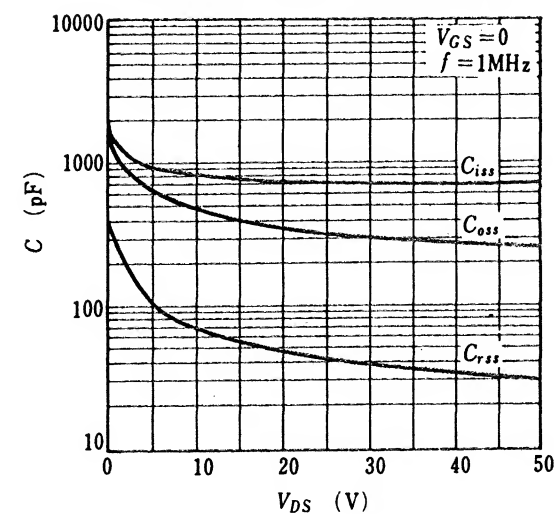
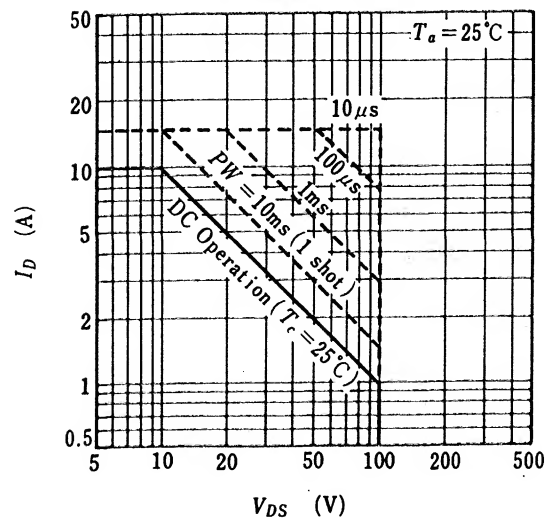
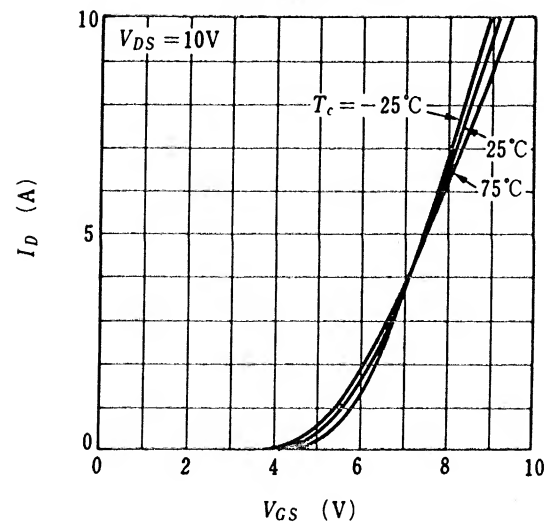
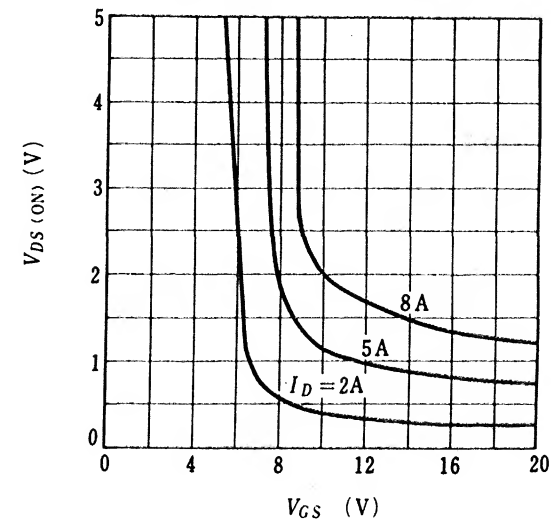
I_{DSS} 分類：GR＝2.6～6.5mA，BL＝6～12mA，V＝10～20mA

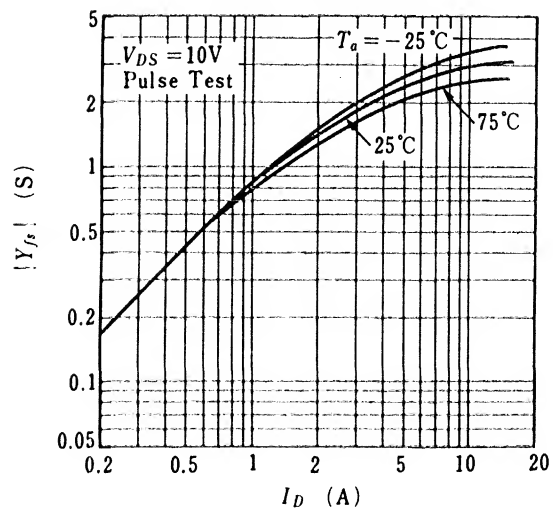
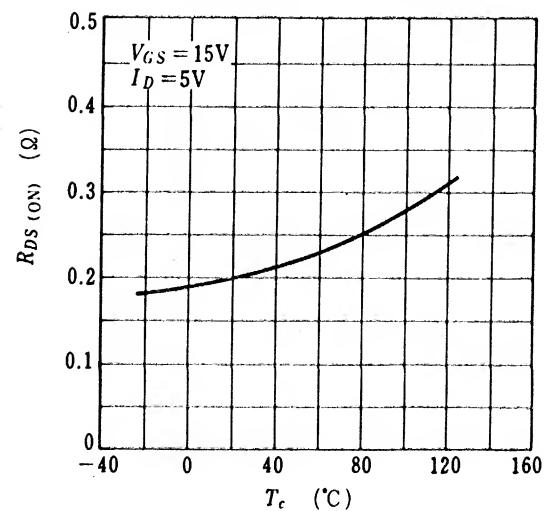
I_D - V_{GS} 特性

I_{GSX} - V_{DS} 特性

ソース接地
T_c＝25℃
I_{GSX}
V_{DS}
A
I_D＝10mA
7
5
3
1
100n
50n
30n
10n
5n
3n
1n
500p
300p
100p
50p
30p
10p
5p
8
12
16
20
24
28
32
I_{GSX} (A)
V_{DS} (V)

NF - I_D 特性

NF - V_{DS} 特性

NF - R_g 特性

NF - f 特性

2SK398

Si MOS型
Nチャンネル

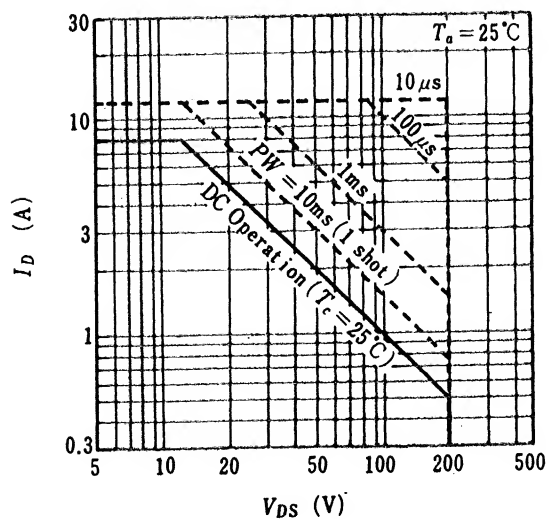
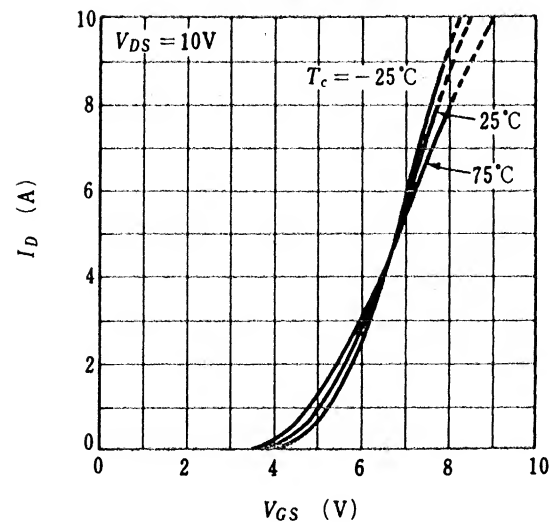
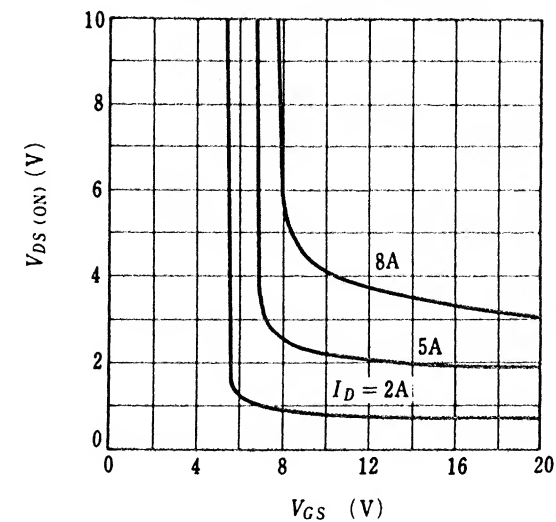
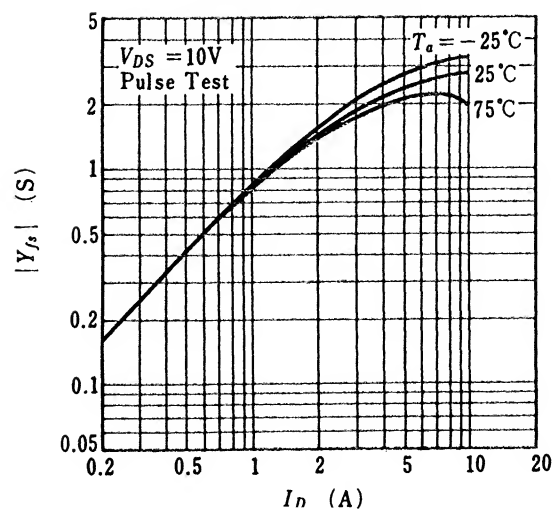
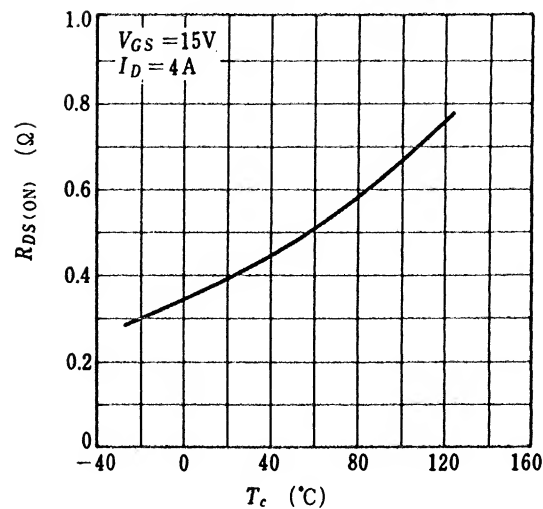
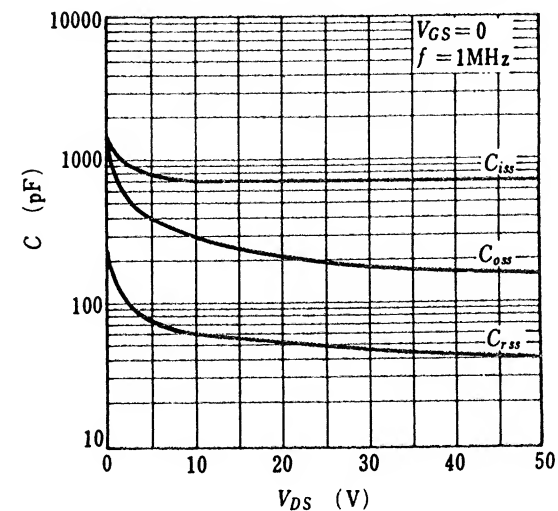
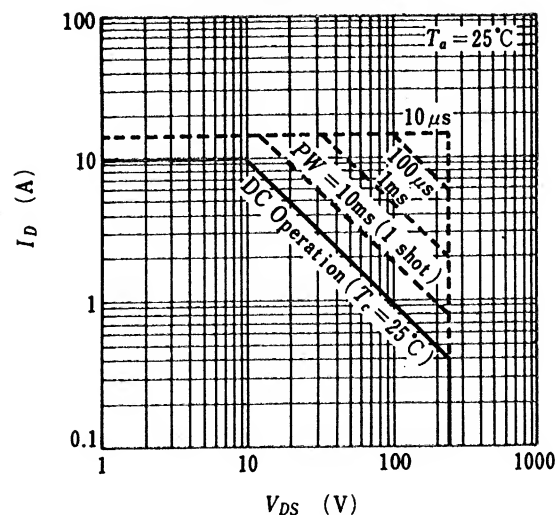
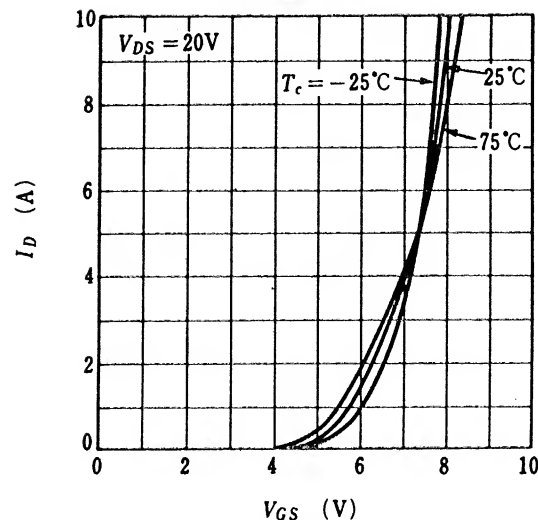
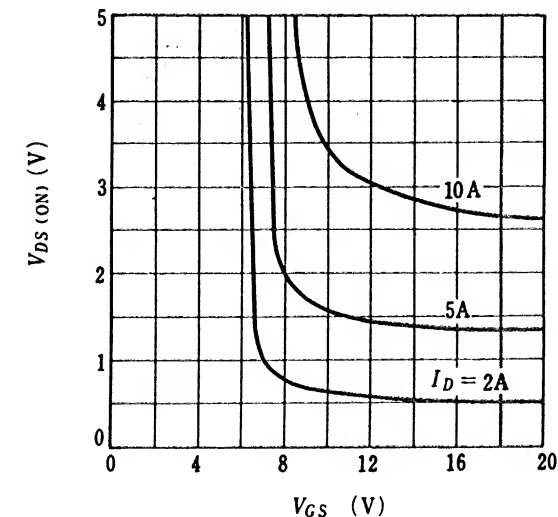
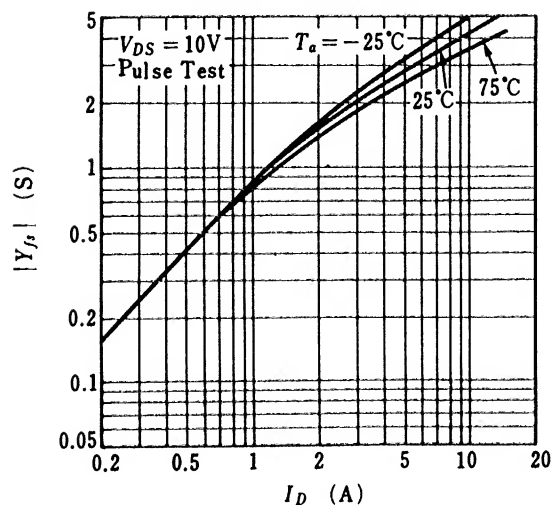
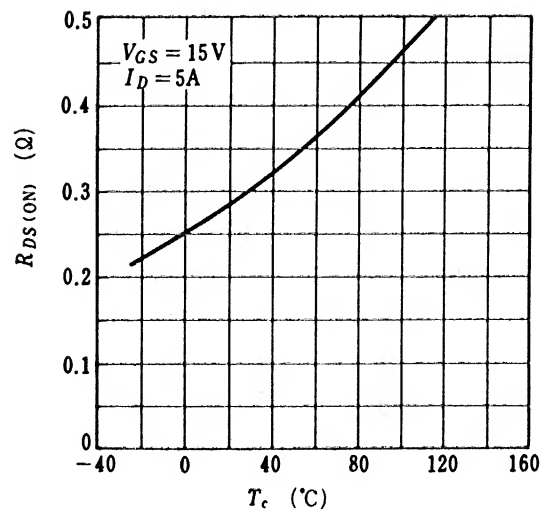
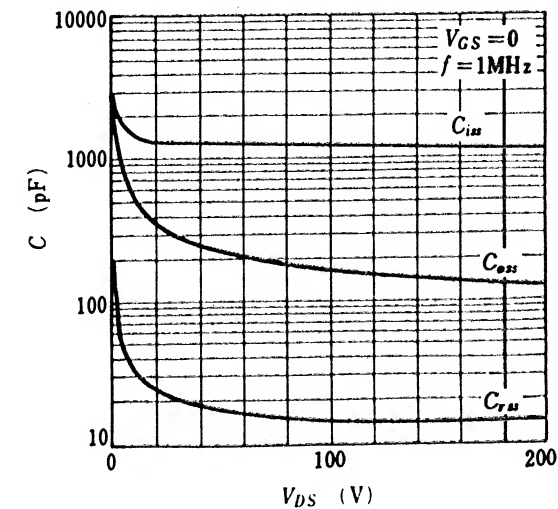
日　立

2SK399

Si MOS型 Nチャンネル 日 立

伝 達 特 性

$V_{DS(ON)}$ - V_{GS} 特 性

$|Y_{fs}|$ - I_D 特 性

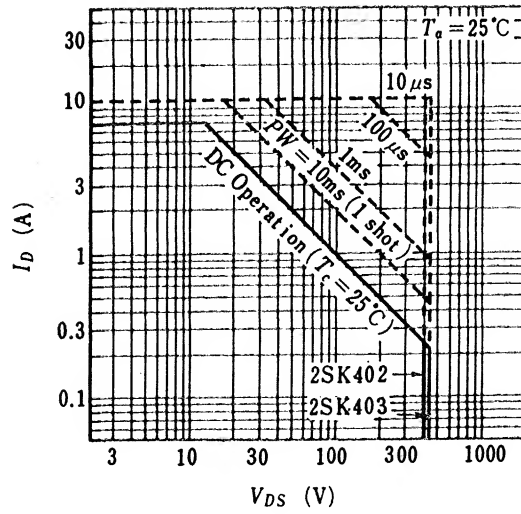
$R_{DS(ON)}$ - T_c 特 性

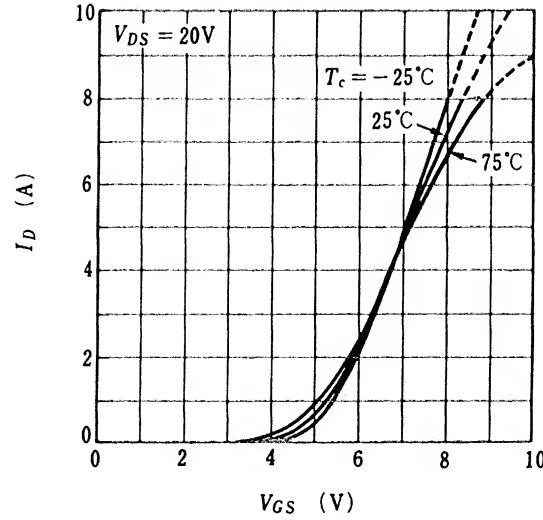
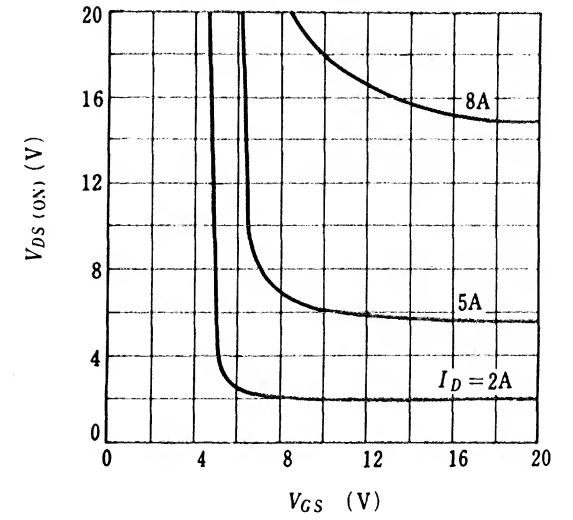
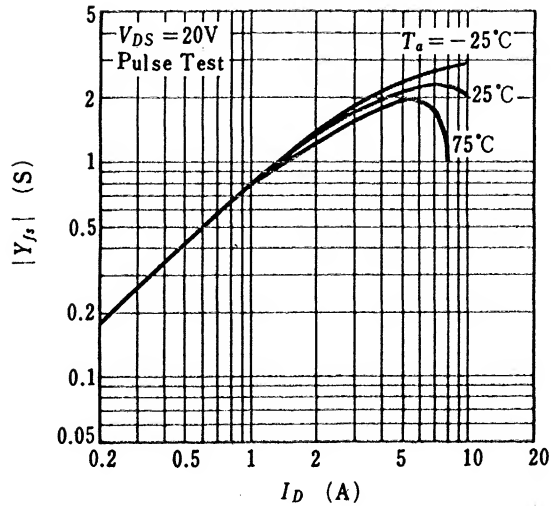
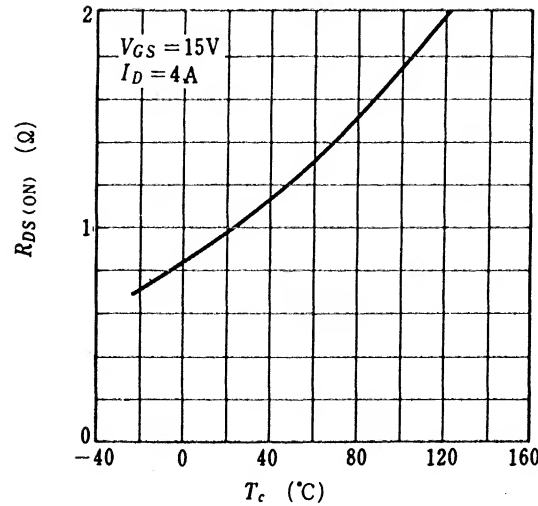
C_{iss}, C_{oss}, C_{rss} - V_{DS} 特 性

2SK400

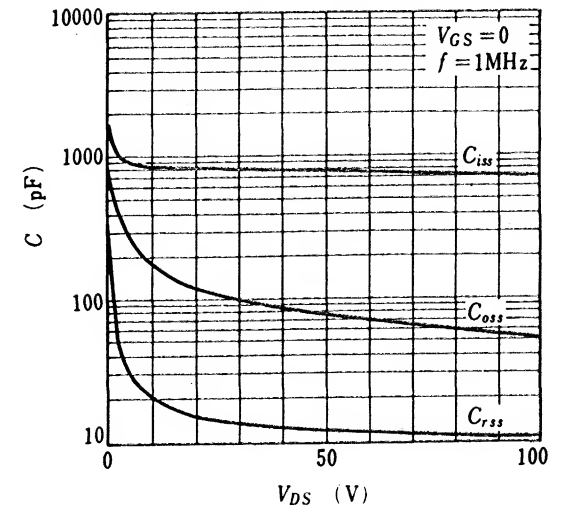
Si MOS型
Nチャンネル

日 立

2SK401

Si MOS型 Nチャンネル 　　　　日　立

2SK402, 403

Si MOS型 Nチャンネル　日立

安全動作領域

伝達特性

$V_{DS(ON)}$ - V_{GS} 特性

$|Y_{fs}|$ - I_D 特性

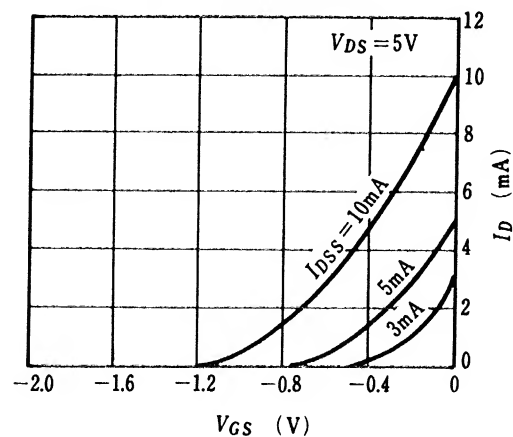
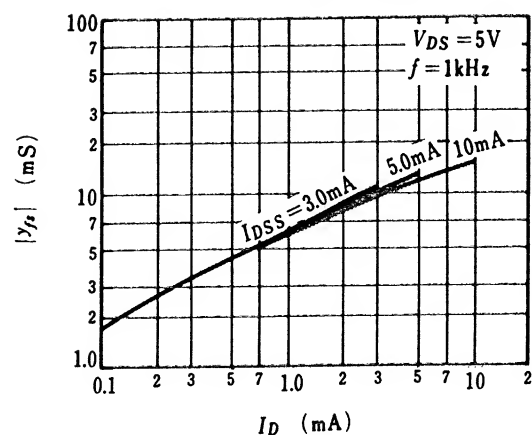
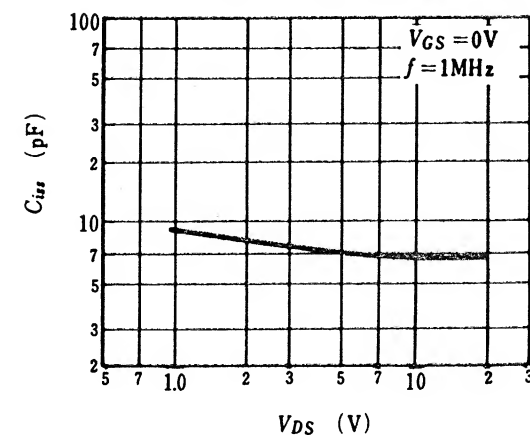
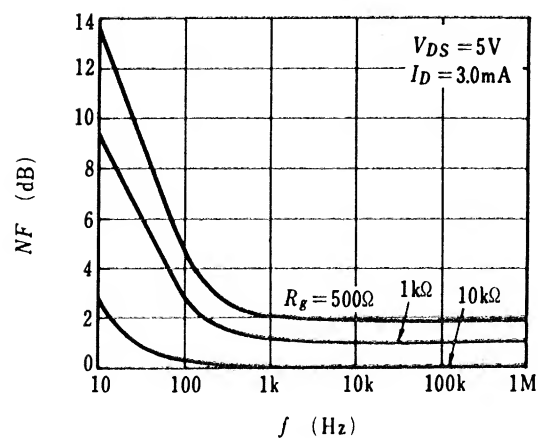
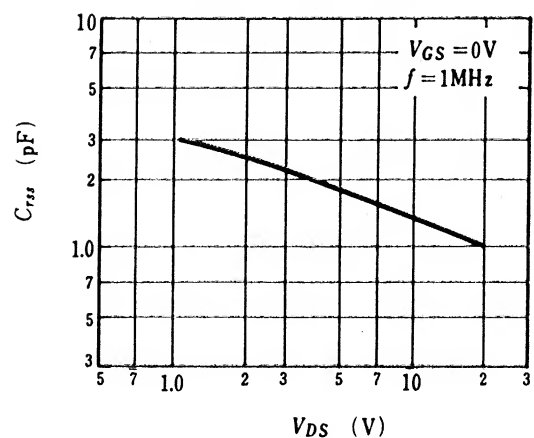
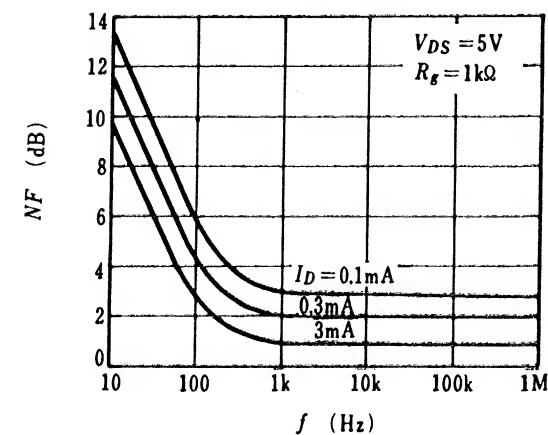
$R_{DS(ON)}$ - T_c 特性

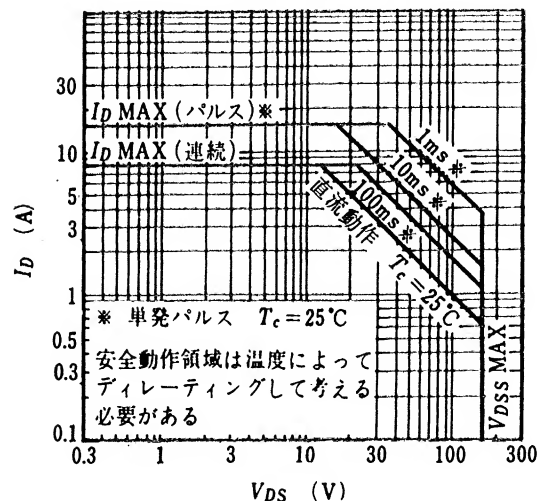
C_{iss}, C_{oss}, C_{rss} - V_{DS} 特性

2SK404

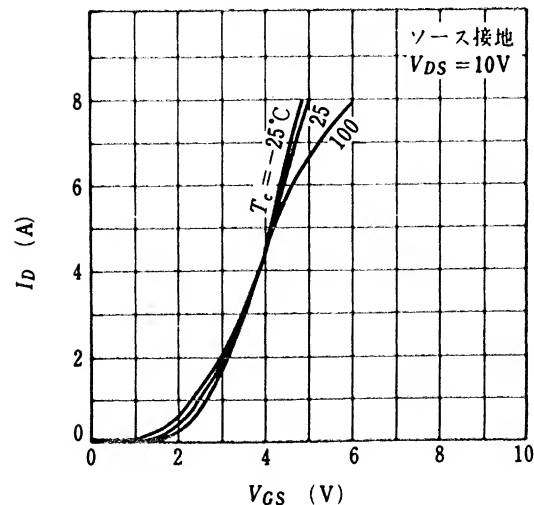
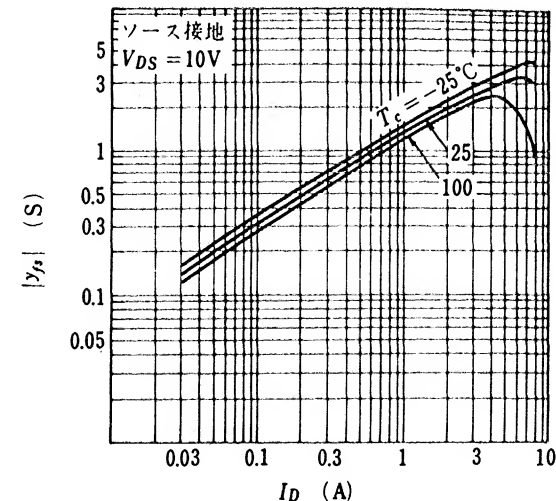
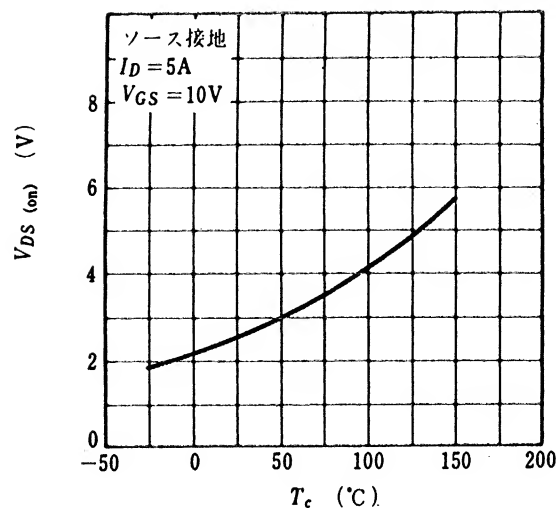
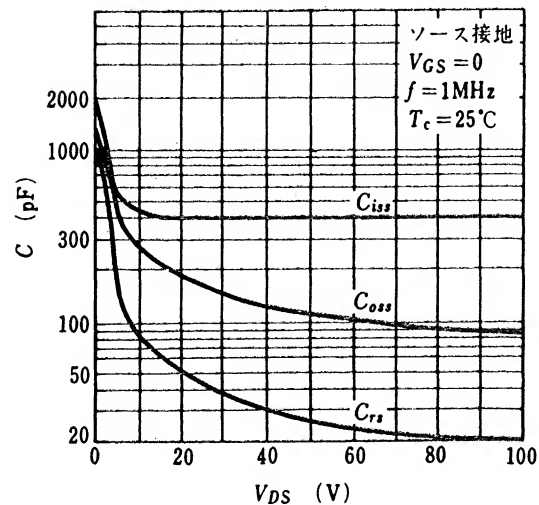
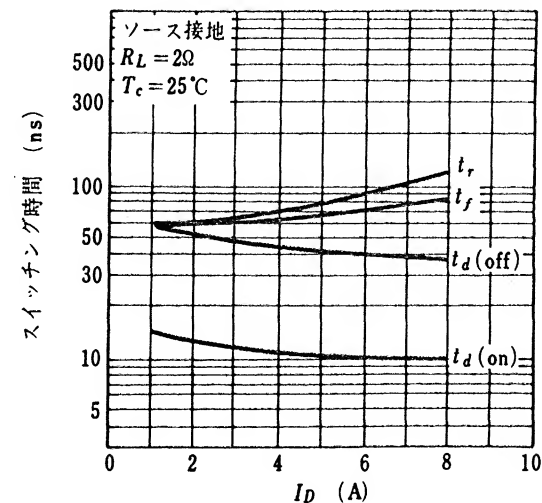
Si 接合型
Nチャンネル

三　洋

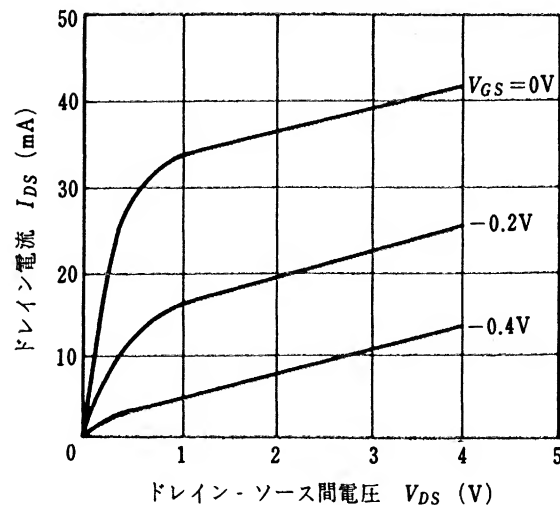
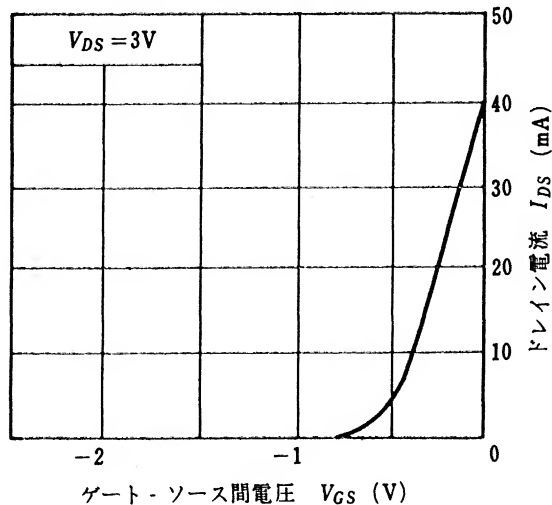
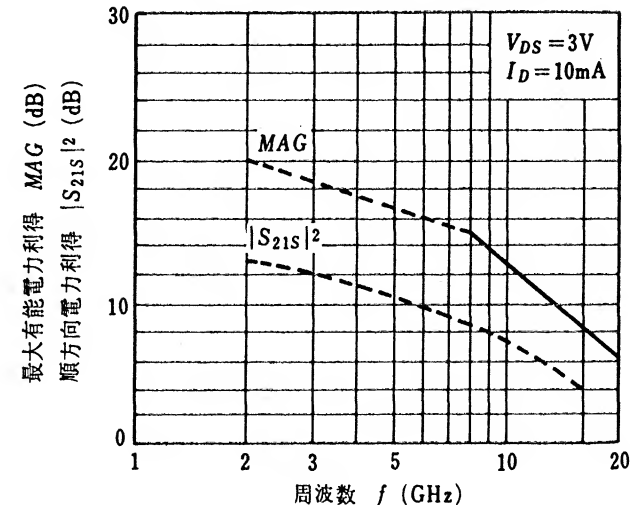
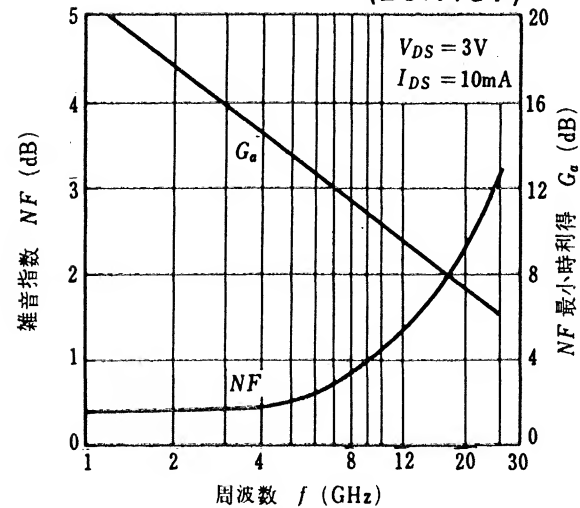
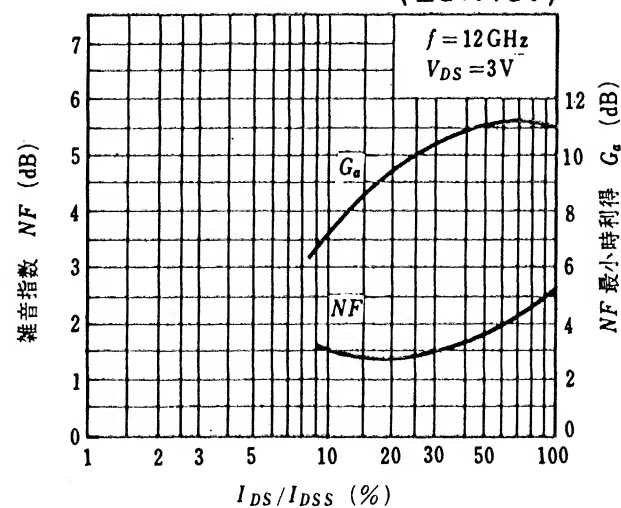
V_{DS}＝5V により次のように分類している.

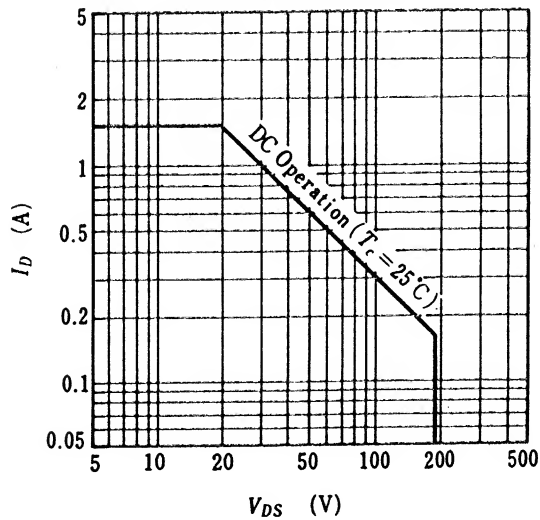
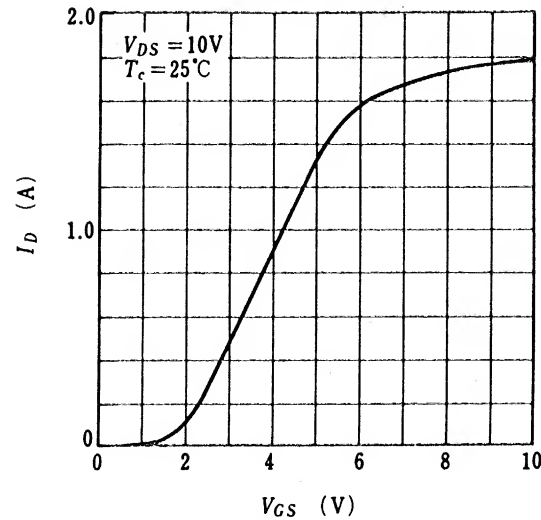
1.2	D	3.0	2.5	E	6.0	5.0	F	12.0

2SK405

Si MOS型 Nチャンネル 東　芝

安全動作領域

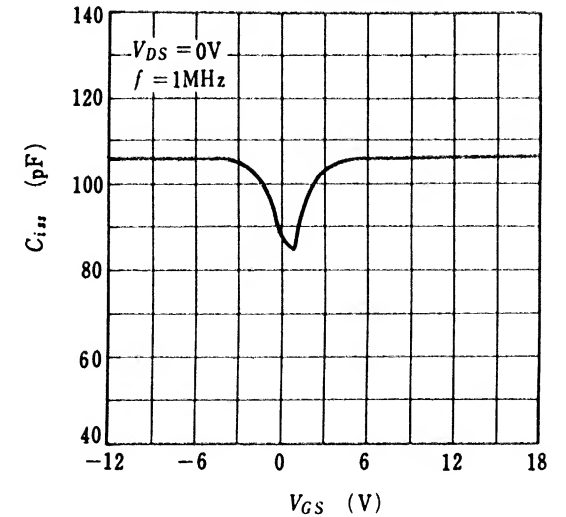
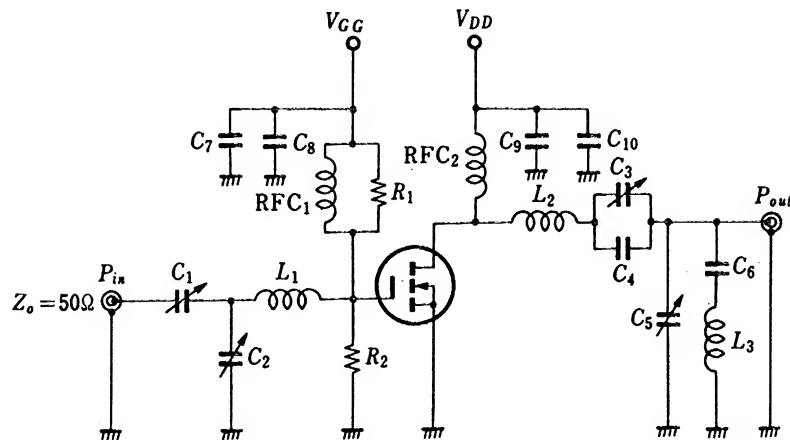
I_D - V_{GS} 特性

$|Y_{fs}|$ - I_D 特性

$V_{DS(on)}$ - T_C 特性

静電容量 - V_{DS} 特性

スイッチング特性

2SK406, 407

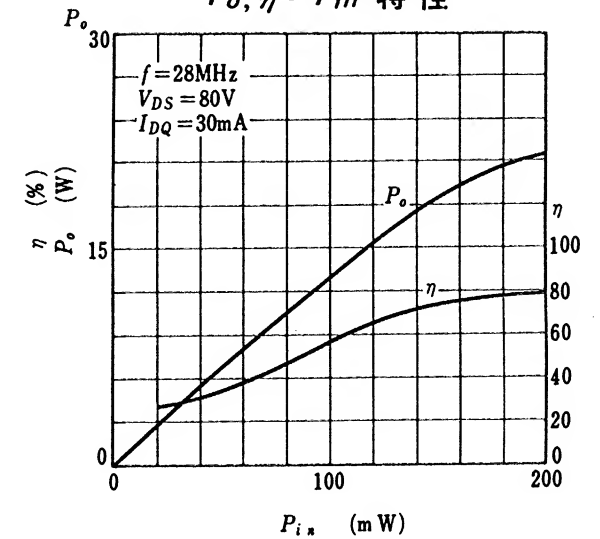
GaAs 型 Nチャンネル　日電

I_{DS} - V_{DS} 特性

I_{DS} - V_{GS} 特性

MAG, $|S_{21S}|^2$ - f 特性

NF, Ga - f 特性 (2SK407)

NF, Ga - I_{DS}/I_{DSS} 特性 (2SK407)

2SK408, 409

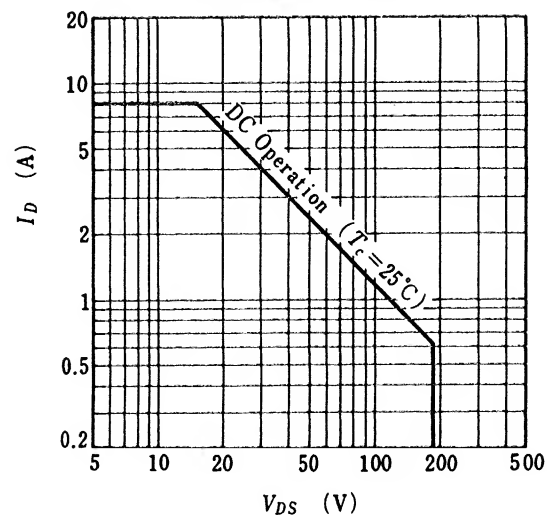
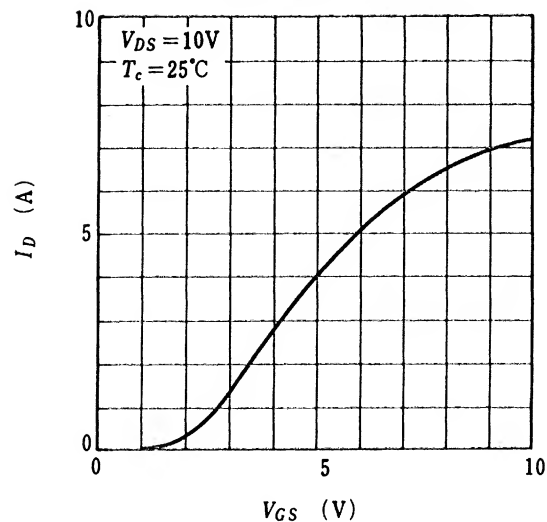
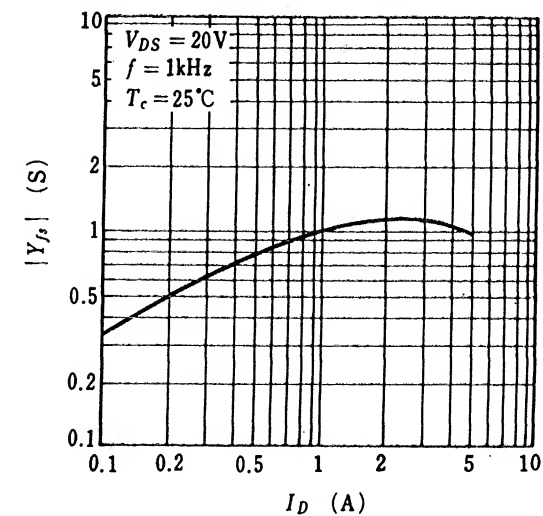
Si MOS型 Nチャンネル　日立

安全動作領域

伝達特性

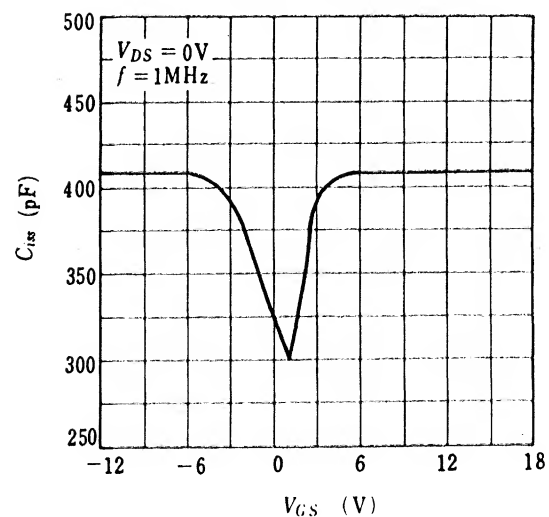
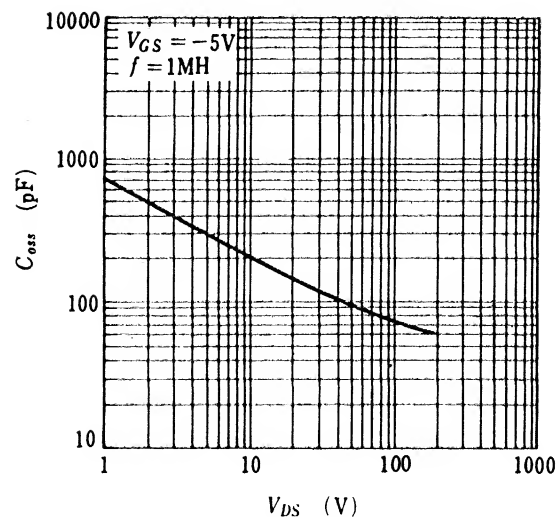
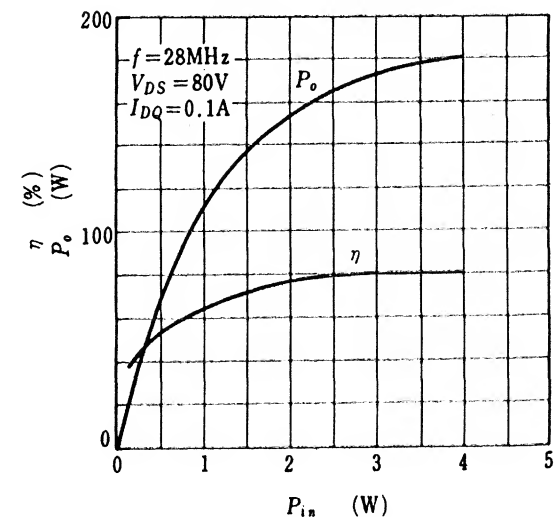
C_{iss} - V_{GS} 特性

28MHz 電力測定回路

C_1, C_2, C_3=～50pF
C_4=68pF
C_5=～20pF
C_6=1.5pF
C_7, C_9=0.1μF
C_8=4.7μF
C_{10}=22μF
L_1：ID=12mm, d=1.5mm, T=6T
L_2：ID=12mm, d=1.5mm, T=9T
L_3：ID=12mm, d=1.5mm, T=5T

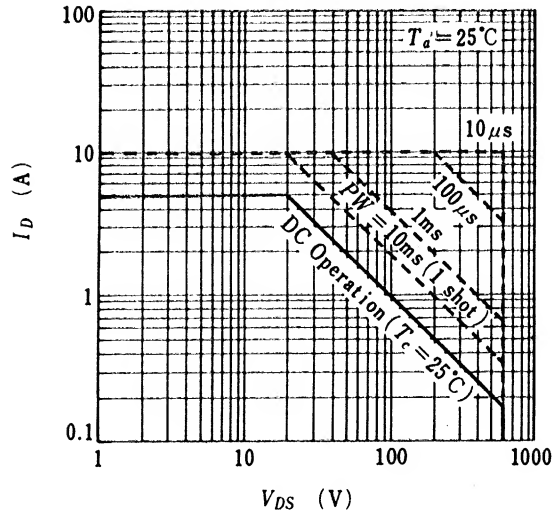
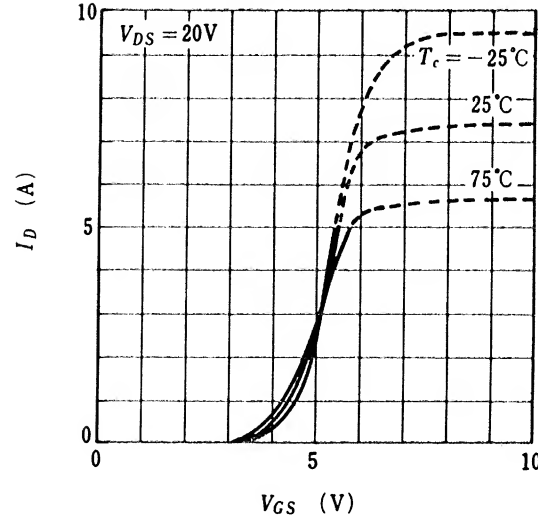
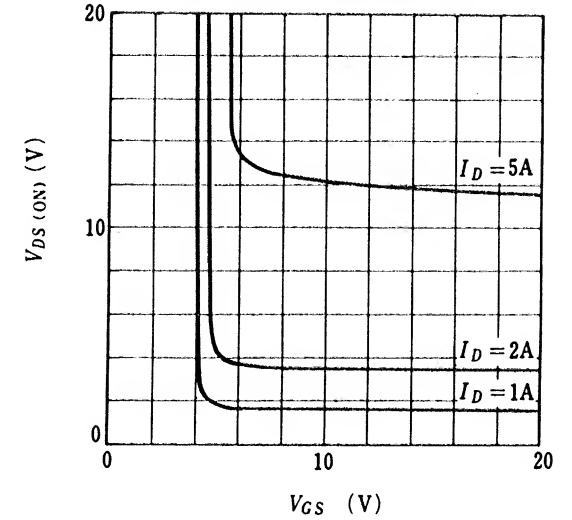
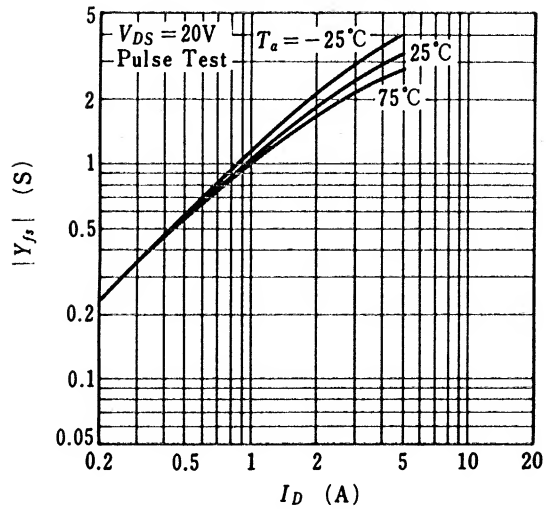
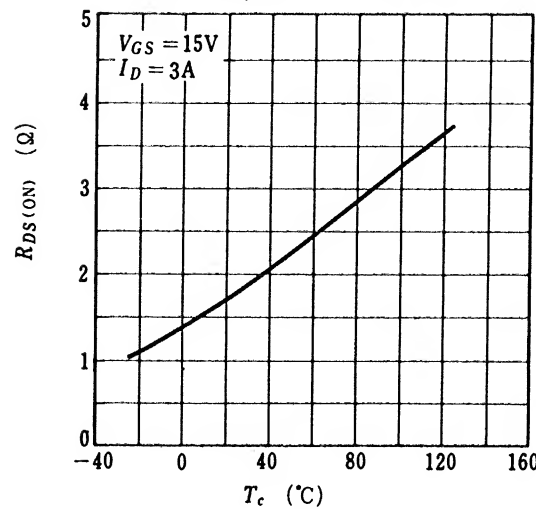
P_o, η - P_{in} 特性

2SK410

Si MOS型
Nチャンネル

日　立

安全動作領域

伝達特性

|Yfs| - ID 特性

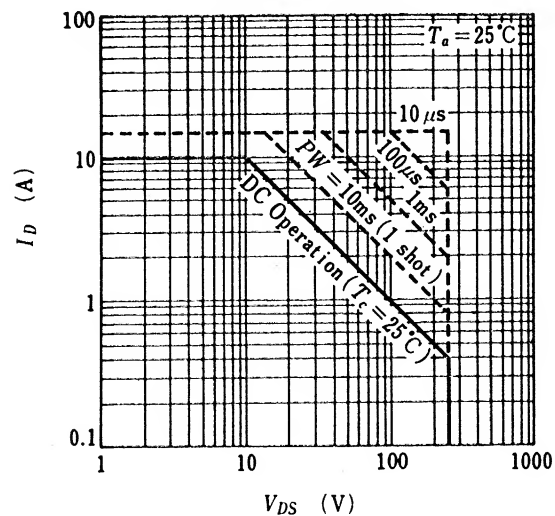
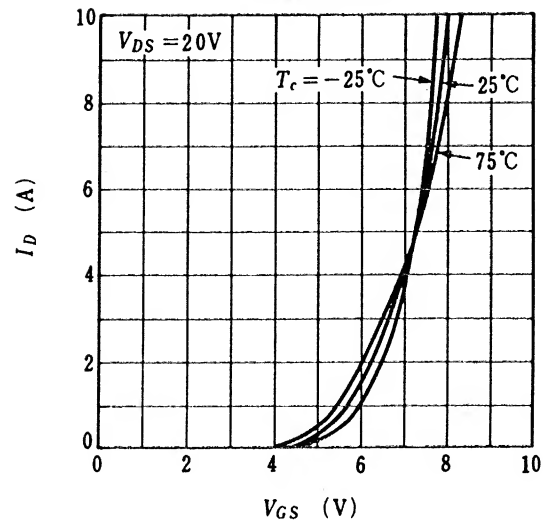
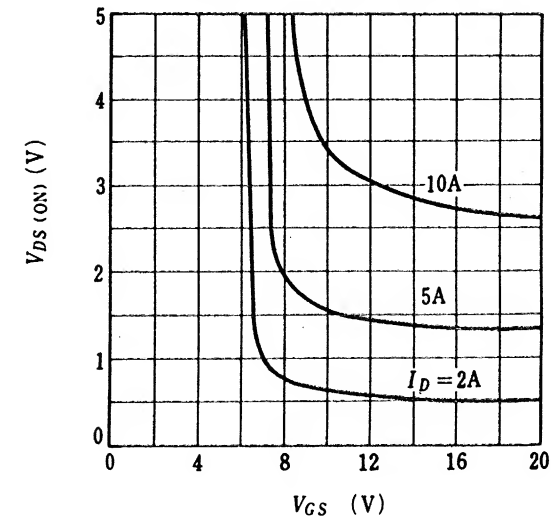
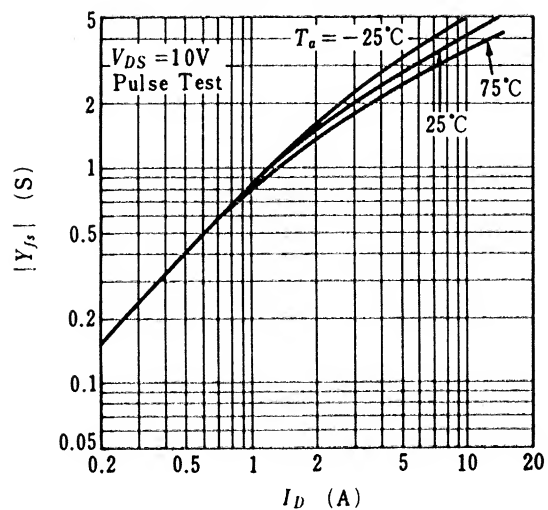
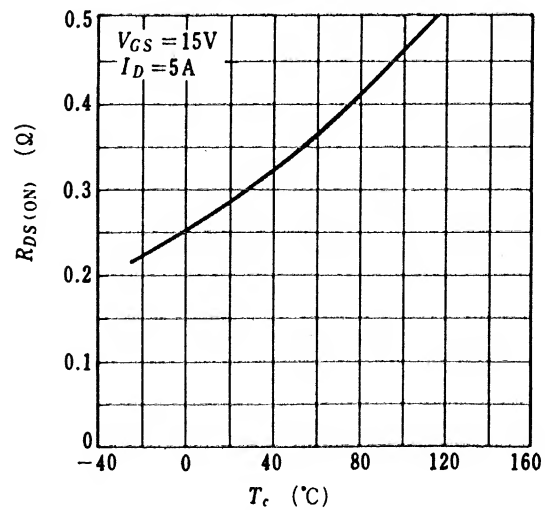
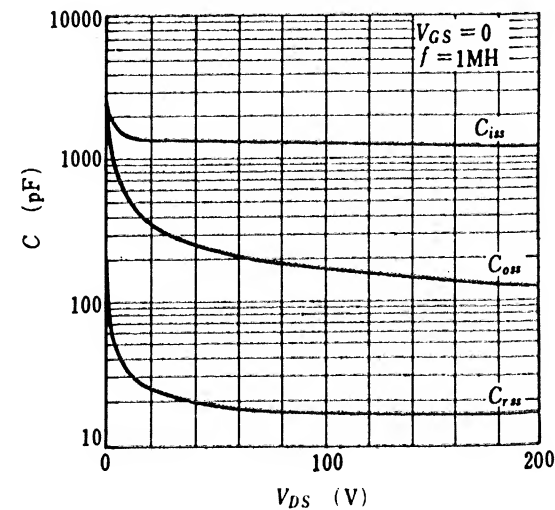
Ciss - VGS 特性

Coss - VDS 特性

Po, η - Pin 特性

2SK411

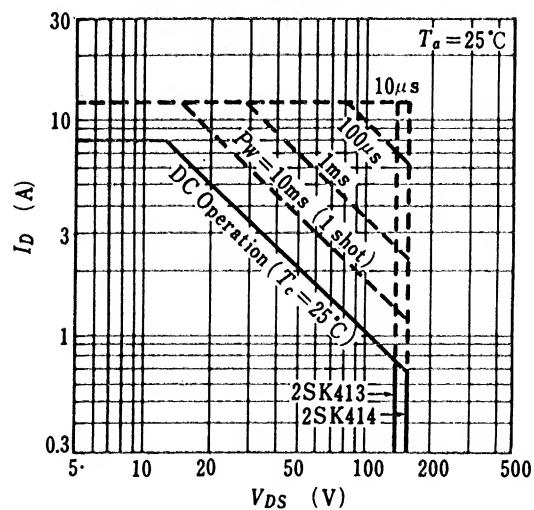
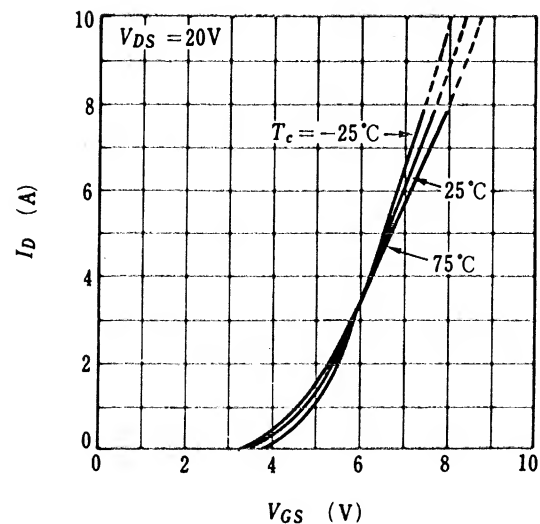
Si MOS型 Nチャンネル 日 立

V_{DS} (ON) - V_{GS} 特性

|Y_{fs}| - I_D 特性

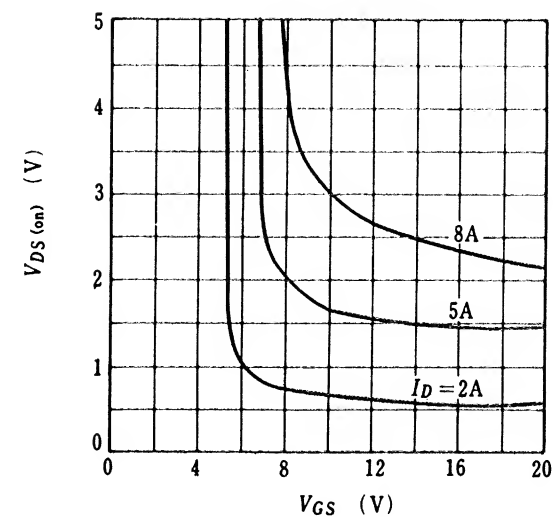
R_{DS} (ON) - T_c 特性

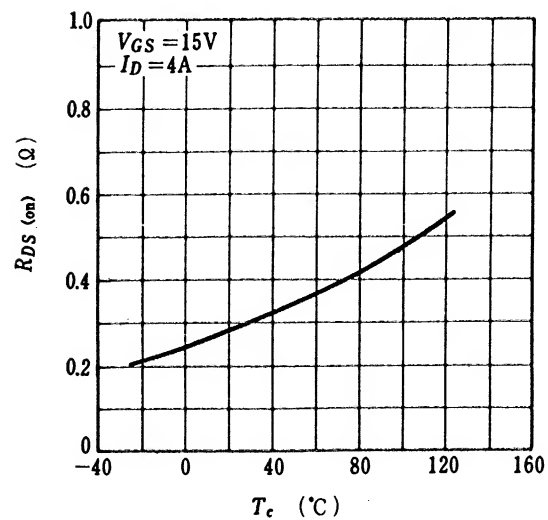
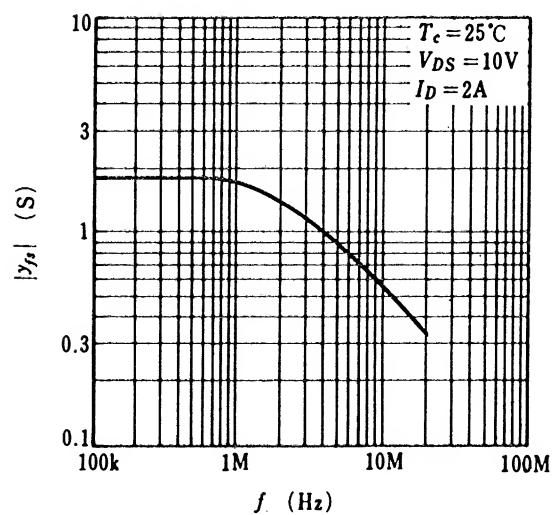
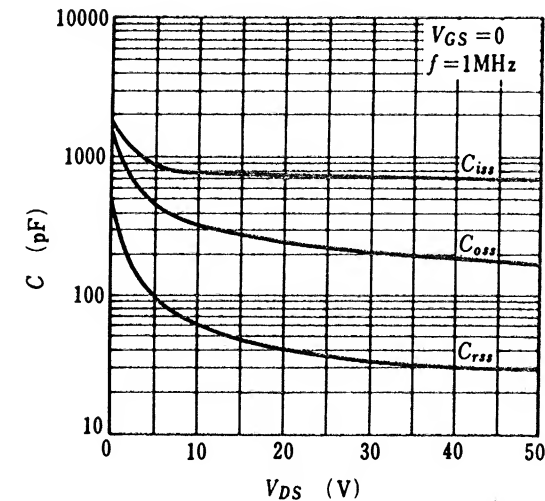
C_{iss}, C_{oss}, C_{rss} - V_{DS} 特性

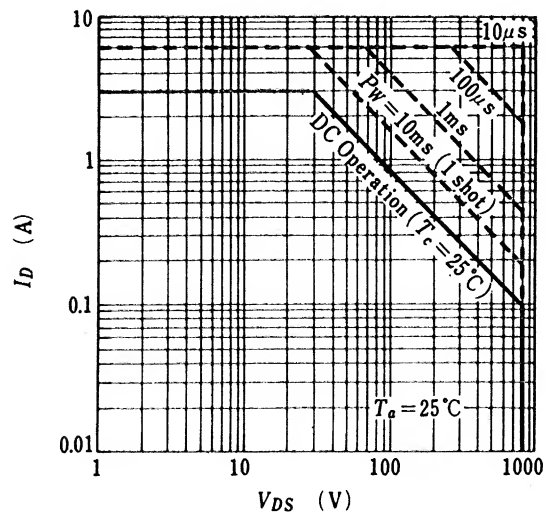
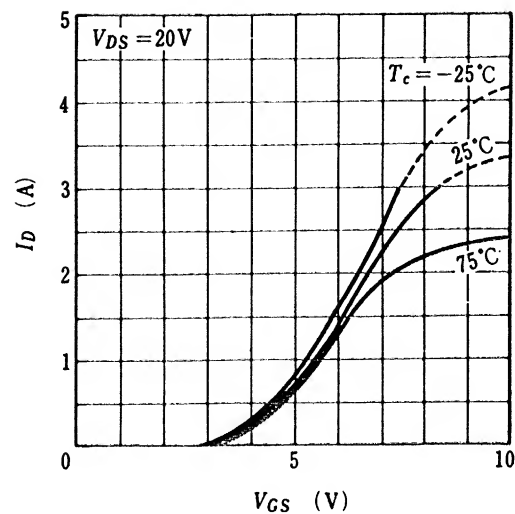
2SK412

Si MOS型 Nチャンネル　日立

2SK413, 414

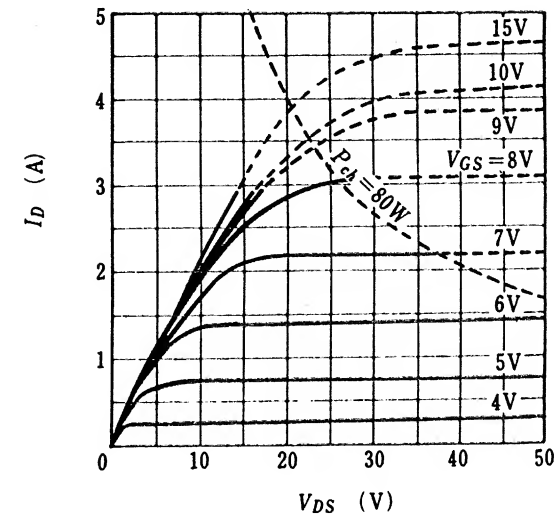
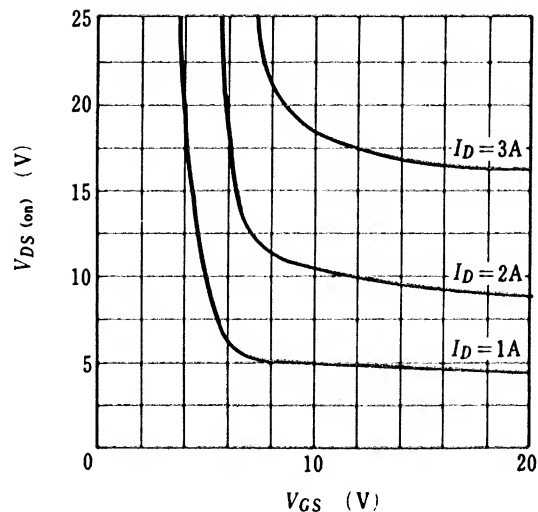
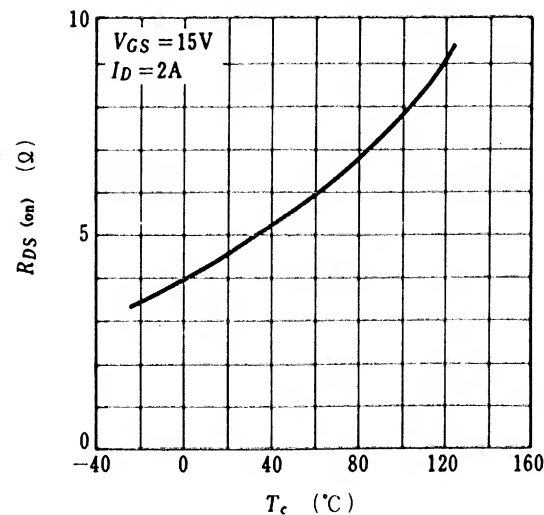
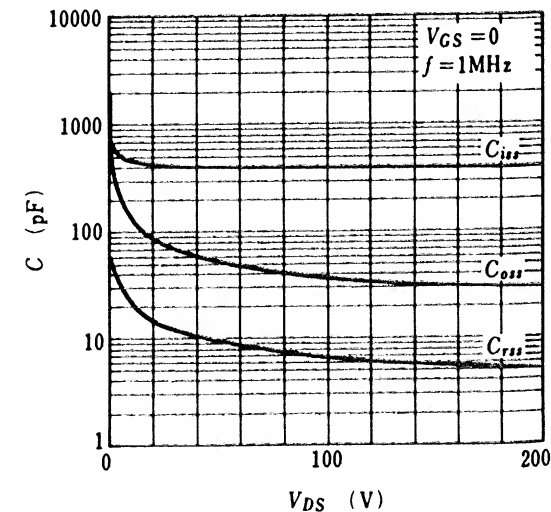
Si MOS型 Nチャンネル　日立

安全動作領域

I_D - V_{GS} 特性

$V_{DS(on)}$ - V_{GS} 特性

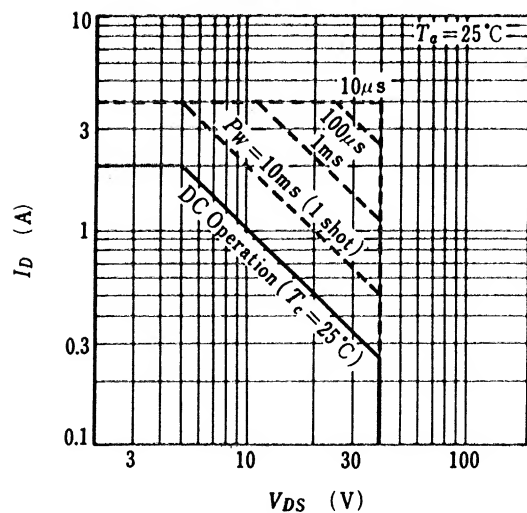
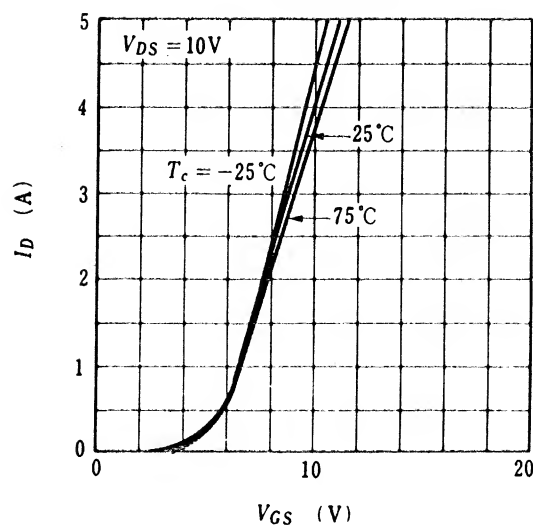
$P_{DS(on)}$ - T_c 特性

$|y_{fs}|$ - f 特性

C_{iss}, C_{oss}, C_{rss} - V_{DS} 特性

2SK415

Si MOS型 Nチャンネル　日立

安全動作領域

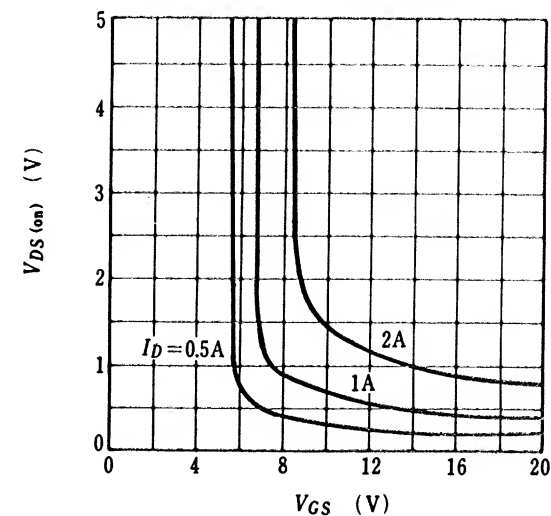
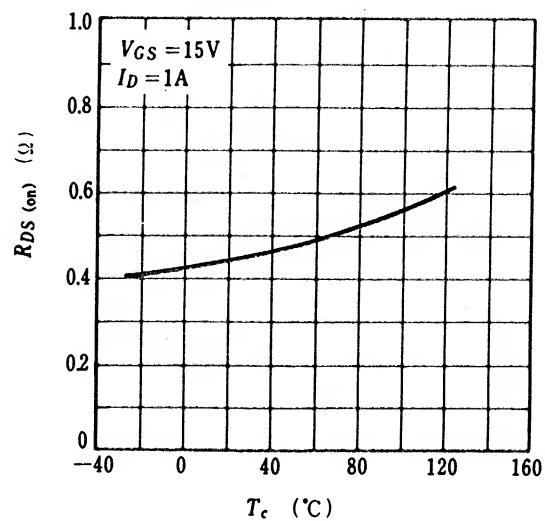
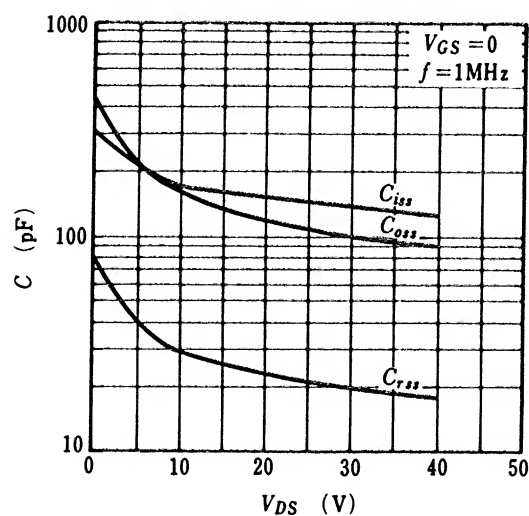
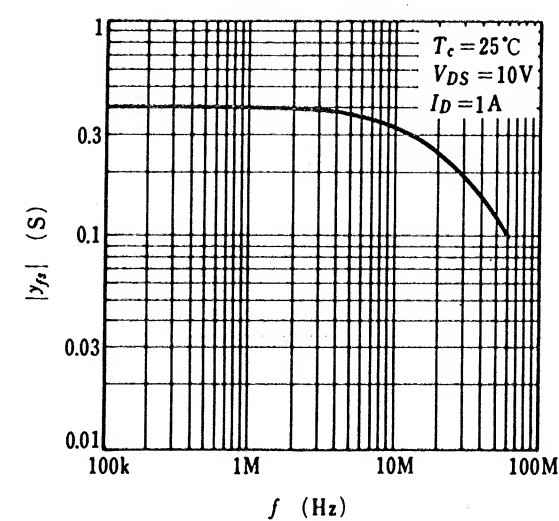
I_D - V_{GS} 特性

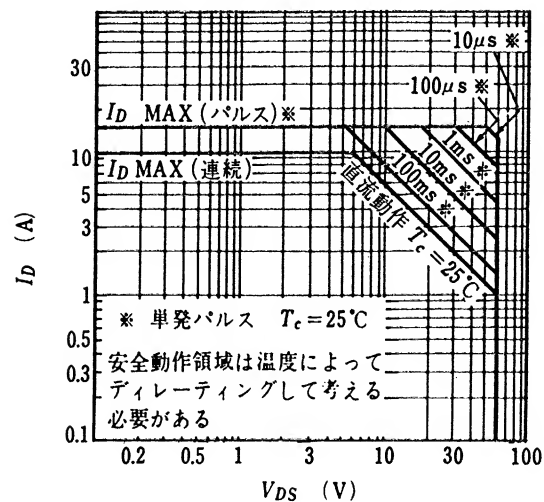
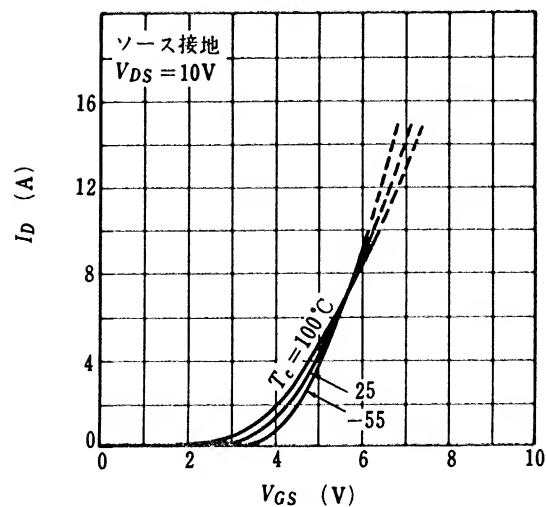
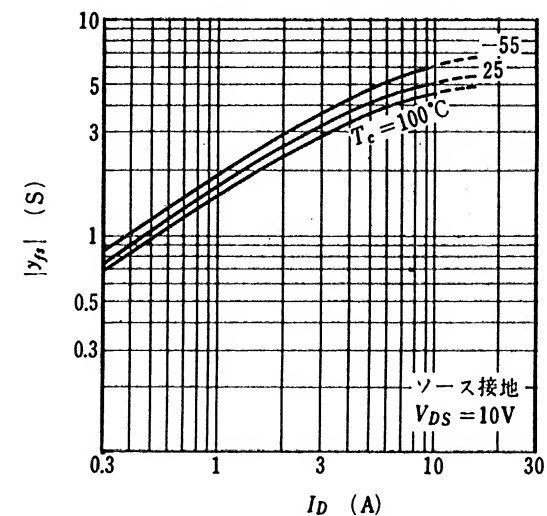
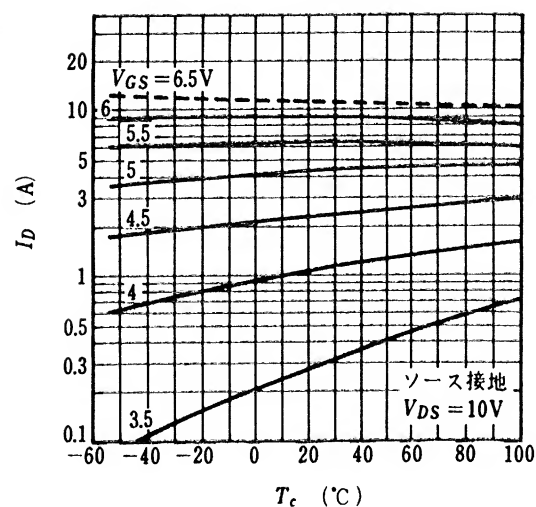
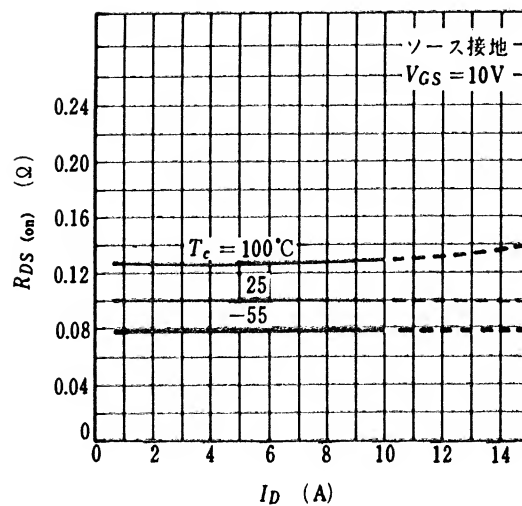
I_D - V_{DS} 特性

$V_{DS(on)}$ - V_{GS} 特性

$R_{DS(on)}$ - T_c 特性

C_{iss}, C_{oss}, C_{rss} - V_{DS} 特性

2SK416

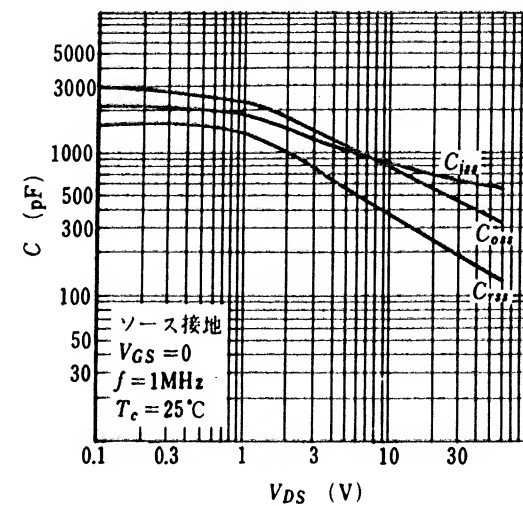
Si MOS型
Nチャンネル

日立

安全動作領域

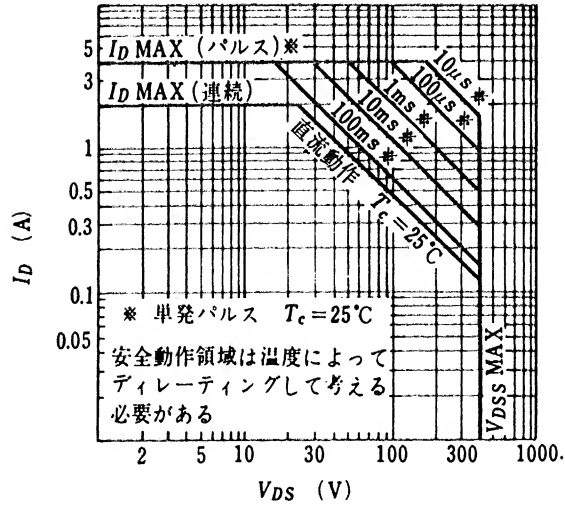
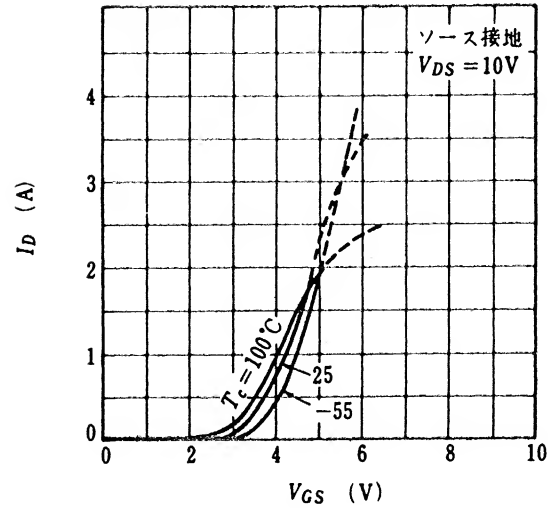
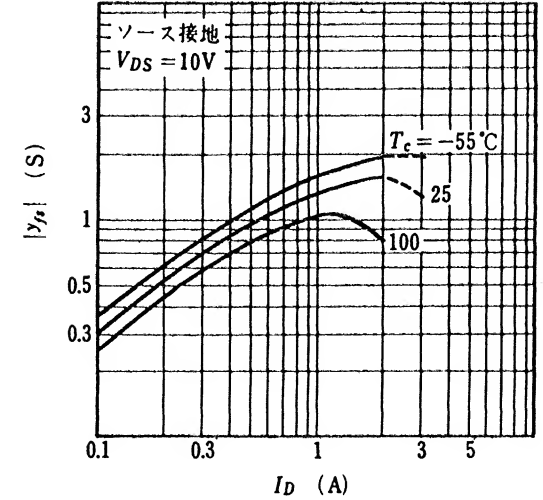
I_D - V_{GS} 特性

$V_{DS(on)}$ - V_{GS} 特性

$R_{DS(on)}$ - T_c 特性

$C_{iss}, C_{oss}, C_{rss}$ - V_{DS} 特性

$|y_{fs}|$ - f 特性

2SK417

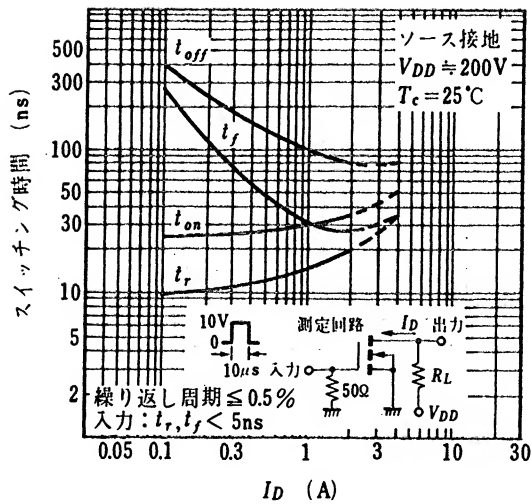
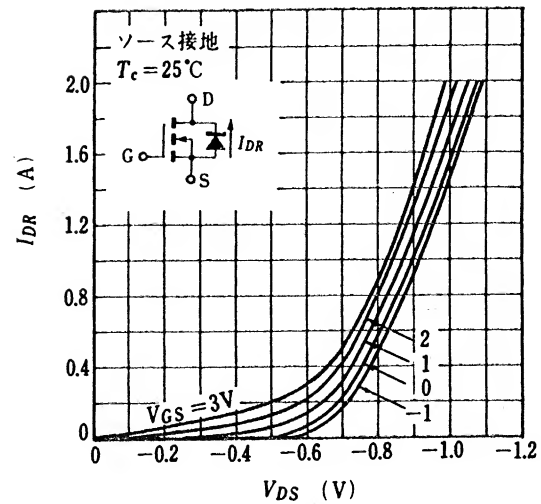
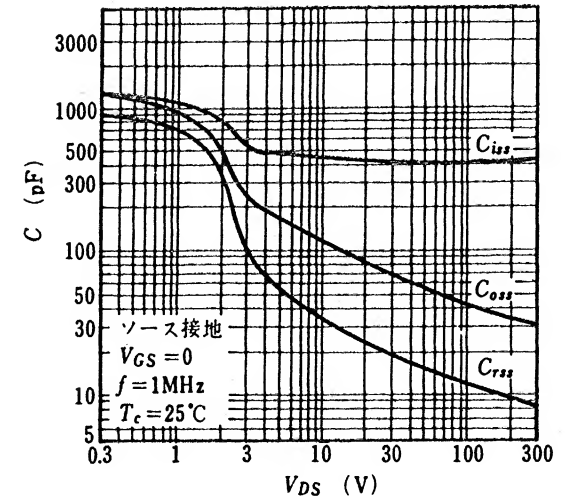
Si MOS型 Nチャンネル　　東　芝

安全動作領域

I_D - V_{GS} 特性

|Y_{fs}| - I_D 特性

I_D - T_C 特性

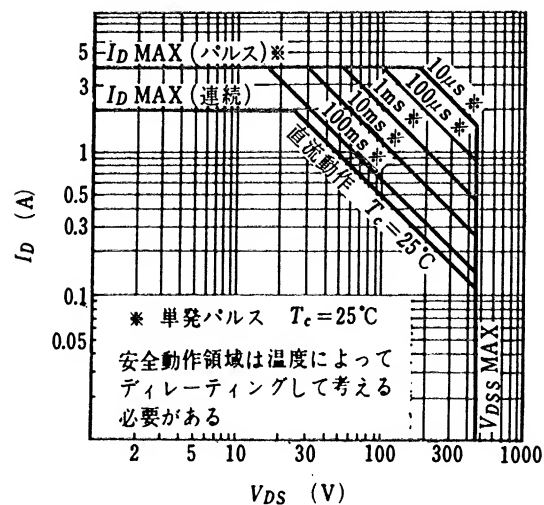
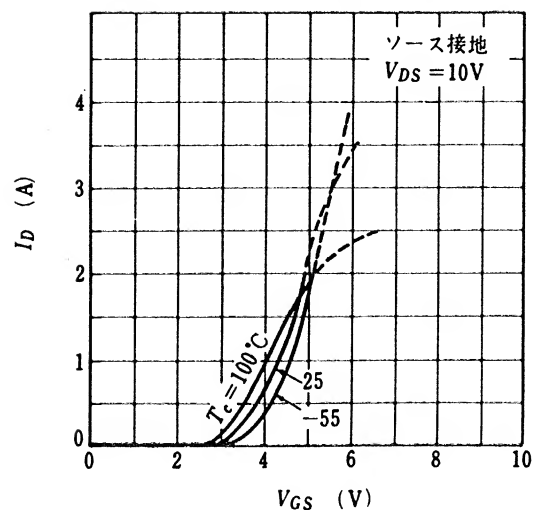
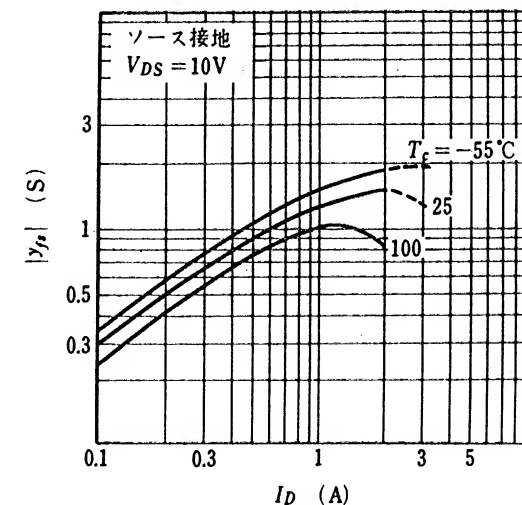
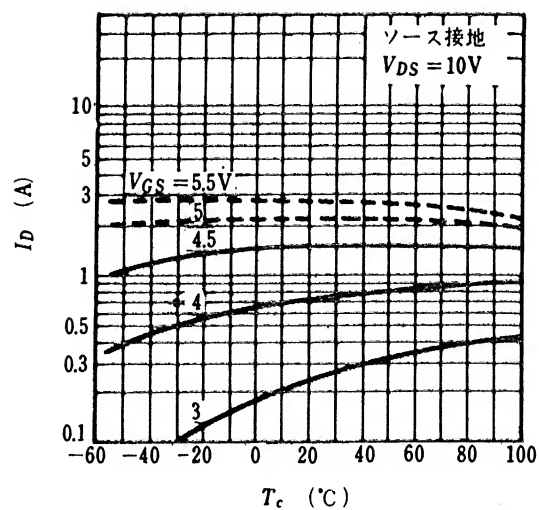
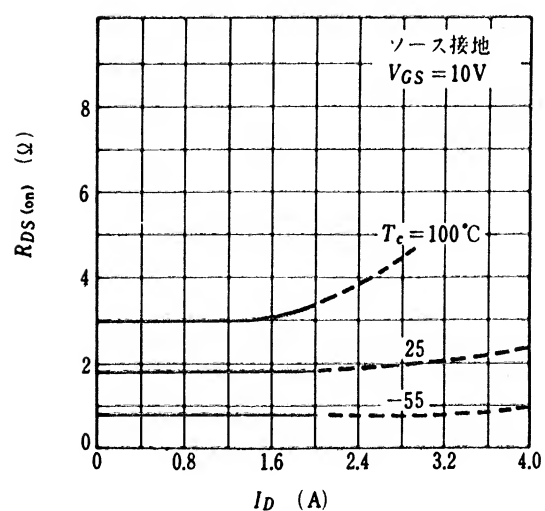
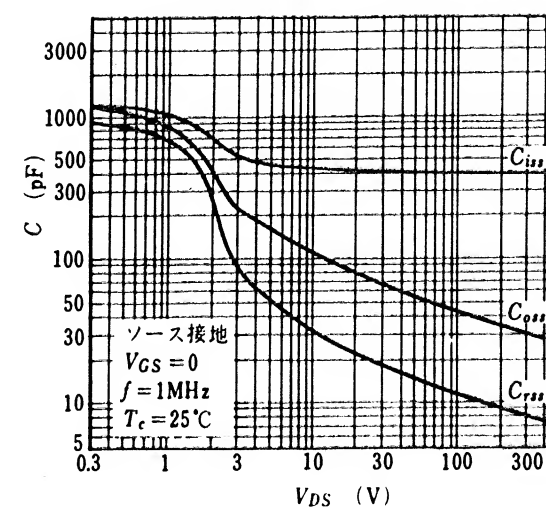
$R_{DS(on)}$ - I_D 特性

静電容量 - V_{DS} 特性

2SK418

Si MOS型 Nチャンネル　　東　芝

安全動作領域

I_D - V_{GS} 特性

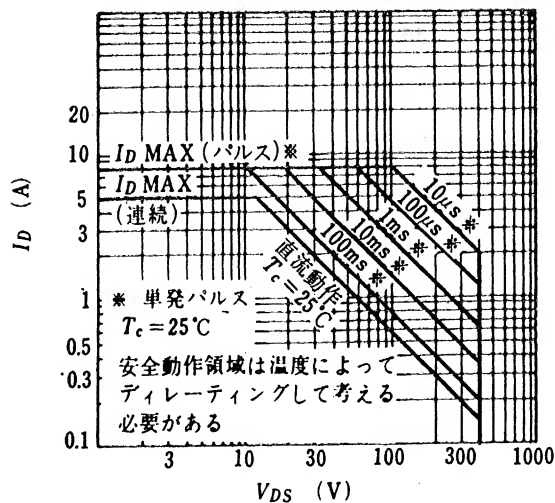
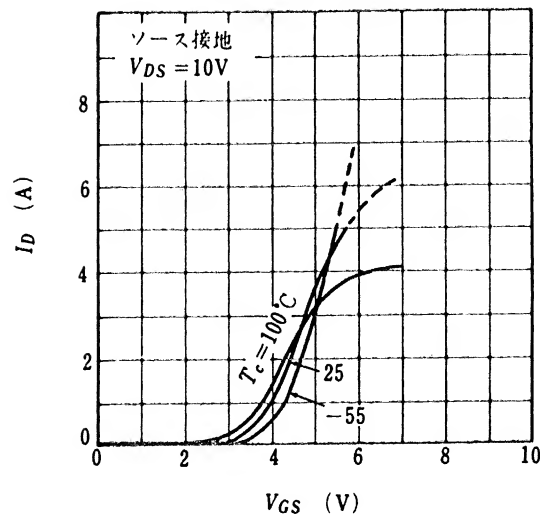
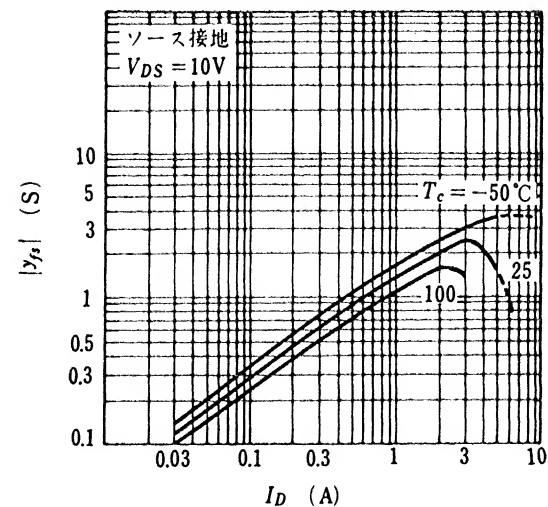
|Y_{fs}| - I_D 特性

スイッチング特性

I_{DR} - V_{DS} 特性

静電容量 - V_{DS} 特性

2SK419

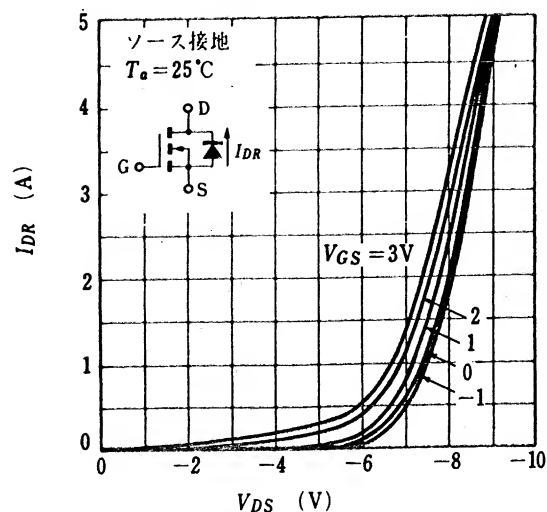
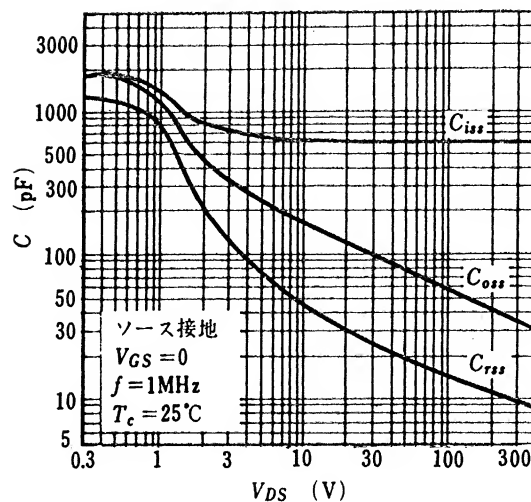
Si MOS型 Nチャンネル　東　芝

2SK420

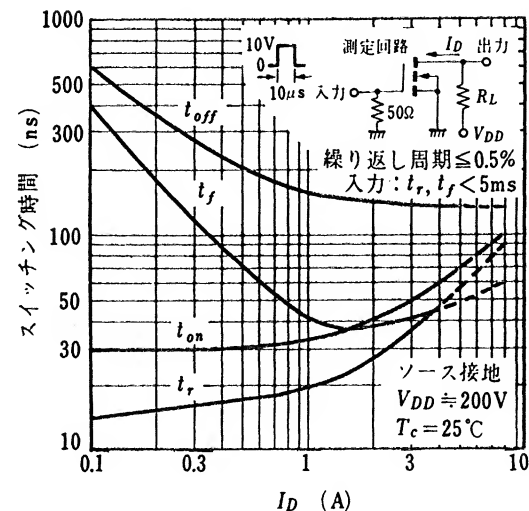
Si MOS型
Nチャンネル

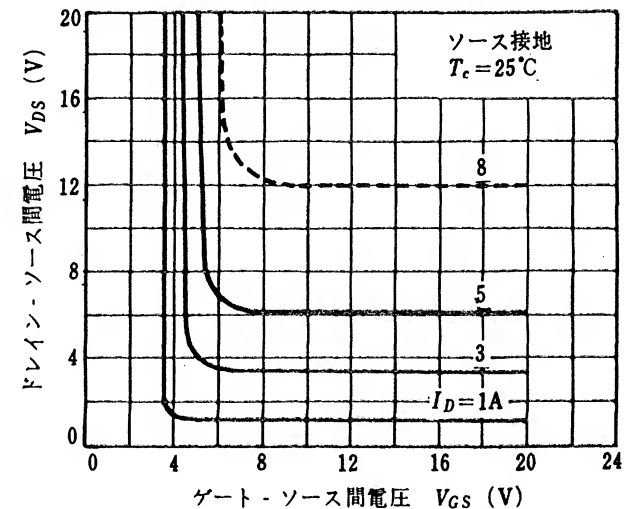
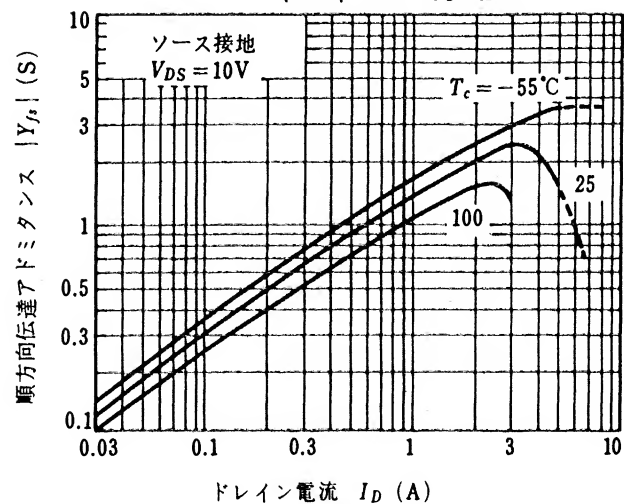
東　芝

安全動作領域

I_D - V_{GS} 特性

|Y_{fs}| - I_D 特性

I_{DR} - V_{DS} 特性

静電容量 - V_{DS} 特性

スイッチング特性

2SK421

Si MOS型
Nチャンネル

東　芝

2SK422

Si MOS型 Nチャンネル　東芝

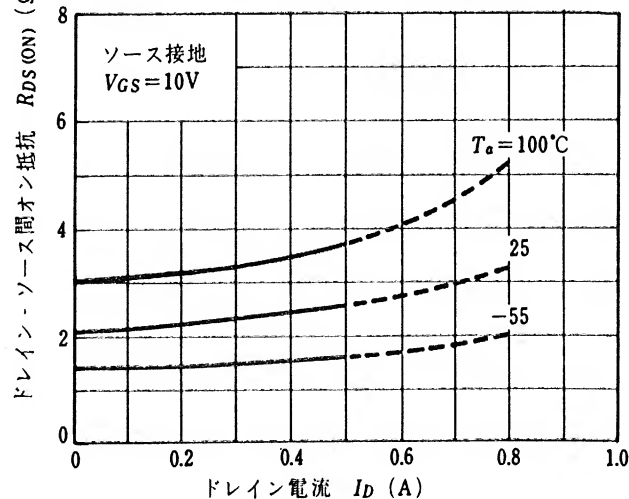
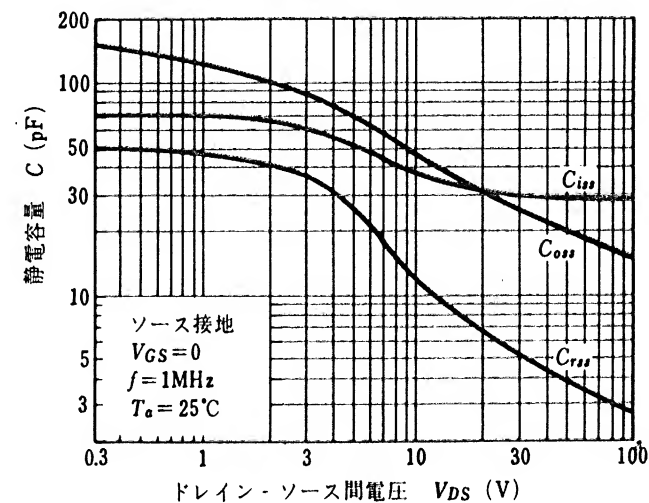
安全動作領域

I_D－V_{GS} 特性

V_{DS}－V_{GS} 特性

|Y_{fs}|－I_D 特性

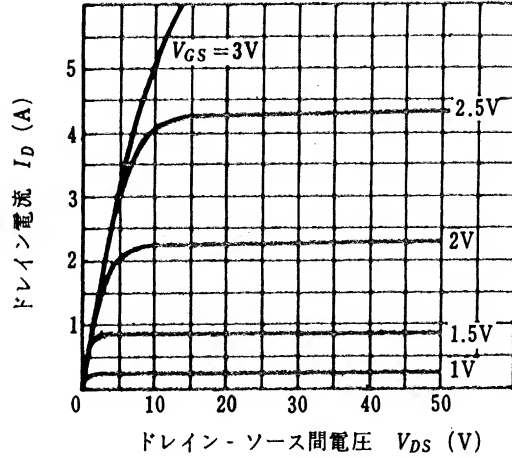
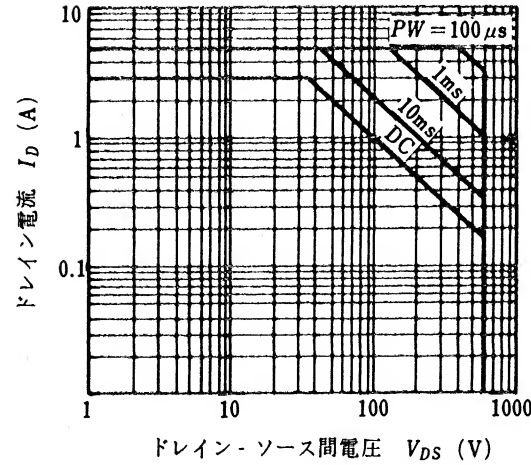
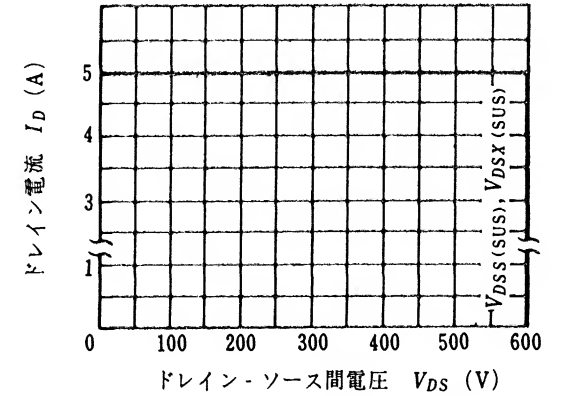
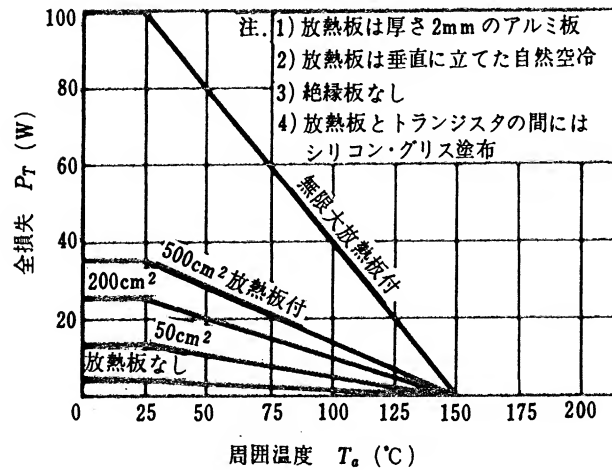
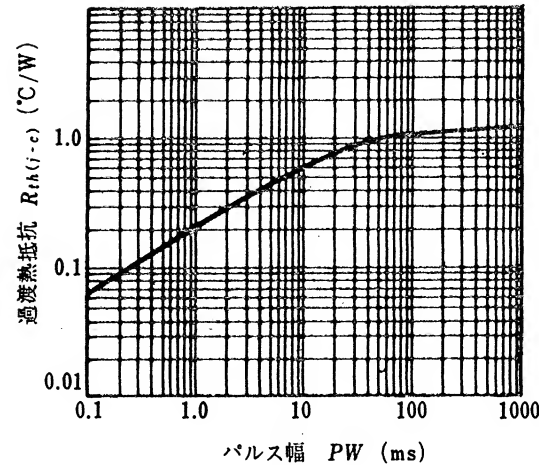
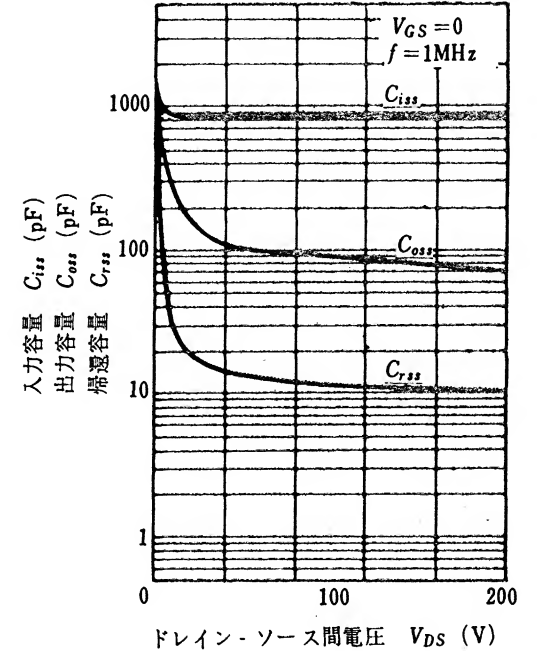
$R_{DS(ON)}$－I_D 特性

静電容量－V_{DS} 特性

2SK423

Si MOS型 Nチャンネル　　東芝

2SK424

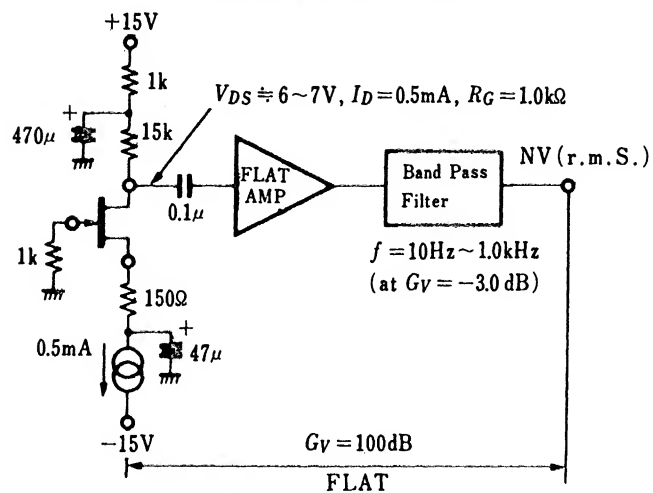
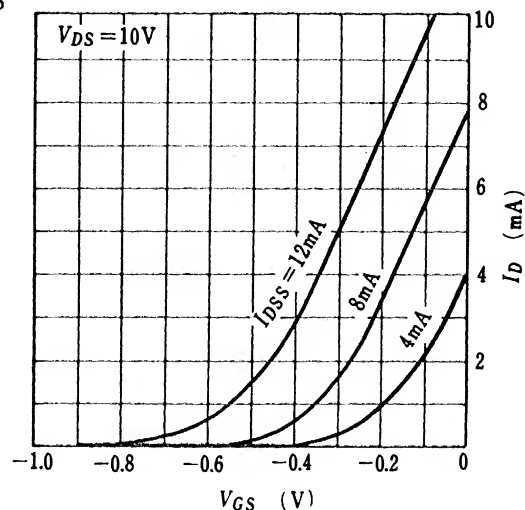
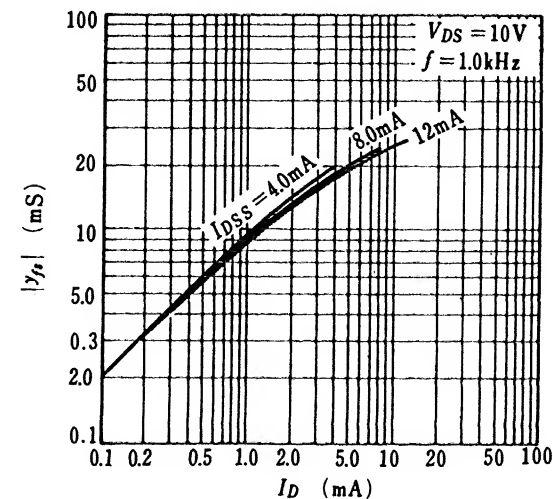
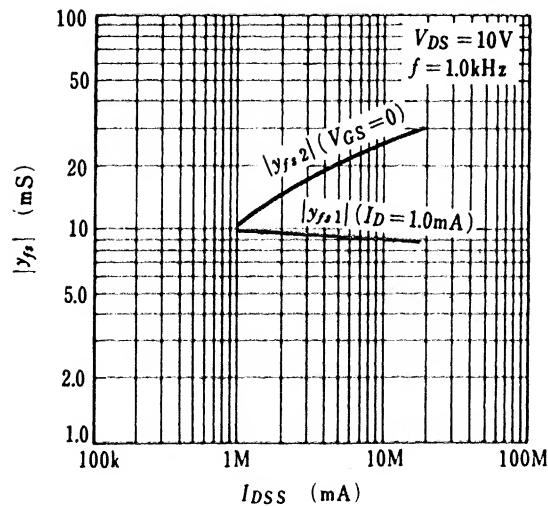
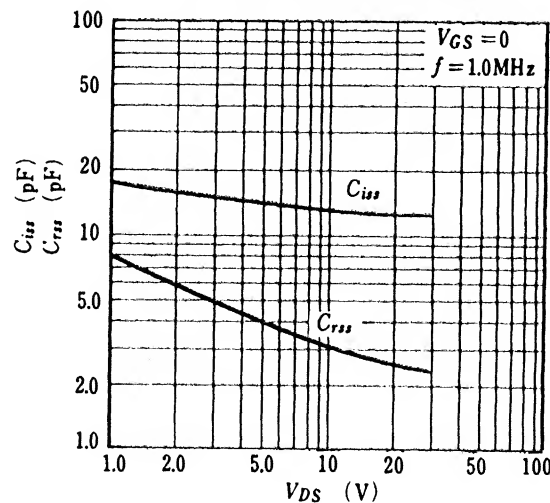
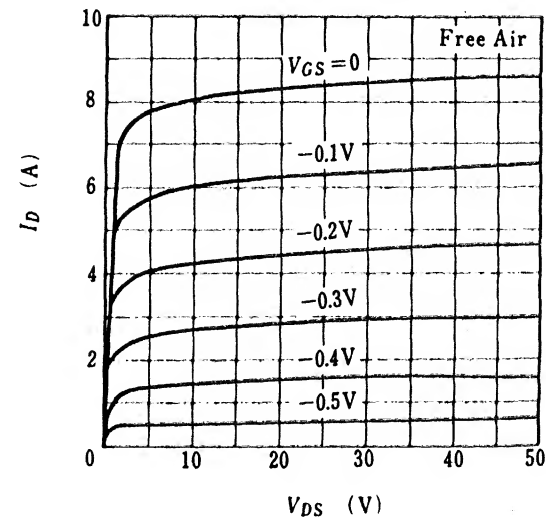
Si MOS型
Nチャンネル

日　電

I_D - V_{DS} 特性

順バイアス安全動作領域

逆バイアス安全動作領域

P_T - T_a 特性

過渡熱抵抗特性

C_{iss}, C_{rss}, C_{oss} - V_{DS} 特性

2SK425, 426

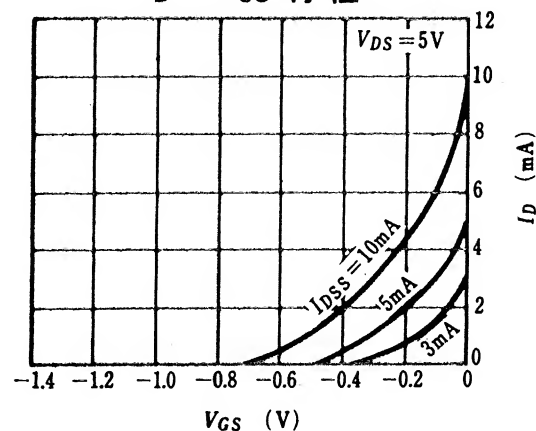
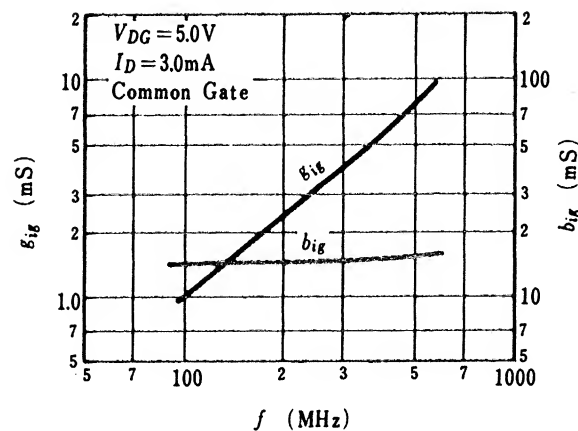
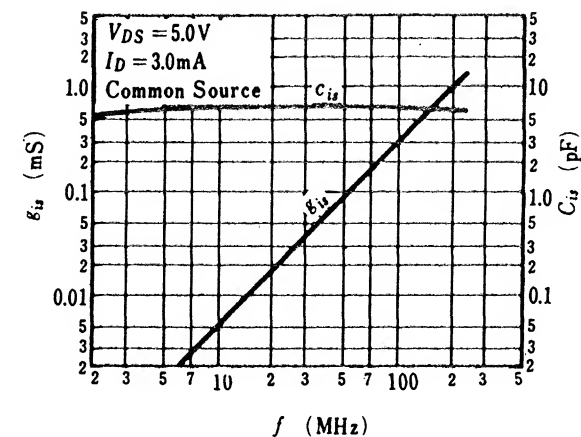
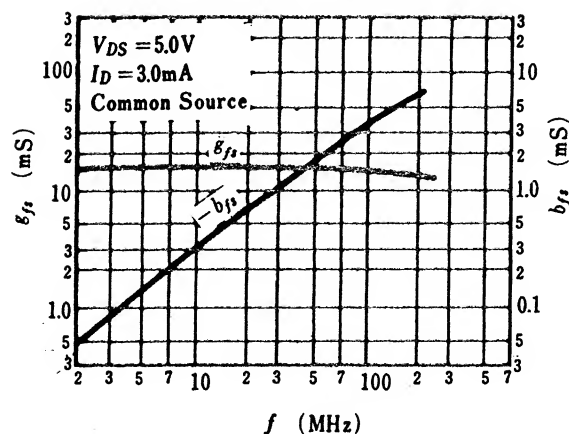
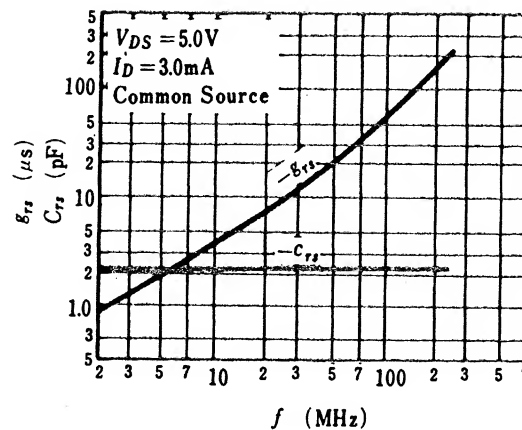
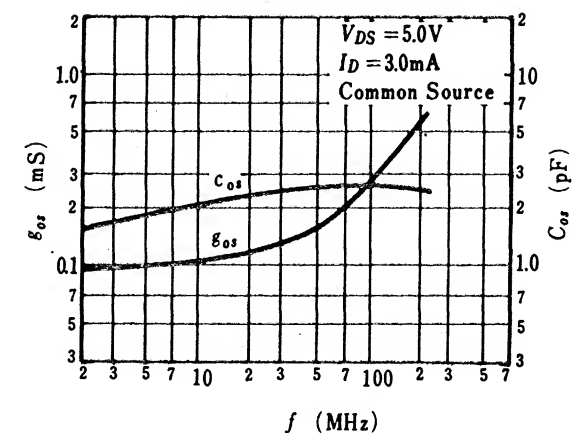
Si 接合型 Nチャンネル　　日　電

I_{DSS} (mA)	1~4	3~6	5~8	7~10	9~12	11~14	13~16	15~18
2SK425	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18
2SK426	X21	X22	X23	X24	X25	X26	X27	X28

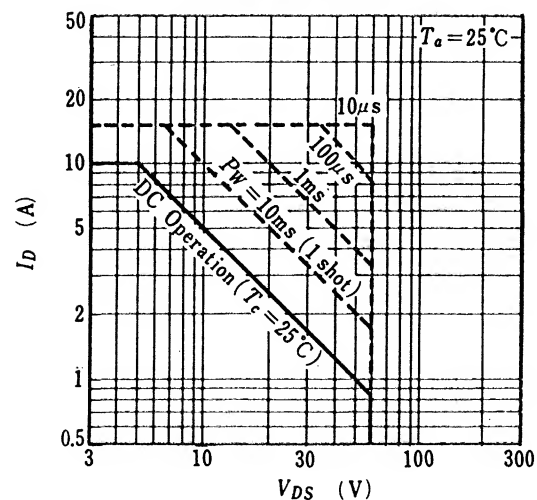
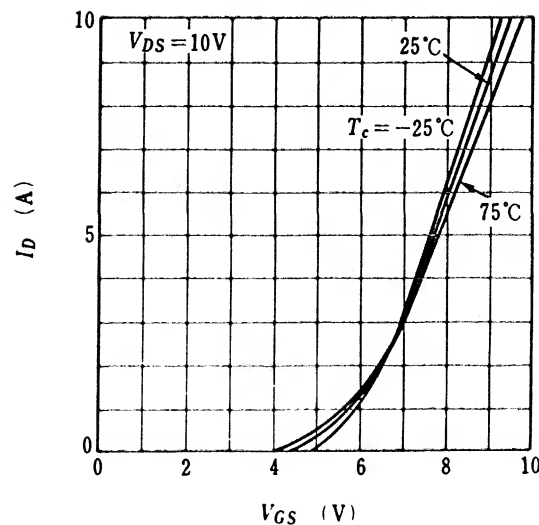
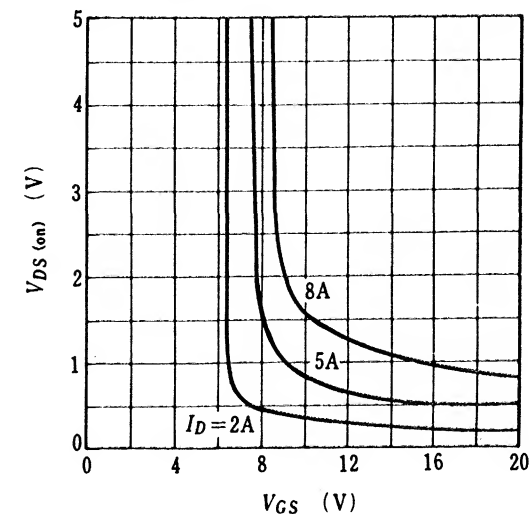
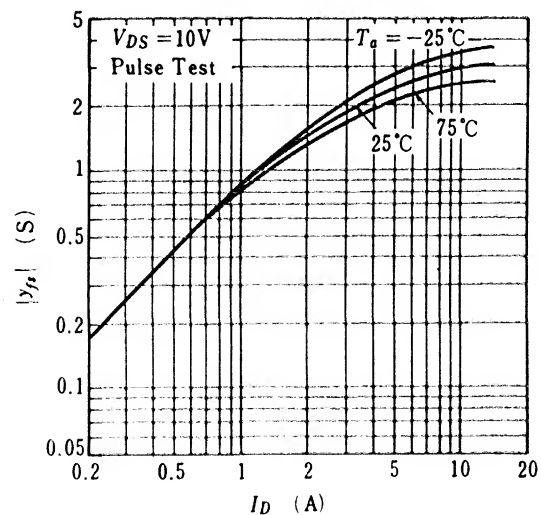
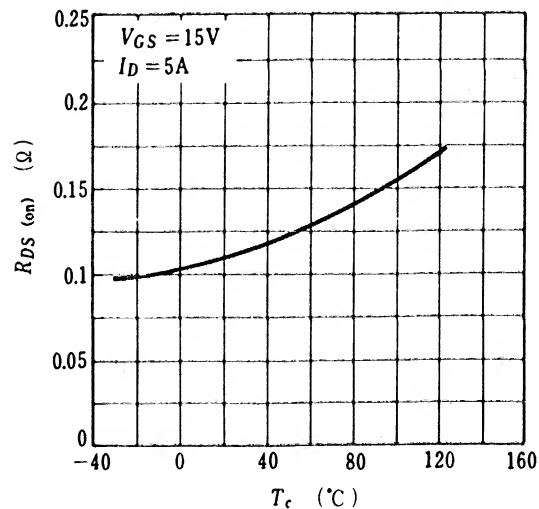
雑音電圧測定回路

I_D - V_{GS} 特性

$|Y_{fs}|$ - I_D 特性

$|Y_{fs}|$ - I_{DSS} 特性

C_{iss}, C_{rss} - V_{DS} 特性

I_D - V_{DS} 特性

2SK427, 436

Si 接合型 Nチャンネル　三　洋

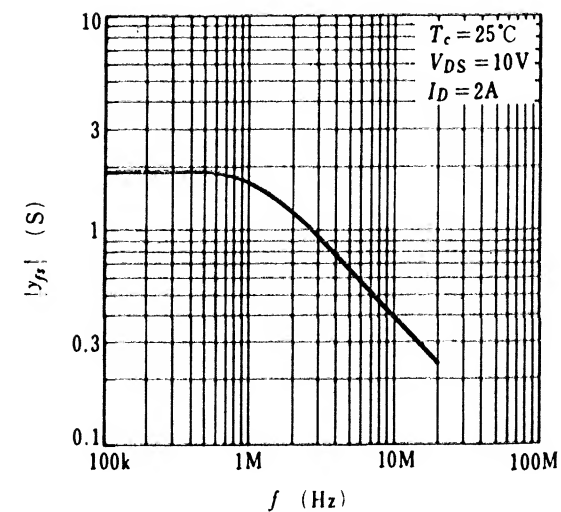
I_{DSS} により次のように分類している（単位：mA）

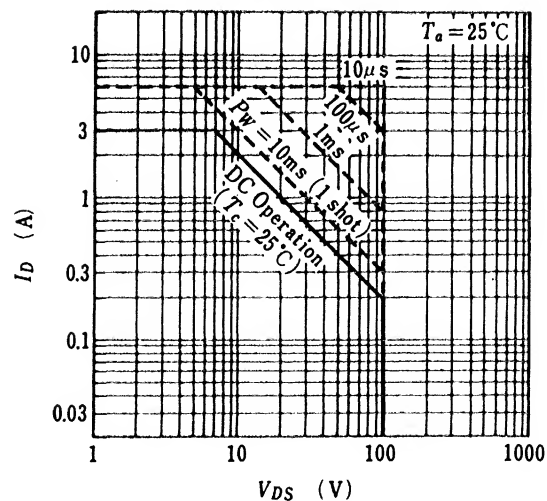
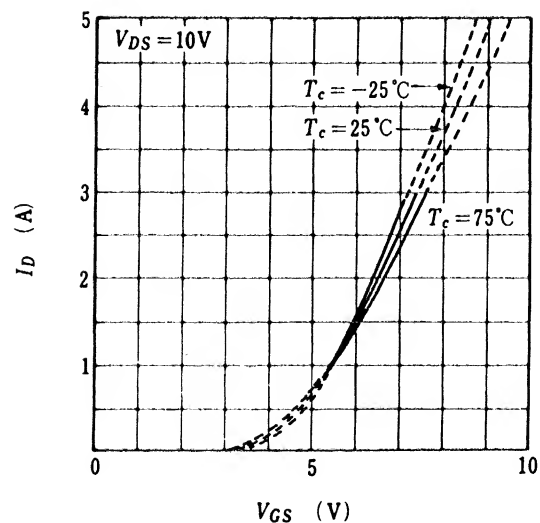
1.2 P 2.1	1.7 Q 3.0	2.5 R 4.2
3.5 S 6.0	5.0 T 8.5	7.3 U 12.0

2SK428

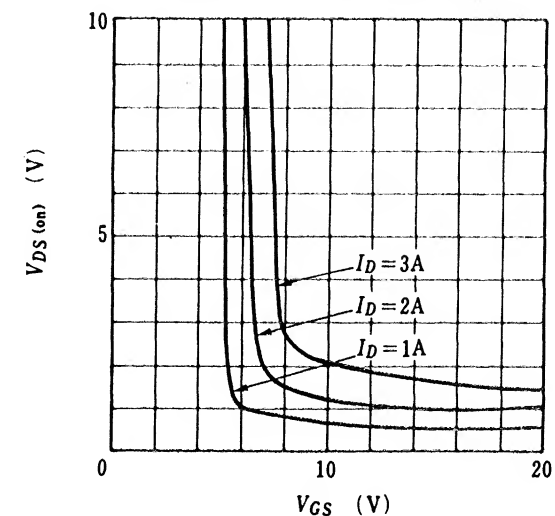
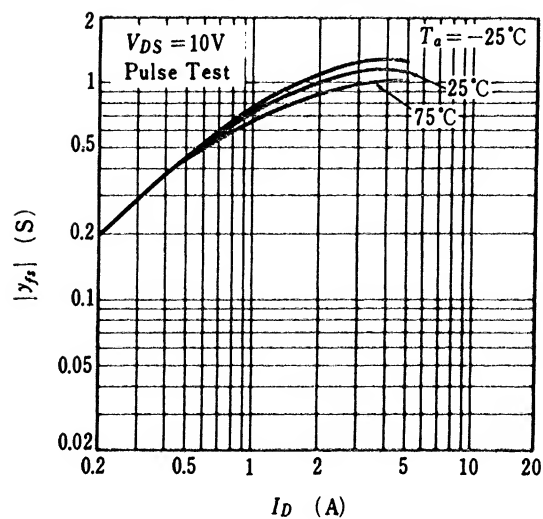
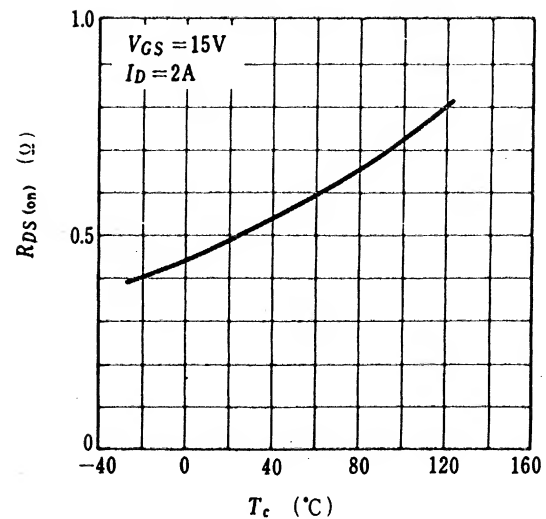
Si MOS 型
Nチャンネル

日　立

I_D - V_{GS} 特性

$V_{DS(on)}$ - V_{GS} 特性

$|y_{fs}|$ - I_D 特性

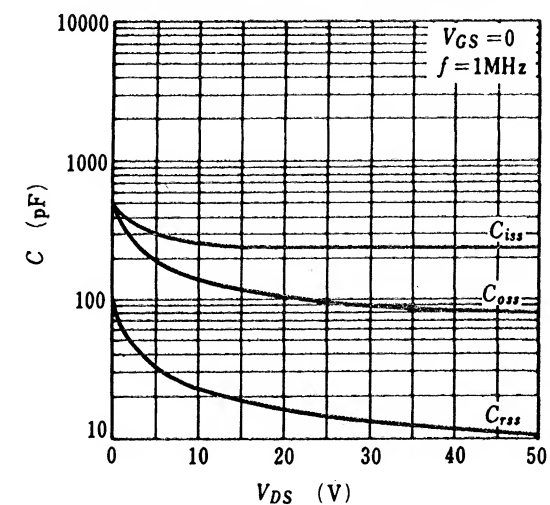
$R_{DS(on)}$ - T_c 特性

$|y_{fs}|$ - f 特性

2SK429

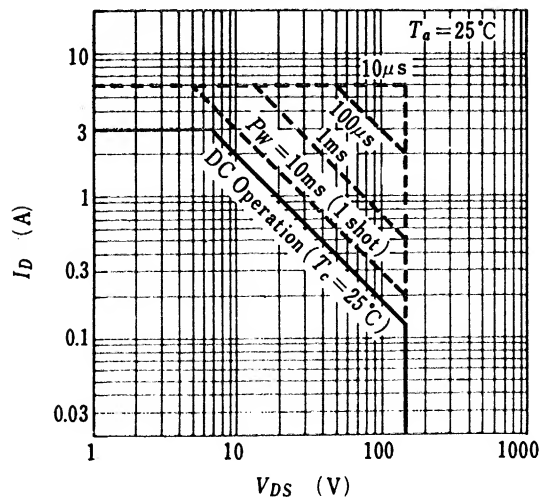
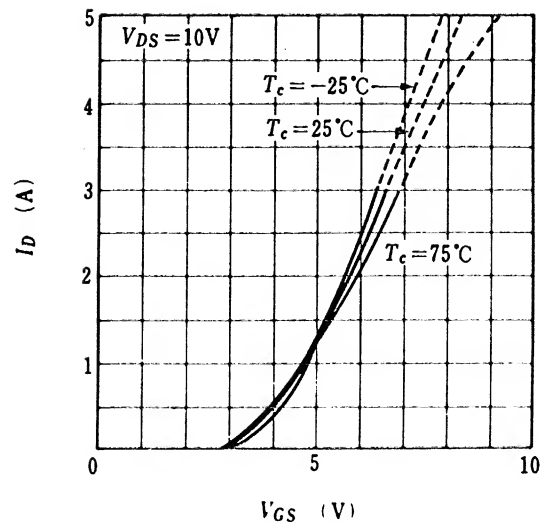
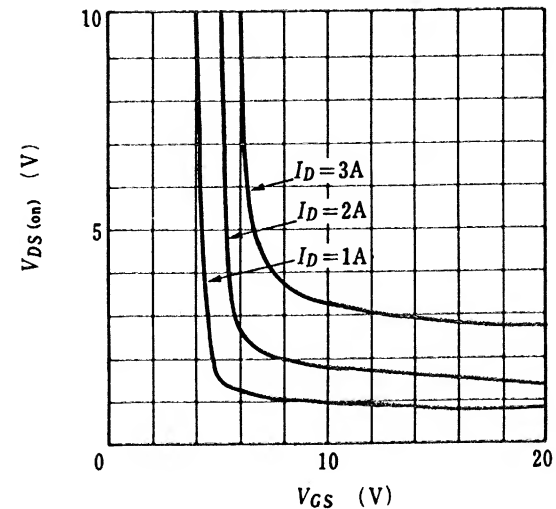
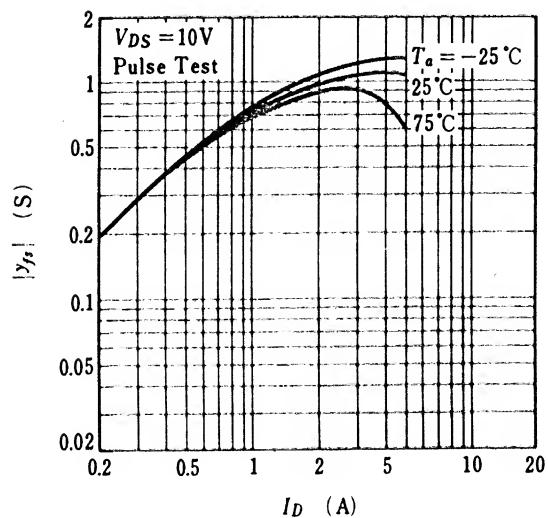
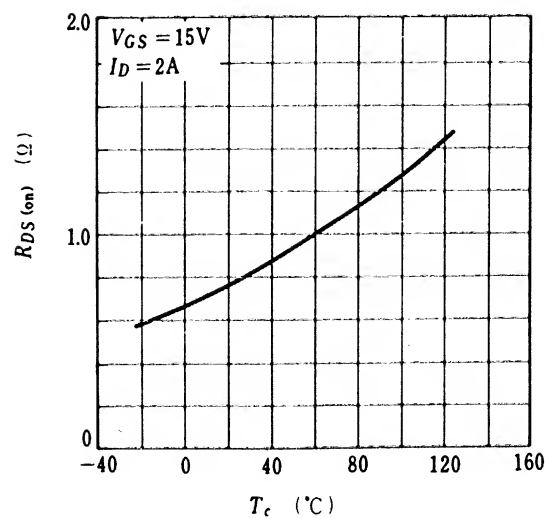
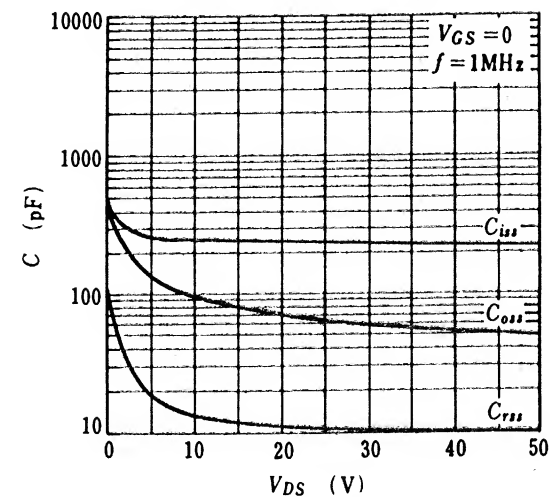
Si MOS型 Nチャンネル　日立

安全動作領域

I_D - V_{GS} 特性

$V_{DS(on)}$ - V_{GS} 特性

$|y_{fs}|$ - I_D 特性

$R_{DS(on)}$ - T_c 特性

C_{iss}, C_{oss}, C_{rss} - V_{DS} 特性

2SK430

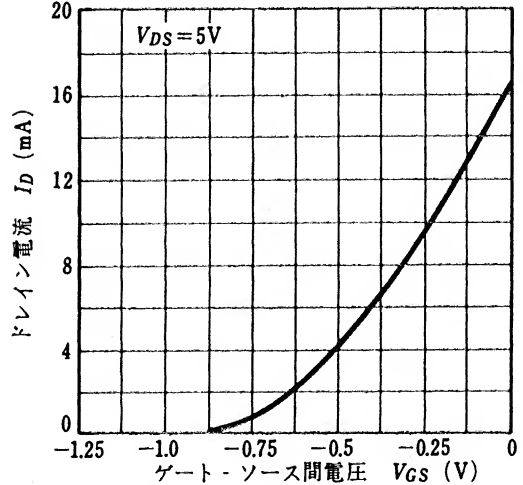
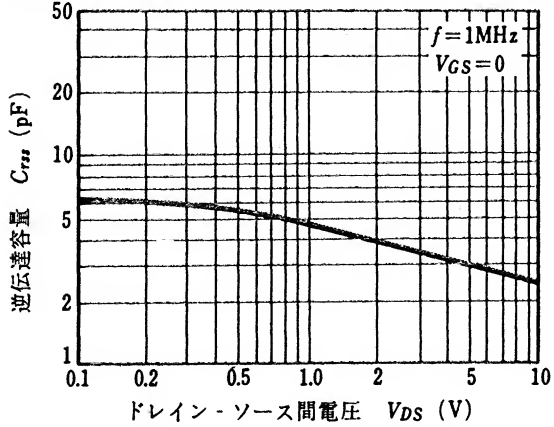
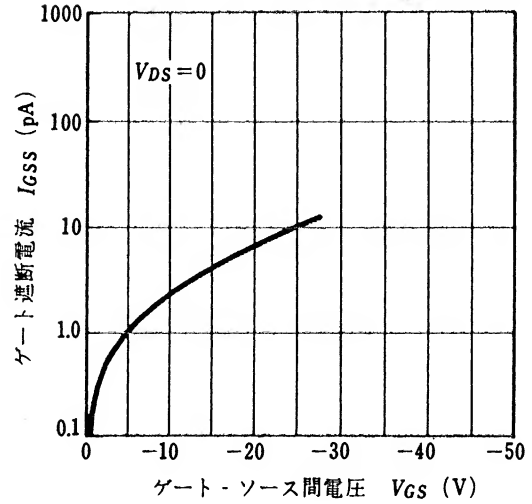
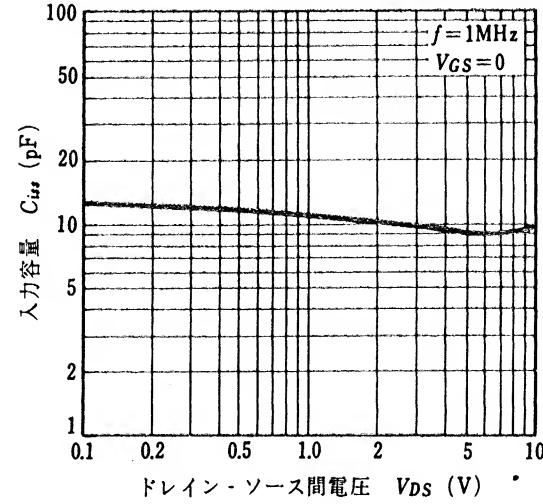
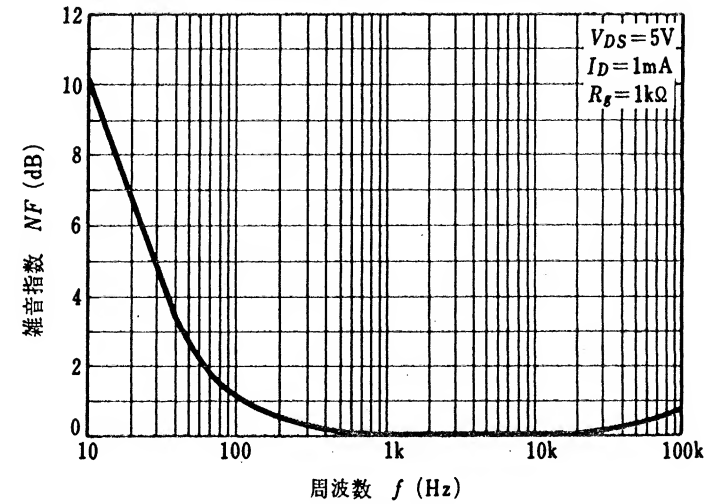
Si MOS 型
Nチャンネル　日　立

安全動作領域

I_D - V_{GS} 特性

$V_{DS(on)}$ - V_{GS} 特性

$|y_{fs}|$ - I_D 特性

$R_{DS(on)}$ - T_c 特性

C_{iss}, C_{oss}, C_{rss} - V_{DS} 特性

2SK435, 494

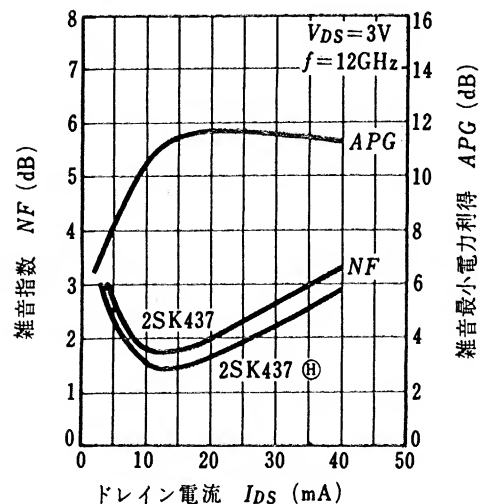
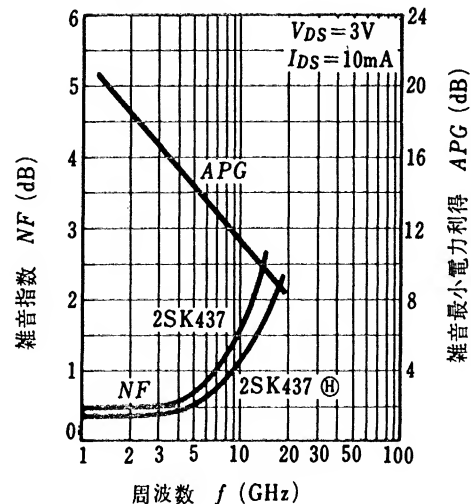
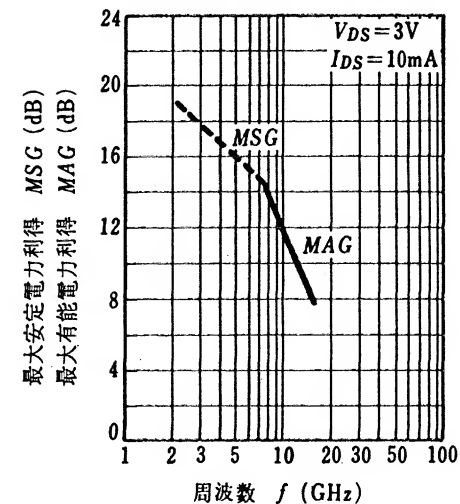
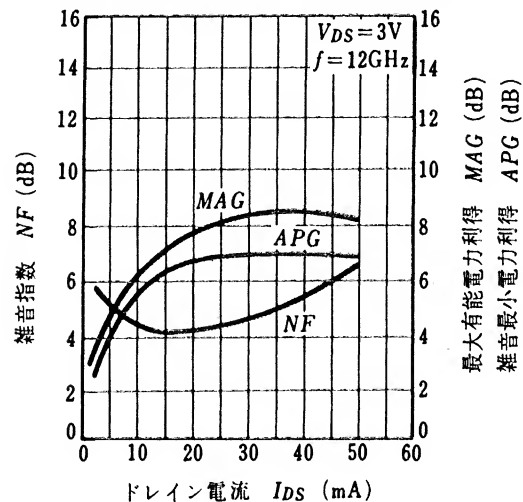
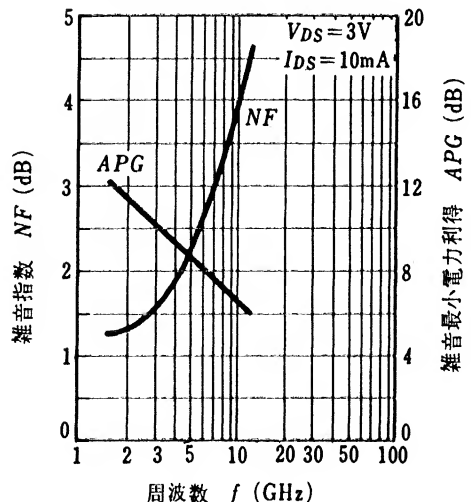
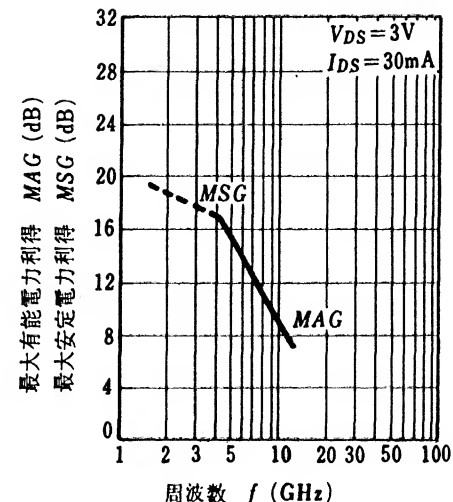
Si 接合型 Nチャンネル　　日　立

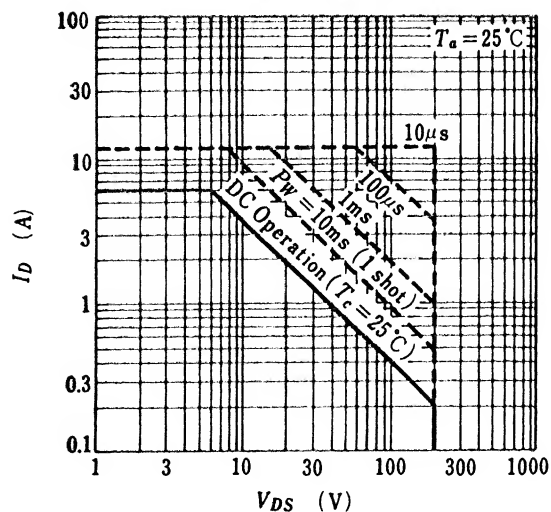
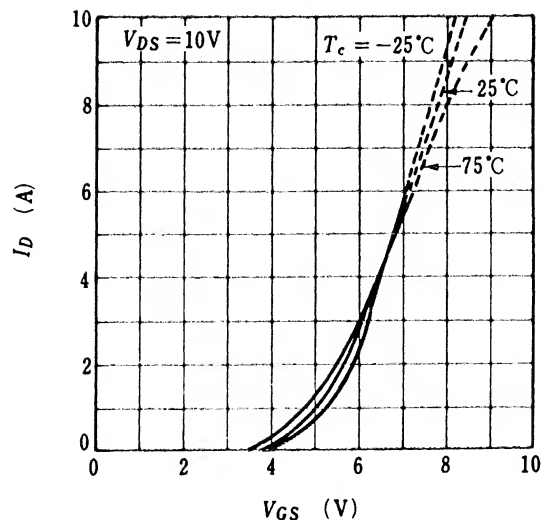
I_{DSS} 区分

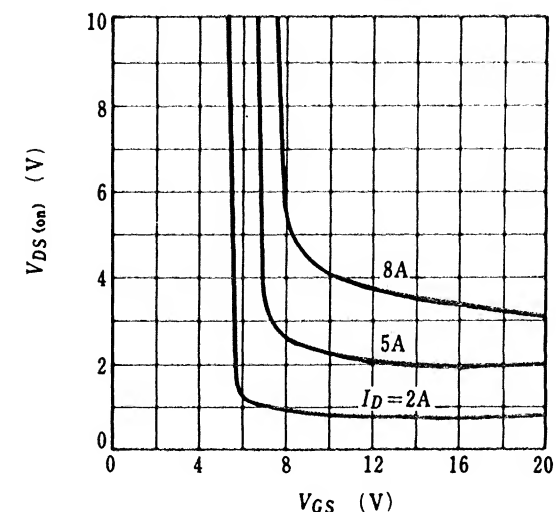
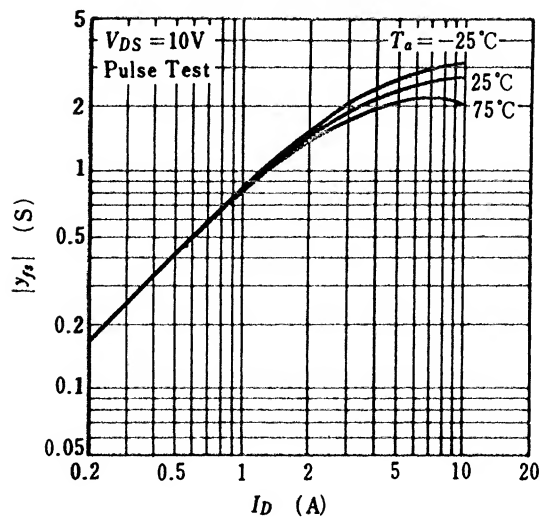
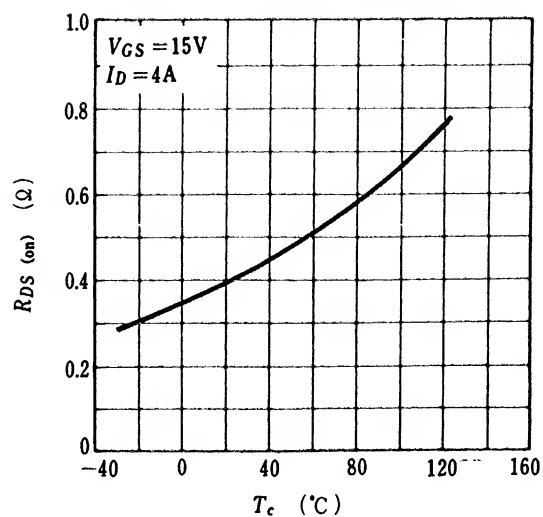
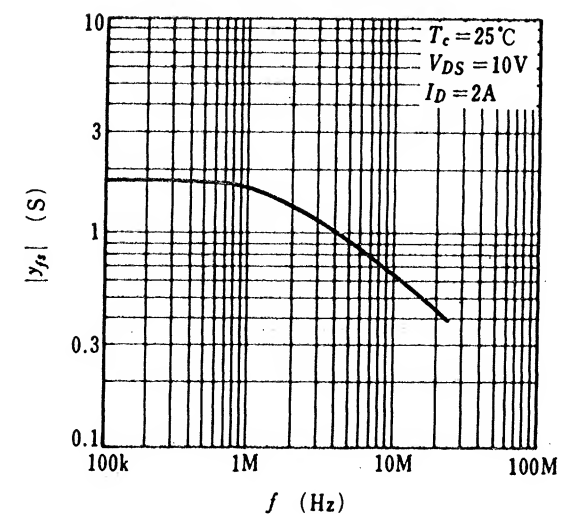
B	C	D	E
6～14	12～22	18～30	26～40

ソース接地伝達静特性

逆伝達容量対ドレイン - ソース間電圧特性

ゲート遮断電流対ゲート - ソース間電圧特性

雑音指数対信号源抵抗特性

入力容量対ドレイン - ソース間電圧特性

雑音指数対周波数特性

2SK437, 437Ⓗ, 438　GaAs MES型 Nチャンネル　松　下

2SK440

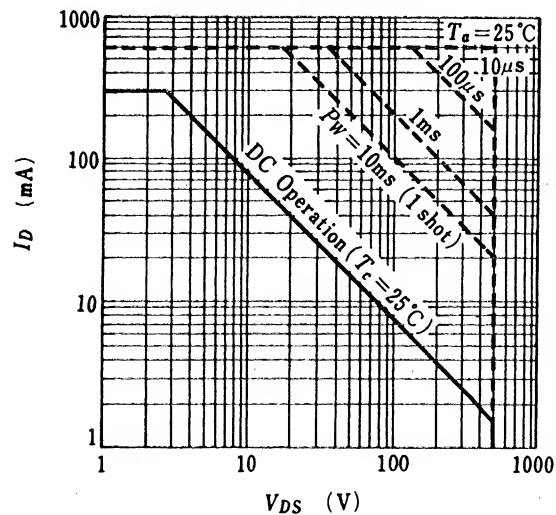
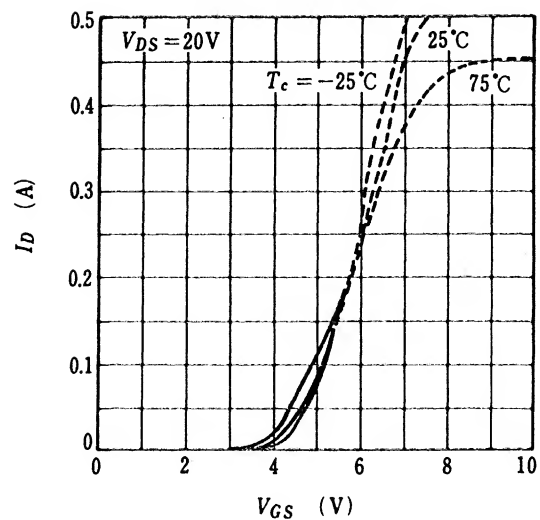
Si MOS型 Nチャンネル　日立

安全動作領域

I_D - V_{GS} 特性

$V_{DS(on)}$ - V_{GS} 特性

$|y_{fs}|$ - I_D 特性

$R_{DS(on)}$ - T_C 特性

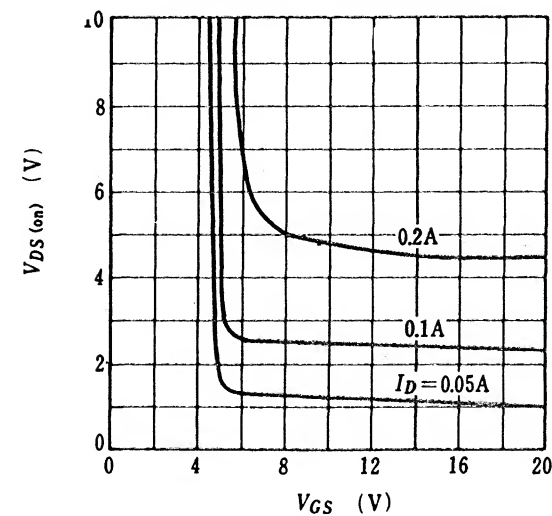
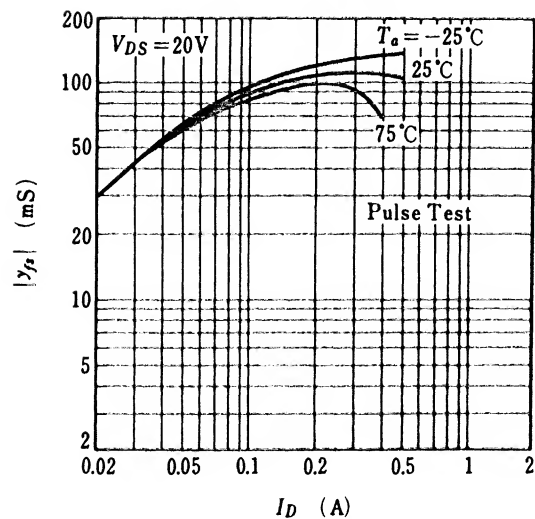
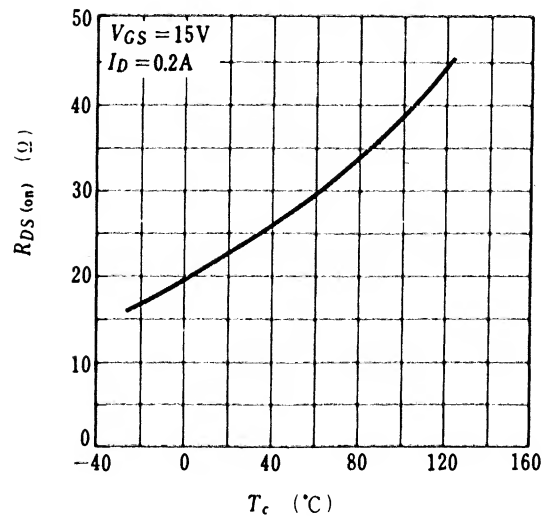
$|y_{fs}|$ - f 特性

2SK441

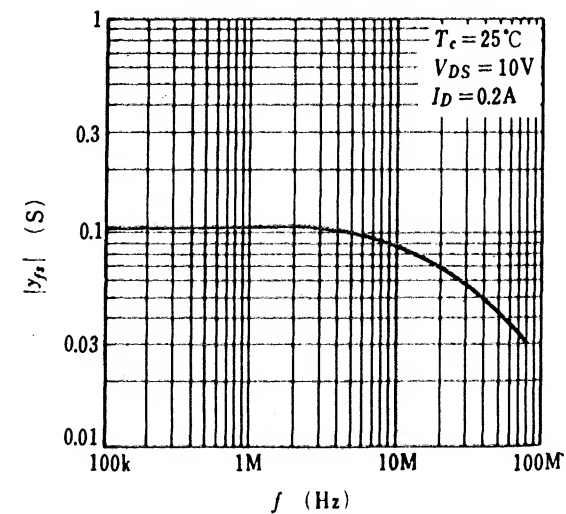
Si MOS型
Nチャンネル

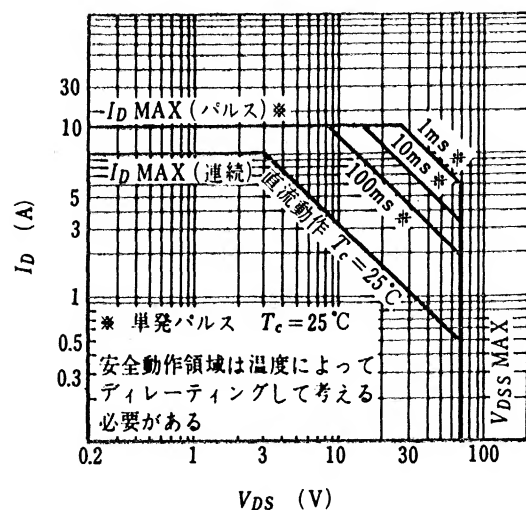
日　立

安全動作領域

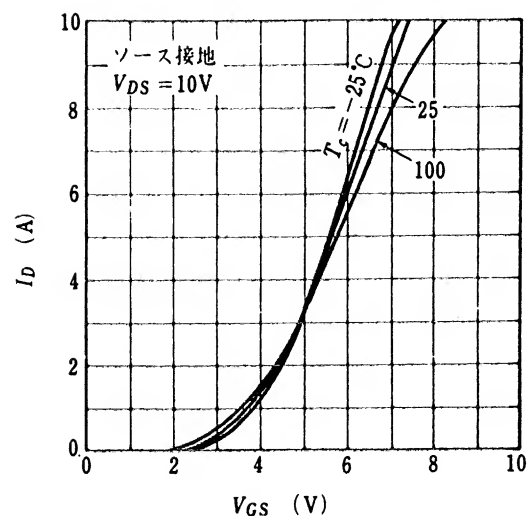
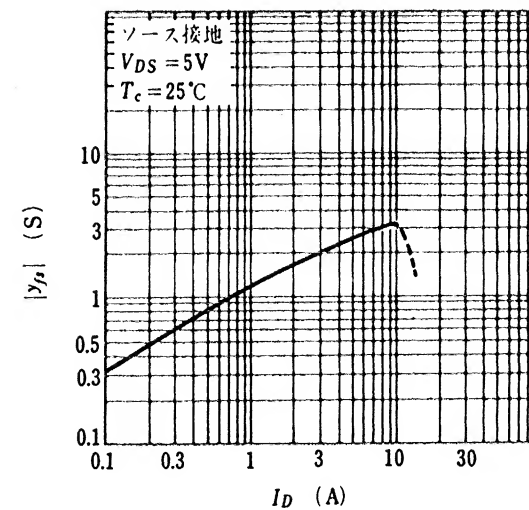
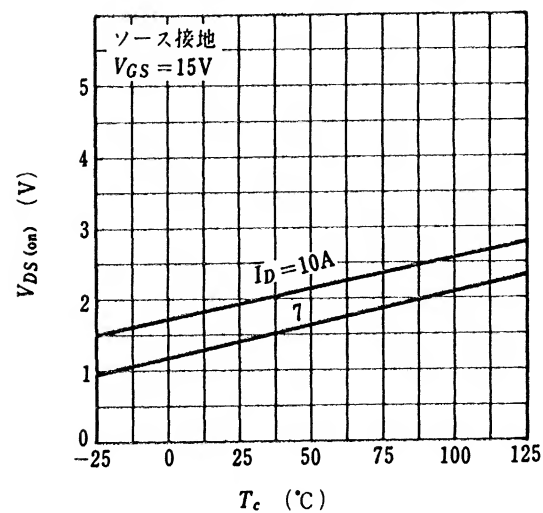
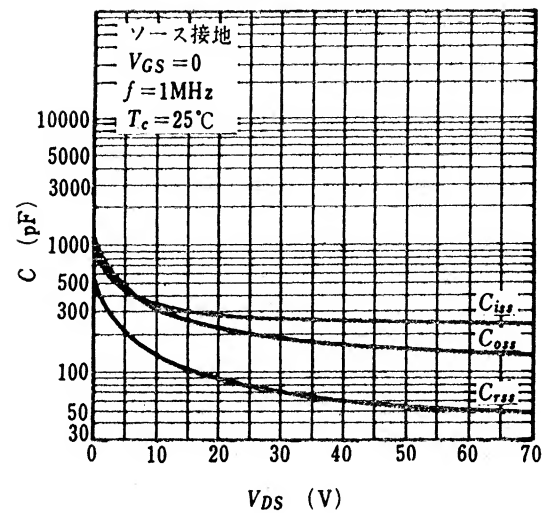
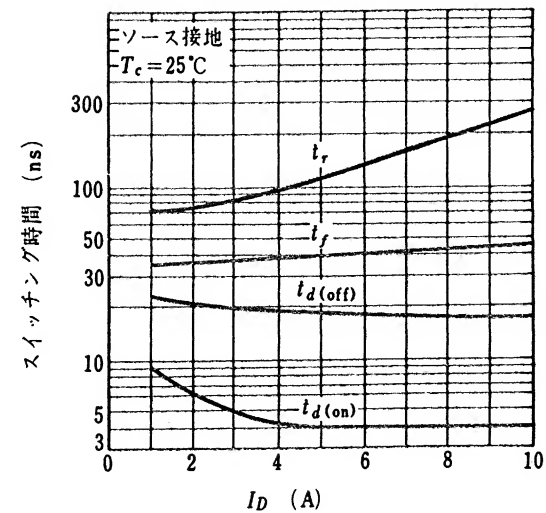
I_D - V_{GS} 特性

$V_{DS(on)}$ - V_{GS} 特性

$|y_{fs}|$ - I_D 特性

$R_{DS(on)}$ - T_c 特性

$|y_{fs}|$ - f 特性

2SK442

Si MOS型 Nチャンネル　東　芝

安全動作領域

I_D - V_{GS} 特性

$|Y_{fs}|$ - I_D 特性

$V_{DS(on)}$ - T_C 特性

静電容量 - V_{DS} 特性

スイッチング特性

2SK443, 444, 445

Si 接合型
Nチャンネル

三 洋

V_{DS} =5V により次のように分類する.

5.0	AJ5	12.0	10.0	AJ6	24.0	16.0	AJ7	38.0

2SK446

Si MOS型 Nチャンネル　日電

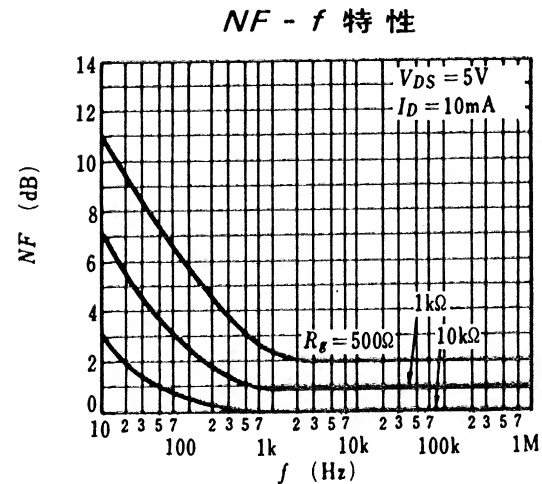
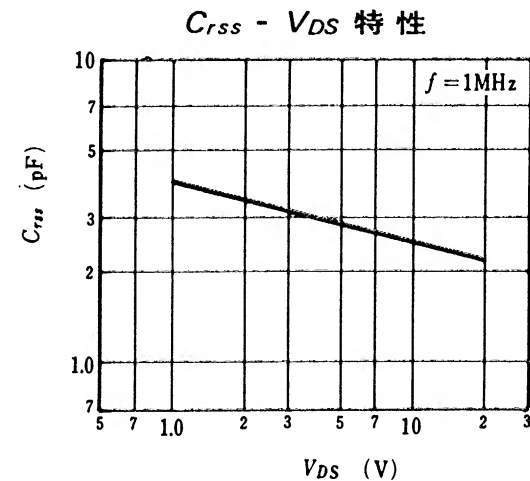
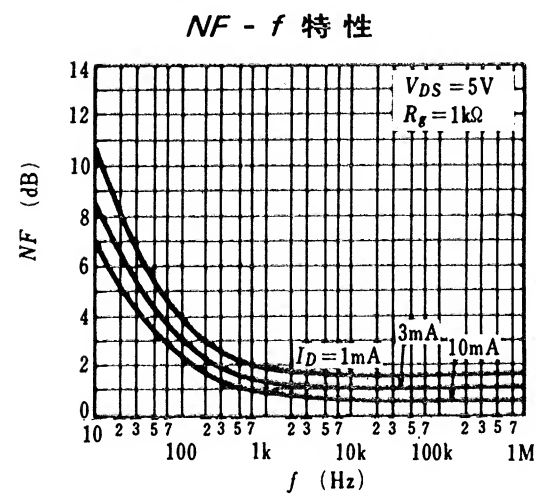
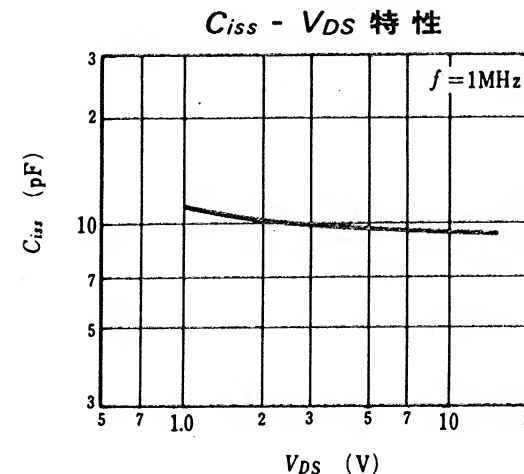
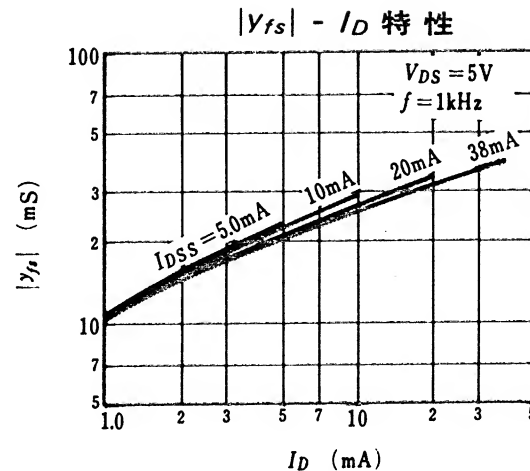
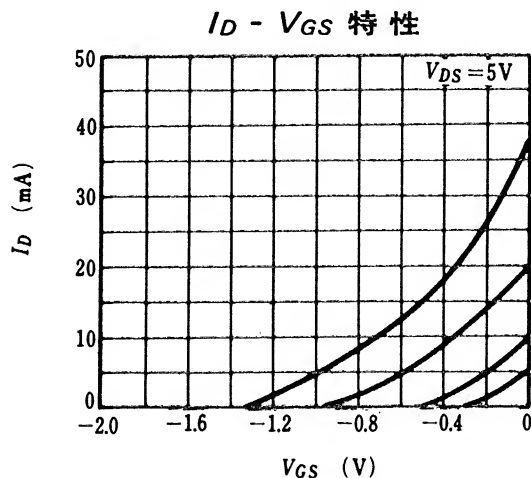
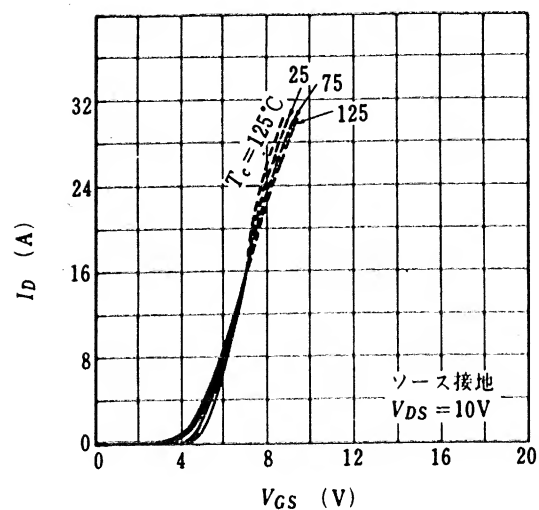
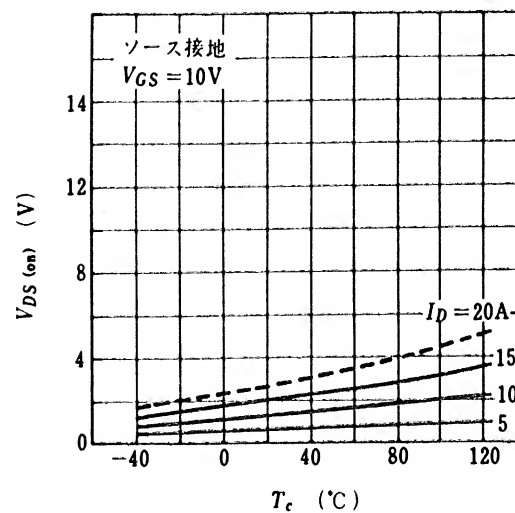
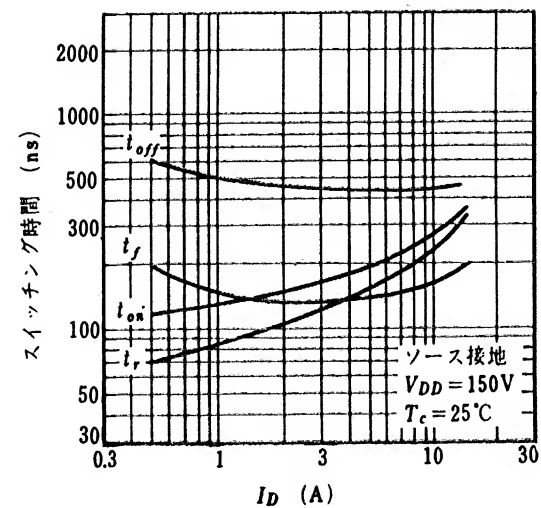
2SK447

Si MOS型 Nチャンネル　　東　芝

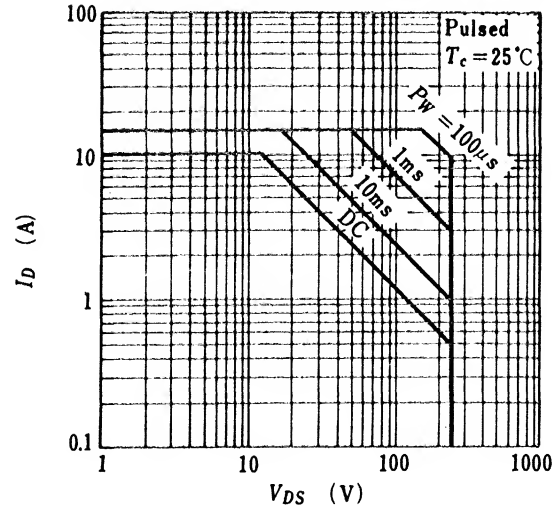
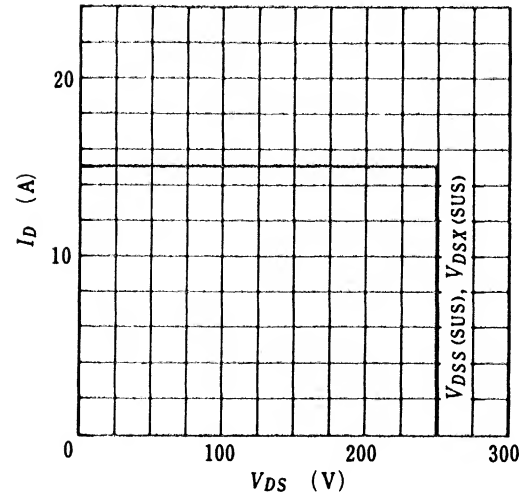
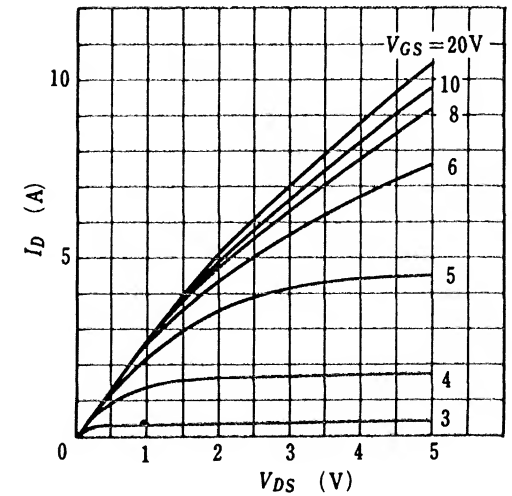
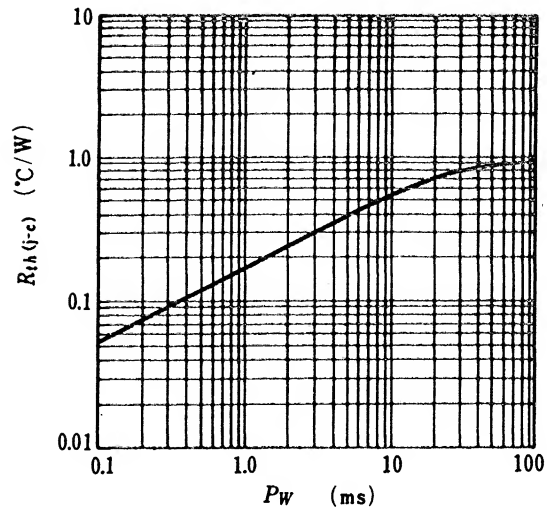
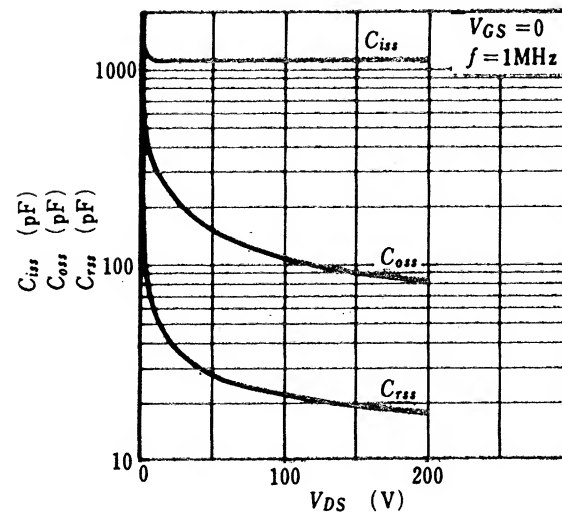
安全動作領域

I_D - V_{DS} 特性

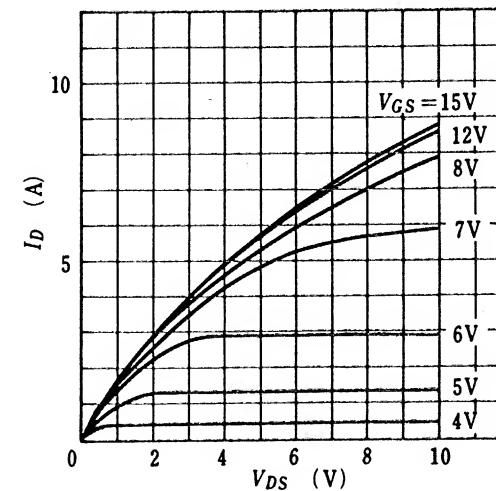
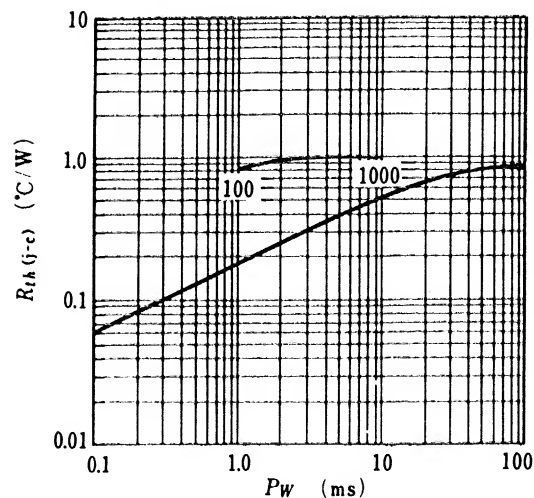
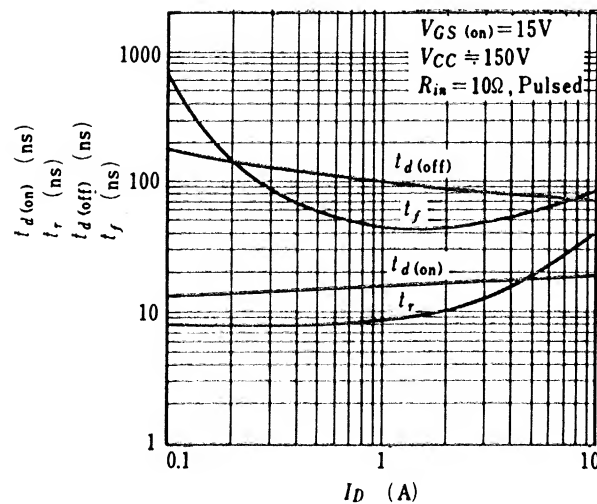
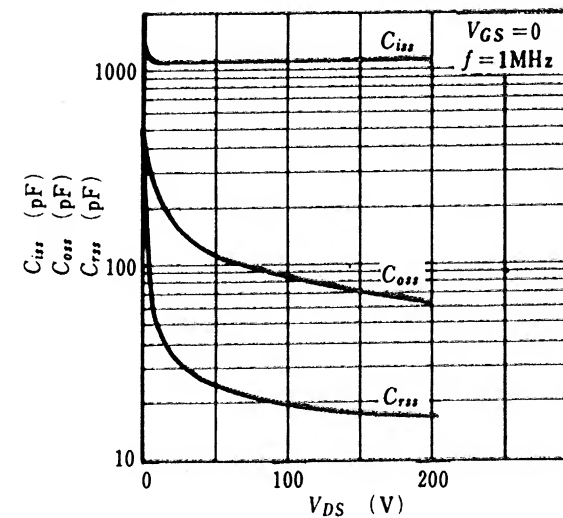
I_S - V_{SDF} 特性

I_D - V_{GS} 特性

$V_{DS(on)}$ - T_c 特性

スイッチング特性

2SK448

Si MOS型 Nチャンネル　日電

順方向バイアス安全動作領域

逆方向バイアス安全動作領域

I_D - V_{DS} 特性

$R_{th(j-c)}$ - P_W 特性

C_{iss}, C_{oss}, C_{rss} - V_{DS} 特性

スイッチング特性

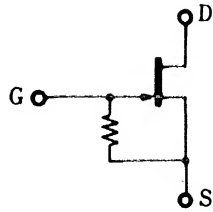
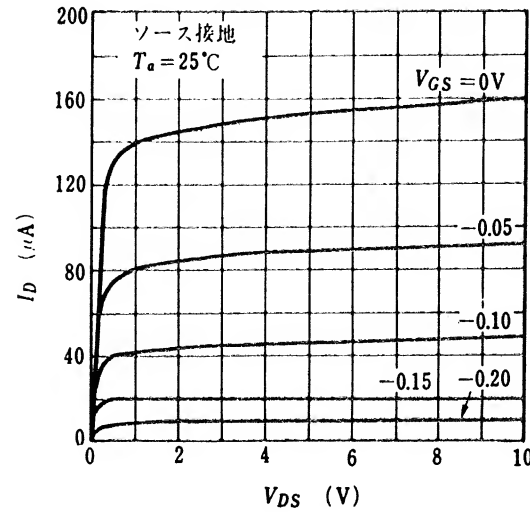
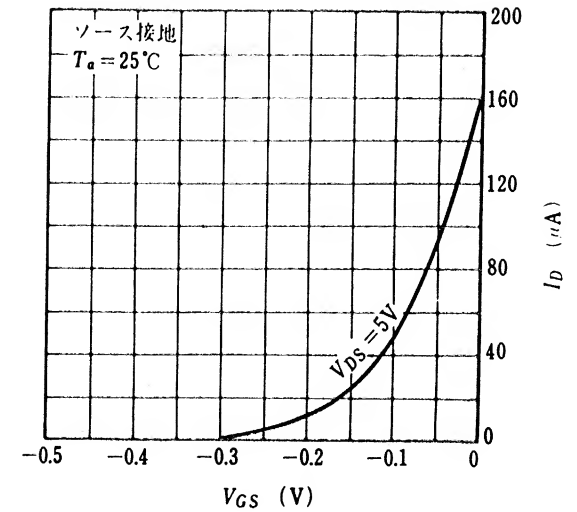
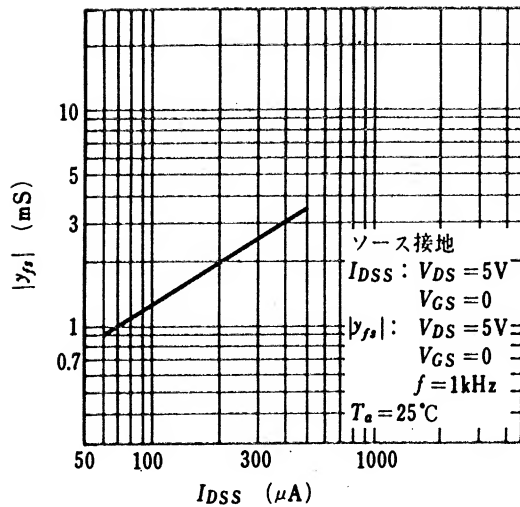
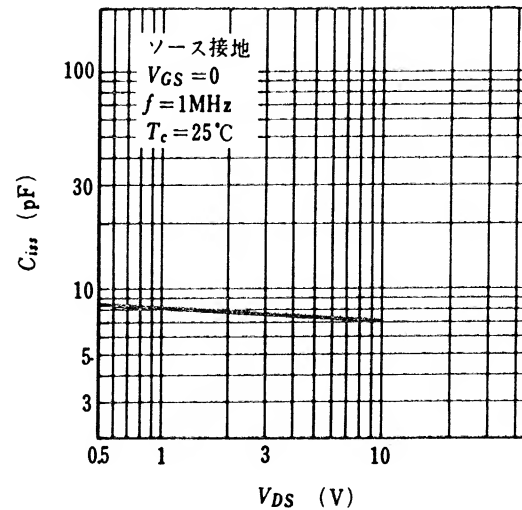
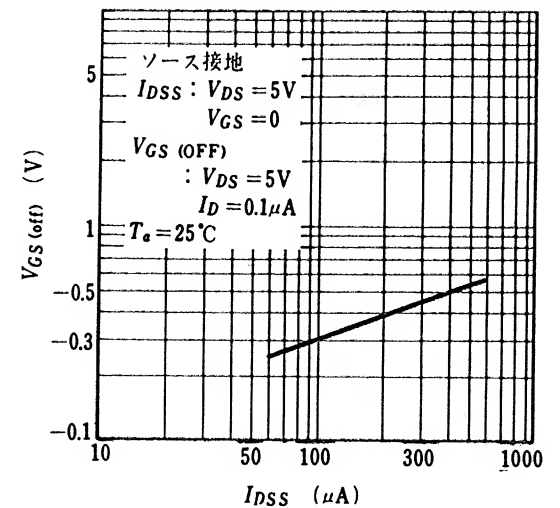
2SK449

Si MOS 型 Nチャンネル　日　電

2SK455, 456

Si 接合型 Nチャンネル

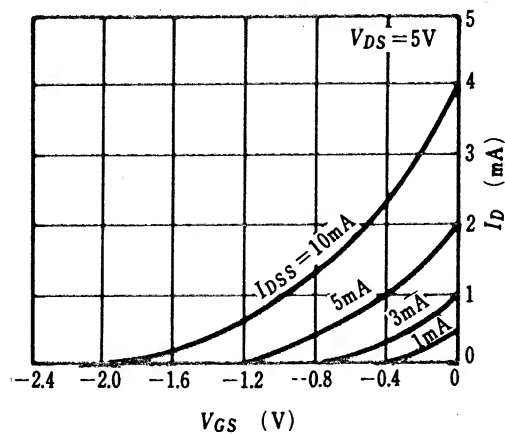
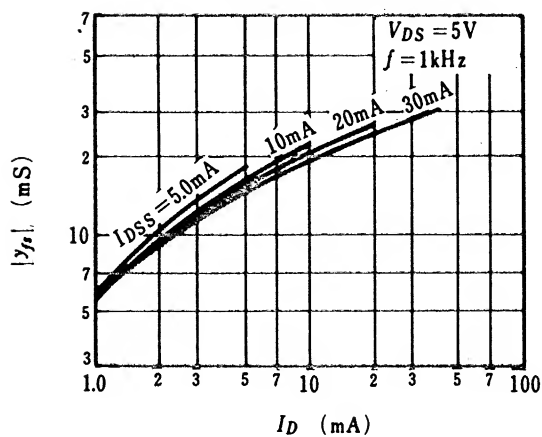
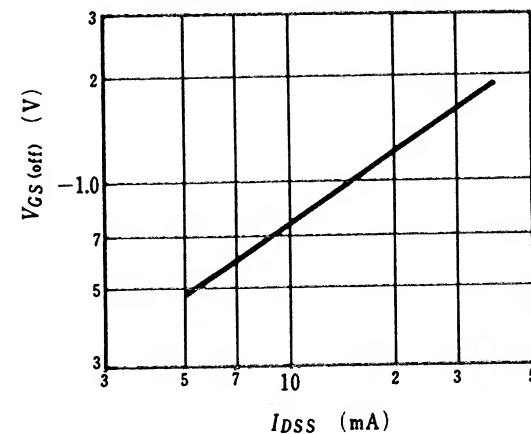
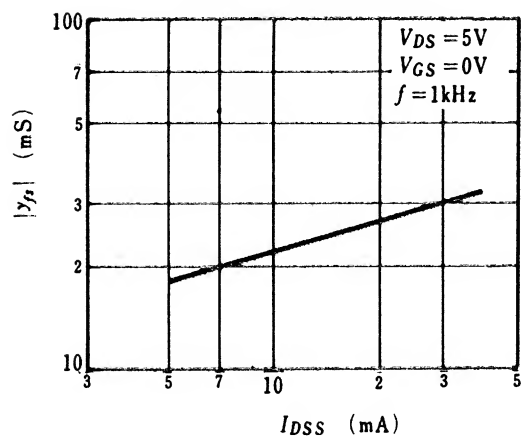
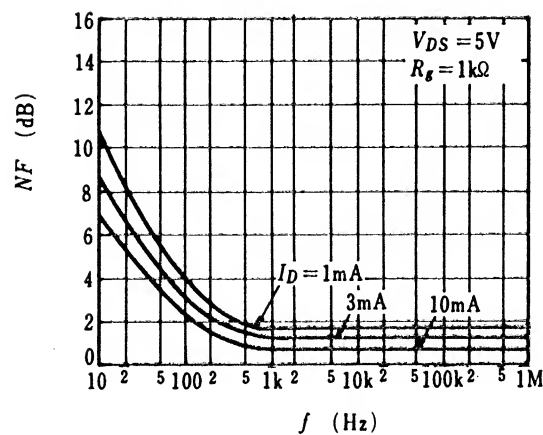
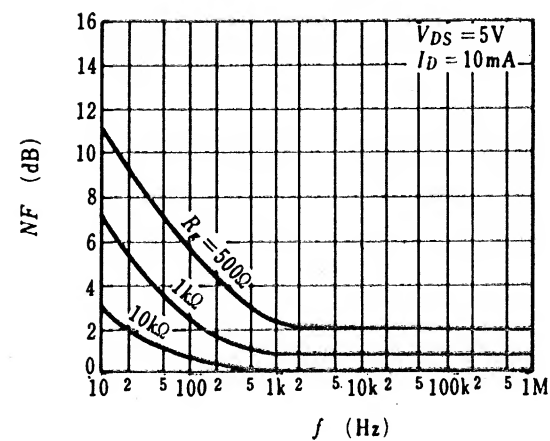
東　芝

I_{DDS} 分類　R：60～120　O：100～200　Y：150～300　G：250～500μA

等価回路

2SK493

Si 接合型
Nチャンネル

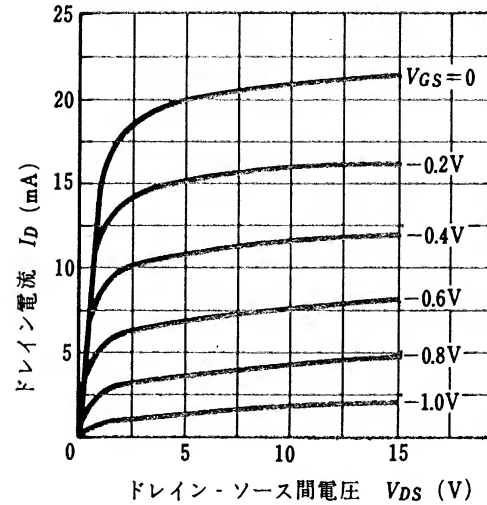
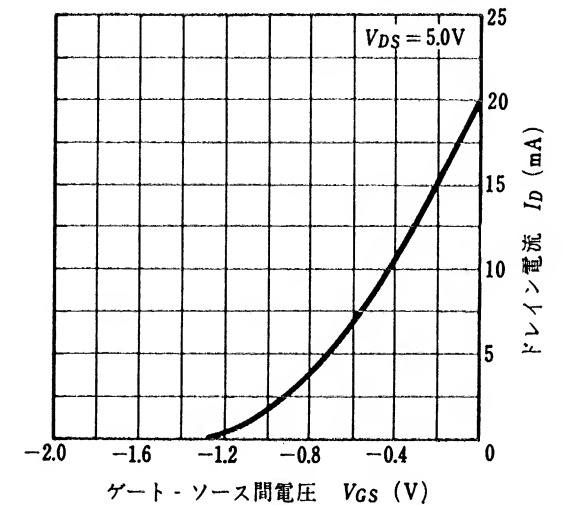
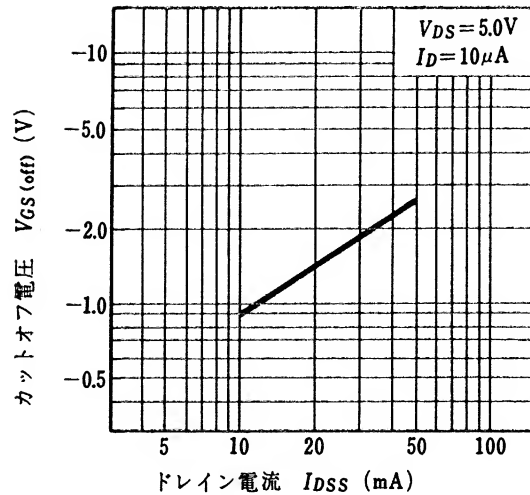
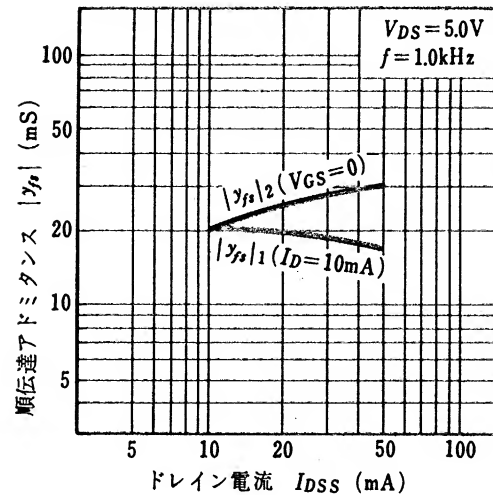
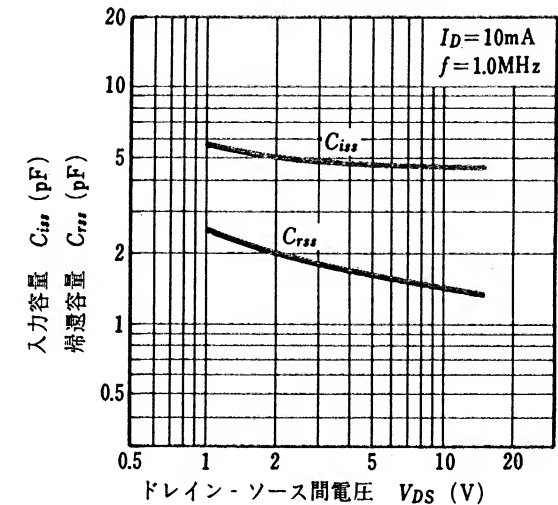
三　洋

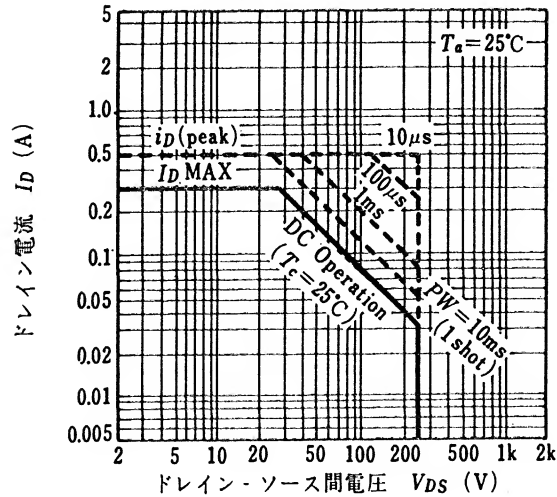
I_D - V_{GS} 特性

$|y_{fs}|$ - I_D 特性

$V_{GS(off)}$ - I_{DSS} 特性

$|y_{fs}|$ - I_{DSS} 特性

NF - f 特性

NF - f 特性

2SK505, 507, 508

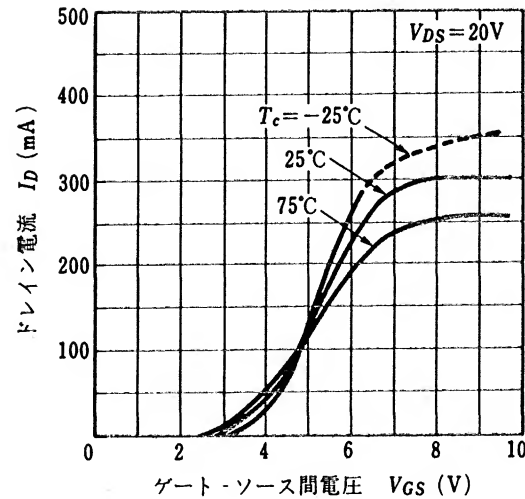
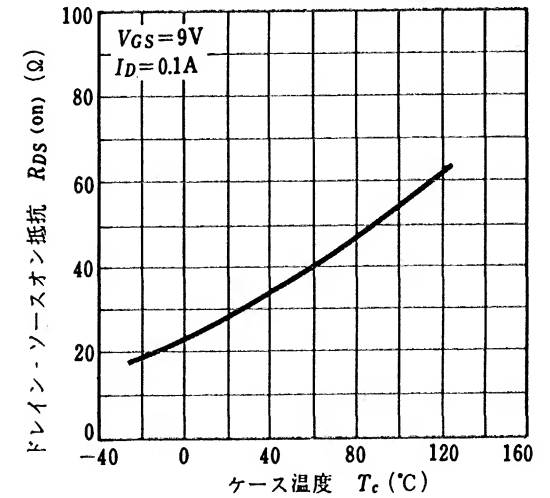
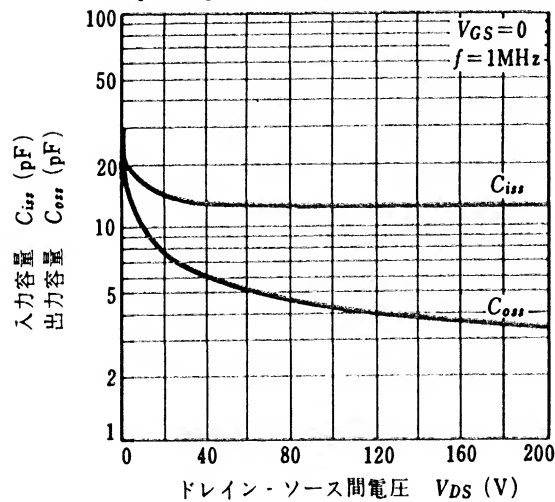
Si 接合型
Nチャンネル

日　電

I_{DSS} 区分

	10～20	15～30	25～50
2SK505, 507	E	F	H
2SK 508	K51	K52	K53

2SK511

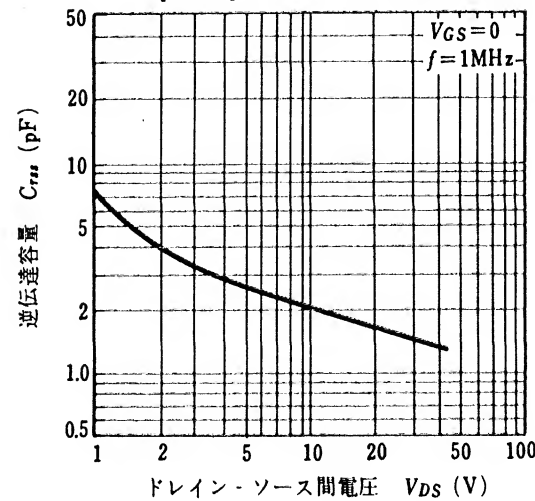
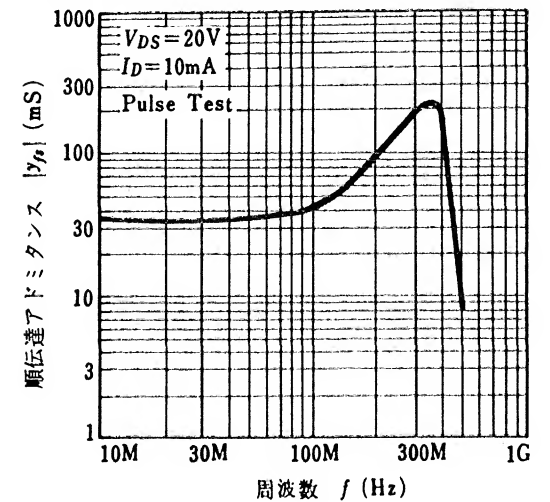
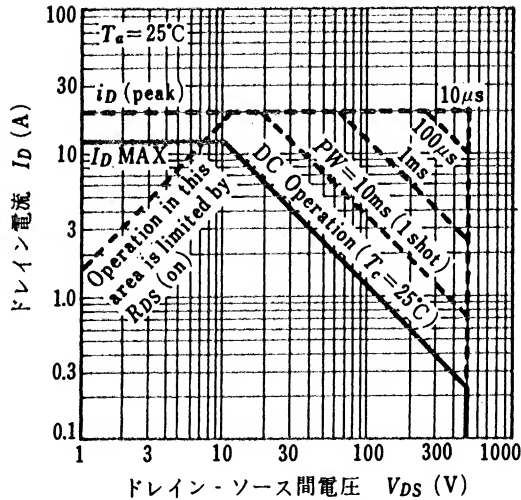
Si MOS型 Nチャンネル　　日立

安全動作領域

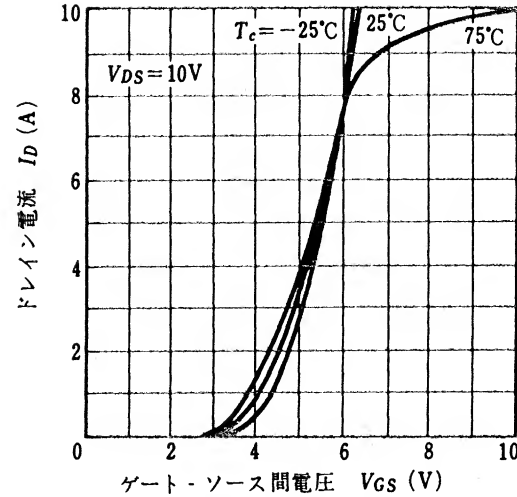
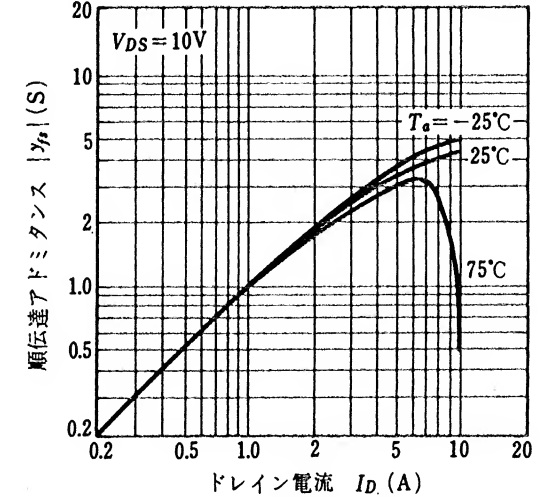
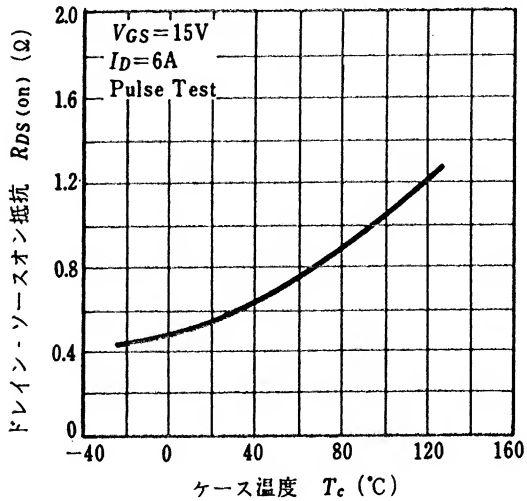
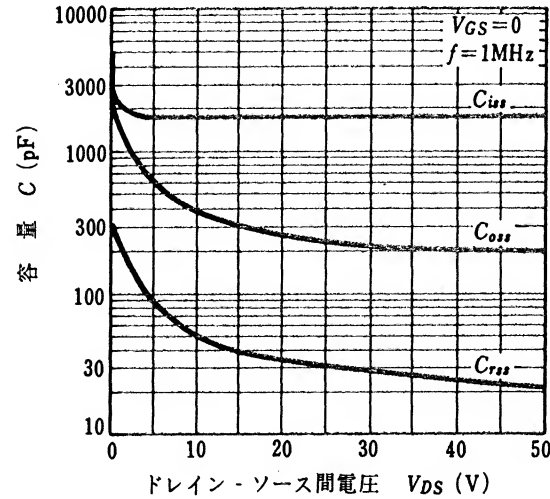
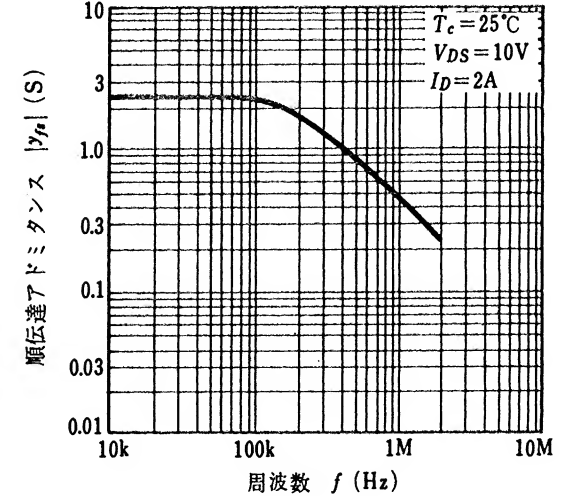
ソース接地伝達特性

ドレイン-ソースオン抵抗対ケース温度特性

入力，出力容量対ドレイン-ソース間電圧特性

逆伝達容量対ドレイン-ゲート電圧特性

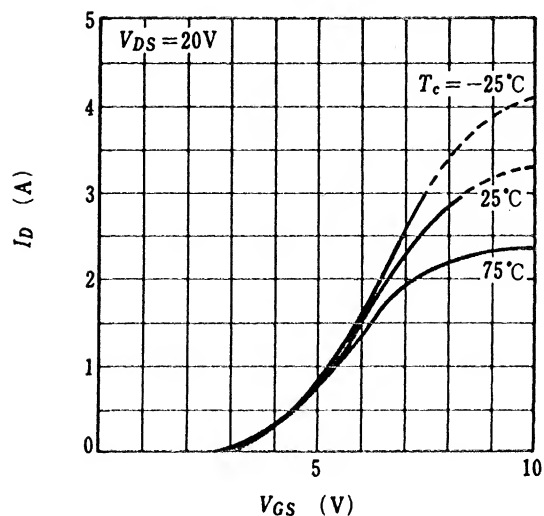
順伝達アドミタンス対周波数特性

2SK512

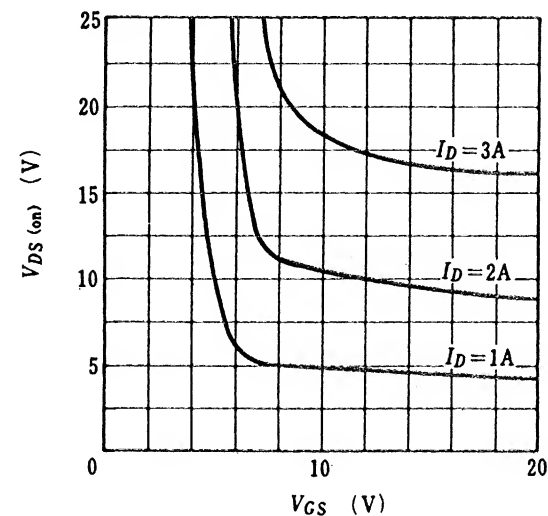
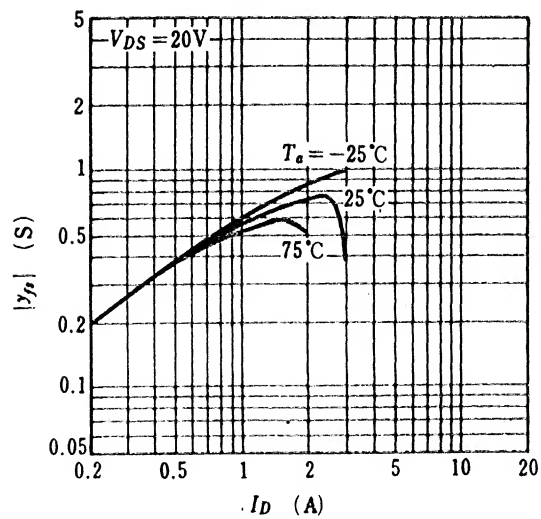
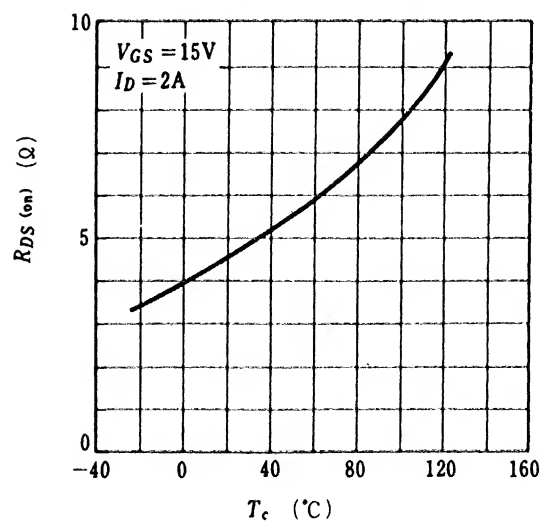
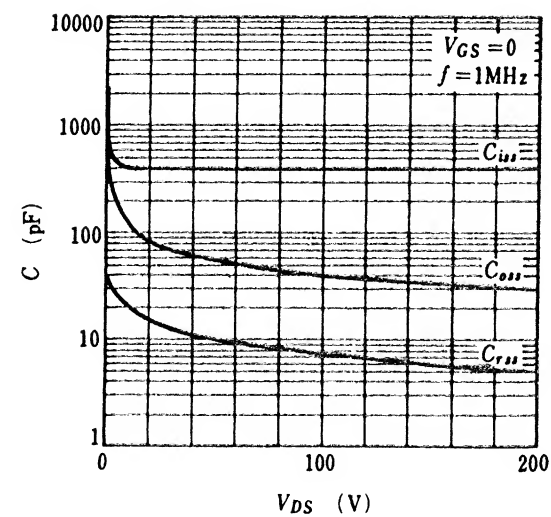
Si MOS型
Nチャンネル

日　立

安全動作領域

ソース接地伝達静特性

順伝達アドミタンス対
ドレイン電流特性

ドレイン・ソースオン抵抗対
ケース温度特性

容量対ドレイン・ソース間電圧特性

順伝達アドミタンス対周波数特性

2SK513

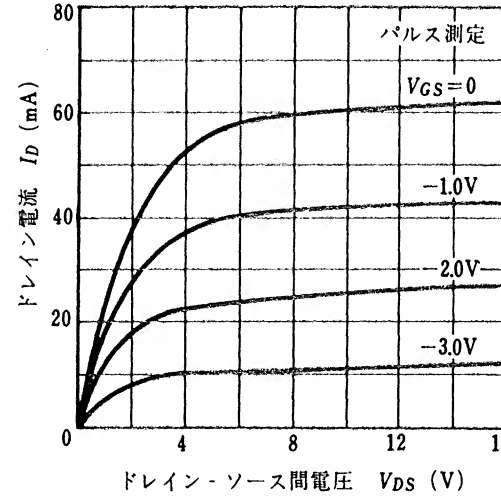
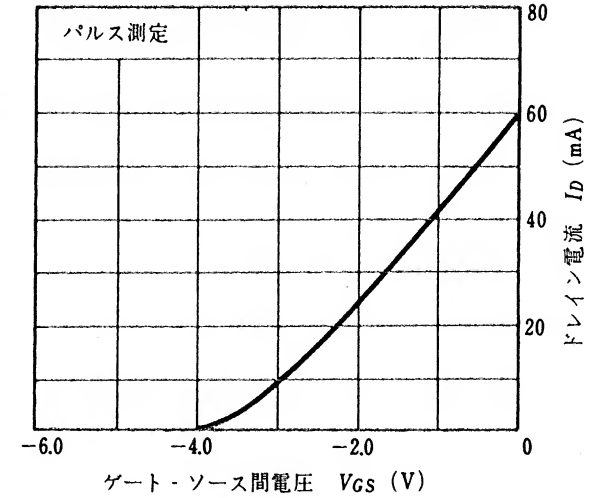
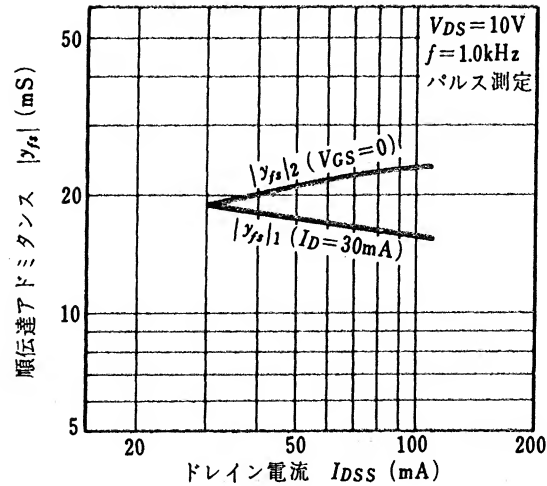
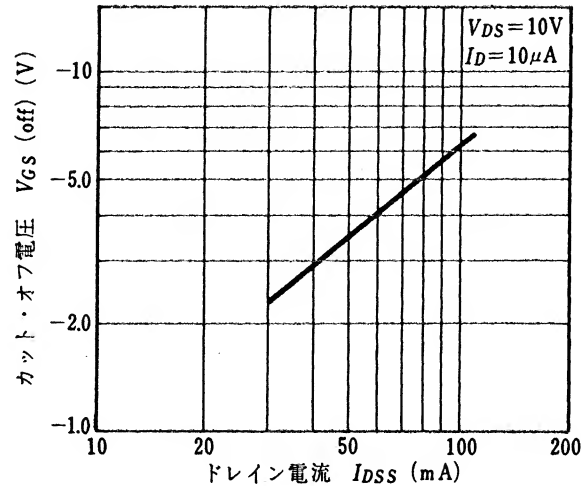
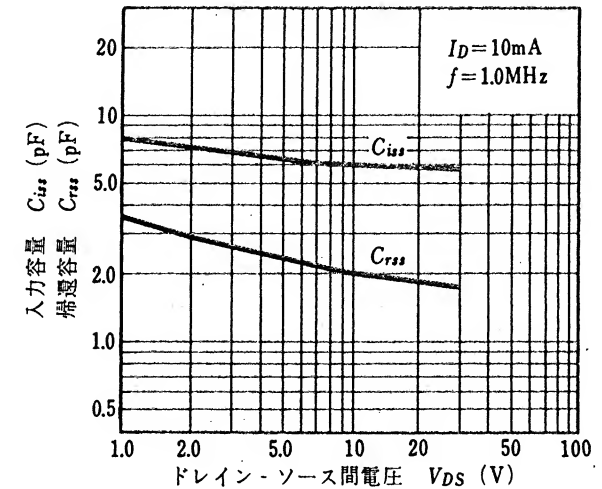
Si MOS型
Nチャンネル
日　立

安全動作領域

I_D - V_{GS} 特性

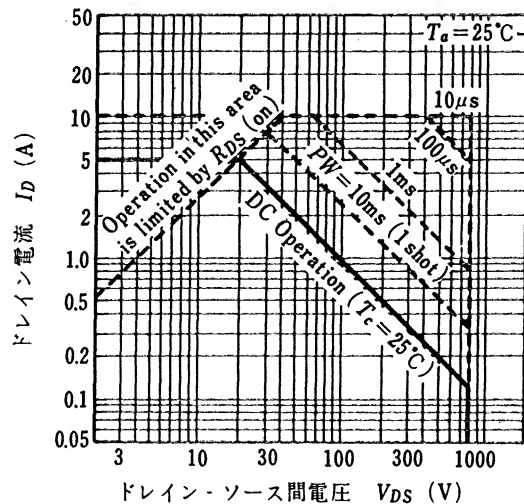
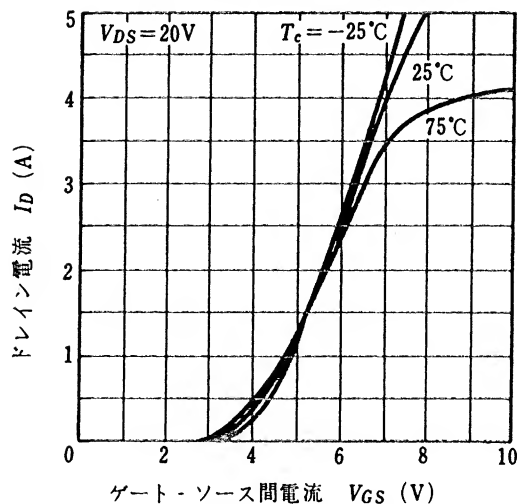
$V_{DS(on)}$ - V_{GS} 特性

$R_{DS(on)}$ - T_C 特性

C_{iss}, C_{oss}, C_{rss} - V_{DS} 特性

2SK518, 519, 520

Si 接合型 Nチャンネル　日電

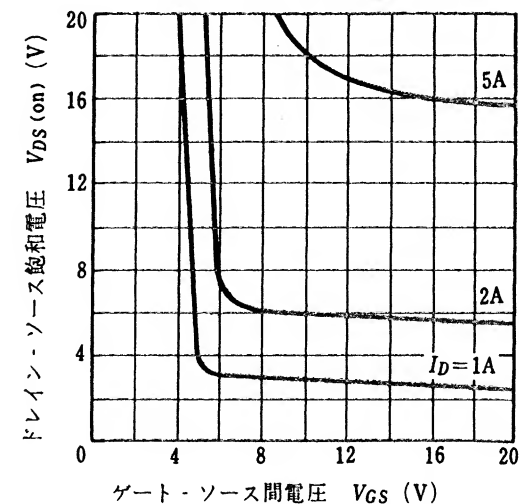
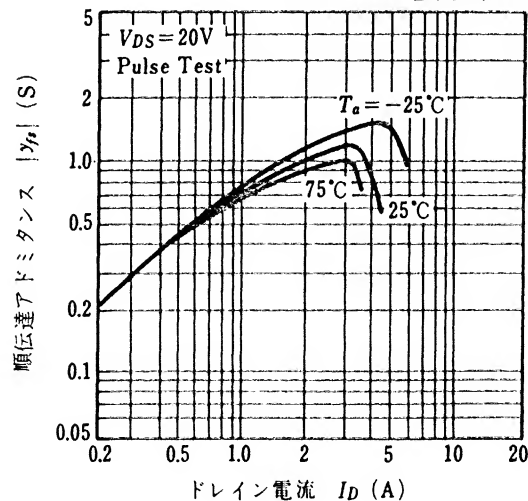
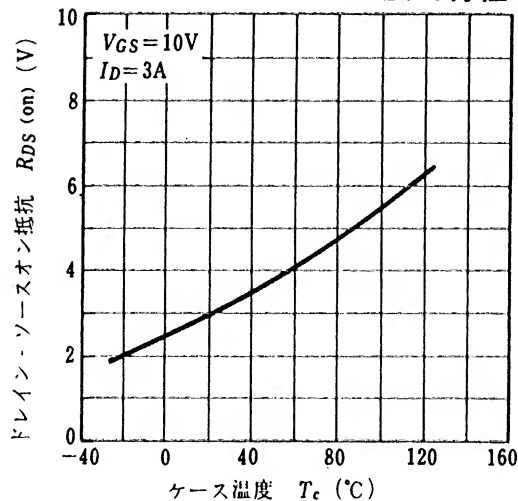
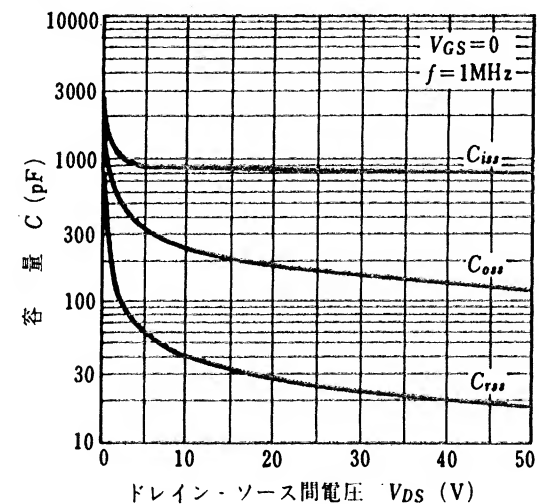
IDSS 区分

	30～50	45～65	60～80	75～95	90～110
2SK518, 519	E	F	H	J	K
2SK520	K41	K42	K43	K44	K45

2SK534

Si MOS型
Nチャンネル

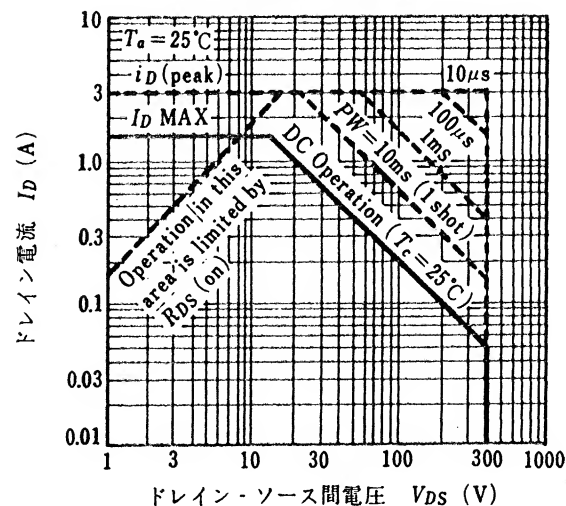
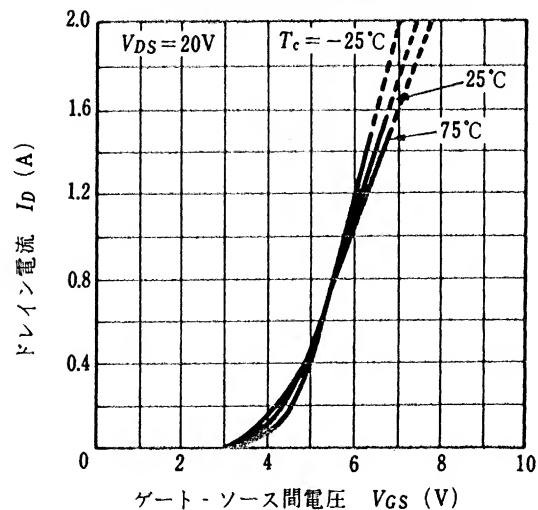
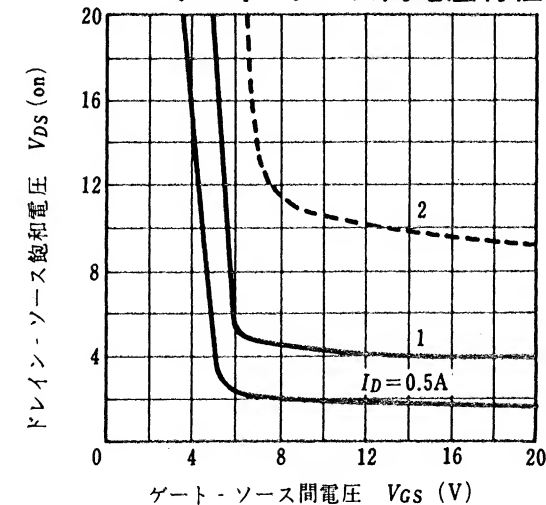
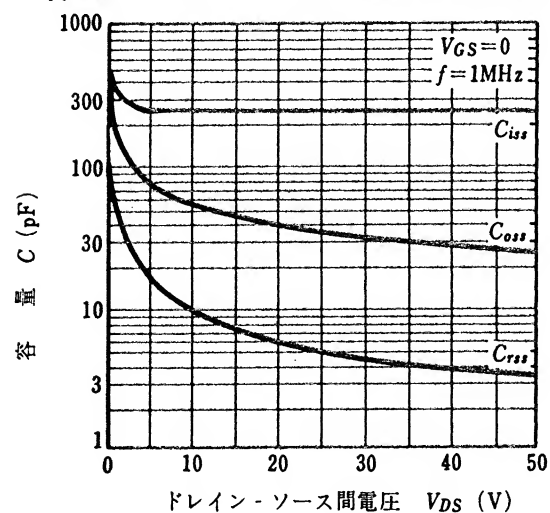
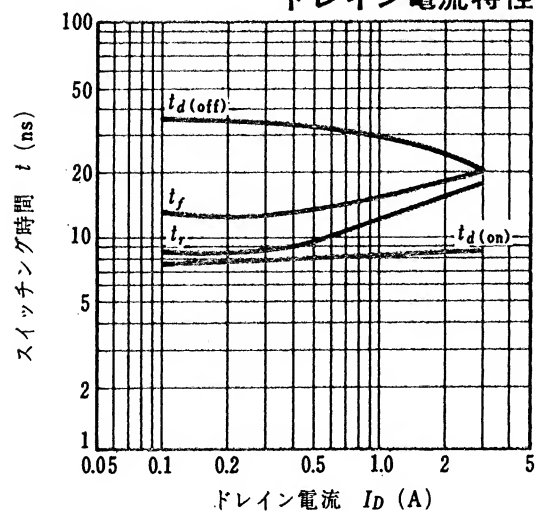
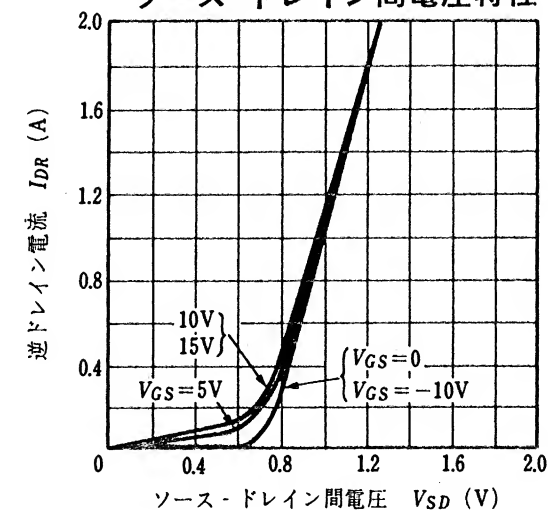
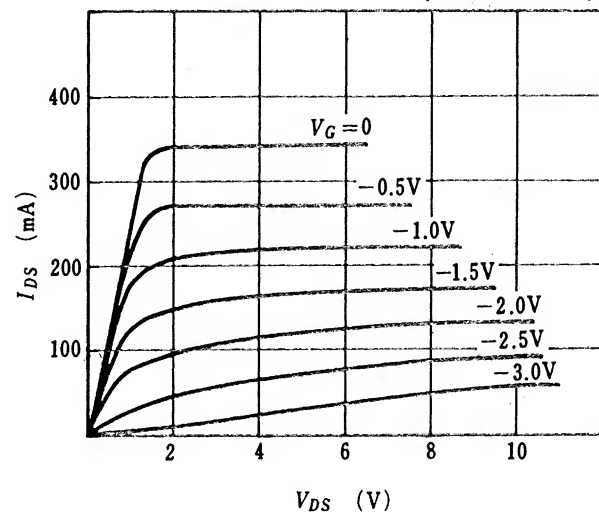
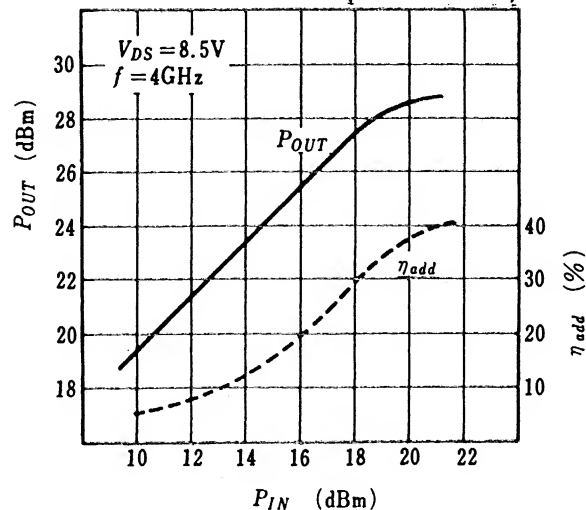
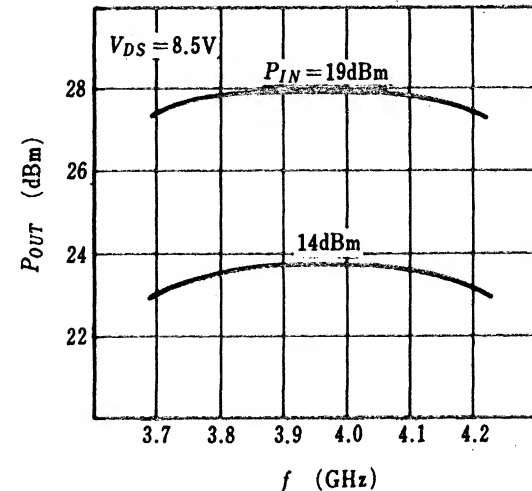
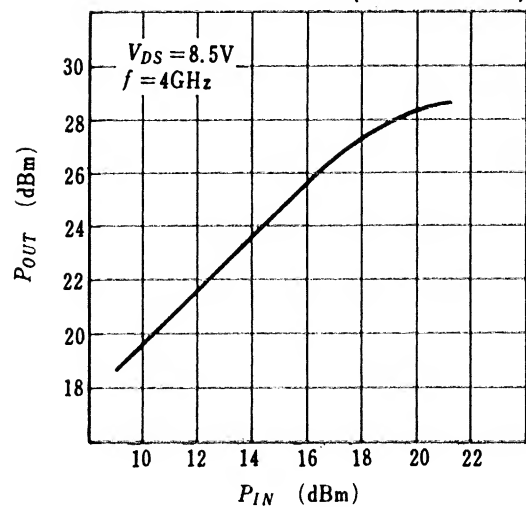
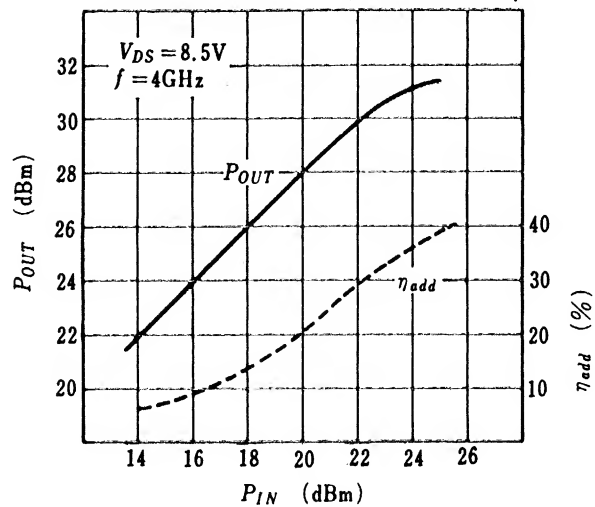
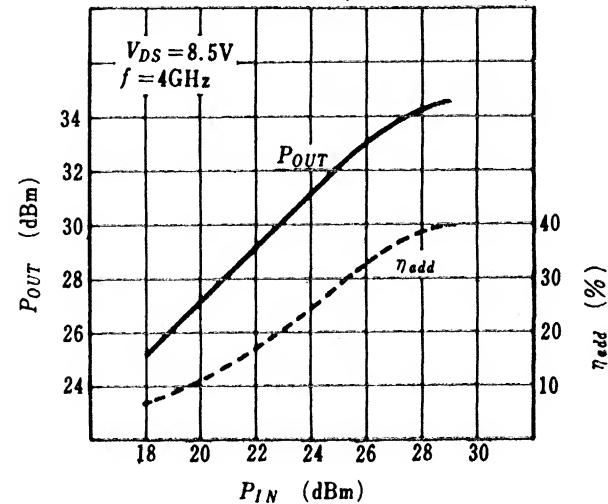
日 立

安全動作領域

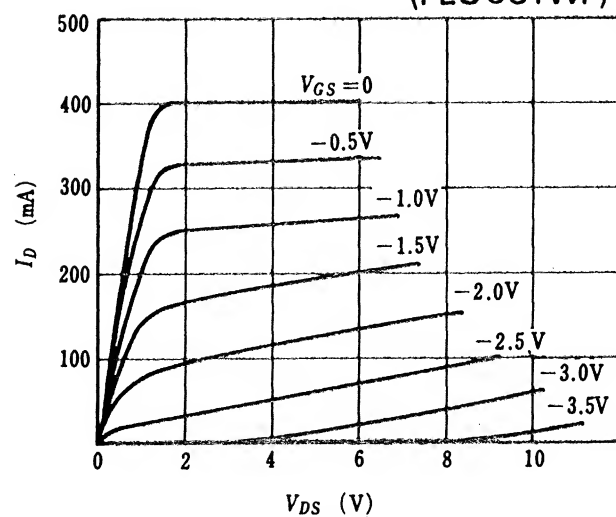
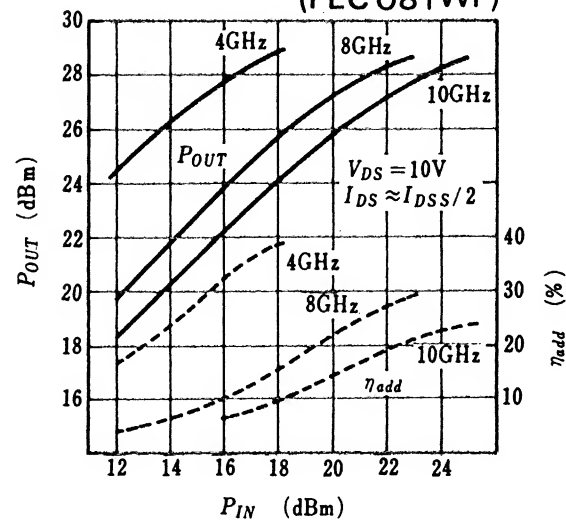
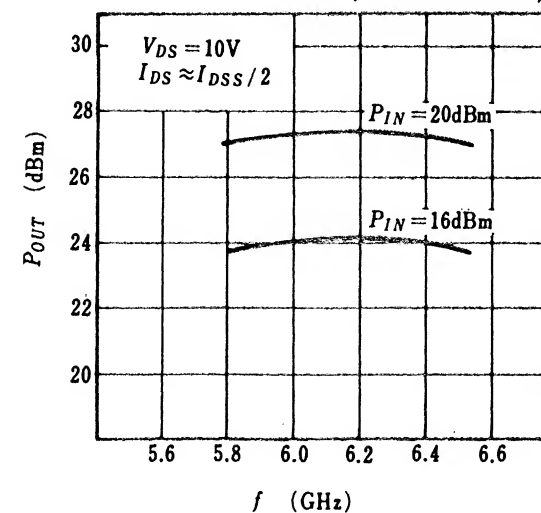
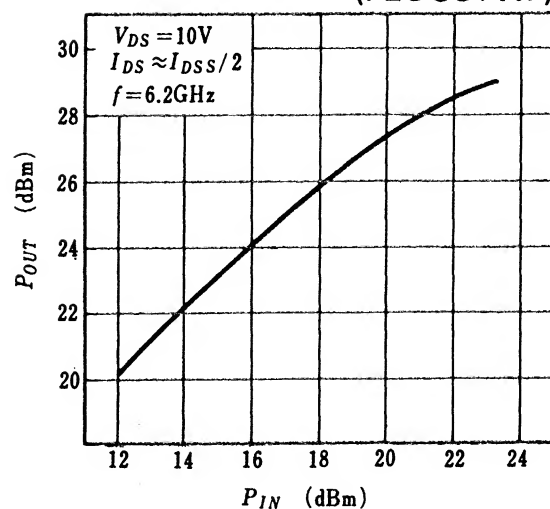
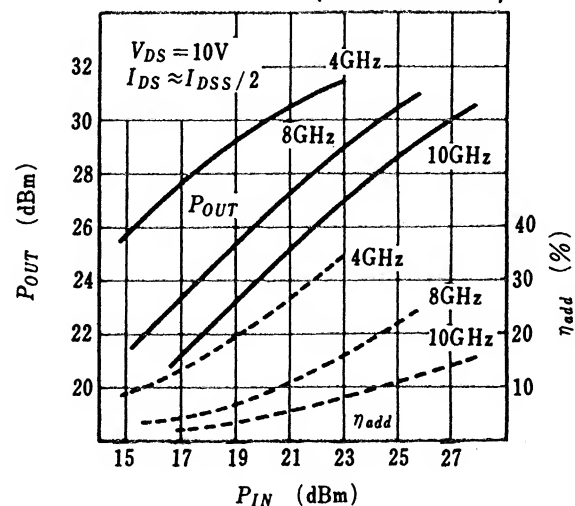
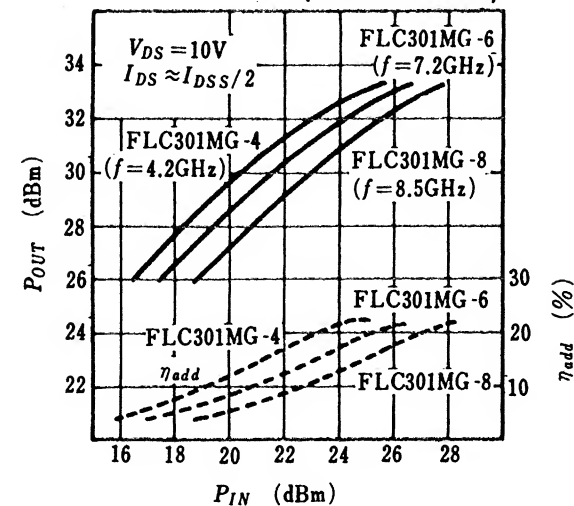
ソース接地伝達静特性

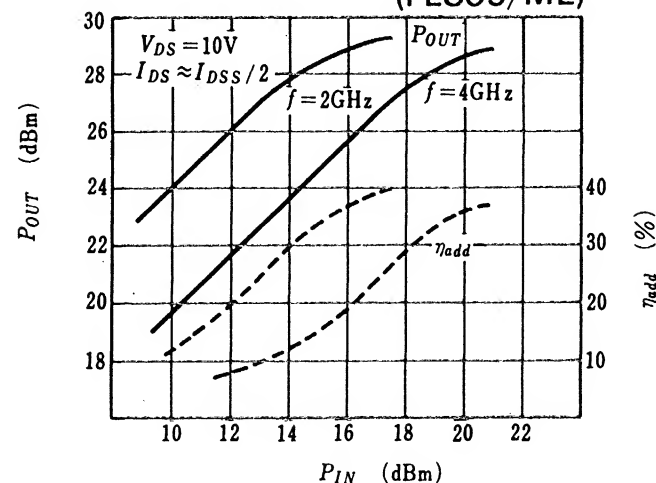
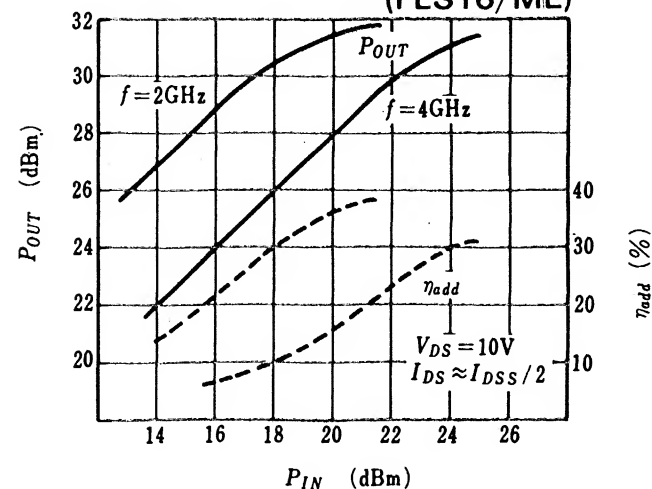
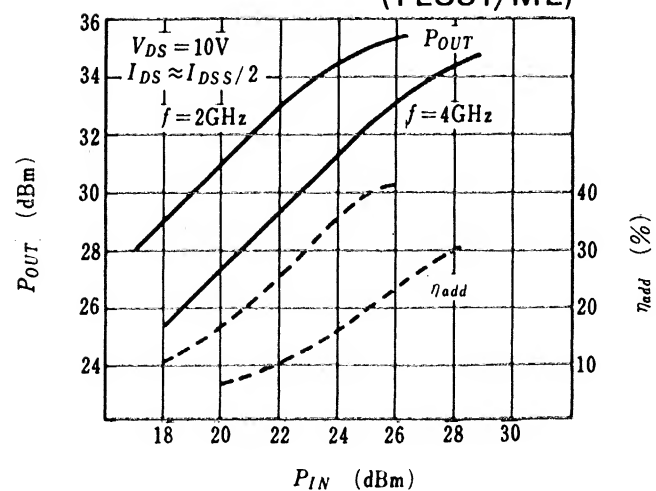
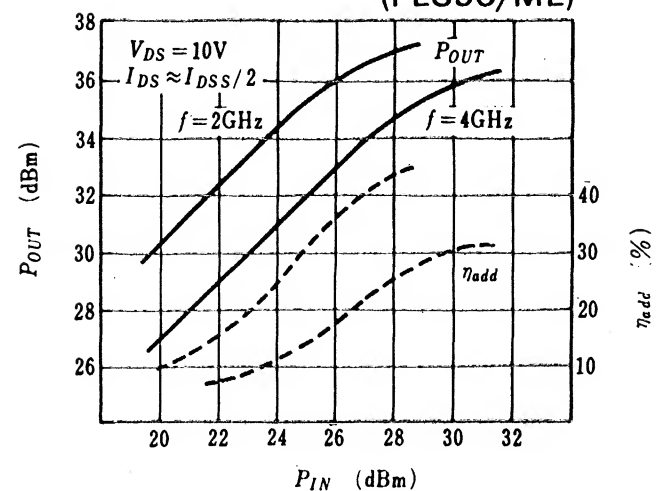
ドレイン-ソース飽和電圧対ゲート-ソース間電圧特性

順伝達アドミタンス対ドレイン電流特性

ドレイン-ソースオン抵抗対ケース温度特性

容量対ドレイン-ソース間電圧特性

2SK535

Si MOS型 Nチャンネル　日立

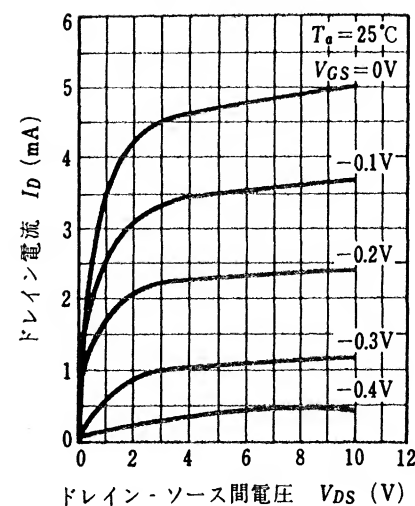
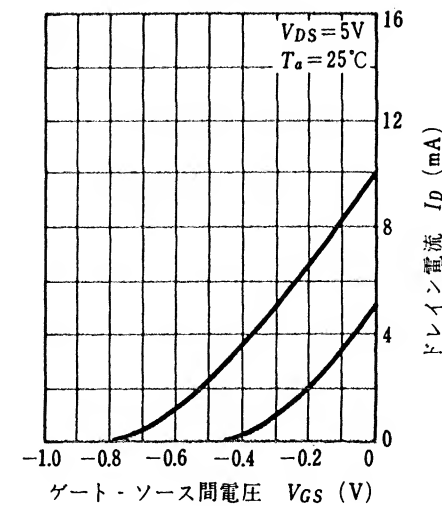
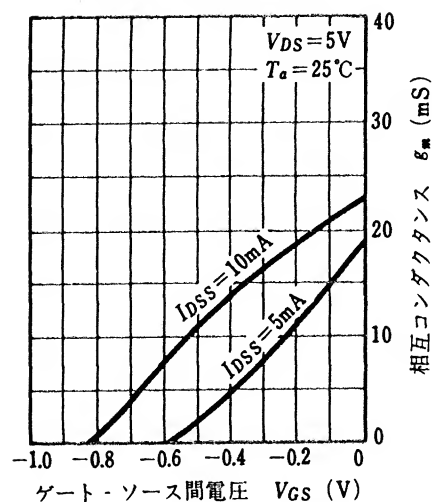
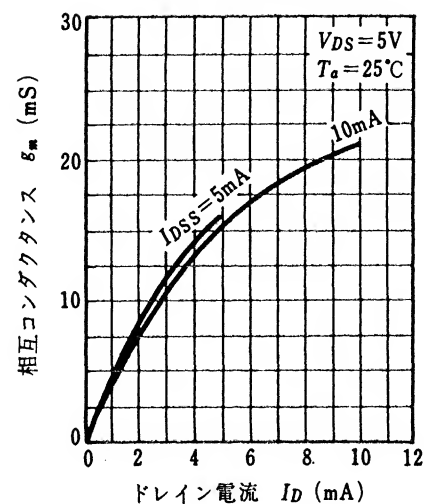
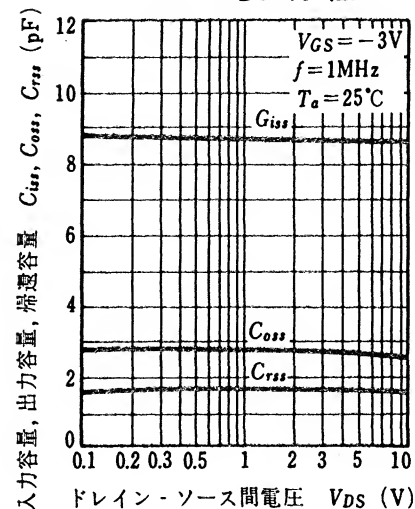
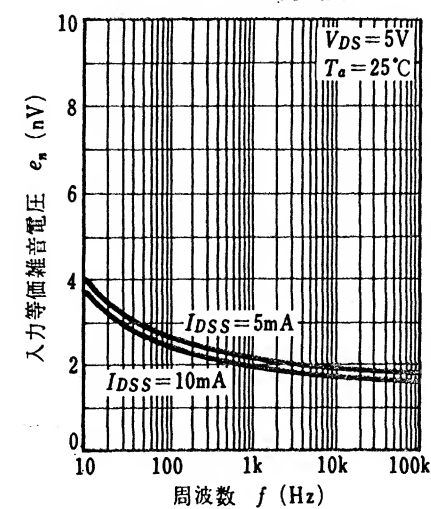
安全動作領域

ソース接地伝達静特性

ドレイン-ソース飽和電圧対ゲート-ソース間電圧特性

容量対ドレイン-ソース間電圧特性

スイッチング時間対ドレイン電流特性

逆ドレイン電流対ソース-ドレイン間電圧特性

FLC08ME, 15ME, 30ME
GaAs型
Nチャンネル
富士通
IDS - VDS 特性
(FLC08ME)
VG=0
−0.5V
−1.0V
−1.5V
−2.0V
−2.5V
−3.0V
IDS (mA)
VDS (V)
POUT - PIN 特性
(FLC08ME)
VDS=8.5V
f=4GHz
POUT
ηadd
POUT (dBm)
ηadd (%)
PIN (dBm)
POUT - f 特性
(FLC08ME)
VDS=8.5V
PIN=19dBm
14dBm
POUT (dBm)
f (GHz)
POUT - PIN 特性
(FLC08ME)
VDS=8.5V
f=4GHz
POUT (dBm)
PIN (dBm)
Pout - PIN 特性
(FLS15ME)
VDS=8.5V
f=4GHz
POUT
ηadd
POUT (dBm)
ηadd (%)
PIN (dBm)
POUT - PIN 特性
(FLC30ME)
VDS=8.5V
f=4GHz
POUT
ηadd
POUT (dBm)
ηadd (%)
PIN (dBm)

FLC081WF, 151WF, 301MG　GaAs型 Nチャンネル　富士通

I_D - V_{DS} 特性 (FLC081WF)

P_{OUT} - P_{IN} 特性 (FLC081WF)

P_{OUT} - f 特性 (FLC081WF)

P_{OUT} - P_{IN} 特性 (FLC081WF)

P_{OUT} - P_{IN} 特性 (FLC151WF)

P_{OUT} - P_{IN} 特性 (FLC301MG)

FLS09/ME, 16/ME, 31/ME, 50/ME GaAs型 Nチャンネル

富 士 通

M47F

Si 接合型 Nチャンネル 松　下

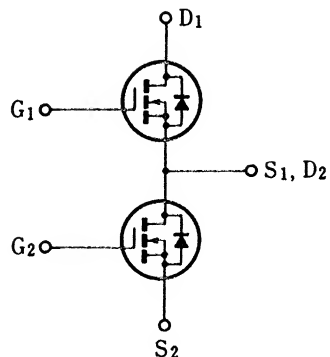
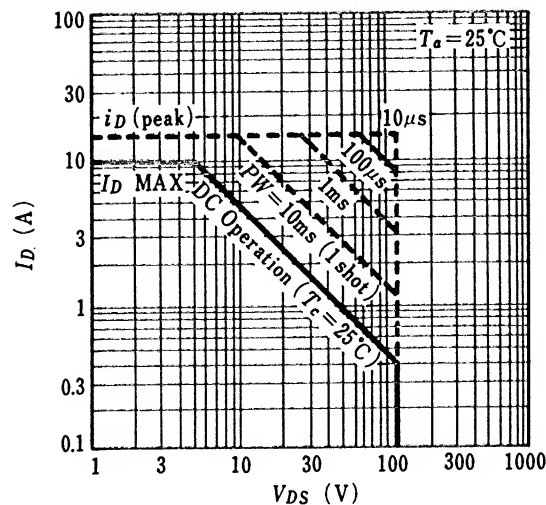
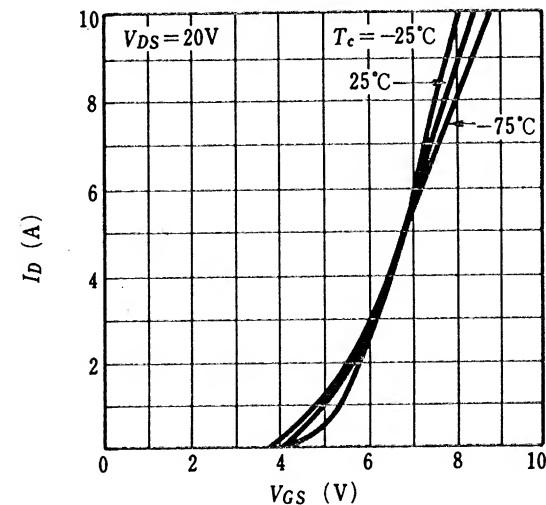
I_{DSS} ランク分類

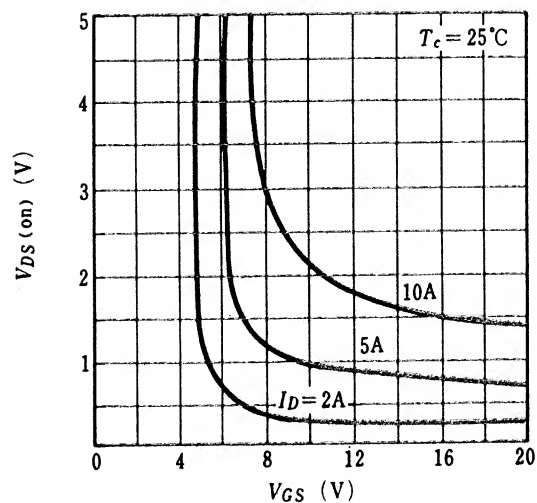
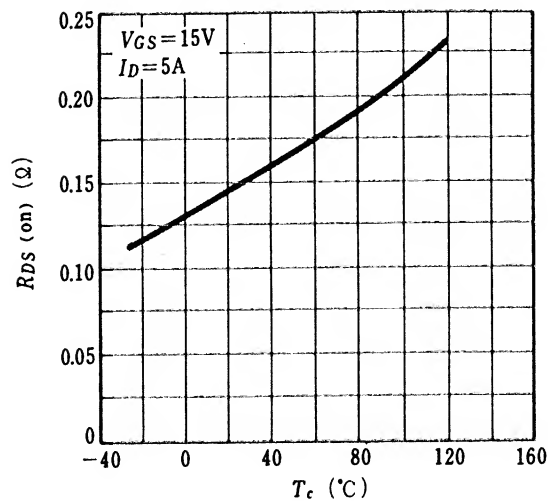
Class	A	B	C	D
I_{DSS} (mA)	0.5～3	2～6	5～12	10～20

PM1210B

Si MOS型
複合Nチャンネル

日　立

安全動作領域

$T_a=25°C$
i_D (peak)
I_D MAX
10μs
100μs
1ms
PW=10ms (1 shot)
DC Operation ($T_c=25°C$)
I_D (A)
V_{DS} (V)

ソース接地伝達特性

$V_{DS(on)}$ - V_{GS} 特性

$R_{DS(on)}$ - T_c 特性

C - V_{DS} 特性

PM1220B

Si MOS型 複合Nチャンネル

日　　立

ソース接地伝達特性

VDS = 10V　Tc = −25°C

25°C

75°C

ID (A)

25 20 15 10 5 0

0 2 4 6 8 10

VGS (V)

|yfs| - ID 特性

VDS = 10V

Pulse Test

Ta = −25°C

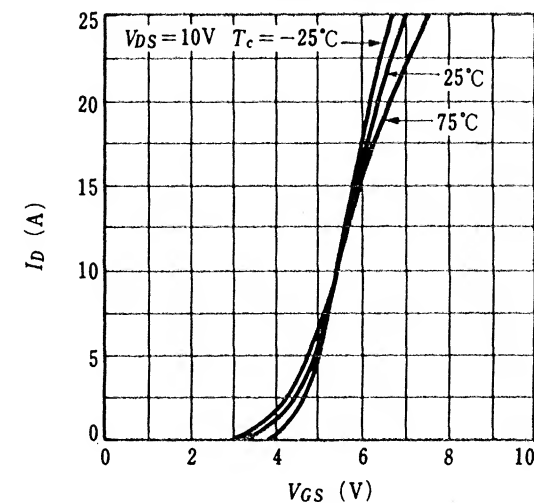
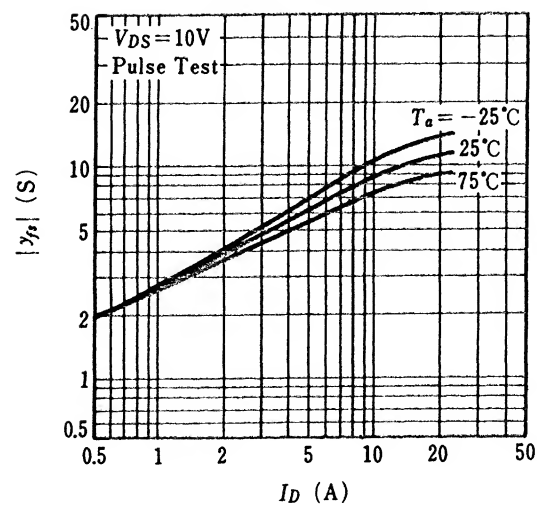
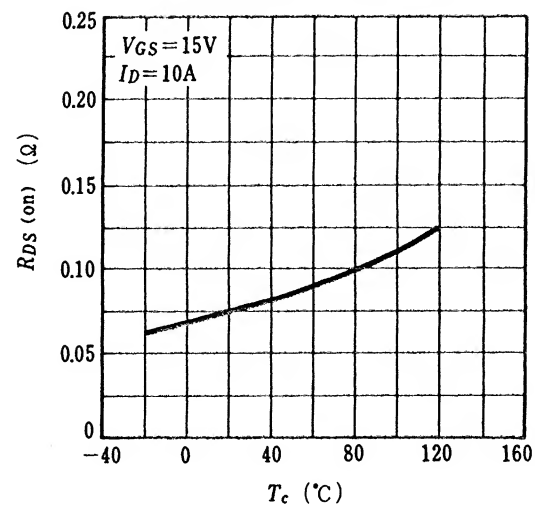
25°C

75°C

|yfs| (S)

50 20 10 5 2 1 0.5

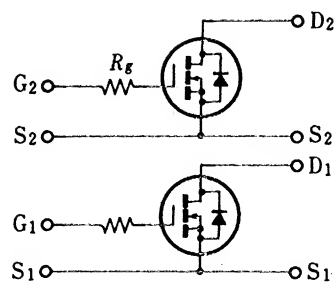
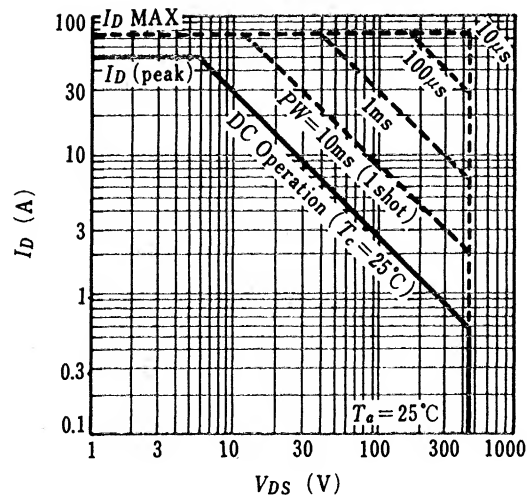
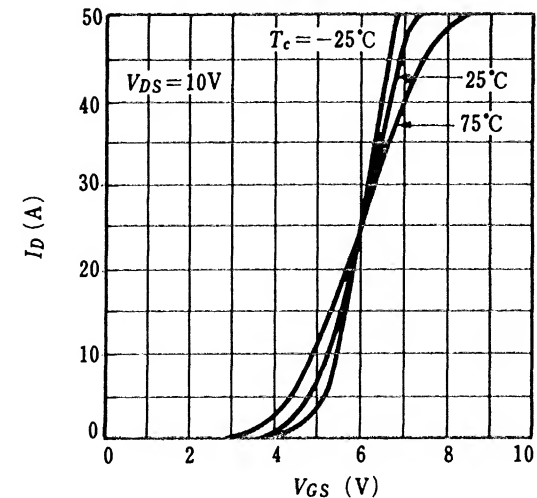
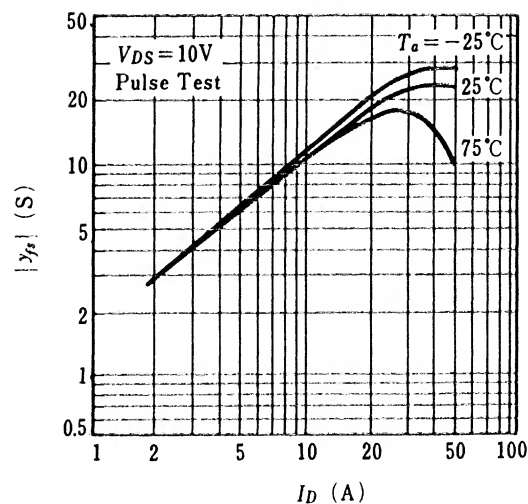
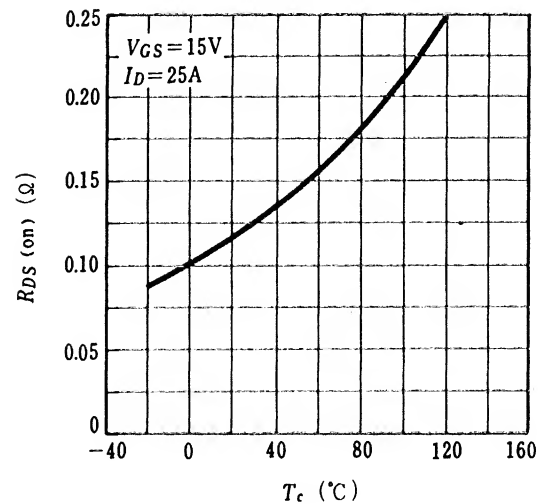
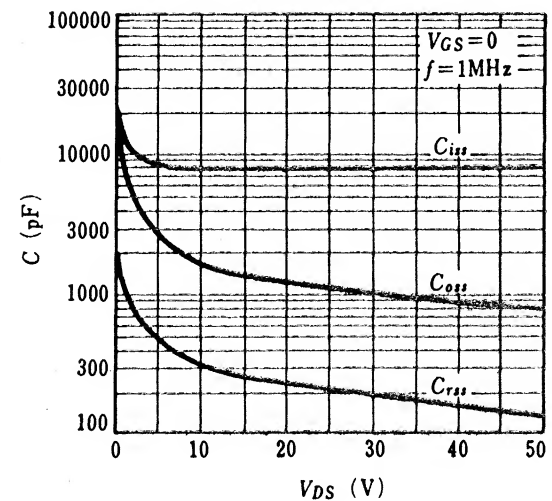
0.5 1 2 5 10 20 50

ID (A)

RDS (on) - Tc 特性

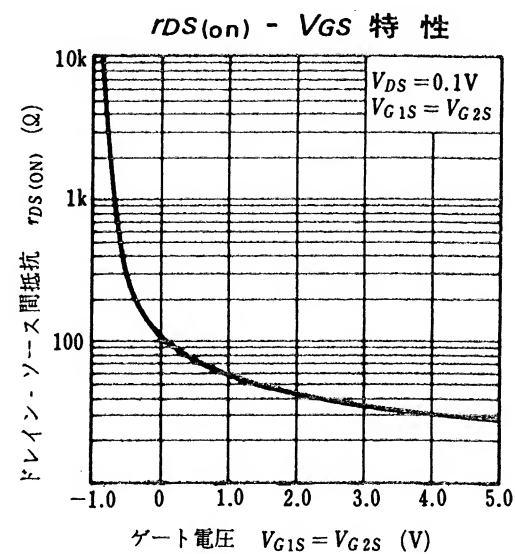
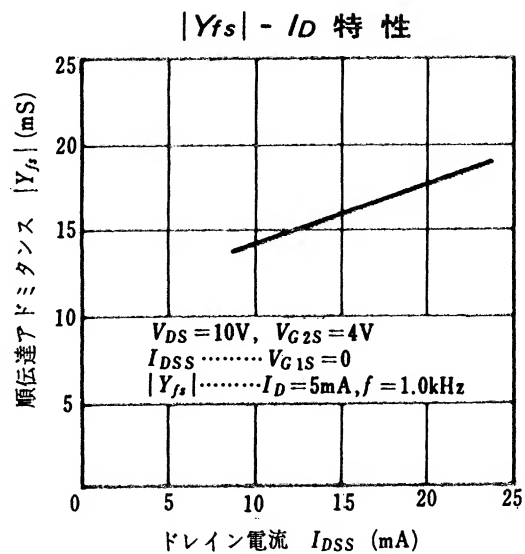
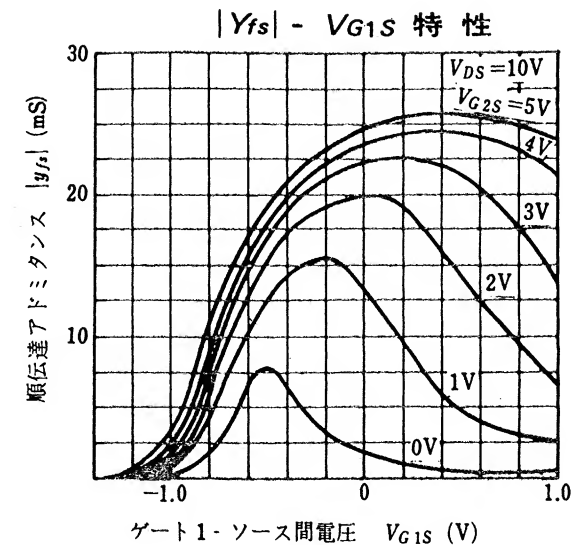
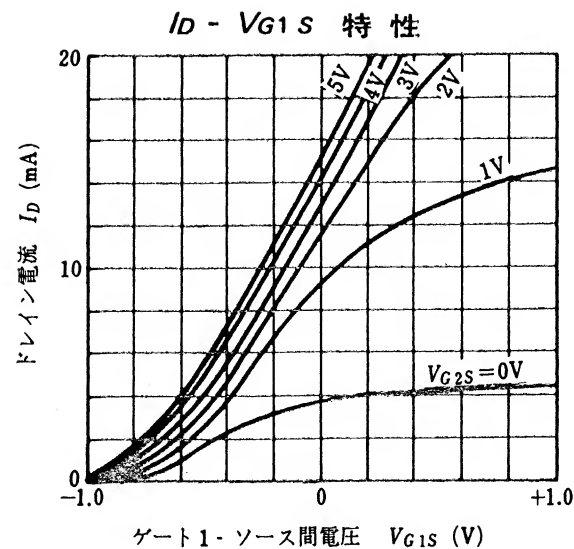
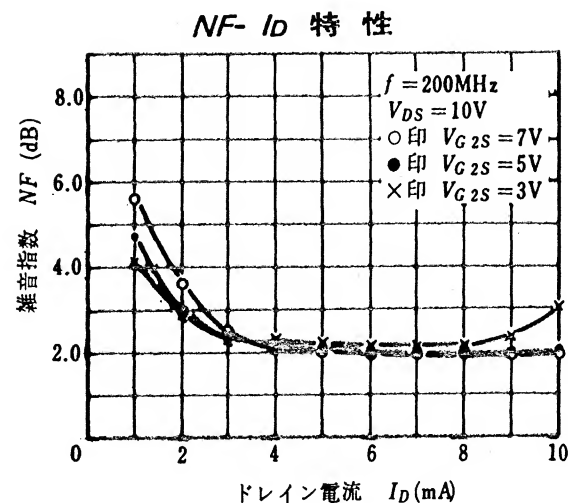
C - VDS 特性

PM4550C

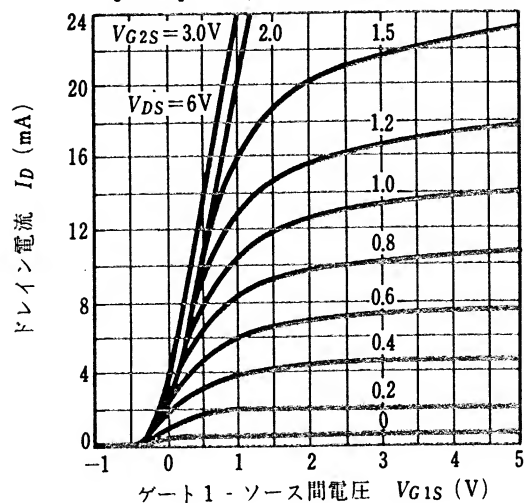
Si MOS型 複合Nチャンネル

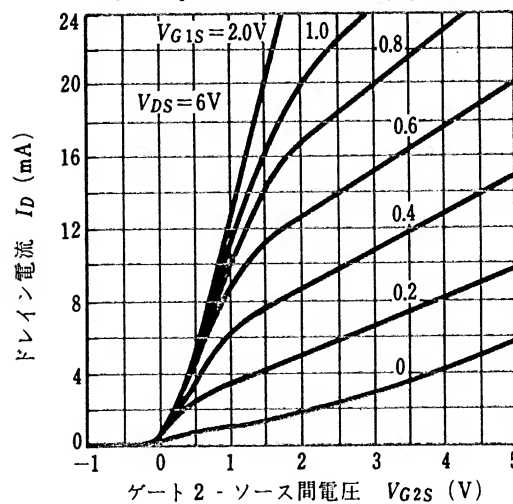
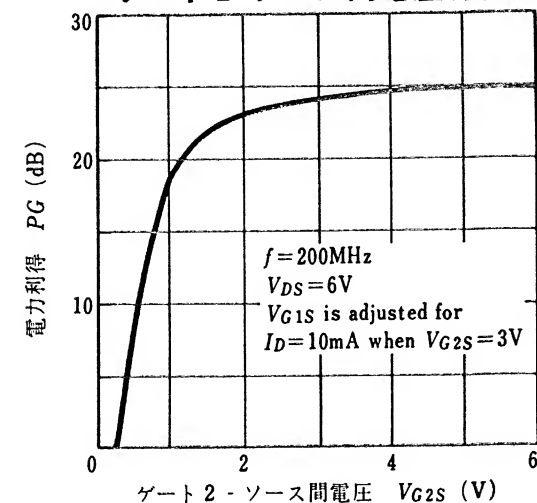
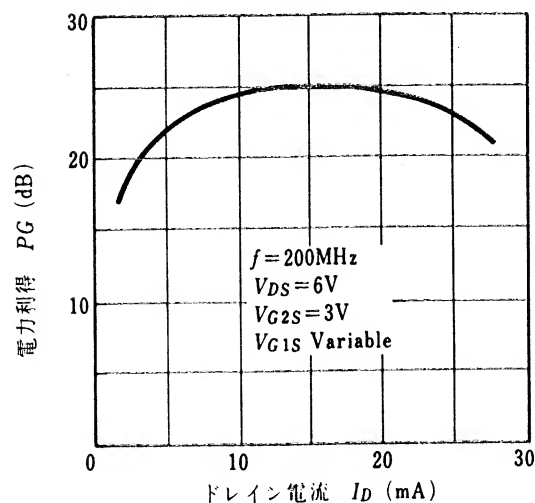
日　立

ソース接地伝達特性

$|y_{fs}|$ - I_D 特性

$R_{DS\,(on)}$ - T_c 特性

C - V_{DS} 特性

3SK47

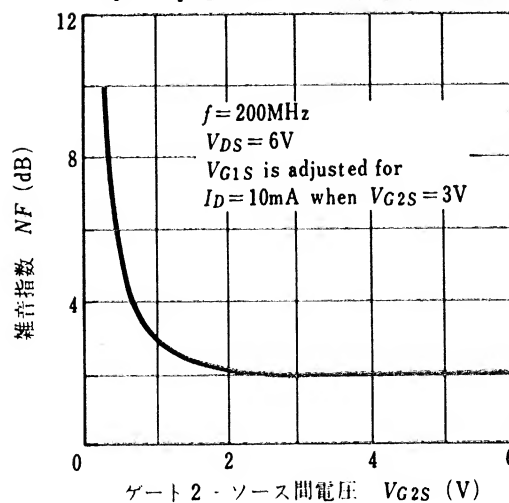
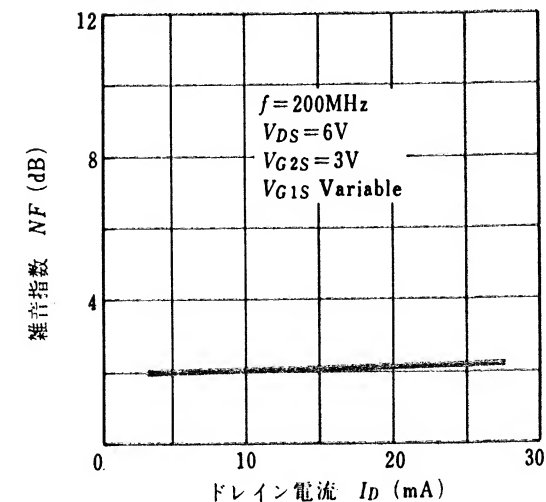
Si MOS型 Nチャンネル 日　電

I_{DSS} 区分／M：4～11mA　L：9～19mA　K：17～25mA

3SK60

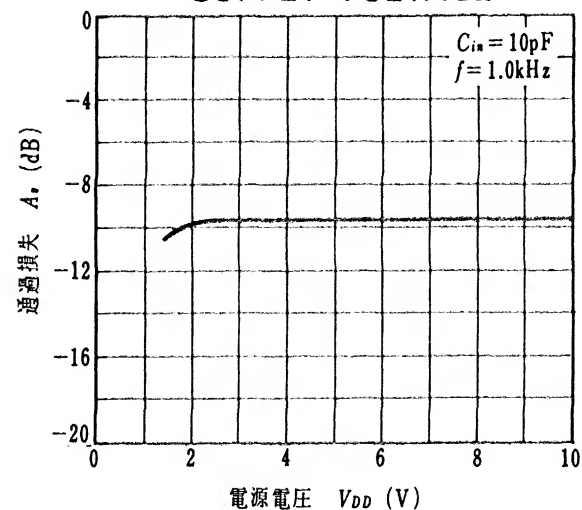
Si MOS型 複合Nチャンネル

日　立

ドレイン電流対
ゲート 1-ソース間電圧特性

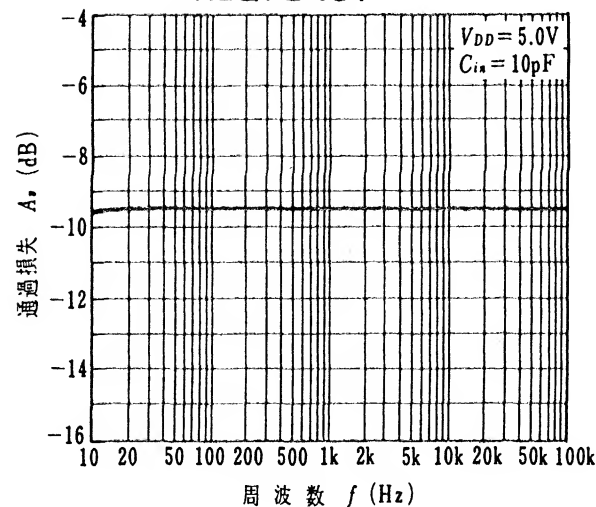
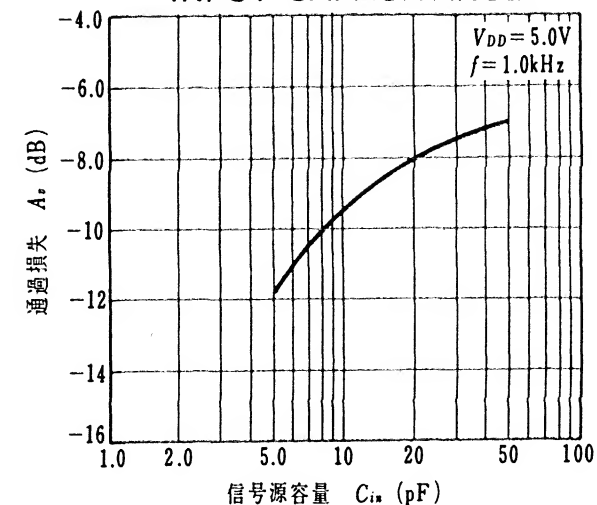
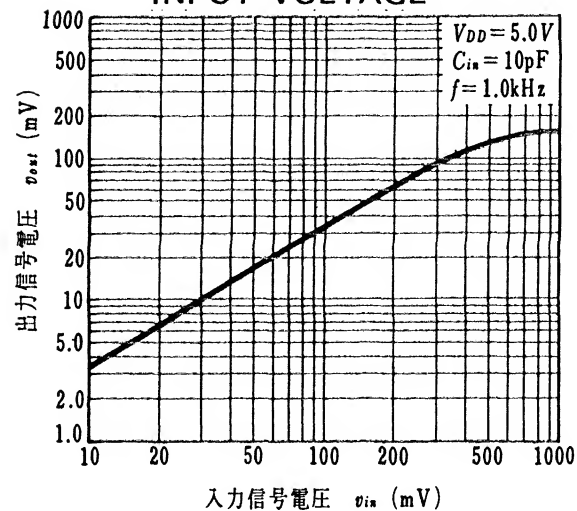
ドレイン電流対

電力利得対

電力利得対ドレイン電流特性

雑音指数対
ゲート 2-ソース間電圧特性

雑音指数対ドレイン電流特性

3SK71

Si接合型
Nチャンネル

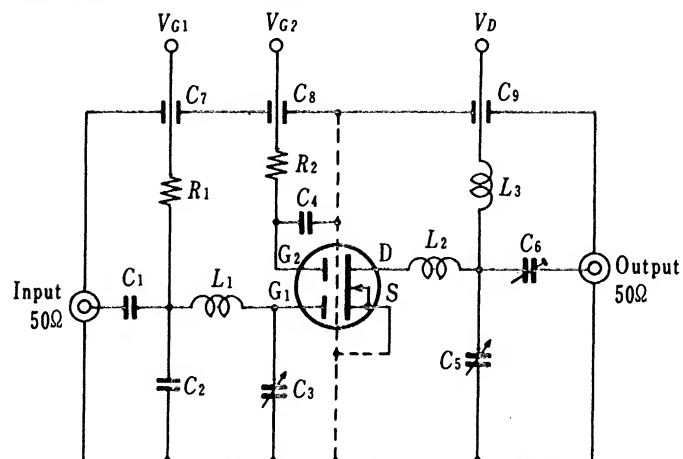
VOLTAGE GAIN vs.
SUPPLY VOLTAGE

C_{in} = 10pF
f = 1.0kHz

0
-4
-8
-12
-16
-20
通過損失 A_v (dB)

0 2 4 6 8 10
電源電圧 V_{DD} (V)

3SK81, 136

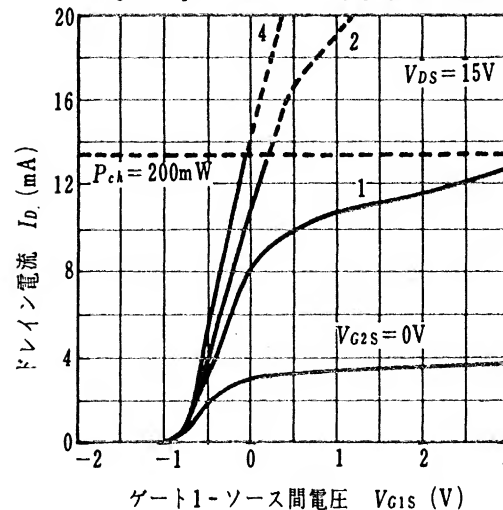
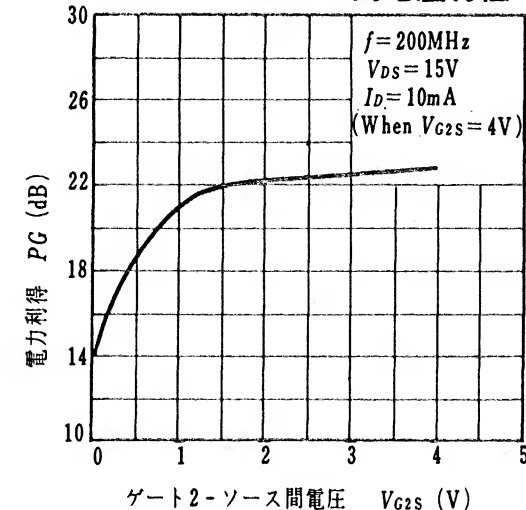
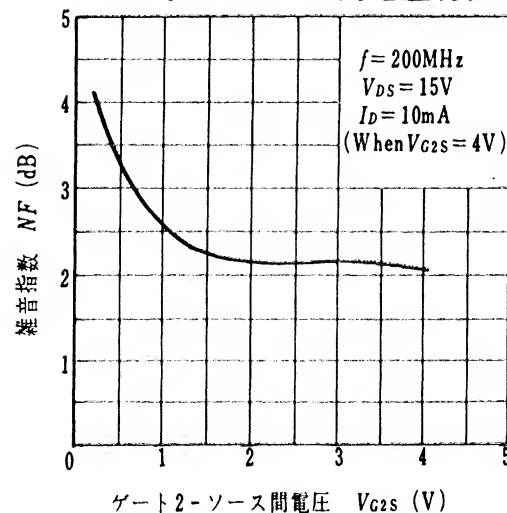
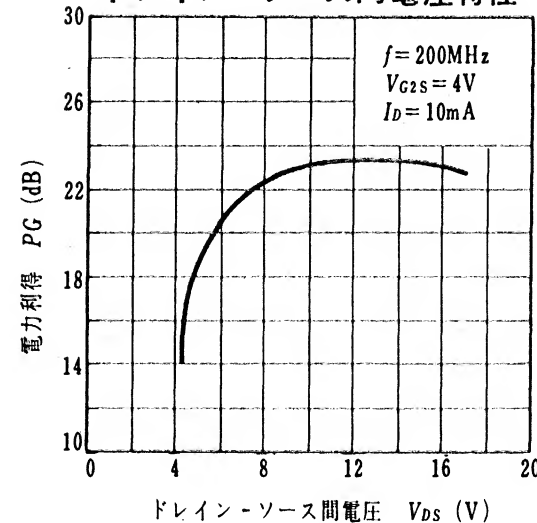
Si MOS型
Nチャンネル

日　立

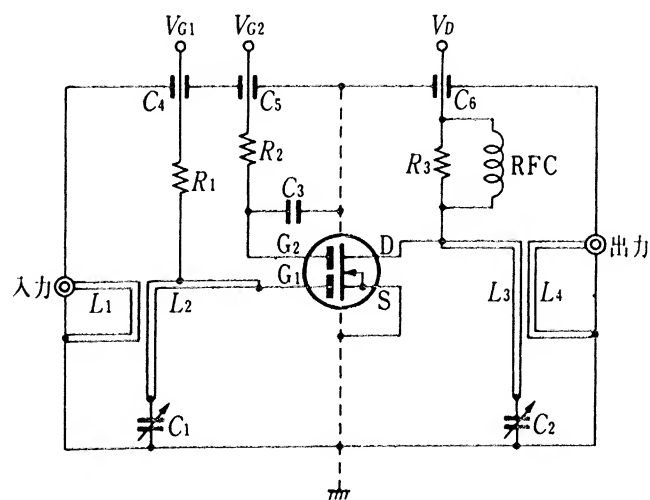
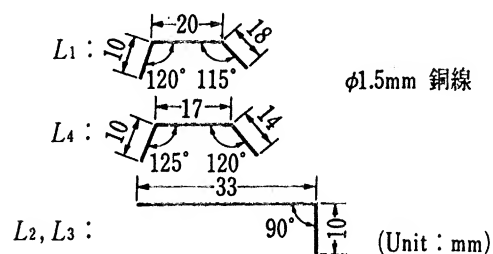
電力利得，雑音指数測定回路

R_1：15kΩ
R_2：11kΩ
C_1：1000pF
C_2：47pF
C_3, C_5, C_6：10pF max 可変コンデンサ
C_4：1000pF 裸円板コンデンサ
C_7, C_8, C_9：1000pF 貫通形コンデンサ
L_1, L_2：ϕ0.8mm エナメル線 2.5T，内径6mm
L_3：ϕ0.8mm エナメル線1.5T，内径6mm

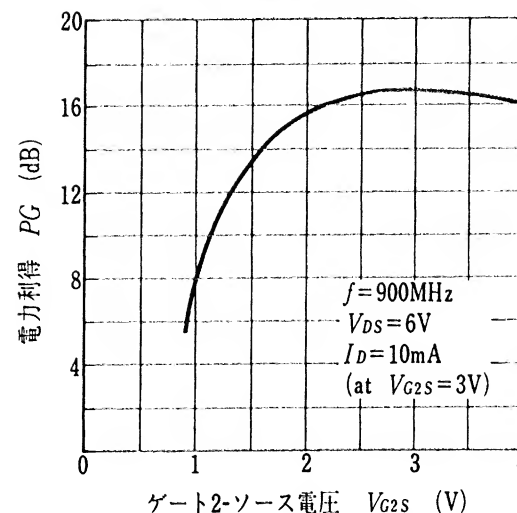
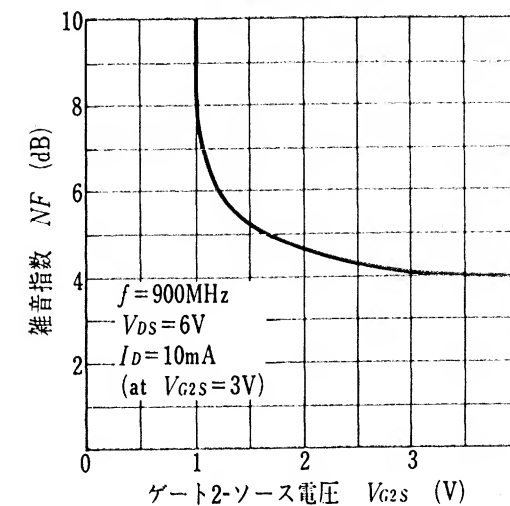
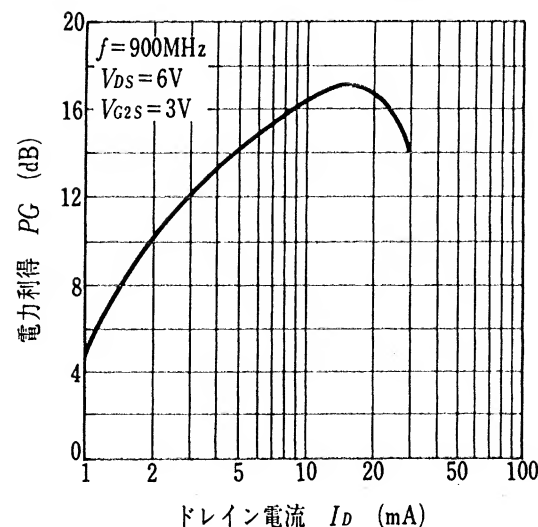
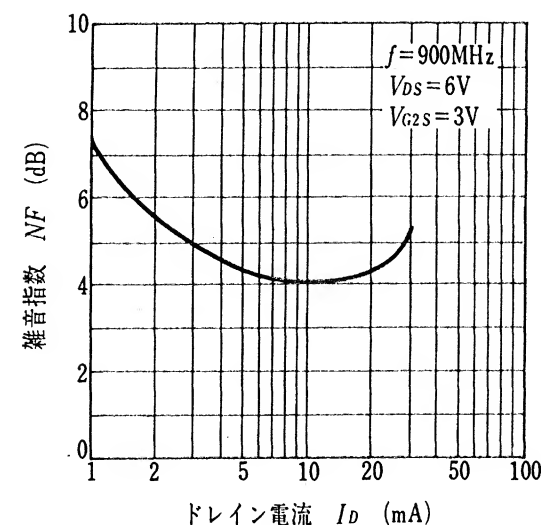
ドレイン電流対ゲート1-ソース間電圧特性

電力利得対ゲート2-ソース間電圧特性

f=200MHz
V_{DS}=15V
I_D=10mA
(When V_{G2S}=4V)
電力利得　PG (dB)
ゲート2-ソース間電圧　V_{G2S} (V)

雑音指数対ゲート2-ソース間電圧特性

電力利得対ドレイン-ソース間電圧特性

3SK82

Si MOS型 Nチャンネル 日 立

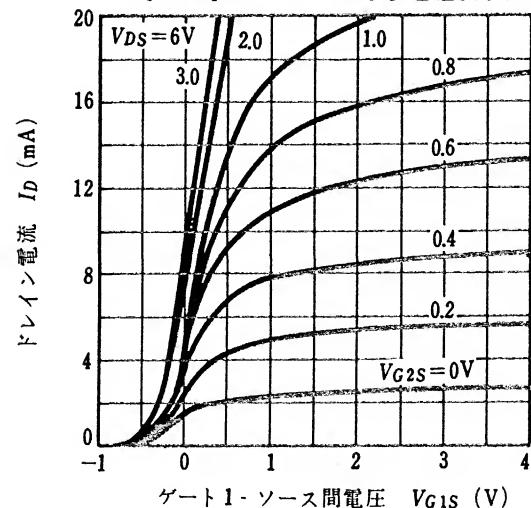
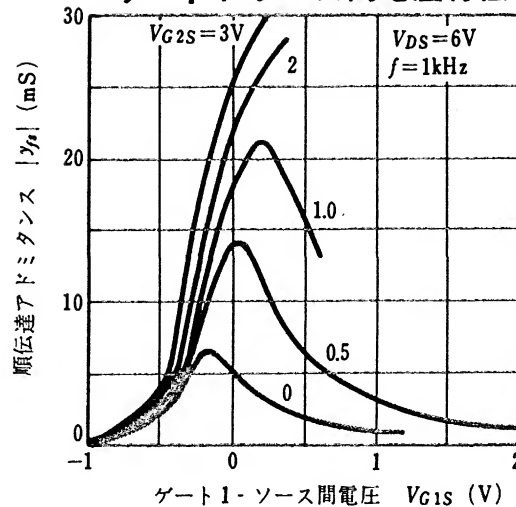
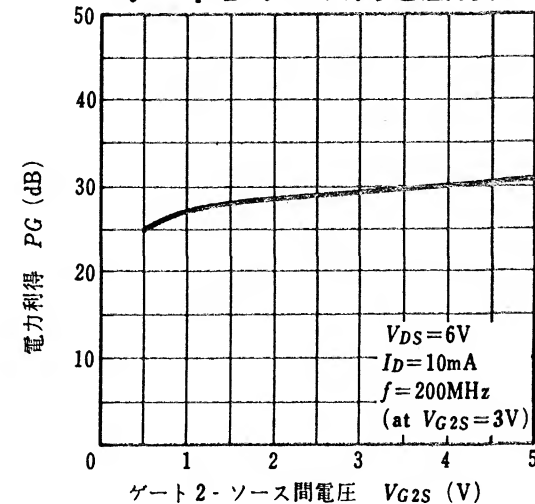
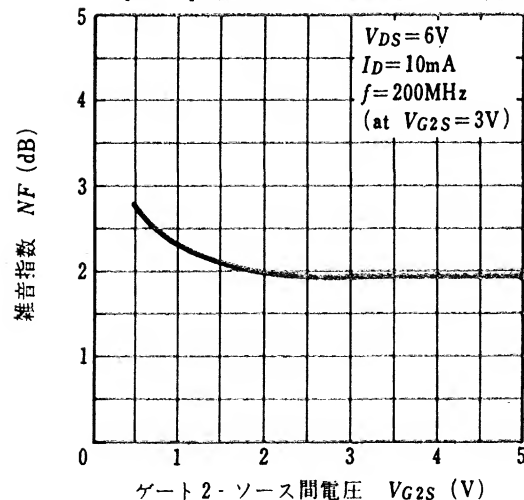
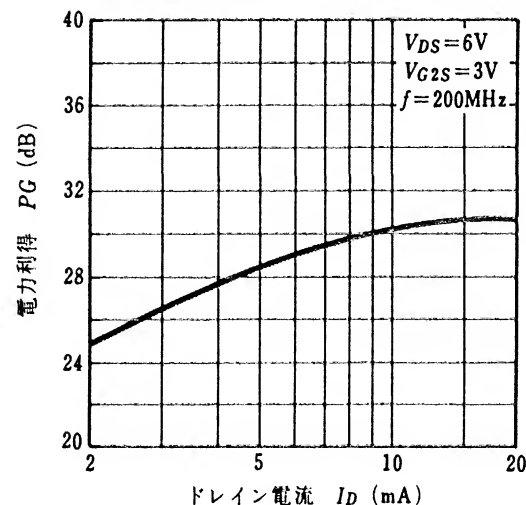
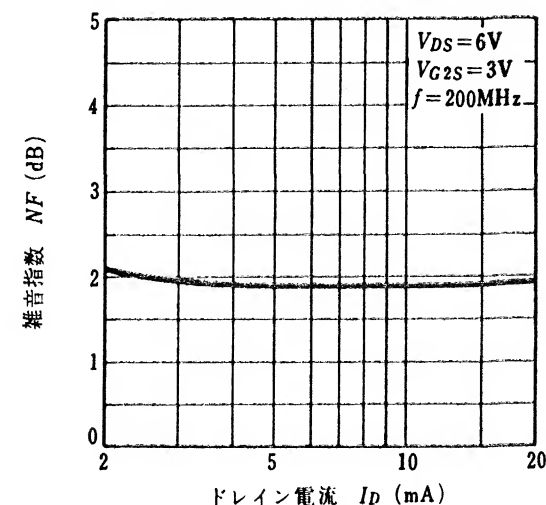
電力利得，雑音指数測定回路

C_1, C_2 ：10pF max可変コンデンサ
C_3 ：1000pF裸円板コンデンサ
$C_4 \sim C_6$：1000pF貫通形コンデンサ
R_1：90kΩ　R_2：47kΩ　R_3：3.3kΩ

RFC：ϕ1.0mmエナメル線4T，内径7mm

電力利得対ゲート2-ソース電圧特性

雑音指数対ゲート2-ソース電圧特性

電力利得対ドレイン電流特性

雑音指数対ドレイン電流特性

3SK96

Si MOS型
複合Nチャンネル

日　立

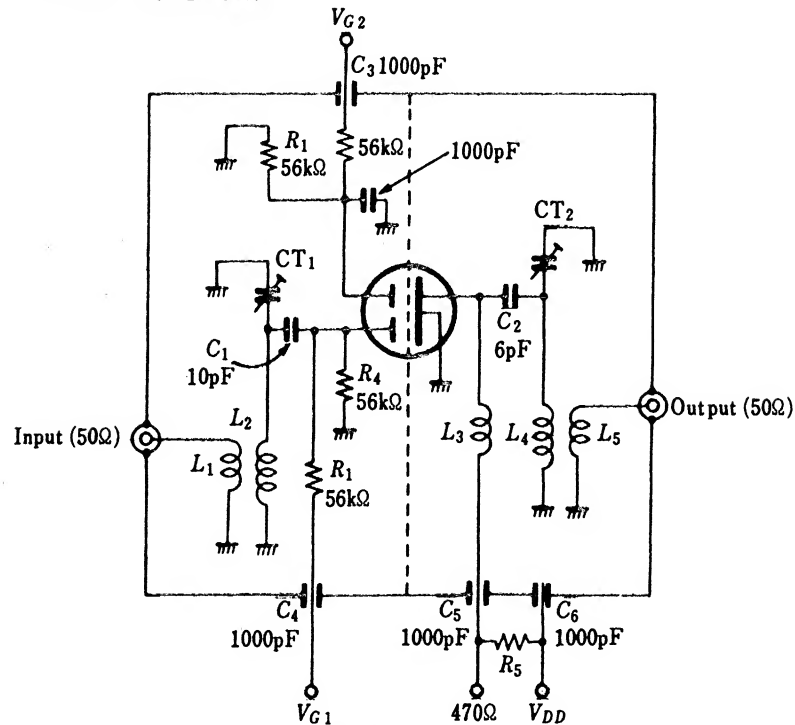
ドレイン電流対
ゲート1-ソース間電圧特性

順伝達アドミタンス対
ゲート1-ソース間電圧特性

電力利得対
ゲート2-ソース間電圧特性

雑音指数対
ゲート2-ソース間電圧特性

電力利得対ドレイン電流特性

雑音指数対ドレイン電流特性

3SK100

Si MOS型 Nチャンネル　松　下

I_{DSS} ランク分類

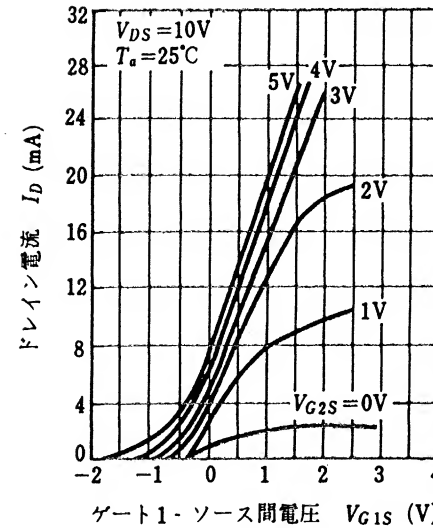
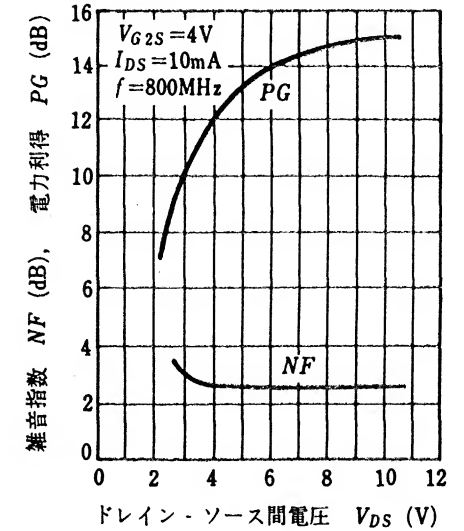
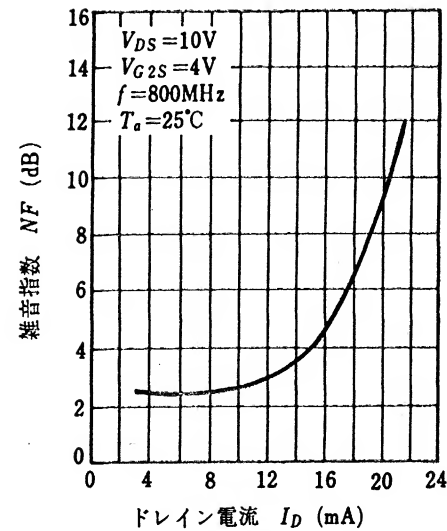
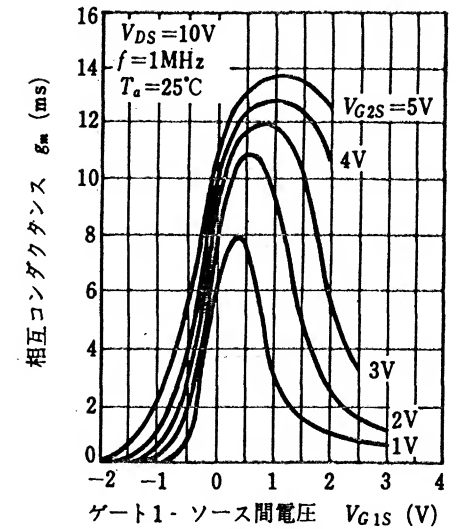
	P	Q	R
I_{DSS} (mA)	0.5～2	1.2～6	4～8

PG, NF 測定回路

L_1, L_5　：長さ 1.5φ のニッケル線

L_3　：0.15φ 7 ターン

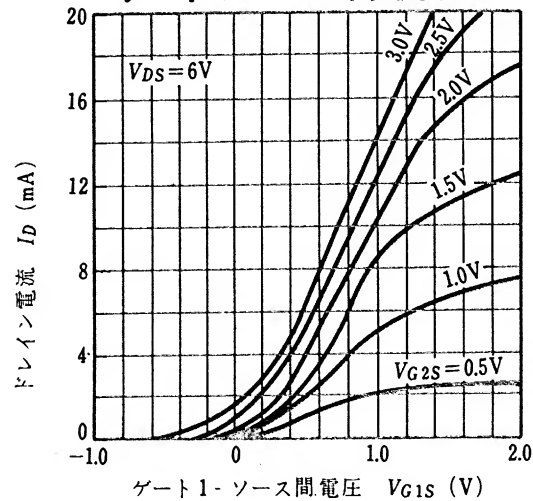
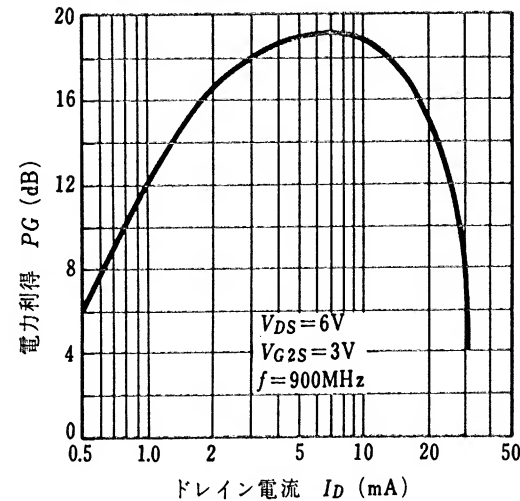
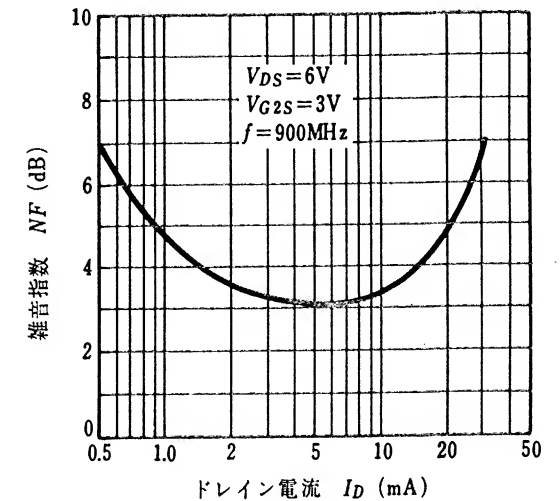
L_2, L_4　：6.0×28×0.8 銅板

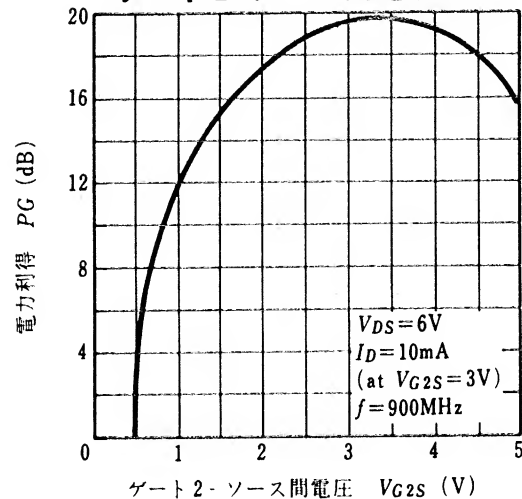
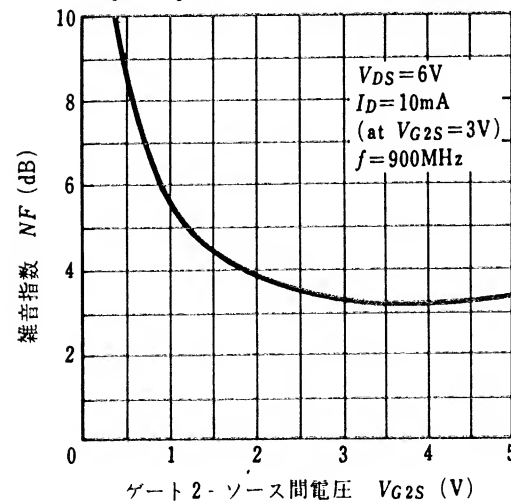
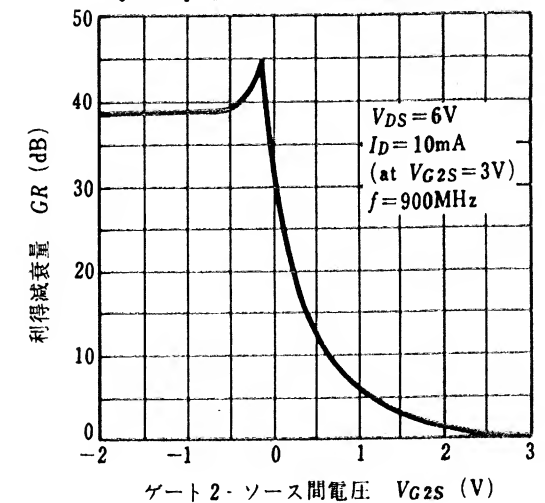
CT, CT_2：3～9pF シリンダ・トリマ

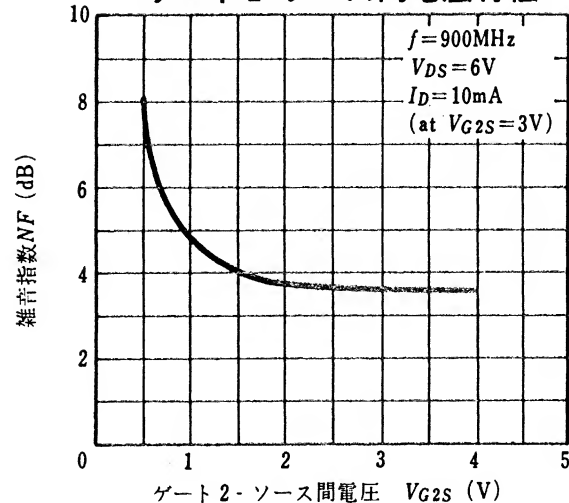
I_D - V_{G1S} 特性

NF, PG - V_{DS} 特性

NF - I_D 特性

gm - V_{G1S} 特性

3SK103, 138

Si MOS型 複合Nチャンネル

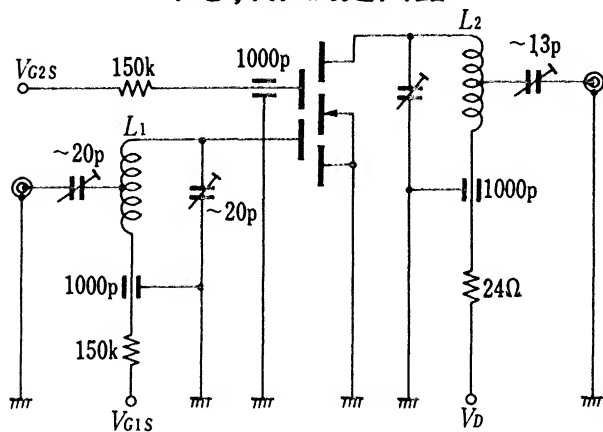
日 立

ドレイン電流対 ゲート1-ソース間電圧特性

電力利得対ドレイン電流特性

雑音指数対ドレイン電流特性

電力利得対 ゲート2-ソース間電圧特性

雑音指数対 ゲート2-ソース間電圧特性

利得減衰量対 ゲート2-ソース間電圧特性

3SK104, 104V, 137 Si MOS型 複合Nチャンネル

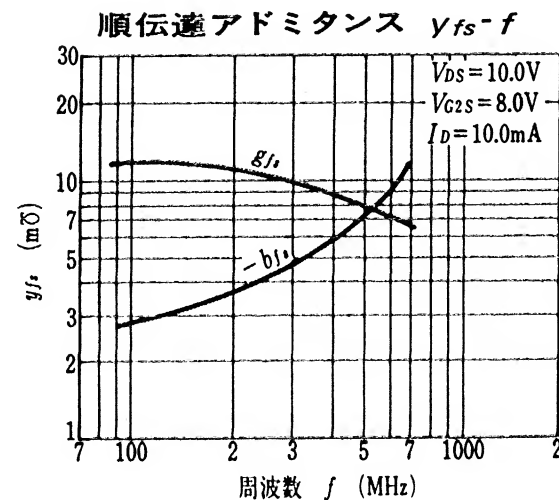
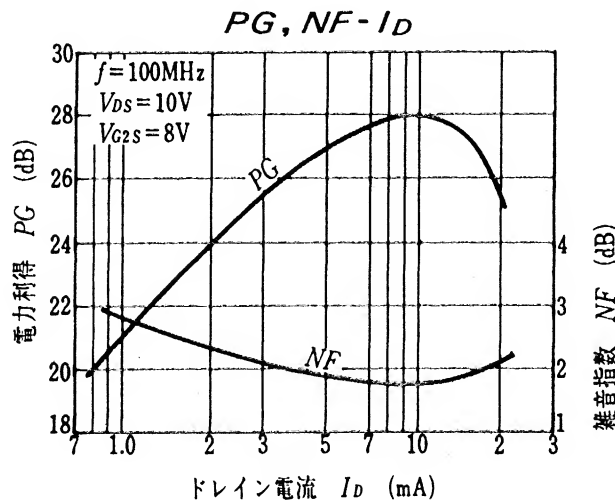
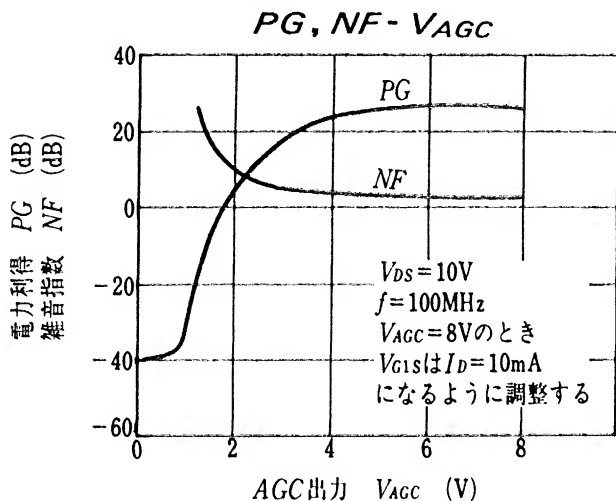
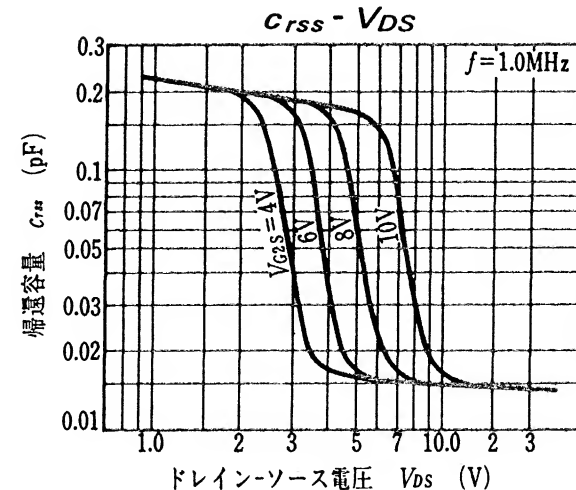
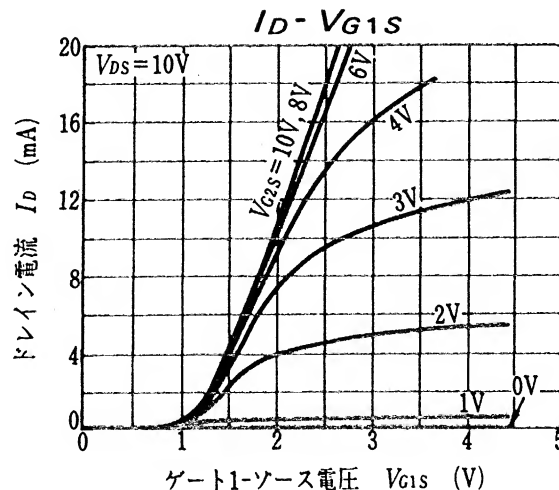
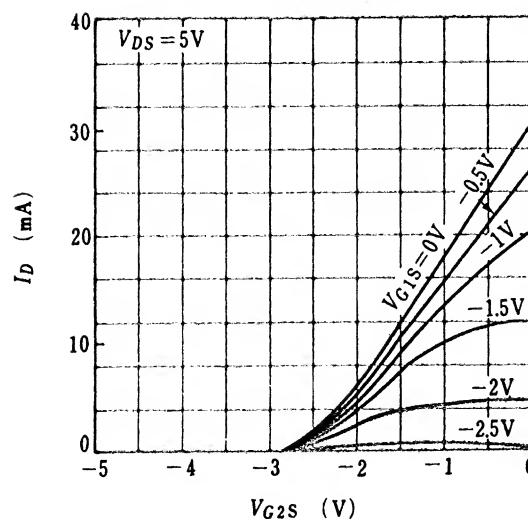
日 立

3SK108

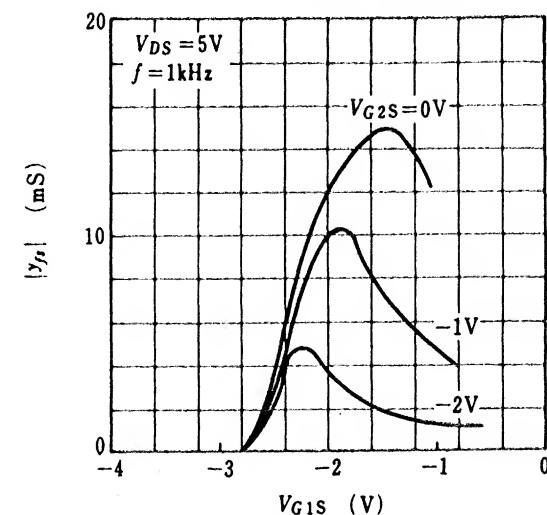
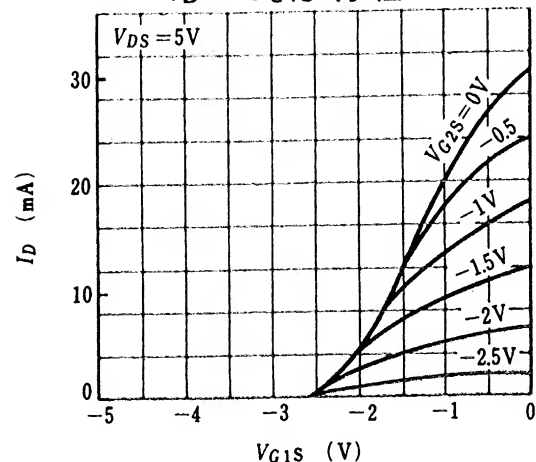
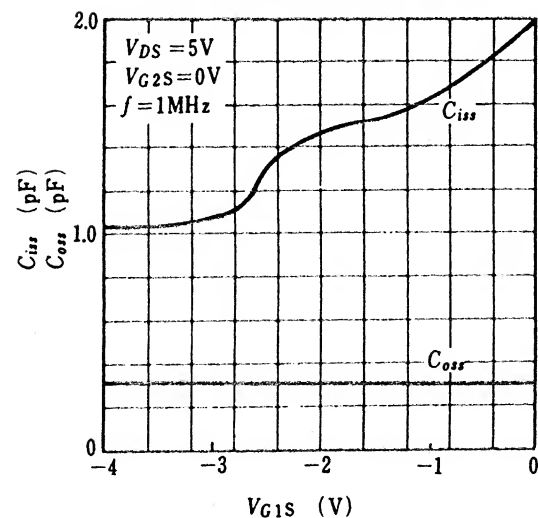
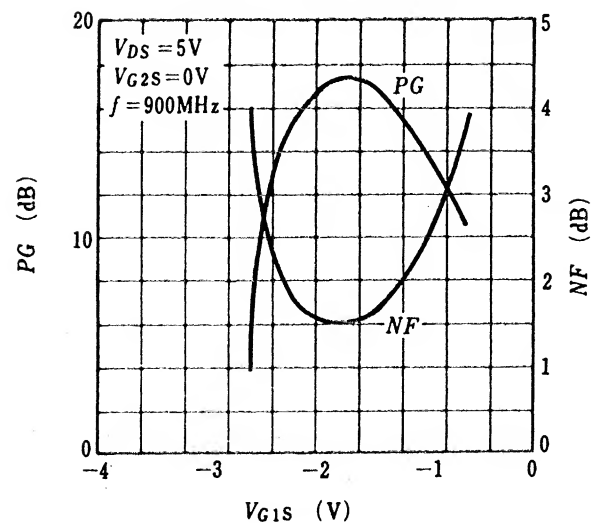
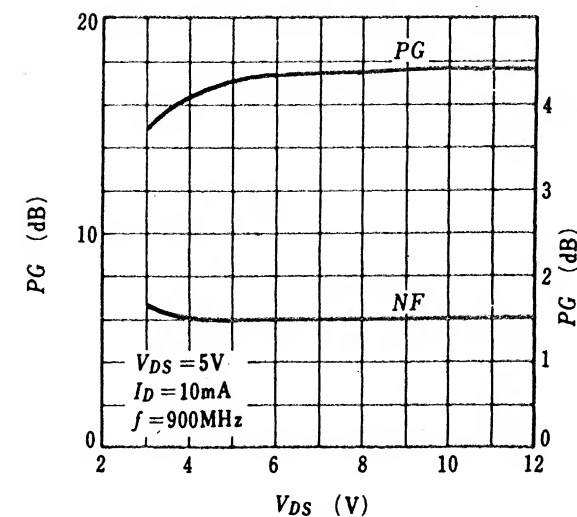
Si MOS型 複合Nチャンネル 三洋

I_{DSX}分類	3 Q 10	7 R 14	10 S 17	14 T 21

L_1：1mmφメッキ線を10mmφ 4T, Gate側より1Tにタップ.
L_2：1mmφメッキ線を10mmφ 6T, Drain側より1Tにタップ.

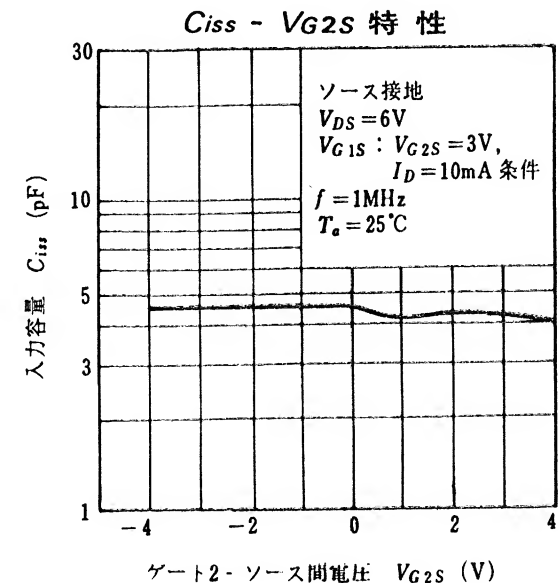
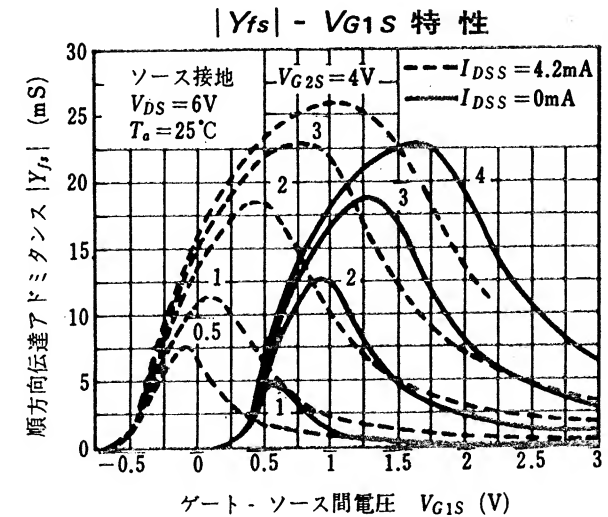
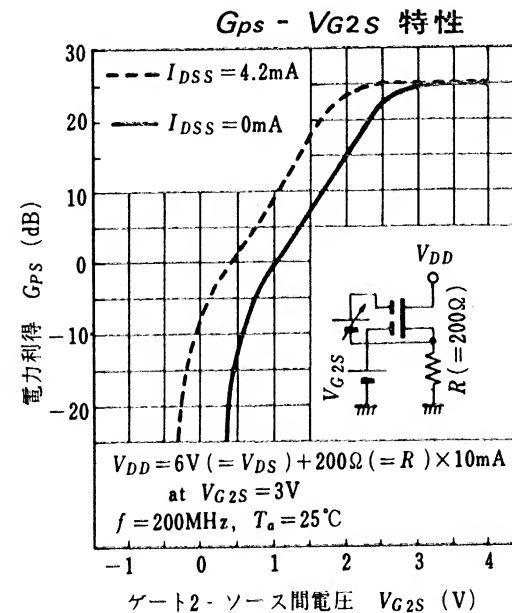
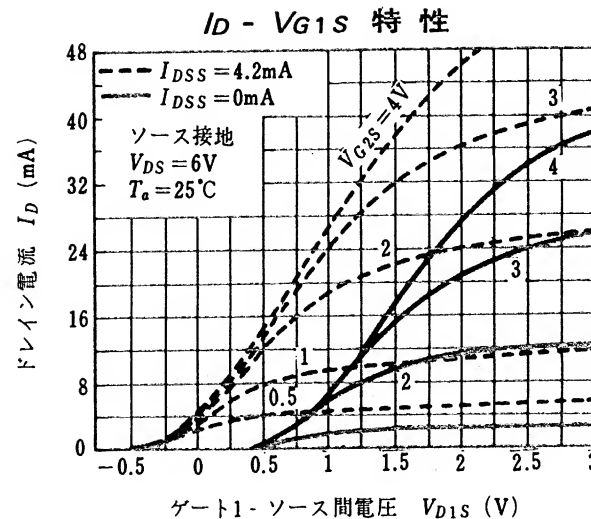
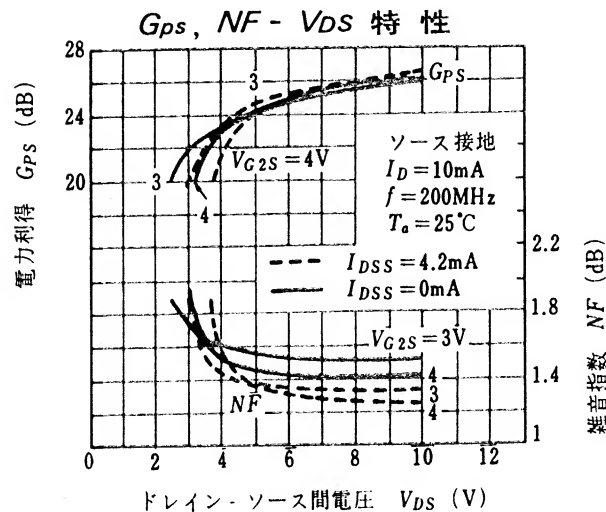
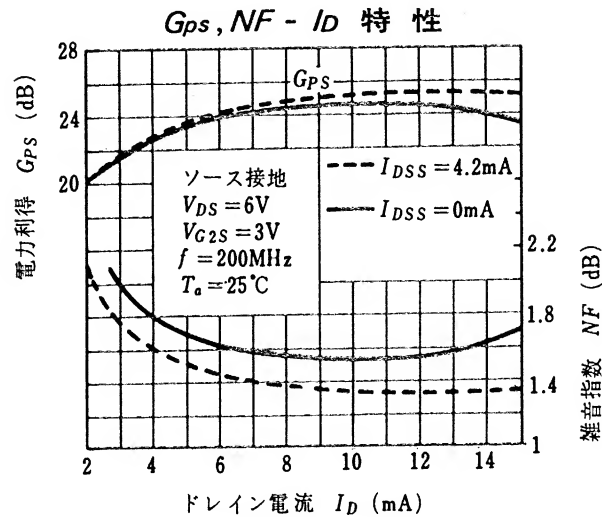
3SK113

GaAs型
複合 Nチャンネル

日　立

F	G	H	J	
10～20	16～32	25～50	40～80	mA

I_D - V_{G1S} 特性

I_D - V_{G2S} 特性

$|y_{fs}|$ - V_{G1S} 特性

C_{iss}, C_{oss} - V_{G1S} 特性

PG - V_{G1S} 特性

PG - V_{DS} 特性

3SK114

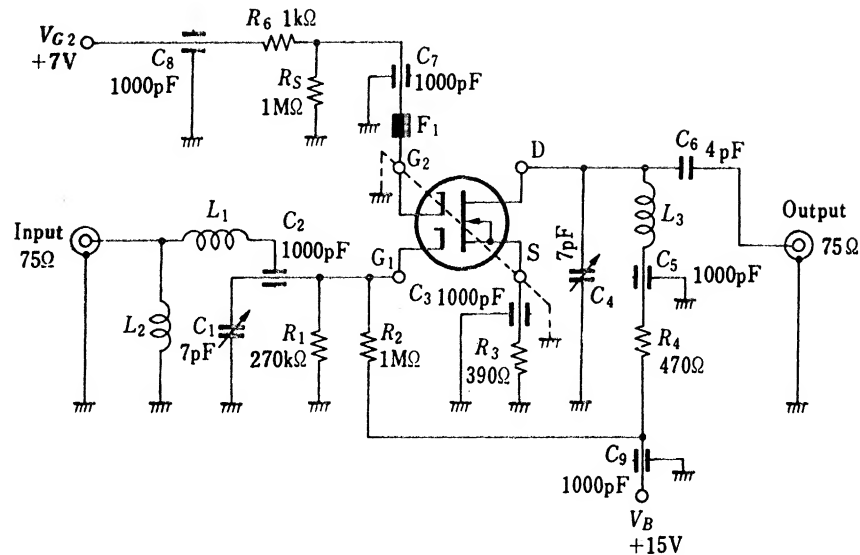
Si MOS型 Nチャンネル　東芝

I_{DSS} 区分　O：0〜2，Y：1〜6（mA）

3SK116

Si MOS型
Nチャンネル

I_{DSS} ランク分類

	P	Q	R
I_{DSS} (mA)	2.5～8	6～17	13～30

PG, NF 測定回路

L_1 : 0.3ϕ PUW　4.9ϕ 3.5T

L_2 : 0.3ϕ PUW　3.2ϕ 1.5T

L_3 : 0.3ϕ PUW　3.2ϕ 4.0T

f=200MHz, BW : 8MHz

3SK121

GaAs型 Nチャンネル 東芝

I_{DSS} 区分 Y：20～35，GR：30～45 (mA)

電力利得，雑音指数および *GR* 測定回路

L_1～L_4：φ0.8mm 銀メッキ線
C　：エアートリマ 村田 TTA25A 200A
RFC_1　：φ0.35mm UEW 3 ID 7T
RFC_2　：φ0.35mm UEW 3 ID 10T

3SK123

Si MOS型 複合Nチャンネル　日電

I_{DSS} 区分　L：0.01～2mA　K：1～6mA

900MHz G_{PS}, NF 測定回路

L_1, L_2 ; 35×5×0.2mm

I_D - V_{G1S} 特性

C_{iss} - V_{G2S} 特性

G_{PS}, NF - V_{G2S} 特性

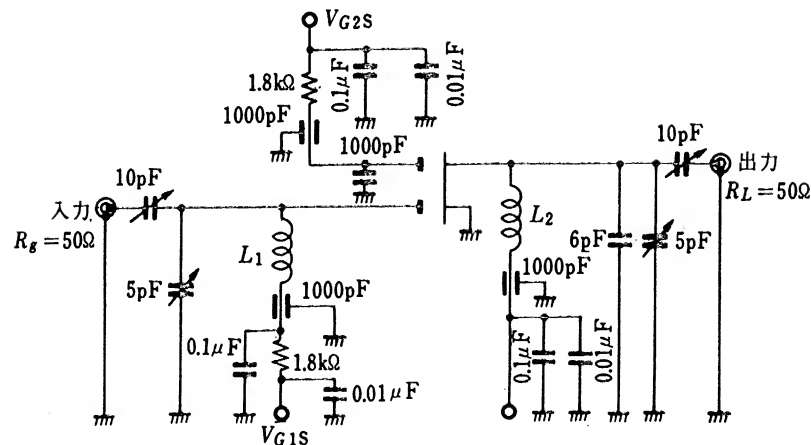
C_{oss} - V_{G2S} 特性

3SK126

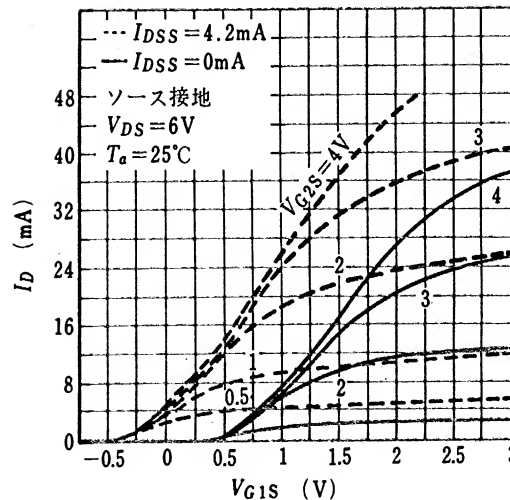
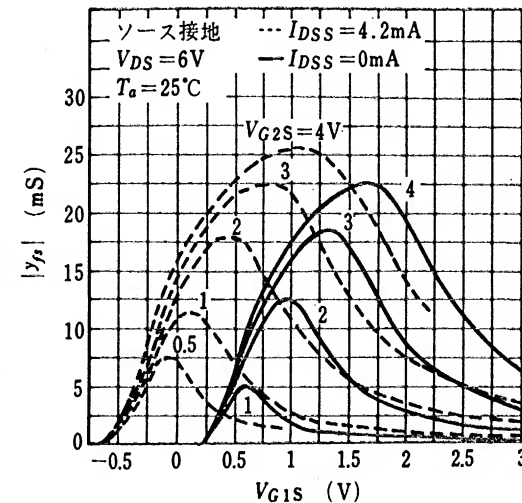
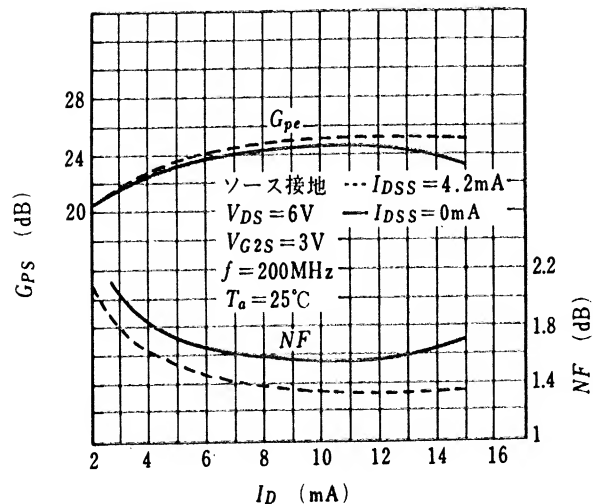
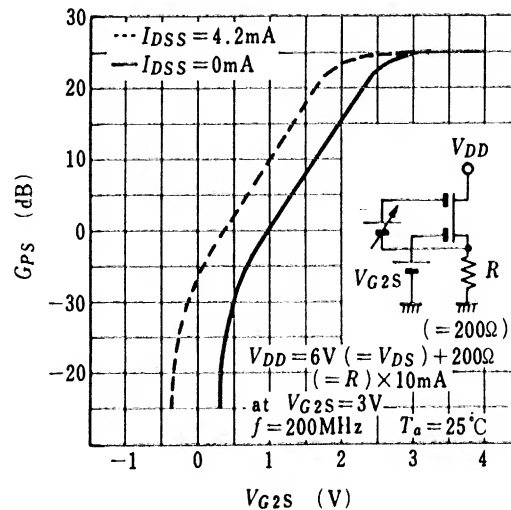
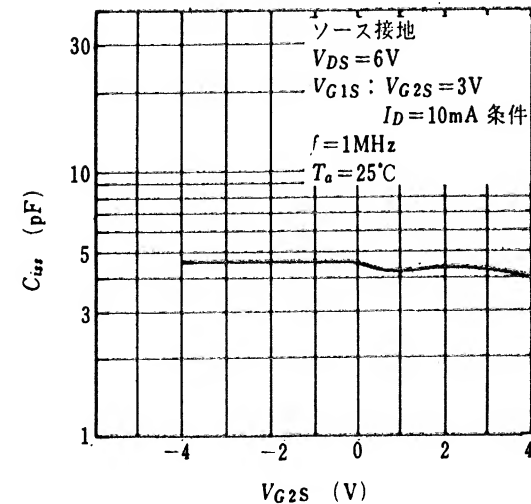
Si MOS型 複合Nチャンネル

東　芝

I_{DSS} 区分　O：0〜2mA，Y：1〜6mA

200MHz 電力利得，雑音指数 測定回路

L_1：1mmφ 銀メッキ銅線，2T，8mm 内径

L_2：1mmφ 銀メッキ銅線，2.5T，8mm 内径

I_D - V_{G1S} 特性

$|Y_{fs}|$ - V_{G1S} 特性

G_{ps}, NF - I_D 特性

G_{ps} - V_{G2S} 特性

C_{iss} - V_{G2S} 特性

3SK127

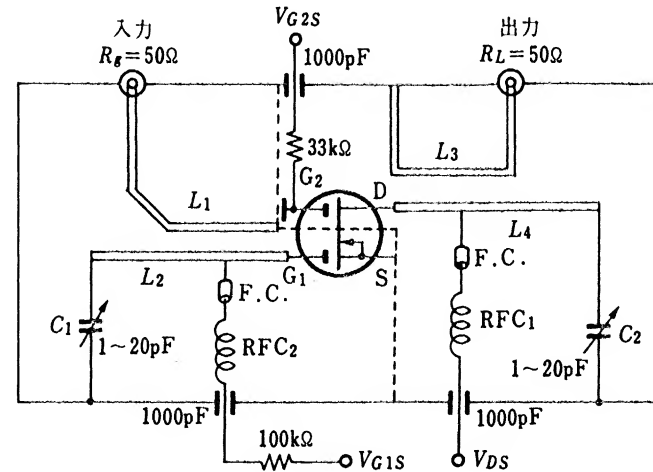
Si MOS型 複合Nチャンネル

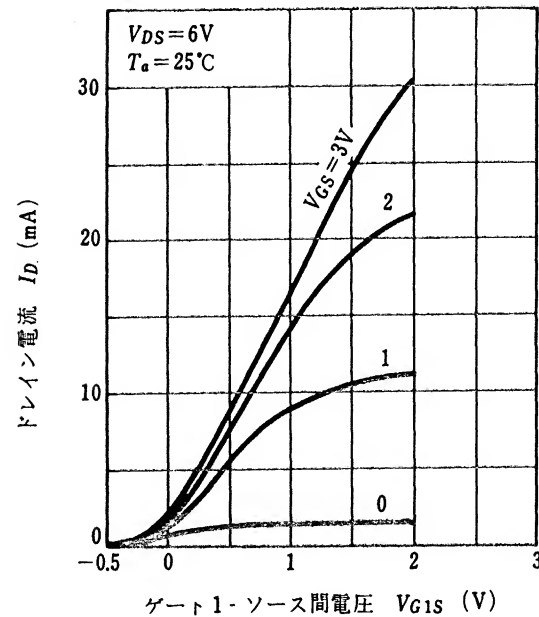
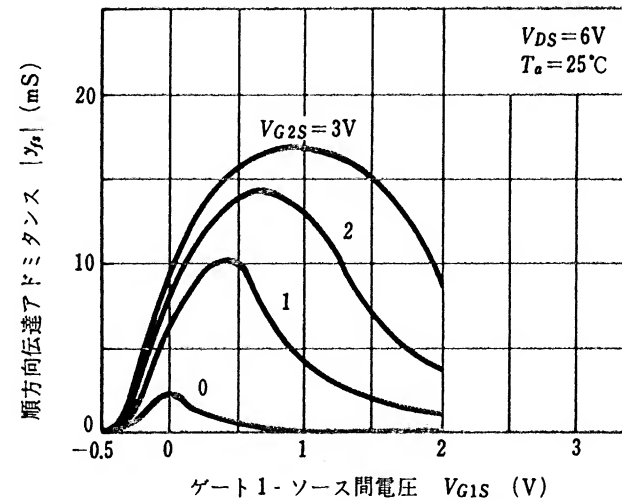
東　芝

I_{DSS} 区分

O：0～2mA

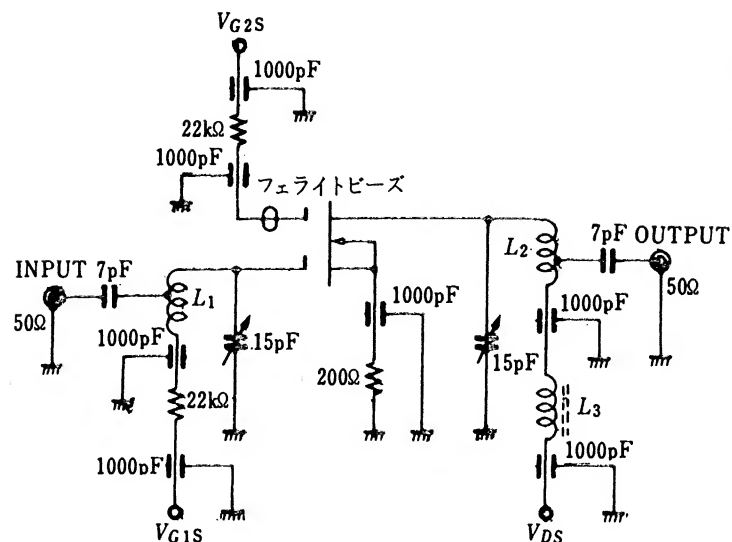
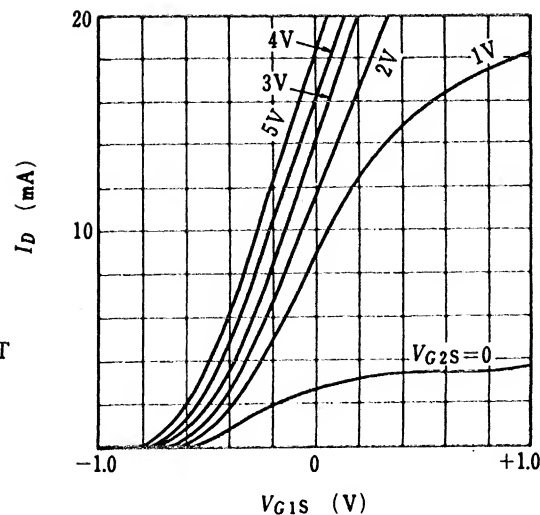
Y：1～6mA

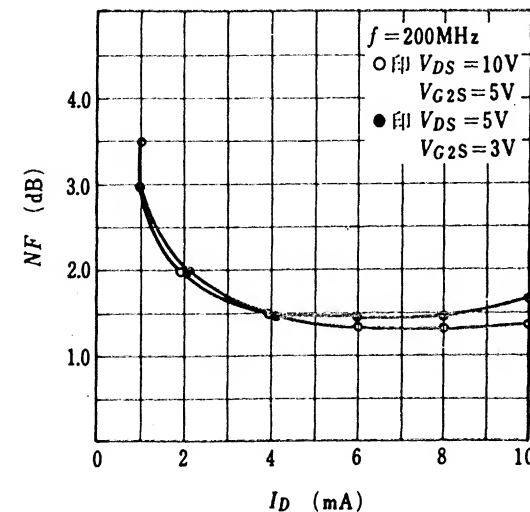
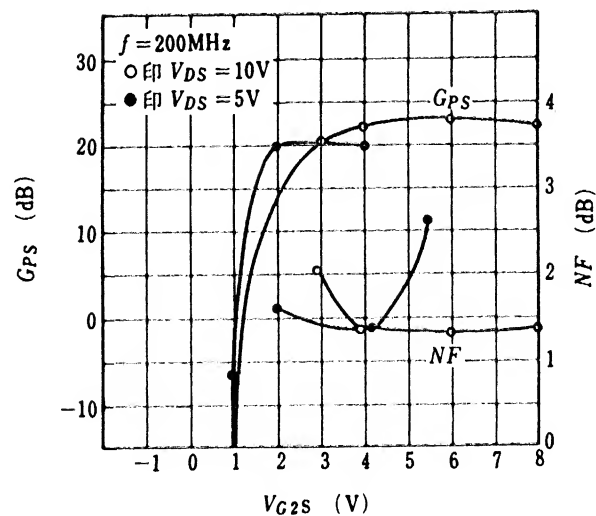
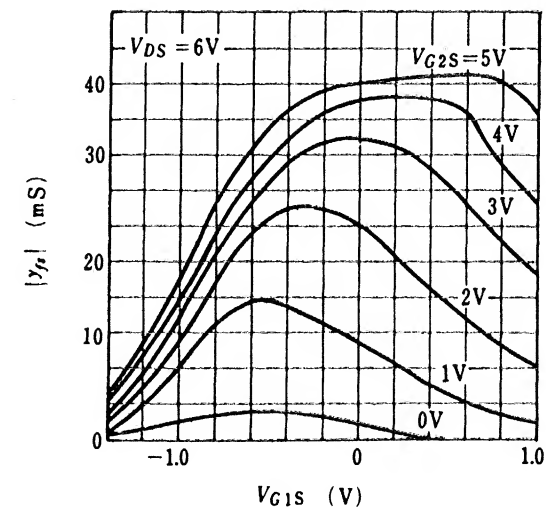
800MHz 電力利得，雑音指数測定回路

L_1～L_4：φ1.0mm 銀メッキ銅線
RFC₁　：φ0.35mm 銅線，7.0T，内径 3mm
RFC₂　：φ0.35mm 銅線，10.0T，内径 3mm
C_1，C_2：エアートリマ TTA 25A 200A
　　村田製作所あるいは相当品
C_3　：1000pF（ディスクコンデンサ）
F.C.　：フェライト・コア

I_D - V_{G1S} 特性

$|y_{fs}|$ - V_{G1S} 特性

3SK131

Si MOS型 複合Nチャンネル 日電

I_{DSS} 区分 V10 7～13mA V11 11～19mA V12 17～25mA

200MHz G_{PS}, NF 測定回路

L_1 : φ0.6mm U.E.W. 7mm 3T
L_2 : φ0.6mm U.E.W. 7mm 3T
L_3 : RFC 2.2μH

I_D - V_{G1S} 特性

NF - I_D 特性

G_{PS} - V_{G2S} 特性

$|y_{fs}|$ - V_{G1S} 特性

3SK132

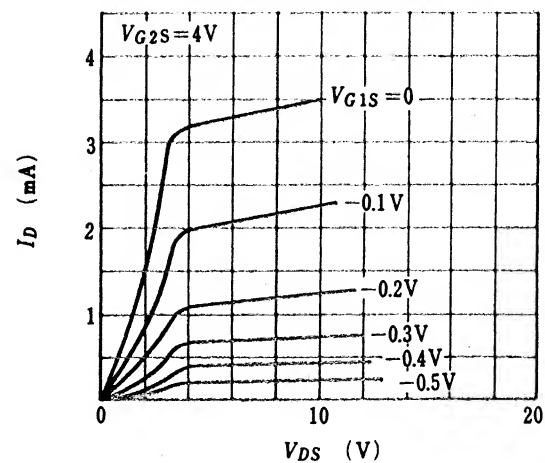
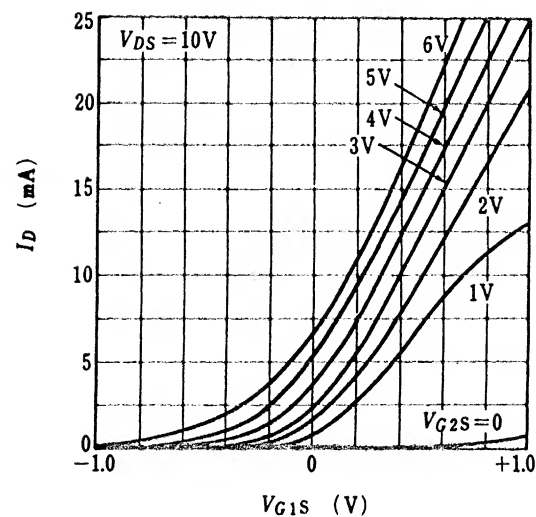
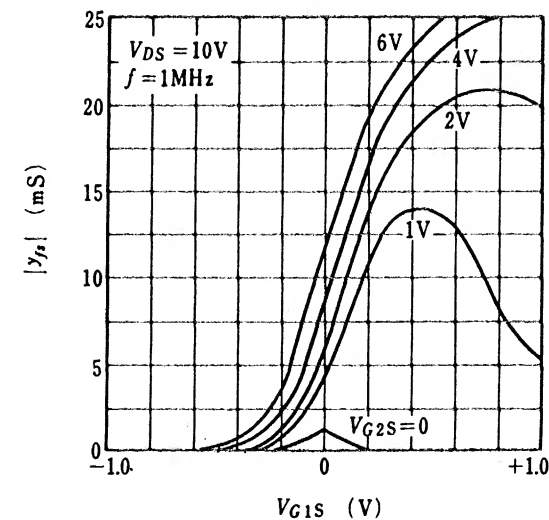
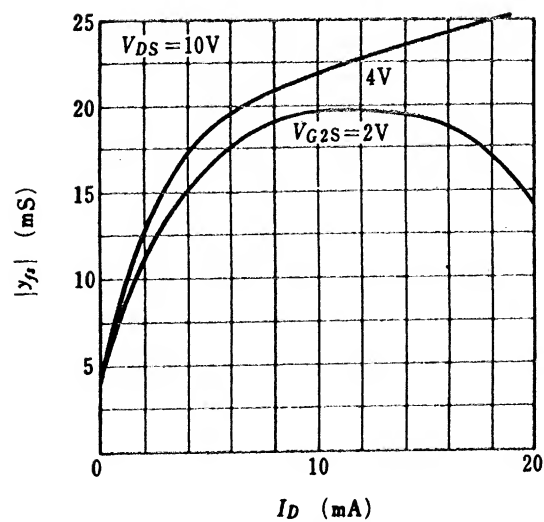
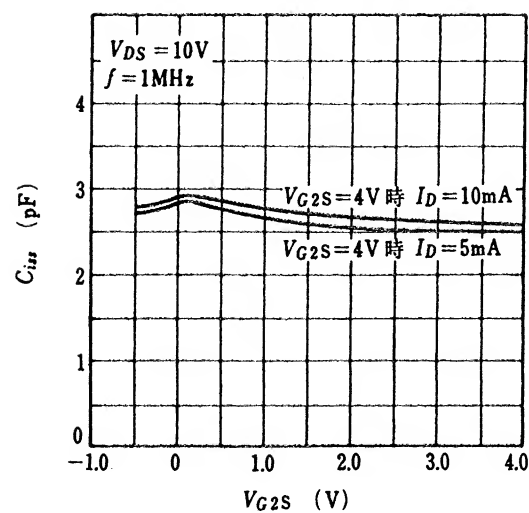
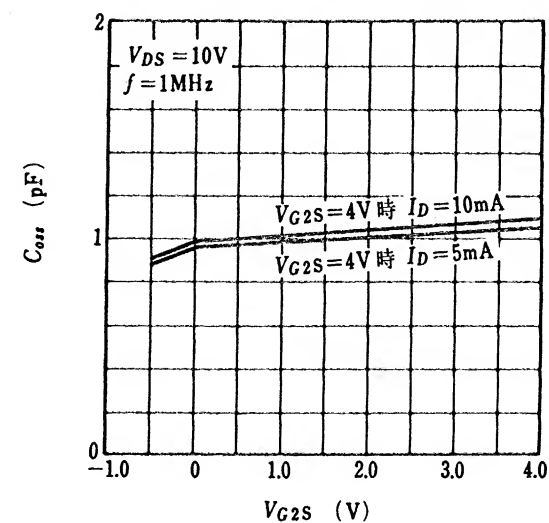
Si MOS型 複合Nチャンネル

日 電

I_{DSS} ランク U32 0.5～5mA U33 3～8mA

I_D - V_{DS} 特性

I_D - V_{G1S} 特性

VDS=10V
6V
5V
4V
3V
2V
1V
VG2S=0
ID (mA)
VG1S (V)

$|y_{fs}|$ - V_{G1S} 特性

$|Y_{fs}|$ - I_D 特性

C_{iss} - V_{G2S} 特性

C_{oss} - V_{G2S} 特性

3SK133

Si MOS型 複合Nチャンネル 日電

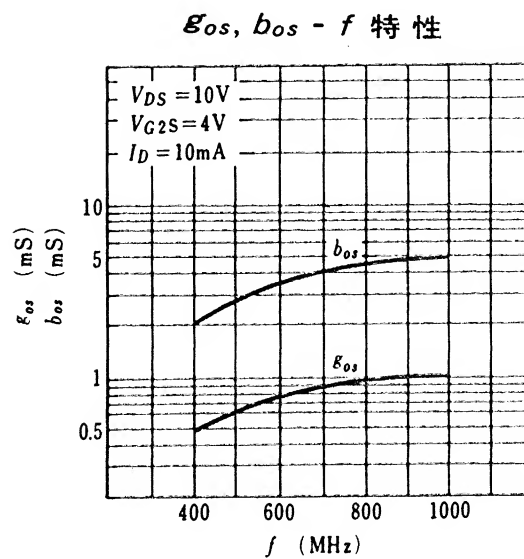
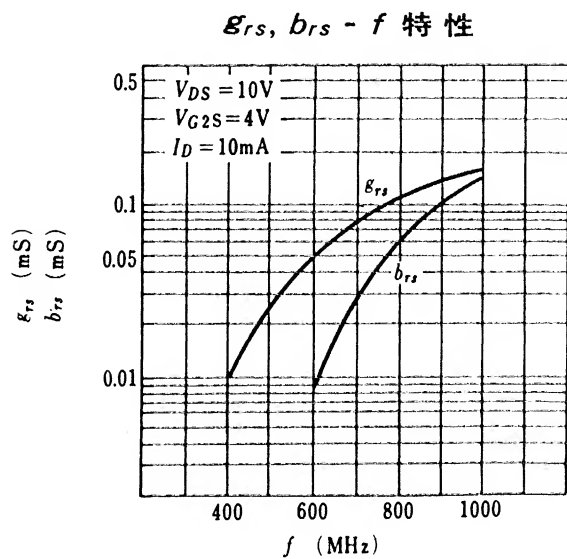
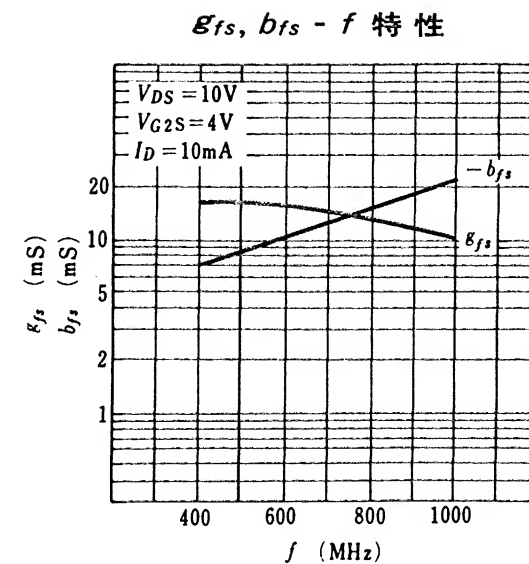
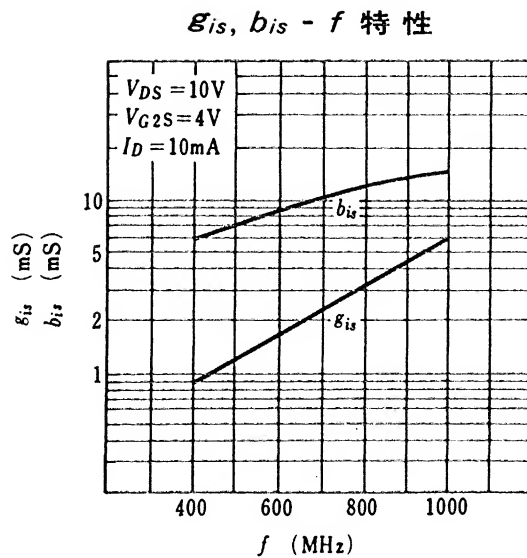
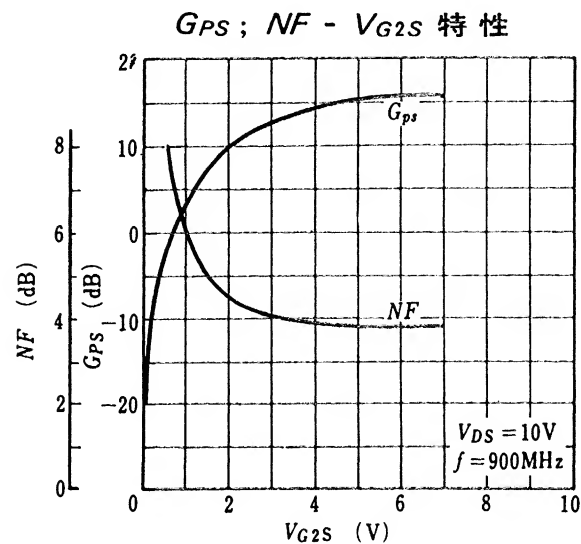
I_{DSS} 区分 U42 0.01〜2mA U43 1〜6mA

G_{PS} ; NF - V_{G2S} 特性

$V_{DS}=10V$
$f=900MHz$

g_{fs}, b_{fs} - f 特性

g_{rs}, b_{rs} - f 特性

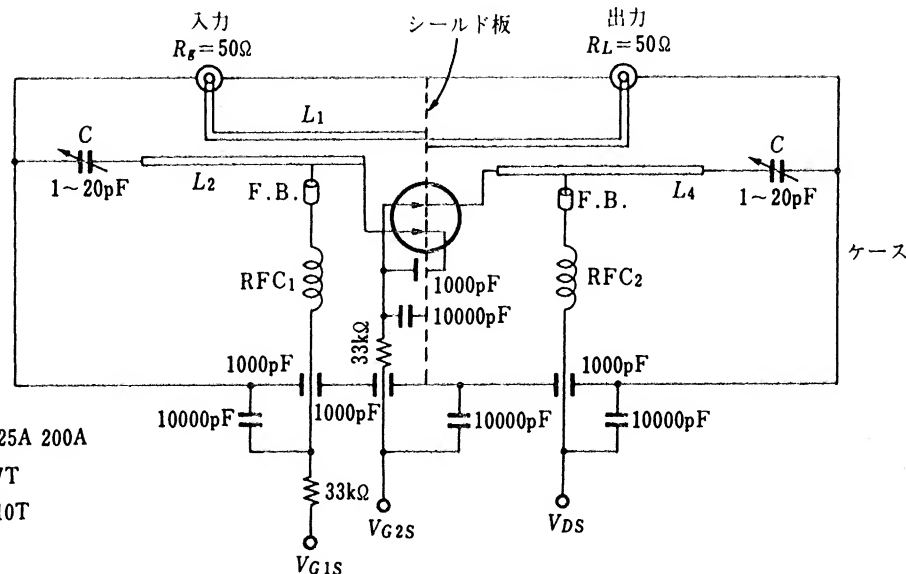
g_{os}, b_{os} - f 特性

3SK140

GaAs MES型 複合Nチャンネル　東芝

I_{DSS} 区分

Y：20～35mA

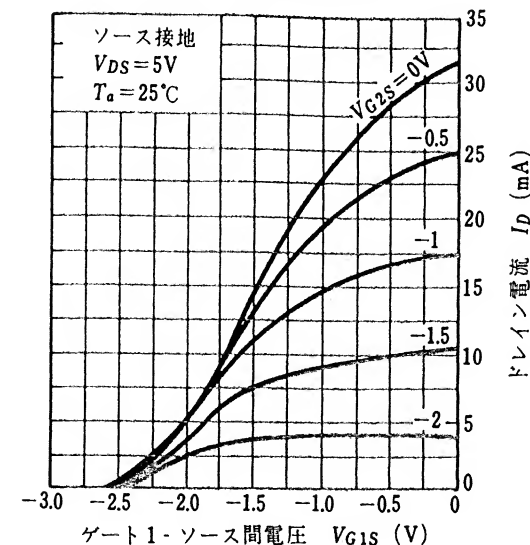
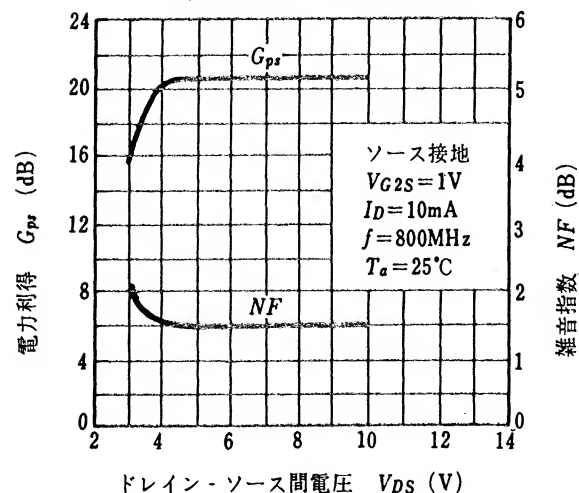
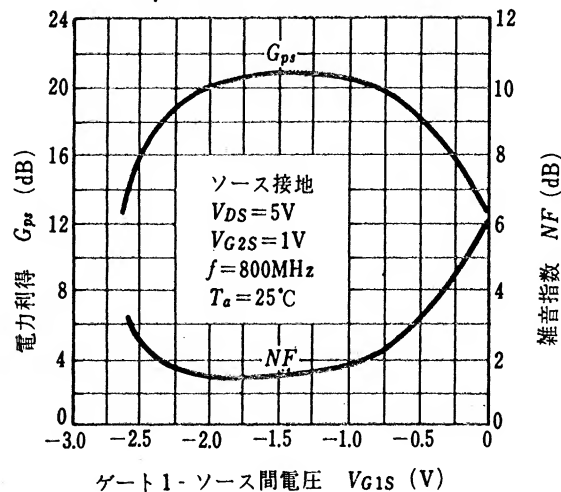
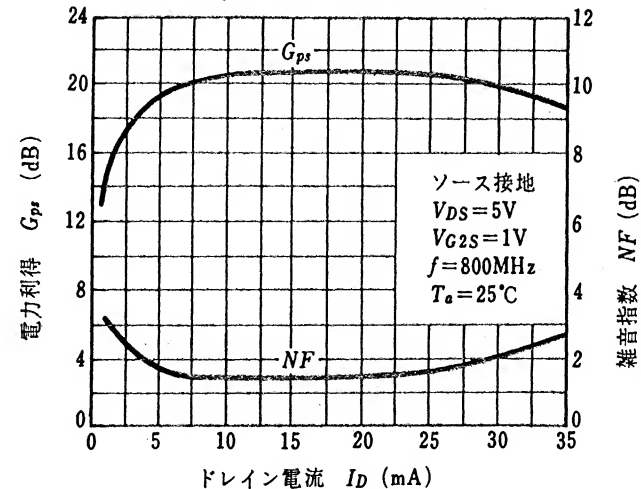
GR：30～45mA

電力利得，雑音指数および GR 測定回路

L_1～L_4：0.8mmφ 銀メッキ線

C　：エアートリマ　村田 TTA25A 200A

RFC_1　：0.35mmφ UEW　3I．D．7T

RFC_2　：0.35mmφ UEW　3I．D．10T

I_D - V_{G1S} 特性

G_{ps}, NF - V_{DS} 特性

G_{ps}, NF - V_{G1S} 特性

G_{ps}, NF - I_D 特性

3SK145, 146

Si MOS型
複合Nチャンネル

東　芝

I_{DSS} 区分

O：0～2mA

Y：1～6mA

電力利得および雑音指数測定回路

L_1～L_4：φ0.8mm 銀メッキ線

C　：エアートリマ 村田 TTA25A 200A

RFC_1　：0.35mmφ UEW 3I.D.7T

RFC_2　：0.35mmφ UEW 3I.D.10T

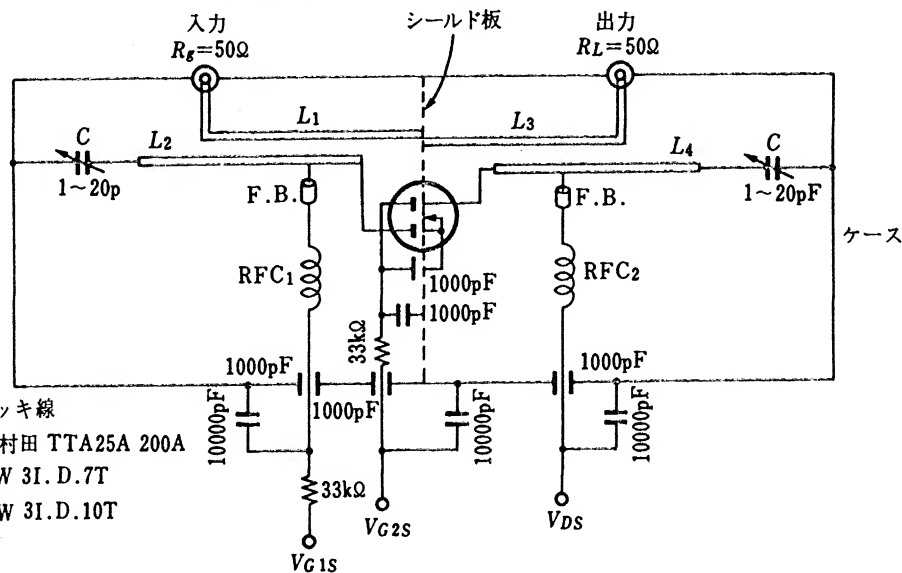
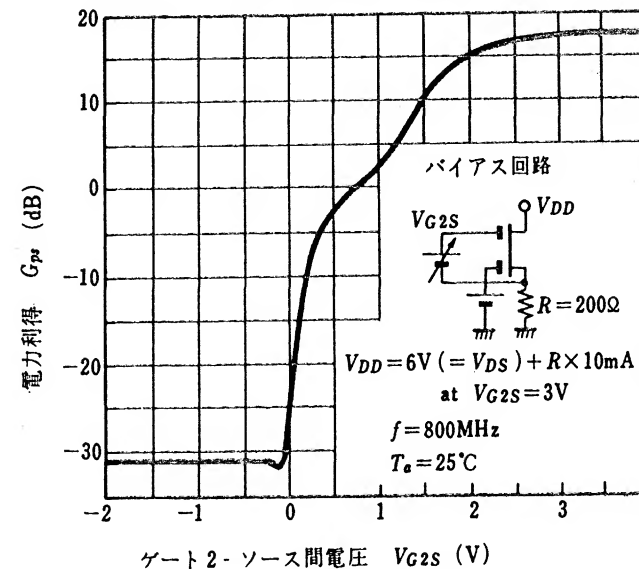
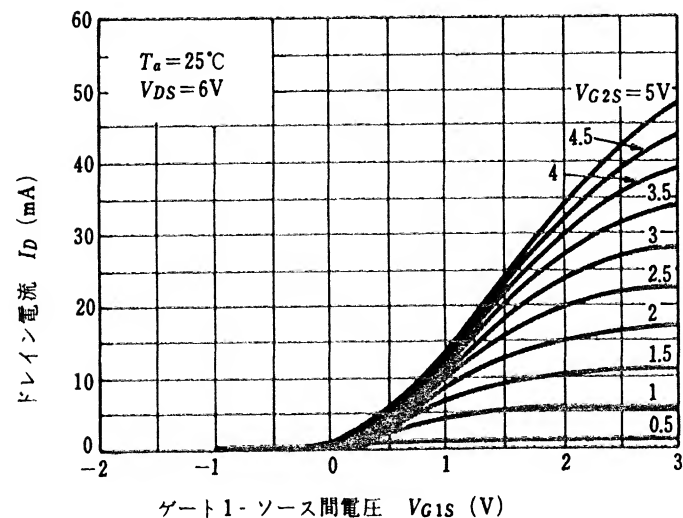
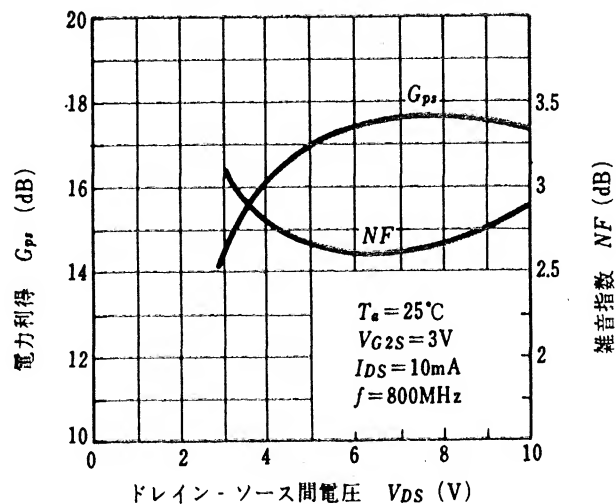
3SK150, 151

Si MOS型
複合Nチャンネル

東　芝

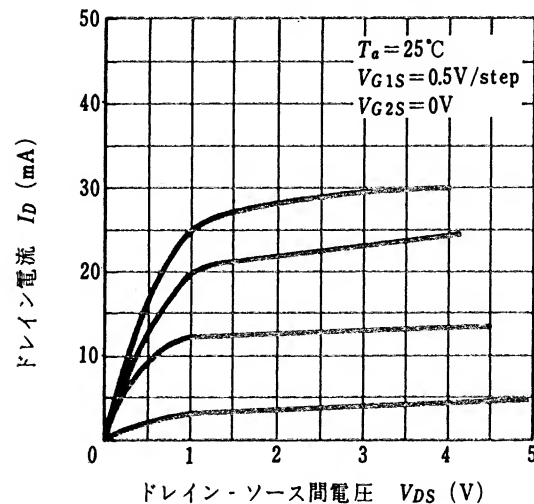
I_{DSS} 区分

Y：3～7mA

GR：6～14mA

MGF1100

GaAs型 複合Nチャンネル

三　菱

ソース接地出力特性

最大安定電力利得，最大有能電力利得，単方向電力利得，安定係数-周波数特性

最小雑音指数，雑音最小電力利得-周波数特性

$V_{DS}=3V$
$I_{DS}=10mA$
$V_{G2S}=0V$, grounded
$T_a=25°C$

G_S

NF min

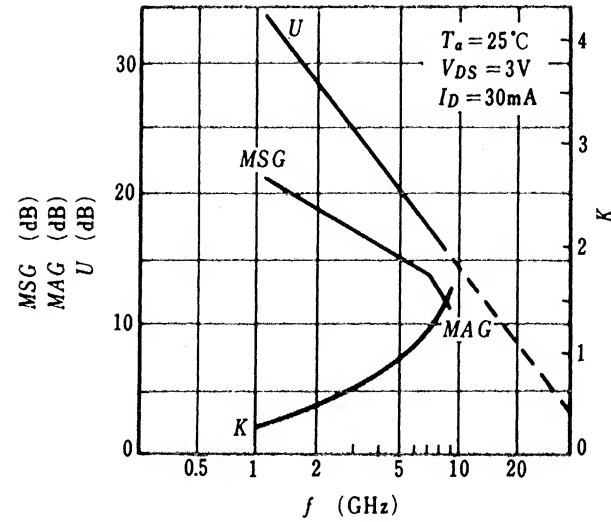
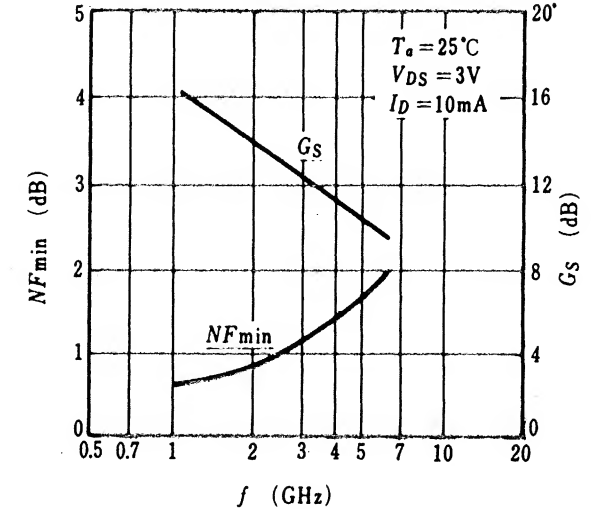
最小雑音指数 NFmin (dB)

雑音最小電力利得 G_S (dB)

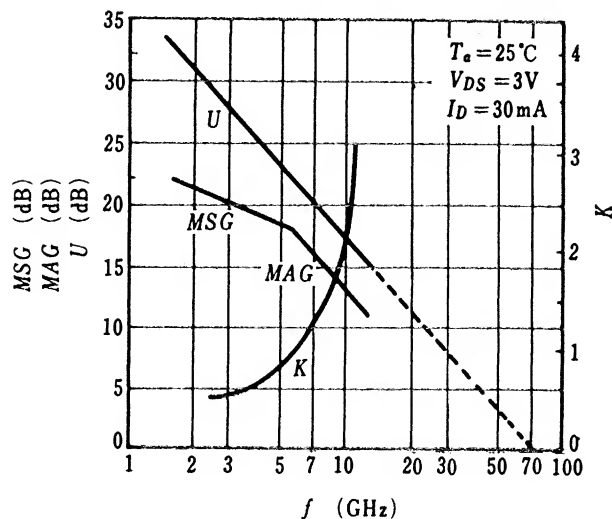
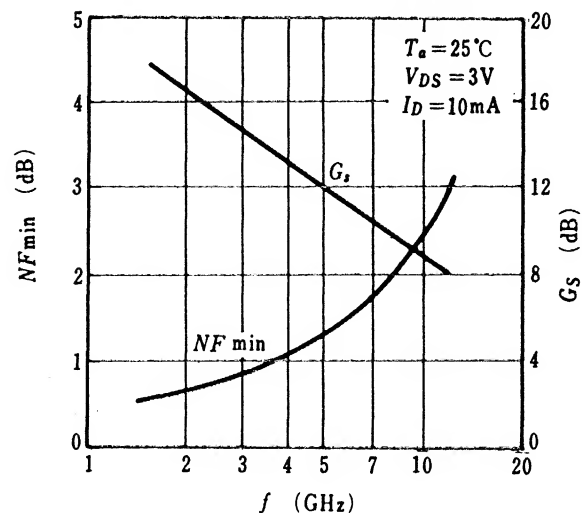
周波数 f (GHz)

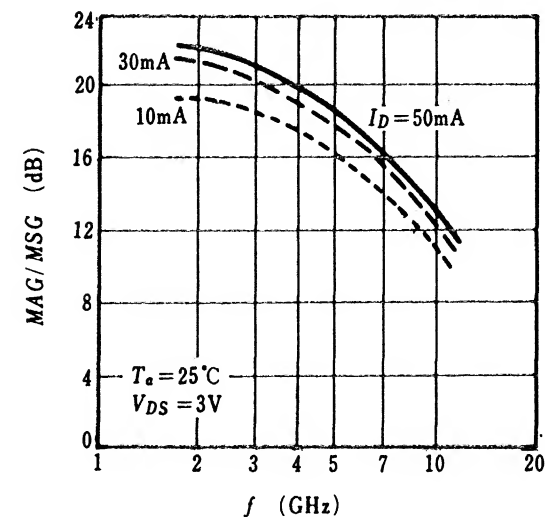
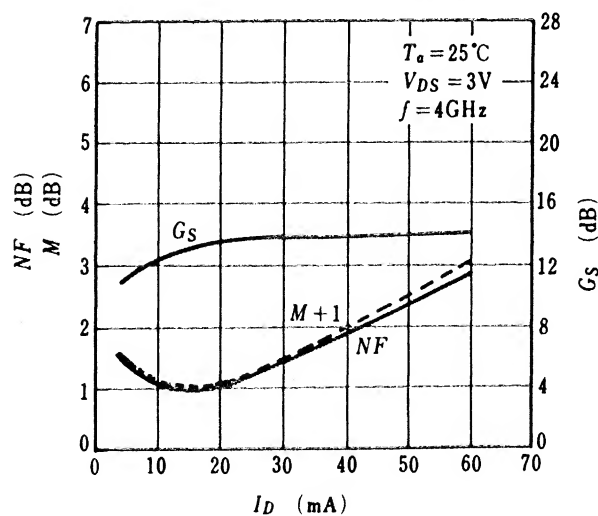
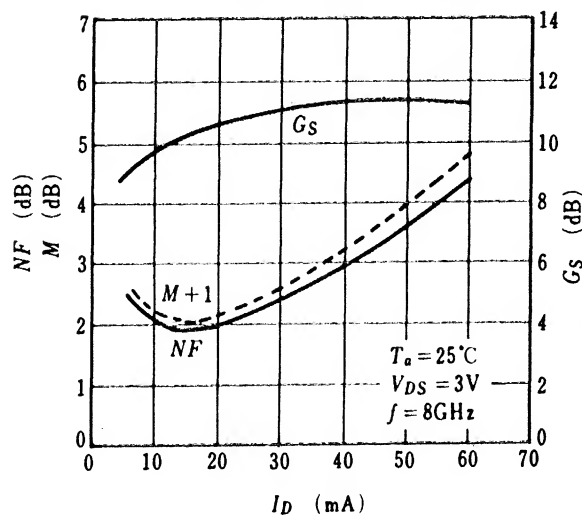
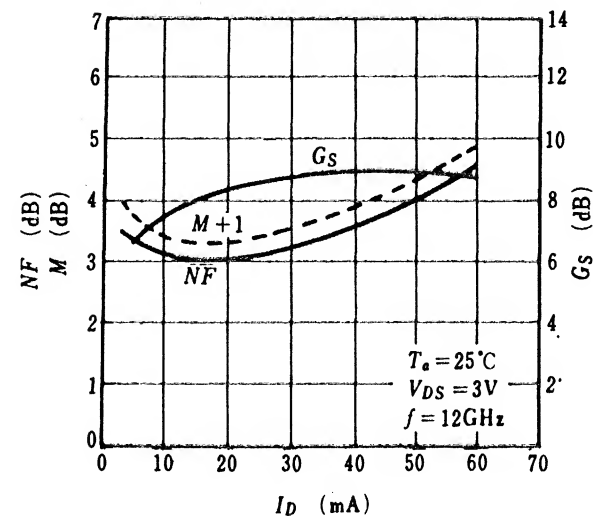
MGF1202

GaAs型 Nチャンネル

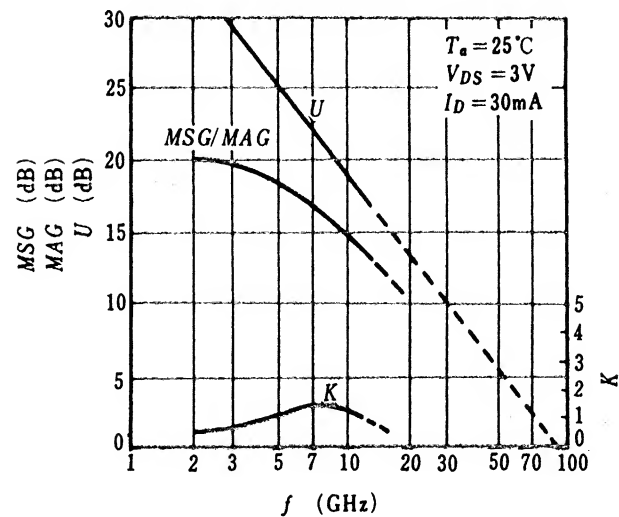
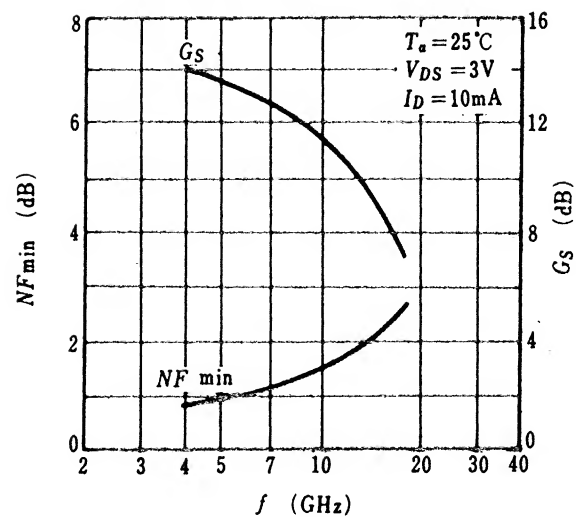
三　　菱

MGF1402, 1421

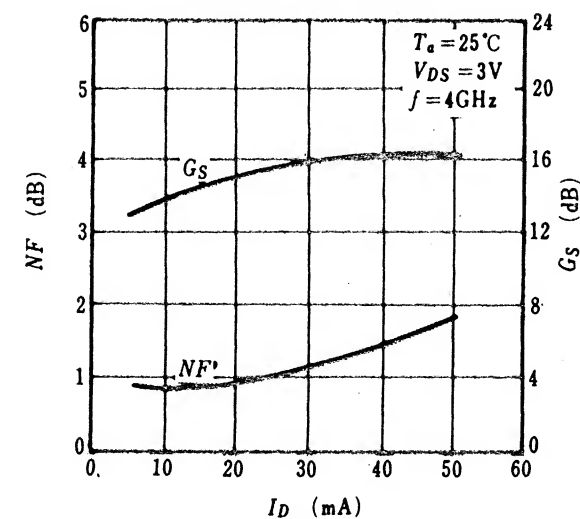
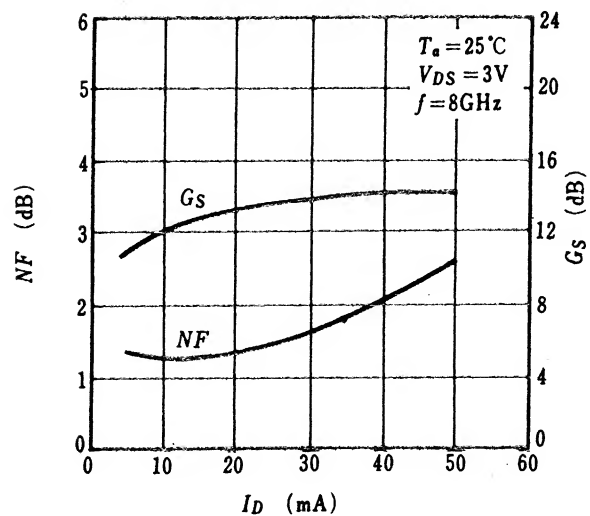
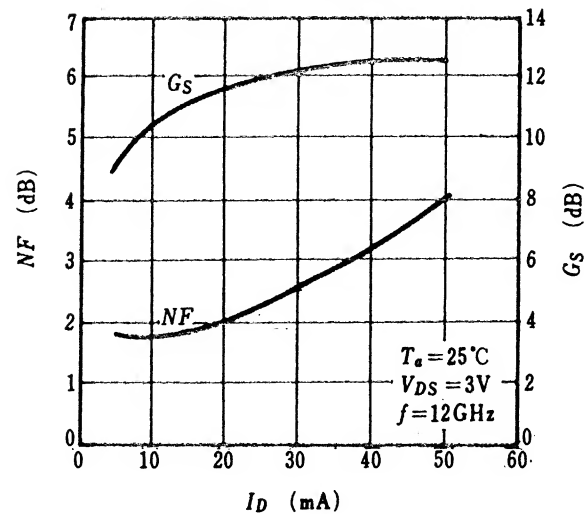
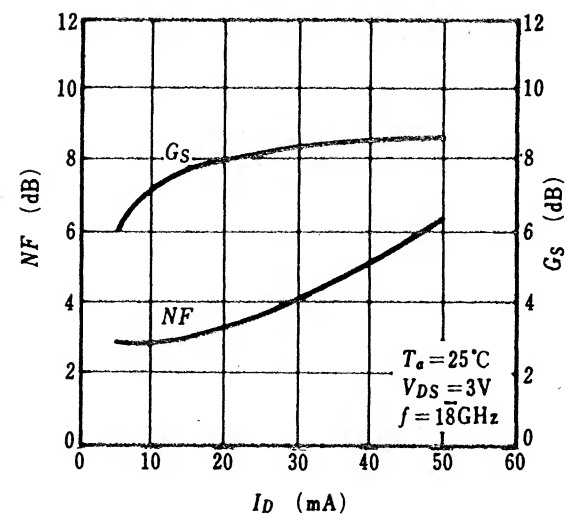
GaAs型 Nチャンネル　　三　菱

MSG, MAG, U, K - f 特性

NFmin, Gs - f 特性

MAG, MSG, - f 特性

NF, M, Gs - ID 特性

NF, M, Gs - ID 特性

NF, M, Gs - ID 特性

MGF1403

GaAs型 Nチャンネル　三菱

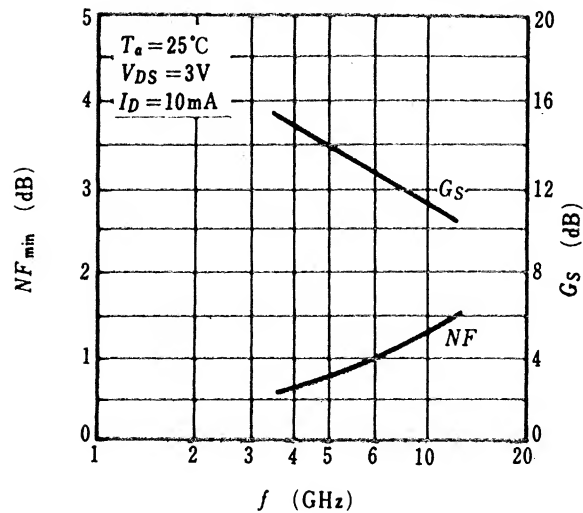
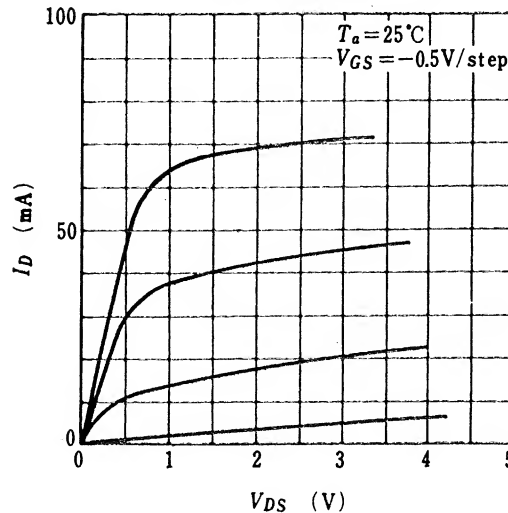
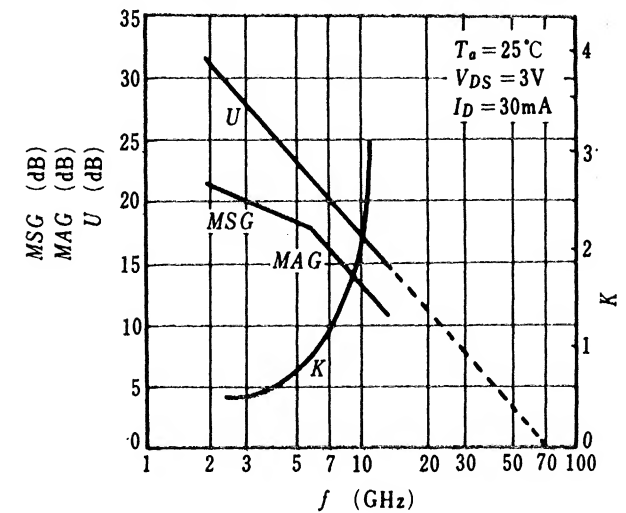
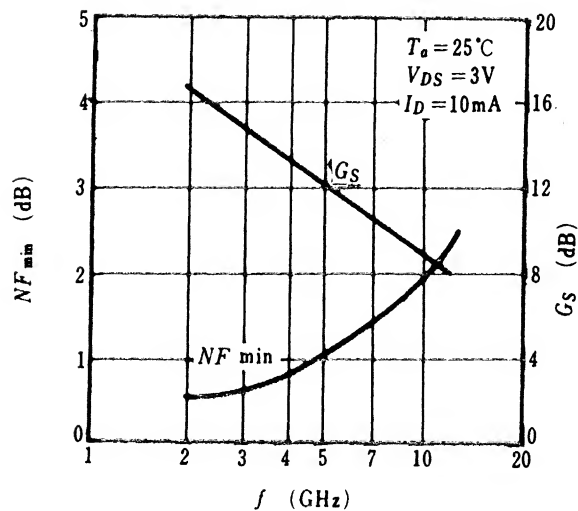
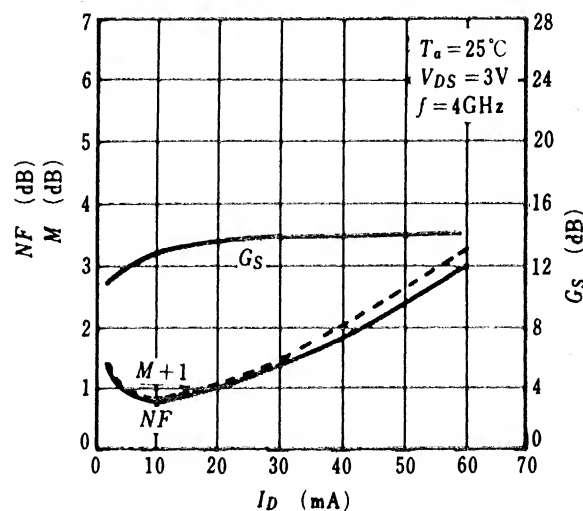
MSG, MAG, U, K - f 特性

NFmin, Gs - f 特性

NF, Gs - ID 特性

NF, Gs - ID 特性

NF, Gs - ID 特性

NF, Gs - ID 特性

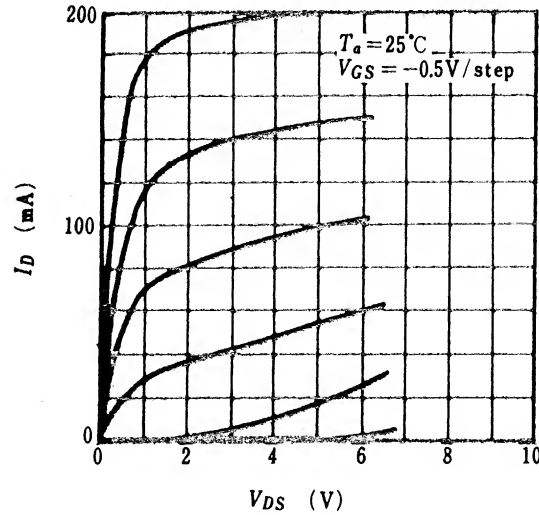
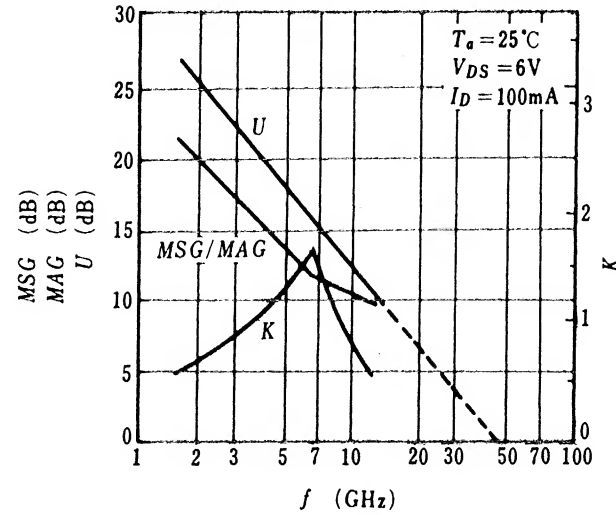
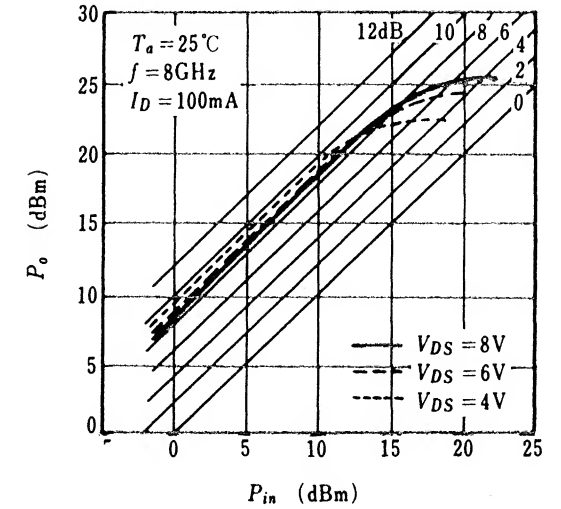
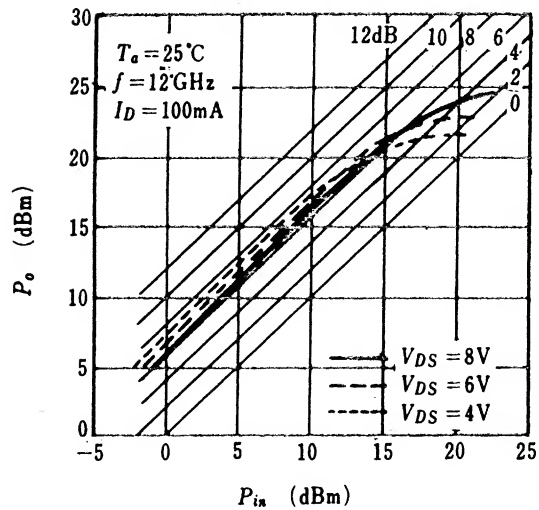
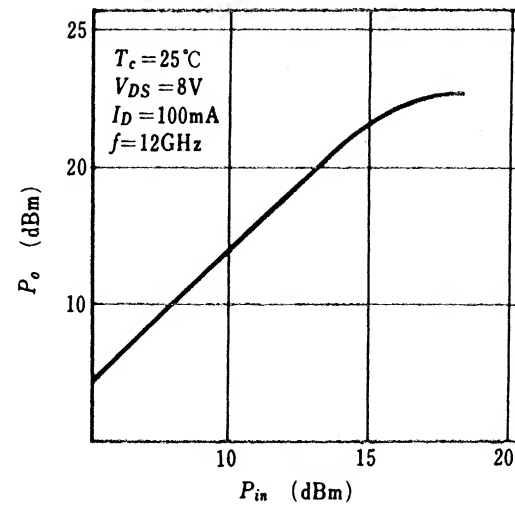
MGF1404, 1412

GaAs型 Nチャンネル　三　菱

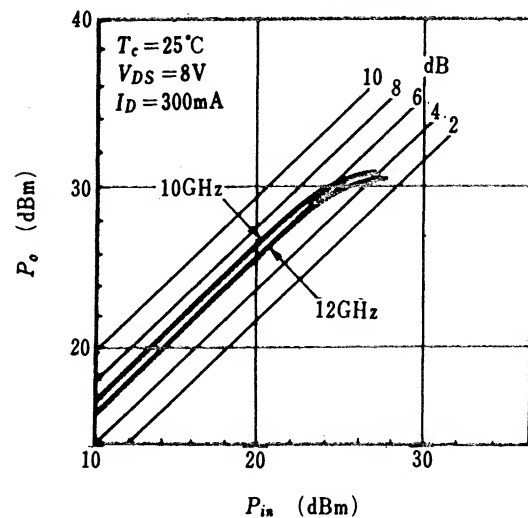
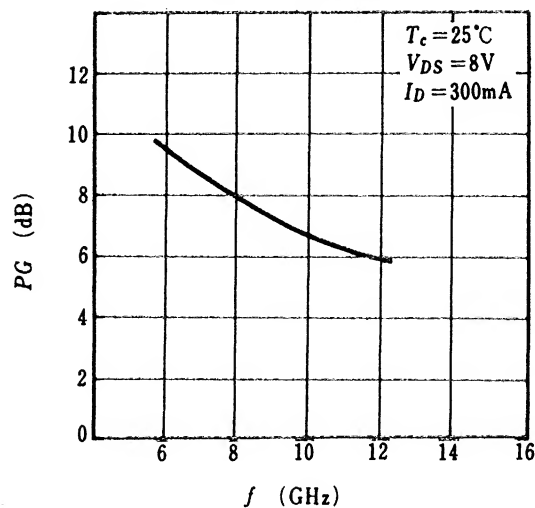
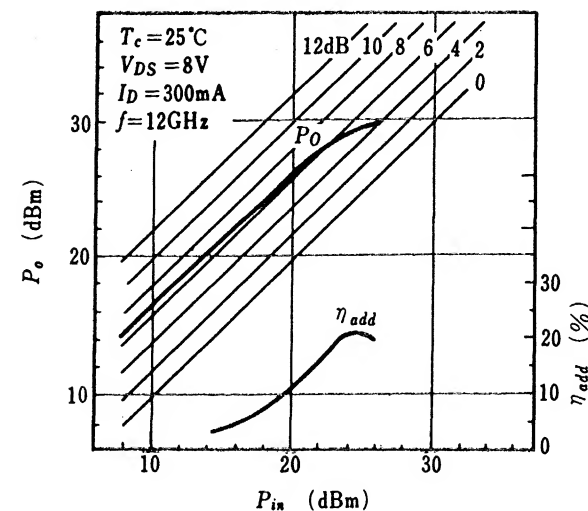
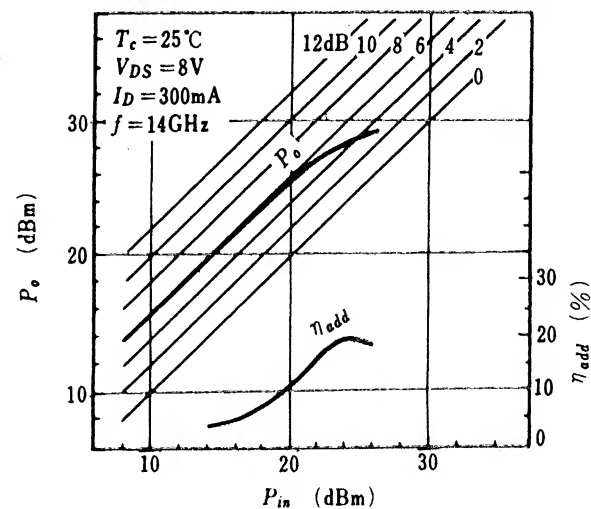
MGF1404
*NF*min, *Gs* - *f* 特性

MGF1412
ソース接地出力特性

MGF1412
MSG, *MAG*, *U*, *K* - *f* 特性

MGF1412
*NF*min, *Gs* - *f* 特性

MGF1412
NF, *M*, *Gs* - *ID* 特性

MGF1801, 1802

GaAs型
Nチャンネル

三　菱

MGF1801
ソース接地出力特性

MGF1801
$MSG, MAG, U, K-f$ 特性

MGF1801
P_o-P_{in} 特性

MGF1801
P_o-P_{in} 特性

MGF1802
P_o-P_{in} 特性

MGF2124, F, G

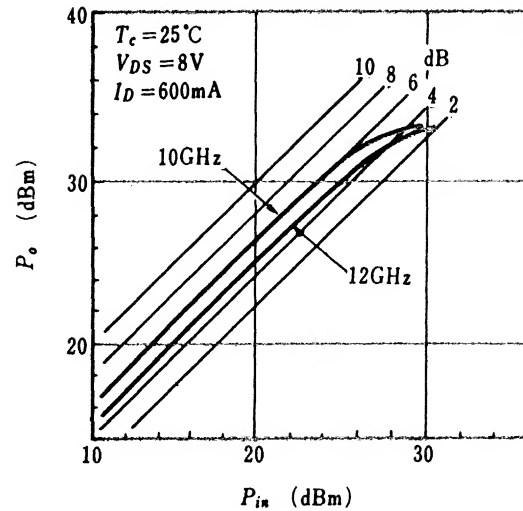
GaAs型 Nチャンネル　三菱

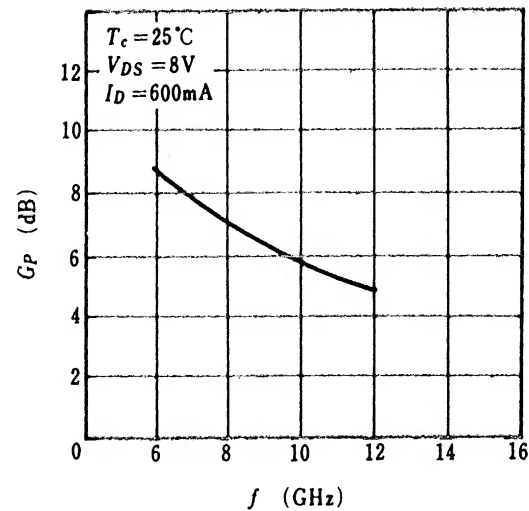
MGF2124
P_o - P_{in} 特性

MGF2124
G_P - f 特性

MGF2124F, G
P_o - P_{in} 特性

MGF2124F, G
P_o - P_{in} 特性

MGF2148, F, G

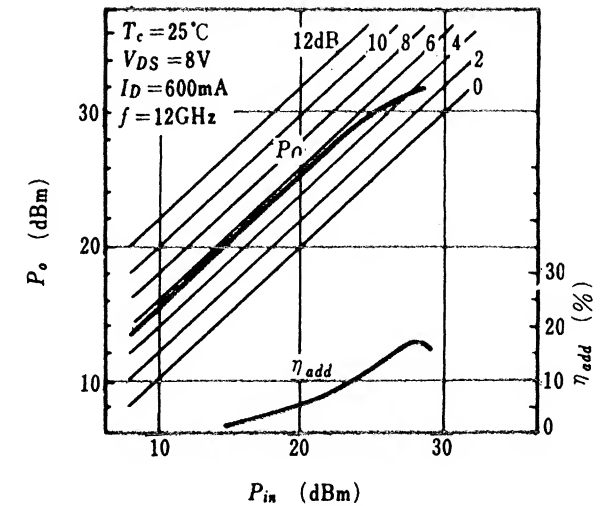
GaAs型
Nチャンネル

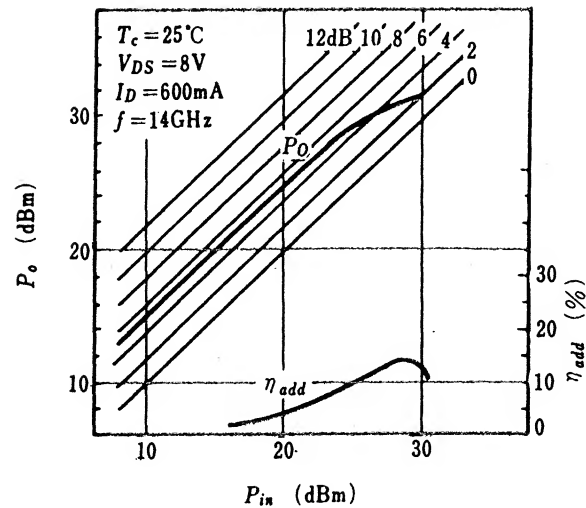
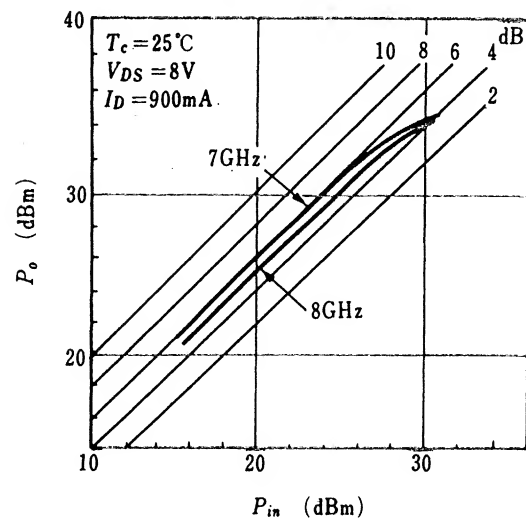
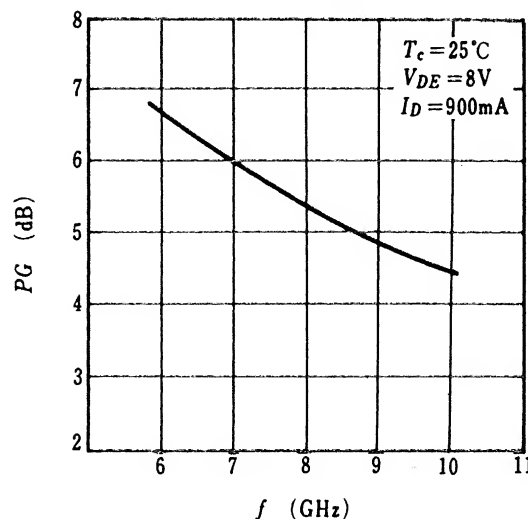
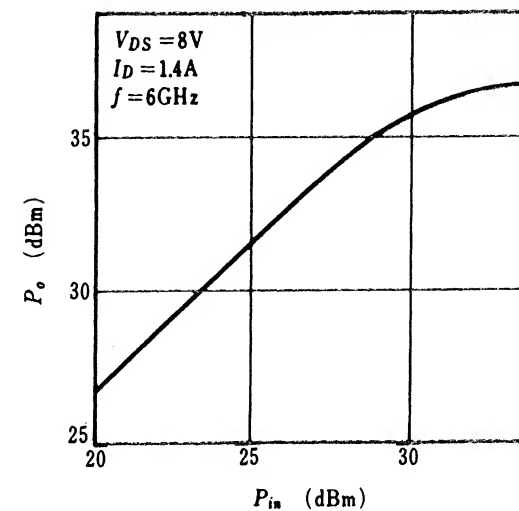
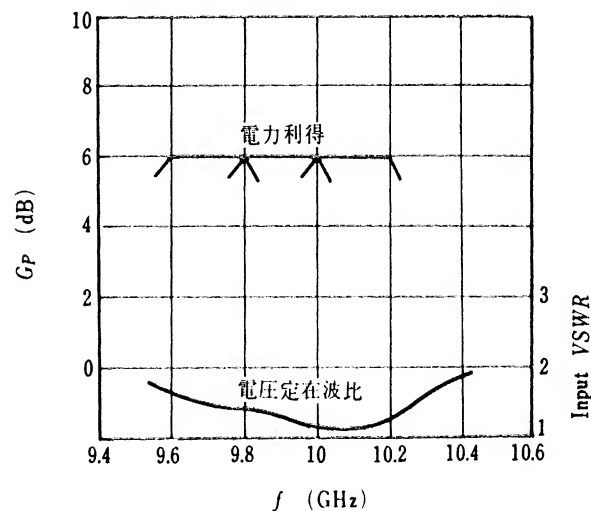
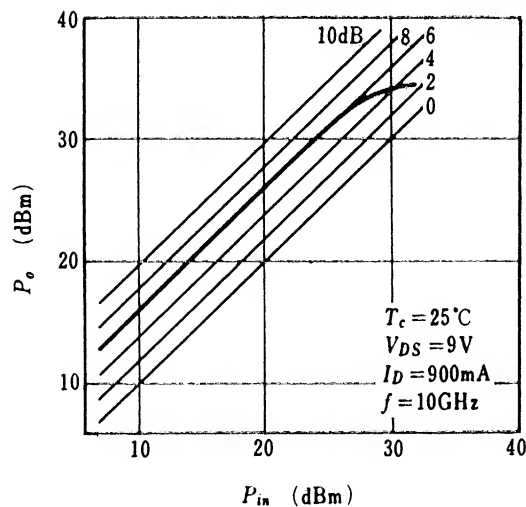
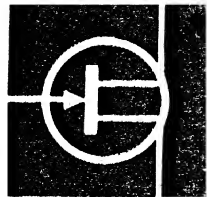
三　菱

MGF2148

P_o - P_{in} 特性

MGF2148

G_P - f 特性

MGF2148F, G

P_o - P_{in} 特性

MGF2148F, G

P_o - P_{in} 特性

MGF2172, 2205, X34M GaAs型 Nチャンネル

MGF2172
G_P - f 特性

MGF2205
P_o - P_{in} 特性

MGF - X34M
G_P, $VSWR$ - f 特性

MGF - X34M
P_o - P_{in} 特性

パワーMOS FET
主要規格一覧表
（外国製）

規格表の見方

(1) 社名
　ITS　：Intersil Inc.
　RCA：RCA Corp.
　SL　：Siliconix Inc.
　SPT：Supertex Inc.

(2) チャネルの欄のP/Nは，1パッケージ内にPチャネルとNチャネルの両方のFETが入っていることを示します．

(3) 最大消費電力の欄の/Uは，1パッケージ内に複数個入っているFETの，1個当りの最大消費電力を示します．

(4) 外囲器の欄のPDIP，CDIPは，それぞれプラスチックDIP，セラミックDIPのことです．

(5) 備考の欄の"*"は，1パッケージ内のFETの個数を示します．

型名	社名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧 (V)				最大直流ドレイン電流 (A)					最大消費電力(W) $Tc=25^{\circ}C$	外囲器	備考
			〜100	101〜300	301〜500	501〜1000	〜1.0	1.1〜3.0	3.1〜5.0	5.1〜10.0	10.1〜			
2N6656	SL	N	35					2				25	TO-3	
2N6657	SL	N	60					2				25	TO-3	
2N6658	SL	N	90					1.9				25	TO-3	
2N6659	SL	N	35					1.4				6.25	TO-39	
2N6660	ITS	N	60					1.2				6.25	TO-39	
2N6660	SPT	N	60					1.1				6.25	TO-39	
2N6660	SL	N	60					1.1				6.25	TO-39	
2N6661	ITS	N	90					1.2				6.25	TO-39	
2N6661	SPT	N	90				0.9					6.25	TO-39	
2N6661	SL	N	90				0.9					6.25	TO-39	
AN0120NA	SPT	N		200			0.03					1.5/U	PDIP18P	2SK*8
AN0120NB	SPT	N		200			0.04					2/U	CDIP18P	2SK*8
AN0120ND	SPT	N		200										CHIP
AN0130NA	SPT	N		300			0.03					1.5/U	PDIP18P	2SK*8
AN0130NB	SPT	N		300			0.04					2/U	CDIP18P	2SK*8
AN0130ND	SPT	N		300										CHIP
AN0140NA	SPT	N			400		0.03					1.5/U	PDIP18P	2SK*8
AN0140NB	SPT	N			400		0.04					2/U	CDIP18P	2SK*8
AN0140ND	SPT	N			400									CHIP
AP0120NA	SPT	P		-200			-.015					1.5/U	PDIP18P	2SJ*8
AP0120NB	SPT	P		-200			-.015					2/U	CDIP18P	2SJ*8
AP0120ND	SPT	P		-200										CHIP
AP0130NA	SPT	P		-300			-.015					1.5/U	PDIP18P	2SJ*8
AP0130NB	SPT	P		-300			-.015					2/U	CDIP18P	2SJ*8
AP0130ND	SPT	P		-300										CHIP
AP0140NA	SPT	P			-400		-.015					1.5/U	PDIP18P	2SJ*8
AP0140NB	SPT	P			-400		-.015					2/U	CDIP18P	
AP0140ND	SPT	P			-400									CHIP
INV5000ANF	ITS	N	80				0.7					2	TO-237	
INV5000ANH	ITS	N	100				0.7					2	TO-237	

型　　名	社　名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧（V）				最大直流ドレイン電流（A）					最大消費電力(W) $Tc=25°C$	外　囲　器	備　　考
			〜100	101〜300	301〜500	501〜1000	〜1.0	1.1〜3.0	3.1〜5.0	5.1〜10.0	10.1〜			
INV5001TND	ITS	N	40					1.2				6.25	TO-39	
IRF120	SL	N	100							8		40	TO-3	
IRF121	SL	N	60							8		40	TO-3	
IRF122	SL	N	100							7		40	TO-3	
IRF123	SL	N	60							7		40	TO-3	
IRF130	RCA	N	100								14	75	TO-204AE/AA	
IRF130	SL	N	100								14	75	TO-3	
IRF131	RCA	N	60								14	75	TO-204AE/AA	
IRF131	SL	N	60								14	75	TO-3	
IRF132	RCA	N	100								12	75	TO-204AE/AA	
IRF132	SL	N	100								12	75	TO-3	
IRF133	RCA	N	60								12	75	TO-204AE/AA	
IRF133	SL	N	60								12	75	TO-3	
IRF140	SL	N	100								27	125	TO-3	
IRF141	SL	N	60								27	125	TO-3	
IRF142	SL	N	100								24	125	TO-3	
IRF143	SL	N	60								24	125	TO-3	
IRF150	SL	N	100								40	150	TO-3	
IRF151	SL	N	60								40	150	TO-3	
IRF152	SL	N	100								33	150	TO-3	
IRF153	SL	N	60								33	150	TO-3	
IRF220	SL	N		200					5			40	TO-3	
IRF221	SL	N		150					5			40	TO-3	
IRF222	SL	N		200					4			40	TO-3	
IRF223	SL	N		150					4			40	TO-3	
IRF230	SL	N		200						9		75	TO-3	
IRF231	SL	N		150						9		75	TO-3	
IRF232	SL	N		200						8		75	TO-3	
IRF233	SL	N		150						8		75	TO-3	
IRF240	SL	N		200							18	125	TO-3	

型名	社名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧（V）				最大直流ドレイン電流（A）					最大消費電力(W) $Tc=25°C$	外囲器	備考
			～100	101～300	301～500	501～1000	～1.0	1.1～3.0	3.1～5.0	5.1～10.0	10.1～			
IRF241	SL	N		150							18	125	TO-3	
IRF242	SL	N		200							16	125	TO-3	
IRF243	SL	N		150							16	125	TO-3	
IRF250	SL	N		200							30	150	TO-3	
IRF251	RCA	N		150							30	150	TO-204AE/AA	
IRF251	SL	N		150							30	150	TO-3	
IRF252	SL	N		200							25	150	TO-3	
IRF253	RCA	N		150							25	150	TO-204AE/AA	
IRF253	SL	N		150							25	150	TO-3	
IRF320	SL	N			400			3				40	TO-3	
IRF321	SL	N			350			3				40	TO-3	
IRF322	SL	N			400			2.5				40	TO-3	
IRF323	SL	N			350			2.5				40	TO-3	
IRF330	SL	N			400					5.5		75	TO-3	
IRF331	SL	N			350					5.5		75	TO-3	
IRF332	SL	N			400				4.5			75	TO-3	
IRF333	SL	N			350				4.5			75	TO-3	
IRF340	SL	N			400						10	125	TO-3	
IRF341	SL	N			350					10		125	TO-3	
IRF342	SL	N			400					8		125	TO-3	
IRF343	SL	N			350					8		125	TO-3	
IRF350	SL	N			400						15	150	TO-3	
IRF351	SL	N			350						15	150	TO-3	
IRF352	SL	N			400						13	150	TO-3	
IRF353	SL	N			350						13	150	TO-3	
IRF420	RCA	N			500			2.5				40	TO-204AE/AA	
IRF420	SL	N			500			2.5				40	TO-3	
IRF421	RCA	N			450			2.5				40	TO-204AE/AA	
IRF421	SL	N			450			2.5				40	TO-3	
IRF422	RCA	N			500			2				40	TO-204AE/AA	

型　　名	社　名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧（V）				最大直流ドレイン電流（A）					最大消費電力(W) Tc=25°C	外　囲　器	備　　考
			～100	101～300	301～500	501～1000	～1.0	1.1～3.0	3.1～5.0	5.1～10.0	10.1～			
IRF422	SL	N			500			2				40	TO-3	
IRF423	RCA	N			450			2				40	TO-204AE/AA	
IRF423	SL	N			450			2				40	TO-3	
IRF430	SL	N			500				4.5			75	TO-3	
IRF431	SL	N			450				4.5			75	TO-3	
IRF432	SL	N			500				4			75	TO-3	
IRF433	SL	N			450				4			75	TO-3	
IRF440	SL	N			500					8		125	TO-3	
IRF441	SL	N			450					8		125	TO-3	
IRF442	SL	N			500					7		125	TO-3	
IRF443	SL	N			450					7		125	TO-3	
IRF450	SL	N			500						13	150	TO-3	
IRF451	SL	N			450						13	150	TO-3	
IRF452	SL	N			500						12	150	TO-3	
IRF453	SL	N			450						12	150	TO-3	
IRF510	RCA	N	100						4			20	TO-220AB	
IRF511	RCA	N	60						4			20	TO-220AB	
IRF512	RCA	N	100						3.5			20	TO-220AB	
IRF513	RCA	N	60						3.5			20	TO-220AB	
IRF520	RCA	N	100							8		40	TO-220AB	
IRF520	SL	N	100							8		40	TO-220AB	
IRF521	RCA	N	60							8		40	TO-220AB	
IRF521	SL	N	60							8		40	TO-220AB	
IRF522	RCA	N	100							7		40	TO-220AB	
IRF522	SL	N	100							7		40	TO-220AB	
IRF523	RCA	N	60							7		40	TO-220AB	
IRF523	SL	N	60							7		40	TO-220AB	
IRF530	RCA	N	100								14	75	TO-220AB	
IRF530	SL	N	100								14	75	TO-220AB	
IRF531	RCA	N	60								14	75	TO-220AB	

型名	社名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧（V）				最大直流ドレイン電流（A）					最大消費電力(W) $Tc=25°C$	外囲器	備考
			〜100	101〜300	301〜500	501〜1000	〜1.0	1.1〜3.0	3.1〜5.0	5.1〜10.0	10.1〜			
IRF531	SL	N	60								14	75	TO-220AB	
IRF532	RCA	N	100								12	75	TO-220AB	
IRF532	SL	N	100								12	75	TO-220AB	
IRF533	RCA	N	60								12	75	TO-220AB	
IRF533	SL	N	60								12	75	TO-220AB	
IRF540	SL	N	100								27	125	TO-220AB	
IRF541	SL	N	60								27	125	TO-220AB	
IRF542	SL	N	100								24	125	TO-220AB	
IRF543	SL	N	60								24	125	TO-220AB	
IRF620	SL	N		200					5			40	TO-220AB	
IRF621	SL	N		150					5			40	TO-220AB	
IRF622	SL	N		200					4			40	TO-220AB	
IRF623	SL	N		150					4			40	TO-220AB	
IRF630	SL	N		200						9		75	TO-220AB	
IRF631	SL	N		150						9		75	TO-220AB	
IRF632	SL	N		200						8		75	TO-220AB	
IRF633	SL	N		150						8		75	TO-220AB	
IRF640	SL	N		200							18	125	TO-220AB	
IRF641	SL	N		150							18	125	TO-220AB	
IRF642	SL	N		200							16	125	TO-220AB	
IRF643	SL	N		150							16	125	TO-220AB	
IRF720	SL	N			400			3				40	TO-220AB	
IRF721	SL	N			350			3				40	TO-220AB	
IRF722	SL	N			400			2.5				40	TO-220AB	
IRF723	SL	N			350			2.5				40	TO-220AB	
IRF730	SL	N			400					5.5		75	TO-220AB	
IRF731	SL	N			350					5.5		75	TO-220AB	
IRF732	SL	N			400				4.5			75	TO-220AB	
IRF733	SL	N			350				4.5			75	TO-220AB	
IRF740	SL	N			400					10		125	TO-220AB	

型　　名	社　名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧（V）				最大直流ドレイン電流（A）					最大消費電力(W) Tc=25°C	外　囲　器	備　　考
			～100	101～300	301～500	501～1000	～1.0	1.1～3.0	3.1～5.0	5.1～10.0	10.1～			
IRF741	SL	N			350					10		125	TO-220AB	
IRF742	SL	N			400					8		125	TO-220AB	
IRF743	SL	N			350					8		125	TO-220AB	
IRF820	SL	N			500			2.5				40	TO-220AB	
IRF821	SL	N			450			2.5				40	TO-220AB	
IRF822	SL	N			500			2				40	TO-220AB	
IRF823	SL	N			450			2				40	TO-220AB	
IRF830	SL	N			500				4.5			75	TO-220AB	
IRF831	SL	N			450				4.5			75	TO-220AB	
IRF832	SL	N			500				4			75	TO-220AB	
IRF833	SL	N			450				4			75	TO-220AB	
IRF840	SL	N			500					8		125	TO-220AB	
IRF841	SL	N			450					8		125	TO-220AB	
IRF842	SL	N			500					7		125	TO-220AB	
IRF843	SL	N			450					7		125	TO-220AB	
IRF9130	SL	P	-100								-12	75	TO-3	
IRF9131	SL	P	-60								-12	75	TO-3	
IRF9132	SL	P	-100							-10		75	TO-3	
IRF9133	SL	P	-60							-10		75	TO-3	
IRF9520	SL	P	-100							-6		40	TO-220AB	
IRF9521	SL	P	-60							-6		40	TO-220AB	
IRF9522	SL	P	-100						-5			40	TO-220AB	
IRF9523	SL	P	-60						-5			40	TO-220AB	
IRF9530	SL	P	-100								-12	75	TO-220AB	
IRF9531	SL	P	-60								-12	75	TO-220AB	
IRF9532	SL	P	-100							-10		75	TO-220AB	
IRF9533	SL	P	-60							-10		75	TO-220AB	
IRFF120	SL	N	100							6		20	TO-39	
IRFF121	SL	N	60							6		20	TO-39	
IRFF122	SL	N	100						5			20	TO-39	

型　名	社　名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧（V）				最大直流ドレイン電流（A）					最大消費電力（W） $Tc=25°C$	外　囲　器	備　考
			～100	101～300	301～500	501～1000	～1.0	1.1～3.0	3.1～5.0	5.1～10.0	10.1～			
IRFF123	SL	N	60						5			20	TO-39	
IRFF130	SL	N	100							8		25	TO-39	
IRFF132	SL	N	100							7		25	TO-39	
IVN5000AND	ITS	N	40				0.7					2	TO-237	
IVN5000ANE	ITS	N	60				0.7					2	TO-237	
IVN5000SND	ITS	N	40				0.9					3.13	TO-52	
IVN5000SNE	ITS	N	60				0.9					3.13	TO-52	
IVN5000SNF	ITS	N	80				0.9					3.13	TO-52	
IVN5000SNH	ITS	N	100				0.9					3.13	TO-52	
IVN5000TND	ITS	N	40					1.2				6.25	TO-39	
IVN5000TNE	ITS	N	60					1.2				6.25	TO-39	
IVN5000TNF	ITS	N	80					1.2				6.25	TO-39	
IVN5000TNH	ITS	N	100					1.2				6.25	TO-39	
IVN5001AND	ITS	N	40				0.7					2	TO-237	
IVN5001ANE	ITS	N	60				0.7					2	TO-237	
IVN5001ANF	ITS	N	80				0.7					2	TO-237	
IVN5001ANH	ITS	N	100				0.7					2	TO-237	
IVN5001SND	ITS	N	40				0.9					3.13	TO-52	
IVN5001SNE	ITS	N	60				0.9					3.13	TO-52	
IVN5001SNF	ITS	N	80				0.9					3.13	TO-52	
IVN5001SNH	ITS	N	100				0.9					3.13	TO-52	
IVN5001TNE	ITS	N	60					1.2				6.25	TO-39	
IVN5001TNF	ITS	N	80					1.2				6.25	TO-39	
IVN5001TNH	ITS	N	100					1.2				6.25	TO-39	
IVN5200HND	ITS	N	40						5			30	TO-66	
IVN5200HNE	ITS	N	60						5			30	TO-66	
IVN5200HNF	ITS	N	80						5			30	TO-66	
IVN5200HNH	ITS	N	100						5			30	TO-66	
IVN5200KND	ITS	N	40						5			50	TO-3	
IVN5200KNE	ITS	N	60						5			50	TO-3	

型名	社名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧 (V)				最大直流ドレイン電流 (A)					最大消費電力 (W) $Tc=25°C$	外囲器	備考
			~100	101~300	301~500	501~1000	~1.0	1.1~3.0	3.1~5.0	5.1~10.0	10.1~			
IVN5200KNF	ITS	N	80						5			50	TO-3	
IVN5200KNH	ITS	N	100						5			50	TO-3	
IVN5200TND	ITS	N	40						4			12.5	TO-39	
IVN5200TNE	ITS	N	60						4			12.5	TO-39	
IVN5200TNF	ITS	N	80						4			12.5	TO-39	
IVN5200TNH	ITS	N	100						4			12.5	TO-39	
IVN5201CND	ITS	N	40						5			30	TO-220	
IVN5201CNE	ITS	N	60						5			30	TO-220	
IVN5201CNF	ITS	N	80						5			30	TO-220	
IVN5201CNH	ITS	N	100						5			30	TO-220	
IVN5201HND	ITS	N	40						5			30	TO-66	
IVN5201HNE	ITS	N	60						5			30	TO-66	
IVN5201HNF	ITS	N	80						5			30	TO-66	
IVN5201HNH	ITS	N	100						5			30	TO-66	
IVN5201KND	ITS	N	40						5			50	TO-3	
IVN5201KNE	ITS	N	60						5			50	TO-3	
IVN5201KNF	ITS	N	80						5			50	TO-3	
IVN5201KNH	ITS	N	100						5			50	TO-3	
IVN5201TND	ITS	N	40						4			12.5	TO-39	
IVN5201TNE	ITS	N	60						4			12.5	TO-39	
IVN5201TNF	ITS	N	80						4			12.5	TO-39	
IVN5201TNH	ITS	N	100						4			12.5	TO-39	
IVN6000CNS	ITS	N			400			2				30	TO-220	
IVN6000CNT	ITS	N			450			2				30	TO-220	
IVN6000CNU	ITS	N			500			1.75				30	TO-220	
IVN6000KNR	ITS	N			350			2.5				41.7	TO-3	
IVN6000KNS	ITS	N			400			2.5				41.7	TO-3	
IVN6000KNT	ITS	N			450			2.5				41.7	TO-3	
IVN6000KNU	ITS	N			500			2				41.7	TO-3	
IVN6000TNS	ITS	N			400		1					12.5	TO-39	

型名	社名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧（V）				最大直流ドレイン電流（A）					最大消費電力(W) $Tc=25°C$	外囲器	備考
			～100	101～300	301～500	501～1000	～1.0	1.1～3.0	3.1～5.0	5.1～10.0	10.1～			
IVN6000TNT	ITS	N			450		1					12.5	TO-39	
IVN6000TNU	ITS	N			500		0.9					12.5	TO-39	
IVN6100TNS	ITS	N			400		0.3					6.25	TO-39	
IVN6100TNT	ITS	N			450		0.3					6.25	TO-39	
IVN6100TNU	ITS	N			500		0.3					6.25	TO-39	
IVN6200CNE	ITS	N	60							10		100	TO-220	
IVN6200CNF	ITS	N	80							10		100	TO-220	
IVN6200CNH	ITS	N	100							10		100	TO-220	
IVN6200CNM	ITS	N		200						10		100	TO-220	
IVN6200CNP	ITS	N		250						10		100	TO-220	
IVN6200CNS	ITS	N			400				5			100	TO-220	
IVN6200CNT	ITS	N			450				5			100	TO-220	
IVN6200CNU	ITS	N			500				5			100	TO-220	
IVN6200CNW	ITS	N				700		3				100	TO-220	
IVN6200CNX	ITS	N				800		2				100	TO-220	
IVN6200KNE	ITS	N	60							10		100	TO-3	
IVN6200KNF	ITS	N	80							10		100	TO-3	
IVN6200KNH	ITS	N	100							10		100	TO-3	
IVN6200KNM	ITS	N		200						10		100	TO-3	
IVN6200KNP	ITS	N		250						10		100	TO-3	
IVN6200KNS	ITS	N			400				5			100	TO-3	
IVN6200KNT	ITS	N			450				5			100	TO-3	
IVN6200KNU	ITS	N			500				5			100	TO-3	
IVN6200KNW	ITS	N				700		3				100	TO-3	
IVN6200KNX	ITS	N				800		2.5				100	TO-3	
IVN6300ANE	ITS	N	60				0.25					1.5	TO-237	
IVN6300ANF	ITS	N	80				0.25					1.5	TO-237	
IVN6300ANH	ITS	N	100				0.25					1.5	TO-237	
IVN6300ANM	ITS	N		200			0.12					1.5	TO-237	
IVN6300ANP	ITS	N		250			0.12					1.5	TO-237	

型　　名	社　名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧（V）				最大直流ドレイン電流（A）					最大消費電力(W) $Tc=25°C$	外　囲　器	備　　考
			～100	101～300	301～500	501～1000	～1.0	1.1～3.0	3.1～5.0	5.1～10.0	10.1～			
IVN6300ANS	ITS	N			400		0.1					1.5	TO-237	
IVN6300ANT	ITS	N			450		0.1					1.5	TO-237	
IVN6300ANU	ITS	N			500		0.1					1.5	TO-237	
IVN6300SNE	ITS	N	60				0.25					1.5	TO-52	
IVN6300SNF	ITS	N	80				0.25					1.5	TO-52	
IVN6300SNH	ITS	N	100				0.25					1.5	TO-52	
IVN6300SNM	ITS	N		200			0.12					1.5	TO-52	
IVN6300SNP	ITS	N		250			0.12					1.5	TO-52	
IVN6300SNS	ITS	N			400		0.1					1.5	TO-52	
IVN6300SNT	ITS	N			450		0.1					1.5	TO-52	
IVN6300SNU	ITS	N			500		0.1					1.5	TO-52	
IVN6660	ITS	N	60					1.2				6.25	TO-39	
IVN6661	ITS	N	90					1.2				6.25	TO-39	
OCF25N18	RCA	N		180							25			CHIP
PCF10N12	RCA	N		120						10				CHIP
PCF10N45	RCA	N			450					10				CHIP
PCF12N08	RCA	N	80								12			CHIP
PCF12N18	RCA	N		180							12			CHIP
PCF12P08	RCA	P	-80								-12			CHIP
PCF15N05	RCA	N	50								15			CHIP
PCF15N12	RCA	N		120							15			CHIP
PCF18N08	RCA	N	80								18			CHIP
PCF2N05	RCA	N	50					2						CHIP
PCF2N08	RCA	N	80					2						CHIP
PCF2N12	RCA	N		120				2						CHIP
PCF2N18	RCA	N		180				2						CHIP
PCF30N12	RCA	N		120							30			CHIP
PCF35N08	RCA	N	80								35			CHIP
PCF3N45	RCA	N			450			3						CHIP
PCF45N05	RCA	N	50								45			CHIP

型名	社名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧 (V)				最大直流ドレイン電流 (A)					最大消費電力(W) $Tc=25^\circ C$	外囲器	備考
			~100	101~300	301~500	501~1000	~1.0	1.1~3.0	3.1~5.0	5.1~10.0	10.1~			
PCF5P12	RCA	P		-120					-5					CHIP
PCF6P08	RCA	P	-80							-6				CHIP
PCF8N18	RCA	N		180						8				CHIP
PCF8P08	RCA	P	-80							-8				CHIP
RFH25P08	RCA	P	-80								-25			
RFH25P10	RCA	P	-100								-25			
RFH30N12	RCA	N		120							30			
RFH30N15	RCA	N		150							30			
RFK10N45	RCA	N			450					10		150	TO-204AE	
RFK10N50	RCA	N			500					10		150	TO-204AE	
RFK25N18	RCA	N		180							25	150	TO-204AE	
RFK25N20	RCA	N		200							25	150	TO-204AE	
RFK25P08	RCA	P	-80								-25	150	TO-204AE	
RFK25P10	RCA	P	-100								-25	150	TO-204AE	
RFK30N12	RCA	N		120							30	120	TO-204AE	
RFK30N15	RCA	N		150							30	120	TO-204AE	
RFK35N08	RCA	N	80								35	150	TO-204AE	
RFK35N10	RCA	N	100								35	150	TO-204AE	
RFK45N05	RCA	N	50								45	150	TO-204AE	
RFK45N06	RCA	N	60								45	150	TO-204AE	
RFL1N08	RCA	N	80				1					8.33	TO-39	
RFL1N08L	RCA	N	80				1					8.33	TO-39	LL=5V
RFL1N10	RCA	N	100				1					8.33	TO-39	
RFL1N10L	RCA	N	100				1					8.33	TO-39	LL=5V
RFL1N12	RCA	N		120			1					8.33	TO-39	
RFL1N12L	RCA	N		120			1					8.33	TO-39	LL=5V
RFL1N15	RCA	N		150			1					8.33	TO-39	
RFL1N15L	RCA	N		150			1					8.33	TO-39	LL=5V
RFL1N18	RCA	N		180			1					8.33	TO-39	
RFL1N18L	RCA	N		180								8.33	TO-39	LL=5V

型名	社名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧 (V)				最大直流ドレイン電流 (A)					最大消費電力(W) Tc=25℃	外囲器	備考
			~100	101~300	301~500	501~1000	~1.0	1.1~3.0	3.1~5.0	5.1~10.0	10.1~			
RFL1N20	RCA	N		200			1					8.33	TO-39	
RFL1N20L	RCA	N		200								8.33	TO-39	LL=5V
RFL1P08	RCA	P	-80				-1						TO-220	
RFL1P10	RCA	P	-100				-1						TO-220	
RFL2N05	RCA	N	50					2				8.33	TO-39	
RFL2N06	RCA	N	60					2				8.33	TO-39	
RFL4N12	RCA	N		120					4			8.33	TO-39	
RFL4N15	RCA	N		150					4			8.33	TO-39	
RFM10N12	RCA	N		120						10		75	TO-204MA	
RFM10N15	RCA	N		150						10		75	TO-204MA	
RFM10P12	RCA	P		-120						-10				
RFM10P15	RCA	P		-150						-10				
RFM12N08	RCA	N	80								12	75	TO-204MA	
RFM12N08L	RCA	N	80								12	75	TO-204MA	LL=5V
RFM12N10	RCA	N	100								12	75	TO-204MA	
RFM12N10L	RCA	N	100								12	75	TO-204MA	LL=5V
RFM12N18	RCA	N		180							12	100	TO-204MA	
RFM12N20	RCA	N		200							12	100	TO-204MA	
RFM12P08	RCA	P	-80								-12	100	TO-204MA	
RFM12P10	RCA	P	-100								-12	100	TO-204MA	
RFM15N05	RCA	N	50								15	75	TO-204MA	
RFM15N05L	RCA	N	50								15		TO-3	LL=5V
RFM15N06	RCA	N	60								15	75	TO-204MA	
RFM15N06L	RCA	N	60								15		TO-3	LL=5V
RFM15N12	RCA	N		120							15	100	TO-204MA	
RFM15N15	RCA	N		150							15	100	TO-204MA	
RFM18N08	RCA	N	80								18	100	TO-204MA	
RFM18N10	RCA	N	100								18	100	TO-204MA	
RFM25N05	RCA	N	50								25		TO-3	LL=5V
RFM25N06	RCA	N	60								25		TO-3	LL=5V

型　　名	社　名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧 (V)				最大直流ドレイン電流 (A)					最大消費電力(W) $Tc=25^{\circ}C$	外　囲　器	備　　考
			〜100	101〜300	301〜500	501〜1000	〜1.0	1.1〜3.0	3.1〜5.0	5.1〜10.0	10.1〜			
RFM3N45	RCA	N			450			3				75	TO-204MA	
RFM3N50	RCA	N			500			3				75	TO-204MA	
RFM5P12	RCA	P		-120					-5			75	TO-204MA	
RFM5P15	RCA	P		-150					-5			75	TO-204MA	
RFM6P08	RCA	P	-80							-6		75	TO-204MA	
RFM6P10	RCA	P	-100							-6		75	TO-204MA	
RFM8N18	RCA	N		180						8		75	TO-204MA	
RFM8N18L	RCA	N		180						8		75	TO-204MA	LL=5V
RFM8N20	RCA	N		200						8		75	TO-204MA	
RFM8P08	RCA	P	-80							-8		100	TO-204MA	
RFM8P10	RCA	P	-100							-8		100	TO-204MA	
RFP10N12	RCA	N		120						10		60	TO-220AB	
RFP10N15	RCA	N		150						10		60	TO-220AB	
RFP10P12	RCA	P		-120						-10			TO-220	
RFP10P15	RCA	P		-150						-10				
RFP12N08	RCA	N	80								12	60	TO-220AB	
RFP12N08L	RCA	N	80								12	60	TO-220AB	LL=5V
RFP12N10	RCA	N	100								12	60	TO-220AB	
RFP12N10L	RCA	N	100								12	60	TO-220AB	LL=5V
RFP12N18	RCA	N		180							12	75	TO-220AB	
RFP12N20	RCA	N		200							12	75	TO-220AB	
RFP12P08	RCA	P	-80								-12	75	TO-220AB	
RFP12P10	RCA	P	-100								-12	75	TO-220AB	
RFP15N05	RCA	N	50								15	60	TO-220AB	
RFP15N05L	RCA	N	50								15		TO-220	LL=5V
RFP15N06	RCA	N	60								15	60	TO-220AB	
RFP15N06L	RCA	N	60								15		TO-220	LL=5V
RFP15N12	RCA	N		120							15	75	TO-220AB	
RFP15N15	RCA	N		150							15	75	TO-220AB	
RFP18N08	RCA	N	80								18	75	TO-220AB	

型名	社名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧 (V)				最大直流ドレイン電流 (A)					最大消費電力(W) Tc=25℃	外囲器	備考
			〜100	101〜300	301〜500	501〜1000	〜1.0	1.1〜3.0	3.1〜5.0	5.1〜10.0	10.1〜			
RFP18N10	RCA	N	100								18	75	TO-220AB	
RFP25N05	RCA	N	50								25		TO-220	LL=5V
RFP25N06	RCA	N	60								25		TO-220	
RFP2N08	RCA	N	80					2				25	TO-220AB	
RFP2N08L	RCA	N	80					2				25	TO-220AB	LL=5V
RFP2N10	RCA	N	100					2				25	TO-220AB	
RFP2N10L	RCA	N	100					2				25	TO-220AB	LL=5V
RFP2N12	RCA	N		120				2				25	TO-220AB	
RFP2N12L	RCA	N		120				2				25	TO-220AB	LL=5V
RFP2N15	RCA	N		150				2				25	TO-220AB	
RFP2N15L	RCA	N		150				2				25	TO-220AB	LL=5V
RFP2N18	RCA	N		180				2				25	TO-220AB	
RFP2N18L	RCA	N		180								25	TO-220AB	LL=5V
RFP2N20	RCA	N		200				2				25	TO-220AB	
RFP2N20L	RCA	N		200								25	TO-220AB	LL=5V
RFP2P08	RCA	P	-80					-2						
RFP2P10	RCA	P	-100					-2						
RFP3N45	RCA	N			450			3				60	TO-220AB	
RFP3N50	RCA	N			500			3				60	TO-220AB	
RFP4N05	RCA	N	50						4			25	TO-220AB	
RFP4N06	RCA	N	60						4			25	TO-220AB	
RFP5P12	RCA	P		-120					-5			60	TO-220AB	
RFP5P15	RCA	P		-150					-5			60	TO-220AB	
RFP6P08	RCA	P	-80							-6		60	TO-220AB	
RFP6P10	RCA	P	-100							-6		60	TO-220AB	
RFP8N18	RCA	N		180						8		60	TO-220AB	
RFP8N18L	RCA	N		180						8		60	TO-220AB	LL=5V
RFP8N20	RCA	N		200						8		60	TO-220AB	
RFP8N20L	RCA	N		200						8		60	TO-220AB	LL=5V
RFP8P08	RCA	P	-80							-8		75	TO-220AB	

型名	社名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧 (V)				最大直流ドレイン電流 (A)					最大消費電力(W) Tc=25℃	外囲器	備考
			~100	101~300	301~500	501~1000	~1.0	1.1~3.0	3.1~5.0	5.1~10.0	10.1~			
RFP8P10	RCA	P	-100							-8		75	TO-220AB	
TA9437A	RCA	N			350					10			TO-204MA	
TA9437B	RCA	N			400					10			TO-204MA	
TA9438A	RCA	N			350					10			TO-220AB	
TA9438B	RCA	N			400					10			TO-220AB	
TFM8N20L	RCA	N		200						8		75	TO-204MA	LL=5V
TN0106N2	SPT	N	60				0.8					3.5	TO-39	
TN0106N3	SPT	N	60				0.5					1	TO-92	
TN0106ND	SPT	N	60											CHIP
TN0110N2	SPT	N	100				0.8					3.5	TO-39	
TN0110N3	SPT	N	100				0.5					1	TO-92	
TN0110ND	SPT	N	100											CHIP
TN0520N2	SPT	N		200			0.7					3.5	TO-39	
TN0520N3	SPT	N		200			0.3					1	TO-92	
TN0520ND	SPT	N		200										CHIP
TN0524N2	SPT	N		240			0.7					3.5	TO-39	
TN0524N3	SPT	N		240			0.3					1	TO-92	
TN0524ND	SPT	N		240										CHIP
VN0104N2	SPT	N	40				0.8					3.5	TO-39	
VN0104N3	SPT	N	40				0.5					1	TO-92	
VN0104N5	SPT	N	40					1.5				15	TO-220	
VN0104N6	SPT	N	40				0.7					0.6/U	PDIP14P	2SK*4
VN0104N7	SPT	N	40				0.7					0.6/U	CDIP14P	2SK*4
VN0104N9	SPT	N	40				0.5					1	TO-52	
VN0104ND	SPT	N	40											CHIP
VN0106N2	SPT	N	60				0.8					3.5	TO-39	
VN0106N3	SPT	N	60				0.5					1	TO-92	
VN0106N5	SPT	N	60					1.5				15	TO-220	
VN0106N6	SPT	N	60				0.7					0.6/U	PDIP14P	2SK*4
VN0106N7	SPT	N	60				0.7					0.6/U	CDIP14P	2SK*4

型　　名	社　名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧（V）				最大直流ドレイン電流（A）					最大消費電力(W) Tc=25°C	外　囲　器	備　　考
			～100	101～300	301～500	501～1000	～1.0	1.1～3.0	3.1～5.0	5.1～10.0	10.1～			
VN0106N9	SPT	N	60				0.5					1	TO-52	
VN0106ND	SPT	N	60											CHIP
VN0109N2	SPT	N	90				0.8					3.5	TO-39	
VN0109N3	SPT	N	90				0.5					1	TO-92	
VN0109N5	SPT	N	90					1.5				15	TO-220	
VN0109N9	SPT	N	90				0.5					1	TO-52	
VN0109ND	SPT	N	90											CHIP
VN0116N2	SPT	N		160			0.35					3.5	TO-39	
VN0116N3	SPT	N		160			0.25					1	TO-92	
VN0116N5	SPT	N		160			0.7					15	TO-220	
VN0116ND	SPT	N		160										CHIP
VN0120N2	SPT	N		200			0.35					3.5	TO-39	
VN0120N2	SPT	N		200			0.25					1	TO-92	
VN0120N5	SPT	N		200			0.7					15	TO-220	
VN0120ND	SPT	N		200										CHIP
VN0204N2	SPT	N	40					1.5				4	TO-39	
VN0204N5	SPT	N	40					3				28	TO-220	
VN0204N6	SPT	N	40				1					1/U	PDIP14P	2SK*4
VN0204N7	SPT	N	40				1					1/U	CDIP14P	2SK*4
VN0204ND	SPT	N	40											CHIP
VN0206N2	SPT	N	60					1.5				4	TO-39	
VN0206N3	SPT	N	60				0.8					1	TO-92	
VN0206N5	SPT	N	60					3				28	TO-220	
VN0206N6	SPT	N	60				1					1/U	PDIP14P	2SK*4
VN0206N7	SPT	N	60				1					1/U	CDIP14P	2SK*4
VN0206ND	SPT	N	60											CHIP
VN0210N2	SPT	N	100					1.5				4	TO-39	
VN0210N3	SPT	N	100				0.8					1	TO-92	
VN0210N5	SPT	N	100					3				28	TO-220	
VN0210ND	SPT	N	100											CHIP

型名	社名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧（V）				最大直流ドレイン電流（A）					最大消費電力(W) $Tc=25^\circ C$	外囲器	備考
			~100	101~300	301~500	501~1000	~1.0	1.1~3.0	3.1~5.0	5.1~10.0	10.1~			
VN0216N2	SPT	N		160				1.5				4	TO-39	
VN0216N3	SPT	N		160			0.8					1	TO-92	
VN0216N5	SPT	N		160				3				28	TO-220	
VN0216ND	SPT	N		160										CHIP
VN0220N2	SPT	N		200			0.7					4	TO-39	
VN0220N3	SPT	N		200			0.4					1	TO-92	
VN0220N5	SPT	N		200				1.5				28	TO-220	
VN0220ND	SPT	N		200										CHIP
VN0300D	SL	N	30					2.5				20	TO-220AB	
VN0300L	SL	N	30				0.44					0.4	TO-92	
VN0300M	SL	N	30				0.7					1	TO-237	
VN0335N1	SPT	N		350					3.5			100	TO-3	
VN0335N2	SPT	N		350			1					6	TO-39	
VN0335N5	SPT	N		350				2.1				50	TO-220	
VN0335ND	SPT	N		350										CHIP
VN0340N1	SPT	N		400					3.5			100	TO-3	
VN0340N2	SPT	N		400			1					6	TO-39	
VN0340N5	SPT	N		400				2.1				50	TO-220	
VN0340ND	SPT	N		400										CHIP
VN0345N1	SPT	N		450				2.5				100	TO-3	
VN0345N2	SPT	N		450			0.35					6	TO-39	
VN0345N5	SPT	N		450				1.5				50	TO-220	
VN0345ND	SPT	N		450										CHIP
VN0350N1	SPT	N		500				2.5				100	TO-3	
VN0350N2	SPT	N		500			0.35					6	TO-39	
VN0350N5	SPT	N		500				1.5				50	TO-220	
VN0350ND	SPT	N		500										CHIP
VN03551N1	SPT	N			550			2.5				100	TO-3	
VN0355N5	SPT	N			550			1.5				50	TO-220	
VN0355ND	SPT	N			550									CHIP

型名	社名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧 (V)				最大直流ドレイン電流 (A)					最大消費電力(W)	外囲器	備考
			～100	10～300	301～500	501～1000	～1.0	1.1～3.0	3.1～5.0	5.1～10.0	10.1～	Tc=25°C		
VN0360N1	SPT	N			600			2.5				100	TO-3	
VN0360N5	SPT	N			600			1.5				50	TO-220	
VN0360ND	SPT	N			600									CHIP
VN0400A	SL	N	40								18	100	TO-3	
VN0400D	SL	N	40								18	75	TO-220AB	
VN0401A	SL	N	40								16	100	TO-3	
VN0401D	SL	N	40								16	75	TO-220AB	
VN0535N2	SPT	N		350			0.25					6	TO-39	
VN0535N3	SPT	N		350			0.1					1	TO-92	
VN0535ND	SPT	N		350										CHIP
VN0540N2	SPT	N			400		0.25					6	TO-39	
VN0540N3	SPT	N			400		0.1					1	TO-92	
VN0540ND	SPT	N			400									CHIP
VN0545N2	SPT	N			450		0.1					6	TO-39	
VN0545N3	SPT	N			450		0.05					1	TO-92	
VN0545ND	SPT	N			450									CHIP
VN0550N2	SPT	N			500		0.1					6	TO-39	
VN0550N3	SPT	N			500		0.05					1	TO-92	
VN0550ND	SPT	N			500									CHIP
VN0600A	SL	N	60								18	100	TO-3	
VN0600D	SL	N	60								18	75	TO-220AB	
VN0601A	SL	N	60								16	100	TO-3	
VN0601D	SL	N	60								16	75	TO-220AB	
VN0606M	SL	N	60				0.4					1	TO-237	
VN0610L	SL	N	60				0.2					0.4	TO-92	
VN0800A	SL	N	80								14	100	TO-3	
VN0800D	SL	N	80								14	75	TO-220AB	
VN0801A	SL	N	80								12	100	TO-3	
VN0801D	SL	N	80								12	75	TO-220AB	
VN0808M	SL	N	80				0.35					1	TO-237	

型名	社名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧（V）				最大直流ドレイン電流（A）					最大消費電力(W) $Tc=25^\circ C$	外囲器	備考
			～100	101～300	301～500	501～1000	～1.0	1.1～3.0	3.1～5.0	5.1～10.0	10.1～			
VN1000A	SL	N	100								14	100	TO-3	
VN1000D	SL	N	100								14	75	TO-220AB	
VN1001A	SL	N	100								12	100	TO-3	
VN1001D	SL	N	100								12	75	TO-220AB	
VN10KE	SL	N	60				0.2					0.315	TO-52	
VN10KM	ITS	N	60				0.5					1	TO-237	
VN10KM	SL	N	60				0.3					1	TO-237	
VN10KN3	SPT	N	60				0.3					1	TO-92	
VN10LE	SL	N	60				0.2					0.315	TO-52	
VN10LM	SL	N	60				0.3					1	TO-237	
VN1106N1	SPT	N	60							9		75	TO-3	
VN1106N2	SPT	N	60					2.5				6	TO-39	
VN1106N5	SPT	N	60							7		45	TO-220	
VN1106ND	SPT	N	60											CHIP
VN1110N1	SPT	N	100							9		75	TO-3	
VN1110N2	SPT	N	100					2.5				6	TO-39	
VN1110N5	SPT	N	100							7		45	TO-220	
VN1110ND	SPT	N	100											CHIP
VN1116N1	SPT	N		160				3				100	TO-3	
VN1116N2	SPT	N		160			1					4	TO-39	
VN1116N5	SPT	N		160				2				45	TO-220	
VN1116ND	SPT	N		160										CHIP
VN1120N1	SPT	N		200				3				100	TO-3	
VN1120N2	SPT	N		200				1				4	TO-39	
VN1120N5	SPT	N		200				2				45	TO-220	
VN1120ND	SPT	N		200										CHIP
VN1200A	SL	N		120							14	75	TO-3	
VN1200D	SL	N		120							14	75	TO-220AB	
VN1201A	SL	N		120							12	100	TO-3	
VN1201D	SL	N		120							12	75	TO-220AB	

型名	社名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧（V） 〜100	101〜300	301〜500	501〜1000	最大直流ドレイン電流（A） 〜1.0	1.1〜3.0	3.1〜5.0	5.1〜10.0	10.1〜	最大消費電力(W) Tc=25℃	外囲器	備考
VN1204N1	SPT	N	40								12	100	TO-3	
VN1204N2	SPT	N	40						3.5			6.5	TO-39	
VN1204N5	SPT	N	40							9		45	TO-220	
VN1204ND	SPT	N	40											CHIP
VN1206B	SL	N		120			0.8					6.25	TO-39	
VN1206D	SL	N		120				1.4				20	TO-220AB	
VN1206L	SL	N		120			0.21					0.4	TO-92	
VN1206M	SL	N		120			0.3					1	TO-237	
VN1206N1	SPT	N	60								12	100	TO-3	
VN1206N2	SPT	N	60						3.5			6.5	TO-39	
VN1206N5	SPT	N	60							9		45	TO-220	
VN1206ND	SPT	N	60											CHIP
VN1210L	SL	N		120			0.16					0.4	TO-92	
VN1210M	SL	N		120			0.25					1	TO-237	
VN1210N1	SPT	N	100								12	100	TO-3	
VN1210N2	SPT	N	100						3.5			6.5	TO-39	
VN1210N5	SPT	N	100							9		45	TO-220	
VN1210ND	SPT	N	100											CHIP
VN1216N1	SPT	N		160						6		100	TO-3	
VN1216N2	SPT	N		160				3.0				6.5	TO-39	
VN1216N5	SPT	N		160					4.5			45	TO-220	
VN1216ND	SPT	N		160										CHIP
VN1220N1	SPT	N		200						6		100	TO-3	
VN1220N2	SPT	N		200				3				6.5	TO-39	
VN1220N5	SPT	N		200					4.5			45	TO-220	
VN1220ND	SPT	N		200										CHIP
VN1304N2	SPT	N	40				0.4					3	TO-39	
VN1304N3	SPT	N	40				0.25					1	TO-92	
VN1304N6	SPT	N	40				0.4					0.5/U	PDIP14P	2SK*4
VN1304N7	SPT	N	40				0.4					0.6/U	CDIP14P	2SK*4

型名	社名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧（V）				最大直流ドレイン電流（A）					最大消費電力(W) $Tc=25^\circ C$	外囲器	備考
			～100	101～300	301～500	501～1000	～1.0	1.1～3.0	3.1～5.0	5.1～10.0	10.1～			
VN1304ND	SPT	N	40											CHIP
VN1306N2	SPT	N	60				0.4					3	TO-39	
VN1306N3	SPT	N	60				0.25					1	TO-92	
VN1306N6	SPT	N	60				0.4					0.5/U	PDIP14P	2SK*4
VN1306N7	SPT	N	60				0.4					0.6/U	CDIP14P	2SK*4
VN1306ND	SPT	N	60											CHIP
VN1310N2	SPT	N	100				0.4					3	TO-39	
VN1310N3	SPT	N	100				0.25					1	TO-92	
VN1310ND	SPT	N	100											CHIP
VN1316N2	SPT	N		160			0.15					3	TO-39	
VN1316N3	SPT	N		160			0.1					0.8	TO-92	
VN1316ND	SPT	N		160										CHIP
VN1320N2	SPT	N		200			0.15					3	TO-39	
VN1320N3	SPT	N		200			0.1					0.8	TO-92	
VN1320ND	SPT	N		200										CHIP
VN1706B	SL	N		170			0.8					6.25	TO-39	
VN1706D	SL	N		170				1.4				20	TO-220AB	
VN1706L	SL	N		170			0.21					0.4	TO-92	
VN1706M	SL	N		170			0.3					1	TO-237	
VN1710L	SL	N		170			0.16					0.4	TO-92	
VN1710M	SL	N		170			0.25					1	TO-237	
VN2222KM	SL	N	60				0.25					1	TO-237	
VN2222L	SL	N	60				0.15					0.4	TO-92	
VN2222LM	SL	N	60				0.25					1	TO-237	
VN2306N1	SPT	N	60								30	125	TO-3	
VN2306N5	SPT	N	60								20	50	TO-220	
VN2306ND	SPT	N	60											CHIP
VN2310N1	SPT	N	100								30	125	TO-3	
VN2310N5	SPT	N	100								20	50	TO-3	
VN2310ND	SPT	N	100											CHIP

型名	社名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧（V）				最大直流ドレイン電流（A）					最大消費電力(W) $Tc=25^{\circ}C$	外囲器	備考
			~100	101~300	301~500	501~1000	~1.0	1.1~3.0	3.1~5.0	5.1~10.0	10.1~			
VN2316N1	SPT	N		160							18	125	TO-3	
VN2316N5	SPT	N		160							12	50	TO-220	
VN2316ND	SPT	N		160										CHIP
VN2320N1	SPT	N		200							18	125	TO-3	
VN2320N5	SPT	N		200							12	50	TO-220	
VN2320ND	SPT	N		200										CHIP
VN2335N1	SPT	N			350					8		125	TO-3	
VN2335N5	SPT	N			350					6		50	TO-220	
VN2335ND	SPT	N			350									CHIP
VN2340N1	SPT	N			400					8		125	TO-3	
VN2340N5	SPT	N			400					6		50	TO-220	
VN2340ND	SPT	N			400									CHIP
VN2345N1	SPT	N			450					6		125	TO-3	
VN2345N5	SPT	N			450				4			50	TO-220	
VN2345ND	SPT	N			450									CHIP
VN2350N1	SPT	N			500					6		125	TO-3	
VN2350N5	SPT	N			500				4			50	TO-220	
VN2350ND	SPT	N			500									CHIP
VN2406B	SL	N		240			0.8					6.25	TO-39	
VN2406D	SL	N		240				1.4				20	TO-220AB	
VN2406L	SL	N		240			0.21					0.4	TO-92	
VN2406M	SL	N		240			0.3					1	TO-237	
VN2410L	SL	N		240			0.16					0.4	TO-92	
VN2410M	SL	N		240			0.25					1	TO-237	
VN30AB	ITS	N	35					1.2				6.25	TO-39	
VN3500A	SL	N			350					6		125	TO-3	
VN3500D	SL	N			350					6		75	TO-220AB	
VN3501A	SL	N			350				5			125	TO-3	
VN3501D	SL	N			350				5			75	TO-220AB	
VN35AA	SL	N	35					2				25	TO-3	

型　　名	社　名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧（V）				最大直流ドレイン電流（A）					最大消費電力(W) $Tc=25°C$	外　囲　器	備　　考
			〜100	101〜300	301〜500	501〜1000	〜1.0	1.1〜3.0	3.1〜5.0	5.1〜10.0	10.1〜			
VN35AB	ITS	N	35					1.2				6.25	TO-39	
VN35AB	SL	N	35					1.2				6.25	TO-39	
VN35AK	ITS	N	35					1.2				6.25	TO-39	
VN4000A	SL	N			400					6		125	TO-3	
VN4000D	SL	N			400					6		75	TO-220AB	
VN4001A	SL	N			400				5			125	TO-3	
VN4001D	SL	N			400				5			75	TO-220AB	
VN40AD	SL	N	40					1.5				40	TO-220AB	
VN40AF	ITS	N	40					1.2				12	TO-202	
VN40AF	SL	N	40					1.3				15	TO-202AA	
VN4501A	SL	N			450				4.5			100	TO-3	
VN4501D	SL	N			450				4.5			75	TO-220AB	
VN4502A	SL	N			450				4			100	TO-3	
VN4502D	SL	N			450				4			75	TO-220AB	
VN46AD	SL	N	40					1.9				40	TO-220AB	
VN46AF	ITS	N	40					1.2				12	TO-202	
VN46AF	SL	N	40					1.6				15	TO-202AA	
VN5001A	SL	N			500				4.5			100	TO-3	
VN5001D	SL	N			500				4.5			75	TO-220AB	
VN5002A	SL	N			500				4			100	TO-3	
VN5002D	SL	N			500				4			75	TO-220AB	
VN64GA	SL	N	60							10		80	TO-3	
VN66AD	SL	N	60					1.9				20	TO-220AB	
VN66AF	ITS	N	60					1.2				12	TO-202	
VN66AF	SL	N	60					1.7				15	TO-202AA	
VN66AK	ITS	N	60					1.2				6.25	TO-39	
VN67AA	SL	N	60					2				25	TO-3	
VN67AB	ITS	N	60					1.2				6.25	TO-39	
VN67AB	SL	N	60				1					6.25	TO-39	
VN67AD	SL	N	60					1.8				20	TO-220AB	

型名	社名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧 (V)				最大直流ドレイン電流 (A)					最大消費電力(W) Tc=25°C	外囲器	備考
			~100	101~300	301~500	501~1000	~1.0	1.1~3.0	3.1~5.0	5.1~10.0	10.1~			
VN67AF	ITS	N	60					1.2				12	TO-202	
VN67AF	SL	N	60					1.6				15	TO-202AA	
VN67AK	ITS	N	60					1.2				6.25	TO-39	
VN80AF	SL	N	80					1.3				15	TO-202AA	
VN88AD	SL	N	80					1.7				20	TO-220AB	
VN88AF	ITS	N	80					1.2				12	TO-202	
VN88AF	SL	N	80					1.5				15	TO-202AA	
VN89AB	ITS	N	80					1.2				6.25	TO-39	
VN89AD	SL	N	80					1.6				20	TO-220AB	
VN89AF	ITS	N	80					1.2				12	TO-202	
VN89AF	SL	N	80					1.4				15	TO-202AA	
VN90AA	SL	N	90					1.7				25	TO-3	
VN90AB	ITS	N	90					1.2				6.25	TO-39	
VN90AB	SL	N	90				0.8					6.25	TO-39	
VN98AK	ITS	N	90					1.2				6.25	TO-39	
VN99AA	SL	N	90					1.8				25	TO-3	
VN99AB	SL	N	90				0.9					6.25	TO-39	
VN99AK	ITS	N	90					1.2				6.25	TO-39	
VNC003A	SL	N	60								60	250	TO-3	
VNC010B	SL	N	60						4			15	TO-39	
VNC011B	SL	N	60						4			15	TO-39	
VND010B	SL	N	80						4			15	TO-39	
VND011B	SL	N	80						4			15	TO-39	
VNE003A	SL	N	100								60	250	TO-3	
VNE010B	SL	N	100						4			15	TO-39	
VNE011B	SL	N	100						4			15	TO-39	
VNG004A	SL	N		150							45	250	TO-3	
VNJ004A	SL	N		200							45	250	TO-3	
VNL001A	SL	N			350					8		175	TO-3	
VNL005A	SL	N			350						25	250	TO-3	

型名	社名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧（V）				最大直流ドレイン電流（A）					最大消費電力(W) $Tc=25°C$	外囲器	備考
			〜100	101〜300	301〜500	501〜1000	〜1.0	5.1〜10.0	1.1〜3.0	3.1〜5.0	10.1〜			
VNM001A	SL	N			400					8		175	TO-3	
VNM005A	SL	N			400						25	250	TO-3	
VNN002A	SL	N			450					6.5		175	TO-3	
VNN006A	SL	N			450						20	250	TO-3	
VNP002A	SL	N			500					6.5		175	TO-3	
VNP006A	SL	N			500						20	250	TO-3	
VNS008A	SL	N				600				6		125	TO-3	
VNS008D	SL	N				600				6		125	TO-220AB	
VNS009A	SL	N				600			5			125	TO-3	
VNS009D	SL	N				600			5			125	TO-220AB	
VNT008A	SL	N				650				6		125	TO-3	
VNT008D	SL	N				650				6		125	TO-220AB	
VNT009A	SL	N				650			5			125	TO-3	
VNT009D	SL	N				650			5			125	TO-220AB	
VO0104ND	SPT	P	-40											CHIP
VO0106N2	SPT	P	-60				-0.5					3.5	TO-39	
VO0116N3	SPT	P		-160			-0.1					1	TO-92	
VO0204N2	SPT	P	-40				-0.8					6	TO-39	
VP0104N2	SPT	P	-40				-0.5					3.5	TO-39	
VP0104N3	SPT	P	-40				-0.4					1	TO-92	
VP0104N5	SPT	P	-40				-1.0					15	TO-220	
VP0104N6	SPT	P	-40				-0.4					0.6/U	PDIP14P	2SJ*4
VP0104N7	SPT	P	-40				-0.4					0.6/U	CDIP14P	2SJ*4
VP0104N9	SPT	P	-40				-0.4					1	TO-52	
VP0106N3	SPT	P	-60				-0.4					1	TO-92	
VP0106N5	SPT	P	-60				-1					15	TO-220	
VP0106N6	SPT	P	-60				-0.4					0.6/U	PDIP14P	2SJ*4
VP0106N7	SPT	P	-60				-0.4					0.6/U	CDIP14P	2SJ*4
VP0106N9	SPT	P	-60				-0.4					1	TO-52	
VP0106ND	SPT	P	-60											CHIP

型名	社名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧（V）				最大直流ドレイン電流（A）					最大消費電力(W) Tc=25°C	外囲器	備考
			～100	101～300	301～500	501～1000	～1.0	1.1～3.0	3.1～5.0	5.1～10.0	10.1～			
VP0109N2	SPT	P	-90				-0.5					3.5	TO-39	
VP0109N3	SPT	P	-90				-0.4					1	TO-92	
VP0109N5	SPT	P	-90				-1					15	TO-220	
VP0109N9	SPT	P	-90				-0.4					1	TO-52	
VP0109ND	SPT	P	-90											CHIP
VP0116N2	SPT	P		-160			-0.2					3.5	TO-39	
VP0116N5	SPT	P		-160			-.425					15	TO-220	
VP0116ND	SPT	P		-160										CHIP
VP0120N2	SPT	P		-200			-0.2					3.5	TO-39	
VP0120N3	SPT	P		-200			-0.1					1	TO-92	
VP0120N5	SPT	P		-200			-.425					15	TO-220	
VP0120ND	SPT	P		-200										CHIP
VP0204N5	SPT	P	-40					-2				27	TO-220	
VP0204N6	SPT	P	-40				-0.4					1/U	PDIP14P	2SJ*4
VP0204N7	SPT	P	-40				-0.4					1/U	CDIP14P	2SJ*4
VP0204ND	SPT	P	-40											CHIP
VP0206N2	SPT	P	-60				-0.8					6	TO-39	
VP0206N3	SPT	P	-60				-0.4					1	TO-92	
VP0206N5	SPT	P	-60					-2				27	TO-220	
VP0206N6	SPT	P	-60				-0.4					1/U	PDIP14P	2SJ*4
VP0206N7	SPT	P	-60				-0.4					1/U	CDIP14P	2SJ*4
VP0206ND	SPT	P	-60											CHIP
VP0210N2	SPT	P	-100				-0.8					6	TO-39	
VP0210N3	SPT	P	-100				-0.4					1	TO-92	
VP0210N5	SPT	P	-100					-2				27	TO-220	
VP0210ND	SPT	P	-100											CHIP
VP0216N2	SPT	P		-160			-0.35					4	TO-39	
VP0216N3	SPT	P		-160			-0.2					1	TO-92	
VP0216N5	SPT	P		-160			-0.8					27	TO-220	
VP0216ND	SPT	P		-160										CHIP

型名	社名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧（V）				最大直流ドレイン電流（A）					最大消費電力(W) $Tc=25°C$	外囲器	備考
			～100	101～300	301～500	501～1000	～1.0	1.1～3.0	3.1～5.0	5.1～10.0	10.1～			
VP0220N2	SPT	P		-200			-0.35					4	TO-39	
VP0220N3	SPT	P		-200			-0.2					1	TO-92	
VP0220N5	SPT	P		-200			-0.8					27	TO-220	
VP0220ND	SPT	P		-200										CHIP
VP0300B	SL	P	-30					-1.3				6.25	TO-39	
VP0300L	SL	P	-30				-0.48					1	TO-92	
VP0300M	SL	P	-30				-0.48					1	TO-237	
VP0335N1	SPT	P			-350			-2.7				100	TO-3	
VP0335N2	SPT	P			-350		-0.7					6	TO-39	
VP0335N5	SPT	P			-350			-1.6				50	TO-220	
VP0335ND	SPT	P			-350									CHIP
VP0340N1	SPT	P			-400			-2.7				100	TO-3	
VP0340N2	SPT	P			-400		-0.7					6	TO-39	
VP0340N5	SPT	P			-400			-1.6				50	TO-220	
VP0340ND	SPT	P			-400									CHIP
VP0345N1	SPT	P			-450			-1.5					TO-3	
VP0345N2	SPT	P			-450		-0.4					6	TO-39	
VP0345N5	SPT	P			-450		-1.0					50	TO-220	
VP0345ND	SPT	P			-450									CHIP
VP0350N1	SPT	P			-500			-1.5				100	TO-3	
VP0350N2	SPT	P			-500		-0.4					6	TO-39	
VP0350N5	SPT	P			-500		-1.0					50	TO-220	
VP0350ND	SPT	P			-500									CHIP
VP0535N2	SPT	P			-350		-0.2					3.5	TO-39	
VP0535N3	SPT	P			-350		-0.1					1	TO-92	
VP0535ND	SPT	P			-350									CHIP
VP0540N2	SPT	P			-400		-0.2					3.5	TO-39	
VP0540N3	SPT	P			-400		-0.1					1	TO-92	
VP0540ND	SPT	P			-400									CHIP
VP0545N2	SPT	P			-450		-.125					3.5	TO-39	

型名	社名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧（V） ～100	101～300	301～500	501～1000	最大直流ドレイン電流（A） ～1.0	1.1～3.0	3.1～5.0	5.1～10.0	10.1～	最大消費電力(W) Tc=25°C	外囲器	備考
VP0545N3	SPT	P			-450		-0.07					1	TO-92	
VP0545ND	SPT	P			-450									CHIP
VP0550N2	SPT	P			-500		-.125					3.5	TO-39	
VP0550N3	SPT	P			-500		-.07					1	TO-92	
VP0550ND	SPT	P			-500									CHIP
VP0808L	SL	P	-80				-0.37					0.4	TO-92	
VP0808M	SL	P	-80				-0.37					1	TO-237	
VP1008B	SL	P	-100				-0.9					6.25	TO-39	
VP1008L	SL	P	-100				-0.37					0.4	TO-92	
VP1008M	SL	P	-100				-0.37					1	TO-237	
VP1106N1	SPT	P	-60							-6		75	TO-3	
VP1106N2	SPT	P	-60					-1.5				6	TO-39	
VP1106N5	SPT	P	-60						-4			45	TO-220	
VP1106ND	SPT	P	-60											CHIP
VP1110N1	SPT	P	-100							-6		75	TO-3	
VP1110N2	SPT	P	-100					-1.5				6	TO-39	
VP1110N5	SPT	P	-100						-4			45	TO-220	
VP1110ND	SPT	P	-100											CHIP
VP1116N1	SPT	P		-160				-2.5				75	TO-3	
VP1116N2	SPT	P		-160			-0.8					6	TO-39	
VP1116N5	SPT	P		-160				-1.8				45	TO-220	
VP1116ND	SPT	P		-160										CHIP
VP1120N1	SPT	P		-200				-2.5				75	TO-3	
VP1120N2	SPT	P		-200			-0.8					6	TO-39	
VP1120N5	SPT	P		-200				-1.8				45	TO-220	
VP1120ND	SPT	P		-200										CHIP
VP1204N1	SPT	P	-40							-7		100	TO-3	
VP1204N2	SPT	P	-40					-2.5				6.5	TO-39	
VP1204N5	SPT	P	-40						-5			45	TO-220	
VP1204ND	SPT	P	-40											CHIP

型名	社名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧（V）				最大直流ドレイン電流（A）					最大消費電力(W) Tc=25°C	外囲器	備考
			～100	101～300	301～500	501～1000	～1.0	1.1～3.0	3.1～5.0	5.1～10.0	10.1～			
VP1206N1	SPT	P	-60							-7		100	TO-3	
VP1206N2	SPT	P	-60					-2.5				6.5	TO-39	
VP1206N5	SPT	P	-60						-5			45	TO-220	
VP1206ND	SPT	P	-60											CHIP
VP1210N1	SPT	P	-100							-7		100	TO-3	
VP1210N2	SPT	P	-100					-2.5				6.5	TO-39	
VP1210N5	SPT	P	-100						-5			45	TO-220	
VP1210ND	SPT	P	-100											CHIP
VP1216N1	SPT	P		-160					-4.5			100	TO-3	
VP1216N2	SPT	P		-160				-2				6.5	TO-39	
VP1216N5	SPT	P		-160					-3.5			45	TO-220	
VP1216ND	SPT	P		-160										CHIP
VP1220N1	SPT	P		-200					-4.5			100	TO-3	
VP1220N2	SPT	P		-200				-2				6.5	TO-39	
VP1220N5	SPT	P		-200					-3.5			45	TO-220	
VP1220ND	SPT	P		-200										CHIP
VP1304N2	SPT	P	-40				-0.25					3	TO-39	
VP1304N3	SPT	P	-40				-0.15					0.8	TO-92	
VP1304N6	SPT	P	-40				-0.2					0.5/U	PDIP14P	2SJ*4
VP1304N7	SPT	P	-40				-0.2					0.5/U	CDIP14P	2SJ*4
VP1304ND	SPT	P	-40											CHIP
VP1306N2	SPT	P	-60				-0.25					3	TO-39	
VP1306N3	SPT	P	-60				-0.15					0.8	TO-92	
VP1306N6	SPT	P	-60				-0.2					0.5/U	PDIP14P	2SJ*4
VP1306N7	SPT	P	-60				-0.2					0.5/U	CDIP14P	2SJ*4
VP1306ND	SPT	P	-60											CHIP
VP1310N2	SPT	P	-100				-0.25					3	TO-39	
VP1310N3	SPT	P	-100				-0.15					0.8	TO-92	
VP1310ND	SPT	P	-100											CHIP
VP1316N2	SPT	P		-160			-0.1					3	TO-39	

型　　名	社　名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧（V）				最大直流ドレイン電流（A）					最大消費電力(W) Tc=25°C	外　囲　器	備　　考
			～100	101～300	301～500	501～1000	～1.0	5.1～10.0	1.1～3.0	3.1～5.0	10.1～			
VP1316N3	SPT	P		-160			-0.06					0.8	TO-92	
VP1316ND	SPT	P		-160										CHIP
VP1320N2	SPT	P		-200			-0.1					3	TO-39	
VP1320N3	SPT	P		-200			-0.06					0.8	TO-92	
VP1320ND	SPT	P		-200										CHIP
VQ0808B	SL	P	-80				-0.9					6.25	TO-39	
VQ1000CJ	ITS	N	60				0.3						DIP14P	2SK*4
VQ1000J	SL	N	60				0.225					0.5/U	PDIP14P	2SK*4
VQ1000N6	SPT	N	60									1.2/U	PDIP14P	2SK*4
VQ1000N7	SPT	N	60									2/U	CDIP14P	2SK*4
VQ1000P	SL	N	60				0.225					0.5/U	CDIP14P	2SK*4
VQ1001J	SL	N	30				0.85					1.3/U	PDIP14P	2SK*4
VQ1001P	SL	N	30				0.85					1.3/U	CDIP14P	2SK*4
VQ1004J	SL	N	60				0.46					1.3/U	PDIP14P	2SK*4
VQ1004P	SL	N	60				0.46					1.3/U	CDIP14P	2SK*4
VQ1006J	SL	N	90				0.4					1.3/U	PDIP14P	2SK*4
VQ1006P	SL	N	90				0.4					1.3/U	CDIP14P	2SK*4
VQ2001J	SL	P	-30				-0.6					1.3/U	PDIP14P	2SJ*4
VQ2001P	SL	P	-30				-0.6					1.3/U	CDIP14P	2SJ*4
VQ2004J	SL	P	-60				-0.6					1.3/U	PDIP14P	2SJ*4
VQ2004P	SL	P	-60				-0.6					1.3/U	CDIP14P	2SJ*4
VQ2006J	SL	P	-90				-0.6					1.3/U	PDIP14P	2SJ*4
VQ2006P	SL	P	-90				-0.6					1.3/U	CDIP14P	2SJ*4
VQ3001J	SL	P/N										1.3/U	PDIP14P	J*2,K*2
VQ3001P	SL	P/N										1.3/U	CDIP14P	J*2,K*2
VQ7254J	SL	P/N										1.3/U	PDIP14P	J*2,K*2
VQ7254N6	SPT	P/N										1.5/U	PDIP14P	
VQ7254N7	SPT	P/N										2/U	CDIP14P	
VQ7254P	SL	P/N										1.3/U	CDIP14P	J*2,K*2

1985年版　最新FET[電界効果トランジスタ]規格表

昭和43年4月1日　初版発行
昭和60年6月20日　発　行
S60. 6. 20　第1刷

編著者　漆原　健彦
編集発行人　飛坐　博
発行所　CQ出版株式会社
〠170 東京都豊島区巣鴨1－14－2
電話(03)947-6311(代表)
振替　東京0-10665

定価 900円

印刷・製本　株式会社 丹誠社

ISBN4-7898-4018-2 C3055 ¥900E